



日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

#5
CFM 180805
09/05/99
G. H. H. 2872

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1 9 9 9 年 4 月 5 日

出 願 番 号

Application Number:

平成 1 1 年特許願第 0 9 8 2 3 2 号

出 願 人

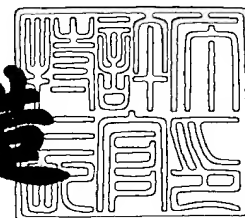
Applicant (s):

キヤノン株式会社

2 0 0 0 年 1 2 月 2 2 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特 2 0 0 0 - 3 1 0 6 8 9 8

【書類名】	特許願
【整理番号】	3967015
【提出日】	平成11年 4月 5日
【あて先】	特許庁長官 殿
【国際特許分類】	G03G 5/00
【発明の名称】	画像形成装置
【請求項の数】	46
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会 社内
【氏名】	宮崎 俊彦
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会 社内
【氏名】	小野 武夫
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会 社内
【氏名】	外處 泰之
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会 社内
【氏名】	長谷川 光利
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会 社内
【氏名】	光武 英明
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 山口 英司

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号 キヤノン株式会社
社内

【氏名】 山田 修嗣

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100070219

【弁理士】

【氏名又は名称】 若林 忠

【電話番号】 03-3585-1882

【選任した代理人】

【識別番号】 100088328

【弁理士】

【氏名又は名称】 金田 暢之

【選任した代理人】

【識別番号】 100106138

【弁理士】

【氏名又は名称】 石橋 政幸

【選任した代理人】

【識別番号】 100106297

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 克博

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願日】 平成11年 3月 5日提出の特許願

【整理番号】 3947016

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 015129

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9705032

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像形成装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 対向配置された一对の基板と前記両基板間に配置された外枠とで構成された外囲器内に、前記一对の基板のうちの、一方の基板上に配置された電子源と、他方の基板上に配置された画像形成部材と、前記基板間に配置されたスペーサとを備える画像形成装置であって、前記スペーサ前記外枠とが導電性を有し、前記スペーサと前記外枠との間の等電位面が、駆動時に略平行となるように、前記スペーサと前記外枠とを電氣的に接続する手段を有することを特徴とする画像形成装置。

【請求項 2】 対向配置された一对の基板と前記両基板間に配置された外枠とで構成された外囲器内に、前記一对の基板のうちの、一方の基板上に配置された電子源と、他方の基板上に配置された画像形成部材と、前記基板間に配置されたスペーサとを備える画像形成装置であって、前記スペーサと前記外枠とが導電性を有し、駆動時に、前記スペーサの上端と前記外枠の上端とに略等しい電位 V_1 が与えられ、前記スペーサの下端と前記外枠の下端とに略等しい、前記電位 V_1 とは異なる電位 V_2 が与えられることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 3】 基板上に、複数の行方向配線と複数の列方向配線とでマトリクス配線された複数の電子放出素子を備える電子源基板であって、前記複数の電子放出素子の各々が、前記行方向配線と前記列方向配線とで囲まれており、且つ、前記行方向配線と前記列方向配線の非交差領域における配線幅が、前記行方向配線と前記列方向配線の交差領域における配線幅よりも広いことを特徴とする電子源基板。

【請求項 4】 基板上に、複数の行方向配線と複数の列方向配線とでマトリクス配線された複数の電子放出素子を備える電子源基板と、前記複数の電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材とを備える画像形成装置であって、前記複数の電子放出素子の各々が、前記行方向配線と前記列方向配線とで囲まれており、且つ、前記行方向配線と前記列方向配線の非交差領域における配線幅が、前記行方向配線と前記列方向配線の交差領域における配

線幅よりも広いことを特徴とする画像形成装置。

【請求項 5】 電子放出素子が接続された配線の複数が配置された基板と、前記電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材が配置された基板と、前記両基板間に配置されたスペーサと、ゲッタとを備える画像形成装置であって、前記スペーサは前記配線上に配置されており、前記ゲッタは前記スペーサが配置されていない配線上に配置されていることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 6】 電子放出素子が接続された配線の複数が配置された基板と、前記電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材が配置された基板と、前記両基板間に配置された複数のスペーサと、ゲッタとを備える画像形成装置であって、前記複数のスペーサは前記配線上に配置されており、前記ゲッタは、前記複数のスペーサ間の配線上に配置されていることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 7】 電子放出素子が接続された配線が配置された基板と、前記電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材が配置された基板と、前記両基板間に配置されたスペーサとを備える画像形成装置であって、前記配線はアーチ状の断面を有し、前記スペーサは前記配線上に配置され、前記配線と接触する端部の角がまるまっていることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 8】 電子放出素子が接続された配線が配置された基板と、前記電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材が配置された基板と、前記両基板間に配置されたスペーサとを備える画像形成装置であって、前記画像形成部材はアーチ状の断面を有する非発光部材を有し、前記スペーサは前記非発光部材上に配置され、前記非発光部材と接触する端部の角がまるまっていることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 9】 基板上に、複数の行方向配線と複数の列方向配線とでマトリクス配線された複数の電子放出素子を備える電子源基板であって、前記行方向配線と前記列方向配線の非交差領域に電位規定部を有することを特徴とする電子源基板。

【請求項 10】 前記電位規定部は、前記配線と接続されている請求項 9 に記載の電子源基板。

【請求項 11】 前記電位規定部は、前記配線の引出し電極である請求項 9 または 10 に記載の電子源基板。

【請求項 12】 前記マトリクス配線は、単一の基板上に形成されている請求項 9 ～ 11 のいずれかに記載の電子源基板。

【請求項 13】 基板上に、複数の行方向配線と複数の列方向配線とでマトリクス配線された複数の電子放出素子を備える電子源基板と、前記複数の電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材とを備える画像形成装置であって、前記行方向配線と前記列方向配線の非交差領域に電位規定部を有することを特徴とする画像形成装置。

【請求項 14】 前記電位規定部は、前記配線と接続されている請求項 13 に記載の画像形成装置。

【請求項 15】 前記電位規定部は、前記配線の引出し線で電極である請求項 13 または 14 に記載の画像形成装置。

【請求項 16】 前記マトリクス配線は、単一の基板上に形成されている請求項 13 ～ 15 のいずれかに記載の画像形成装置。

【請求項 17】 電子源が配置された第 1 基板と、メタルバックにて被覆された蛍光体及び非発光部材が前記電子源と対向するように配置された第 2 基板とを備える画像形成装置であって、前記蛍光体と前記非発光部材とは互いに異なる厚さを有しており、前記第 2 基板の、前記蛍光体及び前記非発光部材が配置された側面とは反対側面に、前記第 1 基板の前記電子源が配置された側面に駆動時に印加される電位に近い電位を印加する手段を有することを特徴とする画像形成装置。

【請求項 18】 基板上に、蛍光体と、前記蛍光体を覆うメタルバックと、前記メタルバックと電氣的に接続された高圧引出し端子とが配置された画像形成基板であって、前記メタルバックと前記高圧引出し端子との間を継ぐ帯状の中継導電膜を備えることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 19】 電子源が配置された電子源基板と、前記電子源基板に対向

は位置され、蛍光体と、前記蛍光体を覆うメタルバックと、前記メタルバックと電氣的に接続された高圧引出し端子とが配置された画像形成基板とを備える画像形成装置であって、前記画像形成基板が、前記メタルバックと前記高圧引出し端子との間を継ぐ帯状の中継導電膜を備えることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 2 0】 電子源が配置された電子源基板と、前記電子源から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材が配置された画像形成基板とを有する外囲器と、前記外囲器の挟持部を有する筐体とを備える画像形成装置であって、前記挟持部は、前記画像形成基板を介さずに前記電子源基板を挟持していることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 2 1】 前記挟持部は、前記電子源基板の前記画像形成基板と重なり合わない部位を挟持している請求項 2 0 に記載の画像形成装置。

【請求項 2 2】 前記挟持部は、前記電子源基板に配されたフレキ部とともに前記電子源基板を挟持している請求項 2 0 または 2 1 に記載の画像形成装置。

【請求項 2 3】 電子放出素子が接続された配線の複数が配置された基板と、前記電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材が配置された基板と、前記両基板間に配置された複数のスペーサとを備える画像形成装置であって、前記複数のスペーサは、スペーサ間の配線数が 5 ～ 5 0 の範囲となるように離散的に前記配線上に配置されていることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 2 4】 前記基板と前記両基板間に配置された外枠とで外囲器が構成されており、前記両基板のいずれか一方の基板面に水平な面で切った断面における外囲器内部面積 A と、前記断面における前記複数のスペーサの総断面積 S との比 S/A が、0.018% ～ 7.8% の範囲である請求項 2 3 に記載の画像形成装置。

【請求項 2 5】 前記両基板と前記両基板間に配置された外枠とで外囲器が構成されており、前記外枠の幅 W と厚さ T との比 W/T が、1.5 ～ 30 の範囲である請求項 2 3 に記載の画像形成装置。

【請求項 2 6】 対向配置された一对の基板と前記両基板間に配された外枠とで構成された外囲器内に、電子源と、前記電子源から放出される電子の照射に

より画像を形成する画像形成部材とを備える画像形成装置であって、前記外枠が、打ち抜きで形成されたものであることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 2 7】 対向配置された一对の基板と前記両基板間に配された外枠とで構成された外囲器内に、電子源と、前記電子源から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材とを備える画像形成装置であって、前記外枠の隅部は、外囲器の内外側で円弧形状を有し、前記円弧形状は、前記内側と前記外側とで異なる曲率を有していることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 2 8】 電子放出素子と、前記電子放出素子に接続された配線と、ゲッタとが配置された電子源基板であって、前記ゲッタは前記配線上に配置されており、前記ゲッタ及び前記配線はいずれもアーチ状の断面形状を有していることを特徴とする電子源基板。

【請求項 2 9】 前記ゲッタは、非蒸発型のゲッタである請求項 2 8 に記載の電子源基板。

【請求項 3 0】 前記配線上に配置されているゲッタの幅は、前記配線の幅よりも狭い請求項 2 8 または 2 9 に記載の電子源基板。

【請求項 3 1】 電子放出素子と、前記電子放出素子に接続された配線と、ゲッタとが配置された基板と、前記電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材とを外囲器内に備える画像形成装置であって、前記ゲッタは前記配線上に配置されており、前記ゲッタ及び前記配線はいずれもアーチ状の断面形状を有していることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 3 2】 前記ゲッタは、非蒸発型のゲッタである請求項 3 1 に記載の画像形成装置。

【請求項 3 3】 前記配線上に配置されているゲッタの幅は、前記配線の幅よりも狭い請求項 3 1 または 3 2 に記載の画像形成装置。

【請求項 3 4】 表示パネルと、前記表示パネルに接続された高圧電源とを備える画像形成装置であって、前記高圧電源が、前記表示パネルの重心よりも下方に配置されていることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 3 5】 前記高圧電源は、前記表示パネルの表示面側と反対側の背面に配置されている請求項 3 4 に記載の画像形成装置。

【請求項 3 6】 前記表示パネルと前記高圧電源とは間隔をもって配置されている請求項 3 4 または 3 5 に記載の画像形成装置。

【請求項 3 7】 蛍光体と黒色部材とが配された第 1 の基板と、電子放出素子が配された第 2 の基板とを対向配置した画像形成装置であって、該電子放出素子の電子放出部直上に、前記黒色部材が配されたことを特徴とする画像形成装置。

【請求項 3 8】 a. 基板、
b. 一对の素子電極からなる電極対を複数の行及び複数の列に沿って配置した基板上の電極対アレイ、
c. 列上の電極対のうち的一方の電極を共通の接続する列配線をスクリーン印刷で各列上の電極対毎に設けてなる基板上的複数の列配線、
d. 行上の電極対のうち他方の電極を共通に接続し、前記列配線と絶縁した行配線をスクリーン印刷で各行上の電極対毎に設けてなる基板上的複数の行配線、
e. 前記複数の列配線からそれぞれ延長してスクリーン印刷で設けてなる複数の列端子部、及び
f. 前記複数の行配線からそれぞれ延長してスクリーン印刷で設けてなる複数の行端子部
を有することを特徴とする電子源基板。

【請求項 3 9】 前記電極対は、オフセット印刷で設けてなる請求項 3 9 に記載の電子源基板。

【請求項 4 0】 a. 第 1 基板、一对の素子電極からなる電極対を複数の行及び複数の列に沿って配置した第 1 基板上的電極対アレイ、前記一对の電極間に配置してなる電子源、列上の電極対のうち的一方の電極を共通に接続する列配線を各列上の電極対毎に設けてなる第 1 基板上的複数の列配線、及び行上の電極対のうち他方の電極を共通に接続し、前記列配線とは絶縁し、前記列配線の線幅より幅広に設定した配線幅の行配線を各行上の電極対毎に設けてなる基板上的複数の行配線を有する電子源基板、

b. 第 2 基板、及び第 2 基板上に配置した画像形成部材を有する画像形成基板、並びに、

c. 前記電子源基板と画像形成基板との間であって、前記行配線上に配置したスパーサ

を有することを特徴とする画像形成装置。

【請求項 4 1】 a. 第 1 基板、一对の素子電極からなる電極対を複数の行及び複数の列に沿って配置した基板上的電極アレイ、前記一对の電極間に配置してなる電子源、列上の電極対のうち一方の電極を共通に接続する列配線を各列上の電極対毎に設けてなる第 1 基板上的複数の列配線、及び行上の電極対のうち他方の電極を共通に接続し、前記列配線とは絶縁し、前記列配線の線幅より幅広に設定した配線幅の行配線を各行上の電極対毎に設けてなる第 1 基板上的複数の行配線を有する電子源基板、並びに

b. 第 2 基板と、複数の行及び複数の列に沿って該第 2 基板上に配置した観察方向に対して縦長矩形の画像形成部材と、該行間の間隔及び該列間の間隔を覆う第 2 基板上的遮光部材とを有し、

該複数行の隣合う行間の間隔を該複数列の隣合う列間の間隔より幅広に設定してなる画像形成基板

を有することを特徴とする画像形成部材。

【請求項 4 2】 a. 第 1 基板、一对の素子電極からなる電極対を複数の行及び複数の列に沿って配置した基板上的電極対アレイ、前記一对の電極間に配置してなる電子源、列上の電極対のうち一方の電極を共通に接続する列配線を各列上の電極対毎に設けてなる第 1 基板上的複数の列配線、及び行上の電極対のうち他方の電極を共通に接続し、前記列配線とは絶縁して各行上の電極対毎に設けてなる第 1 基板上的複数の行配線を有する電子源基板、並びに

b. 第 2 基板と、複数の行及び複数の列に沿って第 2 基板上に配置した観察方向において縦長矩形の画像形成部材と、該複数行の隣合う行間の間隔及び該複数列の隣合う列間の間隔を覆う第 2 基板上的遮光部材とを有する画像形成基板を有する画像形成装置であって、

前記複数列間の間隔毎に前記電子源を対向配置させてなることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 4 3】 前記画像形成部材は、各列毎に、同色に発光する様に、発

光部材を設けてなる請求項 4 2 に記載の画像形成装置。

【請求項 4 4】 前記画像形成部材は、各列毎に、青色発光、緑色発光及び赤色発光する様に、発光部材を設けてなる請求項 4 3 に記載の画像形成装置。

【請求項 4 5】 a. 第 1 基板、一对の素子電極からなる電極対を複数の行及び複数の列に沿って配置した基板上の電極対アレイ、前記一对の電極間に配置してなる電子源、列上の電極対のうち一方の電極を共通に接続する列配線を各列上の電極対毎に設けてなる第 1 基板上の複数の列配線、及び行上の電極対のうち他方の電極を共通に接続し、前記列配線とは絶縁して各行上の電極対毎に設けてなる第 1 基板上の複数の行配線を有する電子源基板、

b. 第 2 基板と、複数の行及び複数の列に沿って第 2 基板上に配置した観察方向において縦長矩形の画像形成部材と、該複数行の隣合う行間の間隔及び該複数列の隣合う列間の間隔を覆う第 2 基板上の遮光部材とを有する画像形成基板、並びに

c. 前記電子源基板と画像形成基板との間隔に配置し、且つ前記行配線上に配置したスペーサを有する画像形成装置であって、

前記複数列間の間隔毎に前記電子源を対向配置させてなる画像形成装置。

【請求項 4 6】 電子基板上に、スペーサを介して画像形成基板を対向配置した画像形成装置であって、前記スペーサは前記電子源を接続する配線上に配置され、該配線と電氣的に接続する導電膜が被覆されており、該導電膜の上端の高さは、前記電子源が電子を放出している時の電位と前記画像形成基板側で与えられる加速電位との間の電位分布において電子源の電位から前記加速電位に向けて 2 k V 電位が高くなる高さ以下であることを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、電子源基板と発光表示板とを対向して設け、電子源基板から画像情報に応じて放出させた電子を発光表示板に供給して画像を形成する画像形成装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

従来より、種々の構成の電子放出用のカソードを備える画像表示装置が提案されてきており、その一例として、図 1 7 1 に断面図として示す構造を有するものが知られている。図 1 7 1 に示す表示装置はフルカラーの表示装置であり、アノード基板 1 0 1 の内面にストライプ状に形成された多数本のアノード電極 1 0 6 が設けられ、アノード電極 1 0 6 上に R、G、B を発光する蛍光体が順次被着された面が形成されている。一方、アノード基板 1 0 6 と対向するカソード基板 1 0 2 上には多数の電子放出用のカソード (F E C) からなる F E C アレー 1 0 5 が設けられており、この F E C アレー 1 0 5 から電子が電界放出され、この放出された電子がアノード電極 1 0 6 によって捕捉され、そこに被着されている蛍光体に電子が供給されて発光が生じるようになっている。この装置での電子放出の制御は、一般に、F E C アレー 1 0 5 側において行なわれており、F E C アレー 1 0 5 から放出された電子は支柱 1 0 4 により所定間隔を保持されて対向したアノード基板 1 0 4 に向かって放出されることになる。

【0 0 0 3】

上記の電子放出に伴う動作を可能とするために、この装置ではアノード基板 1 0 1 とカソード基板 1 0 2 との間の空間が所定の真空度の空間として形成されており、この真空度を維持するためにこれらの基板の周縁部がシール材 1 0 3 により封止されている。

【0 0 0 4】

なお、アノード電極 1 0 1 とカソード基板 1 0 2 との間隔 t は、例えば数百 μ m とされ、また、アノード電極 1 0 6 に印加される電圧は例えば数百 V とされる。また、アノード電極 1 0 6 には不図示のアノード引出電極により表示装置の外部に位置する表示制御装置に接続されていて、表示制御装置により所定のタイミングで応じてアノード電極 1 0 6 に電圧の印加が行なわれる。更に、F E C アレー 1 0 5 におけるカソード電極やゲート電極も不図示のカソード引出電極やゲート引出電極により表示装置の外部に位置する表示制御装置に接続されて、表示制御装置により所定のタイミングでこれらの電極への電圧の印加が行なわれる。

【0 0 0 5】

上述した画像表示装置における電子放出部は F E C アレーによって形成されているものであるが、電子放出部に配列する電子放出素子についても種々の構成が提案されている。例えば、表面伝導型電子放出素子は、構造が単純で製造も容易なことから、大面積にわたって多数素子を配列形成できる利点がある。そこで、この特徴を活かすための種々の応用が研究されている。例えば、電荷ビーム源、表示装置等の画像形成装置への利用が挙げられる。多数の表面伝導型電子放出素子を配列した例としては、並列に表面伝導型電子放出素子を配列し、個々の素子の両端を配線にて夫々結線した行を多数行配列した電子源が挙げられる（例えば、本願出願人による特開平 1 - 1 0 3 1 3 3 2 号公報）。

【 0 0 0 6 】

なお、表示装置等の画像形成装置においては、近年、液晶を用いた平板型表示装置が、C T R 方式のものに替わって普及してきたが、液晶を用いたものは自発光型でないために、バックライト等を持たなければならない等の問題があり、自発光型の表示装置が望まれてきた。

【 0 0 0 7 】

このような表面伝導型電子放出素子を多数配置した電子源と、この電子源から放出された電子によって可視光を発光させる蛍光体とを組み合わせた表示装置である画像形成装置は、大画面の装置でも比較的容易に製造でき、かつ表示品位の優れた自発光型表示装置となり、自発光型表示装置の提供という点からも好ましいものである。

【 0 0 0 8 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、大画面化に対応可能であり、かつ表示品位の優れた構成を有する画像形成装置を提供することにある。

【 0 0 0 9 】

【課題を解決するための手段】

本発明の画像形成装置の一態様例は、対向配置された一对の基板と前記両基板間に配置された外枠とで構成された外囲器内に、前記一对の基板のうちの、一方の基板上に配置された電子源と、他方の基板上に配置された画像形成部材と、前

記基板間に配置されたスペーサとを備える画像形成装置であって、前記スペーサ前記外枠とが導電性を有し、前記スペーサと前記外枠との間の等電位面が、駆動時に略平行となるように、前記スペーサと前記外枠とを電氣的に接続する手段を有することを特徴とする。

【0010】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、対向配置された一对の基板と前記両基板間に配置された外枠とで構成された外囲器内に、前記一对の基板のうちの、一方の基板上に配置された電子源と、他方の基板上に配置された画像形成部材と、前記基板間に配置されたスペーサとを備える画像形成装置であって、前記スペーサと前記外枠とが導電性を有し、駆動時に、前記スペーサの上端と前記外枠の上端とに略等しい電位V1が与えられ、前記スペーサの下端と前記外枠の下端とに略等しい、前記電位V1とは異なる電位V2が与えられることを特徴とする。

【0011】

本発明に係る電子源基板の一態様は、基板上に、複数の行方向配線と複数の列方向配線とでマトリクス配線された複数の電子放出素子を備える電子源基板であって、前記複数の電子放出素子の各々が、前記行方向配線と前記列方向配線とで囲まれており、且つ、前記行方向配線と前記列方向配線の非交差領域における配線幅が、前記行方向配線と前記列方向配線の交差領域における配線幅よりも広いことを特徴とする。

【0012】

本発明に係る画像形成装置の他の態様例は、基板上に、複数の行方向配線と複数の列方向配線とでマトリクス配線された複数の電子放出素子を備える電子源基板と、前記複数の電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材とを備える画像形成装置であって、前記複数の電子放出素子の各々が、前記行方向配線と前記列方向配線とで囲まれており、且つ、前記行方向配線と前記列方向配線の非交差領域における配線幅が、前記行方向配線と前記列方向配線の交差領域における配線幅よりも広いことを特徴とする。

【0013】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、電子放出素子が接続された配線の複数

が配置された基板と、前記電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材が配置された基板と、前記両基板間に配置されたスペーサと、ゲッタとを備える画像形成装置であって、前記スペーサは前記配線上に配置されており、前記ゲッタは前記スペーサが配置されていない配線上に配置されていることを特徴とする。

【0014】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、電子放出素子が接続された配線の複数配置された基板と、前記電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材が配置された基板と、前記両基板間に配置された複数のスペーサと、ゲッタとを備える画像形成装置であって、前記複数のスペーサは前記配線上に配置されており、前記ゲッタは、前記複数のスペーサ間の配線上に配置されていることを特徴とする。

【0015】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、電子放出素子が接続された配線が配置された基板と、前記電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材が配置された基板と、前記両基板間に配置されたスペーサとを備える画像形成装置であって、前記配線はアーチ状の断面を有し、前記スペーサは前記配線上に配置され、前記配線と接触する端部の角がまるまっていることを特徴とする。

【0016】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、電子放出素子が接続された配線が配置された基板と、前記電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材が配置された基板と、前記両基板間に配置されたスペーサとを備える画像形成装置であって、前記画像形成部材はアーチ状の断面を有する非発光部材を有し、前記スペーサは前記非発光部材上に配置され、前記非発光部材と接触する端部の角がまるまっていることを特徴とする。

【0017】

本発明の電子源基板の他の態様例は、基板上に、複数の行方向配線と複数の列方向配線とでマトリクス配線された複数の電子放出素子を備える電子源基板であ

って、前記行方向配線と前記列方向配線の非交差領域に電位規定部を有することを特徴とする。

【0018】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、基板上に、複数の行方向配線と複数の列方向配線とでマトリクス配線された複数の電子放出素子を備える電子源基板と、前記複数の電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材とを備える画像形成装置であって、前記行方向配線と前記列方向配線の非交差領域に電位規定部を有することを特徴とする。

【0019】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、電子源が配置された第1基板と、メタルバックにて被覆された蛍光体及び非発光部材が前記電子源と対向するように配置された第2基板とを備える画像形成装置であって、前記蛍光体と前記非発光部材とは互いに異なる厚さを有しており、前記第2基板の、前記蛍光体及び前記非発光部材が配置された側面とは反対側面に、前記第1基板の前記電子源が配置された側面に駆動時に印加される電位に近い電位を印加する手段を有することを特徴とする。

【0020】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、基板上に、蛍光体と、前記蛍光体を覆うメタルバックと、前記メタルバックと電気的に接続された高压引出し端子とが配置された画像形成基板であって、前記メタルバックと前記高压引出し端子との間を継ぐ帯状の中継導電膜を備えることを特徴とする。

【0021】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、電子源が配置された電子源基板と、前記電子源基板に対向は位置され、蛍光体と、前記蛍光体を覆うメタルバックと、前記メタルバックと電気的に接続された高压引出し端子とが配置された画像形成基板とを備える画像形成装置であって、前記画像形成基板が、前記メタルバックと前記高压引出し端子との間を継ぐ帯状の中継導電膜を備えることを特徴とする。

【0022】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、電子源が配置された電子源基板と、前記電子源から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材が配置された画像形成基板とを有する外囲器と、前記外囲器の挟持部を有する筐体とを備える画像形成装置であって、前記挟持部は、前記画像形成基板を介さずに前記電子源基板を挟持していることを特徴とする。

【 0 0 2 3 】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、電子放出素子が接続された配線の複数配置された基板と、前記電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材が配置された基板と、前記両基板間に配置された複数のスペーサとを備える画像形成装置であって、前記複数のスペーサは、スペーサ間の配線数が 5 ～ 5 0 の範囲となるように離散的に前記配線上に配置されていることを特徴とする。

【 0 0 2 4 】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、対向配置された一对の基板と前記両基板間に配された外枠とで構成された外囲器内に、電子源と、前記電子源から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材とを備える画像形成装置であって、前記外枠が、打ち抜きで形成されたものであることを特徴とする。

【 0 0 2 5 】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、対向配置された一对の基板と前記両基板間に配された外枠とで構成された外囲器内に、電子源と、前記電子源から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材とを備える画像形成装置であって、前記外枠の隅部は、外囲器の内外側で円弧形状を有し、前記円弧形状は、前記内側と前記外側とで異なる曲率を有していることを特徴とする。

【 0 0 2 6 】

本発明の電子源基板の一態様例は、電子放出素子と、前記電子放出素子に接続された配線と、ゲッタとが配置された電子源基板であって、前記ゲッタは前記配線上に配置されており、前記ゲッタ及び前記配線はいずれもアーチ状の断面形状を有していることを特徴とする。

【 0 0 2 7 】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、電子放出素子と、前記電子放出素子に接続された配線と、ゲッタとが配置された基板と、前記電子放出素子から放出される電子の照射により画像を形成する画像形成部材とを外囲器内に備える画像形成装置であって、前記ゲッタは前記配線上に配置されており、前記ゲッタ及び前記配線はいずれもアーチ状の断面形状を有していることを特徴とする。

【 0 0 2 8 】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、表示パネルと、前記表示パネルに接続された高圧電源とを備える画像形成装置であって、前記高圧電源が、前記表示パネルの重心よりも下方に配置されていることを特徴とする。

【 0 0 2 9 】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、蛍光体と黒色部材とが配された第 1 の基板と、電子放出素子が配された第 2 の基板とを対向配置した画像形成装置であって、該電子放出素子の電子放出部直上に、前記黒色部材が配されたことを特徴とする。

【 0 0 3 0 】

本発明の電子源基板の他の態様例は、

- a. 基板、
 - b. 一对の素子電極からなる電極対を複数の行及び複数の列に沿って配置した基板上の電極対アレイ、
 - c. 列上の電極対のうちの一方向の電極を共通の接続する列配線をスクリーン印刷で各列上の電極対毎に設けてなる基板上の複数の列配線、
 - d. 行上の電極対のうち他方向の電極を共通に接続し、前記列配線と絶縁した行配線をスクリーン印刷で各行上の電極対毎に設けてなる基板上の複数の行配線、
 - e. 前記複数の列配線からそれぞれ延長してスクリーン印刷で設けてなる複数の列端子部、及び
 - f. 前記複数の行配線からそれぞれ延長してスクリーン印刷で設けてなる複数の行端子部
- を有することを特徴とする。

【 0 0 3 1 】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、

- a. 第 1 基板、一对の素子電極からなる電極対を複数の行及び複数の列に沿って配置した第 1 基板上の電極対アレイ、前記一对の電極間に配置してなる電子源、列上の電極対のうち一方の電極を共通に接続する列配線を各列上の電極対毎に設けてなる第 1 基板上の複数の列配線、及び行上の電極対のうち他方の電極を共通に接続し、前記列配線とは絶縁し、前記列配線の線幅より幅広に設定した配線幅の行配線を各行上の電極対毎に設けてなる基板上の複数の行配線を有する電子源基板、
- b. 第 2 基板、及び第 2 基板上に配置した画像形成部材を有する画像形成基板、並びに、
- c. 前記電子源基板と画像形成基板との間であって、前記行配線上に配置したスペーサを有することを特徴とする。

【 0 0 3 2 】

本発明の画像形成部材の一態様例は、

- a. 第 1 基板、一对の素子電極からなる電極対を複数の行及び複数の列に沿って配置した基板上の電極アレイ、前記一对の電極間に配置してなる電子源、列上の電極対のうち一方の電極を共通に接続する列配線を各列上の電極対毎に設けてなる第 1 基板上の複数の列配線、及び行上の電極対のうち他方の電極を共通に接続し、前記列配線とは絶縁し、前記列配線の線幅より幅広に設定した配線幅の行配線を各行上の電極対毎に設けてなる第 1 基板上の複数の行配線を有する電子源基板、並びに
- b. 第 2 基板と、複数の行及び複数の列に沿って該第 2 基板上に配置した観察方向に対して縦長矩形の画像形成部材と、該行間の間隔及び該列間の間隔を覆う第 2 基板上の遮光部材とを有し、

該複数の行の隣合う行間の間隔を該複数の列の隣合う列間の間隔より幅広に設定してなる画像形成基板

を有することを特徴とする像形成部材。

【 0 0 3 3 】

本発明の画像形成装置の他の態様は、a. 第1基板、一对の素子電極からなる電極対を複数の行及び複数の列に沿って配置した基板上の電極対アレイ、前記一对の電極間に配置してなる電子源、列上の電極対のうちの一方の電極を共通に接続する列配線を各列上の電極対毎に設けてなる第1基板上の複数の列配線、及び行上の電極対のうちの他方の電極を共通に接続し、前記列配線とは絶縁して各行上の電極対毎に設けてなる第1基板上の複数の行配線を有する電子源基板、並びに

b. 第2基板と、複数の行及び複数の列に沿って第2基板上に配置した観察方向において縦長矩形の画像形成部材と、該複数行の隣合う行間の間隔及び該複数列の隣合う列間の間隔を覆う第2基板上の遮光部材とを有する画像形成基板を有する画像形成装置であって、

前記複数列間の間隔毎に前記電子源を対向配置させてなることを特徴とする。

【0034】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、

a. 第1基板、一对の素子電極からなる電極対を複数の行及び複数の列に沿って配置した基板上の電極対アレイ、前記一对の電極間に配置してなる電子源、列上の電極対のうちの一方の電極を共通に接続する列配線を各列上の電極対毎に設けてなる第1基板上の複数の列配線、及び行上の電極対のうちの他方の電極を共通に接続し、前記列配線とは絶縁して各行上の電極対毎に設けてなる第1基板上の複数の行配線を有する電子源基板、

b. 第2基板と、複数の行及び複数の列に沿って第2基板上に配置した観察方向において縦長矩形の画像形成部材と、該複数行の隣合う行間の間隔及び該複数列の隣合う列間の間隔を覆う第2基板上の遮光部材とを有する画像形成基板、並びに

c. 前記電子源基板と画像形成基板との間隔に配置し、且つ前記行配線上に配置したスペーサを有する画像形成装置であって、

前記複数列間の間隔毎に前記電子源を対向配置させてなることを特徴とする。

【0035】

本発明の画像形成装置の他の態様例は、電子基板上に、スペーサを介して画像

形成基板を対向配置した画像形成装置であって、前記スペーサは前記電子源を接続する配線上に配置され、該配線と電氣的に接続する導電膜が被覆されており、該導電膜の上端の高さは、前記電子源が電子を放出している時と電位と前記画像形成基板側で与えられる加速電位との間の電位分布において電子源の電位から前記加速電位に向けて 2 k V 電位が高くなる高さ以下であることを特徴とする。

【 0 0 3 6 】

【発明の実施の形態】

本発明の画像形成装置の一例を図 1 に示す。図 1 は画像形成装置の組立展開図であり、代表的な構成部材が示されている。1 は製品内部を埃などから保護する金属や樹脂等から形成された前カバーで、2 は製品内部を埃などから保護すると共に、低反射処理が施された樹脂やガラスから構成された光透過性の前面保板で、組立時に前カバー 1 の内部に適当な固定手段により固定される。3 は左上板、4 は右上板で夫々が後述の画像表示パネル 7 を挟み支持するための剛性を有する金属板等で構成されている。5 は左前面断熱部材、6 は右前面断熱部材で夫々が後述の画像表示パネル 7 を挟み支持する部分の断熱性と緩衝性を目的に、発泡性の樹脂またはゴムで形成されている。7 は画像表示パネルで S E D と呼ばれる自発光型の画像表示装置で、2 枚のガラス板と枠で真空容器を形成し、周辺部に複数のフレキシブルケーブルが設けられている。8 は左後面断熱材、9 は右後面断熱材で、画像表示パネル 7 を後面側から挟支持する。これらの断熱材は、先の左右の前面断熱部材 5 及び 6 と同じ材料から構成することができる。

【 0 0 3 7 】

1 0 は左下板、1 1 は右下板で、夫々後面側から画像表示パネル 7 を挟み支持する左上板 3、右上板 4 と同じ材質から構成できるもので、左下板 1 0 は左上板 3 と、右下板 1 1 は右上板 4 と互いにねじなどの固着手段により固定されている。

【 0 0 3 8 】

上記左上板 3、左下板 1 0、右上板 4、右下板 1 1、左後板 1 2、および断熱材 5、6、8、9 により挟持部が構成されている。

【 0 0 3 9 】

また、表示パネルは、詳しくは後述するが、蛍光体等の発光部材を有するフェースプレート（画像形成基板または蛍光体基板）と、複数の電子放出素子から構成された電子源を有するリアプレート（電子源基板）とを対向させて配置したものである。そして、リアプレートは、前記電子源を駆動するための配線などの取り出し部を必要とするため、フェースプレートよりもその大きさが大きい。このため、前記挟持部はリアプレートのみを挟持することが好ましい。そして、さらには、挟持部の脱着の簡便性から、リアプレートのフェースプレートと重なり合わない部分を挟持するのが好ましい。

【 0 0 4 0 】

また、リアプレートには、前述したように、駆動配線の取り出し部が配されている。さらには、駆動回路と接続するためのフレキシブルケーブルが上記取り出し部に取り付けられている。このため、前記挟持部はリアプレートと共に、前記フレキシブルケーブルを挟持することが好ましい。

【 0 0 4 1 】

1 2 はフレキシブルケーブルの左押え、1 3 は右押えで、夫々が画像表示パネル 7 を挟み支持する部分で、左上板 3 と左下板 1 0、上右板 4 と右下板 1 1 とを接続固定する部材であり、画像表示パネル 7 のフレキシブルケーブルの貫通部が千鳥状に設けられ、剛性を有する金属等の材料から形成されている。1 4 は、X 字状のフレーム（X フレーム）で、先の前カバー 1 のねじ固定部、左下板 1 0 と右下板 1 1 の固定部を設け、更に後述のスタンドユニット 1 5 やボード取付け板 1 6 の固定部を設け、材質は剛性を有するアルミニウムなどの金属で形成されている。1 5 はスタンドユニットで、画像形成装置全体を支持する目的で X フレーム 1 4 にねじで固定され、内部に剛性と重量のある金属、外部は外観性の良い樹脂または金属の薄板からなっている。1 6 はボード取付け板で、複数のプリント基板固定部を設けた樹脂または金属等の薄板からなる部材で、先の X フレーム 1 4 にねじ等の固定手段で固定される。1 7 は電気実装ボード類で、画像表示パネル 7 に画像を表示するための電気回路等であり、電源部、信号入力部、信号制御部、パネル駆動部などからなり、各部はプリント基板に電子素子を実装し、互いに電気ケーブルなどで接続されている。1 8 は、ファンユニットで、先の画像表

示パネル7や電気実装ボード類17から発生する熱を筐体外部へ放熱する目的で、ファンと固定部材で構成され、先のXフレーム14にねじ等の固定手段で固定される。19は後カバーで、製品内部を埃などの異物から保護するとともに放熱用の開口部を設け、金属または樹脂等の薄板で形成されている。

【0042】

図2に表示パネル部の一例の展開図を、図3に組み立てた状態の図を示す。1はガラス板等からなるリアプレート、2はパネル内を真空に真空排気するための排気管、3は画像形成部に高圧を印加するための高圧端子、4はパネルの外周部を支持する外枠（枠部材）、5はパネル内のガスを吸着するゲッタ、6は外枠と画像形成部間の大気圧支持をする周辺支持体、7は画像形成部内へかかる大気圧に対する耐性を持たせるためのスペーサ、8はガラス板からなるフェースプレート、9は画像形成部であり、取り出し電極、ブラックストライプ（低抵抗部材で作成したマスク部材）、蛍光体、メタルバック（金属膜）からなり、10は電子放出素子が複数形成された電子源基板、11は電子源領域からY方向配線を外部への取り出すためのY取り出し配線、12は電子源領域からX方向配線を外部へ取り出すためのX取り出し配線、13は排気管及び高圧端子を接着するためのシート状に仮焼成されたフリットデアルシートフリット、14は外枠とリアプレート及びフェースプレートを接着するためのフリットである。図4は図3におけるフェースプレート8の高圧端子取り出し部9-1を説明するための図であり、図5は図3のA-A断面を示し、高圧端子部を説明するための図である。1はリアプレート、3は高圧端子、3-1は絶縁部材、3-2は導入線で、3-2は導電性材料であり、フェースプレート8に形成される取り出し部9-1と電氣的接続がなされている。9は画像形成部、10は電子源領域、14はフリットである。図6は図3のB-B断面図を示し、ゲッタ及び周辺支持体を説明するための図である。5はゲッタであり、5-1はゲッタ支持体、5-2は支持線、5-3はゲッタ材料、5-5はゲッタループ、6は周辺支持体である。図7及び8は、表示パネルをフェースプレート側及び側面側から見た図であり、図7は多数のスペーサが平行に配列されたもので、図8はスペーサが千鳥状に配置されたものである。図9は線状ゲッタ及び周辺支持体6が設けられた外枠を示す図である。線状ゲ

ッタの構成を図16に示す。この線状ゲッタの設置は、まずBa等からなる線状のゲッタを所定の長さに切断してゲッタ線を作製し、その非蒸着方向にゲッタ線と加工後の長さが等しくなるように折り曲げ加工などにより成形された例えばNi線を適当な間隔でスポット溶接し、Ni線とゲッタ線とで複数のループを形成する。このループ構造の固定は、細長い柱状のガラス製などの支持部材に、支持部材に埋め込まれそこから突き出させた金属線への溶接によって行うことができる。

【0043】

また、図10は表示パネルにおけるスペーサの長手方向に直交する断面図であり、4-1はフェースプレート基板、4-2はリアプレート基板、4-3は行方向配線（上配線）、4-4は電子放出部、4-5は導電性フリット、4-6はリアプレート側スペーサ電極、4-7は高抵抗膜、4-8はスペーサ基板、4-9はリアプレート側スペーサ電極、4-10はブラックストライプ、4-11は緑色蛍光体である。フェースプレート基板4-1に形成されたメタルバック（図示せず）に印加された加速電圧により、電子放出部4-4より電子放出した電子は加速され、電子放出部4-4の直上に配置された、蛍光体4-11に衝突し、蛍光体を緑色に発光させる。

【0044】

図11は表示パネルのスペーサの長手方向に平行な方向の断面図であり、5-1はフェースプレート基板、5-2はリアプレート基板、5-3は列方向配線（下配線）、5-4は負側の素子電極、5-5は正側の素子電極、5-6ブラックストライプである。5-7は青色蛍光体、4-8は赤色蛍光体、4-9は緑色蛍光体である。この断面方向にはフェースプレート基板5-1に形成されたメタルバック（図示せず）に印加された加速電圧により、電子放出部（図示せず）より電子放出した電子は加速され、5-7～9の各色の蛍光体に衝突し、蛍光体を発光させる。このとき、電子は正側の素子電極5-5の方向に偏向するため、蛍光体は素子電極間に形成される放出部の直上からシフト（d）させた位置に配置する。

【0045】

なお、図10で示すスペーサは、高抵抗膜の外側にスペーサ電極が設けられているものであるが、このスペーサ表面の構成としては、図61に示される構成も好適に用いられる。

【0046】

図12及び13は電子源基板への電子放出素子の形成工程を示すものである。以下図面を参照しながらこの基板の製造方法を説明する。最初に図12を参照しながら、本発明の電子放出基板パネルの製造方法の一例を説明する。まず、よく洗浄された基板9上に金属材料からなる導電性薄膜を形成し、そのパターンをフォトリソグラフィによって微細加工し、一对の素子電極1, 2を多数形成する。ここで、基板9としては、石英ガラス、Naなどの不純物含有量を減少したガラス、青板ガラス、青板ガラスにスパッタ法あるいはCVD法などにより形成したSiO₂を積層した基板など、及びアルミナ等のセラミック等が挙げられる。

電極1, 2の形成方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、プラズマSVD法等の真空系を用いて成膜した後にリソグラフィでパターンニングしてエッチングする方法や、有機金属を含有するMOペーストをガラス凹板を使ってオフセット印刷する方法を選択することができる。素子電極1, 2の材料としては導電性を有するものであればどのようなものでもあってもかまわないが、例えば、Ni、Cr、Au、Mo、W、Pt、Ti、Al、Cu、Pd等の金属あるいは合金、及びPd、Ag、Au、RuO₂、Pd-Ag等の金属あるいは金属酸化物とガラスなどから構成される印刷導体、及びポリシリコン等の半導体材料、及びIn₂O₃-SnO₂等の透明導電体等が挙げられる(図12(a))。

【0047】

次にY方向配線4として導電性ペーストを印刷形成する。この時Y方向配線4は素子電極2と接続するように形成する。配線は膜厚が厚いほうが電気抵抗を低減できるため有利である。そのため厚膜印刷法、特にスクリーン印刷法を用いるのが好ましく、銀、金、銅、ニッケル等の導電性ペーストを用いることができる。より高精細なパターンニングが要求された場合には、感光性ペーストを用いて大まかなパターンをスクリーン印刷によって形成した後に、露光。現像することによって良好な配線が得られる。なお、所望のパターンを形成した後にはペースト中

のビヒクル成分を除去するために、そのペースト、使用ガラス基板の熱特性に応じた温度（400～650℃）で焼成される（図12（b））。

【0048】

次に、層間絶縁膜5をX方向配線とY方向配線の交差部に形成する。この層間絶縁膜は、例えば酸化鉛を主成分とするガラス物質、例えば、 PbO 、 B_2O_3 、 ZnO 、 Al_2O_3 、 SiO_2 等から適宜選ばれる成分の混合物で形成される。厚さは、絶縁性を確保できれば特に制限はないが、通常は10～100 μm 、好ましくは20～50 μm である。この層間絶縁膜の形成は、酸化鉛を主成分とするフリットガラス、エチルセルロースなどの適当なポリマー及び有機溶剤からビヒクルとを混合してなるペーストをスクリーン印刷等により所定位置塗布した後焼成して行う。なお、層間絶縁膜は、少なくともY方向配線とX方向配線の交差部を被覆すればよいので、その形状は図12に限るものではない（図12（c））。

【0049】

次に、X方向配線6を層間絶縁膜上に形成する。この配線も電気抵抗を低減したほうが有利であるため、膜厚を厚く形成できる厚膜印刷法を用いるのが好適である。そこでY方向配線形成と同じようにしてスクリーン印刷法で導電ペーストを用い、配線を形成した後焼成する。なお、このとき各配線を素子2と接続する（図12（d））。次に、導電性薄膜3を形成する。材料の具体例を挙げるならば、Pt、Ru、Ag、Au、Ti、In、Cu、Cr、Fe、Zn、Sn、Ta、W、Pd等の金属、 PdO 、 SnO_2 、 In_2O_3 、 PbO 、 Sb_2O_3 等の酸化物、 HfB_2 、 ZrB_2 、 LaB_6 、 CeB_6 、 YB_4 、 Gd_2B_4 等のホウ化物、 TiC 、 ZrC 、 HfC 、 TaC 、 SiC 、 WC 等の炭化物、 TiN 、 ZrN 、 HfN 等の窒化物、Si、Ge等の半導体、カーボン、 $AgMg$ 、 $NiCu$ 、 Pb 、 Sn 等であり、微粒子膜からなる。なお、ここで述べる微粒子膜とは複数の微粒子が集合した膜であり、その微細構造として、微粒子が個々に分散配置した状態のみならず、微粒子が互いに隣接、あるいは重なり合った状態（島状も含む）の膜を指す。

【0050】

これらの電子放出部形成用は薄膜を形成する手段としては良くバブルジェット方式が用いられる。これは原理・構成として非常に簡単であり、高速化、液滴の微小化が容易であるなどの多くの利点を持つ為である。実際には、前述の導電性材料を含む有機金属化合物の溶液を所定の位置にのみ液滴として付与し乾燥させた後、加熱処理により有機金属化合物を熱分解することにより、金属あるいは金属酸化物などの微粒子からなる導電性薄膜が形成される（図13）。

本発明で用いた電子放出素子としては、低実効仕事関数物質の層、例えばカーボン膜（ SP^2 膜）が好ましく、米国特許第5,591,061号、日本特許第2854532号などに開示された活性化工程によって得ることができるものである。

また、その他の低実効仕事関数物質の層としては、例えば米国特許第5,679,043号、同第5,763,997号に開示されたアモルフィック・ダイヤモンド膜、CVDダイヤモンド膜を用いることができる。

【0051】

図14はフェースプレートをリアプレート側から見た平面図であり、図15は図14のA-Aで断面である。これらに図示されたフェースプレートは例えば次のような操作により得ることができる。まず、耐大気圧強度を持ったソーダライムガラス（青板ガラス）、あるいは青板ガラスと熱膨張率のほぼ等しい高歪点ガラスからなる基板61上に、まず、無機の黒色含量を含むガラスペーストを用いて、格子状のブラックマトリクス62をスクリーン印刷により形成する。ブラックマトリクスの材料は、カーボン含有ペーストなど、導電性を有する材料を用いても良い。次に、ブラックマトリクス62の開口部分にR、G、Bの3原色蛍光体パターン（63-R、63-G、63-B）をスクリーン印刷により形成する。次に、印刷ペースト中の有機バインダを焼失（例えば430℃）させた後、CRTなどで通常用いられているフィルミング処理（蛍光体上にアクリル系薄膜を形成する処理）を行い、例えば厚さ1000Å～2000Åのアルミニウム薄膜を蒸着により成膜する。その後、430℃で焼成し、アルミニウム薄膜と蛍光体間にあるアクリル系薄膜を焼失させ、1000Å～2000Åのアルミニウム薄膜からなるメタルバック64が形成される。

【0052】

上記の画像形成装置における画像表示パネルとしては、種々の構成のものが利用できるが、例えば、図 1 7 に示す構成のものを挙げることができる。この表示パネルは、表面伝導型電子源基板を、耐大気圧強度を持ったガラス材からなるリアプレート 4 0 0 5、支持枠（枠部材） 4 0 0 7、フェースプレート 4 0 0 0 の中に収め、各部材の所定の接合部をを接着して、リアプレート 4 0 0 5 とフェースプレート 4 0 0 0 の間に形成された空間を密閉した構成を有する。この密閉には例えば、フリットガラス等が用いられる。フェースプレート 4 0 0 0 の内側には、メタルバック 4 0 0 6（詳細は不図示）と、蛍光体 4 0 0 8 が配置してあり、メタルバック 4 0 0 9 に接続された高圧端子 4 0 1 1 が画像形成装置外部に引き出され、高圧端子には高圧電源 4 0 1 0 が接続されている。また表面伝導型電子源基板 4 0 0 1 上に形成された列方向配線 4 0 0 3、行方向配線 4 0 0 4 は、画像形成装置外部に延びる X 方向端子 D X 1 等、Y 方向端子 D Y 1 等にそれぞれ接続されており、これらの配線により電子放出素子 4 0 0 2 からの電子の放出を画像情報に応じて制御してフェースプレートでの画像表示が行われる。なお、電子源基板の強度等が十分なものであれば、電子源基板にリアプレートの機能を兼用させることができる。

【 0 0 5 3 】

【実施例】

以下、本発明で用い得る各部の構成における実施例等について説明する。

【 0 0 5 4 】

（構成 1）

表示パネルの内部は上記のように所定の真空度が維持されるように外界に対して密封された状態にある。更に、この内部の真空度を維持する目的でゲッタが配置されるのが一般的である。また、この内部が真空となることで表示パネル自体の大気圧に対する十分な耐性を確保するための各種の手段や方法をとる必要が生じる場合がある。そのような場合においては、例えば、リアプレートとフェースプレートとの間に構造上の強度を高める目的でスペーサーを配置することで、大気圧に対する強度を向上させることができる。

【 0 0 5 5 】

まず、このスペーサと電子放出素子から放出された電子との関係を図 2 5 を用いて説明する。図 2 5 において、3 0 はフェースプレート、2 0 はスペーサ、4 1 はスペーサ電極、1 3 は配線、1 1 1 は電子放出部、3 1 は電子源の形成されたリアプレート基板、1 1 2 は電子軌道、2 5 は等電位線を示す。スペーサ 2 0 の帯電により電子はスペーサ側に吸引される。これを、補正するために、スペーサ電極 4 1 をスペーサ 2 0 に形成し、スペーサ近傍の電子放出部 1 1 1 付近の電位を補正することにより、電子放出部付近での電子の軌道をスペーサ 2 0 から反発する方向にし、電子をフェースプレート 3 0 の正規の位置に到達させることが可能である。

【0 0 5 6】

そこで、本構成では、そのようなスペーサーとゲッタとの配置における一例としては、ゲッタ材が配線電極上に配置される構成であって、且つ支持部材をゲッタの上に配置させない構成をとるものである。その実施例について以下に述べる。

【0 0 5 7】

(実施例 1)

構成 1 の第 1 の実施例を図 1 8 を用いて説明する。図 1 8 において、3 0 はフェースプレート（蛍光体、メタルバック等は省略してある）、2 0 はスペーサ、4 1 は電子源基板側形成されたスペーサ電極、1 3 は配線、4 2 はスペーサと接続される配線、1 1 1 は電子放出部、3 1 は電子源の形成されたリアプレート基板、1 1 2 は電子軌道、2 5 は等電位線、1 0 1 はゲッタを示す。スペーサ 2 0 の帯電により吸引される電子の電子軌道補正するために、スペーサ上に形成された電極 4 1 の高さ a をゲッタ上面までの高さ b よりもより大きくする。 a の大きさは、ゲッタ上面までの高さ b 、画像形成装置の構造、駆動条件、高抵抗膜の帯電除去の能力により任意に選択することが可能であるが、帯電で電子がスペーサ 2 0 側に引き寄せられることに対する電子軌道補正を行うには、少なくとも $a > b$ であることが必要である。更に $0 \leq a - b \leq 100 \mu\text{m}$ であるのが好ましい。ただし、スペーサの帯電を除去できる状況では a と b は略等しい値を選択することが可能である。また、ゲッタ上面までの高さ b についても任意の値を選択する

ことが可能である。また、スパッタ形成、溶射形成等の各種製法を適用することができる。

【0058】

この構成においては、ゲッタをスペーサの配置する部分に形成しないことにより、表面をスペーサで覆われることなく、単位長さ当たりの露出面積が増大し原料の使用効率をあげることができる。また、ゲッタ101にスペーサから力が加わらないため、スペーサ組立工程時や真空排気後にゲッタの破壊、欠落が起こりにくい効果がある。また、一般に電子軌道はスペーサの電子源基板側の電場の影響を強く受けるため、スペーサの下にゲッタを形成しないことにより、ゲッタの製法において、精密な高さ制御を行いにくい製法も適用できる効果もある。

【0059】

この構成により、ゲッター膜を画像形成装置の表示領域内に、スペーサ近傍の電子軌道の乱れを生じることなく形成することが容易となり、輝度の経時的変化（経時的低下）が少なくかつビームずれが少ない高品質の画像形成装置の提供が可能となった。

【0060】

電子放出部付近の電子軌道補正は各種の方法を適用することが可能である。上述のスペーサ電極の高さを大きくする方法の他、スペーサと接続する配線の高さを大きくすることも可能である。配線は、電子源基板にフォトリソグラフィ法を用いたパターンニングやスクリーン印刷等の精度の高い形成方法を用いて一括形成することが可能であり、この方法を用いた場合には、電子放出部に対しての位置ずれをより小さくすることが可能である。

【0061】

配線材料としては、各種導電材料を適用することができる。例えば、スクリーン印刷法を用いて配線を形成する場合には、金属とガラスペーストと混合させた塗布材料、また、めっき法を用いて金属を析出させる場合には、めっき浴材料が適用可能である。スペーサと接続する近傍の高くなった配線部は、高さ補正する部分とその下に形成され部分が電氣的に接続されていれば、他の配線と同じ高さは他配線と同様の方法を用いて一括形成し、高さ補正する分のみ他の製法を適

用可能である。また、スペーサの形状としては、板状の他に円柱等の各種形状を適用することが可能である。

【0062】

図19は、この実施例を適用した表示パネルの斜視図であり、内部構造を示すためにパネルの一部を切り欠いて示している。図中、3115はリアプレート、3116は側壁、3117はフェースプレートであり、3115～3117により表示パネルの内部を真空に維持するための気密容器を形成している。

【0063】

図18の構成は例えば以下のようにして得ることができる。列方向配線（図示せず）および絶縁層（図示せず）を電子源基板31形成した後、Agペーストをスクリーン印刷法により塗布し、行方向配線13を形成した。、各配線幅は300 μm として形成した。また、スペーサ20の厚みは220 μm にし、形成したスペーサ電極41の厚み0.2 μm の厚で形成した。また、本実施例に用いたゲッタ101は以下の様にして形成した。ゲッタ形成は、配線形成後に行っており、マスクを用いて、行方向配線13の上に、減圧プラズマ溶射法により非蒸発型ゲッターを成膜した。なお、成膜は、低圧アルゴン雰囲気中で行い、ゲッター材料は日本ゲッターズ株式会社製のZr-V-Mn-Alの組成の合金であるHS-405（325 mesh）粉末を用いた。本実施例において形成されたゲッター材の膜厚は、平均して40 μ 程度である。また、ゲッタ101の形成領域はスペーサの幅と同程度もしくは、若干小さく形成することが望ましい。これは、配線からはみ出して、電子軌道が大きく偏向されるのを防ぐためであり、任意の値を選択することが可能である。

【0064】

なお、この例では、スペーサの長さと同様長さでゲッタを形成したが、スペーサが配置される配線上のスペーサのない部分にもゲッタを形成することも可能である。この様子を図20に示す。図20に於いて、スペーサの下にはゲッタは形成しておらず、より大容量のゲッタが必要な場合に適用される。

【0065】

（実施例2）

構成 1 の第 2 実施例を図 2 1 にパネルの断面図として示す。この構成は、スペーサ 2 0 の電子源基板側の電極 4 2 はスペーサの端面のみに形成し、スペーサの配置される配線 4 2 の高さを高くすることにより、電子軌道の補正を行っている。なお、他の構成は上記の第 1 の例と同様である。

【 0 0 6 6 】

ここで、列方向配線 4 2 の形成方法について説明する。この例では、行方向配線（図示せず）および絶縁層（図示せず）を電子源基板 3 1 形成した後、A g ペーストをスクリーン印刷法により塗布し、行方向配線 1 3 を形成した。また、スペーサと接続される行方向配線 4 2 は、他の行方向配線 1 3 と同様に形成したあと、さらにスクリーンを変えて、この配線部 4 2 のみに多層印刷することにより形成した。本例においては、 $20\text{ }\mu\text{m}$ の厚さで各行方向配線 1 3 を形成した後、さらに 3 回の印刷をを行い $25\text{ }\mu\text{m}$ の高さの補正量とした。また、各配線幅は $300\text{ }\mu\text{m}$ として形成した。また、スペーサ 2 0 の厚みは $250\text{ }\mu\text{m}$ にし、端部に形成したスペーサ電極 4 1 の厚みは $1\text{ }\mu\text{m}$ の厚で形成した。なお、端面への電極塗布はディスペンサを用いて行い、約 $150\text{ }\mu\text{m}$ 幅で A g ペーストを塗布し、 450°C で焼成することによりスペーサ電極 4 1 を形成した。

【 0 0 6 7 】

なお、本例においては、素子ピッチの大きさは行方向配線間方向には $680\text{ }\mu\text{m}$ 、列配線方向には $300\text{ }\mu\text{m}$ ピッチとした。また、a、b は列方向配線及び絶縁層の厚みを含む高さであり、本例においては、a の大きさは $95\text{ }\mu\text{m}$ 、ゲッタ 1 0 1 の厚みは $35\text{ }\mu\text{m}$ として b の大きさを $65\text{ }\mu\text{m}$ とした。

【 0 0 6 8 】

(実施例 3)

図 2 2 は、この構成 1 の第 3 の実施例を示す図であり、第 1 の実施例と同じ構成においてスペーサ 2 0 の表面 2 2 に高抵抗膜を設けなかった点が異なる。なお、本例においては、素子ピッチの大きさは行方向配線間方向には $800\text{ }\mu\text{m}$ 、列配線方向には $600\text{ }\mu\text{m}$ ピッチとした。スペーサ電極 4 1、2 3 の高さはいずれも $180\text{ }\mu\text{m}$ とし、a の大きさは $230\text{ }\mu\text{m}$ 、ゲッタ 1 0 1 の厚みは $50\text{ }\mu\text{m}$ として b の大きさを $100\text{ }\mu\text{m}$ とした。

【0069】

(実施例4)

図23は、第4の実施例を示す図であり、第1の実施例と同じ構成においてスペーサ20に高抵抗膜とフェースプレート側のスペーサ電極を設けなかった点が異なる。また、本例において、46の接続部は導電性フィラーを有しない絶縁性のフリットを用いている。また、本例に於いては、スペーサに隣接する行方向配線13の上に形成された。ゲッタの形成厚を他の配線より高くしてある。本例の構成により、スペーサに隣接する電子源、及びその隣の電子源から放出される電子の電子軌道を補正することが可能である。

【0070】

なお、本例においては、素子ピッチの大きさは行方向配線間方向には $800\mu\text{m}$ 、列配線方向には $450\mu\text{m}$ ピッチとした。スペーサ電極41の高さはいずれも $600\mu\text{m}$ とし、aの大きさは $650\mu\text{m}$ 、スペーサに隣接するゲッタの厚みは $100\mu\text{m}$ としてbの大きさを $150\mu\text{m}$ 、その他のゲッタの厚みは $50\mu\text{m}$ としてcの大きさを $100\mu\text{m}$ とした。

【0071】

(実施例5)

図24は、この構成1の第5の実施例を示す図であり、第1の実施例と同じ構成においてスペーサに円柱形状スペーサ102を用いたものである。図示はしていないが、スペーサ102はスペーサ電極及び高抵抗膜を備えており、以下の様に形成した。まずスペーサ電極の製法であるが、Agペーストを平板上にバーコータを用いて均一な厚みに展開する。次に、この展開したAgペーストに円柱スペーサの端面を略垂直に押し当てることにより、円柱側に電極材であるAgペーストを転写した。この円柱を 120°C で乾燥させた後、円柱の上下を逆転させて同様にAgペーストを転写し、乾燥後 450°C で2時間焼成して円柱の上下に電極を形成した。また、実施例一と同様なスパッタを2回行うことによりスペーサ102の全面に高抵抗膜を形成した。なお、ゲッタ101等の他の構成材料の形成は第1の例と同様な方法を用いた。本例においては、素子ピッチの大きさは行方向配線間方向には $550\mu\text{m}$ 、列配線方向には $250\mu\text{m}$ ピッチとした。電子源

基板側およびフェースプレート側スペーサ電極（図示せず）の高さはいずれも 60 μm とし、ゲッタの厚みは 40 μm とした。

【0072】

パネル内厚 d を 1.4 mm、加速電圧を 6 kV として、上述した構成の画像形成装置を駆動したところ、特性劣化が少なく色ずれのない非常に高品位な画像の提供が本例において可能となった。

【0073】

以上の構成 1 では、ゲッタを画面領域内に配置しゲッタのない位置にスペーサを配置することにより、特性劣化が少なく且つ輝度にむらを生じず、色ずれの少ない高品位の画像装置を提供することが可能となった。また、電子被照射体は特定せず、マルチ平面電子源を成す電子発生装置においても同様の効果を発揮できる。

【0074】

（構成 2）

上記の構成 1 は更に以下に示す構成とすることができる。

【0075】

図 26 は、この構成を適用した表示パネルの斜視図であり、内部構造を示すためにパネルの一部を切り欠いて示している。また、図 27 は図 26 の A-A' 断面の模式図である。各部の番号は図 26 に対応している。図中、1015 はリアプレート、1016 は側壁（支持枠）、1017 はフェースプレートであり、リアプレート 1015、側壁 1016 およびフェースプレート 1017 により、表示パネルの内部を真空に維持するための外圍器（気密容器）を形成している。また、気密容器内部には、大気圧を支えるためのスペーサ 1020 が設けられている。

【0076】

フェースプレート 1017 には蛍光膜 1018 及びメタルバック 1019 が形成されている。リアプレート 1015 には基板 1011 が固定されているが、この基板 1011 上には冷陰極素子 1012 が NXM 個形成されており、M 本の行方向（X 方向）配線 1013 と N 本の列方向（Y 方向）配線 1014 により結線

されている。

【0077】

1013はスペーサ1020が設置される行方向配線、1021は配線1013上に形成された非蒸発型ゲッタ、1022はメタルバックを介してフェースプレート1017とスペーサ1020を接着する接着剤、1101はスペーサ近傍の電子放出素子1012から放出された電子の電子軌道、1102はスペーサ近傍の等電位線を示す。

【0078】

スペーサ1020は、薄板状の絶縁性部材1の表面に高抵抗膜11を成膜し、かつフェースプレート1017の内側(メタルバック1019)及び基板1011の表面(行方向配線1013)に面したスペーサの当接面3に低抵抗膜21を成膜した部材からなる。薄板状のスペーサ1020は、行方向(X方向)に沿って配置されている。高抵抗膜11は、基板1011側では低抵抗膜21及び非蒸発型ゲッタ1021を介して行方向配線1013と電氣的に接続されており、フェースプレート1017側では低抵抗膜21及び接着剤1022を介してメタルバック1019と電氣的に接続されている。

【0079】

上記スペーサが配置された行方向配線間には、少なくとも、5～50本の行方向配線が配置されることが好ましい。

【0080】

非蒸発型ゲッタ1021及び接着剤1022は、スペーサ1020が配線1013またはメタルバック1019と機械的な当接及び電氣的接続を成すに際して、配線1013、メタルバック1019及びスペーサ1020間の緩衝機能を有している。

【0081】

すなわち、非常に薄いメタルバック1019が剥がれたり破れてしまうのを防止する効果や、小さい比抵抗が要求される配線1013aにクラックが入って抵抗が大きくなるのを防止する効果や、脆弱性のある材料からなるスペーサの場合でスペーサが破損するのを防止する効果などがある。

【0082】

また、非蒸発型ゲッタ1021と接着剤1022は、フェースプレート1017側或いは電子源をなす基板1011側のどちらに対して用いても上記の緩衝効果を得ることが出来る。

【0083】

また、上記緩衝効果は、画像表示のなされる領域以外（例えば、配線の引出し部など）においても当然有効である。

【0084】

また、スペーサ近傍での電子軌道制御の観点からは、スペーサ20の正帯電により吸引される電子の軌道補正をするために、スペーサ上に形成された電極21の高さaをゲッタ上面（ゲッタのない場合は配線上面）までの高さbよりもより大きくする。aの大きさは、ゲッタ上面までの高さb、画像形成装置の構造、駆動条件、高抵抗膜の帯電除去の能力により任意に選択することが可能であるが、帯電で電子がスペーサ20側に引き寄せられることに対する電子軌道補正を行うには、少なくとも $a > b$ であることが必要である。ただし、スペーサの帯電を除去できる状況ではaとbは略等しい値を選択することが可能である。また、ゲッタ上面までの高さbについても任意の値を選択することが可能である。

【0085】

ここで、スペーサに形成された電極の上端の高さは、電子放出素子の電子放出部の上面よりも高いことが好ましい。一方、該電極の高さの上限は、電子放出素子から電子を放出している時の電子放出素子の電位と加速電極の電位との間の電位分布が均等に分布しているとした時に、電子放出部から加速電極側に向けて電子放出部の電位よりも2kV電位が高くなる高さに制御するとよい。ここで、電子を放出している時の電子放出部の電位とは、電子放出素子に印加される電位のうちの高い方の電位をいう。また、該スペーサに形成された電極としては、図27、28に示したようにスペーサの側面に回り込むものに限るものではなく、スペーサにおいて、配線側に当接する端部のみ電極を形成したものであってもよい。この場合、上述したスペーサに形成する電極の上端の高さとは、スペーサに形成する電極を形成する基体との接触面の高さである。スペーサに以上のよ

うな電極（抵抗膜）を形成した後に、該電極よりもシート抵抗の高い高抵抗膜を形成する場合であっても、上述の条件は好適に適用できる。

【0086】

この構成により、ゲッター膜を画像形成装置の表示領域内に、スペーサ近傍の電子軌道の乱れを生じることなく形成することが容易となり、輝度の経時的变化（経時的低下）が少なくかつビームずれが少ない高品質の画像形成装置の提供が可能となる。また、スペーサの形状としては、板状の他に円柱等の各種形状を適用することが可能である。また、材質としてガラスが適している。また、スペーサの高さは、0.5mm～5mmが適している。

【0087】

また、図27に示されるように外囲器内に、外囲器内を真空に保つための補助ポンプとして補助ゲッター1023を配置する場合がある。この場合、ゲッター材が画像表示領域中に飛散し、電極間の電氣的短絡を防ぐ目的で、補助ゲッター1023と電子放出素子1012、配線群1013、1014及び及びアノード電極をなす膜厚500Å～5000Åのメタルバック1019（アルミニウム、銅、銀などの金属膜を用いる）を含む領域との間に、遮蔽体1024を設けておく場合がある。尚、画像表示領域に形成されたゲッター1021のみで、外囲器内を十分に真空に保つことができる場合は、補助ゲッター1023並びに遮蔽体1024を形成しておかなくともよい。

メタルバック1019の膜厚は電子を透過するのに十分に薄く設定される。

【0088】

（実施例1）

ここで、本発明のもっとも特徴的な部分であるゲッタとスペーサの詳細について説明する。図28、29は構成2の実施例を説明するための図であり、電子線装置をなす表示パネルの断面図である。スペーサ1020の低抵抗膜21は、マスク治具を用いてスパッタ法によりアルミニウムを約0.1μmの厚みだけ成膜し、フェースプレート1017側および電子源基板1011側に形成した。電子源基板1011側の低抵抗膜21は電子源基板1011に当接される面3のみに形成した。次に、高抵抗膜11として、WとGeの合金窒化膜をアルゴンガスと

窒素ガスの混合ガス中でWターゲットとGeターゲットを同時スパッタする反応性スパッタ法により、約 $0.2\mu\text{m}$ の厚さに形成した。このとき、高抵抗膜11のシート抵抗値は、約10の10乗 $[\Omega/\square]$ であった。導電性を有するWとGeの合金窒化膜は我々の研究により帯電防止性に優れていることが確認されている。

【0089】

なお、本実施例では、全ての行方向配線1013上行方向配線の長さと略同じ長さで非蒸発型ゲッタ1021（幅 $200\mu\text{m}$ 、厚み $40\mu\text{m}$ ）を形成した。

【0090】

本実施例では、列方向配線（図示せず）および絶縁層（図示せず）を電子源基板1011上に形成した後、Agペーストをスクリーン印刷法により塗布し、行方向配線1013（厚み $20\mu\text{m}$ ）を形成した。各配線幅は $300\mu\text{m}$ として形成した。なお、電子放出素子1012の行方向配線方向のピッチは $630\mu\text{m}$ 、列方向配線方向には $305\mu\text{m}$ ピッチとした。

【0091】

さらに、本実施例においては、スペーサ1020は接着剤1022にて、フェースプレート1017に固定した後、電子源基板1011とフェースプレート1017とを組み立てることにより配置した。なお、接着剤1022には、球状のガラス製絶縁性フィラーに金属めっきを施したものをフリットガラス中に分散させたものを用い、フェースプレート1017とフェースプレート側低抵抗膜21との電氣的接続とスペーサ1020の固定を行った。

【0092】

（実施例2）

本実施例では、実施例1の行方向配線を列方向配線の幅よりも広くし、図13に示した構成とした。そして、スペーサを行方向配線上に配置した。

行方向配線には、画像表示する際には、走査信号が入力される。このため、より低抵抗なものとするために、本実施例では、行方向配線の幅を列方向配線よりも広く設定した。また、スペーサのアライメントに要求される精度も実施例1よりも低くできた。

【0093】

また、本実施例で形成した画像形成装置のフェースプレートの蛍光膜の構成としては、図14に示したものをを用いた。各色の蛍光体は、図に示した様に、縦長矩形状とした。また、3原色の配列としては、図に示したように、列方向（図のY方向）に同色の蛍光体が配列され、行方向（図のX方向）に3原色の蛍光体が赤、緑、青の順で繰り返し配列されている。遮光部材としてブラックマトリクスを用い、隣接する同じ色の蛍光体間方向（図のY方向）のピッチを、隣接する異なる色の蛍光体間方向（図のX方向）のピッチよりも広くし、リアプレート側の配列と同様にした。つまり、幅の広い遮光部材の領域の直下に前記行方向配線が配置される。そして、スペーサは、幅の広い遮光部材の領域に当接する。

上記以外の構造は実施例1と同様である。

以上の構成とすることで、本実施例の画像形成装置は、より大面積で、より高輝度なものが実現できた。

【0094】

（構成3）

スペーサの固定については以下に示す構成をとることができる。

【0095】

（リアプレートにスペーサを固定する場合）

リアプレート上には素子を駆動するためにマトリックス状、またははしご状に配線が形成される。スペーサをリアプレートに固定するときは、フリットガラス等を用いて、配線の上に固定される。このとき、スペーサとフェースプレートとの接点はブラックストライプを介して行われる。

【0096】

（フェースプレートにスペーサを固定する場合）

また、スペーサがフェースプレートに固定されるときは、ブラックストライプに、リアプレートと同様フリットガラス等で固定される。リアプレートとの接触は、配線を介して行われる。

【0097】

（配線、ブラックストライプの断面）

配線、ブラックストライプは、印刷、フォトリソなどの手法で形成され、断面は扇状、蒲鉾状、矩形、などの形状を呈し、スペーサとは、頂点、ライン上、平面で接する。

【0098】

(スペーサの位置ずれの場合の許容範囲)

配線、ブラックストライプが凸状の断面を有する場合において、以上で述べたように、スペーサはリアプレート、フェースプレートと両者、あるいはいずれかと、配線、ブラックストライプを介して接続されるが、スペーサが設置される配線、ブラックストライプとスペーサの位置ずれが生じてしまうことがある。その結果、スペーサのずれ量によってスペーサの角と設置台が当たってしまうため、ずれの許容範囲は以下のようにした。

【0099】

前記設置台の頂部と前記スペーサの間の位置ずれを x 、前記スペーサの厚みを t とすると

$$x < t / 2$$

とする。(図30参照)

【0100】

(スペーサの傾きの許容範囲)

スペーサは、位置ずれだけでなく、傾きも問題となる。設置台に対して、スペーサの傾きによっては、角に荷重がかかって破損の可能性が生じる。そのため、以下のような許容範囲に傾きを限定した。スペーサの厚みを t 、設置台の曲率半径を R 、スペーサの傾き θ とすると、図31のように

$$R \sin \theta < t / 2$$

となる。

【0101】

(スペーサ位置ずれと傾きの許容範囲)

さらに、位置ずれ、傾きの両方が生じることがある。前記スペーサの厚みを t 、設置台の曲率半径を R 、スペーサの傾きを θ 、リアプレートの平面のスペーサの傾いた方向を x 軸としたとき、設置台でのスペーサの位置ずれを x 、とし、

スペーサと設置台の接点がスペーサ厚み中央よりもX軸方向に大きいとき

$$R \sin|\theta| < x + t / 2$$

であれば、スペーサの角が設置台に接することはない。(図 3 2)

【0 1 0 2】

なお、スペーサの厚みを t 、設置台の曲率半径を R 、スペーサの傾きを θ 、リアプレートの平面のスペーサの傾いた方向を x 軸としたとき、設置台でのスペーサの位置ずれを x とし、スペーサと設置台の接点がスペーサ厚み中央と設置台の頂点の間にあるとき

$$R \sin|\theta| > x - t / 2$$

を満たせば、スペーサの角が設置台に接するのを避けることができる。(図 3 3)

【0 1 0 3】

(スペーサに R をつける方法)

スペーサのずれ、傾きを抑えるほかに、スペーサの角を丸くし、荷重の集中を小さくすることも可能である。小さくとも、 R の大きさは $10 \mu m$ が望ましく、スペーサの強度、配線、ブラックストライプなどの幅、曲率によって好適な R を使用する。(図 3 4)

【0 1 0 4】

(スペーサより広い幅の平面を有する設置台の場合)

前記スペーサに接触する接触部に前記スペーサより広い幅の平面を有する設置台において、スペーサが垂直に設置されているとき、スペーサの厚みを t 、前記スペーサの位置ずれを x 、設置台の平面部の幅を w とすると、スペーサの中央が設置台からはずれる場合

$$x < w / 2 + t / 2$$

の条件によって、スペーサの角と設置台との干渉を抑えることができる。(図 3 5)

以上述べたような条件を満たすことにより、大気圧によるスペーサの破損を抑えることができる。

【0 1 0 5】

以上の構成 3 の実施例を以下に示す。

【0106】

(実施例 1)

(傾きと位置ずれの許容範囲の設定)

本実施例では、前述した図 1 8 に示した表示パネルを作製した。

【0107】

(電子源作製)

まず、あらかじめ基板 1 0 1 1 上に行方向配線 1 0 1 3、列方向配線 1 0 1 4、電極間絶縁層および表面伝導型電子放出素子 1 0 1 2 の素子電極と導電性薄膜を形成した。

【0108】

(スペーサ基板の作製)

次に、ソーダライムガラスからなる絶縁性部材からなるスペーサ 1 (40mm×2mm×0.2mm) を作製した。

【0109】

(スペーサの高抵抗膜と電極成膜)

スペーサ表面のうち、気密容器の画像領域内にかかる 4 面 (40×2、40×0.2 の各表裏面) に後述の高抵抗膜 1 1 を成膜し、フェースプレート、リアプレートに当接する 2 面 (40×0.2 の 2 面) および、40×2 の面のフェースプレート、リアプレートに接する辺から 0.1mm の高さまでの領域 (40×0.1) に導電性膜を形成した。高抵抗膜としては、Cr および Al のターゲットを高周波電源で同時スパッタすることにより形成した Cr-Al 合金窒化膜 (200 nm 厚、約 $1e9 [\Omega/\square]$) を用いた。導電性膜は、スペーサに成膜された高抵抗膜とフェースプレート、高抵抗膜とリアプレートの電氣的接続を確保する目的のほかに、スペーサ周辺の電場を制御し電子放出素子からの電子線の軌道制御を行う目的がある。

【0110】

(フェースプレートとスペーサ組み立て)

フェースプレートとスペーサ組み立てについて説明する。フェースプレートのスペーサが配置される個所にフリットを塗布した。その後、スペーサが配置され

る位置にスペーサよりわずかに大きな溝を有する治具を、フェースプレートと位置合わせする。そしてスペーサを治具の溝に挿入し、熱工程を通すことによって前述のフリットによって、スペーサを固定する(図36)。ここで使った治具の溝は、スペーサの幅、スペーサの表面の膜の厚みなどを考慮し、幅 $250\mu\text{m}$ としてある。

【0111】

(フェースプレートとリアプレートの封着)

次に、スペーサの固定されたフェースプレートをリアプレートに固定する。リアプレート1015と側壁1018の接合部およびフェースプレート1017と側壁1016の接合部に、フリットガラスを塗布した。そしてリアプレート1015を、フェースプレート1017に側壁1016を会して配置し、大気圧中で 400°C 乃至 500°C で10分以上焼成することで封着した。

【0112】

(封着するリアプレートとスペーサの関係)(図37)

本実施例では、スペーサの厚みが 0.2mm 、高さが 2mm 、治具の溝の幅が 0.25mm 、リアプレートの配線が幅 0.3mm 、配線の曲率が $R=0.5\text{mm}$ であった。ゆえに、スペーサの最大ずれ幅は 0.025mm 、最大傾きは 0.025rad 、である。このとき、最大のずれのとき、傾きは0であるので、

$$x < t/2$$

を満たし、最大傾きのときも、スペーサと設置台の接点がスペーサ厚み中央よりもX軸方向に大きい条件で、

$$R \sin|\theta| < x + t/2$$

を満たす。よって、スペーサの角が配線に当たることはない。

【0113】

(電子源プロセス、封止)

以上のようにして完成した気密容器内を排気管を通じ真空ポンプにて排気し、十分な真空度に達した後容器外端子 $Dx1 \sim Dx_m$ と $Dy1 \sim Dy_n$ を通じ、行方向配線電極1013及び列方向配線電極1014を介して各素子に給電して前述の通電フォーミング処理と通電活性化処理を行うことによりマルチ電子源ビー

ム源を製造した。次に、 $1\text{e-}6$ [Torr] 程度の真空度で、不図示の排気管をガスバーナーで熱することで溶着し外囲器（気密容器）の封着を行った。最後に、封止後の真空度を維持するために、ゲッター処理を行った。

【0114】

（画像形成）

以上のように完成した表示パネルにおいて、各冷陰極素子（表面伝導型電子放出素子）1012には、例えば図26に示すような構成の容器外端子 $D \times 1 \sim D \times m$ と $Dy1 \sim Dy n$ を通じ、走査信号および変調信号を不図示の信号発生手段によりそれぞれ印加することにより電子を放出させ、メタルバック1019には、高圧端子 Hv を通じて高圧を印加することにより放出電子ビームを加速し、蛍光膜1018に電子を衝突させ、各色蛍光体を励起・発光させることで画像を表示した。なお、高圧端子 Hv への印加電圧 Va は3 [kV]ないし10 [kV]、各配線1013、1014間への印加電圧 Vf は14 [V]とした。

【0115】

このとき、スペーサ1020に近い位置にある冷陰極素子1012からの放出電子による発光スポットも含め、二次元上に等間隔の発光スポット列が形成され、鮮明で色再現性の良いカラー画像表示ができた。

【0116】

以上述べたように、配線上でのスペーサの位置ずれと、傾きの最大値を設定しその範囲内で組み立てを行い、大気圧によるスペーサの破損を抑えることができる。

【0117】

（実施例2）

（スペーサより幅のある平面を持った配線）

本実施例では、スペーサより幅のある平面を持った配線でのスペーサの配置について述べる。スペーサおよび、組み立ての条件は実施例1と同じである。すなわち本実施例では、スペーサの厚みが0.2mm、高さが2mm、治具の溝の幅が0.5 mm、リアプレートの配線が幅0.3mm、配線の平面の幅が $W=0.2$ mmであった（スペーサのずれの許容範囲）（図38）。

【0 1 1 8】

この条件では、

$x < w / 2 + t / 2$ を満たす。ゆえにスペーサの角が配線に当たることなく、大気圧によるスペーサの破損を抑えることができる。

【0 1 1 9】

以上述べたように。本発明に基づいた条件を適用することにより、スペーサは、われを生じることがないため、構造上の強度の低下を防止可能となり、真空度の維持が確保できた。ゆえに、高輝度高画質である画像表示可能となった。

【0 1 2 0】

(構成 4)

表示パネル内部の構成としては以下の構成をとることもできる。図 2 2 は構成 4 を適用した画像表示装置の表示パネル内部の構成における表面伝導型電子放出素子から放出されている電子ビームを模式的に示しており、カソード基板とアノード基板の断面図 (図 3 9 (a))、表面伝導型電子放出素子から放出された電子ビームのアノード基板上における電子ビームの形状 (図 3 9 (b))、図 3 9 (b) 上 A-A' 上での強度分布 (図 3 9 (c)) を示している。

【0 1 2 1】

各電子放出素子は行方向、列方向に間隔 P_x 、 P_y で行列状に配列し、電圧印加の方向は全て行方向に平行で、図 3 9 では、電極 1 1 0 2 を高電位側にして V_f 印加している。該電子放出素子 (素子長: L) から放出した電子ビームのアノード基板上でのビーム径 S_x 、 S_y に関して以下の関係式 (I) (II) を満たす。

$$S_x = K_x \times 2 d (V_f / V_a)^{1/2} [K_x : 0.8 \leq K_x \leq 1.0] \quad \dots (I)$$

$$S_y = L + 2 K_y \times 2 d (V_f / V_a)^{1/2} [K_y : 0.8 \leq K_y \leq 0.9] \quad \dots (II)$$

このとき、該電子ビームの強度分布は、図 3 9 (b)、(c) に示す通り、電圧印加方向の高電位側に偏向して、ビーム形状は電子放出部から遠い部分の強度が強い楕円形状となる。このため、電子ビームの蛍光体への照射量を最大にし、また均一性を良くするためには、該電子源とそれに対応する該蛍光体の位置関係を、該電子放出部とそれに対応する該蛍光体の電子放出部から遠い方の端とを S_x だけの距離をもって配置することが最良であることが分かった。これにより、放出

電子の一部がブラックストライプ 1 0 1 0 によりけられても、蛍光体を照射する電子量は最大にすることができ、高輝度化が可能となり、さらに位置ずれに対する変動も小さくなり均一性も良くなる。また、該電子源とそれに対応する該蛍光体の位置関係を上記のように配置することによって、該柱状スペーサはブラックストライプ上に接続され、発光の障害とならないために、高画質な表示が可能となる。

【 0 1 2 2 】

(柱状スペーサの位置と形状)

図 4 0 を用いて、柱状スペーサの位置に関して説明する。図 4 0 (a) はアノード基板を上面からの図、図 4 0 (b) は画像形成装置内部で側面からの図、図 4 0 (c) はカソード基板の上面 (真空側) からの図である。ここでは、該スペーサ 1 0 2 0 は柱状形状であり、該電子放出素子から放出された 1 次電子ビームの非照射部位に設置されている。具体的には、該電子放出部から放出される電子ビームは、電圧印加方向の高電位側に偏向して、真空中を徐々に広がってアノード基板に到達するため、該柱状スペーサはアノード基板上で電子ビームが照射しない位置に配置されれば、1 次電子ビームに直接さらされないことになる。これによって、該円柱状スペーサが該電子ビームから受ける影響を最小にすることができ、該スペーサが表示画像に影響を及ぼさない高画質を実現できることになる。ここで、該電子放出素子から放出された 1 次電子ビームの非照射部位とは、Y 方向に隣り合う電子放出素子のほぼ中間領域である。特に、それぞれの素子から等距離の場所は、高精細化を実現する上で好ましい位置である。

【 0 1 2 3 】

また更に、Y 方向に隣り合う電子放出素子と同一直線上にほぼ位置していると、X 方向に隣り合う電子放出素子から放出された 2 つの電子ビームの間に柱状スペーサは配置することになる。このため、該スペーサは 4 つの電子ビームの囲まれて全ての電子ビームを妨げることなく存在でき、電子線による帯電の影響も少なくでき、スペーサの歩留りが向上することになる。また、画素間での輝度の均一性が向上し高画質な画像表示が可能となる。

【 0 1 2 4 】

該電子放出部 1105 の直上のアノード基板上にはブラックストライプ 1010 があり、該柱状スペーサ 1020 はアノード基板とブラックストライプ 1010 上で接続されている。これにより、該柱状スペーサ 1020 はアノード基板とブラックストライプ 1010 を介して接続し、カソード基板と X 方向配線を介して接続されることになり、表側からは見えないで強固に固定できることになる。また、該スペーサ表面に形成した場合の帯電防止用の高抵抗膜を流れる微小電流を逃がすことができる。これによって、該柱状スペーサが画像に影響しない高画質を実現できる。

【0125】

また、特に、Y 方向の互いに隣り合う電子放出素子の間隔 P_y が電子ビームのアノード基板上での Y 方向ビーム径 S_y よりも大きい場合を図 41 に示す。図 41 の上部はカソード基板を示し、マルチ電子源が形成されている。図 41 下部には図 41 の上部のマルチ電子源から放射された電子ビームがアノード基板上に当たって発光した可視光形状が模式的に示されている。つまり、垂直方向で電子ビームがピクセルの中に十分おさまリ、垂直方向で電子ビームの届かない領域ができる場合には、 $(P_y - S_y)$ の幅の該電子ビームの届かない領域に該柱状スペーサを配置させる。この場合、該柱状スペーサの該カソードとの接合面は、Y 方向において隣り合う電子放出部と同一直線上に存在することが最も良い。

【0126】

また、図 42 に電子の飛翔領域の他の例を示す。

【0127】

また、Y 方向の互いに隣り合う電子放出素子の間隔 P_y が電子ビームのアノード基板上での Y 方向ビーム径 S_y 以下の場合について、マルチ電子源から放射された電子ビームがアノード基板上に当たって発光した可視光形状を模式的に図 5 に示す。この場合には、Y 方向で隣り合う該電子放出素子からの電子ビームが蛍光体上で重なり合うため、スペーサ形状は柱状が望ましく、Y 方向に隣り合う電子放出素子と同一直線上にほぼ位置していると、X 方向に隣り合う電子放出素子から放出された電子ビームのちょうど間に柱状スペーサは配置し、電子ビームを妨げることなく存在できる。その結果として高画質の画像を表示することができる。

【0 1 2 8】

(スペーサ被覆層：共通)

図 4 0 はこの構成における柱状スペーサ近傍の構造を示している。スペーサ 1 0 2 0 は絶縁性部材 1 の表面に帯電防止を目的とした高抵抗膜 1 1 を成膜し、かつフェースプレート 1 0 1 7 の内側（メタルバック 1 0 1 9 等）及び基板 1 1 0 1 の表面（行方向配線 1 0 1 3 または列方向配線 1 0 1 4）に電氣的接合がとれるように低抵抗膜 2 1 を成膜した部材からなるもので、上記目的を達成するのに必要な数だけ、かつ必要な間隔をおいて配置され、フェースプレートの内側および基板 1 1 0 1 の表面に接合材 1 0 4 1 により固定される。また、高抵抗膜は、絶縁性部材 1 の表面のうち、少なくとも気密容器内の真空中に露出している面に成膜されており、柱状スペーサ 1 0 2 0 上の低抵抗膜 2 1 および接合材 1 0 4 1 を介して、フェースプレート 1 0 1 7 の内側（メタルバック 1 0 1 9 等）及び基板 1 1 0 1 の表面（行方向配線 1 0 1 3 または列方向配線 1 0 1 4）に電氣的に接続される。ここで説明される態様においては、柱状スペーサ 1 0 2 0 は、行方向配線 1 0 1 3 に電氣的に接続されている。

【0 1 2 9】

該柱状スペーサ 1 0 2 0 としては、基板 1 1 0 1 上の行方向配線 1 0 1 3 および列方向配線 1 0 1 4 とフェースプレート 1 0 1 7 内面のメタルバック 1 0 1 9 との間に印加される高電圧に耐えるだけの絶縁性を有し、かつ該スペーサ 1 0 2 0 の表面への帯電を防止する程度の導電性を有する必要がある。

【0 1 3 0】

柱状スペーサの絶縁性部材 1 としては、例えば石英ガラス、N a 等の不純物含有量を減少したガラス、ソーダライムガラス、アルミナ等のセラミックス部材等が挙げられる。該スペーサの断面形状は、多角形状、円形状等スペーサの長さ（カソード基板とアノード基板の間隔を支える方向の距離）に比べて十分小さい対角距離の断面形状であれば良い。ここで、断面形状の対角距離とスペーサの長さの比（アスペクト比）は、1 : 1 0 ~ 1 : 1 0 0 0 程度が良い。例えば、長さ 1mm、断面形状は 100 μm × 50 μm の長方形のスペーサとか、長さ 2mm で断面が直径 100 μm の円形状のスペーサが適している。

【0131】

また、該スペーサの断面形状は、図43に示す通り、正方形、長方形、菱形、六角形等の多角形状(図43(a))や円形状等、十分な強度が確保でき、カソード基板とアノード基板と設置できる面積があればよい。

【0132】

望ましくは、図43(b)に示すような断面形状が曲線で囲まれているような角を丸めた多角柱、図43(c)に示すような円や楕円等の円柱が電界集中するような部分をもたないために適当である。特に、円柱は形状が対称であるために作製が容易で、また配置の際の接合方向や位置ずれに対しての許容範囲が広くなり、特に望ましい。

【0133】

スペーサ1020を構成する高抵抗膜11には、高電位側のフェースプレート1017(メタルバック1019等)に印加される加速電圧 V_a を帯電防止膜である高抵抗膜11の抵抗値 R_s で除した電流が流される。そこで、スペーサの抵抗値 R_s は帯電防止および消費電力からその望ましい範囲に設定される。帯電防止の観点から表面抵抗 R/\square は 10 の 12 乗 Ω 以下であることが好ましい。十分な帯電防止効果を得るためには 10 の 11 乗 Ω 以下がさらに好ましい。表面抵抗の下限はスペーサ形状とスペーサ間に印加される電圧により左右されるが、 10 の 5 乗 Ω 以上であることが好ましい。絶縁材料上に形成された帯電防止膜の厚み t は $10\text{ nm} \sim 1\text{ }\mu\text{ m}$ の範囲が望ましい。特に、材料の表面エネルギーおよび基板との密着性や基板温度によっても異なるが、成膜時間、再現性、膜応力等の観点より、膜厚は $50 \sim 500\text{ nm}$ であることが望ましい。表面抵抗 R/\square は ρ/t であり、以上に述べた $R\square$ と t の好ましい範囲から、帯電防止膜の比抵抗 ρ は $0.1[\Omega\text{ cm}]$ 乃至 10 の 8 乗 $[\Omega\text{ cm}]$ が好ましい。さらに表面抵抗と膜厚のより好ましい範囲を実現するためには、 ρ は 10 の 2 乗乃至 10 の 6 乗 $\Omega\text{ cm}$ とするのが良い。

【0134】

帯電防止特性を有する高抵抗膜11の材料としては、例えば金属酸化物を用いることが出来る。金属酸化物の中でも、クロム、ニッケル、銅の酸化物が好まし

い材料である。その理由はこれらの酸化物は二次電子放出効率が比較的小さく、冷陰極素子 1012 から放出された電子がスペーサ 1020 に当たった場合においても帯電しにくいためと考えられる。金属酸化物以外にも炭素は二次電子放出効率が小さく好ましい材料である。特に、非晶質カーボンが高抵抗であるため、スペーサ表面の抵抗を所望の値に制御しやすい。

【0135】

該柱状スペーサ 1020 を構成する低抵抗膜 21 は、高抵抗膜 11 を高電位側のフェースプレート 1017 (メタルバック 1019 等) 及び低電位側の基板 1101 (配線 1013、1014 等) と電氣的に接続する為に設けられたものであり、以下に列挙する複数の機能を有することが出来る。

①高抵抗膜 11 をフェースプレート 1017 及び基板 1101 と電氣的に接続する。

【0136】

既に記載したように、高抵抗膜 11 はスペーサ 1020 表面での帯電を防止する目的で設けられたものであるが、高抵抗膜 11 をフェースプレート 1017 (メタルバック 1019 等) 及び基板 1101 (配線 1013、1014 等) と直接或いは当接材 1041 を介して接続した場合、接続部界面に大きな接触抵抗が発生し、スペーサ表面に発生した電荷を速やかに除去できなくなる可能性がある。これを避ける為に、フェースプレート 1017、基板 1101 及び当接材 1041 と接触する柱状スペーサ 1020 の当接面或いは側面部に低抵抗層 21 を設けた。

②高抵抗膜 11 の電位分布を均一化する。

【0137】

陰極素子 1012 より放出された電子は、フェースプレート 1017 と基板 1101 の間に形成された電位分布に従って電子軌道を成す。柱状スペーサ 1020 の近傍で電子軌道に乱れが生じないようにする為には、高抵抗膜 11 の電位分布を全域にわたって制御する必要がある。高抵抗膜 11 をフェースプレート 1017 (メタルバック 1019 等) 及び基板 1101 (配線 1013、1014 等) と直接或いは当接材 1041 を介して接続した場合、接続部界面の接触抵抗の

為に、接続状態のむらが発生し、高抵抗膜 11 の電位分布が所望の値からずれてしまう可能性がある。これを避ける為に、柱状スペーサ 1020 がフェースプレート 1017 及び基板 1101 と当接するスペーサ端部の全長域に低抵抗層を設け、この低抵抗層に所望の電位を印加することによって、高抵抗膜 11 全体の電位を制御可能とした。

③放出電子の軌道を制御する。

【0138】

冷陰極素子 1012 より放出された電子は、フェースプレート 1017 と基板 1101 の間に形成された電位分布に従って電子軌道を成す。スペーサ近傍の冷陰極素子から放出された電子に関しては、スペーサを設置することに伴う制約（配線、素子位置の変更等）が生じる場合がある。このような場合、歪みやむらの無い画像を形成する為には、放出された電子の軌道を制御してフェースプレート 1017 上の所望の位置に電子を照射する必要がある。フェースプレート 1017 及び基板 1101 と当接する面の側面部に低抵抗層を設けることにより、柱状スペーサ 1020 近傍の電位分布に所望の特性を持たせ、放出された電子の軌道を制御することが出来る。

【0139】

低抵抗膜 21 は、高抵抗膜 11 に比べ十分に低い抵抗値を有する材料を選択すればよく、Ni, Cr, Au, Mo, W, Pt, Ti, Al, Cu, Pd等の金属、あるいは合金等より適宜選択される。

【0140】

接合材 1041 は該柱状スペーサ 1020 が行方向配線 1013 およびメタルバック 1019 と電氣的に接続するように、導電性をもたせる必要がある。すなわち、導電性接着材や金属粒子や導電性フィラーを添加したフリットガラスが好適である。

【0141】

該柱状スペーサの巨視的な配列方法については、図 44 に示したように、（a）規則的に格子点状の場合、（b）Y 方向に隣接するスペーサ列が X 方向に半ピッチだけずれている場合、（c）規則的な配列で所々抜けている場合、また、ラ

ンダムに配列していても良い。重要な点は、該スペーサによって大気圧が支持され、電子ビームを妨げずに輝点の均一性が保たれていれば良い。

【0 1 4 2】

(構成 5)

表示パネルとしてスペーサを用いる場合におけるそのスペーサの配置については以下の各実施例の構成をとることができる。

【0 1 4 3】

(実施例 1)

図 4 5 ~ 図 4 9 はこの構成 5 を適用した真空容器の実施例 1 を説明する図である。図 4 5 は平板型ディスプレイの真空容器の概略図であり、図 4 6 は図 4 5 における A - A 断面図であり、図 4 7 は図 4 5 における B - B 断面図であり、図 4 8 は図 4 6 における C - C 断面図であり、図 4 9 はスペーサの斜視図である。

【0 1 4 4】

図中、101 は前面基板 (厚さ $T1 = 2.8 \text{ mm}$) であり、102 は前面基板 101 に対向した位置に配置された背面基板 (厚さ $T2 = 2.8 \text{ mm}$) であり、103 は 2 枚の基板の間に配置され、気密に接着された枠部である。2 枚の基板間距離 D は 2 mm である。枠部 103 の内側の大きさは、 x 方向長さ $W1 = 112 \text{ mm}$ 、 y 方向長さ $W2 = 52 \text{ mm}$ であり、枠部 103 と前面基板 101 および背面基板 102 とはフリットガラス (不図示) により気密に接着されている。105 は 2 枚の基板の間に配置され、断面円形状である円柱スペーサ (半径 $R = 0.1 \text{ mm}$ 、高さ $H = 2 \text{ mm}$) であり、間隔 $P1 = P2 = 12 \text{ mm}$ にて正方格子点に配置されており、本数は 50 本である。

【0 1 4 5】

前面基板 101、背面基板 102、枠部 103 および円柱スペーサ 105 の材質は青板ガラスである。104 は、これらの構成部材によって真空容器 106 が構成されている。

【0 1 4 6】

背面基板 102 上には、電子を放出する素子である表面伝導型の電子放出素子 109 が搭載されており、前面基板 102 には、電子を照射することで発光し、

画像を表示する蛍光体 108 が搭載されている。107 は蛍光体 108 が発光して画像を表示する画像表示領域 (120 mm × 67 mm) である。

【0147】

図 48 において、A は C-C 断面図における枠部 103 の内側の面積であり、 $A = W1 \times W2$ であるので、 5824 mm^2 であり、スペーサの総断面積 S は 50 本分の円柱スペーサ 104 の断面積の和であるスペーサ総断面積であるので、 $S = 50 \times \pi \times R^2$ であり、 $S = 1.57 \text{ mm}^2$ である。ここで、支持効率比 η は比 S/A であり、支持効率 η は 0.027% である。

上記 S/A は 0.018% から 7.8% の範囲が好ましい。本実施例の S/A は 0.027% であるので、上記好ましい範囲に入る。

【0148】

次に真空容器 106 を用いた平板型画像表示装置を説明する。まず、電子放出素子 109 などが搭載された背面基板 102 を電子放出部 103 をホットプレート上に上側に向けてセットし、円柱スペーサ 104 を配置する位置にフリットガラスをディスペンサを用いて塗布する。そして、専用治具にて円柱スペーサ 104 をフリットガラス上に配置し、加熱することでスペーサ 104 を背面基板 102 に接着する。

【0149】

次に、背面基板 102 の上に、あらかじめ z 方向の上下にフリットガラスを塗った枠部 103 をセットし、さらに、蛍光体 108 などが搭載された前面基板 101 を、蛍光体 108 が電子放出素子 109 と対向するように位置合わせして固定する。さらにその上にホットプレートをのせ、荷重をかけながらフリットガラスの接着温度まで加熱し、その後冷却することで気密な真空容器を製造する。また、本発明では不図示であるが、背面基板 102 または前面基板 101 には排気管を接着する。その後、排気管を利用して外部の真空ポンプによって内部の空気を排除して、 10^{-6} torr 程度の真空とする。そして、電子放出素子 109 と外部駆動基板等を接続してに通電処理を行い、電子を放出する機能を与える。さらに、電子放出素子 109 に駆動電圧を印加して電子を放出させ、蛍光体 108 と電子放出素子 109 間に 3 kV ~ 15 kV の高電圧を印加して電子を蛍光体 1

08へ加速して照射し、発光させる。その光は前面基板101を透過する。外部から前面基板101を見ると、画像表示領域107に従来より高質の画像が表示され、目標の達成を確認した。

【0150】

(実施例2)

図50～図51は本発明による真空容器の実施例を説明するである。図50は平板型ディスプレイの真空容器の横方向における断面図であり、実施例1の図48に相当する。図51はスペーサの斜視図である。図中、101は前面基板（厚さ $T1 = 2.8\text{ mm}$ ）であり、102は前面基板101に対向して基板間隔 $D = 2\text{ mm}$ の位置に配置された背面基板（厚さ $T2 = 2.8\text{ mm}$ ）であり、103は2枚の基板の間に配置され、気密に接着された枠部である。枠部103の内寸はx方向方向は $W1 = 820\text{ mm}$ 、y方向は $W2 = 500\text{ mm}$ である。枠部103と前面基板101および背面基板102とはフリットガラス（不図示）により気密に接着されている。105は2枚の基板の間に配置された断面長方形形状である長手スペーサの一つである板スペーサ（x方向長さ $L = 40\text{ mm}$ 、y方向長さ $T = 0.2\text{ mm}$ 、高さ $H = 1.8\text{ mm}$ ）であり、x方向に間隔 0.1 mm 以下（ほぼ連続）で、間隔y方向に間隔 $P3 = 27.072\text{ mm}$ にて均一に連続配置されており、本数は288本である。なお、図において板スペーサ105の本数は省略されている。これらの構成部材によって真空容器106が構成されている。前面基板101、背面基板102、枠部103および板スペーサ105の材質は青板ガラスである。

【0151】

背面基板102上には、電子を放出する素子である表面伝導型の電子放出素子109が搭載されており、前面基板102には、電子を照射することで発光し、画像を表示する蛍光体108が搭載されている。107は蛍光体108が発光して画像を表示画像表示領域（ $720.792\text{ mm} \times 406.08\text{ mm}$ ）ある。

【0152】

図50において、AはC-C断面図における枠部103の内側の面積であり、 $A = W1 \times W2 = 4.10 \times 10^5\text{ mm}^2$ であり、Sは288本（ $=n$ ）分の板ス

ペーサ 105 の断面積の和であるスパーサ総断面積 $S = n \times T \times L$ なので、 $S = 2.30 \times 10^3 \text{ mm}^2$ である。ここで、支持効率 η は 0.56% であり、望ましい構成の真空容器である。

【0153】

次に、この真空容器 106 を用いて平板型画像表示装置を製造した。まず、電子放出素子 109 などが搭載された背面基板 102 を電子放出部 103 をホットプレート上に上側に向けてセットし、長手スパーサ 105 を配置する位置にフリットガラスをディスペンサを用いて塗布する。そして、専用治具にて長手スパーサ 105 をフリットガラス上に配置し、加熱することで長手スパーサ 105 を背面基板 102 に接着する。

【0154】

次に、背面基板 102 の上に、あらかじめ z 方向の上下にフリットガラスを塗った枠部 103 をセットし、さらに、蛍光体 108 などが搭載された前面基板 101 を、蛍光体 108 が電子放出素子 109 と対向するように位置合わせして固定する。さらにその上にホットプレートをのせ、荷重をかけながらフリットガラスの接着温度まで加熱し、その後冷却することで気密な真空容器を製造する。また、本発明では不図示であるが、背面基板 102 または前面基板 101 には排気管を接着する。その後、排気管を利用して外部の真空ポンプによって内部の空気を排除して、 10^{-6} torr 程度の真空とする。そして、電子放出素子 109 と外部駆動基板等を接続してに通電処理を行い、電子を放出する機能を与える。さらに、電子放出素子 109 に駆動電圧を印加して電子を放出させ、蛍光体 108 と電子放出素子 109 間に $3 \text{ kV} \sim 15 \text{ kV}$ の高電圧を印加して電子を蛍光体 108 へ加速して照射し、発光させる。その光は前面基板 101 を透過する。外部から前面基板 101 を見ると、画像表示領域 107 に従来より高質の画像が表示され、目標の達成を確認した。

【0155】

また、板スパーサ 105 の配置を千鳥配置とした場合、スパーサの本数は 256 本が必要であり、スパーサの総断面積 S は 256 本分の板スパーサ 105 の断面積の和であり、 $S = 2.05 \times 10^3 \text{ mm}^2$ である。この場合、支持効率 η は 0

、50%であり、望ましい構成の真空容器である。

【0156】

また、図52及び53に示す構成とすることができる。図52中、101は前面基板（厚さ $T1 = 2.8\text{ mm}$ ）であり、102は前面基板101に対向して基板間隔 2 mm の位置に配置された背面基板（厚さ $T2 = 2.8\text{ mm}$ ）であり、103は2枚の基板の間に配置され、気密に接着された枠部である。枠部103の内寸はx方向方向は $W1 = 820\text{ mm}$ 、y方向は $W2 = 500\text{ mm}$ である。枠部103と前面基板101および背面基板102とはフリットガラス（不図示）により気密に接着されている。105は2枚の基板の間に配置された断面長方形形状である板スペーサ（x方向長さ 40 mm 、y方向長さ 0.2 mm 、z方向長さ $=1.8\text{ mm}$ ）であり、x方向に間隔 0.1 mm 以下（ほぼ連続）で、間隔y方向に間隔 $P3 = 27.072\text{ mm}$ にて均一に連続配置されており、本数は288本である。なお、図において板スペーサ105の本数は省略されている。前面基板101、背面基板102、枠部103および板スペーサ105の材質は青板ガラスである。また、図53のように、板スペーサ105の配置を千鳥配置とした場合、x方向間隔は 2.55 mm 、y方向間隔は 27.072 mm であり、スペーサの本数は256本である。なお、枠部材の角部はこれらの図面に示されているように面取りした湾曲状とすることができる。この場合の曲率は、例えば内径 $10\text{ mm} \pm 1.0\text{ mm}$ 、外径 $18\text{ mm} \pm 1.0\text{ mm}$ とすることができ、このような径での湾曲状の角部を有する枠部材は、対角10インチから30インチなどの大画面のものにまで適用可能である。

【0157】

（構成6）

枠部材の構成としては以下の構成を採ることもできる。図54にその一例を示す。支持部材103は、前面板101及び背面板102と実質的に同様な熱膨張率をもつ材料で形成され、前面板、背面板及び支持部材で基本的な容器が構成される。支持部材の隅部形状は、容器内側、外側両方円弧形状であることがもっとも好ましいが、内側もしくは外側のみ円弧形状であっても良く特に限定されるものではない。また、円弧形状の曲率は内、外側とも限定されるものではないが、特に内、

外同心円で曲率半径は 1 ~ 50mm が強度的に好ましい。

支持部材は、くり貫き加工、研削加工、加熱プレス加工、棒材からの折り曲げ加工、打ち抜き加工などの各種形成方法により形成される。この構成において、有効表示エリアを対角 30 インチとする縦、横比 3 : 4 のカラー画像形成装置を作成できた。

【0158】

図 5 5 に支持棒の他の例を示す。この支持棒は、青板ガラス板材から研削加工にて厚さ 3.6mm 幅 7 mm、隅部内側曲率半径 2 ± 0.5 mm することで形成することができた。更にリアプレートとの封着面にディスペンサによって低融点ガラスペーストを塗布し、乾燥後、380℃で10分間前処理（仮焼成）することで低融点ガラス層を形成した。低融点ガラスはフェースプレート同様、日本電気硝子社製 LS-3081 をペーストとして用いた。

【0159】

また図 5 6 に示す構成を適用して有効表示エリアを対角 10 インチとする縦、横比 3 : 4 のカラー画像表示装置を作成することができる。この場合の支持棒は、青板ガラス板材からくり貫き加工にて厚さ 1.6mm 幅 13 mm、隅部内側曲率半径 10 ± 1.0 mm、隅部外側曲率半径 18 ± 1.0 mm のものとして作製できる。尚、隅部の円弧形状は内、外とも同一中心を持つものとしている。更にリアプレートとの封着面にディスペンサによって低融点ガラスペーストを塗布し、乾燥後、380℃で10分間前処理（仮焼成）することで低融点ガラス層を形成した。低融点ガラスはフェースプレート同様、日本電気硝子社製 LS-3081 をペーストとして用いた。

【0160】

この構成によれば、背面板と前面板との間において背面板と前面板の間隔を外周部において支持する支持部材の隅部形状を少なくとも容器内側もしくは外側において円弧形状にする事により、支持部材を一体型で成形することが容易になり、分割支持部材構成で見られていた隅部でのスローリークの発生や封着後の容器の破損（剥がれ）を低減する事ができ、歩留まりの良い信頼性の高い画像形成装置が得られる。さらに支持部材自体の強度が向上することにより取り扱いも安易に

なり装置等の簡略化により生産性を向上させる事ができる。

【0161】

また、この構成において、背面板と前面板との間において背面板と前面板の間隔を外周部において支持する支持部材の隅部形状を少なくとも容器内側もしくは外側において円弧形状にする事により、支持部材を一体型で成形することが容易になり、分割支持部材構成で見られていた隅部でのスローリークの発生や封着後の容器の破損(剥がれ)を低減する事ができ、歩留まりの良い信頼性の高い画像形成装置が得られた。また、支持部材自体の強度が向上することにより取り扱いも安易になり装置等の簡略化により生産性を向上させる事ができた。

【0162】

(構成7)

一方、フェースプレート、支持棒、リアプレートの接合部の構成としては以下の各実施例の構成をとることができる。

【0163】

実施例1

本実施例は、画像表示装置の大画面化における課題に対して、目標を達成した例である。図57および図58はこの構成の実施例1を説明する図である。図57は気密容器の概略断面図であり、図58は気密容器の構成部材を分解した概略斜視図である。

【0164】

図中、101は前面基板(厚さ2.8mm)であり、102は前面基板101に対向した位置に配置された背面基板(厚さ2.8mm)であり、103はフリットガラス105によって前面基板101と背面基板103と気密に接着された外枠である。外枠103の幅Wは3mm、厚さTは1mmであり、縦横比Aは3である。また、フリットガラス105の厚みは0.2mmである。

【0165】

104は気密容器106の内部を真空にした時に外部から印加される大気圧に対して、気密容器の変形を抑制するためのスペーサ104である。大きさは、x方向長さtは0.2mm、y方向長さ40mm、z方向長さ1.2mmであり、

フリットガラス 1 0 7 (厚さ 0. 2 mm) にて片側固定されている。図 5 7、5 8 ではスペーサは 3 本しか記載されていないが、実際は 2 5 0 本である。

【0 1 6 6】

1 0 6 は前面基板 1 0 1 と背面基板 1 0 2 と外枠 1 0 3 によって構成された気密容器であり、1 1 0 は気密空間である。気密容器 1 0 6 の大きさは、x 方向 9 0 0 mm、y 方向 5 8 0 mm、z 方向 7 mm である。また、前面基板 1 0 1 と背面基板 1 0 2 と外枠 1 0 3 とスペーサ 1 0 4 の材質は青板ガラスである。

【0 1 6 7】

1 0 9 は背面基板 1 0 2 上に搭載された表面伝導型電子放出素子であり、1 0 8 は前面基板上に搭載され、表面伝導型電子放出素子 1 0 9 で発生した電子を照射することで発光する蛍光体である。表面伝導型電子放出素子 1 0 9 についての詳しい技術は特開平 7 - 2 3 5 2 5 5 等で開示されている。

【0 1 6 8】

次に、気密容器の製造方法を説明する。はじめに、前面基板 1 0 1 に蛍光体 1 0 8 等を形成し、次に、背面基板 1 0 2 上に表面伝導型電子放出素子 1 0 9 などを設け、その後、背面基板 1 0 2 の上にフリットガラス 1 0 5 と外枠 1 0 3 を積層して配置して、さらにスペーサ 1 0 4 とフリットガラス 1 0 7 を治具にて位置決めして配置し、外枠 1 0 3 とスペーサ 1 0 4 に荷重を加えながらホットプレートにてフリットガラス 1 0 5 の接着温度まで加熱し、接着させ、冷却する。さらに、外枠 1 0 3 の上に、フリットガラス 1 0 5 と前面基板 1 0 1 をのせ、治具等で適切な位置で固定し、ホットプレートでフリットガラス 1 0 5 の接着温度まで加熱し、フリットガラス 1 0 5 に荷重を加えながら、気密に接合する。そして、降温してホットプレートから取り出し、気密空間 1 1 0 を具備する気密容器 1 0 6 を完成した。

【0 1 6 9】

次に、気密容器 1 0 6 を用いた画像表示装置の製造方法について説明する。はじめに、排気管 (不図示) を介して気密空間 1 1 0 の空気を排出して真空にし、表面伝導型電子放出素子 1 0 9 と外部の駆動回路 (不図示) 等を接続し、表面伝導型電子放出素子 1 0 9 に通電することで電子放出部としての性能を与え、外部

の駆動回路より画像を表示するべく通電することで、表面伝導型電子放出素子より電子を発生させ、蛍光体 108 に照射し、蛍光体 108 が発光することで画像表示に成功し、画像表示装置の製造を完了した。

【0170】

次に、能力最大である前面発光の状態では駆動を行い、前面基板 101 および背面基板 102 の温度がそれぞれ上昇しても、外枠 103 およびフリットガラス 105 においてスローリークは発生せず、安定した気密容器と画像表示装置を得ることができた。その後、排気管(不図示)を切断除去した。

【0171】

続いて、厚さ T を 1 mm を対象にし、上述した第一の条件である外枠 103 の幅 $W = 3$ mm を中心として、幅 $W = 1, 2, 5, 30, 40$ mm である外枠について FEM 解析を行い、引き剥がし応力 σ がスローリークにつながるクラックが発生しないと考えられる 12 MPa 以下であることを判定基準とした。さらに外枠 103 の幅 $W = 2, 5, 30, 40$ mm である外枠を用いて気密容器を作成し、さらに画像表示装置を製造した。

【0172】

そして、能力最大の駆動を行い、ヘリウムリークディテクタを用いてスローリークチェックを特に領域 C および D にて行い、スローリークがないことを確認した。

【0173】

また、外枠の幅 W が大きくなると、それに伴って、気密容器を製造する際にフリットガラス 105 を用いて外枠と前面基板および背面基板を加熱接合するために必要な荷重が大きくなり、製造装置の消耗等が激しくなり、製造コストが高くなってしまふ。従って、実用的には、幅 W は 30 mm 以下であることが適当である。

【0174】

これらの結果を表 1 に示す。

【0175】

【表 1】

表 1 実施例 1 を説明する表

項目	判定						判定基準
幅 W [mm]	1	2	3	5	30	40	実測値
厚さ T [mm]	1	1	1	1	1	1	実測値
縦横比 A	1	2	3	5	30	40	W/T
FEM解析	×	○	○	○	○	○	×: 応力 $\sigma > 120\text{Pa}$ ○: 応力 $\sigma \leq 120\text{Pa}$
駆動	×	○	○	○	○	○	×: 駆動せず ○: リークなし
実用性		○	○	○	○	△	△: 非実用的 ○: 実用的

本実施例では、大画面を有する気密容器およびそれを用いた画像表示装置において、外枠 103 の縦横比 A が、枠幅 W が $2 \leq W \leq 30$ であり、 $2 \leq A \leq 30$ であれば、実用的な範囲で、スローリークが発生しにくいことを検討および製造を行うことで示した。

また、上記 W/T の比は、1.5 ～ 30 の範囲が好ましい。

【0176】

また、本実施例ではスペーサ 104 として長さ 40 mm、厚さ 0.2 mm の形状を用いたが、形状および大きさをこれに限定するものではない。例えば、長さが 200 mm、厚さ 0.1 mm でもよく、また、半径が 0.1 mm 程度の円柱形状でもよい。

【0177】

なお、30 インチ角の大画面に適用する場合は、例えば $W = 13\text{ mm}$ 、 $T = 1.3\text{ mm}$ 、フリット厚み 0.3 mm、 $A = 10\text{ mm}$ 、スペーサ Z 方向 1.8 mm、容量大きさ 7.5 mm とすることができる。

【0178】

実施例 2

本実施例では、実施例 1 と同じく、画像表示装置の大画面化における課題に対して、目標を達成した例である。本実施例は、外枠 103 とスペーサ 104 のサイズが異なるだけで、その他の構成部材のサイズは実施例 1 と同じである。

【0179】

本実施例では、外枠 1 0 3 の幅 W は 1 2 mm であり、厚さ T は 3 mm であり、外枠の縦横比 A は 4 である。またそれにともない、スペーサ 1 0 4 の z 方向の長さが 3. 2 mm である。。また、フリットガラス 1 0 5 の厚みは 0. 2 mm である。また、前面基板 1 0 1、背面基板 1 0 2、外枠 1 0 3 およびスペーサ 1 0 4 の材質は、高歪点ガラスである。

【 0 1 8 0 】

これらの部材を用いて、実施例 1 と同じ方法で気密容器を製造し、そして画像表示装置を製造し、最大能力における駆動においてスローリークがないことを確認した。

【 0 1 8 1 】

さらに、外枠の幅 $W = 1 2$ に対して、厚さ T を、 $T = 3$ mm を中心として $T = 2, 4$ mm と振って気密容器、さらには画像表示装置を製造し、実施例 1 と同様の検討、確認を行った。その結果を表 2 に示す。なお、厚さ T を変化させるにあたり、スペーサ 1 0 4 の z 方向の長さも、それぞれ、2. 2 mm, 4. 2 mm と変更した。

【 0 1 8 2 】

【表 2】

表 2 実施例 2 を説明する表

項目	判定			判定基準
幅W	1 2	1 2	1 2	実測値
厚さT	2	3	4	実測値
縦横比A	6	4	3	W/T
F E M解析	○	○	○	×: 応力 $\sigma > 12\text{MPa}$ ○: 応力 $\sigma \leq 12\text{MPa}$
駆動	○	○	○	×: 実施せず ○: リークなし
実用性	○	○	○	△: 非実用的 ○: 実用的

本実施例では、大画面を有する気密容器およびそれを用いた画像表示装置において、外枠 103 の外枠の幅Wが $W = 12$ であり、縦横比Aが、 $3 \leq A \leq 6$ であれば、実用的な範囲で、スローリークが発生しにくいことを検討および製造を行うことで示した。

【0183】

なお、例えば、30インチの表示部の場合は、 $A = 10$ 、 $W = 13$ 、 $T = 1.3$ 、また10インチの表示部の場合は、 $A = 8.6$ 、 $W = 12$ 、 $T = 1.4$ とすることができる。

【0184】

(構成 8)

更に、フェースプレート、支持枠、リアプレートの接合部周辺については以下のような構成をとることができる。この構成は、フェースプレートの画像形成部

材（蛍光体）領域の周辺から、支持枠との接合面にかけて第1の導電性膜を有し、支持枠上のフェースプレートとの接合面から、支持枠上のリアプレートとの接合面にかけて第2の導電性膜を有するものである。また、この構成ではリアプレート側の電子源基板中の複数の電子放出素子と配線の周辺に第3の導電性膜を有してもよい。更に、第1の導電性膜と第2の導電性膜との接合部に、第1の導電性膜と第2の導電性膜とを電気的に接合する導電性材料が形成されていてもよく、フェースプレートと支持枠との間が、導電性のフリット乃至は接着剤により接合されてもよい。

【0185】

図59にこの構成の一例を示す。この例では、フェースプレート（前面板）7上の画像形成部材6の周辺から支持枠9との接合部にかけて、第1の導電性膜10が形成されており、支持枠9上には、前面板7との接合部からリアプレート（背面板）4との接合部にかけて第2の導電膜11が形成されている。また、第1の導電膜10と第2の導電膜11は接合部分で電気的に接続しており、電気的接続を確保するための導電性材料12を形成しても良い。また、導電性材料12を用いずに、接合材14にAuやAg等の導電性のフィラーを混合させた導電性フリットガラスを用いて、電気的接続を確保することもできる。

【0186】

第2の導電膜11の背面板4との接合部分は、電子源2を駆動する時の電位と近い電位になるように維持するのが好ましく、例えば図59に示すように、支持枠9の背面板4との接合端面に導電膜2と接触するように電極13を形成し、電極13を例えばグランド電位に接続する。

【0187】

第1の導電膜10は、表面抵抗 R_s （シート抵抗）が $10^{11}\Omega/\square$ 以下となるように形成する。なおシート抵抗 R_s は、厚さが t 、幅が w で長さが l の薄膜の長さ方向に測定した抵抗値 R を $R = R_s (l/w)$ とおいたときに現れる値で、抵抗率を ρ とすれば、 $R_s = \rho/t$ である。シート抵抗 R_s を上記範囲に設定する理由は、先述したイオンなどによる帯電を除去するためには R_s が $10^{11}\Omega/\square$ 以下であることが好ましいからである。第2の導電膜11のシート抵抗は、1

$10^8 \Omega/\square \sim 10^{11} \Omega/\square$ とするのが好ましい。これも、イオンなどによる帯電を除去するためには R_s が $10^{11} \Omega/\square$ 以下であることが好ましいからであり、また、画像形成部材 6 に高電圧が印加された時に第 2 の導電膜 11 を電流が流れることにより消費される電力を抑えるためには R_s が $10^8 \Omega/\square$ 以上であることが好ましいからである。

【0188】

支持棒 9 周囲の構造パラメータを考慮し、第 1 の導電膜 10 および第 2 の導電膜 11 のシート抵抗を上記範囲内で適宜設定することで、支持棒周囲の電界の乱れを制御することも可能である。ここで、画像形成部材 6 に印加する高電圧の値を V_a とし、画像形成部材 6 の端部から支持棒との接合部との距離を L とし、支持棒の高さを H 、第 1 の導電膜と第 2 の導電膜のシート抵抗をそれぞれ R_{s1} 、 R_{s2} とする。例えば、 $V_a/2$ となる電位が前面板と支持棒との接合部位に来るようにするためには、 $R_{s1}/R_{s2} = H/L$ とすれば良い。また、 R_{s1}/R_{s2} が極力小さくなるように設定すれば、図 59 に示すように、画像形成部材 6 と電子源 2 との間の平衡電界を支持棒近傍まで継続させることができる。

【0189】

また、図 59 に示した様な、フェースプレートとリアプレートに対し、略平行な等電位面を形成すると、見かけ上、放出された電子の軌道に影響を与えずに支持棒と画像形成部との距離を詰めることができる。この結果、表示装置全体に占める画像表示部の割合が大きくとれるので好ましい。この様な、等電位面を形成するには、前述した様に、 R_{s1}/R_{s2} が極力小さくなる様に設定することで実現できる。

【0190】

また、フェースプレートとリアプレートとの間に、表面のシート抵抗が制御されたスペーサを配置した場合には、表面のシート抵抗がスペーサと同様のシート抵抗を有する支持棒とする。さらに、第一の導電膜をメタルバックを支持棒部まで延長することで構成する。この様にすることで、スペーサのフェースプレート側の端部（上端）および、支持棒のフェースプレート側の端部（上端）はメタルバックに印可される電位が与えられる。

【0 1 9 1】

さらに、支持枠のリアプレート側の端部（下端）および、スペーサのリアプレート側の端部（下端）とを略同一の電位に設定することで、支持枠表面とスペーサ表面の電位分布は略等しくなる。

以上の様に設定することで、駆動時に、フェースプレートとリアプレートに対し、略平行な等電位面を形成することが可能となる。

【0 1 9 2】

なお、ここでの導電膜の形成用材料としては、炭素材料や酸化錫、酸化クロム、ITOなどの金属酸化物や、導電性材料が酸化シリコン等に分散されたものなどは、容易にかつ大面積にわたり均一な膜を形成できるため好適である。導電膜 1 0、1 1 の成膜方法としては、スパッタ法、真空蒸着法、塗布法、電子ビームによる重合法、プラズマ法、CVD法等が挙げられる。これらのいずれの方法によっても、安定した導電膜を容易に得られる。

【0 1 9 3】

次に、本発明の表示プレートの第 2 の形態を図 6 0 に示す。図 6 0 中、図 5 9 と同じ符号を付けた部材は同じ物を示す。図 6 0 で示した画像形成装置と、図 5 9 で示した画像形成装置との相違点は、ガラス等の絶縁性基体上に形成された電子源 2 と配線 3 の、少なくとも周囲の絶縁基体上に第 3 の導電性膜 1 6 を有している点にある。

【0 1 9 4】

この構成によれば、上記背面板内の電極もしくは導電性薄膜が形成されていない領域、例えば、各 X 方向配線 3 x の間、各 Y 方向配線 3 y の間、それぞれの電子放出素子間に存在する基板 1 の表面等に、第 3 の導電膜が形成される。そして、第 3 の導電膜は、電子放出素子の駆動電圧に近い電位となるように、電極電位やグランド電位などに電氣的に接続されているため、これらの領域が帯電することにより発生する電子ビーム軌道の歪みや揺らぎを抑えることができる。第 3 の導電膜のシート抵抗は、帯電を防止する観点から $10^{11} \Omega / \square$ 以下であることが好ましく、また、各配線や電極間の絶縁を確保し、リーク電流による無効な消費電力を抑える観点から $10^8 \Omega / \square$ 以上であることが好ましい。第 3 の導電膜を

構成する材料や成膜方法は、第1の導伝膜や第2の導伝膜と同じ材料や成膜方法を用いることができる。

【0195】

第3の導伝膜16は、各配線や電極間の絶縁を確保するような抵抗値に設定してあるため、電子源を形成した背面板全体に成膜しても良く、また、予め基板1上に第3の導伝膜を成膜し、その上に電子源2や配線群3を形成しても良い。

【0196】

次に、この構成、例えば図59または60に示す構成における接合部の作製について説明する。まず、画像表示部分となる前面板7を作成した。前面板7には、予めガラス基板5の片側全面にITOからなる透明電極を設けておいた。ITO膜は本発明における第1の導伝膜としての機能を備えており、シート抵抗は $2 \times 10^3 \Omega/\square$ とした。

【0197】

画像形成部材であるところの蛍光膜6は、カラーを実現するためにストライプ形状の蛍光体とし、先にブラックストライプを形成し、その間隙部にスラリー法により各色蛍光体を塗布して蛍光膜6を作製した。ブラックストライプの材料として通常良く用いられている黒鉛を主成分とする材料を用いた。また、蛍光膜6の電子源に対向する面側にはメタルバックを設けた。メタルバックは、蛍光膜6の作製後、蛍光膜6の内面側表面の平滑化处理（通常、フィルミングと呼ばれる）を行い、その後A1を真空蒸着することで作製した。

【0198】

次に、支持枠9を作成した。支持枠9はソーダライムガラスからなり、電子ビーム蒸着により酸化クロムからなる第2の導伝膜を成膜した。シート抵抗は $3 \times 10^{10} \Omega/\square$ とした。また、支持枠9の背面板と接合される接合面と第2の導伝膜端部にかけて、A1の蒸着膜からなる電極を形成した。

【0199】

以上のようにして多数の表面伝導型電子放出素子を作製した背面板の3mm上方に、先ほど作成した前面板7を支持枠9を介して配置し、前面板7と支持枠9との接合部にはAu微粒子のフィラーを混合させた導電性フリットガラスを塗布

し、支持枠 9 と背面板 4 との間には通常の（絶縁性の）フリットガラスを塗布して、大気中で 4 1 0℃で 1 0 分間焼成することで封着した。

【0 2 0 0】

更に、第 3 の導電膜を用いた構成は、まず、RF マグネトロンスパッタによって、上記背面板の電子源が形成された側の前面に、第 3 の導電膜を形成する。使用したターゲットは炭素であり、膜厚は約 2 n m である。このときのシート抵抗値は $5 \times 10^8 \Omega / \square$ 程度であった。次に、蛍光膜 6 とメタルバックからなる画像形成部材を形成後、画像形成部材周辺のガラス基板上に、炭素系薄膜からなる第 1 の導電膜 1 0 を形成した。第 1 の導電膜 1 0 の形成は、粒径 0. 1 μ m の炭素分散材料を有機溶剤に分散した溶液をスプレーコートすることにより行った。炭素分散材料は黒鉛を主成分として、導伝率を下げるために T i O 2 を添加されているものを用いた。また、塗布後に、上記炭素系薄膜を安定化するために 2 0 0℃で熱処理を行った。このように作成された第 1 の導電膜の膜厚は約 1 μ m であり、シート抵抗は $2 \times 10^7 \Omega / \square$ であった。更に、支持枠 9 を作成した。支持枠 9 はソーダライムガラスからなり、電子ビーム蒸着により酸化錫からなる第 2 の導電膜を成膜した。シート抵抗は $2 \times 10^{10} \Omega / \square$ とした。また、支持枠 9 の背面板と接合される接合面と第 2 の導電膜端部にかけて、A l の蒸着膜からなる電極を形成した。このような操作によって第 1 ～第 3 の導電膜を用いた構成を得ることができた。

【0 2 0 1】

（構成 9）

一方、スペーサ自体の構成として種々の構成が取り得るが、例えば図 6 1 に示す構成のものを好ましく用いることができる。なお、このようなスペーサは以下のようにして行うことができる。

【0 2 0 2】

まず、PD ガラスは、真空容器の外囲器をなすフェースプレート、リアプレート及び枠部材などに使用しているソーダライムガラスと熱膨張率が近いので、表示パネル組立や真空プロセス中の熱工程で表示パネルの破壊や歪みを生じにくい。また、高電界（数 k V / m m）以下での電荷移動がソーダライムガラスに比べ

格段に少ないので、フェースプレート上のアノード電極及びリアプレート上の電子源間に印加される高電圧下においても、スペーサ沿面での放電やスペーサ部材の劣化が生じにくい。以上から、スペーサ部材及び表示パネルの信頼性が格段に向上する。

【 0 2 0 3 】

スペーサが、フェースプレート及びリアプレート接する 2 面及び／または接続する側面部の一部への電極の形成は以下の工程により行うことができる。

(a) スペーサ電極形成部に開口を有する成膜マスクをスペーサに位置合せ・密着させた後、スパッタリング成膜装置内にセットする。

(b) スパッタリング成膜装置内を排気し、所望の真空度に達した後、所望のターゲット材を所望のイオン化ガスによりスパッタし、スペーサ表面に所望の材料を成膜する。

(b-1) 下引き層としての Ti を、チタンターゲットをアルゴンガス中でスパッタリングして成膜する。

(b-2) スペーサ電極としての Pt を、プラチナターゲットをアルゴンガス中でスパッタリングして成膜する。

【 0 2 0 4 】

下引き層としてのチタンは、スペーサ基板をなすガラス（酸化物を含む）と酸化しにくいプラチナとの密着性を強化する機能を有する。低抵抗膜（スペーサ電極）としてのプラチナは高抵抗膜と接するので、表示パネル作製工程（特に熱工程）や高電圧印加工程において、高抵抗膜及びその境界部での変質を起こしにくい材料として選択したものである。

【 0 2 0 5 】

上記低抵抗膜（スペーサ電極）は、スペーサがフェースプレート上のアノード及びリアプレート上の配線と電氣的導通をスペーサ全体にわたって保つ機能と、かつスペーサ近傍を飛翔する電子軌道に対し所望の制御を行う機能と、2 次電子放出係数の小さい低抵抗部材よりスペーサ表面で 2 次電子放出を制御し、スペーサ帯電を抑制する機能を合せ持つ。

【 0 2 0 6 】

次に、スペーサが真空容器をなす表示パネル内に表出する面に帯電防止機能を有する高抵抗膜を形成する。まず、スパッタリング成膜装置内を排気し、所望の真空度に達した後、所望のターゲット材を所望のイオン化ガスによりスパッタリングし、スペーサ表面に所望の材料を成膜する。例えば、下引き層として窒化アルミニウムをアルミニウムターゲットを窒素ガス中でスパッタリングして成膜（ $200 \sim 500 \text{ \AA}$ ）する。次に、高抵抗膜としての窒化タングステン・ゲルマニウム合金化合物（WGeN）を、タングステンターゲットとゲルマニウムターゲットを窒素ガス中で同時スパッタリングして成膜（ $500 \sim 3000 \text{ \AA}$ ）する。

【0207】

この高抵抗膜は、リアプレート上の電子源から放出された放出電子あるいはGフェースプレート上のアノードから反射した反射電子、あるいはその他のイオン化物質、あるいは紫外線やX線の衝突によりスペーサ表面で発生する2次電子の量を高抵抗膜の2次電子放出特性及び表面構造により制御し、帯電の発生を抑制する機能を有する。また、高抵抗膜の抵抗値を適度に制御することにより、発生した帯電荷を速やかに除去し、かつ高電界下においても電流による発熱を適度に抑制することができる。

【0208】

（構成10）

スペーサを用いた表示パネルの真空容器内の真空度を維持する手段としてゲッタを容器内に配置する場合には、スペーサとスペーサの間に少なくとも1種のゲッタが配設された構成をとることができる。そのような構成の1例を図62に示す。図62において、1は電子源で、複数の電子放出素子を基板上に配置し、適当な配線を施したものである。2はリアプレート、3は支持枠、4はフェースプレート、9、14はゲッタ、15は板状スペーサ、接合部において、フリットガラスなどを用いて互いに接着され、外囲器5を形成している。

【0209】

上記のようにして形成されたフェースプレートと電子源基板に対し、ゲッタ9を設置する位置としては、スペーサとスペーサの間でフェースプレート側ではメタルバック上あるいは黒色導電材上、電子源基板上ではX方向配線上があげられ

る。設置はいずれか一方に行ってもよいし、双方に行ってもよい。また設置領域は、画像表示領域内全域に、まんべんなく分散して配置されることが望ましい。さらに、ゲッタ9の設置面積としては、前記板状スペーサと前記電子源基板および前記画像形成部材との設置面積より大きく配設されていることが望ましい。

【0210】

一方、ゲッタ14を配置する位置としては、画像形成装置内でかつ画像表示領域外でメタルバック、電子源に対し絶縁されてあれば、フェースプレート4上でもリアプレート上に設置しても良い。

【0211】

スペーサは、その占有面積および、電子光学的な観点から、配線上に配置することが好ましい。この様にすることで電子放出素子の配置に影響を与えなくて済む。また、上記ゲッタ9を電子源基板側に配置する場合においても、スペーサと同様、配線上に配置することが好ましい。また、ゲッタを配線上に配置する場合には、例えば図62に示すように、スペーサが配置された領域を除いた領域に配置することが好ましい。これは、一つには、配線上に配置されたゲッタ上に、さらにスペーサを配置した場合には、ゲッターの一部がスペーサによって覆われることで、ゲッターの面積が低減してしまうからである。

【0212】

また、スペーサが複数配置される場合には、ゲッターの一部がスペーサによって覆われない様に、複数のスペーサ間の配線上に配置することが好ましい。

上記配線が行方向配線と列方向配線のようなマトリクス配線の場合には、上記ゲッターの配置される配線は、行方向配線、列方向配線のどちらか一方でも良いし、また双方に配置しても良い。

【0213】

上記のゲッタ9、14は、その材料としてTi、Zr、Cr、Al、V、Nb、Ta、W、Mo、Th、Ni、Fe、Mnのうちから選ばれる一種以上の金属、またはその合金からなるもの、あるいはBaが使われ、適当なマスクをのせて真空蒸着法またはスパッタリング法、ゲッタフラッシュ法によって製造可能である。以下にゲッタの配置における実施例を示す。

【0214】

(実施例1)

図62の構成において、メタルマスクを用いて画像表示領域内の上配線102上に、スパッタリング法によりZr-V-Fe合金よりなるゲッタ層109を形成する。ゲッタ層9の厚さは $2\mu\text{m}$ となるように調整し、ゲッタ9の幅 $400\mu\text{m}$ で板状スペーサの幅 $200\mu\text{m}$ より太く、かつ長く形成した。非蒸発型ゲッタを形成した。使用したスパッタリングターゲットの組成は、Zr:70%、V:25%、Fe:5%(重量比)である。

【0215】

(実施例2)

更に、図63に本構成の他の例を示す。この例では、フェースプレート4の全てのブラックマトリクス12上にスパッタリング法によりTi-Al合金よりなるゲッタ層9を形成した。Ti-Al合金のゲッタ層109の厚さは $5\mu\text{m}$ とし、幅は板状スペーサの幅 $150\mu\text{m}$ より太く、長く形成した。スパッタリングに用いたターゲットの組成は、Ti85%、Al15%の合金である。

【0216】

(実施例3)

図64に本実施例について示す。ここでは蒸発型ゲッタが図64に示すワイヤー状のものであることと、ゲッタフラッシュを抵抗加熱で行った以外は、実施例1と同様に画像形成装置を作成した。

【0217】

(実施例4)

本実施例を図65に示す。本実施例では、実施例1の長さ20mmの板状スペーサが50mmおきに千鳥に画像表示領域の全ての上配線上に配置し、ゲッタ9をスペーサとスペーサの間に形成した以外は、実施例1と同様に画像形成装置を作成した。

【0218】

(実施例5)

本実施例の画像形成装置を図66に示す。本実施例では、実施例1の工程の工

程-xと実施例2の工程の工程-yをそれぞれ行い、上配線102上とブラックマトリクス12上にゲッタ9を形成した以外は、実施例1と同様に画像形成装置を作成した。

【0219】

以上の構成10によれば、前記ゲッタ材の設置面積は前記板状スペーサと前記電子源基板および前記画像形成部材との設置面積より大きく配設されていることにより、広い面積で、しかも、最もガスを放出する部分の近傍にゲッタ材が配置されることになる。その結果、外囲器内に発生したガスはゲッタ材に速やかに吸着され、外囲器内の真空度が良好に維持されるので、電子放出素子からの電子放出量が安定し、特性の劣化を抑制でき、結果的に、長時間動作させた場合の輝度の低下、とりわけ、画像表示領域の外側付近での輝度の低下、および輝度むらを抑制することができる。

【0220】

(構成11)

ゲッタの配置については更に以下の構成を利用することができる。

すなわち、

(1) 第一に、外囲器内に、複数の電子放出素子が基板上にマトリクス状に配置し対向する電極と配線で結線された電子源基板と、前記基板に対向して設けられた蛍光膜を有する画像形成部材とを有する表示パネルにおいて、該電子源基板の配線上に非蒸発ゲッタが形成され、かつ連続する該非蒸発ゲッタの任意の二点間の電気抵抗が、同二点間の該非蒸発ゲッタが形成される配線の電気抵抗より高いことを特徴とする構成、

(2) 第二に、上述の電子源基板の結線方法が、対向する電極の一方を結線した走査側配線ともう一方を結線した信号側配線で形成された単純マトリクス配線において、上述の非蒸発ゲッタが形成される配線が、該電子源基板の走査側配線であることを特徴とする構成を挙げることができる。

【0221】

この構成によれば、NEGを形成した配線部分とNEGを形成しなかった配

線部分が混在する場合において、配線部分毎の電圧降下ばらつきを小さく抑えられ、その結果非蒸発ゲッタを形成することによる輝度ばらつきを小さく抑えられて、ガスを放出する部分の近傍である配線上にゲッタ材が配置することができる。これにより、封着工程後に外囲器内に発生したガスはゲッタ材に速やかに吸着され、外囲器内の真空度が良好に維持されるので、電子放出素子からの電子放出量が安定する。単純マトリクス配線の電子源基板の場合、走査側配線、信号側配線の両方の配線上に形成しても片側の配線のみ形成しても構わないが、片側のみに形成する場合、走査側配線上に形成することが好ましい。それは単純マトリクス駆動の際、信号配線である Y 方向配線より走査配線である X 方向配線の方が電流容量が大きいことが好ましく、必然的に X 方向配線の幅が広くなり、NEG の形成面積を大きくできるからである。

【 0 2 2 2 】

図 6 7、6 8 は、2 次元的に配置された電子源を、マトリクス配線で接続された構成を模式的に示したものである。図 6 7 は平面図、図 6 8 は A-A' に沿った断面の構成を示す。102 は X 方向配線 (走査側配線、上配線)、103 は Y 方向配線 (信号側配線、下配線) で、それぞれ素子電極 105、106 を介して電子放出素子 108 に接続されている。Y 方向配線 103 と X 方向配線 102 の交差部は、Y 方向配線 103 の上に絶縁層 104 が形成され、その上に X 方向配線 102 が形成されている。X 方向配線 102、Y 方向配線 103、素子電極 105、106、電子放出素子はフォトリソプロセスと真空蒸着法を組み合わせたもの、メッキ法、印刷法、金属を溶液に溶かし液滴で付与し焼成する方法等で形成される。

【 0 2 2 3 】

この電子源基板の配線上に非蒸発型ゲッタ (NEG) 109、110 を形成する。X 方向 (走査側配線、上配線)、Y 方向 (信号側配線、下配線) 両方向とも非蒸発型ゲッタを形成してもよいし、片側のみに形成してもよい。片側の場合、好ましくは X 方向配線上に形成することが望ましい。これは単純マトリクス駆動の際信号配線である Y 方向配線より走査配線である X 方向配線の方が電流容量が大きいことが好ましく、必然的に X 方向配線の幅が広くなり、NEG の形成面積を大きくできるからである。また、画像表示領域内全域に、まんべんなく分散して配置される

ことが望ましい(この意味より、本ゲッタは面内ゲッタと称す)。

【0224】

配線上に形成する非蒸発型ゲッタ(NEG)は、その材料としてTi、Zr、Cr、Al、V、Nb、Ta、W、Mo、Th、Ni、Fe、Mnのうちから選ばれる一種以上の金属、またはその合金からなるものが使われ、フォトリソプロセスによるパターンニングと真空蒸着法やスパッタリング法によって製造可能であり、また上記ゲッタ材のうちから選ばれる一種以上の金属、またはその合金からなるものや、それらに他の金属、非金属材料を混ぜ、スクリーン法やオフセット法の印刷法、メッキ法等を用いても製造可能である。

【0225】

この時、非蒸発ゲッタの連続する任意の二点間の電気抵抗は、非蒸発ゲッタの下部にある配線の同二点間の電気抵抗より高くする。これは非蒸発ゲッタを形成した配線部分と形成しなかった配線部分がある画像形成装置において、後述する素子形成工程のフォーミング工程や活性化工程、さらには駆動時に配線に電流を流す際、その上部の主成分が金属である非蒸発ゲッタにも電流が流れ、配線よりも非蒸発ゲッタの抵抗が低い場合には、非蒸発ゲッタに配線より大きい電流が流れ、電圧降下が大きく変わり、画像形成装置の輝度ばらつきを生じさせてしまう場合がある。非蒸発ゲッタの連続する任意の二点間の電気抵抗が、非蒸発ゲッタの下部にある配線の同二点間の電気抵抗より高い場合には、非蒸発ゲッタの形成された配線部分と形成されていない配線部分の電圧降下のばらつきが小さく、輝度ばらつきを少なくすることが出来る。

【0226】

以下この構成における実施例を挙げる。

【0227】

(実施例1)

本実施例の表示パネルは、図69に模式的に示された装置と同様の構成を有し、X方向配線(上配線)102、Y方向配線(下配線)103上に一本おきに非蒸発型ゲッタ(NEG)が配置されている。また、本実施例の表示パネルは、基板上に、複数(100行×300列)の表面伝導型電子放出素子が、単純マトリクス配線された電

子源1を備えている。

【0228】

電子源1の一部平面図を図67に示す。また、図中A-A'の断面図を図68に示す。但し、図67、図68で、同じ記号を付したものは同じ物を示す。ここで101は電子源基板、102は図69のDoxmに対応するX方向配線(上配線、走査側配線とも呼ぶ)、103は図69のDoynに対応するY方向配線(下配線、信号側配線とも呼ぶ)、108は電子放出部を含む導電性膜、105,106は素子電極、104は層間絶縁層である。ゲッタ層109,110の厚さは $2\mu\text{m}$ となるように調整した。この膜厚により、連続した非蒸発ゲッタの膜上の任意の二点間の非蒸発ゲッタの抵抗値は、その下部の同二点間の配線の抵抗より高く形成された。

【0229】

ここで下配線、上配線ともに抵抗率(体積抵抗率)は $5 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ であり、一方のゲッタの体積抵抗率は $4.1 \times 10^{-7} \Omega\text{m}$ である。ある点における下配線の断面積は $1000 \mu\text{m}^2$ 、そこでのゲッタ断面積は $100 \mu\text{m}^2$ であり、 1cm の間隔における抵抗値はそれぞれ 0.5Ω 、 20.5Ω であり、下配線の抵抗値よりもゲッタの抵抗値を十分大きくすることができた。また、ある点での上配線の断面積は $1500 \mu\text{m}^2$ 、そこでのゲッタの断面積は $100 \mu\text{m}^2$ であり、 1cm の間隔における抵抗値はそれぞれ 0.33Ω 、 20.5Ω であり、上配線の抵抗値よりもゲッタの抵抗値を十分に大きくすることができた。

【0230】

なお、本実施例では非蒸発型ゲッタの形成方法にフォトリソプロセス、スパッタ成膜法を用いたが、これに限るものでなく、メタルマスクを用いたパターンニング方法や、ディスペンサーや印刷で接着剤を描画し非蒸発型ゲッタの粉末を接着したもの、メッキ法等を用いても同様の効果が得られる。また、本実施例のようにNEGを配線一本おきに形成するのではなく、任意のパターンに形成する場合においても作成方法は同様であり、後述する同様の効果が期待できる。

【0231】

(実施例2)

図70に本実施例の特徴を最も良く表す図を示す。実施例1との相違はX方向

配線（上配線）上にのみ非蒸発ゲッタを一本おきに形成したことである。

【0 2 3 2】

以上の構成 1 1 によれば、複数の電子放出素子が基板上にマトリクス状に配置され結線された電子源基板と、前記基板に対向して設けられた蛍光膜を有する画像形成装置において、前記画像形成装置の電子源基板の配線の上に非蒸発ゲッタを形成することにより、広い面積で、しかも、最もガスを放出する部分の近傍にゲッタ材が配置されることになる。この際配線上方にゲッタ材の蒸発源を設ける必要がないので、駆動時の電子軌道に影響を及ぼすことがなく、封着工程後に外囲器内に発生したガスはゲッタ材に速やかに吸着され、外囲器内の真空度が良好に維持されるので、電子放出素子からの電子放出量が安定し、特性の劣化を抑制でき、結果的に、長時間動作させた場合の輝度の低下、とりわけ、画像表示領域の外側付近での輝度の低下、および輝度むらを抑制することができる。

【0 2 3 3】

また、非蒸発ゲッタを形成する際、非蒸発ゲッタの電気抵抗を配線の電気抵抗より高くする事により、非蒸発ゲッタの形成された配線部分と形成されていない配線部分がある場合でも、電圧降下のばらつきが小さく抑えられ、その結果、画像形成装置の輝度ばらつきが小さく抑えられる。

【0 2 3 4】

さらに、ゲッタの活性化工程が、蒸発型ゲッタを組み込む工程およびゲッタフラッシュ工程を必要とせず、熱工程でできるので歩留まり良く画像形成装置を製造することができる。

【0 2 3 5】

（構成 1 2）

ゲッタの配置態様としては更に以下の構成を取り得る。すなわち、複数の電子放出素子を配列した電子源基板と、画像形成部材を有する発光表示基板と、が対向に配置されて外囲器が形成される表示パネルにおいて、該電子源基板に形成される配線の上に、非蒸発型ゲッタ (NEG) が断続的に設置されることを特徴とする構成である。

【0 2 3 6】

この構成によれば、配線上などに設置されるNEGの長さが1つの連続対としては短くなるため、膜に発生する応力が大きくなりません。このためNEGの膜剥れが抑制され、画像表示領域内全域でNEGの均一分布の崩れるところなくなり、その結果画像表示装置内の圧力分布を均一に保つことができる。またNEGだけでなくその下に配置された配線ごと剥れ、断線が生じる確率を減らすことができる。さらに剥れたNEGや、完全には剥れていないが部分的にNEG膜が浮いてしまった箇所がきっかけとなり、放電やショートが発生させることも抑制できる。これにより、画像表示装置の形成の歩留まりを高めることも可能となる。

【 0 2 3 7 】

また上記断続的に設置されるNEGの長さが、上記電子放出素子の画素ピッチよりも短いこと、または上記電子放出素子の画素ピッチと同じである構成も取り得る。

【 0 2 3 8 】

表示パネルは2次元に電子放出素子を配置するため、電気エネルギーや信号を供給する配線は、マトリクス配線に代表されるように積層配線が多く交差部分を持つこととなる。交差部分は意図的に平坦化処理を施さなければ段差を持ち、図7 1-(a)の21部に示すようなところは膜応力による断線が発生しやすくなったり、逆に図7 1-(b)の22部に示すように接点でない部分での絶縁が損なわれる危険もある。特に交差部に導電性の材料を厚みを増やして積み重ねる場合にその危険が大きい。NEGは金属でありできるだけ厚みを稼ぐことが望ましいので、配線交差部上のNEGの設置は断線や、上下配線間のショートの原因を高める。

【 0 2 3 9 】

またNEG膜作成プロセス上、配線のような細長いパターン上に連続的に設置する場合には、特にメタルマスクを使ったマスクデポを想定すると、NEG材の回り込みなども予想される(図7 2 (a))。

【 0 2 4 0 】

本構成では、NEGの長さを画素ピッチと同じもしくは短くすることとするため、上記配線の交差部を避けて設置することができ、断線やショートの原因は回避しやすくなる。またメタルマスクを使う場合についても、NEG膜の不連続部にが

マスクの補強パターンを付けたのと同じ効果を発揮することとなり、NEG材の回り込みが避けられる(図72(b))。その結果画像形成装置形成の歩留まりを向上することが可能となる。以下本構成の実施例を挙げる。

【0241】

(実施例1)

図73は、本発明の画像形成装置の構成の一例を模式的に示すものである。1は電子源で、複数の電子放出素子を基板上に配置し、適当な配線を施したものである。2はリアプレート、3は支持枠、4はフェースプレートで、接合部において、フリットガラスなどを用いて互いに接着され、外囲器5を形成している。NEG膜9は、画像表示領域内の、X方向配線(上配線)上のほぼ全面に分割配置されている。

【0242】

電子源1の一部平面図を図74に示す。また、図中B-B'断面図を図75に示す。但し、図74、図75で、同じ記号を付したものは同じ物を示す。ここで81は電子源基板、82は図1のDoxmに対応するX方向配線(上配線とも呼ぶ)、83は図73のDoynに対応するY方向配線(下配線とも呼ぶ)、88は電子放出部を含む導電性膜、89は電子放出部、85,86は素子電極、84は層間絶縁層、87は素子電極85と下配線83と電氣的接続のためのコンタクトホールである。

【0243】

ここでは、X方向配線(上配線)に沿うように、各行に複数個の開口が形成されたメタルマスクを、位置合わせを行いながら電子源基板81上に被せて固定する。開口は長さが6.7mm、幅が240 μ mで、0.89mm間隔でX方向配線の全長に渡るよう設けられている。このマスクを被せた電子源基板81をスパッタリング装置内に設置する。ターゲットにZr-V-Fe=70wt%:25wt%:5wt%の合金を用い、スパッタリング法により、厚さ1 μ mの合金層を形成し、NEG膜810とした。

【0244】

(実施例2)

X方向配線(上配線)に沿うように、各行に複数個の開口が形成されたメタルマスクを、位置合わせを行いながら電子源基板81上に被せて固定する。開口は長

さが $490\mu\text{m}$ 、幅が $240\mu\text{m}$ で、 $200\mu\text{m}$ 間隔でX方向配線の全長に渡るよう設けられている。このマスクを被せた電子源基板81をスパッタリング装置内に設置する。ターゲットに $\text{Zr-V-Fe}=70\text{wt}\%:25\text{wt}\%:5\text{wt}\%$ の合金を用い、スパッタリング法により、厚さ $1\mu\text{m}$ の合金層を形成し、NEG膜1210とした(図76)。

【0245】

(実施例3)

以下の工程により、図73に示す構成に基づく表示パネル用の電子源を作製した。

【0246】

工程-A

まず基板1を洗剤、純水および有機溶剤を用いて十分に洗浄した。ここにスパッタ法によりPtを $0.1\mu\text{m}$ 堆積し、フォトリソグラフィ技術を用いて加工し、基板1上に電極間隔 $L=2\mu\text{m}$ 、長さ $W=300\mu\text{m}$ の素子電極1305,1306を形成した。

工程-B

次にAgペーストインキを印刷、焼成して幅 $270\mu\text{m}$ 、厚さ $8\mu\text{m}$ のY方向配線103を形成した。

工程-C

続いてガラスペーストを印刷、焼成(焼成温度 550°C)して厚さ $20\mu\text{m}$ の SiO_2 層間絶縁膜を形成した。

工程-D

さらにAgペーストを印刷、焼成して幅 $340\mu\text{m}$ 、厚さ $12\mu\text{m}$ のX方向配線102を形成した。

工程-E

実施例1の工程-gと共通。

工程-F

電子源基板1にホトレジスト(AZ4620ヘキスト社製)をスピナーで回転塗布後、X方向配線(上配線)、及びY方向配線(下配線)に沿うように、各行及び各列に複数個の開口が形成されたメタルマスクを、位置合わせしながら電子源基板1301上に被せ、仮固定する。メタルマスクの開口は長さが 6.7mm 、幅が $240\mu\text{m}$ で、 0.8

9mm間隔でX方向配線の全長に渡るよう設けられている。90℃で30分ベークした後、メタルマスクをつけたまま電子源基板1301を露光、現像し、開口部のレジストを除去した。

工程-G

このマスクを被せた電子源基板1 プラズマ溶射装置内に設置する。この装置の粉末供給部(ホッパー)にZr-V-Fe=70wt% : 25wt% : 5wt%の合金からなるゲッタ粉末ST707(サエス社製)を装填し、フローガスをArとしてパワー15kWのArプラズマ中に粉末を供給し、厚さ50 μm のNEG層を形成した。

工程-H

NEG膜を成膜した電子源基板1301を、レジスト剥離液(マイクロポジトリムーバ1165)中に入れ、メタルマスクごと開口部以外のNEGをリフトオフで除去し、NEGパターンニングを行った。

以上により、面内ゲッタを備えた電子源1を形成した。

【0 2 4 7】

(実施例4)

電子源基板にホトレジスト(AZ4620ヘキスト社製)をスピナーで回転塗布後、X方向配線(上配線)に沿うように、各行に複数個の開口が形成されたメタルマスクを、位置合わせしながら電子源基板上に被せ、仮固定する。メタルマスクの開口は、X方向は長さ490 μm 、幅240 μm 、間隔200 μm 、Y方向は長さ250 μm 、幅100 μm 、間隔440 μm である。90℃で30分ベークした後、メタルマスクをつけたまま電子源基板を露光、現像し、開口部のレジストを除去した。

【0 2 4 8】

以上の構成1 2によれば、いずれの場合も膜剥れや上下配線間ショートが殆どなく、画像形成領域内の輝度のばらつきが抑えられた。また放電などによる不良の発生も低減され、表示パネルの歩留まりが向上した。

【0 2 4 9】

(構成1 3)

ゲッタの配置態様の他の例について述べる。本構成は、該非蒸発型ゲッターの断面形状がアーチ状であることを特徴とする。好ましくは上記非蒸発型ゲッター

が、上記電子放出素子に電圧を印加するための走査側配線上あるいは信号側配線上に配置されることを特徴とするものであり、上記いずれの配線巾よりも短い範囲に配置されることを特徴とする。また、上記非蒸発型ゲッターが、走査側配線（上配線）と信号側配線（下配線）とを絶縁するために両者の間に介在する絶縁層よりもアノード側に位置することを特徴とするものであり、上記非蒸発型ゲッターが外囲器内でアノードよりも下部にあることを特徴とするものである。

【 0 2 5 0 】

本構成によれば、電子放出素子およびその近傍から放出されるガスと、電子が衝突する際に画像形成部材から放出されるガスを効率よく吸収できるため、局所的な圧力の上昇を防ぐことが出来る。加えて、配置する非蒸発型ゲッターの断面形状のために、電子ビームの軌道の物理的な障害となることがなく、また、非蒸発型ゲッターの帯電による電子ビームの軌道への影響も最小限にとどめることが出来る。さらに、非蒸発型ゲッターの配置に微妙な位置ずれがあった場合でも、電子ビームの軌道への影響を低減することが出来る。

また、ゲッタの断面形状をアーチ状とすることで、ゲッタ表面の突起部を低減できるので、ゲッタ表面への局所的な電界集中を緩和する作用をも有するので好ましい。

【 0 2 5 1 】

さらには、断面形状がアーチ状のゲッターに加え、ゲッターが配置された配線の断面形状をもアーチ状にすることが好ましい。

この様に、ゲッタおよび配線の断面形状をアーチ状とすることで、ゲッタおよび配線表面の突起部を低減できるので、ゲッタおよび配線表面への局所的な電界集中を緩和する作用が更に増すので好ましい。

また、この様に断面形状を制御する上で、用いるゲッターとしては、成形性の優れる非蒸発型ゲッタを用いることが好ましい。

また、ゲッターの幅は、配線の幅よりも狭くすることが好ましい。これは、配線を形成した後にゲッターを形成するため、ゲッターのアライメント精度を緩和することができるためである。

【 0 2 5 2 】

第 1 の例は、電子源基板の電子放出素子を駆動するために電圧印加するための配線に、Zr を主成分とする合金から成る非蒸発型ゲッターを配置し、その断面形状をアーチ状にするものである。以下図 7 7 を用いて説明する。図 7 7 (a) は本発明の画像形成装置の構成の一例を模式的に示すものである。1 は電子源基板（リアプレートともいう）で、複数の電子放出素子をガラス等の絶縁性基板上に配置し、後述する配線を施したものである。2 は X 方向配線（下配線）で、3 は Y 方向配線（上配線）である。4 は電子放出素子で、素子電極 5、6 との間に形成されている。7 は上配線上に配置した非蒸発型ゲッターである。

【 0 2 5 3 】

電子源基板 1 について、図 7 7 (b) を用いて詳述する。図 7 7 (b) は図 7 7 (a) の電子源基板 1 を模式的に記したものである。X 方向配線 2 と Y 方向配線 3 の間に、両者を絶縁するための層間絶縁層 8 が配置されていることが示されている。

【 0 2 5 4 】

図 7 8 (a) は図 7 7 (b) の、A-A' 面の断面図を示したものである。また、図 7 8 (b) は、電子放出素子の駆動時にフェースプレート 16 に加速電圧を印加した場合の電子ビームの軌道を、X 方向配線 2 を相対的に陽極として駆動した場合を想定して示した模式図である。電子放出素子 4 の電子放出部 9 より放出した電子は、プラス信号電圧を印加する X 方向配線に引き寄せられ、図のような曲線軌道を描くことが知られている。この時、非蒸発型ゲッター 7 の断面形状が矩形であれば、ゲッターのエッジで電子ビームの軌道が妨げられ、フェースプレート 16 に到達して蛍光膜 14 を発光するのに適当でない。また、非蒸発型ゲッター 7 の断面形状が矩形であれば、電子ビームの軌道とプラス電位である非蒸発型ゲッター 7 の距離がエッジ部分で接近し、電子ビームの軌道を電氣的に曲げ、フェースプレート 16 に到達して蛍光膜 14 を発光するのに適当でない。さらに、複数の電子放出素子が配置された電子源基板 1 においては、すべての素子から放出される電子ビームの軌道が非蒸発型ゲッター 7 により障害を受けるのを避けなければならない。製造工程において、同時に非蒸発型ゲッター 7 を作製する場合、1ヶ所の非蒸発型ゲッター 7 の配置位置にずれが生じれば、すべての非蒸発型ゲッター 7 の配置がずれることになり、製造の精度を出すことが困難となる。従って、非蒸発型ゲッ

ター7の断面形状がアーチ状であれば、矩形である場合に比べて、製造の歩留まりが上がることになる。

【0255】

X方向配線およびY方向配線上には、非蒸発型ゲッターが配置される。その断面形状は図78に記したようにエッジ部分が丸みを帯びたアーチ状である。非蒸発型ゲッターとしては、市販のZr系合金（例えば、HS-405パウダー（日本ゲッターズ製）、St-707（SAES製）など）が適用でき、製造時に断面がアーチ状になるよう作製する。

【0256】

（実施例1）

本実施例の画像形成装置は、図77に模式的に示された装置と同様の構成を有し、印刷法で形成したX方向配線（下配線）2、Y方向配線（上配線）3上に非蒸発型ゲッタ（NEG）が配置されている。

【0257】

上配線および下配線の形状に開口を持つメタルマスクを準備し、十分な位置合わせをした後、スパッタリング法によりZr-V-Fe合金を成膜した。準備したマスクの開口部は逆テーパ加工し、作製する非蒸発型ゲッターの断面形状がアーチ状になるようにした。なお、ゲッタ層7の厚さは $50\mu\text{m}$ となるように調整した。以上により、非蒸発型ゲッタを備えた電子源1を形成した。使用したスパッタリングターゲットの組成は、Zr;70%、V;25%、Fe;5%(重量比)である。

【0258】

本実施例では、幅 $280\mu\text{m}$ の配線上に幅 $240\mu\text{m}$ の非蒸発ゲッタを配置した。ここで、該ゲッタと最近接の電子放出素子の電子放出部のうちの一点と交差する接線を有するゲッタ表面の点Aにおいて半径を $2.4\mu\text{m}$ （ゲッタ幅の1%）である円とゲッタの交点B、Cを求め、B-A-Cがなす角である内角をはかったところ、 174 度であった。また、半径を $12\mu\text{m}$ （ゲッタの幅の5%）として前述の内角をはかったところ、 150 度であった。本実施例では、前記点B、Cはゲッタの断面と交差する点であったが、ゲッタが層が薄く、点B、Cがゲッタと交差しない時には、ゲッタ端の接線と前記半径を有する円の交点とを点B

、Cとして内角を求めればよい。

【0 2 5 9】

なお、本実施例では非蒸発型ゲッタの形成方法にメタルマスクを用いたプロセスで説明したが、これに限るものでなく、フォトリソグラフィを用いたパターンニング方法と斜方向から蒸着を組み合わせたものや、ディスペンサーや印刷で接着剤を描画し非蒸発型ゲッタの粉末を接着したもの、メッキ法等を用いて、断面形状をアーチ状に加工しても良い。

【0 2 6 0】

(実施例 2)

図 7 8 の構成について以下の操作でゲッタを作製した。上配線の形状に開口を持つメタルマスクを準備し、十分な位置合わせをした後、スパッタリング法により Zr-V-Fe 合金を成膜した。準備したマスクの開口部は逆テーパ加工し、作製する非蒸発型ゲッターの断面形状がアーチ状になるようにした。なお、ゲッタ層 110 の厚さは $2\mu\text{m}$ とした。使用したスパッタリングターゲットの組成は、Zr: 70%、V: 25%、Fe: 5% (重量比) である。

【0 2 6 1】

(実施例 3)

本実施例では、図 6 6 に示した画像形成装置を作成した。尚、本実施例のゲッタ 9 の断面形状は、実施例 2 と同様アーチ状であり、その製造方法も実施例 2 と同様にして行った。また、本実施例の画像形成装置は、スペーサ 1 5 を有している。また、各電子放出素子を駆動するための配線は、上配線と下配線がマトリクス状に配置されたものである。そして、上記、ゲッターおよびスペーサは、共に、上配線上に配置されている。また、上記配線上に配置したゲッターと同様の製法および形状のゲッターを、フェースプレート側にも配置した。フェースプレート側のゲッタは、各色の蛍光体間混色などを防ぐための黒色部材上に配置した。一方、上記スペーサは、フェースプレートとも接触しており、スペーサの接触位置が、前記黒色部材上になる様に配置してある。尚、ゲッターおよびスペーサの配置位置は、フェースプレート上およびリアプレート上のどちらにおいても、その配置領域が重ならないようにした。

【0262】

本実施例の様に、スペーサを配置することで、より大面積の画像形成装置が実現できる。そして、スペーサが配置された領域を除いた領域にゲッターを配置した理由の一つは、配線上に配置されたゲッター上に、さらにスペーサを配置した場合には、ゲッターの一部がスペーサによって覆われることで、ゲッターの面積が低減してしまうからである。

さらに、本発明のスペーサの形状は、図34に示したように、角がまるまった形状とした。これは、スペーサの角部での電界集中や、角部への応力集中などによる不慮の破損を防止するためである。

以上のような構造をした本実施例の画像形成装置を駆動し、画像を表示させたところ、高輝度で長期にわたり良好な画像が得られた。

【0263】

(構成14)

一方、電子源基板に設ける行(横)方向配線(例えば上配線)及び列(縦)方向配線(例えば下配線)は絶縁層を介した交差部に積層構造を有するものである(図79(a)及び(b)参照)。そこで、縦方向配線(上及び横方向配線が良好な表面形状を有していないと、下配線に生じている凸部が層間絶縁膜を貫通して上配線とショートしたり、フェースプレートとリアプレート間の所望としない放電が発生するという問題が発生する恐れが生じる。そこで、上配線と下配線の表面形状を、 R_a で表わされる表面粗さで、 $0.5\mu m$ 以下、好ましくは $0.3\mu m$ 以下、より好ましくは $0.2\mu m$ 以下、かつ R_z で表わされる表面粗さが $5\mu m$ 以下、好ましくは $3\mu m$ 以下、より好ましくは $2\mu m$ 以下となるように形成するのが望ましい。

【0264】

本発明者らの検討によると、下配線と上配線との交差部における層間絶縁不良(上下ショート)及びフェースプレートとリアプレート間の放電現象は配線の表面において大きな突起があればその発生の可能性があることがわかった。しかし、数百万個所にも及ぶ交差部の全てにわたって突起の有無を検査することは実質的には不可能である。そこで、代わりに何らかの代表的なパラメータを用いた検

査方法で代用することを目的としてさまざまな検討を行ったところ、電極が上記の表面粗さを満たしていることでこれらの問題の発生が有意に低減されることを発見した。なお、 R_a は工業製品の表面粗さを表わす中心線平均粗さであり、 R_z は工業製品の表面粗さを表わす 10 点平均粗さを表わすパラメータである。このような表面粗さを満たすには、導電性ペーストに用いられる導電性微粒子の粒子サイズはおよそ $0.1 \mu m \sim 2 \mu m$ 程度、更に望ましくは $0.3 \mu m \sim 1.0 \mu m$ 程度の粒子サイズで、なるべく球状の形状をしたものを使うことが望ましい。

【0265】

表3にここで用いたペーストを示す。

【0266】

【表3】

表3

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4
粒子形状	球形	球形	球形	球形
$R_a (\mu m)$	0.292	0.268	0.198	0.177
$R_z (\mu m)$	2.854	2.571	1.916	1.884
ショート数	1	1	0	0
	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8
粒子形状	球形	フレーク状	球形	球形
$R_a (\mu m)$	0.161	0.355	0.467	0.367
$R_z (\mu m)$	1.818	3.353	4.122	3.45
ショート数	0	3	5	4

配線の形成はスクリーン印刷方法によった。用いたスクリーン版は、SX300メッシュを使い、乳剤の厚さが $15 \mu m$ の東京プロセスサービス制作のものである。作製したパターンの縦方向配線のピッチは $230 \mu m$ 、 $110 \mu m$ 幅で 720 本、横方向配線のピッチは $690 \mu m$ 、 $240 \mu m$ 幅で 480 本形成し、その後 $400 \sim 520^\circ C$ の焼成温度で焼成した。

【0267】

層間絶縁層としては、ノリタケカンパニーリミテッド社製 NP-7730 ペーストを用い 3 回印刷、焼成を繰り返して、配線間の交差部においては膜厚がおよ

そ16～20 μm であった。このような構成において、縦方向配線と、横方向配線の交差部の数は34万5600個所である。絶縁層の信頼性、すなわち上下ショートをチェックには自作のマトリックスチェッカーを用いてすべての交差部における上下ショートの有無を約30分でスキャンしてチェックできる装置を用意した。表に示したとおり、 R_a が0.3 μm 以下、 R_z が3 μm 以下の場合に上下ショートが非常に少なく、更に R_a が0.2 μm 以下、 R_z が2 μm 以下の場合上下ショートが全くなくなっており、配線の層間絶縁の信頼性が向上しているのがわかる。

【0268】

一方、白金で素子電極がフォトリソグラフィ方法によって形成されたガラス基板を用意し、これに上記の実施例4のペーストを使用して縦方向配線、層間絶縁層、横方向配線をこの順に形成した。このときに得られた縦方向配線及び横方向配線の R_a は0.211、 R_z は2.286であった。

【0269】

このような配線の表面粗さを制御する構成によれば、電子放出素子を駆動するために配線の信頼性を高める、すなわち上下配線間でのショートをなくして製造歩留まりを向上させることができた。また、表示パネルの輝度を上げるために安定したアノード電圧(V_a)を上げることができる。

【0270】

(構成15)

電子源基板に設けられる電子放出素子としては、対向する1対の素子電極間を連絡する導電性薄膜に電子放出部を形成した構成のものが好適に利用され、この一対の素子電極がそれぞれの配線、例えばその一方が列方向配線と、他方が行方向配線と接続される。そのような電子源基板の構成として、全ての電子放出素子が行方向配線及び列方向配線により囲まれた構成をとることができ、この構成によって電子源基板における帯電量をより均一化することができる。

【0271】

また、ここで、行方向配線が複数本の列方向配線により囲まれ、かつ列方向配線が複数本の行方向配線により挟まれる領域を交差領域と定義する。

この際に、各素子を列方向配線および行方向配線で囲む構成に加え、上記交差領域外に配置された行方向配線または列方向配線の少なくとも一方の配線幅を、上記交差領域内の行方向配線または列方向配線の幅よりも広くすることで、電子源基板の帯電量をより一層均一化することができるので好ましい。

【0272】

また、図98、99などに示すように、上記交差領域外の行方向配線および列方向配線の双方の幅を上記交差領域内の行方向配線または列方向配線の幅よりも広くすることがさらに好ましい。

【0273】

図80に示した様に本構成の電子源は、表面伝導型電子放出素子を複数並べ、マトリクス状の配線で各々接続された構成（ここでは不特定の9つの電子源のみ図示。）とする電子源である。本構成では図80の行配線X1および列配線Y1に接続するの電子放出素子において、その外側の基板面露出部の帯電量が内側となるX2,X3及びY2,Y3に接続する電子放出素子と同等となるよう冗長の行方向配線X0、列方向配線Y0および電極102'、103'を設け、すべての電子放出素子が行方向（X）配線、及び、列方向（Y）配線で囲まれた構成としたことが特徴となっている。ここで好ましくは該冗長配線に接続した電極には該電子放出部を有する導電性薄膜は設けない構成とする。これは不必要な素子電流を浪費しないためである。更に好ましくは、上記冗長配線Y0は隣接した電子放出素子から放出された電子の軌道が他の2素子と同じになるよう、上記配線Y1,Y2,Y3と同一の形状とすることで素子周囲の電位分布を同等となるようにする。X0についても同様X1,X2,X3と同一形状とする。

【0274】

以下、図面を参照しながら本構成の製造手順の一例を説明する。図81（a）～（f）に本発明の製造工程を表わす上面図を示す。図81（a）～（f）では不図示の基板上に対して電子源を3×3個、計9個を行列状にマトリクス配線した例を示す。図中、202,203は一对の素子電極、206は第一の配線層である列方向配線、208は列方向配線206と第二の配線である行方向配線207との層間絶縁膜、207は第二の配線層である行方向配線、204は電子放出部形成用の膜である。209は

第二の配線層207と電極202とを接続するため、絶縁層208に形成された窓である。

【0275】

先ず、予め洗浄された基板に、オフセット印刷法を用いて素子電極のパターンを印刷し、続いて焼成することにより、一対の素子電極202,203を形成する（図81（a））。本素子電極は電子放出部薄膜と配線とのオーム接触を良好にするために設けられるものである。通常、電子放出部薄膜は、配線用の導体層と比べて著しく薄い膜であるために「ヌレ性」、「段差保持性」等の問題を回避するために設けているものである。素子電極の形成方法としては、蒸着法、スパッタリング法、プラズマCVD法等の真空系を用いる方法や、触媒に金属成分及びガラス成分を混合した厚膜ペーストを印刷、焼成することにより形成する厚膜印刷法がある。ここで電子放出部形成用の導電性薄膜を該電極上に形成するには電極エッジのステップカバレッジを良くするため、電子放出部近傍の素子電極は膜厚が薄い方が望ましい。そこで、厚膜印刷法を用いる場合はその際、使用するペーストとして、有機金属化合物により構成されたMODペーストを使用することが望ましい。もちろん、これ以外の成膜方法を用いても差し支えなく、また構成材料として、電気伝導性のある材料であれば、特に限定されるものではない。

【0276】

ここで本発明の特徴である第一の配線層206と、下配線である第一の配線層206の取り出し部（列端子部）と、上配線である第二の配線層207の取り出し部（行端子部）とを同時に形成する（図81（b））。第一の配線層206の形成で、列方向配線は電子放出素子の電極203に接続形成されるもの以外に端の素子で片側に配線が形成されていない（ここでは左端の素子列）領域に冗長配線Y0および冗長電極202',203'を設ける。この冗長配線は1列だけに限るものではなく複数設けても構わない。

【0277】

尚、配線層の形成方法には、素子電極部分とは異なり、膜厚が厚い方が電気抵抗を低減することができ有利である。特に電子放出素子数が多く形成される画像形成装置においては、単層で比較的厚い膜が得られる、厚膜ペーストを用いた厚

膜印刷法を用いるのが適当である。もちろん、電子放出素子の数、密度等により薄膜配線の適用も可能である。厚膜印刷法としてスクリーン印刷法を用いた場合、好ましくは上記冗長の列配線Y0の下に上記素子電極で列配線Y0に接続する側の電極を連結させて1列連続した線状に形成することもできる。

【0278】

次に層間絶縁膜208を形成する。(図81(c))この層間絶縁膜208は列方向配線と行方向配線の交差する部分に形成した。この層間絶縁膜208の構成材料としては、通常絶縁性を保てるものであれば良く、例えば、SiO₂薄膜や金属成分を含まないPbOを主成分とした厚膜ペーストによる膜等である。

【0279】

次に、本発明の特徴である第二の配線層を形成する。(図81(d))第二の配線層207の形成で、行方向配線は電子放出素子の電極203に接続形成されるもの以外に端の素子で片側に配線が形成されていない(ここでは上端の素子列)領域に冗長配線X0および冗長電極202^{*}, 203^{*}を設ける。この冗長配線は1行だけに限るものではなく複数設けても構わない。更に、後述するように行列状にマトリクス配線された表面伝導型電子源群を一行ずつ順次駆動する走査信号が印加される方法で電子源を駆動する場合、少なくとも上記冗長配線は隣接する配線X1以外の配線と接続する。

【0280】

次に、各電極202、203間をつなぐ様に、導電性膜204を形成する。導電性膜は、有機金属錯体溶液をインクジェット法により付与し、焼成することで形成する(図81(e))。かかるインクジェット法による付与は、例えば特開平8-273521号公報、特開平8-277294号公報、特開平9-69334号公報などに開示されている。

以上の工程でフォーミング前の電子源基板が形成される(図180)。図180では、図81に示さなかった、取り出し部が示してある。この様に、電子源基板に形成される各部材を印刷法により形成することで、より低コストで形成することができる。

本構成の冗長配線X0は上記Dox1乃至Doxmのいずれか1つと接続し、Y0は上記Do

y1乃至Doynのいずれか1つと接続する場合もあるし、外部端子Dox0、Doy0として外部で電位規定する場合もある。

【0281】

更に、図82に示すように各電子放出素子を配線で区画される領域に配置し、更に、X方向配線の取り出し部をY方向配線と同時に印刷形成し、絶縁層を交差部に設けた後、X方向配線の1つおきの所定配線（図ではX0とX2）を結線する配線162'をX方向配線の印刷形成時に同時形成することもできる。

以上の様に、図80に示した冗長電極102'、103'、或いは図82に示した、各配線を表示装置外部の駆動回路に接続するための取り出し部（引き出し電極）などの電位規定部材を、前記交差領域外の基板表面に配置することが基板表面の電位を規定する上で好ましい。

しかも、上記電位規定部材を各配線に接続すれば、電位規定部材専用の電源を用意しなくて済むのでより好ましい。

【0282】

以下本構成の実施例等について説明する。

【0283】

実施例1、比較例1

本発明の第1の実施例として、平面型の表面伝導型放出素子を多数単純マトリクス配置した図83のような電子源基板の構成を用いて、電子源を構成した。本実施例では、行方向配線(X配線)1ライン毎に、120個の素子が並び、また、列方向配線(Y配線)1ライン毎に、80個の素子が並んでいる電子源基板を用い、画像形成装置を作成した。そのため、後述する、Dxmのmは80、Dynのnは120である。本実施例にかかる複数の電子放出素子がマトリクス配線された基板1の一部の平面図を第84図に示す。また、図中のA-A'断面図を第85図に示す（図中、電子放出部5は省略する）。

【0284】

本実施例にかかる電子源の製造工程を、第86図、第87図に示す。但しこれらの図中で同じ符号を付したものは同じ部位を示す。ここで141は層間絶縁層、142はコンタクトホールである。以下に当該工程を説明する。

工程-a

清浄化した青板ガラス上に、厚さ $0.5\mu\text{m}$ のシリコン酸化膜をスパッタ法で形成した基板1上に、真空蒸着法により、厚さ 5nm のCr、厚さ 600nm のAuを順次積層した後、フォトレジスト(AZ1370/ヘキスト社製)をスピナーにより回転塗布、ベークした後、フォトマスク像を露光、現像して、下配線72のレジストパターンを形成し、Au/Cr堆積膜をウェットエッチングして、所望の形状の下配線72を形成した(図86(a))。

【0285】

ここで本発明の特徴となる冗長配線としてY0を設けておく。

工程-b

次に、厚さ、 $1.0\mu\text{m}$ のシリコン酸化膜からなる層間絶縁層141をRFスパッタ法により堆積した(図86(b))。

工程-c

工程-bで堆積したシリコン酸化膜にコンタクトホール142を形成するためのフォトレジストパターンを作り、これをマスクとして層間絶縁層141をエッチングしてコンタクトホール142を形成した。エッチングは CF_4 と H_2 ガスを用いたRIE(Reactive Ion Etching)法によった(図86(c))。

工程-d

その後、素子電極2、3と素子電極間ギャップとなるべきパターンをフォトレジスト(RD-2000N-41/日立化成社製)で形成し、真空蒸着法により、厚さ 5nm のTi、厚さ 100nm のNiを順次堆積した。上記フォトレジストパターンを有機溶剤で溶解し、Ni/Ti堆積膜をリフトオフし、素子電極間隔Lが $20\mu\text{m}$ 、幅Wが $300\mu\text{m}$ の素子電極2、3を形成した(図86(d))。

工程-e

素子電極2、3の上にX方向配線となる上配線73フォトレジストパターンを形成した後、厚さ 5nm のTi、厚さ 500nm のAuを順次真空蒸着により堆積し、リフトオフにより不要な部分を除去して、所望の形状の上配線73を形成

した(第87図(e))。ここで本発明の特徴となる冗長配線X0を設けておく。

工程-f

膜厚100nmのCr膜を真空蒸着により堆積・パターニングし、そのうえに有機Pd(ccp4230奥野製薬(株)社製)をスピナーにより回転塗布、300℃で10分間の加熱焼成処理をした。また、こうして形成された導電性薄膜4の膜厚は10nm、シート抵抗値は $5 \times 10^4 \Omega/\square$ であった。その後、Cr膜および焼成後の導電性薄膜4を酸エッチャントによりエッチングして所望のパターンを形成した。

工程-g

コンタクトホール142部分以外にレジストパターンを形成し、真空蒸着により厚さ5nmのTi、厚さ500nmのAuを順次堆積した。リフトオフにより、不要な部分を除去する事により、コンタクトホール142を埋め込んだ(第87図(g))。

【0286】

次に、以上のようにして作製した未フォーミングの電子源を用いて電子源を構成した。以下第83図を用いて説明する。まず、基板71上に下配線72、層間絶縁層(不図示)、上配線73、素子電極75導電性膜74を形成した。上述のようにして多数の表面伝導型電子放出素子74を設けた電子源基板を真空容器に装着した。

工程-h:

本実施例のフォーミング工程では、第88図に模式的に示した真空処理装置を用い、Y方向配線をグランドに接続した共通電極に接続し、X方向配線(上配線)のそれぞれに印加される電圧パルスのパルス幅が1msec、パルス間隔が240msecとなるようにした。パルスにより、パルス幅1msec、パルス間隔3.3msecのパルスを生成し、スイッチング装置により1パルス毎に電圧を印加するX方向配線を1ラインずつ隣に切り替えることを繰り返した。

【0287】

パルス波高値は11V、パルス波形は矩形波とした。また、フォーミング処理中、表示パネル全体を50℃に保持し、パルス印加と同時に実施例1の工程(3

）と同様に H_2 と N_2 よりなる混合ガスを導入した。

工程-I:

次に活性化工程を行う。雰囲気を形成する有機物質のガスとしてはベンゾニトリルを用い、分圧としては 1×10^{-6} Torrに制御し、パルスの印加の仕方は上記フォーミング工程と同じであるが、全てのX方向配線に対して同時に処理を行うことができないので、X方向配線10ラインを1ブロックとし、1ラインに1パルスずつ順番に10回の印加を行うことを繰り返し1ブロックを活性化終了し、これを残りのブロック分順次処理を行って完了した。ラインに印加されるパルス幅は1msec、パルス間隔が10msecとし、パルス波形は矩形波とし、16Vの波高値とした。

【0288】

その後、基板全体を 300°C に保持しながら排気を続け、真空チャンバー内の圧力が 1×10^{-5} Pa以下で室温に降温し、高圧端子（第4図の407）を通じて71-ド電極に1KV印加し、各素子に15Vの駆動パルスを印加して電子放出量Ieとバラツキの標準偏差 σ を、特に注目する冗長配線と隣接する配線に接続する素子について測定したところ以下の結果となった。

【0289】

ここで比較例1は上記冗長配線X0、Y0が設けられていないこと以外は同じ構成で同じ工程を用いて作製した電子源である。

【0290】

【表4】

表4

	Y1ラインの平均のIe	σ_{y1}	X1ラインの平均のIe	σ_{x1}
実施例1	1.8 μA	0.1	1.8 μA	0.1
比較例1	2.0 μA	0.4	2.1 μA	0.5

以上の結果から、冗長配線により電子放出量の均一性が向上した。

【0291】

（実施例2、3、比較例2）

本構成の第2、3の実施例として、平面型の表面伝導型放出素子を多数単純マトリクス配置した図17のような電子源を印刷配線用いて形成し、これを画像形

成部材と組み合わせて画像形成装置を構成した。

【0 2 9 2】

以下、第 8 9 図を利用して本実施例の構成、製造手順を説明する。

【0 2 9 3】

実施例 2

(a) ~ (f) に本実施例の製造工程を表わす上面図を示す。(a) ~ (f) では不図示の基板に対して電子源の一部として画像形成領域の角に位置する 3 × 3 個、計 9 個を行列状にマトリクス配線した部分を示す。図中、202, 203 は一対の素子電極、206 は第一の配線層、208 は第一の配線と第二の配線との層間絶縁膜、207 は第二の配線層、204 は電子放出部形成用の膜である。全体の素子は行方向に 720、列方向に 240 並んだ構成とした。

【0 2 9 4】

先ず、予め洗浄された基板（ここでは、ソーダライムガラス基板を使用）に、素子電極の印刷、焼成を行い、一対の素子電極 202, 203 を形成する。（第 8 9 図 (a)）本実施例では、膜の成膜方法として厚膜印刷法を使用した。ここで使用した厚膜ペースト材料は、MOD ペーストで金属成分は Au である。印刷の方法はスクリーン印刷法を用いた。所望のパターンに印刷の後、70℃で10分乾燥し、次に本焼成を実施する。焼成温度は550℃で、ピーク保持時間は約8分である。印刷、焼成後のパターンは片側の素子電極 203 が 350 × 200 ミクロン、片側の素子電極 202 が 500 × 150 ミクロンと左右非等長のパターンを形成し、膜厚は ~ 0.3 ミクロン、素子電極 202, 203 の間隔は 20 μm とした。

【0 2 9 5】

次に第一の配線層を形成する。（図 8 9 (b)）第一の配線層 206 の形成では Y 方向配線を全パターン形成し、Y 方向配線は素子電極 203 に接続形成される。本実施例では、第一の配線層 206 の形成方法として厚膜スクリーン印刷法を用いた。ペースト材料は酸化鉛を主成分とするガラスバインダーに導電性材料の微粒粉を混合したものである。本実施例では、導電性材料が Ag のペーストを使用した。所望のパターンでスクリーン印刷を行い、110℃で20分の乾燥を行った後、550℃、ピーク保持時間 15 分の焼成を行って第一の配線層 206 である幅 100

ミクロン、厚み 1 2 ミクロンの Y 方向配線を得た。ここで本発明の特徴である第一の配線層 206 を形成する。(第 8 9 図 (b)) 第一の配線層 206 の形成で、列方向配線は電子放出素子の電極 203 に接続形成されるもの以外に端の素子で片側に配線が形成されていない左端の素子列に隣接して冗長配線 Y0 および冗長電極 2 0 2'、2 0 3' を設けた。

【0 2 9 6】

ここで上記冗長の列配線 Y0 の下に上記素子電極で列配線 Y0 に接続する側の電極が連結し、第 8 9 図 (a) に示したように 1 列連続した線状に形成しておいた。

【0 2 9 7】

ここで層間絶縁膜 208 を形成する。(第 8 9 図 (c)) この層間絶縁膜 208 は X 方向配線と Y 方向配線の交差部する部分に形成し、この層間絶縁膜 208 の構成材料としては、金属成分を含まない PbO を主成分とした厚膜ペーストを用いた。

【0 2 9 8】

該絶縁層 208 の形成方法は厚膜スクリーン印刷法を用いた。所望のパターンでスクリーン印刷を行い、1 1 0℃で 2 0 分の乾燥を行った後、5 5 0℃、ピーク保持時間 1 5 分の焼成を行って 5 0 0 × 5 0 0 ミクロン、厚み ~ 3 0 ミクロンの層間絶縁膜 208 を得た。

【0 2 9 9】

次に、第二の配線層 207 を形成する。(第 8 9 図 (d)) 第二の配線層 207 の形成では第一の配線層 206 とは逆に X 方向配線を全パターン形成し、X 方向配線は素子電極 202 に各々接続形成される。形成方法は第一の配線層 206 と同様の厚膜スクリーン印刷法を用いた。使用した厚膜ペースト材料は、第一の配線層 206 と同じく A g ペーストで金属成分は A g である。所望のパターンでスクリーン印刷の後、1 1 0℃で 2 0 分の乾燥を行った後、5 5 0℃でピーク保持時間 1 5 分の焼成を行って、第一の配線層 206 上に第二の配線層 207 である幅 1 0 0 ミクロン、厚み 1 2 ミクロンの X 方向配線を得た。このように第二の配線層の形成により X 方向配線と Y 方向配線が互いに絶縁された複数 (2 層) の層からなるマトリクス配線が完成した (図 8 9 (d))。

【0 3 0 0】

以上で、マトリクス配線の部分が完成したわけであるが、ペースト材料、印刷方法等はここに記したものに限るものではない。最後に電子放出部形成用の導電性薄膜204を形成する。(第89図(e))電子放出部形成用の膜204(表面伝導型電子源)の形成方法は、以下に説明する液滴付与方法を用いた。

【0301】

液滴を液滴付与装置により該素子電極上に付与するわけであるが、液滴の基になる溶液は水、金属化合物および有機溶媒からなり液滴を生じさせる粘度のものが用いられ、本実施例では金属化合物の金属成分としてはPdを用い、液滴付与装置としてはインクジェット装置、本実施例ではバブルジェット方式の装置をもちいた。焼成は300℃で10分間行い、膜厚としては100Åとなるよう吐出液滴量を調整し、シート抵抗は、 4×10^4 となる膜を形成した。

【0302】

本図では、9素子部分のみを図示したが、これをX方向720列、Y方向240列に同時に形成する事で複数層から成る単純マトリクス方式による電子源基板の構成が完成した。次に、以上のようにして作成した表面伝導型電子源を有する電子源基板を用いて表示パネルを構成した。更に、本構成の特徴である冗長の行配線X0,列配線Y0は容器外端子Dx0,Dy0を通じて接地し、電位を規定した。

【0303】

(実施例3)

図90に示したように冗長の配線を2ラインもうけ、印刷断線の影響を少なくしたもので製造の工程、構成部材は実施例2と同じにした。ただし、冗長配線の下の電極を連結して線状のパターンを設けることはしなかった。冗長配線X0,X0'およびY0,Y0'は容器内で接続させ、容器外端子Dx0,Dy0を通じて接地し、電位を規定した。

【0304】

比較例2は冗長配線を設けずに構成した画像形成装置で製造工程は実施例2と同じ条件としたものである。

これらの構成を用いた場合に得られた結果を以下に示す。

【0305】

【表 5】

表5

	Ie (Y1)	σ_{y1}	Ie (X1)	σ_{x1}
実施例2	1. 7 μ A	0. 1	1. 7 μ A	0. 1
実施例3	1. 6 μ A	0. 1	1. 6 μ A	0. 1
比較例2	1. 9 μ A	0. 35	2. 0 μ A	0. 4
	輝度 (Y1)	σ_{y1}	輝度 (X1)	σ_{x1}
実施例2	4000cd	150	4100cd	160
実施例3	3900cd	130	3900cd	145
比較例2	3700cd	500	3800cd	540

上記のように素子近傍に冗長配線を設けることで電子源としての均一性が向上し、輝度のバラツキも減少した。ここで輝度の平均値が減少したのは電子ビームの形状が電位分布により変形し、フェースプレートのブラックストライプに照射される割合が増加し、光に変換される効率が低下したためである。

【0 3 0 6】

(実施例 4)

上記実施例では冗長配線を容器外端子を通じて電位規定していたが、この実施例では容器内部で行方向の冗長配線は電子放出素子に接続する行配線のいずれか 1 つ、ここでは一つ置いて隣の配線と接続し、列方向の冗長配線は隣接する列配線と接続したことが特徴である。図 9 1 に示したように該冗長行配線 X0 と隣接する行配線の一部に絶縁層 161 を形成し、その後第三の配線として該冗長配線 X0 と 1 つ置いて隣の行配線 X2 とを接続する形で 162 を形成した。

【0 3 0 7】

以上の構成を採用することにより、上記冗長配線を設けたことで配線に挟まれていない電子放出素子がなくなり、素子周辺の帯電状態がすべての素子で同等となったため、上記現象と対応して電子源として以下ような効果が得られた。

- (1) 電子放出特性の均一性が向上。
 - (2) 電子ビームの形状の均一性が向上。
 - (3) 電子放出特性および電子ビームの形状の時間的変動が減少。
 - (4) 帯電量が減少し、電極、配線との放電による電子源の劣化が無くなった。
- すなわち、上記電子源を用いた画像形成装置では輝度の均一性が増し、より高画質な特性が実現できた。

【0308】

(構成16)

一方、表示パネルにおける配線取り出し部の構成としては以下の構成をとることができる。すなわち、行方向又は、列方向の取り出し配線部の長さを最適化し、画像表示部の周辺部をできる限り狭くした構成を提供するものである。以下のこの構成における実施例を挙げる。

【0309】

(実施例1)

次に、図92の一形体である表面伝導型放出素子を用いた表示パネル（画像表示装置）は、取り出し配線部の長さを具体的に説明するためにフレキケーブルを実装する前のパネルの一部分を平面上に示した図である。1は画像表示装置の表面伝導型放出素子と、行方向と列方向の配線が印刷配線によって形成されている素子基板、2は、素子基板1に対して対向する位置に配置されて、蛍光体とアノード電極が平面上に配置されたフェイスプレートで、3は、表面伝導型放出素子がマトリクス配線上の交点に配置された画素部で、4は、列方向配線を複数のブロックに分割してフレキケーブル（不図示）と圧接するために印刷配置された列方向側の一ブロックの取り出し配線、5は4と同様に行方向配線を複数のブロックに分割してフレキケーブル（不図示）と圧接するための印刷配置された一ブロックの取り出し配線で、6は、画像表示を行った時に画素部から放出されるガスを吸着するためのゲッタ部材、7はフェイスプレートと素子基板1とを真空封止するために用いられる枠を示す。次に、Lは本実施例1で求められた取り出し配線長を示し、11は画素部3からの沿面放電に対して考慮されて配置されたゲッタ6までの距離、12は、真空封止を行うために構成された枠の幅で、12外形部がフェイスプレート2の外形部となる。

【0310】

13はフレキケーブルと圧接実装するためのフレキ接合部の長さ、14は、素子基板の外形部から印刷配線がされているまでの距離、15は、素子基板上に印刷配線される時の印刷角度と、取り出し配線を複数のブロックに分割した時の一ブロック内での長さ17とブロック間とのクリアランス量16から決定される長さである。

【0311】

取り出し配線長を最適化するにあたって、実施例1では行方向配線側と列方向配線側との取り出し配線長を同じとした。その理由として画素部3から素子基板1までの幅を同じにすることでフレキケーブルの実装後のパネル組み立て部材等が、同一仕様で構成することができるためコスト等の低減につながるためである。従って、取り出し配線長の説明に対しては列方向配線側で行うこととする。行方向配線側、列方向配線側の取り出し配線長は、同じ長さに限定されるものではなく、パネルの設計上からそれぞれの長さを変えても良い。

【0312】

次に、取り出し配線長 L を決定するにあたって詳細に説明する。配線長 L は、11~17によって決定される。まず11は、前述したように画素部3からゲッタ6までの距離である。ゲッタ6は画像表示を行った時に画素部から放出されるガスを吸着するための部材であり、表示駆動を行った場合にフェイスプレート2の蛍光体に表面伝導型放出素子からの放出電流による電子が衝突した際に発生するガスを吸着し、パネル内は常に一定の真空度（約 $10E-5$ torr 近辺）が維持される。ゲッタ部材は一般的には金属材料等で構成されており、例えば、素子基板1上の取り出し配線上とフェイスプレート2の空間上に配置されたワイヤ状の形状で構成されている。パネル内に金属部材が配置されていることに対する問題点として、フェイスプレート2に印加されている高圧電圧（アノード電圧）との沿面放電がある。沿面放電は、ゲッタ部材を画素部3に近接するほど起こりやすく、又アノード電圧値に依存する。従って、最低限沿面放電を回避するためにはある程度画素部3からの距離をおくことが必要とされる。本実施例1では11は実験的に確認された値を用いており、少なくとも4mm以上（アノード電圧12kv）の距離をおいていることとする。次に12である。まず、フェイスプレートと素子基板1とを真空封止するために用いられる枠7について説明する。枠7はパネル内の真空度に対して、外部（大気中）からのスローリークを防止する目的と、パネル作製工程において工程中に行われるベーキング等に熱処理時でのパネルの熱応力による変形を防止するためのものである。枠部材は、主として接着材系が用いられている。スローリークは、フェイスプレート2と接着材との界面状から起こるものと考えられ

ており、スローリークを回避するための枠部の幅は約3mm~10mm程度の幅をもつことが必要とされることが判っている。従って本実施例1では、熱応力による変形防止をも考慮して、12の枠7の幅を少なくとも5mm以上であることとした。

【0313】

次に、フレキケーブルとの接合部である13について説明する。表示装置として外部の表示回路との接続を行うためのフレキ接合部は、フレキケーブルとの接触抵抗が重要となってくる。特に行方向配線側では表面伝導型放出素子が複数接続されていることから数Aの電流値が流れる。従って取り出し配線とフレキケーブルとのアライメント不良によって接触位置のずれが生じ接触抵抗が不安定となったり、又接触抵抗値が高くなったりした場合には断線や接触部での電圧降下という問題がおき、表示駆動に対して画質の低下やライン欠陥を及ぼすことになる。以上のような問題を無くし信頼性を高める方法としては、本実施例1ではACF（異方性導線膜）などの技術を用いてフレキケーブルとのコンタクトを行っている。

【0314】

更に、本実施例1ではフレキ接合部13上にはパネル作製工程のなかでプローブ等を使用したプロセスにも対応できる様にしている。例えば第1図形体での作製工程が終了した時点で、行、列の各配線の隣接間ショートをチェックする場合には、フレキ接合部上のいずれかの位置にプローブ等の接触部針をコンタクトして計測を行うことが可能となる。以上の様にフレキ接合部13は、フレキケーブルとの接触安定性と他の工程でのチェック用のコンタクト部も含めて、5mmと設定した。14は、素子基板の外形部から印刷配線がなされているところのクリアランス量で、印刷装置で決定されてくる量であり、実施例1では2mmとなっている。

次に、15は前述したように、取り出し配線の一ブロック内の長さ17とブロック間とのクリアランス量16と、印刷配線での印刷方向における印刷角度 θ によって決まる。これら具体的に説明するために図93を用いる。図93(a)は、図92のパネルの一部を列方向配線部に対して拡大した図で、特に列方向の取り出し配線4の部分でフレキケーブルが実装された状態が示されている。また、わかりやすくするため、左側の取り出し配線の2ブロックは、フレキケーブルの実装図は省き、図93(b)に2ブロック間でのクリアランス部分の拡大図を示した

。更に、 $l9 > l8$ とした場合でのフレキ接郷部を示した。1、4は図92で説明した素子基板と列方向配線の取り出し配線、8は取り出し配線の1ブロックに対応したフレキケーブル、18は画素部の列方向の全長を示し、19は列方向のフレキ接合部の全長、110は18の画素部の長さに対して19のフレキ接合部がはみ出す場合の片側の長さである。又、111はフレキケーブル8が取り出し配線4に対してアライメントマーク9によって位置あわせ後、圧接されたときの片側のはみ出し量で本実施例1では $l11 = 2.5\text{mm}$ とした、112はブロック間に圧接されたフレキケーブルのマージン量を示し、マージン量はフレキケーブル実装時での装置からある決められてしまうもので、数mm程度必要とされ実施例1では $l12 = 3\text{mm}$ 以上と設定した。通常、フレキケーブルによって配線の接合を行う場合フレキ接合部は、画素内の配線ピッチよりも配線ピッチを細くし、実装密度をあげているのが一般的である。又、フレキ接合部の全長19は、フレキ接合部とブロック間ごとのフレキケーブルのクリアランス16によって決まるため、高精細のXGA等の表示装置では $l9 > l8$ となり、比較的画素数が少ない場合は、 $l9 < l8$ になる場合が多い。次に、19を求めるための計算を行うと、まず1ブロック間のピッチ Bp は、1ブロック間内の本数 X とし、配線ピッチ P とした時に、

$$Bp = X * P + l6 \cdots \textcircled{1}$$

として求められ、次に、列方向配線数 Dyn とした時の全ブロック数 Bn は、

$$Bn = Dyn / X \cdots \textcircled{2}$$

として求められる。そして①、②より19は

$l9 = Bn * Bp$ (ブロック数 * ブロック間ピッチ) によって求められる。次に、18を求める計算としては、画素部3内の画素ピッチ Pn と列方向配線数 Dyn から $l8 = Pn * Dyn$ として求められる。

【0315】

次に、上記に示した計算により110は $l10 = l9 - l8 / 2$ を求める。110がプラスとなる場合には、フレキ接郷部の両端は画素部3からはみ出し、マイナスとなる場合にはフレキ接合部の両端は画素部3内に配置されることとなる。

通常ブロック間内の配線ピッチ P は、画素内でのピッチ Pn よりも高精細に形成されているため、フレキ圧接部の長さ17を長くすることによって18と19はほぼ同

じ長さもしくはそれ以下で構成されることが可能である。実際には、フレキケーブルのピッチ間精度、フレキケーブルの圧接時でのアライメント精度、又圧接を行う装置の問題、更にはフレキケーブルを表示回路系に接続する場合に用いるコネクタ等のピン数の制限などを考慮すると、17の長さは実際にはある程度限定されるのが現状である。

【0 3 1 6】

上記計算から、110の値が極端にプラスもしくはマイナスとなった場合、すなわちフレキ圧接部のトータルの長さが、画素部3の長さに対して差が大きくなるような条件で配線ピッチが設定された場合には、クリアランス16の値を変えたり1ブロック内の本数Xを変えて最適値となる15を計算し、18と19との差をできる限り近づける様な設定にするのが望ましい。

【0 3 1 7】

次に、15を求めるには、印刷配線での印刷方向における印刷角度 θ と前述した110によって求めることができる。印刷角度 θ は、印刷時に使用されるメッシュの角度で決定される、例えばメッシュ角度に対してそれより大きい角度を持った配線パターンを印刷しようとしても、メッシュ上からのペーストの吐出不良や干渉によって配線の断切れが発生したりする。本実施例1では上記の条件より印刷角度 θ は約25度とされている。以上より、15は以下の計算によって求めることができる。

$$15 = 110 / \tan \theta \quad (\theta = 25 \text{度}) \cdots \textcircled{3}$$

上記示した①～③において、①でフレキ接合部の1ブロック間の配線数Xとブロック数とブロック間のクリアランス量16、②においては画像表示装置の大きさと画素数等が支配的であることから、以下に示した表で各画像表示装置の仕様と取り出し配線部の仕様を変えたときの15の最適値を求めた。尚15の値は列方向配線側で算出するが、行方向配線側についても同様な計算によって求められるものである。

【0 3 1 8】

なお、 θ は45度未満に設定することができる。

【0 3 1 9】

【表 6】

画像表示仕様

画像表示仕様	素子数(列×行)	配線ピッチ(列×行)mm	B(mm)
30"VGA	2560×1600	0.23×0.67	742
42"XGA	4096×2304	0.23×0.69	932
60"HD	5760×1080	0.23×0.69	1324

1. 30"VGA仕様

画素内配線数D_{in} 2560

画素内配線ピッチP_{in} 0.29

フレキシ間 B=8

ブロック内配線ピッチP 0.2

印刷角度 θ=25

ブロック間本数	ブロック間ピッチB _o (mm)	全ブロック数B _n	B(mm)	B _o (mm)	H0(mm)	B _o (mm)
40	16	64	1024	742	141	302
80	24	32	768	742	13	28
160	48	16	640	742	-51	-108
320	72	8	576	742	-63	-178
640	136	4	544	742	-99	-212

フレキシ間 B=15

ブロック間本数	ブロック間ピッチB _o (mm)	全ブロック数B _n	B(mm)	B _o (mm)	H0(mm)	B _o (mm)
40	23	64	1472	742	365	783
80	31	32	992	742	125	269
160	47	16	752	742	5	11
320	79	8	632	742	-65	-118
640	143	4	572	742	-85	-182

2. 42"XGA仕様

画素内配線数D_{in} 4096

画素内配線ピッチP_{in} 0.23

フレキシ間 B=8

ブロック内配線ピッチP 0.2

印刷角度 θ=25

ブロック間本数	ブロック間ピッチB _o (mm)	全ブロック数B _n	B(mm)	B _o (mm)	H0(mm)	B _o (mm)
40	16	102	1627	932	348	745
80	24	51	1239	932	144	309
160	48	25	1017	932	43	91
320	72	13	915	932	-9	-16
640	136	6	864	932	-34	-72

フレキシ間 B=15

ブロック間本数	ブロック間ピッチB _o (mm)	全ブロック数B _n	B(mm)	B _o (mm)	H0(mm)	B _o (mm)
40	23	102	2339	932	704	1509
80	31	51	1576	932	322	691
160	47	25	1195	932	131	282
320	79	13	1004	932	26	78
640	143	6	909	932	-12	-25

上記の表は、30インチ、42インチ、60インチでの画像表示サイズに対して、フレキシ接合部間のクリアランス量16を8mm、15mmとした時の15の値を求めたものである。実際に上記の表から15を決定する場合には、例えば60"のHD仕様をみると、クリアランス16を8mmに設定し、ブロック間本数を320本のにしたときでの15が30mmとなり最も小さくなることが判る。逆に30"のVGAの場合には、クリアランス16を15mmに設定し、ブロック間本数を160本とした時に15が11mmとなり最小になることが判る。以上の様に各画像表示サイズごとにフレキシ接合部でのブロック間本数等を変えた場合での計算を行い、最適値の15を設定することが可能となる。尚、1ブロック間の配線本数は上記の値に限定されるものではなく必要に応じて変えてよい。更に、15がマイナス値を示すのは、フレキシ接合部の全長が画素部3の全長に対し短くなるためであって15を決定するにあたっては特に問題にはならない。

【 0 3 2 0 】

次に、沿面距離 l_1 と枠 l_2 の加算された値 ($l_1=4\text{mm}$ 、 $l_2=5\text{mm}$ で $l_1+l_2=9\text{mm}$)と、決定された l_5 に対しての比較を行う。つまり上記各表より求められた最適値 l_5 に対して、実施例1ではゲッタ6配置用の沿面距離 l_1 とフェイスプレート上に設けた枠 l_2 は最低限必要とされる。従って、 l_5 の値が 9mm 以下であった場合すなわち、 $l_1+l_2>l_5$ の場合には l_5 の替わりに l_1+l_2 の値となり、 $l_1+l_2<l_5$ の場合には l_5 が取り出し配線長 L 値を決める値とされる。又、 $l_1+l_2>l_5$ となった場合は沿面距離 l_1 のすぐ近傍に l_2 の枠を設置してよい。そして、 l_3 、 l_4 に上記で決定された l_5 もしくは l_1+l_2 の値を加算して取り出し配線長 L が求まる。以上、実施例1では取り出し配線数の距離 L をゲッター部6、フェイスプレート部の枠7で構成された場合での最適値を示した。それにより、画像表示パネルの狭額縁化を目指したパネルを実現することが可能となった。

【 0 3 2 1 】

(実施例2)

図94に本実施例2の図を示す。実施例2は、実施例1に対してゲッター6を排除し、画素部3内のマトリクス配線上にゲッタを形成されている点が大きく異なる。マトリクス内のゲッタは、非蒸発型ゲッター材料を使用し実施例1と同様に、画像表示をおこなった時での画素部からの放出ガスを吸着するための部材として使われる。図94において1、2、3、4、5、7及び、12、13、14、15は実施例1と同様であることから説明は省略する。 l_1 はフェイスプレートの枠7を構成する時での画素部3からの距離で、図93の l_1 と同様に高圧電圧(アノード電圧)との沿面放電を回避するための距離で $l_1=4\text{mm}$ で構成されている。取り出し配線長 L は、実施例1と同様に配線長 l_5 の値をどのように設定されるかで決まる。 l_5 は実施例1に示したごとく、取り出し配線のフレキ接合部17と1ブロック間のクリアランス l_6 等により決まり取り出し配線を求めるための計算式等はすべて実施例1と同じでよく、実施例2においても l_5 の値は実施例1で示した表をもとに決定されてよい。又、印刷配線の角度 θ も実施例1と同じでよい。

【 0 3 2 2 】

次に、沿面距離 l_1 と枠 l_2 の加算された値 ($l_1=4\text{mm}$ 、 $l_2=5\text{mm}$ で $l_1+l_2=9\text{mm}$)

と、決定された15に対しての比較を行う。つまり実施例1と同様な理由により $11 + 12 > 15$ の場合には15の替わりに $11 + 12$ の値が決定され、 $11 + 12 < 15$ の場合には15が取り出し配線長L値を決める値とされる。そして、13、14に上記で決定された15もしくは $11 + 12$ の値を加算して取り出し配線長Lが求まる。又、実施例2においても取り出し配線Lを決めるにあたっては $11 + 12$ の値が最低限必要である。

【0323】

以上、取り出し配線数の距離Lをフェイスプレート部の枠7で構成された場合での最適値を示した。それによって、画像表示パネルの狭額縁化を目指したパネルを実現することが可能となった。

【0324】

本構成では、画像表示装置で画像を表示する場合での取り出し配線の長さを決定するにあたって、取り出し配線部の長さをいくつかの設定条件をもとに算出できることを可能としている。従って、表示パネルの大型化や、配線数の増加に伴った場合においても画像表示装置の狭額縁化に対応したパネルを実現することができる。又、狭額縁化によってパネルの計量化も図ることができる。

【0325】

(構成17)

電子源基板の配線の取り出し部については更に以下の構成を採用することができる。すなわち、X方向配線とY方向配線の幅が、上記画像形成領域内よりも該画像形成領域に近接する画像形成領域の外側で、広く形成された領域を有する構成(第1の例)とすることができる。更に、該画像形成領域に近接する画像形成領域の外側の4角で、上記X方向配線ないしはY方向配線の幅が広く形成された領域を有する構成をとることもできる。

【0326】

図95および図96は、電子放出素子がマトリックス状に配置された電子源基板を用いた、本発明の第1の画像形成装置の構成を示す概略構成図(平面図)で、図95は画像形成領域の左端の周辺部分、図96は画像形成領域の上端の周辺部分を拡大して示したものである。なお、画像形成領域の右端、および画像形成領域の下端も、それぞれ図95、図96と対称の形態を有している。

【0 3 2 7】

また、配線6、7は、それぞれ、画像形成領域の外側、すなわち電子放出素子の形成されていない場所まで引き出されており、その場所においてその幅を太く形成している。これは、画像形成領域の外側において基板表面の露出面積を減じるため、この部位における帯電を生じにくくしている。

【0 3 2 8】

図9 7は、図9 5および図9 6に示した本発明の第1の画像形成装置の断面方向から見た図である。図9 7において、31は電子源を形成した基体であるリアプレート、32は透明な基体の内面に蛍光膜33とメタルバック34等が形成されたフェースプレートである。

【0 3 2 9】

第1の例においては、上述したように、配線6、7が、それぞれ、画像形成領域の外側、すなわち電子放出素子の形成されていない場所まで引き出されており、かつ、その場所においてその幅を太く形成しており、画像形成領域外側の電気抵抗の高い面の露出面積を減じたため、画像形成領域端部における画像の乱れを防止できる。

【0 3 3 0】

図9 8～1 0 0は、第2の例を示す概略構成図（平面図）で、画像表示領域の4角のうち、左上端部分を拡大して示したものであるが、他の3つの角も同様の形態を有する。なお、これらの図において、図中の番号は、それぞれ図1、図2中の同じ番号で示したものと同一である。

【0 3 3 1】

配線6、7は、前述したように、 m 本の X 方向配線7は、 $DX1$ 、 $DX2$ 、 \dots 、 DXm 、 n 本の Y 方向配線6は、 $DY1$ 、 $DY2$ 、 \dots 、 DYn からなるが、左上端の角において、 $DX1$ と $DY1$ の形状を図9 8に示したように、広く変形させている。これは、画像形成領域の外側の角の部分で基板表面の露出面積を減じるため、この部位における帯電を生じにくくしている。なお、同様に、不図示の、左下端では、 DXm と $DY1$ 、右上端では $DX1$ と DYn 、右下端では DXm と DYn をそれぞれ広く変形させて、画像形成領域の外側の角の部分で基板表面の露出面積を減じている。

【0332】

ここで、本構成では、画像形成領域の外側の角の部分で基板表面の露出面積を減じることが目的であるため、図99の様に、X方向配線（左上端ではDX1）のみを広く変形させても良く、また、図100の様に、Y方向配線（左上端ではDY1）のみを広く変形させても良い。

【0333】

図101は、それぞれ、電子放出素子がマトリックス状に配置された電子源基板を用いた、第3の例を示す概略構成図（平面図）で、画像表示領域の4角のうち、左上端部分を拡大して示したものであるが、他の3つの角も同様の形態を有する。なお、図101において、図中の番号は、それぞれ図98～100中の同じ番号で示したものと同一である。図101中、9は、画像形成領域の外側の角部に配された導電部材である。導電部材9は、画像形成領域の角の部分の基板表面の露出面積を減じるために配されたものであり、配線6、7と同じ材料を用いることができる。ここで、導電部材9は、配線6、7のいずれか一本と電気的にほぼ等電位となるよう接続することで、電位を規定することができる。

【0334】

次に本構成の実施例を挙げる。

【0335】

（実施例1）

本実施例にかかわる基本的な画像形成装置の構成は、図98～100と同様である。配線6の幅は画像形成領域内部で約 $70\mu\text{m}$ とし、配線6間の距離は約 $220\mu\text{m}$ とした。また、画像形成領域の外側、すなわち、最も端に位置する素子電極の外側の領域において、配線6の幅を $150\mu\text{m}$ に広げ、配線6間の距離、すなわち基板表面の露出する幅は約 $140\mu\text{m}$ とした。なお、配線6は、そのまま引き出し電極となるよう、基体1の端まで形成する。

【0336】

配線7の幅は画像形成領域内部で約 $280\mu\text{m}$ とし、配線7間の距離は約 $340\mu\text{m}$ とした。また、画像形成領域の外側、すなわち、最も端に位置する素子電極の外側の領域において、配線7の幅を $440\mu\text{m}$ に広げ、配線7間の距離、すなわち基板表面の

露出する幅は約 $180\mu\text{m}$ とした。なお、配線7は、そのまま引き出し電極となるよう、基体1の端まで形成する。

【0337】

(実施例2～4)

実施例1と同様に、配線6を形成する。なお、ここで、配線6のうち、DY1とDY n は、画像形成領域の外側の4角において、図98と同様になるように、形を広げて形成した。次に、実施例1と同様に、層間絶縁層8を形成する。更に、実施例1と同様に、上配線7を形成する。なお、ここで、配線7のうち、DX1とDX m は、画像形成領域の外側の4角において、図98と同様になるように、形を広げて形成した。ここで、形を広げて形成した領域でのDY1とDX1との距離は、約 $200\mu\text{m}$ 以下となるように形成した。

【0338】

さらに、配線7を図99の様に形成した実施例3、配線6を図100の様に形成した実施例4においても、同様に4角の部分においても、画像の乱れの無い、長時間にわたって安定な高品質な画像が得られた。

【0339】

(実施例5)

本実施例5にかかわる基本的な画像形成装置の構成は、図97、図101と同様にスクリーン印刷で配線を構成した点にある。また、本実施例における画像形成装置の製造法は、図102～103に示している。以下、これらの図97～100、図102～103を用いて、本実施例にかかる画像形成装置の基本的な構成及び製造法を説明する。

工程-a

実施例1と同様に、清浄化したガラス基体1上に、素子電極2、3を形成する(図102(a))。

工程-b

実施例1と同様に、配線6を形成する。ここで、導電部材9を所定の位置、すなわち、画像形成領域の外側の4角の位置に、同時に形成する(図102(b))。なお、導電部材9と配線6との間の距離は、約 $200\mu\text{m}$ 以下とした。

工程-c

次に、実施例1と同様に、層間絶縁層8を形成する。ここで、導電部材9が、次の上配線形成時に、最近接の上配線と接続しないように、導電部材9の上にも層間絶縁層8を形成する（図102(c)）。

工程-d

実施例1と同様に、上配線7を形成する。ここで、導電部材9が、最近接の次の配線7と接続するように形成される（図103(d)）。なお、導電部材9と配線7の最近接の配線との間の距離は、約200 μ m以下とした。

【0340】

以上の工程により、素子電極2、3が配線6、7によってマトリックス状に結線された、基板が形成できる。

【0341】

工程-e以降は、実施例1と同様に電気的外部取り出しは配線を異方性導電膜（ACF）で接続する形で行って、本実施例における画像形成装置を作製し、画像表示を行なった。その結果、テレビジョンとして十分満足できる輝度（約150fL）で良好な画像を長時間にわたって安定に表示でき、4角の部分においても、画像の乱れの無い高品質な画像が得られた。

【0342】

この構成によれば、電子源基板表面に露出した、電気抵抗の高い表面における帯電を抑制し、電子放出素子からの放出電子の軌道に対する影響を排除したので、良好な画像を長時間にわたり保持し得る大画面の平面型の画像形成装置、例えば、カラーフラットテレビが実現できる。

【0343】

（構成18）

一方、フェースプレートに設けられた蛍光体層、メタルバック及びブラックマトリックスなどの表示部については、表示パネル（画像表示装置）の薄型化を実現するためには、画像表示パネルの厚さを薄くしなければならず、図17で示したリアプレート4005とフェースプレート4000の距離を小さくしなければならない。この事より、リアプレート4005とフェースプレート4000の間

にはかなり高い電界が生じる事になる。ここでメタルバック 4006 は蛍光体膜全体に高電圧 V_a を印加し、また蛍光体の帯電を防止し、また蛍光体から後方（リアプレート方向）に出た光を鏡面効果により前方に取り出すという目的を持ったため、連続膜であるのが好ましい。またメタルバック 4006 は、加速された電子がメタルバック 4006 を通して蛍光体を励起しなければならないので、薄い膜状であるのが好ましい。しかしながら蛍光体は一般に粉体であり、したがって蛍光体膜はポーラスになり表面にはかなりの凹凸が存在する。また、蛍光体の混色防止や、ビーム位置が多少ずれても色ずれを起こさないようにするためや、外光を吸収し画像のコントラストを向上する、などの理由で設けられるブラックマトリクスと上記蛍光体膜にもかなりの凹凸が存在する。そのために蛍光体膜上に直接金属を成膜したのでは連続膜にならないので、一般的にメタルバック作製の工程としてフィルミング工程が用いられている。

【0344】

そこで、メタルバックはフェイスプレートと接触しており、メタルバックのいずれの場所にも $20\ \mu\text{m} \times 20\ \mu\text{m}$ の範囲内に、これらの接触部分が2点以上存在するもしくは接触面積が5割以上とする構成を採用することができ、かかる構成を採用することで、表示パネル（画像表示装置）のリアプレートとフェイスプレートの間の電界強度が $1\ \text{kV/mm}$ 以上となっても、メタルバックとフェイスプレートとの接触部が適度に存在するため、クーロン引力が働いた時に接触部にかかる力が小さくなり、メタルバックがはがれる可能性が著しく減少し、耐久性・信用性に優れたものとなる。

【0345】

また上記メタルバックのいずれの場所にも $20\ \mu\text{m} \times 20\ \mu\text{m}$ の範囲内に、上記接触部分が3点以上存在するもしくは接触面積が5割以上とすることにより、クーロン引力により接触部にかかる力が更に小さくなり、メタルバックがはがれる可能性が著しく減少し、耐久性・信用性に優れたものとなる。

【0346】

以上のように、フェイスプレートがブラックマトリクスを有することにより外光を吸収しコントラストを向上させ、隣の画素の蛍光体が混色する事を防ぎつつ

、メタルバックがブラックマトリクスと接触しているために、広い範囲でメタルバックが浮くことなく、したがってクーロン引力が働いた際にメタルバックと蛍光体およびブラックマトリクスの接触部にかかる力が小さくなるので、クーロン引力によりメタルバックがはがれる可能性が小さくなる。

【0347】

またメタルバックを作製する工程において、蛍光体膜およびブラックマトリクスの高さの差が大きいと、フィルミング工程の際に樹脂材料が蛍光体もしくはブラックマトリクスの低い部分に多く溜まり、フィルムの膜厚が厚くなってしまう。この上に金属膜を作製した後に焼成して樹脂材料を除去しようとする、熱分解により生じるガスの量がフィルムの膜厚の厚い部分で多くなり、メタルバックの浮きが発生してしまう。そこで一画素中の蛍光体膜の平均厚さを t_p (μm)、そこに隣接するブラックマトリクスの平均厚さを t_b (μm)、蛍光体の平均粒径を r_p (μm)とした時に、ブラックマトリクスの平均厚さ t_b を、

$$t_p - r_p < t_b < t_p + r_p$$

とする事により、蛍光体もしくはブラックマトリクスの低い部分に樹脂材料が溜まることなく、したがってメタルバックの浮きが生じクーロン力ではがれる可能性が低くなる。

【0348】

また上記フェイスプレートの蛍光体膜作製領域のガラス基板を凹ませ、そこに蛍光体を充填する事によって、一画素あたりの蛍光体膜の上面の平均高さとなりに隣接するブラックマトリクスの平均高さの差が、蛍光体の平均粒径以下であるようにする事により、蛍光体膜およびブラックマトリクスの低い部分に、フィルミング工程の際に樹脂材料が溜り、フィルムが厚くなり、焼成の際にメタルバックが浮くといった問題が起こりにくくなる。

また上記フェイスプレートはブラックマトリクスを有し、該ブラックマトリクス上に、ブラックマトリクスとは異なる材料の物質が積層され、メタルバックと接触させる事により、メタルバックがブラックマトリクス上に設けられた材料と接触しているために、広い範囲でメタルバックが浮くことなく、したがってクーロン引力が働いた時にメタルバックと蛍光体およびブラックマトリクスの接触部

にかかる力が小さくなるので、クーロン引力によりメタルバックがはがれる可能性が小さくなる。

【0 3 4 9】

またメタルバックを作製する工程において、金属膜が作製されたフィルムが、バルクもしくは非常に粒径の小さい粒子からなるスクリーン上に接していると、焼成の際に熱分解により発生したガスが抜け難く、メタルバックの浮きが発生し易くなる。また逆に金属膜が作製されたフィルムが、非常に粒径の大きな粒子からなるスクリーンに接していると、フィルムの平坦度が高いと、焼成後にメタルバックとフェイスプレートの接触部が非常に少なくなり、クーロン引力によりメタルバックがはがれ易くなってしまふ。そこで上記ブラックマトリクス上に積層される材料の平均粒径を r_z (μm) とし、蛍光体の平均粒径を r_p (μm) としたときに、

$$r_p \div 2 < r_z < 3 r_p \div 2$$

とすることによって、焼成の際にメタルバックの浮きが発生し難く、しかもメタルバックとフェイスプレートの接触部が少なくならないので、クーロン引力がかかった際にメタルバックがはがれ難い。

【0 3 5 0】

また上記ブラックマトリクス上に積層される材料をの拡散反射率が 70 % 以上とすることにより、蛍光体から出た光がブラックマトリクス上の材料に吸収されず、前方に効率よく取り出す事が出来、画像表示装置に輝度が向上する。

【0 3 5 1】

また上記ブラックマトリクス上に積層される材料は、上記蛍光体とする事により、本発明の本質である接触部の多いメタルバックを作製し易くなり、さらにフェイスプレートの作製工程が単純となり、製造コストを削減する事が出来る。

【0 3 5 2】

また上記フェイスプレートにはカラー画像を表示するため3色の蛍光体が塗り分けられており、上記ブラックマトリクス上に積層される蛍光体はそのうち1色の蛍光体が8割以上を占めるようにする事により、本発明の本質である接触部の多いメタルバックを作製し易くなり、さらにフェイスプレートの作製工程が単純

となり、製造コストを削減する事が出来る。

【0 3 5 3】

また上記フェイスプレートにはカラー画像を表示するため3色の蛍光体が塗り分けられており、上記ブラックマトリクス上に積層される蛍光体は、両隣の2色の蛍光体とすることにより、本発明の本質である接触部の多いメタルバックを作製し易くなり、さらにフェイスプレートの作製工程が単純となり、製造コストを削減する事が出来る。

【0 3 5 4】

また上記ブラックマトリクスに積層される2色の蛍光体のブラックマトリクスの領域を占める面積比は(4~6):(6~4)とすることにより、本発明の本質である接触部の多いメタルバックを作製し易くなり、さらにフェイスプレートの作製工程が単純となり、製造コストを削減する事が出来る。

【0 3 5 5】

また上記ブラックマトリクスに積層される2色の蛍光体のブラックマトリクスの領域を占める面積比は(9.5~6):(0.5~4)とすることにより、本発明の本質である接触部の多いメタルバックを作製し易くなり、さらにフェイスプレートの作製工程が単純となり、製造コストを削減する事が出来る。

【0 3 5 6】

また上記フェイスプレートのブラックマトリクス作製領域のガラス基板が凹んでおりブラックマトリクスの材料が充填され、蛍光体膜の上面の平均高さブラックマトリクスの部分の平均高さの差を、蛍光体の平均粒径以下とすることにより、本発明の本質である接触部の多いメタルバックを作製し易くなる。

【0 3 5 7】

またメタルバックの凹凸の差が大きいと、接触部に1ヶ所対したのメタルバックの表面積が大きくなり、接触部にかかるクーロン引力が大きくなるので、上記メタルバックのいずれの場所でも $20\mu\text{m} \times 20\mu\text{m}$ の範囲内のメタルバックの凹凸の差を蛍光体の平均粒径以下とする事によって、メタルバックにクーロン引力がかかった際に、接触部にかかる力が小さくなり、メタルバックがはがれる可能性が少なくなる。

【0358】

以下本構成の実施例を挙げる。

【0359】

(実施例1)

図104、図105及び図108により、本構成の主題であるフェイスプレートおよびメタルバックの構成について説明する。厚さ2.8mmのソーダライムガラスを洗浄・乾燥させた後、ガラスペーストおよび黒色顔料を含んだ黒色顔料ペーストを用い、図108(a)のように、縦方向に幅100 μ m、ピッチ290 μ mのストライプを240本、横方向に幅300 μ m、ピッチ650 μ mのストライプを720本有するパターンを、縦・横共に20 μ mの厚さでスクリーン印刷法により作製し、ブラックマトリクスとした。本実施例ではスクリーン印刷法によりブラックマトリクスを作製したが、もちろんこれに限定されるものではなく、たとえばフォトリソグラフィ法をもちいて作製してもよいが、膜厚が厚い事とコストの関係上スクリーン印刷法を用いる事が好ましい。また、ブラックマトリクスの材料として、ガラスペーストと黒色顔料を含んだ黒色顔料ペーストを用いたが、もちろんこれに限定されるものではなく、たとえばカーボンブラックなどを用いてもよいが、スクリーン印刷で作製する事や、膜厚が20 μ mと厚いため上記黒色顔料ペーストを用いた。またブラックマトリクスは、本実施例では図108(a)のように、マトリクス状に作製したが、もちろんこれに限定される訳ではなく、ストライプ状配列やデルタ状配列やそれ以外の配列であっても良い。

【0360】

次に、図108(a)に示すように、ブラックマトリクスの開口部に、赤色・青色・緑色の蛍光体ペーストを用いてスクリーン印刷法により、3色の蛍光体を1色ずつ3回に分けて作製する。本実施例ではスクリーン印刷法を用いて蛍光体膜を作製したが、もちろんこれに限定される訳ではなく、たとえばフォトリソグラフィ法などにより作製しても良い。また蛍光体はCRTの分野で用いられているP22の蛍光体とし、赤色(P22-RE3; Y2O2S:Eu³⁺)、青色(P22-B2; ZnS:Ag,Al)、緑色(P22-GN4; ZnS:Cu,Al)のもので平均粒径はメジアン径D_{med}で7 μ mのものを用いたが、もちろんこれに限定される訳ではなく、その他の蛍光体を用い

ても良い。また蛍光体の膜厚は、平均して $20\ \mu\text{m}$ 程度になるように作製した。ここで、蛍光体の膜厚が十分平坦にならないような場合には、十分な平坦度をもつ平板ガラスにイソプロピルアルコール (IPA) を吸収させた不織布をもうけ、これによりフェイスプレート上の蛍光体膜およびブラックマトリクスを加圧し平坦度を増してもよい。ついで、この基板を $450^{\circ}\text{C} \cdot 4$ 時間焼成する事により、ペースト中に含まれる樹脂分を熱分解除去し、対角画面サイズ10インチ、アスペクト比4:3、ドット数 720×240 からなるフェイスプレートを得た。ここで蛍光体およびブラックマトリクスの厚さを蝕針式表面粗さ測定器をもちいて測定したところ、一画素中の蛍光体膜の平均厚さとそこに隣接するブラックマトリクスの平均厚さの差が、蛍光体の平均粒径である $7\ \mu\text{m}$ をこえるような場所は観測されなかった。

【0361】

次に、このフェイスプレート上にメタルバックを作製する方法について説明する。上記のようにして作製したフェイスプレートをスピンコーター上に配置し、純水にコロイダルシリカを溶解させた溶液を、基板を回転させながら塗布し、蛍光体層の凹凸部を湿潤させた。続いてポリメタクリレートをトルエンに溶解した溶液を、基板を回転させながら全面に均一になるようにスプレーにより塗布し、温風を基板に吹きかける事により乾燥させ、蛍光体層およびブラックマトリクス上に、樹脂フィルムを作製する事によって、表面の平坦化を行なった。ここで、平坦化のための工程として、蛍光体膜を湿潤した後にポリメタクリレートをトルエンに溶解した溶液を塗布したが、もちろんこれに限定されるものではなく、他の溶剤系ラッカー液を用いても良いし、その他の方法としてたとえばアクリルエマルジョンを蛍光体に塗布し乾燥させるという工程を行なっても良い。この後平坦化されたフェイスプレートに 1000 オングストロームのアルミニウム膜を真空蒸着法により作製した。次にこのフェイスプレートを焼成炉内に搬入し、 450°C まで加熱する事により樹脂フィルムを熱分解除去した。

【0362】

このようにして得られたフェイスプレートを、走査電子顕微鏡 (SEM) で観察

し、メタルバックと蛍光体およびブラックマトリクスとの接触部を観察した。この際、高加速電圧で観察すると厚さ 1 0 0 0 オングストロームのメタルバックが観察しにくいので、加速電圧 2 kV で観察した。SEM でメタルバックを観察すると、接触部のメタルバックは蛍光体もしくはブラックマトリクスに沿った形状になっており、上記接触部が良好に観察する事が出来る。SEM の観察により、 $20\mu\text{m} \times 20\mu\text{m}$ の範囲にある接触部の数および接触面積を測定した。測定は選択したブラックマトリクスの開口部からそこに隣接する 8 箇所のブラックマトリクス開口部とそれらに囲まれた範囲で行ない、その測定をフェイスプレートの全面から無作為に $N=10$ 箇所取り出して行なった。その結果を表 1 に示す。観察の結果、メタルバックの接触部が $20\mu\text{m} \times 20\mu\text{m}$ の範囲で 2 ヶ所未満のところはなく、フェイスプレートに良好に接触している事が観察された。

【0 3 6 3】

また、上記のフェイスプレートを真空チャンバ中でフェイスプレートより十分大きい電極に対向して一定のギャップをあけて固定し、メタルバックに DC で高電圧を印加し徐々に印加電圧を上昇させ、放電を開始した電圧を測定し電界強度（以後、放電開始電界強度と呼ぶ事にする。）を求めた。ただし、ここで電界強度はメタルバックに印加した電圧をリアプレートとフェイスプレートのギャップ距離で割ったものとする。測定の結果、放電開始電界強度は 7.7 kV/mm であった（結果を表 7 に示す）。このようにして、メタルバックが良好に接触しているフェイスプレートを得る事が出来、それにより画像表示装置の信頼性を向上する事が出来た。

【0 3 6 4】

（実施例 2）

つぎに、図 1 0 7 及び図 1 0 8 により、本発明第 2 の実施例について説明する。実施例 1 と同様の厚さ 2.8 mm のソーダライムガラスを洗浄・乾燥させた後、実施例 1 と同様な方法で、厚さ $3\mu\text{m}$ のブラックマトリクスを作製した（図 1 0 7 (a)）。次に、実施例 1 と同様に、ブラックマトリクスの開口部に 3 色の蛍光体を用いて、図 1 0 8 (a) にあるような配置で厚さ $20\mu\text{m}$ 蛍光体膜を作製した（図 1 0 7 (b)）。ここで、ブラックマトリクス上に蛍光体が多少積層されても、

ブラックマトリクスが光を吸収するので混色はおこらない。

【0365】

次に、ブラックマトリクス上にフェイスプレートの凹凸を減らすために、積層物を設ける工程について説明する。この積層物の主目的は、メタルバックの接触部を増やす事に有り、フェイスプレートの凹凸が存在すると、メタルバックの浮きが発生し易くなるため凹凸を減らす必要がある。また、ここでその積層物の表面が平滑すぎると、フィルミング工程において、フィルム焼成後にブラックマトリクスとメタルバックの密着性が悪くなる可能性が有り、また逆に凹凸が大きすぎるとメタルバックの接触部が減る事や、メタルバックが連続膜にならない可能性があるため、積層物に用いる材料の平均粒径を考慮したほうが好ましい。また、この積層物が光吸収性をもつと、蛍光体から発せられた光が吸収され、前面に取り出される光の効率が低下するので、上記材料の拡散反射率が70%以上あるのが好ましい。本実施例では上記の理由を考慮し、平均粒径4 μm の酸化マグネシウム粉末を用いた。これを樹脂バインダーに分散し、酸化マグネシウムペーストを作製し、ガラス基板上に厚さ20 μm の膜を作製し、拡散反射率を測定したところ85%程度の良好な値を示した。本実施例では上記積層物の材料として平均粒径4 μm の酸化マグネシウム粉末を用いたが、もちろんこれに限定される訳ではなく、上記のような要求を満たすものなら、たとえば窒化ボロンなどを用いても良い。上記酸化マグネシウムペーストを用いて、ブラックマトリクス上にスクリーン印刷法により積層物を作製した(図107(c))。本実施例では、スクリーン印刷法により上記積層物を作製したが、もちろんこれに限定される訳ではなく、たとえばフォトリソグラフィ法などにより作製しても良い。ここで、実施例1と同様に蛍光体および積層物の膜厚が十分平坦にならないような場合には、十分な平坦度をもつ平板ガラスにイソプロピルアルコール(IPA)を吸収させた不織布をもうけ、これによりフェイスプレート上の蛍光体膜およびブラックマトリクス状の積層物を加圧し平坦度を増してもよい。ついで、この基板を450°Cで4時間焼成する事により、ペースト中に含まれる樹脂分を熱分解除去しフェイスプレートを得た。作製したフェイスプレートの膜厚・表面粗さを蝕針式表面粗さ測定器により測定したところ、一面素中の蛍光体膜の平均高さと、そこに隣接

するブラックマトリクス of 平均高さの差が、蛍光体の平均粒径である $7\mu\text{m}$ を超えるような場所は観測されなかった。次に、実施例1と同様な方法でフェイスプレート上にメタルバックを作製し、フェイスプレートを得た (図107(d))。

【0366】

このようにして作製したフェイスプレートを、実施例1と同様にSEMで観察し、 $20\mu\text{m} \times 20\mu\text{m}$ の範囲にある接触部の数および接触面積を測定した。その結果を表7に示す。観察の結果、メタルバックの接触部が $20\mu\text{m} \times 20\mu\text{m}$ の範囲で2ヶ所未満のところはなく、フェイスプレートに良好に接触している事が観察された。また実施例1と同様に、放電開始電界強度を測定したところ、 7.3 kV/mm であった。上記のフェイスプレートと実施例1で用いたものと同様のマルチ電子ビーム源を備えたリアプレートをを用いて画像表示装置を作製したところ、画像表示装置の耐久性および信頼性を向上する事が出来た。また、ブラックマトリクス上に酸化マグネシウムの積層物を設け光の利用効率を向上させた事により、画像表示装置の輝度が10%程度向上した。

【0367】

(実施例3)

次に、図109及び図108を用いて、本発明第3の実施例について説明する。実施例1と同様の厚さ2.8mmのソーダライムガラスを洗浄・乾燥させた後、実施例1と同様な方法で、厚さ $3\mu\text{m}$ のブラックマトリクスを作製した (図109(a))。次に、ブラックマトリクスの開口部に、図108(a)に示すような配列で、3色の蛍光体膜を作製した。蛍光体膜の作製は、スクリーン印刷法によりおこない、3色の蛍光体を1色ずつ3回に分けて作製する。ここで、2色目までは実施例3と同様に作製した (図109(b))。3色目は、フェイスプレートの凹凸が少なくなるように、ブラックマトリクス上にも積層した (図109(c))。ここで、実施例1と同様に蛍光体の膜厚が十分平坦にならないような場合には、充分な平坦度をもつ平板ガラスにイソプロピルアルコール (IPA) を吸収させた不織布をもうけ、これによりフェイスプレート上の蛍光体膜を加圧し平坦度を増してもよい。ついで、この基板を $450^{\circ}\text{C} \cdot 4$ 時間焼成する事により、ペースト中に含まれる樹脂分を熱分解除去し、フェイスプレートを得た。このようにして作製し

たフェイスプレートの膜厚・表面粗さを蝕針式表面粗さ測定器により測定したところ、一画素中の蛍光体膜の平均高さ、そこに隣接するブラックマトリクス上の蛍光体の平均高さの差が、蛍光体の平均粒径である $7\mu\text{m}$ を超えるような場所は観測されなかった。また、このフェイスプレートを光学顕微鏡により観察したところ、ブラックマトリクス上には最後に印刷した蛍光体が8割以上の面積を占めて存在していた。

【0368】

次に、実施例1と同様な方法でフェイスプレート上にメタルバックを作製し、フェイスプレートを得た(図109(d))。

【0369】

このようにして作製したフェイスプレートを、実施例1と同様にSEMで観察し、 $20\mu\text{m}\times 20\mu\text{m}$ の範囲にある接触部の数および接触面積を測定した。その結果を表7に示す。観察の結果、メタルバックの接触部が $20\mu\text{m}\times 20\mu\text{m}$ の範囲で2ヶ所未満のところはなく、フェイスプレートに良好に接触している事が観察された。また実施例1と同様に、放電開始電界強度を測定したところ、 6.5kV/mm であった。上記のフェイスプレートと実施例1で用いたものと同様のマルチ電子ビーム源を備えたリアプレートをを用いて画像表示装置を作製したところ、画像表示装置の耐久性および信頼性を向上する事が出来た。

【0370】

(実施例4)

次に、図106および図108を用いて、本発明第5の実施例について説明する。実施例1と同様の厚さ 2.8mm のソーダライムガラスを洗浄・乾燥させた後、実施例1と同様な方法で、厚さ $3\mu\text{m}$ のブラックマトリクスを作製した(図106(a))。次に、ブラックマトリクスの開口部に、図108(a)に示すような配列で、3色の蛍光体膜を作製した。蛍光体膜の作製は、スクリーン印刷法によりおこない、3色の蛍光体を1色ずつ3回に分けて作製する。また、蛍光体を印刷するパターンはブラックマトリクスの開口部の位置にドットとして印刷するのではなく、蛍光体が図108で見て縦ストライプ状になるように印刷する。まず、一色目の蛍光体を印刷する際に、そこに隣接するブラックマトリクスの縦ブラック

ストライプ（ブラックマトリクス縦パターン）上にも、略半分程度はみだすように印刷を行なった（図 106 (b)）。続いて2色目の蛍光体を印刷する際に、隣接する縦ブラックストライプのうち、一色目の蛍光体に乗っている部分に関しては、2色目の蛍光体を重ねるようにし、もう一方の縦ブラックストライプ上には略半分程度はみだすように印刷を行なった（図 106 (c)）。続いて3色目の蛍光体を印刷する際には、隣接する縦ブラックストライプ状に乗っている隣接画素の蛍光体に重ねるようにして印刷した（図 106 (d)）。ここで、実施例 1 と同様に蛍光体の膜厚が十分平坦にならないような場合には、十分な平坦度をもつ平板ガラスにイソプロピルアルコール（IPA）を吸収させた不織布をもうけ、これによりフェイスプレート上の蛍光体膜を加圧し平坦度を増してもよい。ついで、この基板を450℃・4時間焼成する事により、ペースト中に含まれる樹脂分を熱分解除去し、フェイスプレートを得た。このようにして作製したフェイスプレートの膜厚・表面粗さを蝕針式表面粗さ測定器により測定したところ、一画素中の蛍光体膜の平均高さと、そこに隣接するブラックマトリクス上の蛍光体の平均高さの差が、蛍光体の平均粒径である7 μm を超えるような場所は観測されなかった。また、このフェイスプレートを光学顕微鏡により観察したところ、ブラックマトリクス上は両隣の画素の蛍光体に覆われていた。

【0371】

次に、実施例1と同様な方法でフェイスプレート上にメタルバックを作製し、フェイスプレートを得た（図 106 (e)）。

【0372】

このようにして作製したフェイスプレートを、実施例1と同様にSEMで観察し、20 μm ×20 μm の範囲にある接触部の数および接触面積を測定した。その結果を表7に示す。観察の結果、メタルバックの接触部が20 μm ×20 μm の範囲で2ヶ所未満のところはなく、フェイスプレートに良好に接触している事が観察された。また実施例1と同様に、放電開始電界強度を測定したところ、6.7 kV/mmであった。上記のフェイスプレートと実施例1で用いたものと同様のマルチ電子ビーム源を備えたリアプレートをを用いて画像表示装置を作製したところ、画像表示装置の耐久性および信頼性を向上する事が出来た。

【0373】

【表7】

表7

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4
接点の数 最小値 (個/20 μm ×20 μm)	5	4	2	3
接点の数 平均値 (個/20 μm ×20 μm)	11.4	10.2	6.8	8.3
接触面積割合 (%)	55	39	19	25
放電開始電界強度 (kV/mm)	7.7	7.3	6.5	6.7

【0374】

(構成19)

一方、表示パネルにおける真空容器部を構成するフェースプレート、枠部材、リアプレートの接合に、ポリフェニル化合物を含む高分子系熱可塑性接着剤を用いることができる。以下本構成の実施例を挙げる。

【0375】

(実施例1)

本実施例における表示パネルは、図110に模式的に示された装置と同様の構成を有し、1は電子源で、複数の電子放出素子を基板上に配置し、適当な配線を施したものである。2はリアプレート、3は外枠、4はフェースプレート、9、14は、接着剤である。図110(b)のC-C'断面図に示す様に、ポリフェニル化合物を有する高分子系熱可塑性の接着剤9、14を介して、リアプレート2及びフェースプレート4は、外枠3との接合部において、それぞれ接合されている。

【0376】

接着剤を用いた接着は、ポリエーテルケトンの主成分とする高分子系熱可塑性のシート状の接着材9、14：テクノアルファ（株）製品名 ステイスティック451を外枠の形状に成型し、設置した後、Arなどの不活性ガス(inert gas)中で350℃の加熱処理により接着剤を軟化させ、圧着(0.3 kg/cm²)し、降温過程で接着剤を硬化することによって接着を行った。電子源1などの内部構造体の固定も同様に行う。また、リアプレート2とフェースプレート4を配置する際に

は、同時に画像表示領域外にBaを主成分とする蒸発型ゲッタのリング状ゲッタ 1 6 配置した。

【0 3 7 7】

なお、接着剤に含有させるポリフェニル化合物としてはポリビスフェノール A カarbonate、ポリスルホン、ポリエーテルケトンなどを挙げることができる。

【0 3 7 8】

(実施例 2)

本実施例は、実施例 1 の接着剤として、ポリスルホンを主成分とする高分子系熱可塑性のシート状の接着材 9, 1 4 : テクノアルファ (株) 製品名 ステイスティック 4 1 5 を用い、加熱処理温度が 3 0 0 °C である点が実施例 1 と異なる。

【0 3 7 9】

(実施例 3)

本実施例は、実施例 1 の接着剤として、ポリエーテルを主成分とする高分子系熱可塑性のシート状の接着材 9, 1 4 : テクノアルファ (株) 製品名 ステイスティック 4 0 1 を用い、加熱処理温度が 2 5 0 °C である点が実施例 1 と異なる。

【0 3 8 0】

(実施例 4)

本実施例は、実施例 1 の接着剤として、ポリスルホンを主成分とする高分子系熱可塑性のペースト状の接着材 9, 1 4 : テクノアルファ (株) 製品名 ステイスティック 3 0 1 を用い、ディスペンサ塗布法で任意の形状にガラス部材にコーティングし、脱法し、150°C で溶剤を蒸発させたのち、加熱処理温度が 3 0 0 °C である点が実施例 1 と異なる。

【0 3 8 1】

以上のように外囲器の形成のための部材の接合部にポリフェニル化合物を含む接着剤を用いると、接着工程における熱処理温度が 3 5 0 °C 以下の1回の接着工程であるので、電力コストを下げ、画像表示装置をはじめとする真空外囲器を提供することができた。

【0 3 8 2】

(構成 2 0)

更に、外囲器形成のための接合においては、接着部を 2 種の接着剤から形成することもできる。例えば、外囲器を主にシールする機能を有する材料と接着機能を有する材料とで接合部を接着形成することができる。このような目的において接合部のシール機能を有するシール材としては、In、Al、Cu、Au、Ag、Pt、Ti、Ni等の金属あるいは合金、および表面にIn、Al、Cu、Au、Ag、Pt、Ti、Ni等の金属あるいは合金をコーティングした有機接着剤や無機接着剤等の材料等から選択することができ、接着機能を有する接着剤としては、本発明の接着剤として、ポリフェニル化合物を有する高分子系熱可塑性の接着材、ポリベンゾイミダゾール樹脂を主成分とする接着剤、ポリイミド樹脂を主成分とする接着剤等の有機接着剤、アルミナ、シリカ、ジルコニア、カーボンを主成分とする無機接着剤等があげられる。

【0 3 8 3】

シール材としてはIn、接着剤としてはジルコニアとシリカを主成分とする無機接着剤が最も好ましいものの一つとして用いられる。シール材としてInワイヤーを用いると、Inワイヤーを任意の形状に成型し、160℃以上で加熱することによりInを軟化させ、圧着し、降温過程でシールした後、アルミナを主成分とするペースト状の接着剤をデイスパenser等でシール材周辺に塗布し、100℃以下で水分を蒸発させてから150℃程度で接着することで前記1～6の条件を満たすことができる。Inとアルミナを主成分とする無機接着剤を用いた接合材は他の接合部に比べ、特に最高熱処理温度が低い点が好ましい。

【0 3 8 4】

また、シール材としてジルコニアとシリカを主成分とするペースト状の無機接着剤をデイスパenser等で任意の形状に成型し、100℃以下で水分を蒸発させた無機接着剤表面上にInをEBやスパッタ等の公知の真空蒸着法によりコーティング膜を形成した後、160℃以上で加熱することによりInを軟化させ、圧着し、降温過程でシールした後、アルミナを主成分とするペースト状の接着剤をデイスパenser等でシール材周辺に塗布し、100℃以下で水分を蒸発させてから150℃程度で接着することで下記1～6の条件を満たすことができる。

1. 耐熱性：真空中バーク（高真空形成）工程における耐熱性
2. シール性：高真空維持（真空リーク極小、ガス透過極小）可能
（但し、真空維持が必要な個所のみ）
3. 接着性：ガラス部材との接着性
4. 放出ガス特性：低放出ガス（高真空維持）特性
5. 熱処理温度：最高熱処理温度がフリット接着（封着）工程のおよそ400℃よりも低温である。
6. 成型性：任意の外枠形状に適合させやすく、接着温度付近で流動化しない。

【0385】

さらに、シール材としてはA1、接着剤としてはポリエーテルケトンの主成分とする高分子系熱可塑性の有機接着剤が用いられる。シール材であるA1、接着剤であるポリエーテルケトンの主成分とする高分子系熱可塑性のシート状の有機接着剤を任意の形状に成型し、330℃以上まで加熱することにより接着剤を軟化させ、圧着し、シールさせ、降温過程で接着剤を硬化することによってに接着させ、前記1～6の条件を満たすことができる。

【0386】

上記のシール機能を有するシール材と接着機能を有する接着剤の少なくとも2つの部材を用いた接合部は、最高熱処理温度が400℃以下の接着工程であるので、電力コストを下げ、輝度低下や寿命短縮の少ない、さらに表示品位が高く、ゲッタ効果も十分な画像表示装置をはじめとする真空外囲器を提供することができる。

【0387】

また、接合部とガラス基板との密着性の向上のために、予め接合面へシール材と同様の金属または合金を真空蒸着あるいは同様の金属または合金を含んだ塗布材をスクリーン印刷、ディッピング、スプレー、ディスペンサ等の公知のコーティング法でコーティングしておいても有効である。

【0388】

以下本構成の実施例を挙げる。

【0389】

(実施例 1)

本実施例の画像表示装置は、図 1 1 1 に模式的に示された装置と同様の構成を有し、1は電子源で、複数の電子放出素子を基板上に配置し、適当な配線を施したものである。2はリアプレート、3は外枠、4はフェースプレートである。図 1 1 1 (b)のC-C'断面図に示す様に、9は接着剤、14はシール材で、リアプレート2及びフェースプレート4は、外枠3との接合部において、それぞれ接合されている。

【0390】

接合は、Inワイヤーをシール材14とし、Inワイヤーを任意の形状に成型し、160℃以上で加熱することによりInを軟化させ、圧着し、降温過程でシールした後、接着剤9として、ジルコニアとシリカを主成分とするペースト状の接着剤：(株)スリーボンド 製品名3715を外枠の形状にディスペンサでシール材周辺に塗布し、100℃以下で水分を蒸発させてから150℃程度で接着を行った。電子源1などの内部構造体の固定も同様に行う。また、リアプレート2とフェースプレート4を配置する際には、同時に画像表示領域外にBaを主成分とする蒸発型ゲッタのリング状ゲッタ16配置した。

【0391】

(実施例 2)

接合部のシール材として、ジルコニアとシリカを主成分とするペースト状の無機接着剤(株)スリーボンド 製品名3715をディスペンサ等で任意の形状に成型し、100℃以下で水分を蒸発させた無機接着剤表面上にInをEBやスパッタ等の公知の真空蒸着法によりコーティング膜15を形成したものをを用いた。次に、シール材を160℃以上で加熱することによりInであるコーティング膜15を軟化させ、圧着し、降温過程でシールした後、接着剤9として、ジルコニアとシリカを主成分とするペースト状の接着剤：(株)スリーボンド 製品名3715を外枠の形状にディスペンサでシール材14周辺に塗布し、100℃以下で水分を蒸発させてから150℃程度で接着を行った。

【0392】

(実施例 3)

本実施例は、リアプレート2とフェースプレート4と外枠3のシール材と接触する部分にEBやスパッタ等の公知の真空蒸着法によりInを蒸着し、実施例1の接合部として、以下の接合部を用いた以外は実施例1の工程と同様に行った。すなわち、本実施例の接合部として、シール材としてはA1、接着剤としてはポリエーテルケトンを主成分とする高分子系熱可塑性の有機接着剤が用いられる。シール材であるA1、接着剤であるポリエーテルケトンを主成分とする高分子系熱可塑性のシート状の有機接着剤を任意の形状に成型し、330℃以上まで加熱することにより接着剤を軟化させ、圧着し、シールさせ、降温過程で接着剤を硬化することによってに接着させ、前記1～6の条件を満たすことができる。

【0393】

(実施例4)

本実施例は、実施例1の接合部として、以下の接合部を用いた以外は実施例1の工程と同様に行った。すなわち、本実施例の接合部として、シール材としてはIn、接着剤としてはポリスルホンを主成分とする高分子系熱可塑性のペースト状の接着材9, 14:テクノアルファ(株)製品名 ステイスティック301が用いられる。Inワイヤーをシール材14とし、Inワイヤーを任意の形状に成型し、160℃以上で加熱することによりInを軟化させ、圧着し、降温過程でシールした後、接着剤9として、ポリスルホンを主成分とする高分子系熱可塑性のペースト状の接着材9, 14:テクノアルファ(株)製品名 ステイスティック301を用い、ディスペンサ塗布法で任意の形状にガラス部材にコーティングし、脱法し、150℃で溶剤を蒸発させたのち、加熱処理温度が300℃以上まで加熱し、圧着し、降温過程で接着剤を硬化することによってに接着させ、前記1～6の条件を満たすことができる。

【0394】

(構成21)

フェースプレートに設けられたメタルバックは、通常ブラックマトリクスを介して隣接する多数の蛍光体層を覆うように設けられており、フェースプレートとリアプレートとの間隔が比較的狭いために、表示パネルの構成や駆動条件によってはメタルバックがリアプレート側へ引っ張られて剥離するという問題が生じる

場合があった。そこで、本構成は、フェースプレートの外側部分に透明電極を設けるという構成によりこのような問題を回避するものである。

【0395】

図112は、本構成を用いた表示パネルの斜視図であり、内部構造を示すためにパネルの一部を切り欠いて示している。図中、1015はリアプレート、1016は側壁、1017はフェースプレートであり、1015～1017により表示パネルの内部を真空に維持するための気密容器を形成している。気密容器を組み立てるにあたっては、各部材の接合部に十分な強度と気密性を保持させるため封着する必要があるが、たとえばフリットガラスを接合部に塗布し、大気中あるいは窒素雰囲気中で、摂氏400～500度で10分以上焼成することにより封着を達成した。また、上記気密容器の内部は10のマイナス6乗[Torr]程度の真空に保持されるので、大気圧や不意の衝撃などによる気密容器の破壊を防止する目的で、耐大気圧構造体として、スペーサ1020が設けられている。フェースプレート1017の下面には、蛍光膜1018が形成されている。本実施態様はカラー表示装置であるため、蛍光膜1018の部分にはCRTの分野で用いられる赤、緑、青、の3原色の蛍光体が塗り分けられている。各色の蛍光体は、たとえば図113(a)に示すようにストライプ状に塗り分けられ、蛍光体のストライプの間には黒色の導電体1010が設けてある。

【0396】

尚、本実施例では、各色の蛍光体（発光部材）の平均膜厚は20 μ m、黒色の導電体（黒色部材または非発光部材）の平均膜厚は6 μ mとした。

黒色の導電体1010を設ける目的は、電子ビームの照射位置に多少のずれがあっても表示色にずれが生じないようにする事や、外光の反射を防止して表示コントラストの低下を防ぐ事、電子ビームによる蛍光膜のチャージアップを防止する事などである。黒色の導電体1010には、黒鉛を主成分として用いたが、上記の目的に適するものであればこれ以外の材料を用いても良い。また、3原色の蛍光体の塗り分け方は前記図113(a)に示したストライプ状の配列に限られるものではなく、たとえば図113(b)に示すようなデルタ状配列や、それ以外の配列（図114）であってもよい。

【0397】

尚、フェースプレートの断面形状を、図178に模式的に示した。この様に、発光部材である各色の蛍光体の平均膜厚と、非発光部材である黒色部材1010の平均膜厚とは異なる。

【0398】

なお、モノクロームの表示パネルを作成する場合には、単色の蛍光体材料を蛍光膜1018に用いればよく、また黒色導電材料は必ずしも用いなくともよい。

また、蛍光膜1018のリアプレート側の面には、CRTの分野では公知のメタルバック1019を設けてある。メタルバック1019には、蛍光膜1018が発する光の一部を鏡面反射して光利用率を向上させる事や、負イオンの衝突から蛍光膜1018を保護する事や、電子ビーム加速電圧を印加するための電極として作用させる事や、蛍光膜1018を励起した電子の導電路としての作用がある。メタルバック1019の作製は、蛍光膜1018をフェースプレート基板1017上に形成した後、蛍光膜表面を平滑化处理し、その上にA1を真空蒸着する方法により形成した。なお、A1以外の材料であっても、上記機能を有するものであればよい。

【0399】

フェースプレートの上面（大気側面）には、図115のように、少なくとも、メタルバックが存在する領域に、ITOを材料とする透明電極1022を設け、接地してある。これによって、マルチビーム電子源とフェースプレート1017上のメタルバック1019との間に数kV以上の高電圧（即ち、2kV/mm以上の高電界）を印加しても、メタルバックには、フェースプレート上面の透明電極1022からのクーロン力が働くので剥れなくなり、画像表示時の放電が防止され、良好な表示画像を得ることができる。

【0400】

また、図112及び図116に示されるような表示パネルを用いた画像表示装置において、各冷陰極素子（表面伝導型放出素子）1012には、容器外端子Dx1~Dxm、Dy1~Dymを通じ、走査信号及び変調信号を不図示の信号発生手段よりそれぞれ印加することにより電子を放出させ、メタルバック1019には、高圧端

子H vを通じて高圧を印加することにより放出電子ビームを加速し、蛍光膜 1 0 1 8に電子を衝突させ、各色蛍光体 (R、G、B) を励起・発光させることで画像を表示した。各配線 1 0 1 3、1 0 1 4 間への印加電圧V fは1 4 [V]とした。高圧端子H vへの印加電圧V aを1 0 [k V]である。比較例としては、以前、フェースプレートの表面を接地していない時は、フェースプレートとリアプレートの距離が2mm、高圧端子H vへの印加電圧V aが8 [k V] ないし1 0 [k V] ではがれる例があった。

【0 4 0 1】

このように、蛍光体の裏面にはメタルバックが有るため、メタルバックの目的である、電位の低下の防止、加速電極としての働き、蛍光体からの発光を鏡面反射することによる輝度の向上、蛍光体が負イオンの衝突によってダメージを受けることを防ぐ等を果たすことができる。それとともに、フェースプレートの表面は透明電極を介して接地されているため、メタルバックがフェースプレートから剥れるのを防ぐことができた。

【0 4 0 2】

また特に、フェースプレートの最表面に透明導電材料を露出させることにより、不要な帯電を抑制することができる。この様な透明導電材料としては、膜状の透明電極を用いればよい。この透明導電材料は、不要な帯電を抑制できる電位を与えればよいが、特に好適には、図 1 1 5に記載のように該透明導電材料を接地すればよい。

【0 4 0 3】

(構成 2 2)

フェースプレートからの高圧電源への引出し線にかかる構成としては以下の構成が利用できる。本構成の実施形態を図 1 1 7～1 2 0を用いて説明する。図 1 1 7は、本発明の画像形成装置の構成の一例を模式的に示す分解斜め模式図である。図 1 1 8は図 1 1 7のA矢視方向からみたアノード端子部の断面を示した部分断面図であり、図 1 1 9 A～Eは、リアプレート基板の作製工程を説明する図で電子源領域の一部分を用いた。図 1 2 0はリアプレートのアノード端子部周辺部を示した平面図である。

【 0 4 0 4 】

1 は電子源を形成するための基板を兼ねるリアプレート、2 は電子源領域で、電界放出素子、表面伝導型電子放出素子などの電子放出素子を複数配置し、目的に応じて駆動できるように素子に接続された配線を形成したものであり、電子源を駆動するために引き出した駆動用配線引き出し部 3 - 1, 3 - 2 により画像形成装置の外部に取り出され、電子源の駆動回路（不図示）に接続される。1 1 は画像形成部材が形成されたフェースプレート、1 2 は電子源領域 2 より放出された電子により発光する蛍光体よりなる画像形成部材、1 0 0 は画像形成部材 1 2 に電圧を供給するために引き出された A g 等の引き出し配線、4 はリアプレート 1 とフェースプレート 1 1 に挟持される外枠であり、電子源駆動用配線引き出し部 3 は外枠 4 とリアプレート 1 の接合部で、例えば低融点ガラス（フリットガラス 2 0 1）に埋設されて外部に引き出される。リアプレート 1 及びフェースプレート 1 1 及び外枠 4 の材料として、青板ガラス、表面に SiO_2 被膜を形成した青板ガラス、Na の含有量を少なくしたガラス、石英ガラスなど、条件に応じて各種材料を用いる。1 0 1 は外部の高圧電源より供給された電圧を導入するための導入線、1 0 2 は導入線 1 0 1 をあらかじめ A g - C u, A u - N i などのろう材料を使用し気密シール処理を施して柱状形状の中心に一体形成した絶縁部材である。絶縁部材 1 0 2 の材料として、アルミナ等のセラミック、N a 含有量の少ないガラスなどのリアプレート 1 材料の熱膨張係数に近い材料でかつ、高電圧に耐える絶縁性を有する材料で、高温度になった場合の熱膨張差による絶縁部材 1 0 2 とリアプレート 1 との接合部での割れを防止する。なお、このような構成をもつ高圧端子以外の構成でもよく、この構成に限定されるものではない。また、導入線 1 0 1 と引き出し配線 1 0 0 との接続を確実にするために、導入線 1 0 1 と引き出し配線 1 0 0 との間に A g パーストや機械的なばね構成などの接続部材を配置構成してもよい。1 0 4 は気密導入端子 1 0 3 を貫入するリアプレート 1 に形成された孔である。気密導入端子 1 0 3 とリアプレート 1 に形成した貫通孔 1 0 4 との間は、フリットガラス 2 0 1 などの気密化が可能な接着部材にて固定する。なお、貫通孔 1 0 4 の形成場所として、リアプレートの駆動用引き出し配線 3 - 1, 3 - 2 の形成されていない 4 隅でかつ、外枠 4 の内側に配置構成される。さ

らに、数 k V の高電圧が導入線 1 0 1 を通して印加された時の放電対策として、ガード配線 1 0 5 を駆動用引き出し配線 3 - 1, 3 - 2 の外側に形成することで、内部で放電が発生しても、ガード配線 1 0 5 でガードされるため駆動用引き出し配線 3 - 1, 3 - 2 を通じて電子源領域へ放電電流が流れ、素子が劣化するなどのダメージが起こらない構成とすることができる。ただし、ガード配線からの導入線 1 0 1 までの沿面距離を、1 m m 以上離れた構成とするべきである。極端に、ガード配線との距離が近いと逆に放電の発生頻度を増加させることになる。

【0 4 0 5】

つづいて、5 は真空化するための排気孔、6 は排気孔 5 に対応する位置に配置するガラス管で、不図示の外部真空形成装置に接続され、電子放出素子を形成する真空処理が終了後封止するためのものである。なお、この他真空装置内で画像形成装置を組立てる方法をとれば、上述のガラス管 6 並びに、排気孔 5 は不要となる。

【0 4 0 6】

以下本構成の実施例を挙げる。

【0 4 0 7】

(実施例 1)

図面により具体的に説明する。図 1 1 7 は、本発明の画像形成装置の構成の一例を模式的に示す分解斜め模式図である。図 1 1 8 は図 1 1 7 の A 矢視方向からみた図であり、特にアノード端子部の断面を示した断面図であり、図 1 1 9 A ~ E は、リアプレート基板の作成工程を説明する図で電子源領域の一部分を用いた。図 1 2 0 はリアプレートのアノード端子部周辺部を示した平面図である。

【0 4 0 8】

1 1 は画像形成部材 1 2 を搭載した青板ガラス材料で形成したフェースプレート、1 0 0 は画像形成部材 1 2 の 1 隅から引き出した A g 材料からなる印刷により形成した引き出し配線で、その形成場所は、リアプレート 1 に形成した貫通孔より導入される高圧端子の導入線と当接可能な位置に形成した。引き出し配線 1 0 0 は画像形成部材 1 2 に重なるように印刷形成することで、電氣的導通を確保した。また、画像形成部材 1 2 はストライプ状の蛍光体、ブラックストライプ、

メタルバックから構成され、蛍光体、ブラックストライプは、印刷により形成し、その後これらの上に A 1 膜を真空蒸着法によりメタルバックとして形成した。

【0 4 0 9】

4 はリアプレート 1 とフェースプレート 1 1 に挟持される青板ガラス材料よりなる外枠であり、駆動用配線引き出し部 3 - 1, 3 - 2 は外枠 4 とリアプレート 1 の接合部で日本電気硝子製の L S 3 0 8 1 のフリットガラス 2 0 1 に埋設して外部に引き出した。1 0 1 は 4 2 6 合金材料よりなる導入線、1 0 2 は導入線 1 0 1 をあらかじめ A g - C u にてろう付けし、真空気密シール処理を施して柱状形状の中心に一体形成したアルミナセラミック製の絶縁部材、1 0 4 は導入線 1 0 1 を一体気密形成した絶縁部材 1 0 2 を導入する貫通孔である。貫通孔 1 0 4 の配置場所については、後述する。

【0 4 1 0】

リアプレート 1 は、図 1 1 7 及び 1 2 0 のように 4 隅のみ配線が形成されない領域となり、その 1 隅の駆動用配線引き出し部 3 - 1, 3 - 2 の一番外側にガード配線 1 0 5 が配置され、ガード配線 1 0 5 から 7 m m 離れたところに貫通孔 1 0 4 を有する構成で、この孔と対向する位置にフェースプレート 1 1 の引き出し配線 1 0 0 が位置するように構成する。この際の組立ては、フェースプレート 1 1 の画像形成部材 1 2 の不図示の蛍光体とリアプレート 1 の電子放出素子とが相互に対応するように注意深く位置合わせする。また、気密導入端子 1 0 3 及び、ガラス管 6 を設置し、かつ上述の位置合わせがなされた状態で、不図示の加熱炉へ投入し 4 2 0 度の温度を付与し、フェースプレート 1 1 とリアプレート 1 と外枠 4 の当設位置に配置したフリットガラス 2 0 1 を溶解させる。その後、冷却させて組立てが終了する。この状態で、フェースプレート 1 1、リアプレート 1、外枠 4、ガラス管 6、気密導入端子 1 0 3 が気密化可能なパネルとして形成できた。この後、ガラス管 6 を介して不図示の真空排気装置に接続し、パネル内を排気し、フォーミング処理、活性化処理を各微粒子膜 2 6 に対して行う。つづいて、パネル内の排気継続し、ベーキング処理を行い、真空パネル内に残留した有機物質分子を除去する。最後に、ガラス管 6 を加熱溶着して封止する。以上の工程にて、真空パネルは完成する。

【0 4 1 1】

次に、駆動用配線引き出し部 3 - 1, 3 - 2 を駆動基板と又、ガード配線 1 0 5 を外部のグランド端子とそれぞれ接続するために、F P C (フレキシブルプリントィッドサーキット) 4 0 1 を図 1 1 9 の位置に外部の F P C 実装装置で電気的な接続及び固定を行う。この後、真空パネルの筐体への組み込みと電気ボードと F P C との接続作業などを行い、画像形成装置が完成する。この際、気密導入端子 1 0 3 の導入線 1 0 1 と高圧電源との配線引き廻し処理は、真空パネルの裏面の隅から出ているために、F P C 4 0 1 との干渉もなくスムーズに実装可能であった。

【0 4 1 2】

以上の画像形成装置にて、高電圧を供給し画像駆動回路と外部映像を入力し画像表示させたところ、長い時間放電などの影響もなく安定に画像表示できることを確認した。

【0 4 1 3】

以上の構成により、

(1) 真空パネルを筐体モジュール化する際の高圧端子のケーブル処理(配線引き廻し)がしやすい。真空パネルの背面側に、駆動用の電気ボードを配置する時、高圧ケーブルの配置において、放電を考慮し空間距離をとる工夫を施す必要性があるが、隅にあると、空間を確保しやすいとともに、設計に自由度もたやすことができる。

(2) リアプレートに M T X 配線を構成する際、対称設計が可能となるため、設計が行いやすいとともに、それを構成するための装置においても好都合である。

(3) 隅には、駆動用の配線などがないことと、ガード配線を配置したこととで、放電に対して有利である。

以上の長所をもつ画像形成装置を提供できた。

【0 4 1 4】

(実施例 2)

図 1 2 1 ~ 1 2 4 A ~ C を用いて、実施例 2 を説明する。図 1 2 1 は、実施例 2 を説明するための画像形成装置の構成の一例を模式的に示す分解斜め模式図で

ある。図 122 はフェースプレート 11 の引き出し配線の種々の構成を示す図であり、図 123 は高電圧を供給する高圧電源部を説明する図であり、図 124 は筐体の内部構造を説明する図である。

【0415】

実施例 2 では、高圧端子を複数配置した構成であり、図 121 のように 2 隅のリアプレート 11 の貫通孔 104 から 2 個の気密導入端子 103 を配置して構成した。この場合のフェースプレート 11 の構成は、図 122 (1) のように引き出し配線を 2 隅から引き出したパターンとなる。また、2 隅の引き出し配線パターンに限るものではなく、例えば図 122 (2)、図 122 (3) に示すように 3 隅ないし 4 隅に配置構成してもよい。なお、前述した各実施形態と同様な各部には同一符号を付して、その説明とそれらの構成、製造方法などを省略する。

【0416】

上述の気密導入端子 103 に高電圧を供給して画像を形成するためには、高圧電源が必要であり、それについての説明を図 123、図 124 を用いて説明する。

【0417】

図 123 の 701 は高圧電源であり、702 は制御回路、703 は駆動回路、704 はトランス、705 は出力電圧を安定化するための電圧フィードバックである。図 124 は筐体構造を説明する図であり、図 124 A は図 122、図 123 の部材を装置内部へ組み込んだ外観図で、図 124 B は A 矢視方向からみた筐体内部の構想を示す断面図、図 124 C は筐体 801 の背面板を取り除いて B 矢視方向からみた図であり、802 は図 123 による表示デバイスの真空パネルであり、803 は真空パネル 802 を駆動する駆動ボード、804 は真空パネル 802 と駆動ボード 803 とを電氣的に接続する FPC、805 は高圧電源 701 と気密導入端子 103 とを接続する高圧配線である。

【0418】

画像形成装置内の不図示の DC 電源より高圧電源 701 内のトランス 704 に入力する。入力 DC はトランス 704 にて所望の電圧値に昇圧され高電圧を出力する。この電圧出力の際の電圧変動を抑制するために、電圧をフィードバック 7

05し、制御回路702にて電圧を制御し駆動回路703を通してトランス704に送る。本実施例で用いた電圧は、10kVで10mAの電圧出力とし、この電圧値を出力する高圧電源701を作製すると、高圧電源701のトランス704を1つで構成した場合、コアの直径で50mm程度のものになってしまうが、これを複数構成するとコアの直径を小さく構成することが可能である。例えば、トランスを2つで構成すれば、1つがうけもつ電流値を1/2とすることができるため、コアの外形直径寸法を30mm程度まで小さくすることができる。同様に4つ設ければ1/4となり、その直径は25mm程度になる。すなわち、コアの直径を小さくすることで、トランス704、高圧電源701を薄型化可能である。これは、図124A~Cに示す画像形成装置801をA矢視からみた断面構造図(図124C)でわかるように、高圧電源701が薄型化すれば、画像形成装置全体の奥行きを薄型化することができる。高圧電源701の配置場所は、気密導入端子103を隅に配置構成しているので、配線の引き廻しを考慮して図124Bのように、気密導入端子103の近傍で、筐体801の隅に配置構成した。

【0419】

以上説明したように、高圧端子を複数真空パネルの隅に配置構成し、さらに高圧電源を複数構成したことにより、装置全体の薄型化に寄与することができた。また、複数の気密導入端子を配置したことで、輝度の勾配が減少した。このことは、大面積化に有利な構成といえる。

【0420】

(実施例3)

図125A、Bを用いて、実施例3を説明する。図125Aは、実施例3を説明するためのフェースプレート側からみた真空パネルの平面図であり、図125Bは、図125AのA-A'方向からみた高圧端子構造部周辺の断面構造図である。なお、前述した各実施形態と同様な各部には同一符号を付して、その説明とそれらの構成、製造方法などを省略する。

【0421】

実施例3では、フェースプレート側に高圧取り出し部を形成した構成であり、

図 125 A, B のように引き出し配線 100 の配線幅中央部の位置にフェースプレート 900 に直径 1 mm の貫通孔を形成し、引き出し配線 100 と電氣的導通を確保すると同時に貫通孔の内周に導電部材 901 である Ag ペーストを塗布形成し、その後、シール材料 902 となるフリットガラスで埋め込み真空気密性を確保した。この構成によれば、リアプレート 1 側に形成される印刷配線などの電極体との沿面距離を確保できるため、放電に対して有利である。

【0422】

(構成 23)

高圧電源用の引出しの構成については、放電が発生した場合に高圧引き出し線との接続部分の抵抗が高いと発熱により、脱ガスして 2 次的な放電が起るという問題があり、これに対しては、接続部分の抵抗を低くすることにより発熱が抑えられ 2 次放電を抑制できる。高圧引き出し配線と中継導電膜との接続長、またメタルバックと中継導電膜との接続長を長く取る、あるいは中継導電膜のシート抵抗をさげることにより接続部分の抵抗を下げるができる。接続長を変えて 2 次的な放電の起る頻度を評価したところ、中継導電膜層と高圧引き出し配線との接続長 $W1$ [mm]、および中継導電膜層とメタルバック層の接続長 $W2$ [mm] の何れも、中継導電膜層のシート抵抗 r [Ω/\square] に対して

$$W1, W2 > (2.5 \times r)^{1/2} \quad (1)$$

を満たす接続長を採ることにより、2 次放電を抑えられる。

【0423】

以下本構成の実施例を示す。

【0424】

(実施例 1)

図 126 (1) ~ (7) に作製工程を示す。(1) まず引き出し配線 4021 を印刷法により作製する。配線は銀ペーストによる配線でシート抵抗が $0.1 \Omega/\square$ 以下となるように作製した。(2) 次に中継導電膜 4025 を同じく印刷法により作製した。導電膜はガラスペーストにカーボンを混合したものをを用い、厚さ

2 μm となるように作製した。その際の中継導電膜 4025 のシート抵抗は 50 Ω/\square であった。中継導電膜の接続長 W は式 (1) を充分満たすように $W = 150\text{ mm}$ とした。(3) 次に絶縁性のブラックストライプ 4022 を同じく印刷法により作製した。この厚さは 3 μm とした。(4) 次に RGB の蛍光体層 4008 を同じく印刷法により作製した。用いた蛍光体は P22 系の蛍光体で、RGB 共に平均粒径 5 μm のものを用いて、厚さ 15 μm の蛍光体層 4008 とした。

(5) 次にコロイダルシリカ、界面活性剤などを含んだ水溶液を蛍光面上に塗布し、まず蛍光体層 4008 の凹凸部を湿潤させ、ついでポリメタクリレートを主成分とした樹脂を可塑剤とともにトルエン、キシレン等の非極性溶媒中に溶解させ、これを蛍光面上にスプレーし、蛍光体凹凸上に o/w 型の小滴を載せ、スピコートにより延伸させたのち、水分と溶剤成分を乾燥除去し厚さ 3 μm のフィルミング膜 4028 を作製した。(6) 次に画像領域のみに開口を持ったアルミ蒸着用マスク 4029 を被せて、1000 Å 厚のアルミをフィルミング膜 4028 上に蒸着した。(7) 最後にこの基板を焼成炉内で 450°C まで 1°C/min の昇温速度にて昇温させ、30 分この温度を維持したのち、-2.5°C/min の降温速度で冷却させ、樹脂中間層を熱分解除去した。フィルミング樹脂 4028 除去後にメタルバック層 4009 は蛍光体層 4008、ブラックストライプ層 4022、中継導電膜層 4025 に覆い被さるようにして接触する。

【0425】

(実施例 2)

図 127 (2) に電極構成を示す。中継導電成膜 4025 は膜厚 3 μm の黒色銀系配線でシート抵抗は 0.5 Ω/\square である。中継導電膜 4025 とメタルバック 4009 との接続長 W_2 は式 (1) を十分満たすように 5 mm の長さを持っている。高圧引き出し配線 4021 は直径 2 mm のタングステンワイヤで、電子源基板 4004 を貫通して、中継導電膜 4021 に押し当てて接触をとっている。接触部分の直径は 1.8 mm であるので、高圧引き出し線 4021 と中継導電膜 4025 との接続長 W_1 はその円周 5.7 mm となり、式 (1) を十分満たす。画像領域およびスペーサ 4020 から中継導電膜 4025 までの距離 L を 12 mm とした。

【0 4 2 6】

中継導電膜 4 0 2 5、絶縁性ブラックストライプ 4 0 2 2、蛍光体層 4 0 0 8、メタルバック層 4 0 0 9 の作成方法は実施例 1 と同様である。

【0 4 2 7】

(実施例 3)

次に別の実施例について説明する。本実施例では中継導電膜 4 0 2 5 を白色銀配線で作製した。本実施例では中継導電膜 4 0 2 5 の下地膜として絶縁性ブラックストライプ 4 0 2 2 を中継導電膜まで延長した。これにより白色銀配線を用いても、画像表示面側からは黒色帯の縁取りしか見えず、画像への妨害感は感じられなかった。中継導電膜材料として以上実施例で使用したもの以外に、酸化ルテニウムを含む導電膜を使用することもできる。

【0 4 2 8】

(実施例 4)

本実施例では、実施例 1 と同様にして形成したフェースプレートを、基板上に複数の電子放出素子を配列形成した電子源と対向させた画像形成装置を作成した。但し、本実施例では、図 1 7 9 に示す様な構成とした。図 1 7 9 (A) に示す様に、中継導電膜を帯状とし、メタルバックの 1 辺とほぼ同等の長さに形成した。

また、図 1 7 9 (B) は図 1 7 9 (A) の F - F' 断面模式図である。

この様に、中継導電膜とメタルバックとの接続長を長くとした結果、放電を発生させた場合においても、中継導電膜付近での 2 次的な放電はみられなかった。

【0 4 2 9】

(構成 2 4)

フェースプレートとリアプレート、特に電子源基板との関係については以下の構成を用いることができる。

【0 4 3 0】

まず、これらの関係については、以下のような課題があった。従来の画像形成装置においては、電子源から放出される電子が画像形成部材の蛍光体に衝突することによって発光する現象を利用しているが、これに伴う以下のような問題点が発生していた。

問題点①陰極周辺領域の電極配置に伴う電界集中

問題点②陽極周辺領域の絶縁部材の帯電（反射電子による帯電）

問題点③陰極周辺領域の絶縁部材の帯電（正電荷粒子による帯電）

以上の攪乱作用により、周辺の領域に局所的な帯電が生じ、ビーム軌道に歪みを与えたり、放電を誘発し電子線放出素子の絶縁耐圧を低下させる原因となっていた。上記問題点を具体的に説明する。

問題点①

電子線放出装置は、巨視的にみて一組の陰極、陽極からなる平行平板キャパシタとみることができる。陰極陽極間隙の周囲を除いた大部分は平行電場が形成され、電界分布は、基本的に均一であるが、陰極陽極の周辺領域は、平行電場が崩れ、電界集中点が生じ、金属、絶縁境界すなわち電位基底部と基板境界に発生する。

【 0 4 3 1 】

電界計算結果によると、陽陰極が同一面積構成では、陽陰極間隙の内部空間の電界に対して、前記の前記電位基底部と基板の境界の電界は約1.3倍の大きさとなる。電界放出は、一般的に、陰極・陽極で対称ではなく、陰極側からの電子放出がより発生しやすい。このため、上記の幾何学的配置に伴う電界集中は、陰極・基板境界からの電子の電界放出として捉えられる。上記電界放出が誘発された場合は、電子線放出装置の基板帯電にともなうビーム軌道ずれと居所的放電の発生原因の一つとなるが、この境界領域の電界集中は、陰極上の電子線放出素子の放出・非放出とは独立に、陽極への加速電圧の印加により生じるため、電子源の非選択期間により緩和することができないなどの問題も生じていた。

問題点②

問題点②を図 1 2 8 を用いて説明する。図 1 2 8 には、陽極としてメタルバック 6 1 0 が形成されており、画像形成領域には蛍光体とブラックストライプからなる画像形成部材 6 0 6 が形成された画像形成装置となっている。本発明のような平板型電子線放出素子の画像表示装置においては、図 1 2 8 に示したように電子線の衝突により可視光を発する蛍光体とブラックストライプからなる画像形成部材 606 と光反射層であるアルミ製のメタルバック 610 に照射された電子ビームのう

ちおよそ5～20%が後方散乱され、電界により高圧印加されたメタルバック610に再突入する。さらに、この後方散乱電子線の一部は、ガラス等の絶縁物からなるフェースプレート605、側壁部609を衝撃し、二次電子放出や吸着ガス脱離によるガス放出が生じる。絶縁物の二次電子放出効率にしたがって、入射電子電流量に対して $(\delta-1)$ 倍の正電荷が絶縁体であるガラス中に発生する。絶縁体の低い導電性により発生した電荷が蓄積され、フェースプレートの局所的帯電となり、電界を攪乱してしまう。この電界の攪乱により、所望の電子線軌道が得られなくなってしまう、色ずれ等を生じる場合が合った。また、吸着ガスが放出されると、電子なだれにより放電が生じやすくなり、リアプレート601側の電極や配線、更には電子放出素子へ損傷を与えることがあった。

問題点③

電子の画像形成部材への衝突の際の反応や、装置内部の雰囲気ガスを電離することにより正イオンが発生する。この正イオンは、加速電極により電子源と画像形成部材との間に生じた電界により電子源から放出された電子とは反対方向に加速され、電子源上に到達する。一方、電子源には、電子放出素子の素子電極のバタニングに必要な絶縁部分が多く存在している。そのため、電子源に到達した正イオンが電子源の絶縁部分に帯電すると、電子放出素子から放出される電子は、帯電した絶縁部分の方向に曲げられて軌道がずれ、発光位置のずれなどの問題が生じる。また、帯電電荷によって放電等が引き起こされる確率が高くなり、装置の信頼性や寿命も損なわれてしまう。

【0432】

以上のような問題点より発生する電界の攪乱や放電は平板型画像形成装置において、高精細化／高色純度、さらには平板型画像形成装置の信頼性に関わる大きな問題点であった。

【0433】

本出願人は、表面伝導型電子放出素子を用いた画像形成装置をより簡単な構成で実現する方法として、複数本の行方向配線と複数本の列方向配線とによって、表面伝導型電子放出素子の対向する1対の素子電極をそれぞれ結線することで、行列状に、多数個の表面伝導型電子放出素子を配列した単純マトリクス型の電子

源を構成し、行方向と列方向に適当な駆動信号を与えることで、多数の表面伝導型電子放出素子を選択し、電子放出量を制御し得る系を考えている。このような、表面伝導型電子放出素子を用いた単純マトリクス型の画像形成装置においても、同様に絶縁性部材の表面に帯電が生じ、電子軌道に影響が出るおそれがある。上述した電子の軌道がずれるという問題は、電子被照射部材として蛍光体を用いていない電子線放出装置においても画像形成装置と同様に発生する。

【0434】

そこで本構成では、最小限の範囲を電位規定することで、陰極側絶縁部の帯電および周辺部の電界放出および陽極絶縁部の帯電を防止し、放出電子軌道の安定と放電を抑制した高耐圧な電子線放出装置および画像形成装置を提供することを目的とする。

【0435】

以下に述べる構成を用いることにより、最外周部の陰極・第2基板境界部の電界放出が抑制され局所的な帯電もなく、さらには、最外周縁部の電子放出素子を駆動した際にも、蛍光体等の画像形成部材にて後方散乱された電子線が絶縁物であるフェースプレート、側壁部等の画像形成部外に入射することがない。さらには、加速電極下の蛍光体から正電荷粒子の離脱にともなう陰極の帯電も抑制される。これらにより、電界に攪乱を与える帯電や電極や電子放出素子に損傷を与える放電等が激減し、高精細／高色純度、さらには平板型画像形成装置の信頼性／安全性が向上する。

【0436】

本構成の一例を、図129等を用いて説明する。図129は、本発明の電子線放出装置を応用した画像形成装置の第1実施例の一部を破断した斜視図であり、図130は、図129に示した画像形成装置をY方向から見た断面を模式的に示した図である。図130において、リアプレート2には、複数の表面伝導型の電子放出素子15がマトリクス状に配列された電子源1が固定されている。電子源1には、ガラス基板6の内面に蛍光膜7と加速電極であるメタルバック8が形成された、画像形成部材としてのフェースプレート3が、絶縁性材料からなる支持枠4を介して対向配置されており、電子源1とメタルバック8との間には、不図

示の電源により高電圧が印加される。これらリアプレート2、支持枠4およびフェースプレート3は互いにフリットガラス等で封着され、リアプレート2と支持枠4とフェースプレート3とで外圍器10を構成する。

【0437】

また、陰極側基板すなわち電子源1の表面には、各電子放出素子15およびそれらを電氣的に接続する配線を除く部位の所定の範圍（図129中、破線で示した範圍）に SnO_2 膜からなる電位規定膜が形成され、この範圍内が電位規定部9となっている。陰極側の電位規定部9は、図130に示すように、メタルバック8と電子源1との間の距離を d とし、陽極側の電位規定部であるメタルバック8上において各電子放出素子15から放出された電子が実際に照射される最大の領域をA、陽極側電位規定部すなわちメタルバックの敷設された領域をB、陰極側電位規定領域をCとしたとき、この領域Bの最外郭から電子源1に向かって垂線を下ろし、この垂線で囲まれた領域よりも電子源1の面に平行ないずれの方向にも d だけ大きい領域Cに位置する。すなわち、図130に示した領域E（領域A、B、C、E、Fは、それぞれ図2ではX方向の線分で示されているが、Y方向についても同様に考える）のX方向およびY方向の長さが d ということである。

さらには、陽極側の電位規定部8は、前記各電子放出素子15から放出された電子が実際に照射される最大の領域である領域Aの最外郭から、陽極として電位規定された面に平行ないずれの方向にも $2\alpha d$ だけ大きい領域に位置する。すなわち、図130に示した領域FのX方向およびY方向の長さが $2\alpha d$ ということである。本実施例では、電子源1とメタルバック8との間の距離 d を5mmとし、 α は0.6mmとした。

【0438】

次に、本実施例の動作について説明する。各電子放出素子15に、容器外端子 D_{ox1} ないし D_{oxm} と D_{oy1} ないし D_{oyn} を通じて電圧を印加すると、電子放出部23から電子が放出される。それと同時にメタルバック8（あるいは不図示の透明電極）に高圧端子HV

を通じて5kVの高電圧を印加して電子放出部23から放出された電子を加速し、フェースプレート3の内面に衝突させる。これにより、蛍光膜7の蛍光体7a

(図 1 3 1 参照) が励起されて発光し、画像が表示される。ところで、本実施例を含む陽極に加速電極を備えた平面型の画像形成装置においては、発光輝度を確保するために加速電圧を大きくすることが要求される。したがって、陽極のメタルバック 8 と陰極の電位規定部 9 の間に印加される電圧は、大きい場合には 20kV 程度にもなり、陽極陰極の間隙の平行電場が形成されている領域の電界は 1kV/cm 乃至数十 kV/cm にも達する。しかしながら、こうした、陽極陰極の最外殻領域は、両電極の間隙のような空間的な対称性が崩れるため、電場が平行からずれ曲げられた状態となる。とくに、陽極陰極と絶縁部材との境界領域は電界集中がおこり、局所的に内部の間隙のほぼ 1.3 倍の電界の集中が生じる。また、通常電界集中に伴う電界放出が問題となるのは、ほとんどの場合、陰極側からの電子放出である。したがって、陰極終端側からみた陽極の電圧印加部分が直上になく、陽極が相対的に陰極よりも小さい構成をとれば、陰極側終端の電界集中が緩和するが、さらには、陽極終端部が陰極終端部よりも陰極への射影面内において内側すなわち電界印加領域側に少なくとも陽極陰極間距離 d だけ引き込んだ構成をとれば、終端部の陽極陰極間距離は実質的に $1/\sqrt{2}$ だけ抑制され、陰極側の電界集中が問題とならないレベルまで緩和させることが可能となる。もちろん、陽極陰極の終端部の投影境界の差として、 d よりおおきく確保しても陰極側の電界集中が緩和されていれば差し支えない。

【 0 4 3 9 】

次に、本発明の陽極陰極の配置のより好ましい構成の説明のために、フェースプレート構成の拡大詳細図を図 1 3 2 に示す。図 1 3 2 において、1005 は導電性向上のため設けられた透明導電膜である ITO 膜 1011 とアルミニウム薄膜のメタルバック 1010 で覆われた蛍光体 1006 がパネル内側に設置された青板ガラスからなるフェースプレートである。最外周縁部の電子放出素子 1002 から放出された一次電子が入射方向から θ の角度で後方散乱され、後方散乱電子が平行電界により再加速されている様子を模式的に表している。 d はフェースプレート 1005 とリアプレート 1001 の間隔であり、実質的に陽極・陰極間の距離に等しい。 F は一次電子線が照射される蛍光体 1006 の周縁部から、導電体であるメタルバック 1010 と ITO 膜 1011 の端部までの距離を表している。

【0 4 4 0】

図 1 3 2 に示すように一次電子線が入射するアルミメタルバック1010上の点を原点にとり、x軸、y軸を図の通りに考えると、後方散乱角 θ で後方散乱した電子線の軌道は

【0 4 4 1】

【数 1】

$$x = v_0 t \sin \theta$$

$$y = \frac{eE_y}{2m} t^2 - v_0 t \cos \theta$$

となる。ここに、 v_0 は後方散乱電子線の後方散乱直後の速度の絶対値、 e 、 m はそれぞれ、電子の電荷、質量である。 E_y 、 t は y 方向電界強度と時間である。なお、ここでは平行電場を仮定しており、x 方向の電界強度 $E_x = 0$ としている。

次に、電子線が電界に再加速されて、着地 ($y = 0$) するまでの距離 $x(\theta) = F$ を求める。そのために、次の関係を用いて、上式に代入、変形すると、

【0 4 4 2】

【数 2】

$$v_0 = \sqrt{\frac{2\alpha e V_a}{m}}$$

$$E_y = \frac{V_a}{d}$$

$$F(\theta) = 2\alpha d \sin 2\theta$$

となる。ここに、 α 、 V_a はそれぞれ、一次電子線と後方散乱電子線のエネルギー比、フェースプレートに印可された一次電子線の加速電圧である。 α は一次電子線が入射する部材の材質、形状、構成等に大きく依存し、一般に $\alpha = 0.6 \sim 1$ である。 F は $\theta = \pi/4$ にて、次式で表される最大値をとり、

$$F = 2\alpha d$$

すなわち、周縁部で生じた後方散乱電子線は周縁部から、最大 $2\alpha d$ の距離に再着地することがわかる。

【0 4 4 3】

以上の考察に基づき、画像形成部の周縁部から $2\alpha d$ 以上に導電体を配し、さらにその外側に側壁部を配置することにより、後方散乱電子線が画像表示エリア外のガラス等の絶縁部や側壁部に衝突することがなくなる。そして、二次電子放出やガス放出等に伴う帯電や放電が減少し、平板型画像形成装置の高精細化／高色純度化、そしてデバイスとしての信頼性が向上する。

【0 4 4 4】

次に、本発明の陽陰極の配置のさらなる好ましい構成の説明のために、リアプレート構成の拡大詳細図として図 1 3 2 を用いて説明する。電子放出部 1002 から放出されたがフェースプレート 1005 の内面に衝突することにより蛍光体 1006 が発光するが、この発光現象以外に、蛍光膜 1006 やメタルバック 1010 に付着した粒子が電離・散乱される現象が生じる。この散乱粒子のうち、正イオンはメタルバック 1010 に印加される電圧により電子源 1003 側に向かって加速され、電界に対して垂直方向の初速度に応じて放物線軌道をとって飛翔する。

【0 4 4 5】

ここで、電子源 1003 とメタルバック 1010 との間の電位差を V_a 、正イオンの水平方向の初期運動エネルギーの最大値を $e V_i$ [eV]、正イオンの質量 m [kg] 電荷量 $+q$ [C] 垂直方向への初速度を v_{in} 、水平方向への初速度を v_{it} としたとき、メタルバック 8 の表面に発生した正イオンが距離 d だけ離れた電子源 1003 に到達するまでに要する時間 t と電子源 1001 の面に平行な方向への移動距離 ΔS は、

【0 4 4 6】

【数 3】

$$v_{in}t + \frac{qVa}{2md}t^2 = d \quad (1)$$

$$Vi = \frac{v_{in}^2 + v_{it}^2}{2m} \quad (2)$$

$$\Delta S = v_{it}t \quad (3)$$

で表わされる。

このとき、正イオンの条件としての最大到達範囲は、下記条件 (4)、(5) で

与えられ

【0 4 4 7】

【数 4】

$$q = +1e \text{ [C]} \quad (4)$$

$$v_{in} = 0 \text{ [m/s]} \quad (5)$$

このとき

【0 4 4 8】

【数 5】

$$\Delta S_{max} = 2d \times \sqrt{\frac{v_i}{V_a}} \quad (6)$$

となる、なお、本実施例では、メタルバック1010と蛍光体1006とをあわせた厚さは約50 μ m以下であるので、電子源1001とメタルバック1010との距離dを、リアプレート1001とフェースプレート1006との距離としても実用上は差し支えない。

【0 4 4 9】

仮に、メタルバック1010の表面で発生した正イオンが、メタルバック1010に印加された電圧によるエネルギーの全てを受けて電子源1003の面と水平な方向に飛び出したとすると、この正イオンが電子源1003に到達するまでの移動距離 ΔS は、(6)式において V_i に V_a を代入し、 $\Delta S_{max} = 2d$ (7)となる。すなわち、メタルバック1010の、実際に電子が衝突する位置から電子源1003の面に対する垂線を延ばし、電子源1003の内面上において、この垂線の電子源1003との交点を中心とする半径2dの範囲内が、メタルバック1010の表面で発生した正イオンが到達する可能性のある部位である。

【0 4 5 0】

したがって、少なくとも(7)式を満たす範囲内を電位規定しておけば、メタルバック1010の表面で発生した正イオンの飛翔方向に電位不定面が存在せず、電子源1が帯電することがなくなる。本実施例では、上述したように陰極側電位規

定部1003を陽極側電位規定部1010から水平にかつ外側に少なくとも d 、さらに、陽極側電位規定部1010を電子被照射領域1006から同じく水平にかつ外側に少なくとも $1.2d$ 離れた所まで配置しているため、陰極側電位規定部1003は被照射領域1006から $2.2d$ 外側にまで形成されていることになり、結果的に、この電位規定部1003の範囲は(7)式を満たしている。もちろん、電位規定部1003の大きさを上述した範囲よりも大きくしても、(7)式を満たす範囲内が電位規定されていることになるので差し支えない。

【0451】

また、電位規定部1003を構成する電位規定膜の抵抗値は比較的高いが、電位規定部1003全体に対する電位規定膜の面積の比率は30%以内であり、他の部分は金属からなる電極等、抵抗値が十分に低い導電材で覆われているため、電位を規定するには十分である。すなわち電位規定部1003は、その全てが抵抗値が低い導電材で構成される必要はなく、抵抗値が低いものと高いものとを組み合わせで構成してもよい。この場合、電位規定部1003の面積のうち50%以上を表面抵抗値が $1 \times 10^5 \Omega/\square$ 以下の導電材で構成し、残りの部分を表面抵抗値が 1×10^0 の $1.2 \times 10^2 \Omega/\square$ 以下の導電材で構成することが好ましい。

【0452】

以上説明したように陰極側基板上に電位規定部1003を設けることで、フェースプレート1005の内面の帯電が発生しなくなるので、電子放出部1002から放出された電子の軌道が安定し、位置ずれのない良好な画像が得られた。また、放電等が引き起こされる確率も極めて低くなり、信頼性の高い画像形成装置が得られた。

【0453】

通常、電子放出素子1015の対の素子電極16、17間の印加電圧は12～16V程度、メタルバック1010と電子源1001との距離 d は2mm～8mm程度、メタルバック8の印加電圧 V_a は1kV～10kV程度である。本実施例では、対の素子電極1016、1017間の印加電圧は14V、メタルバック1010と電子源1との距離は上述したように5mm、メタルバック8の印加電圧 V_a は5kVとした。

【0454】

なお、本構成における電位規定部は、例えばX方向及びY方向での素子電極の配置ピッチからなる微小領域中の基板よりも抵抗が小さく電位が規定されている部分の割合が30%以上の領域として認識することができる。

【0455】

(構成25)

フェースプレートとリアプレートとの関係については、フェースプレートよりもリアプレートを大きくする構成をとることができる。例えば、リアプレートのサイズは、900mm×580mm、フェースプレートサイズ850mm×530mmを使用することができる。

【0456】

表面伝導型電子放出素子を、基板を兼ねるリアプレート上に複数形成し、マトリクス状に配線して電子源を形成し、これを用いて画像形成装置を作製した。図133は、その一例である画像表示装置の正面図である。図133において、101は電子放出素子を構成した青板ガラスからなるリアプレート、105は電子放出部、109はメタルバック及び蛍光体が形成された青板ガラスからなるフェースプレート、111は外枠、403はX方向配線、406はY方向配線、316は画像表示装置を駆動するための駆動用プリント基板、206はX、Y方向配線403、406とプリント基板316とを接続するFPC、である。なお、配線の取り出しは、例えば画像表示部が10インチ角の場合3方向から、30インチ角の場合4方向からとすることができる。次に、本構成の実施例を挙げる。

【0457】

(実施例1)

図133に画像表示装置にFPCとプリント基板を接続した図を示す。図にはFPCを分割した状態を示すが、一括FPCでもよい。

【0458】

まず、リアプレート101の外部取出し配線であるX方向電極配線403にACFをFPC206を接続する位置に貼り付ける。次にリアプレート101のX方向電極配線403とそこからプリント基板までを接続するのに必要なFPC206を接合する位置にセットしX方向電極配線403の位置合わせを行い一致させる。

F P C 2 0 6 の F P C 電極 2 0 7 と リアプレート 1 0 1 の X 方向電極配線 403 が一致したところで、F P C 2 0 6 と画像表示装置を熱圧着ツールの下に移動させる。その後熱圧着ツールを降ろして F P C 2 0 6 と X 方向電極配線 403 を A C F によって熱圧着させ F P C 2 0 6 と X 方向電極配線 403 の接合を完了した。このように、F P C 206 と X 方向電極配線 403 の接合を完了し 1 辺の接合を行った。それをリアプレート 101 の X 方向電極配線 403、Y 方向電極配線 406 の必要な 4 辺について行った。その後、リアプレート 101 に接合された F P C 206 についているコネクタ(不図示)をプリント基板 316 のコネクタ部にさし込み、リアプレート 101 とプリント基板 316 の接続が完了した。この画像表示装置の X 方向配線には 1 4 V の任意の電圧信号を、Y 方向配線には 7 V の電位とし、フェースプレートのメタルバックに 5 k V のアノード電圧を印加したところ、放電のない任意の良質な画像を表示することができた。

【 0 4 5 9 】

以上のようにして、画像表示装置を製造した。以上のように作製した画像表示装置はリアプレートのみ外部取出し電極を持つため、通電処理時にリアプレートのみプローバ等を上から落して工程ができるため容易に電極に電圧や電流を流すことができ、電極部の接触不良がほとんどなくなるため、均一な画像を作製することができる。

【 0 4 6 0 】

また、F P C の接合時に、画像表示装置を反転することなく接合ができるため、反転による画像表示装置の保持方法の煩雑や割れの危険がなく、接合時の時間が短縮できる。また、反転無しの接合と比較して、接合装置が単純で容易なため不良がほとんどない接合ができる。

【 0 4 6 1 】

(実施例 2)

本発明の実施例 2 を以下に示して説明する。本発明のフェースプレートサイズは、9 0 0 m m × 5 8 0 m m、リアプレートサイズは 8 5 0 m m × 5 3 0 m m を使用した。

【 0 4 6 2 】

このフェースプレート、外枠、リアプレートを使用してパネルを作製するが、一部のパネルの作製方法については第1実施例と同様であるので異なる部分のみを述べる。図 1 3 4 は、その一例である画像表示装置の正面図である。図 1 3 4 において、2 1 0 は電子放出素子を構成した青板ガラスからなるリアプレート、1 0 5 は電子放出部、403はX方向配線、406はY方向配線、316は画像表示装置を駆動するための駆動用プリント基板、206はX、Y方向配線403、406とプリント基板316とを接続するFPC、である。フェースプレートは省略してある。

【0 4 6 3】

まず、基板に前述の電子放出部105を形成しておく。また、画像表示装置のフェースプレートの内側表面には、あらかじめ蛍光体を塗布し、さらに蛍光体の表面に導電性を持たせたメタルバックを形成しておく。

【0 4 6 4】

このフェースプレート、外枠、リアプレート201、排気管（不図示）等に低融点ガラスを塗布し、フェースプレートの位置とリアプレートとの位置合わせを行った後、治具等により固定したのち、電気炉にいれて低融点ガラスの融点以上の温度に加熱し、接合し機密容器を完成させる。

【0 4 6 5】

その後、配線を通してブローバーによって通電処理を行い、最後に排気管を封止する。次に、上記のように作製した画像表示装置の外部取出し配線とFPCとを接続させる方法を説明する。図 1 3 4 に画像表示装置にFPCとプリント基板を接続した図を示す。まず、フェースプレートを下にして、圧着装置上にセットする。次に、リアプレート201の外部取出し配線であるX方向電極配線403又は503にACFを、FPC206を接続する位置に貼り付ける。次にリアプレート201のX方向電極配線403又は503とそこからプリント基板までを接続するのに必要なFPC206を接合する位置にセットしX方向電極配線403又は503の位置合わせを行い一致させる。FPC206のFPC電極207とリアプレート201のX方向電極配線403又は503が一致したところで、FPC206と画像表示装置を熱圧着ツールの下に移動させる。その後熱圧着ツールを降ろしてFPC206とX方向電極配線403又は503をACFによって熱圧着させFPC206とX

方向電極配線403又は503の接合を完了した。このように、FPC206とX方向電極配線403又は503の接合を完了し1辺の接合を行った。それをリアプレート201のX方向電極配線403又は503、Y方向電極配線406又は506の必要な4辺について行った。その後、リアプレート201に接合されたFPC206についているコネクタ(不図示)をプリント基板316のコネクタ部にさし込み、リアプレート201とプリント基板316の接続が完了した。この画像表示装置のX方向配線には14Vの任意の電圧信号を、Y方向配線には7Vの電位とし、フェースプレートのメタルバックに5kVのアノード電圧を印加したところ、放電のない任意の良質な画像を表示することができた。

【0466】

以上のように作製した画像表示装置は実施例1と異なり、通電処理時、FPC接合時にフェースプレートを下にしてセットして工程を得ることになるが、セットする時にリアプレートを下かフェースプレートを下にするかの違いだけで、特に工程に差が生じることはない。このように、フェースプレートのみにより外部取出し電極を持つため、通電処理時にフェースプレートのみによりプローバ等を落して工程ができるため容易に電極に電圧や電流を流すことができ、電極部の接触不良がほとんどなくなるため、均一な画像を作製することができる。

【0467】

また、FPCの接合時に、画像表示装置を反転することなく接合ができるため、反転による画像表示装置の保持方法の煩雑や割れの危険がなく、接合時の時間が短縮できる。また、反転無しの接合と比較して、接合装置が単純で容易なため不良がほとんどない接合ができる。

【0468】

(実施例3)

本構成の実施例3を以下に示して説明する。本構成のフェースプレートサイズは、300mm×250mm、リアプレートサイズは350mm×300mmを使用した。まず、リアプレート101に実施例1と同様に電子放出部105や電極を形成しておく。また、画像表示装置のフェースプレート109の内側表面には、あらかじめ蛍光体107を塗布し、さらに蛍光体に表面に導電性を持たせたメタル

バック108を形成しておく。このフェースプレート109、外枠111、リアプレート101、排気管（不図示）等に低融点ガラスを塗布し、フェースプレート109の位置とリアプレート101との位置合わせを行なう。この時、リアプレートとフェースプレートの1辺又は2辺の端面を一致させるように位置合わせを行った後、治具等により固定したのち、電気炉にに入れて低融点ガラスの融点以上の温度に加熱し、接合し機密容器を完成させる。（図135（a）、（b）参照）

【0469】

次にこのフェースプレート、外枠、リアプレートを使用してパネルを作製するが、一部のパネルの作製方法については第1実施例と同様であるので異なる部分のみを述べる。図136は、その一例である画像表示装置の正面図である。図136において、101は電子放出素子を構成した青板ガラスからなるリアプレート、105は電子放出部、109はメタルバック及び蛍光体が形成された青板ガラスからなるフェースプレート、111は外枠、403はX方向配線、406はY方向配線、316は画像表示装置を駆動するための駆動用プリント基板、206はX、Y方向配線403、406とプリント基板316とを接続するFPC、である。その後、配線を通してプローバによって通電処理を行い、最後に排気管を封止する。次に、上記のように作製した画像表示装置の外部取出し配線とFPCとを接続させる方法を説明する。図136に画像表示装置にFPCとプリント基板を接続した図を示す。

【0470】

まず、フェースプレート201の外部取出し配線であるX方向電極配線403にACFをFPC206を接続する位置に貼り付ける。次にリアプレート1のX方向電極配線403とそこからプリント基板までを接続するのに必要なFPC206を接合する位置にセットしX方向電極配線403の位置合わせを行い一致させる。FPC206のFPC電極207とフェースプレート201のX方向電極配線403が一致したところで、FPC206と画像表示装置を熱圧着ツールの下に移動させる。その後熱圧着ツールを降ろしてFPC206とX方向電極配線403をACFによって熱圧着させFPC206とX方向電極配線403の接合を完了した。このように、FPC206とX方向電極配線403の接合を完了し1辺の接合を行った。それをフェースプレート201のX方向電極配線403、Y方向電極配線406の必

要な3辺について行った。また、X方向電極配線403、Y方向電極配線406の各1辺のみをFPC接合し、合計2辺をFPC接合したものでよい。(図137参照)その後、フェースプレート201に接合されたFPC206についているコネクタ(不図示)をプリント基板316のコネクタ部にさし込み、フェースプレート201とプリント基板316の接続が完了した。この画像表示装置のX方向配線には14Vの任意の電圧信号を、Y方向配線には7Vの電位とし、フェースプレートのメタルバックに5kVのアノード電圧を印加したところ、放電のない任意の良質な画像を表示することができた。以上のようにして、画像表示装置を製造した。

【0471】

このように、フェースプレートの上に外部取出し電極を持つため、フォーミング、活性化工程時にフェースプレートの上にプローバー等を落して工程ができるため容易に電極に電圧や電流を流すことができ、電極部の接触不良がほとんどなくなるため、均一な画像を作製することができる。また、接合辺が2辺又は3辺のため電極部の接触部が少なくなるため実施例1、2よりさらに接触不良が低減する。

【0472】

また、FPCの接合時に、画像表示装置を反転することなく接合ができるため、反転による危険がなく、接合時の時間が短縮できる。また、反転無しの接合と比較して、接合装置が単純で容易なため不良がほとんどない接合ができる。また、接合辺が2辺又は3辺のため実施例1、2より接合時間がより短縮できる。

【0473】

本構成によれば、作製プロセスが容易となり、FPC接続時での接続信頼性が高く、またFPCの接合方向が一緒なのでFPC処理が容易となり、基板回転がないので安全性も向上し、製造時間の短縮となる。このように作製時の接続不良の減少により均一な画像を効率よく得られ、信頼性の高い画像表示装置を安定に供給することが可能になるので生産性のよい画像表示装置を提供することができる。

【0474】

(構成 26)

一方、図 1 に示すような画像表示装置全体の組立にかかる構成としては以下の
ような構成をとり得る。

【0475】

(実施例 1)

図 138 に、本発明による画像表示装置の斜視図を示した。同図において、1 はマルチ電子ビーム源を形成した電子源基板、2 は電子線照射により発光する蛍光体を備えし表示用基板、3 は電子源基板 1 の配線端部に直接接続された駆動 IC である。図 139 は、この駆動 IC を配線端部に接続する部分の断面を示した図である。1 は電子源基板、6 は電子源基板 1 上に形成された行又は列配線の一部である取り出し電極部、3 は駆動 IC チップ、4 は駆動 IC チップの接続端子として形成された金属（例えば金）によるバンプ、5 は導線性接着材、7 は封止材である。ここで、行または列配線 6 としては導電性ペーストを印刷形成する。配線は膜厚が厚い方が電気抵抗を低減できるため有利である。そのため厚膜印刷法、特にスクリーン印刷法をもちいるのが好ましく銀、金、銅、ニッケル等の導電性ペーストを用いることができる。なお、より高精細なパターンニングが要求された場合には、感光性ペーストを用いて大まかなパターンをスクリーン印刷によって形成した後に、露光、現像することによって良好な配線形状が得られる。なお、所望のパターンを形成した後にはペースト中のビヒクル成分を除去するために、そのペースト、使用ガラス基板の熱特性に応じた温度（400～650℃）で焼成される。

【0476】

また、厚膜配線を形成する技術としては、例えば、特開平 8-227656 に開示されている。すなわち、基板上に、無電解メッキによって下地金属層を形成し、この下地金属層上に所定パターンで絶縁層を形成し、この絶縁層の隙間部分、すなわち、下地金属層が露出している部分に電気メッキにより金属層を形成し、絶縁層を除去した後、露出している下地金属層をエッチング除去して、所望の導電パターンを形成するものである。

【0477】

さて、図139のような構成は、いわゆるCOG（チップ・オン・ガラス）と呼ばれる実装形態であり、同図に示した行又は列配線に駆動ICを実装する工程は、以下のようにしてなされる。

【0478】

駆動ICチップ3上のバンパ4に導線性接着剤5を転写し、電子源基板1上に配設した取り出し電極部6とアライメント後、電子源基板1上に駆動ICチップ3を下降させてマウントする。その後、加熱・紫外線照射等によって導電性接着剤を硬化させ、適当な樹脂材料によってICチップ3の保護コート7を行い実装を完成する。

【0479】

上述のような実装形態を電子源基板1に行うための具体的な取り出し電極部のレイアウトを図140に示した。同図において、6は列側配線の取り出し電極部であり、9は行側配線の取り出し電極部である。また、8、10は駆動ICとこれに接続される他の駆動回路部との接続を行う電極部である。同図において破線による四角で囲った部分の内側の電極部は、駆動ICとの接続部分に相当する。

【0480】

図141に電極部8（または10）の実装例を示した。3から8は図139の駆動IC実装部と同様である。11は、駆動IC3と他の駆動回路部とを接続するためのフレキシブルケーブルの導電材料による電極部、12は樹脂フィルムである。フレキシブルケーブルの電極11と電極部8とは、駆動ICと同様に導電性接着剤で接続される。

【0481】

尚、取り出し電極の接続部の接続面の大きさは、行側と列側で異なる。すなわち、行側の場合には、行選択した場合の総素子数分の駆動電流が流れるため、FE型の電子放出素子で0.05Aから0.2A程度、表面伝導型電子放出素子で1～10A程度の瞬時電流が流れる。一般的な導電性接着材の電流容量0.5A/mm²からすれば、接続部の面積は、0.1mm²から20mm²の領域を取る必要がある。

【0482】

一方、列側の場合には、当該素子分の駆動電流が流れるため、FE型の電子放出素子で $5\mu\text{A}$ から $20\mu\text{A}$ 程度、表面伝導型電子放出素子で $0.2\text{mA}\sim 2\text{mA}$ 程度の実効電流が流れる。一同様に接続部の面積は、 0.00001mm^2 から 0.04mm^2 の領域を取る必要がある。但し、導電性接着剤の導電フィラーの大きさなどによる最小実装面積に限界があるため、 0.00001mm^2 という実装面積は実際には 40ミクロン角程度 、すなわち 0.00016mm^2 程度が限界と考えられる。

【0483】

さて、このマルチビーム電子源の配線交差部による容量成分をLCRメータにより測定したところ、交差部当たり 0.05pF で、 $n=3072$ とすると 154pF となった。一方、約 30mm の取り出し電極部での誘導成分は、 30nH とマトリクス部での誘導成分は 320nH と測定された。従って、共振周波数は、 22MHz と求められた。一方、課題図2における V_s および V_e の立ち上がり時間を調べたところ、それぞれ約 60nsec および 80nsec で、最高周波数成分としては約 17MHz となる。したがって、共振周波数を駆動信号の最高周波数よりも高くすることができ、リングングの発生を十分低減することができた。尚、取り出し電極部と駆動IC部とをフラットケーブルでつなぐ従来の実装方法の場合、前記取り出し電極部、 80mm のフラットケーブル部及び駆動ICまでの電気回路パターンでの誘導成分は約 170nH あり、共振周波数は 18MHz となり、共振周波数に近い周波数となりリングングの発生の懸念が生じる。

【0484】

以上説明したように、行および列配線端部に駆動ICを直接実装することにより、配線取りだし部及び駆動ICとの接続部の誘導成分を最小限とすることができ、マトリクス配線に形成される容量成分とによる共振周波数を十分高くとることができ、駆動信号にリングング波形が加算されることが回避され高品位な画像表示を行うことができた。

【0485】

(実施例2)

本実施例は、実施例1と行側配線端部での駆動IC実装は同様であるため、説

明を省略する。本実施例の列側配線端部での駆動 IC の実装部を図 140 および図 142 を用いて説明する。図 140 における A 部の列側配線端部の構成が実施例 1 と異なるために、その拡大図を示したものが図 142 である。同図 (a) は実施例 1 における A 部の拡大図であり、6 は厚膜配線による取り出し電極部、13 は駆動 IC との接続部である。一方、同図 (b) は本実施例における A 部の拡大図である。6 は厚膜配線による取り出し電極部であり、14 は薄膜配線による補助電極部である。13 は補助電極部 14 上に設けられる駆動 IC との接続部である。

【0486】

次に、補助電極部の役割について説明する。一般に、厚膜配線はスクリーン印刷やめっきなど、低抵抗配線の形成は容易に行うことが出来るが、表面の平面性を十分にとる事は難しく、研磨や或いは接続部の面積を十分にとる必要でてくる場合がある。一方、薄膜配線は、フォトリソグラフィを用いる場合やオフセット印刷を用いる場合など、微細な領域にわたり十分平滑性の良い電極部を形成することができる。具体的には、真空蒸着法、スパッタリング法、プラズマ CVD 法等の真空系を用いて成膜した後にリソグラフィ法でパターニングしてエッチングする方法や、有機金属を含有する MO ペーストをガラス凹版を使ってオフセット印刷する方法を選択することができる。電極部 14 の材料としては導電性を有するものであればどのような物であっても構わないが、例えば、Ni、Cr、Au、Mo、W、Pt、Ti、Al、Cu、Pd 等の金属あるいは合金、及び Pd、Ag、Au、RuO₂、Pd-Ag 等の金属あるいは金属酸化物とガラス等から構成される印刷導体、及びポリシリコン等の半導体材料、及び In₂O₃-SnO₂ 等の透明導電体等があげられる。従って、必要最小限の接続部の面積で駆動 IC の実装を行うことができる。尚、本実施例においてはマルチ電子ビーム源 1 には青板ガラスを用い、電極部 14 にはオフセット印刷による Ni 薄膜を用いた。電極部 14 の厚さは 0.1 μm、幅は 100 μm、長さは 400 μm とした。

【0487】

また、前に述べたように、リングングの発生に寄与する可能性のある誘導成分 L は、 $L_c + (L_c/n)$ で示される。これは行選択駆動を行った場合のうち多

くの電子放出素子が電子放出動作状態のときに相当する。一方、特定の画像を表示する場合であり、選択行の内わずかの素子数しか電子放出状態になる場合には、 L の式のうち実質的に n が小さい数字をとり L_c の成分が無視できない状態が発生する。この場合、先に $L=30\text{ nH}$ と見積ったところを最大2倍の $L=60\text{ nH}$ と見積られる場合も生じてくる。この対策として、 LCR の直列共振回路における R 成分として、補助電極14に実効的に減衰定数 $\xi=2R/\sqrt{L/C}$ が1以上となるような配線抵抗を（この場合 $10\ \Omega$ 以上の値）積極的に与えてやることにより、リングングの発生を抑制する、いわゆるダンピング効果を得ることが出来る。

【0488】

また、何らかの原因で配線に異常電位が加わった場合には、列側の駆動ICにも印加されてしまい、駆動ICを壊してしまう可能性に対しても、上に述べたのと同様に積極的に補助電極14に抵抗を与えることで保護抵抗の役割を与える事が出来る。仮に、 3 V の異常電位を配線側で起こした場合には、駆動ICの流入可能電流を 10 mA として、補助電極での抵抗を $300\ \Omega$ とすると駆動ICへの印加は全く起こらない。前述したオフセット印刷による補助電極部14は、圧膜配線端部と駆動IC実装部13までの抵抗値としては、約 $300\ \Omega$ が得られた。

【0489】

以上説明した様に、本実施例では、取り出し電極部に薄膜による補助電極を設けることにより、より高密度に、また、より安定駆動を行うことができる。

【0490】

（構成27）

装置の組立にかかる構成としては以下の構成を更に挙げることができる。

【0491】

（実施例1）

図143に、本発明の画像表示装置において、駆動電気回路部104を構成する電気回路基板の基板レイアウト図を示す。本発明の画像表示装置は、フェースプレート101とリアプレート102からなる画像表示部103、画像表示のための駆動電気回路部104、それらを支持する支持構造部材105、更に外装部

材（カバー：不図示）と電源ユニット 110 で構成されている。図 143 は画像表示装置を画像表示側の反対側から見たときのレイアウトを示している。

【0492】

駆動電気回路基板 104 は、大きく分けると、走査回路基板 106、変調回路基板 107、画像データ発生回路基板 108、入力インターフェース（I/F）基板 109 からなる。走査回路基板 106 は画像表示部 103 のリアプレート 102 基板の走査配線 4002 を線順次選択するパルス走査信号を発生する。この時、走査回路基板 106 はリアプレート 102 の走査配線を左右同時から駆動するため、走査回路基板 #1：106a、走査回路基板 #2：106b からなる。変調回路基板 107 は、リアプレート 102 の走査配線と直交した変調側配線 4003 からマルチ電子源をパルス幅変調駆動するためのパルス変調信号を発生する。本実施例においては画像表示装置のサイズが大きく、2 枚の変調回路基板 107a、b に分割して構成した。

【0493】

画像データ発生回路基板 108 は、画像情報を変調回路基板 107 への変調データに変換する。入力インターフェース（I/F）基板 109 は、入力画像信号から R・G・B コンポーネント信号を出力するデコーダ部と入力画像信号に重畳されている同期信号（SYNC）を分離し、各種タイミング信号を発生する。

【0494】

本実施例において、駆動電気回路部 104 を構成する電気回路基板のなかで、発熱が大きな変調回路基板 107 を上方にレイアウトし、変調回路基板 107 への信号を出力する画像データ発生回路基板 104 をその下方にレイアウトした。また 1 対の走査回路基板 106 は画像表示装置の左右端にレイアウトした。

【0495】

図 144 に本発明の画像表示装置の駆動電気回路の機能ブロック図を、図 145 にそのタイミング図を示す。P2000 は表面伝導型電子放出素子を単純マトリクス構成したマルチ電子源を配したリアプレートとフェースプレートで構成された画像表示部（以下表示パネルと略す）であり、本実施例においては 480×2556 個の表面伝導型素子 P2001 が垂直 480 行の行配線と水平 2556

列の列配線によりマトリクス配線され、各表面伝導型素子 P 2 0 0 1 からの放出電子ビームが高圧電源部 P 3 0 から印加される高圧電圧により加速され不図示のフェースプレート側蛍光体に照射されることにより発光を得るものである。この不図示の蛍光体は用途に応じて種々の色配列を取ることが可能であるが、一例として RGB 縦ストライプ状の色配列とする。

【0496】

本実施例においては以下前記水平 852 (RGB トリオ) * 垂直 480 ラインの画素数を有する表示パネルに HDTV 相当のテレビ画像を表示する応用例を示すが、HDTV に限らず NTSC のような高精細な画像やコンピュータの出力画像など、解像度やフレームレートが異なる画像信号に対しても、ほぼ同一の構成で容易に対応できる。

【0497】

本実施例において、走査回路 106 が選択した行 P 2 0 0 2 上の素子をパルス幅変調して駆動することで、パルス幅に応じた期間だけ各素子から電子放出する。この走査回路が選択するラインを順次走査することで 2 次元画像が形成される。

【0498】

以下、画像信号の流れに従って説明する。画像信号は、まず、入力 I/F 基板 109 に入力する。入力 I/F 基板 109 は P 1、P 2 ブロックからなる。P 1 は、HDTV のコンポジットビデオ入力を受け RGB コンポーネント信号 (図 145、T 101) を出力する HDTV-RGB デコーダ部である。このユニット内にて入力ビデオ信号に重畳されている同期信号 (SYNC、図 145 : T 102) を分離し、またサンプリング CLK 信号 (CLK1) を生成し出力する。P 2 は、P 1 にてデコードされたアナログ RGB 信号を、表示パネルを輝度変調するためのデジタル階調信号に変換するために必要な以下のタイミング信号を発生するためのタイミング発生部である。

- ・ P 1 からの RGB アナログ信号をアナログ処理部 P 3 にて直流再生するためのクランプパルス、
- ・ P 1 からの RGB アナログ信号にアナログ処理部 P 3 にてにブラंक期間を付

加するためのブランキングパルス、

- ・ アナログ RGB 信号を A/D 部 P 6 にてデジタル信号に変換するためのサンプルパルス（不図示）、
- ・ ラインメモリ P 10、輝度ラインメモリ P 22 を書き込み、読み出しするタイミング信号
- ・ 走査制御信号 Y s c a n

RGB コンポーネント信号は、画像データ発生回路基板 108 に入力される。画像データ発生回路基板 108 は、P 3 ~ P 10 のブロックからなる。P 3 は、P 1 からの出力原色信号それぞれに備えられるアナログ処理部であり、主に以下の動作をする。

- ・ P 2 からクランプパルスを受け直流再生を行なう。
- ・ P 2 からブランキングパルスを受けブランキング期間を付加する。
- ・ P 1 から入力された原色信号の振幅制御や P 1 から入力された原色信号の黒レベル制御を行なう。

【0499】

LPFP 5 は、A/D 部 P 6 の前段に置かれるプリフィルタ手段である。A/D 部 P 6 は LPFP 5 を通過したアナログ原色信号を必要階調数で量子化する A/D コンバータ手段である。逆 γ テーブル P 7 は、入力されるビデオ信号を表示パネルが有する発光特性に変換するために備えられた階調特性変換手段である。本実施例のようにパルス幅変調により輝度階調を表現する場合、輝度データの大きさに発光量がほぼ比例するリニアな特性を示すことが多い。一方ビデオ信号は、CRT を用いた TV 受像機を対象としているため、CRT の非線形な発光特性を補正するために γ 処理を施されている。このため本実施例のようにリニアな発光特性を持つパネルに TV 画像を表示させる場合、P 7 のような階調特性変換手段で γ 処理の効果を打ち消す必要がある。P 10 は、各原色信号毎に備えられる水平ラインメモリ手段であり、RGB 其々の輝度データを変調回路基板 107 へ出力する。（図 145 : T 105）

【0500】

一方、106 a, b は、走査回路基板であり、Y シフトレジスタ部 P 1002

、プリドライバP1003、スイッチトランジスタから構成される。

Yシフトレジスタ部P1002は、水平周期のシフトクロック及び行走査開始トリガを与えるための垂直周期のトリガ信号を受け行配線P2002を逐次、走査するための選択信号を各行配線毎に備えられるプリドライバ部P1003に順に出力する。各行配線を駆動する出力部は例えば、FET手段P1004、P1006から構成される。プリドライバ部P1003はこの出力部を応答良く駆動するためのものである。FET手段P1004は行選択時に導通するスイッチ手段で選択時に $-V_{ss} = -7\text{V}$ 電位を行配線に印加する。FET手段P1006は行非選択時に導通するスイッチ手段で非選択時にGND電位を行配線に印加する。図145、T112に行配線駆動波形の一例を示す。

【0501】

次に、画像データ発生回路108からのラインメモリ出力P10であるRGB輝度データが変調回路基板107に入力された後の信号の流れを説明する。1水平期間の間に、RGB輝度信号は其々、水平方向の素子数2556個(R1-R852、G1-G852、B1-B852)が出力される。これを1水平期間の間に変調側配線に接続した2556個のドライバに転送し、各変調ドライバはパルス幅変調出力を発生する必要がある。そこで、高速に変調側ドライバへのデータ転送を行うためにラインメモリP10をいったん、16ブロックからなる輝度ラインメモリP22に転送し、各ラインメモリP22が其々160個の変調ドライバデータを同時に転送するようにした。すなわち、P10のRGBラインメモリの出力をP2003で接続されたパネルの蛍光体色に応じた順番に並べ替えて直列信号に変換し、輝度信号用ラインメモリP22に転送する。

【0502】

シフトレジスタ・ラッチ回路P1101は、ラインメモリP22からの水平周期毎の2556個の列配線数の輝度データ列(画像情報)をシフトクロック(図3:T107)により読み込み、図3:T108のようなLDパルスによりシフトレジスタ・ラッチ回路P1101内のラッチ回路P11101bに並列にラッチし、PWMジェネレータ部P1102に2556個の1水平列分のデータを一度に転送する。

【0503】

各列配線毎に備えられるPWMジェネレータ部P1102はシフトレジスタ・ラッチ回路P1101内のラッチ回路からの輝度データ（画像情報）を受け、図145：T110に示す波形のように水平周期毎にデータの大きさに比例したパルス幅を有するパルス信号を発生する。

【0504】

P1104はトランジスタなどで構成されるスイッチ手段であり、 $+V_s = 7V$ 電圧出力をPWMジェネレータ部P1102からの出力が有効な期間列配線に印加し、PWMジェネレータ部P1102からの出力が無効な期間は列配線を接地する。図145：T111に列配線駆動波形の一例を示す。

【0505】

このような方法により、順次行配線を走査し、それに対応する画像情報でパルス幅変調された値で列配線を駆動し表示パネルP2000に画像を形成する。変調回路基板107のうち、輝度ラインメモリからパルス幅変調駆動信号を発生するドライバ段はIC化されている。即ち、ドライバICは160ch分の変調ドライバと、各ドライバのパルス幅変調データを転送、ラッチするシフトレジスタ回路とラッチ回路およびPWMジェネレータを有している。本実施例では、水平2556列の列配線に対して、輝度データを160個ずつシフトするシフトレジスタを使用しているため、シフト数としては、 $320 \times 8 = 2560$ 個であり、PWMジェネレータ部等もそれぞれ2560個で構成されている。ただし、スイッチ手段；P1104の2560個の出力端のうち左右それぞれ2ラインは、列配線に接続していない。

【0506】

次に、各ボードにおける発熱量を見積もってみた。算出にあたり、水平852(RGBトリオ)*垂直480ラインの素子数を想定し、また入力信号としては60Hzプログレシブスキヤンの画像信号を仮定した。素子特性に関しては、14V駆動時に1素子に流れる素子電流は1mAとした。

【0507】

1) 変調回路基板

変調回路基板における発熱は、A：出力トランジスタにおける電力損出と、B：ロジック部における電力消費に起因する。

A：出力トランジスタにおける電力損出であるが、1トランジスタのON抵抗を100Ωとすると、全白画面表示を行うと、

$$\begin{aligned} P_{losA} &= R_{on} \times (I_f)^2 \times 2556 \\ &= 100 \times (1 \text{ mA})^2 \times 2556 \\ &= 0.3 \text{ W} \end{aligned}$$

B：ロジック

前述の様に、1H（走査線480本、60Hzプログレシブスキャンにおいては～30us）期間の間に、2556個のPWMジェネレータP1102に8bit輝度データを転送する必要がある。この時のデータ転送時のロジック消費電力が最も多い。即ち、ドライバIC内で消費されるロジック消費電力が最も多い。

【0508】

即ち、ドライバIC1個あたりに、160個の8bitデータを転送するシフト動作とPWMカウンタ回路が動作する。一般に、一ロジックの消費電力は

$$P_{logic} = (1/2) \times f \times C \times (V_{logic})^2$$

ここで、fは動作周波数、Cはロジックゲート容量、V_{logic}はロジック動作電圧本実施例において、シフトカウンタ、PWMカウンタクロック=9MHzで動作させたところドライバIC1個あたり、1Wの消費電力が消費された。全部でドライバICは

$$P_{losB} = 1 \text{ W} \times 16 = 16 \text{ Wの電力損出になった。}$$

【0509】

2) 走査回路基板

変調回路基板における発熱は、A：出力トランジスタにおける電力損出と、B：ロジック部における電力消費に起因する。

B：走査回路基板の、ロジックの動作周波数は、低くほとんど問題にならなかった。

A：出力トランジスタによる損出（1トランジスタのON抵抗を0.2Ω、一つの基板当り）

$$\begin{aligned} P_{losA} &= R_{on} \times (\text{ライン} I_f / 2)^2 \\ &= 0.2 \times (2556 \text{mA} / 2)^2 \\ &= 0.3 \text{W} \end{aligned}$$

【0510】

3) 画像データ発生回路

変調回路基板における発熱は、主に、B:ロジック部における電力消費に起因する。ロジック部の消費電力は、ロジック動作電圧を3.3V動作させると10w程度だった。

1)~3)の結果より、最も発熱の多い変調回路基板107を画像表示部の上端に配し、また画像データ変換回路基板が変調回路基板の下に配した。また一对の走査回路基板を画像表示部の右または左端に配した。これにより画像表示装置は、駆動電気回路部からの発熱を効率よく放熱し、安定した動作をした。

本実施例によれば、駆動電気回路部を構成する電気回路基板からの発熱を、外装部材の上下に設けた空気取り入れ口から自然対流で十分に放熱することができた。

【0511】

これによりファンレスが実現され、静粛性の高い画像表示装置が実現された。特に、画像表示装置の解像度が増加した場合は、変調回路基板のロジック部の発熱が大きく本実施例のようなレイアウトが効果が高い。例えば水平方向画素数1920(×3素子数)、走査線1080本、60Hzプログレシブスキャンにおいては、前述のPWMカウンタやシフトクロックを>20MHzで動かす必要がある。この場合、ロジックの動作電圧を下げることはできても、ICの出力電圧で決まるロジックICのサイズは変えられないため、ロジックゲート容量が変わらず、ドライバIC1個あたり2Wの消費電力が消費され、変調回路基板の発熱が増えた。

【0512】

(構成28)

装置の組立にかかる構成としては以下の構成を更に挙げることができる。

【0513】

図 1 4 6 はこの構成の実施例における表示パネルのリアプレート側のコネクタの配置を示す図である。1 は真空封止された表示パネルである。表示パネルの詳しい構造および製造方法は後述する。2 は列配線端子となるフレキシブルケーブルおよびコネクタである。3 は行配線端子となるフレキシブルケーブルおよびコネクタである。4 は加速電圧端子である。

【0 5 1 4】

図 1 4 7 は表示パネル 1 に制御部、駆動部、電源部等を実装した場合の配置図である。5 は変調駆動部である。6 は走査駆動部である。7 は加速電圧発生部である。8 は装置全体の制御部である。9 は加速電圧用配線である。1 0 は装置の電源部である。

【0 5 1 5】

図 1 5 1 は加速電圧端子 4 の取り付け構造および行配線、列配線、加速電極との位置関係を示す図である。1 0 1 はリアプレートで、表示パネル 1 の裏面の構造部材である。1 1 1 はフェイスプレートで、表示パネル 1 の表面の構造部材である。1 0 4 は支持枠であり、フェイスプレート 1 1 1 とリアプレート 1 0 1 を支持する構造部材である。1 3 1 は加速電圧を供給するケーブルである。1 1 6 は加速電圧端子である。1 3 2 はゴムキャップである。1 2 2 はリアプレートに開けられた貫通穴である。1 2 1 は加速電圧端子領域を支持する中空部材である。1 2 0 は加速電圧の取り出し配線である。1 1 2 は加速電極であり、フェイスプレート 1 1 1 上に形成されており、取り出し配線 1 2 0 を通じて加速電圧端子 1 1 6 と電氣的に接続されている。1 0 2 は電子源領域であり、行配線、列配線、電子源が配置されており、リアプレート 1 0 1 上に形成されている。

【0 5 1 6】

図 1 5 0 は画像を表示するための処理の流れを示すブロック図である。3 1 は映像入力部である。3 2 は A/D コンバート部である。3 3 はタイミング制御部である。3 4 は信号処理部である。S 1 は入力された複合映像信号である。S 2 は同期分離された映像信号である。S 3 は複合映像信号 S 1 から分離された同期信号である。S 4 はデジタル化された映像信号である。S 5 は変調信号である。S 6 は変調駆動部に対するタイミング信号である。S 7 は走査信号である。S 8 は

走査駆動部に対するタイミング信号である。S8は加速電圧である。

【0517】

映像信号入力部31は複合映像信号S1を入力し、映像信号S2と同期信号S3に分離する。A/Dコンバート部32は映像信号S2をデジタル化しデジタル映像信号S4を出力する。タイミング制御部33は同期信号S3を基に、装置全体の動作タイミング信号を出力する。映像信号処理部34はデジタル映像信号S4を処理し、走査信号S7および変調信号S5を出力する。走査駆動部6は走査タイミング信号S8と走査信号S7に従い、行配線端子3を経由して、表示パネル1の行配線を±10V以下の低電圧で駆動する。変調駆動部は変調タイミング信号S6と変調信号S5に従い、列配線端子2を経由して表示パネル1の列配線を±10V以下の低電圧で駆動する。加速電圧発生部7は、高電圧を発生し、表示パネル1に加速電圧S8を供給する。表示パネル1の不図示の行配線と列配線の交点には不図示の電子源が配置されており、行配線と列配線の単純マトリックス駆動により電子ビームが発生し、表示パネル1内の不図示の蛍光体を発光させて画像を表示する。表示パネル1の構造および電子源の詳細については後述する。

【0518】

加速電圧発生手段7の高電圧発生方法としては、フライバック方式あるいはフォワードコンバータ方式等が用いられる。

【0519】

行配線端子3は表示パネル1内の不図示の行配線の両側に接続されており、2組の走査駆動部6によって全く同じ信号によって駆動される。こうする事により、行配線に流れる電流が両側に分散され、行配線の部分的な電圧降下が小さくなる。

【0520】

この装置の内、加速電圧端子4、電源部7、加速電圧用配線9は数KV～20KV程度の高電圧部、その他の部分は5V～15V程度の低電圧部である。高圧部と低圧部との距離Lは、1mm/KV以上離れている事が放電耐圧による安全上は望ましい。図147のように各部をレイアウトする事により低電圧部と高電圧部の

距離Lを容易に20mm以上離して配置する事が可能となり、放電耐圧が向上し装置の安全性が高まる。

【0521】

さらに、高電圧部は高電圧発生回路によるノイズの輻射が大きいため、装置の制御部8や駆動部5、6などの低電圧部を、高電圧部より離れた場所に配置可能となり、高電圧部の輻射ノイズによる回路の誤動作の可能性も低減できた。

【0522】

図152は表示パネル1のリアプレート101を正面から見た図である。この図では不図示のフレキシブルケーブル2、3は列配線105、行配線106の端の電極部にACFによって熱圧着接続される。リアプレートにおいても、列配線105、行配線106、不図示の電子源等からなる低電圧部の電子源領域102と高電圧部の加速電圧端子の中空部122との間の距離Lは0.5mm/KV以上離れている事が放電耐圧による安全上あるいは表示パネル1の性能維持のためには望ましく、1mm/KV以上離れていればさらに望ましい。行配線端子、列配線端子、加速電圧端子を図146のように配置する事によって、図152に示すように低電圧部の電子源領域と高電圧部の加速電圧端子の中空部122を容易に20mm以上離して配置する事が可能となり、表示パネル1内部での放電耐圧が向上して、装置の安全性が高まるとともにパネルの性能を長時間維持する事が容易となる。

【0523】

また、以上で述べた安全上望ましい高圧部と低圧部との距離（高圧部と低圧部が20mm以上離れている）を満たしていれば、図148に示したように加速電圧端子4は必ずしも表示パネル1の辺の中央に配置される必要はない。さらに図示はしていないが、同様に列配線端子12および行配線端子13も辺のどの部分に配置されてもよい。

【0524】

また、本発明を縦形の表示装置に適用する場合もほぼ同様の構成で実現できる。装置の重心が下方になるように、図149のように電源部7、10を装置の下方に配置し、装置内のレイアウトを多少変化させた点を除いては上記実施例と同様である。

【0 5 2 5】

特に、高圧電源は重量が高いため、表示パネルの重心よりも、下方に配置することにより、表示装置を設置した際の安定性が増すので好ましい。

また、各電源などの発熱部材は、表示パネルを構成するリアプレートには直接接触しない様に配置することが好ましい。これは、電源からの熱が表示パネルに意図しない応力を与えるのを避けるためである。

【0 5 2 6】

(構成 2 9)

画像形成装置からの除電を行う場合には以下の構成が利用できる。

【0 5 2 7】

(実施例 1)

図 1 5 3 が本構成の実施例での画像表示装置である。この実施例では実際に画像表示装置として駆動させた場合における除電駆動を行う時の方法を述べる。まず、画像表示装置の説明として、画像表示部 1 は実施例 1 と同じである。駆動方法としては、走査方法を線順次とし、表示画像に階調をつけるために、一水平走査時間 (1 H) 内の電子放出期間を変調信号の時間幅で制御することにより、蛍光体の発光総量を制御し階調表現することを基本としている。

図 1 5 3 において、信号分離回路 12 は NTSC などの映像信号から、水平同期信号、垂直同期信号、デジタル映像信号等を作製するための回路である。この中には映像中間周波数回路、映像検波回路、同期分離回路、ローパスフィルター、A/D 変換回路、タイミング制御回路等が含まれている。14 は、画像表示部の行方向配線を駆動するための走査信号側ドライバーであり、信号分離回路 12 で分離作製された水平同期信号に基づいて、走査信号を出力する回路である。13 は画像表示部の列方向を配線を駆動するための変調信号側ドライバであり、信号分離回路 12 で分離作製された水平同期信号、垂直同期信号、デジタル映像信号などから変調信号を出力する回路である。

【0 5 2 8】

1 6 は本画像表示装置の電源状態を検知する回路で、電源 SW の ON / OFF に応じた信号を出力する。更に、1 7 では SW OFF 信号をもとに表示装置の

除電駆動を行うために信号をコントローラ 11 に出力しているタイマ回路である。タイマ回路 17 からの信号がアクティブ状態の時には、 $V_a=0V$ に対応した信号が出力されることとなる。又、7、8 は実施例 1 と同様に高圧電源 8 とアノード電流検出回路 7 である。図 158 は、本発明の画像表示装置の画像表示部を駆動する際に、行方向配線（すなわち走査信号を供給する側の配線）、列方向配線（すなわち、変調信号を供給する側の配線）の引き出し線に印加する電圧のタイミングチャートの一例を表している。同図のタイミングチャートは前記画像表示装置のある行 I 、 $I+1$ 、 $I+2$ を順々に駆動している時の I 、 $I+1$ 、 $I+2$ 行の行方向配線に印加している電圧と、変調信号側である列方向配線 J 、 $J+1$ 、 $J+2$ 列の列方向配線に印加している電圧を表した図である。（必然的に $1 < I < M-2$ 、 $1 < J < N-2$ 、 M は行方向配線本数、 N は列方向配線本数である）同図では、ある 1 水平走査期間 K では、 I 行目の表示、 $K+1$ では $I+1$ 行目の行を表示 $K+2$ では $I+2$ 行目の行を表示している。線順次走査する際の走査側である、行方向配線は 1 水平走査期間（以降 $1H$ とする）ごとに順番に選択され、選択された行の行方向配線には、 $1H$ に相当するパルス幅を持つ波高値 $-1/2V_f$ (V_f はここでは駆動電圧であり、およそ $V_f = 2V_{th}$) の走査信号が順番に印加されていく。走査は全方向配線に付いて行われた後は、又始めの行から順番に繰り返される。列方向配線には、行方向配線に印加する走査信号と同期して、選択された行に表示する映像信号に対応した $1/2V_f$ の波高値を有する。変調信号が全列方向配線に印加される。変調信号は、操作信号の立ち上がりに同期して立ち上がり、映像信号に対応した時間だけ波高値 $1/2V_f$ の状態を維持した後立ち上がる。（以後変調信号が立ち上がってから、次に立ち上がるまでの期間を単に変調信号のパルス幅と呼ぶ）変調信号のパルス幅は、選択された行に表示する映像信号の RGB の 3 色に分解した時のそれぞれの輝度に対応しているが、実際には高品位な画像を表示するためにさまざまな補正をかけるため単純な比例関係ではない。このように、電圧印加することにより、選択された行の表面伝導放出型素子には、変調信号のパルス幅だけ駆動電圧 V_f が印加される。表面伝導放出型素子の放出電流 I_e は V_f に対して上述したような明確な閾値特性をもっているため、この結果として選択された行には、所望の映像信号に対応した画像が表示される。さらに、線順次に操作を行っていくことにより画

像表示部内の全表面伝導型放出素子にわたって画像の表示が行われる。

【0 5 2 9】

次に、本実施例の除電作用について説明する。画像表示装置における除電駆動を行う方法としては、画像表示中に例えば、 I_e の変化率を検知して V_a をある時間停止しておくことは画像表示装置として不可能である。そのため電源状態の変化を検知するためのSW ON/OFF検知回路16を設けて、画像表示装置のSWがOFFされたことを検知しその信号をタイマ回路15に出力する。タイマ回路15はSW信号のOFFを認識しコントロール回路11に除電駆動を行うための $V_a = 0$ V指示信号を一定時間出力する。そしてコントロール回路11は、タイマ回路15の信号をもとに、高圧コントロール信号によって高圧電源8の V_a 制御を0 Vに設定する。

【0 5 3 0】

図1 5 4に上記の制御に対応したタイミングチャートを示した。まず、画像表示装置がT 1なる時間においてSWがOFFされた場合には、SW ON/OFF検知回路よりOFFのロジックレベルの信号が出力される。タイマ回路1 5は、OFF時での信号の変化、例えば本実施例2ではH→Lへの信号の立ち下がりをとらえ、タイマカウンタを作動させる。タイマカウンタは、タイマ回路内部で設定されたカウンタ回路によって決定されコントローラ回路1 1に対して $V_a = 0$ に対応したロジック信号（本実施例2ではL→Hレベル）をTaなる時間だけ出力する。コントローラ回路1 1はタイマ回路1 3の信号の変化をとらえ、除電駆動を開始する。

【0 5 3 1】

除電駆動は、Taの間行われ、コントロール回路1 1から高圧コントロール信号 $V_a = 0$ の設定が高圧電源8に対してなされ、一方素子駆動のみを行うために走査側ドライバ1 4と変調信号側ドライバ1 3はそのまま駆動される。そして、タイマカウンタによりTaの時間が終了する場合には、タイマカウンタの出力信号はH→Lに変化され、コントローラ回路1 1はその信号の変化をとらえることで除電駆動の解除を行い素子駆動も停止される。以上の制御では、アノード電流検出回路7からのアノード電流 I_e の検出を行わずに除電駆動を行ったが、アノード電流値 I_e の値を取り込んで除電駆動を行ってもよい。具体的には、例えばTaなる時間のタイマカウンタの信号が出力された時点で、コントローラ回路1 1がアノード

電流 I_e の値を検知し、その値に対して除電駆動を行うかどうかの判断をしてもよい。判断方法としては、コンパレータ回路等を用いて I_e との比較を行い、コンパレータ回路に設定された設定 I_e 値以上の I_e であれば除電駆動を行うものとする。そして、 T_a 時間内で I_e が設定値以下になればその時点で除電駆動は完了する。又 T_a の時間が経過しても I_e の値が設定値以上であれば引き続き除電駆動を継続する。この場合、アノード電流 I_e は、電気的な信号として変換されて（アナログ信号または、ADコンバータを通してのデジタル信号）コンパレータ回路に入力される。更に、コンパレータ回路で設定される設定 I_e 値は、画像表示装置で表示駆動される時に印加される V_a の値に応じて変更される。

【0532】

更に、別の方法としては、SWの状態時間に応じて T_a の時間設定を行ってもよい。その場合には、タイマ回路13がSW ON/OFF検知回路16からの信号をもとにON時間の計測する。画像表示装置のON時間が短い場合には T_a の時間を短くし、ON時間が長い場合は T_a を長くする。又、この時にもアノード電流 I_e を検知して前述したようなコンパレータ回路を用いた制御を行ってもよい。それにより画像表示の駆動時間に応じた除電駆動を行うことが可能である。

【0533】

更に、別の方法として、コントローラ内部にCPUあるいはシーケンサ等を備え、シーケンス処理によって除電駆動を行ってもよい。図155に、シーケンスで行う場合のフローチャートを示したので簡単に説明する。S10によってSWのON/OFF状態の判定がされる。SWがOFF状態であればS11でアノード電流 I_e の値を検知して除電駆動が必要か否かの判断がされる、許容値以上であればS12に進む。次に、除電駆動を行う場合にはS12でのタイマの設定を行う。除電時間は前述した T_a の時間に相当する。次にS13で除電駆動を行う。除電駆動は $V_a = 0\text{ V}$ 、素子駆動ONの状態としてS12で設定された時間だけ除電を行う。除電駆動がS14で完了したことが判断されると、S15で再度 I_e の値を検知し除電駆動の停止かどうかの判断がおこなわれる。そして除電駆動停止の場合にはS16で素子駆動がOFFされる。

【0534】

以上、本実施例ではSWのON/OFF信号を検知し除電駆動の制御を可能と

した。本実施例によって、画像表示装置の表示時間に応じて除電駆動を行うことができ除電効果も向上し、真空放電の要因の一つである表面電位上昇をふせぎ表示装置の信頼性も向上した。又、短時間の間でSWのON/OFFが繰り返される場合（例えばTVからゲームに切り替える時）などにも本実施例の方法によって除電駆動が可能である。

【0535】

（実施例3）

次に本発明の実施例3を説明する。実施例3は、除電駆動を画像表示中にも行う様にしている。画像表示回路の構成及び、画像表示の制御回路等はすべて実施例2と同じであることから説明は省略する。実施例3の制御方法としては、アノード電流検出回路7によって検知された I_e の値が、設定値 I_e をこえた場合にタイマ回路によって除電駆動を行う時間 T_a が設定される。設定された T_a の信号の開始から、水平同期信号に同期させて数フレームに1回の割合で $V_a=0$ の高圧コントロール信号が出力され除電を行うものである。図156にそのタイミングチャートを示したので具体的に説明する。

【0536】

まず、アノード電流検出回路7より常時アノード電流 I_e がコントローラ回路11に取り込まれる。コントローラ回路11内では、実施例2と同様にコンパレータ回路が用いられ、設定値 I_e に対して、検出された I_e が設定値以上の場合には、コンパレータ回路からコントローラ回路11を通してタイマ回路15にその信号が入力される。タイマ回路15は入力された信号を検知することで、タイマ信号 T_a を出力する。 T_a の出力方法は実施例2と同様である。タイマ信号 T_a が出力されると、コントローラ回路11ではその信号の変化（L→H）をとらえて、水平同期信号と同期を取りながら $V_a=0$ の信号を出力する。水平同期信号は、NTSC信号である場合には60Hzの周期で同期信号が出力されることから、例えば実施例3では水平同期信号をカウントするカウンタと、 T_a の信号と水平同期信号との同期をとる同期回路によって、2フィールド（1フレーム）に1回の割合で $V_a=0$ vの信号を高圧電源8に対して出力されるように上記カウンタの設定を行うようにしている。それによって、高圧電源8への制御は約16msec間 $V_a=0$ vとなり、素子駆動のみ

を行う除電駆動の期間が 1 フレームに 1 回存在することになる。以上の様な制御を行うことで、画像表示中においても表示装置への除電駆動が実現できる。また除電駆動の設定に関しては水平同期信号をカウントするカウンタの設定値を変えることで可能である。本実施例 3 で設定した除電駆動周期によって画像の表示に対してフリッカ等の影響がある場合には、カウンタの設定値を増やして除電駆動周期を長くしてもよい。その場合には、 T_a の設定時間も長くしたほうがよい。更に実施例 3 においても、 I_e の値を検知し、設定されている T_a の時間内に I_e の値が設定 I_e 以下になった場合には、除電駆動を解除することも可能である、又 T_a の時間が終了しても I_e の値が設定 I_e 値以上の場合には引き続き除電駆動を継続する。更に、実施例 2 と同様に別の方法として、コントローラ内部に CPU あるいはシーケンサ等を備え、シーケンス処理によって除電駆動を行ってもよい。図 1 5 7 にシーケンス処理で行なった場合でのフローチャートを示し、そのフローを簡単に説明する。まず S17 でアノード電流 I_e の判断が行われ、設定 I_e 値以上である場合には、S18 で除電駆動のタイマ設定 T_a がおこなわれる。次に S19 で水平同期信号から予め設定されているカウント値をもとにして所定の水平同期信号をカウントした後、S20 にて $V_a = 0$ で素子駆動のみの除電駆動を行う。除電駆動制御は前述した制御と同じである。次に S21 で設定時間 T_a が終了したかの判断がなされる。設定時間が終了なのであれば S22 で再度アノード電流 I_e の検知を行い、設定値以下であれば S23 で V_a を所定の電圧で設定し、水平同期カウンタをディセーブル状態にして、通常の画像表示駆動を行い、 I_e の値が設定以上で除電駆動が必要であれば設定値以下になるまで引き続き除電駆動が継続される。

以上実施例 3 では、画像表示中においても除電駆動を行うことを可能とし、実施例 2 と同様に真空放電の要因の一つである表面電位上昇をふせぎ表示装置の信頼性も向上した。

【 0 5 3 7 】

(構成 3 0)

画像表示面を分割駆動する構成について実施例により説明する。

【 0 5 3 8 】

(実施例 1)

図159は実施例に用いた表示パネルの斜視図であり、内部構造を示すためにパネルの1部を切り欠いて示している。前記N×M個の表面伝導型放出素子は、M本の行方向配線1003と電氣的に2つの区画に分割したN本の列方向配線1004により単純マトリクス配線されている。

【0539】

次に、前記実施例の表示パネルに用いたマルチ電子ビーム源の製造方法について説明する。本発明の画像表示装置に用いるマルチ電子ビーム源は、表面伝導型放出素子を単純マトリクス配線した電子源であれば、表面伝導型放出素子の材料や形状あるいは製法に制限はない。しかしながら、発明者らは、表面伝導型放出素子の中では、電子放出部もしくはその周辺部を微粒子膜から形成したものが電子放出特性に優れ、しかも製造が容易に行えることを見いだしている。したがって、高輝度で大画面の画像表示装置のマルチ電子ビーム源に用いるには、最も好適であると言える。そこで、上記実施例の表示パネルにおいては、電子放出部もしくはその周辺部を微粒子膜から形成した表面伝導型放出素子を用いた。

【0540】

以下、図160を参照しながら本実施例のマルチ電子ビーム源製造方法の一例を説明する。図160は電子源の一部分を拡大して示した図である。まず、よく洗浄された基板9上に金属材料からなる導電性薄膜を形成し、そのパターンをフォトリソグラフィーによって微細加工し、一对の素子電極1、2を多数形成する。ここで、基板9としては、石英ガラス、Na等の不純物含有量を減少したガラス、青板ガラス、青板ガラスにスパッタ法あるいはCVD法等により形成したSiO₂を積層したガラス基板等、及びアルミナ等のセラミック等があげられる。電極1、2の形成方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、プラズマCVD法等の真空系を用いて成膜した後にリソグラフィー法でパターンニングしてエッチングする方法や、有機金属を含有するMOペーストをガラス凹版を使ってオフセット印刷する方法を選択することができる。素子電極1、2の材料としては導電性を有するものであればどのような物であっても構わないが、例えば、Ni、Cr、Au、Mo、W、Pt、Ti、Al、Cu、Pd等の金属あるいは合金、及びPd、Ag、Au、RuO₂、Pd-Ag等の金属あるいは金属酸化物とガラス等

から構成される印刷導体、及びポリシリコン等の半導体材料、及び $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$ 等の透明導電体等があげられる。本実施例においては基板 9 には青板ガラスを用い、素子電極 1 と 2 には Ni 薄膜を用いた。素子電極の厚さは 1000 [オングストローム]、電極間隔は 2 [マイクロメートル] とした。(図 160 (a))

【0541】

次に列方向配線 4 として導電性ペーストを印刷形成する。この時列方向配線 4 は素子電極 1 と接続する様に形成する。配線は膜厚が厚い方が電気抵抗を低減できるため有利である。そのため厚膜印刷法、特にスクリーン印刷法をもちいるのが好ましく銀、金、銅、ニッケル等の導電性ペーストを用いることができる。図 160 (b) には、電子源の中央部で列方向配線を断線し、電氣的に 2 つの区画に分割してある様子を示している。この断線個所の列方向配線の先端は図に示すように円形の形状にパターンニングを施した。このようにすることで、メタルバックに印加されている高電圧による電位分布が断線部分のエッジ部分において急峻になることを避けることができ、配線の断線部からメタルバックへの放電を起こすことを防ぐことができた。なお、より高精細なパターンニングが要求された場合には、感光性ペーストを用いて大まかなパターンをスクリーン印刷によって形成した後に、露光、現像することによって良好な配線形状が得られる。なお、所望のパターンを形成した後にはペースト中のビヒクル成分を除去するために、そのペースト、使用ガラス基板の熱特性に応じた温度 (400~650℃) で焼成される。(図 160 (b))

【0542】

次に層間絶縁膜 5 を行方向配線と列方向配線の交差部に形成する。この層間絶縁膜は、例えば酸化鉛を主成分とするガラス物質、例えば PbO 、 B_2O_3 、 ZnO 、 Al_2O_3 、 SiO_2 等から適宜選ばれる成分の混合物で形成される。厚さは、絶縁性を確保できれば特に制限はないが、通常は 10~100 μm 、好ましくは 20~50 μm である。この層間絶縁膜の形成は、酸化鉛を主成分とするフリットガラス、エチルセルロースなどの適当なポリマーおよび有機溶剤等からビヒクルとを混合してなるペーストをスクリーン印刷等により所定位置塗布した後焼

成して行う。

【0 5 4 3】

尚、層間絶縁膜は、少なくとも列方向配線と行方向配線の交差部を被覆すればよいので、その形状は図 1 に限るものではなく、適宜選択することができる。（図 1 6 0（c））

【0 5 4 4】

次に行方向配線 6 を層間絶縁膜上に形成する。この配線も電気抵抗を低減したほうが有利であるため、膜厚を厚く形成できる厚膜印刷法を用いるのが好適である。そこで列方向配線形成と同じようにしてスクリーン印刷法で導電性ペーストを用い、配線を形成した後に焼成する。なお、このとき各配線を素子電極 2 と接続する様に形成する。（図 1 6 0（d））

【0 5 4 5】

次に、表面伝導型電子放出素子の導電性薄膜 3 を形成する（図 1 6 1）。

【0 5 4 6】

次に、マルチ電子ビーム源の駆動方法について詳しく説明する。ここでは、表面伝導型電子放出素子群を列方向に上下二分割し、同時にライン走査して画像を形成する、所謂、画面分割駆動法により画像形成を行う駆動方法について詳しく説明する。図 1 6 2 は表示パネルを駆動する駆動回路の構成例を示すブロック図である。同図において、表示する画像データは、例えば NTSC 信号などのテレビジョン信号から、あるいはパーソナルコンピュータなどで生成されて入力され、画像メモリ 109 に格納される。なお、説明を簡単にするため、画像メモリ 109 は VRAM として一般的なデュアルポート RAM であるとし、不図示の CPU などにより画像が展開されている間でも、その格納内容を読取ることができるものとする。また、表示パネル 108 の上半分の素子を駆動制御するためにラインメモリ 105a、変調信号発生器 107a、走査回路 102a を設け、下半分の素子を駆動制御するためにラインメモリ 105b、変調信号発生器 107b、走査回路 102b を設ける。

【0 5 4 7】

さて、制御回路 103 は、上画面、下画面の順に画像メモリ 109 から一ライン分の画像データを取り出すためのアドレス信号を生成するとともに、画像メモリ 109 に

対してはリード信号を出力し、ラインメモリ105aと105bに対しては交互に書込信号を出力する。画像メモリ109からラインメモリ105aと105bへの接続は共通になっているので、ラインメモリ105aと105bへの書込みは交互に行う必要がある。制御回路103は、それぞれ一ライン分のデータがラインメモリ105aと105bに格納されると、メモリロードタイミング信号Tmry-aおよびTmry-bを出力するとともに、次ラインのデータの読出しを行う。

【0548】

変調信号発生器107aは、ラインメモリ105aに格納されたデータに対応する駆動信号を列方向配線端子Dy1からDymへ出力し、また走査回路102aは、制御回路103から入力されたTscan-a信号により、端子Dx1からDx(m/2)に接続された行方向配線のうち表示すべきラインの配線へ駆動信号を出力する。これと同時に、変調信号発生器107bは、ラインメモリ105bに格納されたデータに対応する駆動信号を列方向配線端子Dz1からDznへ出力し、また走査回路102bは、制御回路103から入力されたTscan-b信号により、端子Dx((m/2)+1)からDxmに接続された行方向配線のうち表示すべきラインの配線へ駆動信号を出力する。すなわち、表示パネル108の二ラインを同時に駆動制御しながら、画像を表示するものである。

【0549】

このように、画面分割駆動法により表示パネル108を駆動制御することにより、表示パネル108の二ラインを同時に発光することができ、ラインの走査周波数を1/2にすることができるので、一ライン当りの発光時間を二倍にして二倍の輝度を得ることができる。

【0550】

以上説明した本実施例の列側を分割配線としたマルチ電子ビーム源を用いて駆動する事により、不要な電子放出を起こさない高輝度で、かつ、品質の良い画像表示を行う事ができた。

【0551】

(実施例2)

本実施例においても列方向配線を電氣的に2つの区画に分割したマルチ電子ビーム源に本発明を適用した例を示す。本実施例は、実施例1と列方向配線の断線

部分の構成が異なるのみであるので、以下実施例 1 と異なる部分のみについて説明する。図 163 は本実施例のマルチ電子ビーム源の一部を拡大して示した図である。図 163 (b) では素子電極 1, 2 および列方向配線 4 を作成した時点での電子源を示すものである。1, 2 は実施例 1 で説明したものと同一素材および構成の素子電極である。4 は実施例 1 で説明したものと同一素材の列方向配線である。実施例 1 と異なるのは断線部分にパターンニングの処理していないことである。図 163 (c) は層間絶縁膜 5 を行方向配線と列方向配線の交差部に形成した時点での図である。実施例 1 と異なるのは、列方向配線 4 の断線部を覆うように層間絶縁膜 5 を形成していることである。このようにすることで、断線部のエッジがフェースプレートの高電圧に対して電氣的に露出することがなくなる。つまり断線部のエッジ部分での電界集中に伴う、断線部分からフェースプレートへの放電を防ぐことができる。さらに本実施例の列方向配線の断線部分の構成では、形状をパターンニングする工程を省くことができる点が有利である。

【0552】

また、配線交差部に断線部分を設けたために、マトリクス配線上の配置が単純となり、高画質化の対応でさらに配線密度を上げる場合にも容易に達成できる。

【0553】

なお層間絶縁膜 5 の素材および形成方法は実施例 1 と同じである。図 163 (d) は行方向配線 6 を層間絶縁膜上に形成した様子を示している。列方向配線の素材および形成方法についても実施例 1 と同じである。

以下、表面伝導型放出素子の導電性薄膜の作成方法、通電フォーミング処理、活性化処理、マルチ電子ビーム源の駆動方法等々は実施例 1 と同じ物を採用した。以上説明した本発明の列側を分割配線としたマルチ電子ビーム源を用いて実施例 1 と同様の駆動を行う事により、不要な電子放出を起こさない高輝度で、かつ、品質の良い画像表示を行う事ができた。

【0554】

(構成 31)

実装部と配線取り出しからの接続の構成としては以下の構成が挙げられる。

【0555】

(実施例 1)

図 164 にこの構成の一例を示す。1 はマルチ電子ビーム源を形成した電子源基板、2 は電子線照射により発光する蛍光体を備えた表示用基板、3 は電子源基板 1 の配線部と駆動電源とを接続するケーブル、4 は駆動電源である。本実施例では行配線側のフラットケーブル長、列配線側のフラットケーブル長を、それぞれ約 100 mm、50 mm とした。また、それぞれの誘導成分は約 100 nH、約 50 nH とした。

このマルチビーム電子源の配線交差部による容量成分を LCR メーターにより測定したところ、交差部当たり 0.04 pF で、 $n = 3072$ とすると 154 pF ($= c$) となった。また、行配線の取り出し部及び電源 5002 との接続ケーブル部の誘導成分は L_r は、約 30 mm の取り出し電極部での誘導成分約 30 nH、駆動電極と取り出し電極部を接続するフラットケーブル (約 100 mm) での誘導成分約 100 nH からなる。 L_r は 130 nH と見積もられる。マトリックス部での誘導成分 (素子間を接続する配線の誘導成分 $L_m \times n$) は約 280 nH である。列配線の取り出部及び電源 5003 との接続部の誘導成分 L_c は約 30 mm の取り出し電極部での誘導成分約 30 nH、駆動電源と取り出し電極部を接続するフラットケーブル (約 50 mm) での誘導成分約 50 nH からなる。 L_c / n は 0.08 nH と見積もられる。従って、 $L = 130 + 280 + 0.08 = 410.08$ nH、 $C = 154$ pF となり、パネル特性周波数は 22 MHz と求められた。一方、図 165 における V_s および V_e の立ち上がり時間を調べたところ、それぞれ約 60 nsec および 80 nsec で、最高周波数成分として約 17 MHz となる。したがって、共振周波数を駆動信号の最高周波数よりも高くすることができ、リングングの発生を十分低減することができた。以上は行選択駆動を行った場合のうち多くの電子放出素子が電子放出動作状態のときに相当する。

【0556】

一方、特定の画像を表示する場合、つまり、選択行のうちのわずかの素子数しか電子放出状態になる場合には、 L の式のうち実質的に n が小さな数字となるため、 L_c 成分はむしろできなくなる場合がある。最大、 L_c / n 成分が 80 nH (列

配線 1 列分の誘導成分) となり、共振周波数 18.3 MHz と求められる。この場合も共振周波数を駆動信号の最高周波数よりも高くすることができ、リングングの発生を十分低減することができた。

【0557】

本実施例では、行・列配線端部と駆動電源の接続部としてフラットケーブルとしたが、これに限定されるものではなく、タブやフレキシブル配線などを用いてもよい。

【0558】

(実施例 2)

本実施例では、マトリクスは配線部を 2 つの群に分割した電子源基板を用いた例を示す。N×M 個の表面伝導型電子放出素子は、2 つの群に分割され、各群を M/2 本の行方向配線 1003 と n 本の行方向配線 1004 により単純マトリックス配線されている。図 166 に斜視図を示す。本実施例では、行配線のフラットケーブル長、列配線のフラットケーブル長を、それぞれ約 100 mm、約 50 mm とした。またそれぞれの誘導成分を約 100 nH、約 50 nH とした。この場合、行配線側のフラットケーブル長、列配線側のフラットケーブル長を、このマルチビーム電子源の配線交差部による容量成分を LCR メーターにより測定したところ、交差部当たり 0.04 pF で、 $n = 3072$ とすると 154 pF (= c) となった。また、行配線の取り出し部及び電源 5002 との接続ケーブル部の誘導成分は L_r は、約 30 mm の取り出し電極部での誘導成分約 30 nH、駆動電極と取り出し電極部を接続するフラットケーブル (約 100 mm) での誘導成分約 100 nH からなる。 L_r は 130 nH と見積もられる。マトリックス部での誘導成分 (素子間を接続する配線の誘導成分 $L_m \times n$) は約 280 nH である。列配線の取り出し部及び電源 5003 との接続部の誘導成分 L_c は約 30 mm の取り出し電極部での誘導成分約 30 nH、駆動電源と取り出し電極部を接続するフラットケーブル (約 50 mm) での誘導成分約 50 nH からなる。 L_c/n は 0.08 nH と見積もられる。従って、 $L = 130 + 280 + 0.08 = 410.08$ nH、 $C = 154$ pF となり、パネル特性周波数は 22 MHz と求められた。一方、図 165 における V_s および V_e の立ち上がり時間を調べたところ

、それぞれ約 60 nsec および 80 nsec で、最高周波数成分として約 17 MHz となる。したがって、共振周波数を駆動信号の最高周波数よりも高くすることができ、リングングの発生を十分低減することができた。以上は行選択駆動を行った場合のうち多くの電子放出素子が電子放出動作状態のときに相当する。

【0559】

一方、特定の画像を表示する場合、つまり、選択行のうちのわずかの素子数しか電子放出状態になる場合には、 L の式のうち実質的に n が小さな数字となるため、 L_c 成分はむしろできなくなる場合がある。最大、 L_c/n 成分が 80 nH (列配線 1 列分の誘導成分) となり、共振周波数 18.3 MHz と求められる。この場合も共振周波数を駆動信号の最高周波数よりも高くすることができ、リングングの発生を十分低減することができた。

【0560】

本実施例では、行・列配線端部と駆動電源の接続部としてフラットケーブルとしたが、これに限定されるものではなく、タブやフレキシブル配線などを用いてもよい。

【0561】

以上のように、マトリクスが上記のように分割されている場合にも、本構成は有効である。

【0562】

(構成 32)

画像装置内における各部材の配置については以下の構成を採ることができる。

【0563】

(実施例 1)

本構成の画像表示装置を図 167 を参照して説明する。図 167 は、画像装置の構成を示す模式的な断面図である。図 167 の画像表示装置は、外装ケース 115 中に表示パネル 100 を収容して構成されている。表示パネル 100 は蛍光体を配したフェースプレート 1007 と、電子放出素子 1002 を配したリアプレート 1005 とを対向させて構成されている。101 はパネル内の暖った空気を自然対流によって流し出す空気取り出し口であり、同じく 102 は空気導入口

である。また、103はフェースプレート1007を外部から防護し、破壊することを防ぐため設置してある透明な樹脂などで作られた前面板である。前面板103には、光学的なフィルターを入れてコントラスト改善などの機能を付加しても良い。次に104は表示パネル100を電氣的に駆動するための駆動回路部であり、フレキシブル配線（不図示）などによって表示パネルの取り出し配線DX1~DXm、DY1~DYnに電氣的に接続されている。本例における表示パネル100のフェースプレート1007、リアプレート1005の温度について図167及び図168を用いて以下に説明する。まず、フェースプレート1007は前述のようにリアプレート1005の電子源1002から放出された電子ビームがフェースプレート1007上のメタルバックに印加された高電圧（アノード電圧： V_a ）によって加速され、フェースプレート1007上に設けられた蛍光体に衝突し、一部は発光し、大部分は熱に変わる。この発熱量は、画像の種類などによっても変わるが、時間的に平均するとほぼ一定と考えられ、これを単位面積あたりで Q_f (W/m^2) とする。また、リアプレート1005上においてはマトリクス配線を通して駆動回路104に戻り、その間にリアプレート上に配線、及び素子電極、電子放出部で熱に変わる。フェースプレートと同様にこの発熱量も時間的に平均するとほぼ一定と考えられ、これを Q_r (W/m^2) とした。次に、駆動回路部104ではリアプレート1005上の電子源を駆動するために、電流を出している。こちらの電流を駆動するに当たって電気回路上に内部損失が発生するためにこれらが発熱源となる。これについても時間的に平均するとほぼ一定と考えられ、 Q_d (W/m^2) とした。これらの関係を模式的な回路図で表わしたのが図168である。本実施例の場合は、 $Q_f = 100$ (W/m^2)、 $Q_r = 20$ (W/m^2)、 $Q_d = 40$ (W/m^2) であり、この時、 $d = 5$ mmとした際に、フェースプレート1007とリアプレート1005の温度がほぼ同じになることがわかった（周辺温度20℃の時、約40℃）。これはフェースプレート1007とリアプレート1005はそれぞれ異なる発熱量をもっているため、これらだけの関係で温度が決まる場合はそれぞれ異なって温度になるのは自明であるが、また別の発熱源である駆動回路部104を $d = 5$ mmの位置に配置することで特にリアプレート1005の温度に影響を与え（より具体的には暖める）フェ

ースプレート1007とリアプレート1005の温度が同じになったと考えられる。これにより、両プレートの熱膨張量の差が減少して熱歪みが減少し、画像歪みや色ずれが実質的には生じなくなる。本実施例のような構成は、ファンなどの可動部分が無いため静粛性が要求される家庭用ディスプレイやコンピュータ用ディスプレイとして好適といえる。

【0564】

(実施例2)

本実施例における外装ケースを含めた構成は実施例1と同様である。本実施例において異なるのは表示パネルの設計として V_a を下げ、同じ輝度を確保するために素子長を大きくして素子電流(I_f 、 I_e)を大きく取れるようにした場合である。本実施例の場合は、 $Q_f = 100$ (W/m²)、 $Q_r = 80$ (W/m²)、 $Q_d = 40$ (W/m²)であり、この時、 $d = 30$ mmとした時、フェースプレート1007とリアプレート1005の温度がほぼ同じになることがわかった。(周辺温度が20℃の時、約40℃)。このように、表面伝導型電子放出素子を用いたディスプレイの場合パネルの設計値を変えることでフェースプレートでの発熱とリアプレートでの発熱との比率が変わってしまう。これにより、実施例1と同様に両プレートの熱膨張量の差が減少して熱歪みが減少し、画像歪みや色ずれが実質的に生じなくなる。

【0565】

(実施例3)

本実施例の構成について図169に示す。図169において実施例と異なるのは外装ケース115に開けられた空気口101、102内に強制対流用ファン301、302を設けたことである。301は空気取り出し用ファンで図面の上方方向に軸流が発生するものである。また302は空気取り込み用ファンで同じく上方方向に軸流が発生するものである。これら2つのファンで外装ケース内横断面積に平均して0.9 m/sの流速が選られた。各発熱量は $Q_f = 100$ (W/m²)、 $Q_r = 20$ (W/m²)、 $Q_d = 40$ (W/m²)であり、この場合 $d = 10$ mmにした時にフェースプレート1007と1005の温度が同じになった。(周辺温度が20℃のとき、約30℃)。この理由については強制対流にすること

でフェースプレート側の温度がより大きく下がり、駆動回路部 104 の発熱のリアプレート 1005 への影響が小さくなる配置にした結果であると考えられる。これにより実施例 1 と同様、両プレートの熱膨張量の差が減少して熱歪みが減少し、画像歪みや色ずれが実質的になくなる。本実施例のような構成は、周辺温度が上がるような環境下においてもパネル温度を上げないようにできるため工場や野外と外気が遮断されないような場所での使用に好適といえよう。

【0566】

(実施例 4)

本実施例の構成について図 170 に示す。図 170 において実施例 3 と異なるのは外装ケース 115 の空気口に防塵フェルタ 401 を付加したことである。各発熱量は本実施例においては実施例 1 と同様、 $Q_f = 100$ (W/m²)、 $Q_r = 20$ (W/m²)、 $Q_d = 40$ (W/m²) である。フェルターを設けたため、コンダクタンスが悪くなり平均流速が下がって約 0.45 m/s と実施例 3 の半分程度になった。この場合、 $d = 7.5$ mm とした時、フェースプレート 1007 とリアプレート 1005 の温度がほぼ同じになることがわかった。(周辺温度が 20℃ の時、約 35℃)。これにより、実施例 1 と同様、両プレートの熱膨張量の差が減少して熱歪みが減少し、画像歪みや色ずれが実質的に生じなくなる。本実施例のような構成は、環境に多少の塵埃があってもフィルタでブロックされるため、屋外に近い場所での使用に好適といえる。

【0567】

以上に実施例で説明した以外にも、種々の設計のディスプレイを実際に作製したり、あるいは実測のデータに基づく熱シミュレーションを行い、フェースプレート 1007 とリアプレート 1005 の温度差がなくなるような駆動回路部 104 の配置を検討したところ、画像面積 30 インチから 100 インチの大きさの画像形成装置において、 d の値を 5 mm ~ 30 mm に配置することで、概ね温度差がなくなることが判明した。

【0568】

(構成 33)

以下に、本発明に係る装置の駆動の一態様例を説明する。

図 172 に SED パネルの駆動回路のブロック図を示す。H100 は表示パネルであり、複数の電子放出素子が行配線と列配線によりマトリクス配線され、電子放出素子からの放出電子ビームが高圧電源部 H103 から印加される高圧電圧により加速され不図示の蛍光体に照射されることにより発光を得るものである。この不図示の蛍光体は用途に応じて種々の色配列を取ることが可能であるが、一例として赤色・緑色・青色（以下 RGB と記す）3 色の縦ストライプ状の色配列とする。

【0569】

本例においては、ビデオ信号入力を表示する構成を示すが、ビデオ信号に限定されず、例えばコンピュータの出力信号など種々の画像信号に対しても同様の構成で対応できる。

【0570】

H104 はある TV 方式で変調されたビデオ信号入力を受けデコード信号とビデオ信号入力に重畳されていた同期信号を分離し出力するデコーダー部である。種々の TV 方式に対応する場合は対応する TV 方式毎に専用デコーダーを備えれば良い。

【0571】

H105 は走査線変換部であり、ビデオ信号入力の有効走査線数と表示パネル H100 のライン数に応じて走査線信号の調整を行い表示パネル H100 のライン数と同数の有効走査線信号を発生させる。例えば入力信号が NTSC 方式のビデオ信号であり表示パネルのライン数が 480 本であった場合、走査線変換部 H105 は、1 フィールドあたり約 240 本の有効走査線数を有しており、2 フィールドで 1 フレームを構成する NTSC 信号から、ノンインターレース（非飛び越し）方式の線順次駆動が可能となるように 1 フィールド = 1 フレームである有効走査線数 480 本の信号を出力する。

【0572】

本実施例では、走査線変換部としてインターレース信号のプログレッシブ信号への変換の際にフレームレートも変換する構成のインターレース→プログレッシブ変換（IP 変換）回路を用いた。ここで、入力信号がインターレース信号であ

る場合、この回路を用いてプログレッシブ信号に変換を行う。そのIP変換のための具体的な構成を図181に示す。この実施例においては、インターレース信号をプログレッシブ信号に変換する際の走査線補完信号の発生に、フィールド間補完とフィールド内補完の両方を用いるように構成している。図181において、17801は信号の動き検出部である。画像信号の動きが大きい時は、フィールド内補完を行うのが好適であり、画像信号の動きが小さい時は、フィールド間補完を行うのが好適であるため、動き検出部において画像信号の動きを検出し、フィールド間補完信号とフィールド内補完信号の合成の比率を決定している。17807はフィールド間補完回路であり、前のフィールド、例えば直前のフィールドの走査信号により、一つおきの走査線信号の間の走査線信号を決定する回路である。より具体的には、一つおきの走査線信号の間の走査線信号として、直前のフィールドの該当走査線の信号を用いるものである。17802は遅延回路であり、フィールド間補完を行うために画像信号を遅延させて出力する。17803は補完回路であり、遅延回路17802から出力される遅延された前のフィールドの信号により、補完すべき走査線信号を作成する。17808はフィールド内補完回路であり、一つおきの走査線信号の間の走査線信号を他の複数の走査線信号、例えば前記一つおきの走査線信号を合成演算することによって作成する回路である。17804は遅延回路であり、フィールド内補完を行うために画像信号を遅延させて出力する。17805は補完回路であり、遅延回路17804から出力される前の走査線信号と、遅延量の異なる走査線信号、例えば遅延されずに入力される走査線信号とを合成することにより、補完すべき走査線信号を作成する。17806は合成回路であり、動き検出部17801からの信号により、補完回路17803と補完回路17805からの補完信号の合成比率を決定して、プログレッシブ信号を出力する。この変換を行う際に、信号はデジタル信号であってもよく、遅延回路としてはメモリを用いることができる。また、このIP変換のための構成は、ハードウェア構成によるものに限らず、演算回路を用いてソフトウェアで行ってもよい。また、フィールド間補完、フィールド内補完のいずれか一方のみを行うものであってもよい。

【0573】

また、本実施例では、走査線変換部 H 1 0 5 は、デコード信号を蛍光体発光色である RGB 原色信号に変換するマトリクス回路も含んでいる。

【 0 5 7 4 】

輝度データサンプル部 H 1 0 6 は、走査線変換部 H 1 0 5 からの RGB 原色信号を受け走査線毎に RGB 3 系統並列に表示パネル H 1 0 0 の 1 ラインあたりの画素数と同数の輝度データをサンプリングする。本例では蛍光体の色配列を RGB 縦ストライプとしたので表示パネル H 1 0 0 の 1 ラインあたりの画素数は、列配線数の $1/3$ の本数である。

【 0 5 7 5 】

ガンマ変換部 H 1 0 7 は RGB 3 系統並列に備えられた階調特性の補正手段であり、ビデオ信号入力があらかじめ持つ非線型性（CRT のガンマ補正など）をリニアな特性にもどしたり、列配線変調部が発生する輝度変調信号と表示パネル H 1 0 0 の発光量の非線型性を補正する。補正量が RGB 3 系統で同じで良い場合は必ずしも 3 系統備える必要はなく後述する列配線変調部 H 1 0 1 への輝度データなど 1 系統の信号のところで補正すればよい。

【 0 5 7 6 】

原色データ並び替え部 H 1 0 8 は、ガンマ変換部 H 1 0 7 から 3 系統並列に送られてくる RGB 3 原色毎の輝度データを表示パネル H 1 0 0 の蛍光体の色配列順に並び替え 1 系統の輝度データとして列配線変調部 H 1 0 1 に出力する。この列配線変調部 H 1 0 1 への輝度データ出力はシステム制御部 H 1 1 1 からの制御信号 ENO により出力するか否かの ON/OFF 制御がなされる。

【 0 5 7 7 】

画像信号を表示させるために本例においては表示パネル H 1 0 0 を線順次走査駆動する。すなわち、画像信号の一走査線期間（前記走査線変換部で表示パネル H 1 0 0 のライン数と同数に変換された後の走査線期間、以下水平 1 周期と呼ぶ）に列配線変調部 H 1 0 1 が備える列配線と同数のレジスタからなるシフトレジスタに輝度データを転送し、次の水平 1 周期の輝度データ転送が始まる前に各列配線毎に備える列配線ドライバがシフトレジスタから輝度データを読み出し、次の水平 1 周期で全列配線同時に輝度データに対応する大きさの駆動量を各列配線

に印加する。

【0 5 7 8】

このシフトレジスタ手段によりシリアル輝度データを並列に各列配線ドライバに伝えるためのいわゆるシリアル—パラレル変換を行っている。

【0 5 7 9】

輝度データのシフトレジスタへの読み込みは、タイミング発生部 H 1 1 0 からのシフトクロック T M 1 により行われ、列配線ドライバ部へのデータの読み込み及び列配線への出力タイミングの制御は、シフトレジスタへの輝度データ転送タイミングを避けた位相に設定されているトリガ信号 T M 2 により行われる。

また行配線走査部 H 1 0 2 はほぼ水平 1 周期に等しい選択電圧パルスを選択タイミング発生部 H 1 1 0 からの水平周期クロック T M 3 および走査開始トリガである T M 4 を受け 1 行配線ずつ順に与えていく。これは例えば行配線数と同数の 1 ビットシフトレジスタを備えれば実現できる。

【0 5 8 0】

タイミング発生部 H 1 1 0 は行配線走査部 H 1 0 2 ・列配線変調部 H 1 0 1 の動作タイミング信号を発生するほか、非図示であるが走査線変換部 H 1 0 5 や輝度データサンプル部 H 1 0 6 などが動作するのに必要なタイミング信号を発生する。ビデオデコーダ部 H 1 0 4 からの同期信号により、入力ビデオ信号に同期した各種タイミング信号を発生することができる。

【0 5 8 1】

行配線選択電圧パルスを印加されたラインの電子放出素子が列配線から印加される駆動量に応じた電子ビームを放出することになるので、列配線変調部 H 1 0 1 へ入力される一水平周期の輝度データと行配線選択電圧パルスの位相が合うように走査開始トリガ T M 4 を設定することで、良好な画像表示が可能となる。

【0 5 8 2】

輝度データに対応する大きさの駆動量を各列配線に印加する方法として下記 4 つの手段で実施できる。

- ① 定電圧源印加・印加時間を輝度データに応じてパルス幅変調する。
- ② 定電流源印加・印加時間を輝度データに応じてパルス幅変調する。

③ 電圧源印加・輝度データに応じて電圧源出力を振幅変調する。

④ 電流源印加・輝度データに応じて電流源出力を振幅変調する。

以下この4手段につき説明する。

①の方法は、各列配線毎に列配線駆動電位を印加するための電圧源手段と各列配線毎に輝度データに応じて前記駆動電位が印加される時間の長さが変わるようにパルス幅変調手段（以下PWM手段と記す）を備えるものである。

【0583】

PWM手段は例えばダウンカウンタなどで構成され、ほぼ一水平周期以下の時間を所望の階調数で区切った時間を一周期とするカウントクロックでシフトレジスタから読み込んだ輝度データの大きさだけ計数し、カウントスタートからカウント終了までのパルスを出力することで実現できる。

このPWM手段からの出力パルスの間電圧源を列配線に接続しそれ以外の期間は接地することにより、輝度データに対応する大きさの駆動量を各列配線に印加することができる。

電圧源をある直流電位を印加するかしないかのSW手段で構成すれば駆動ドライバ部を簡単な回路で実現でき、安価な駆動回路を提供することができる。

【0584】

②の方法は①の各列配線毎の電圧源手段を電流源手段に置き換えたものであり、PWM手段からの出力パルスの間電流源を列配線に接続しそれ以外の期間は接地することにより、輝度データに対応する大きさの駆動量を各列配線に印加することができる。

この方式は表示パネルH100が高解像度化されたり大画面化されたときに有効な方法である。高解像度化されると電子放出素子の数も増えるため、線順次走査駆動を前提としている駆動方法では選択時の行配線には大きな電流（1ライン分の電子放出素子の駆動電流の総和）が流れる。行配線の抵抗値によってはこの電流による電圧降下が発生することがある。すなわち電圧源による駆動ではこの配線電圧降下の影響で電子放出素子に印加される駆動電圧が減少し、結果輝度低下する恐れがある。電流源による駆動の場合は配線電圧降下が起きても電子放出

素子に印加される駆動電圧は変わらないため、輝度変動しないという長所がある。

【0585】

③ ①の方法では輝度階調をPWM手段で実現していたがパルス幅を輝度データに応じて変えるのではなく、列配線に電圧源が接続される時間（パルス幅）を一定に設定し輝度データに応じて電圧源の出力電圧振幅を変えても良い。

出力電圧振幅を変える手段としては、例えば各列配線毎にD/A変換器を備え水平周期毎にシフトレジスタに転送される輝度データを前記D/A変換器に伝え出力すればよい。

PWM手段の場合約一水平周期期間を輝度階調数で割った周波数で出力パルス幅を計数していたが、表示パネルH100の大画面/高解像度化がすすみライン数が増えた場合一水平周期は短くなり、PWM動作周波数が高くなる。また画質向上のために階調数を増加させる場合にもやはりPWM動作周波数が高くなる。一方輝度データに応じて出力電圧振幅を変える方法は、列配線を駆動する時間は一定なので列配線変調部の動作周波数は格段に遅くすることが出来る。

【0586】

④の方法は③の各列配線毎の電圧源手段を電流源手段に置き換えたものであり、輝度データに応じて電流源の出力電流振幅を変えるものである。②同様行配線の電圧降下が懸念させる場合有効な方法である。

【0587】

①～④の駆動方法でそれぞれ輝度データに応じた駆動量と表示パネルH100の発光量の関係が変わる場合があるので、それぞれの駆動方法の発光特性に応じてガンマ変換部H107の変換特性を変える必要がある。

【0588】

例えばPWM変調の場合は輝度データと発光量はほぼリニアな関係となり、あらかじめビデオ信号につけられているガンマ特性をキャンセルするような変換特性をガンマ変換部H107は持てば良い。

また、表示パネルH100の電子放出素子は図176に示される駆動電圧－電子放出量特性を有しており、駆動電圧－発光量特性もほぼ同様となる。したがって

③の電圧振幅変調で輝度階調を表現する場合にはこの特性を考慮した変換特性をガンマ変換部H107は持てば良い。

【0589】

なお、図176に示した特性図は、電子放出素子の（放出電流 I_e ）対（素子印加電圧 V_f ）特性、及び（素子電流 I_f ）対（素子印加電圧 V_f ）特性の典型的な例を示すものである。なお、放出電流 I_e は素子電流 I_f に比べて著しく小さく、同一尺度で図示するのが困難であるうえ、これらの特性は素子の大きさや形状等の設計パラメータを変更することにより変化するものであるため、2本のグラフは各々任意単位で図示した。表示装置に用いた素子は、放出電流 I_e に関して以下に述べる3つの特性を有している。第1に、ある電圧（これを閾値電圧 V_{th} と呼ぶ）以上の大きさの電圧を素子に印加すると急激に放出電流 I_e が増加するが、一方、閾値電圧 V_{th} 未満の電圧では放出電流 I_e はほとんど検出されない。すなわち、放出電流 I_e に関して、明確な閾値 V_{th} を持った非線形素子である。第2に、放出電流 I_e は素子に印加する電圧 V_f に依存して変化するため、電圧 V_f で放出電流 I_e の大きさを制御できる。第3に、素子に印加する電圧 V_f に対して素子から放出される電流 I_e の応答速度が速いため、電圧 V_f を印加する時間の長さによって素子から放出される電子の電荷量を制御できる。

以上のような特性を有するため、表面伝導型電子放出素子を表示装置に好適に用いることができた。例えば、多数の素子を表示画面の画素に対応して設けた表示装置において、第1の特性を利用すれば、表示画面を順次走査して表示を行うことが可能である。すなわち、駆動中の素子には所望の発光輝度に応じて閾値電圧 V_{th} 以上の電圧を適宜印加し、非選択状態の素子には閾値電圧 V_{th} 未満の電圧を印加する。駆動する素子を順次切り替えてゆくことにより、表示画面を順次走査して表示を行うことが可能である。また、第2の特性か、または第3の特性を利用することにより、発光輝度を制御することができるため、階調表示を行うことが可能である。

【0590】

また①～④いずれかの駆動方法だけでなく、これらを組み合わせた駆動方法も当然実現できる。例えば階調表現としてPWM手段と振幅変調手段の両方を備え、

階調表現の一部を振幅変調で行うことで表現可能な階調数をふやしたり、PWMクロック周波数を遅くすることが出来る。あるいはPWM手段と振幅変調手段の両方を備え、輝度データに応じた階調表現はPWM手段で行い明るさ調整や色調整などを振幅変調で行ってもよい。逆に階調表現が振幅変調で明るさや色調整がPWM変調でもよい。さらに電圧源出力と電流源出力の両方を備え、電圧源出力電圧で決まるある電位までは電圧源で駆動しそこから電流源で駆動することも実現できる。この駆動により駆動印加時の過渡的な立ち上がり特性を改善することができる。

【0591】

また本実施例は自動明るさ制御機能（以下ABLと呼ぶ）を実現するために平均輝度レベル検出部H109を備える。この機能は、画像表示装置の消費電力抑制や発光面の温度上昇抑制のために、表示パネルの平均輝度があるレベルを超えないように制御するものである。平均輝度レベル検出部H109は、ガンマ変換部H107からの輝度データ出力から表示パネルH100に表示される一フレーム期間の平均輝度レベルを検出し検出信号DT5をシステム制御部H111に伝える。システム制御部H111は、図172に示されるパネル駆動部のシステム制御を司る部分であり、CPU、CPUの動作を規定するプログラムが格納されているROM、CPUを安定に立ち上げるためのリセット手段、例えば列配線変調部H101の出力をON/OFF制御するなど各部動作状態を2値で規定したりユーザーI/Fからの指示情報をCPUに取り込むためのIO手段、各部の動作状態を広範囲の中から規定するためのD/A変換手段やそのデータを保存するためのRAM、電源OFF時もデータを保持し次の電源ON時に読み出し前の状態を再現させるためのバックアップメモリ、ABLや各部動作状態監視のためのA/D変換手段などからなる。

【0592】

本例においてはシステム制御部H111は、列配線変調部H101からの各列配線駆動量の大きさを可変する制御信号CNT1を出力する。また列配線駆動出力を出力するか否かを制御するON/OFF信号であるEN1を出力する。列配線変調部H101はこの列配線駆動量が印加された結果列配線に生じるパルス電

圧の振幅値を検出し検出信号 D T 1 をシステム制御部 H 1 1 1 に伝える。

この場合制御信号 C N T 1 は列配線に電圧源を接続する場合は電圧源の出力電圧を全列配線同時に変化させ、電流源が接続される場合は電流源の出力電流を全列配線同時に変化させる。あるいは全列配線同時でなく、C N T 1 を 3 原色 R G B 毎に 3 系統持ち R の列配線、G の列配線、B の列配線ごとに変化させてもよい。

【 0 5 9 3 】

またシステム制御部 H 1 1 1 は、行配線変調部 H 1 0 2 からの各行配線選択電位を可変する制御信号 C N T 2 を出力する。また行配線選択電圧パルスを出力するか否かを制御する O N / O F F 信号である E N 2 を出力する。行配線変調部 H 1 0 2 はこの行配線選択電位を検出し検出信号 D T 2 をシステム制御部 H 1 1 1 に伝える。

この場合制御信号 C N T 2 は選択時の行配線に印加される電位を制御するが、C N T 2 を 2 系統持ち非選択時の行配線の電位を制御することもできる。

【 0 5 9 4 】

またシステム制御部 H 1 1 1 は、高圧電圧発生部 H 1 0 3 からの高圧出力電圧の大きさを可変する制御信号 C N T 3 を出力する。高圧電圧発生部 H 1 0 3 はこの高圧出力電圧を検出し検出信号 D T 3 をシステム制御部 H 1 1 1 に伝える。A B L 動作は列配線駆動量を可変する C N T 1 を利用して実現できる。すなわちシステム制御部 H 1 1 1 が平均輝度レベル検出部 H 1 0 9 からの検出信号 D T 5 をモニタして平均輝度レベルに応じて平均輝度レベルが低いときは列配線駆動量は制御せず、ある平均輝度レベル以上になったときに C N T 1 により列配線駆動量を小さくしていくことで表示パネル H 1 0 0 の平均発光量を抑制する。

また列配線駆動部が電圧源により構成される場合は、行配線選択電位を可変する制御信号 C N T 2 を利用して同じように A B L 動作が実現できる。

【 0 5 9 5 】

いままで A B L 動作のために平均輝度レベル検出部 H 1 0 9 からの検出信号 D T 5 を利用する説明をしたが、これに限定される訳でなく、例えば高圧電圧発生部 H 1 0 3 から表示パネル H 1 0 0 に流れる平均電流の検出値を用いても良い。

また輝度抑制手段として表示パネルH100の電子放出素子の駆動量を制御する例で説明したが、これに限定される訳でなく、例えば高圧電圧発生部H103の出力を制御したり、あるいは列配線変調部に入力される輝度データの大きさを制御しても実現できる。

【0596】

図172に示す画像表示装置においては、さらに主電源部H121、S電源部H122、K電源部H123を備える。主電源部H121は非図示であるが電源スイッチ手段を備えこのスイッチ手段がONのときにAC入力を受けS電源部H122、K電源部H123、高圧電圧発生部H103に電力供給するための電源出力PS0を出力する。この電源出力PS0はシステム制御部H111からの制御信号PCN0により出力するか否かのON/OFF制御がなされる。また主電源部H121はAC入力を監視する検出信号DT4を出力しシステム制御部H111に伝える。

【0597】

主電源部H121はシステム制御部H111とユーザーI/F部H112からなるブロックSへの電力供給ラインの一つである電源出力PSSを出力する。電源出力PSSはユーザーI/F部H112とユーザーI/F部H112からの入力を受け処理できるシステム制御部H111の最小部分のみが動作するために給電する。ここでは電源出力PSSのみで動作している状態をスタンバイモードと呼ぶ。スタンバイモードではユーザーI/F部H112内に含まれるリモコン受信部が生きておりユーザー指示によりシステムが立ち上がることが出来る。

【0598】

S電源部H122はビデオデコーダ部H104、走査変換部H105、輝度データサンプル部H106、ガンマ変換部H107、原色データ並び替え部H108、平均輝度レベル検出部H109、タイミング発生部H110からなるブロック1とブロックSへの電力供給ラインである電源出力PS1を出力する。この電源出力PS1はシステム制御部H111からの制御信号PCN1により出力するか否かのON/OFF制御がなされる。

【0599】

K電源部H123は列配線変調部H101、行配線走査部H102からなるブロック2への電力供給ラインである電源出力PS2を出力する。この電源出力PS2はシステム制御部H111からの制御信号PCN2により出力するか否かのON/OFF制御がなされる。

高圧電圧発生部H103からの出力PS3はシステム制御部H111からの制御信号PCN3により出力するか否かのON/OFF制御がなされる。

【0600】

システム制御部H111は電源立ち上がり時の動作手順や電源立ち下げ時の動作手順、異常時の動作手順を規定する。表示パネルH100は高圧電圧印加定格値および表示パネルH100内の電子放出素子は印加電圧定格値を有する。これらの定格値を超えると表示パネルH100が破損してしまう恐れがあるため、電源立ち上げ時や電源立ち下げ時、あるいは予期せぬ故障などが起こってもこれらの定格値を超えることがないようにするためである。

【0601】

電源立ち上げ時の処理手順を図174に示す。

電源立ち上げ時は、主電源部H121内の電源SWがONされることでスタートするモードとスタンバイモードから立ち上がるモードとがある。電源SWがONされると主電源部H121にAC電源が給電され主電源部H121は電源出力PSSをブロックSに給電する。システム制御部H111内のリセット手段が電源出力PSSの安定後CPUを動作させる。CPUは動作プログラムが格納されているROMからプログラムをダウンロードし、以降プログラムに従いシステムを初期化する。

この初期化時にさらにシステム制御部H111は電源出力コントロール信号PCN0~3をOFF状態に設定し、列配線変調部H101への輝度データ出力イネーブル信号EN0・列配線変調部H101からの駆動量出力イネーブル信号EN1・行配線走査部からの選択パルス出力イネーブルEN2をOFF状態にし、高圧電圧出力値や列配線駆動量・行配線選択電位を制御する信号CNT1~3を出力最小値の状態に設定する。

【0602】

スタンバイモードにおいては初期化はすでに終了している。初期化が終了したらシステム制御部H111はブロックS、ブロック1を起動するために電源出力コントロール信号PCN0、PCN1をONにする。これにより主電源部H121よりメイン給電ラインPS0が出力され、S電源部H122から電源出力PS1が出力される。PS1が給電された後システム制御部H111は内蔵されているバックアップメモリから、表示パネルH100の駆動条件データ（高圧電圧出力値設定データや列配線駆動量設定データ・行配線選択電位設定データなど）を読み出す。PS1がブロック1に給電されることで入力されたビデオ信号を処理する部分が動作を開始する。

【0603】

システム制御部H111はブロック1の動作が安定するのを待った後ブロック2を起動するために電源出力コントロール信号PCN2をONにする。また列配線駆動量・行配線選択電位の出力準備のために列配線駆動量設定データ・行配線選択電位設定データを内蔵するD/Aコンバータ手段に転送することでCNT1、CNT2信号を出力する。また列配線変調部H101や行配線走査部H102内のシフトレジスタのデータがすべて0になるよう初期化する。

列配線電位異常監視信号DT1、行配線電位異常監視信号DT2により正常に列配線駆動量・行配線選択電位の出力準備が行われたことを確認した後、システム制御部H111は列配線変調部H101への輝度データ出力イネーブル信号EN0を出力状態にし、次に列配線変調部H101からの駆動量出力イネーブル信号EN1を出力状態にし、次に行配線走査部からの選択パルス出力イネーブルEN2を出力状態にする。

【0604】

システム制御部H111は電源出力コントロール信号PCN2をONにし、所望の高圧電圧を出力するために高圧電圧出力値設定データを内蔵するD/Aコンバータ手段に転送しCNT3を所定値に設定する。高圧電圧の立ち上げをソフトスタートにするために、いきなり所定値をCNT3に出力するのではなく最小値からある時定数でゆるやかに所定値に達するようにD/Aコンバータ手段へのデータ転送を段階的に行う。00

【0605】

以上の手順により立ち上げは完了する。あとDT1～4を監視し異常があれば異常処理モードに移る。また電源OFF要求があれば、電源OFFモードに移る。図173においては、電源立ち上がりシーケンスの説明のみを行っているので上記内容しか説明していないが、システム制御部H111が例えばユーザー要求に応じて画質調整できるなど他の機能があることは言うまでもない。

【0606】

図174に立ち下げ時の処理手順を示す。ユーザーI/F部H112経由でシステム制御部H111がリモコンなどによるユーザーからの電源OFFの指示信号を受け取るとシステム制御部H111は電源OFFモードに入る。まず高圧電源を立ち下げるために高圧電圧出力値設定制御信号CNT3を最小にし電源出力コントロール信号PCN3をOFFにする。

システム制御部H111は 行配線走査部からの選択パルス出力イネーブルEN2をOFF状態にし次に列配線変調部H101からの駆動量出力イネーブル信号EN1をOFF状態にしその次に列配線変調部H101への輝度データ出力イネーブル信号EN0をOFF状態にする。

【0607】

次にブロック2を立ち下げるためにシステム制御部H111は列配線駆動量・行配線選択電位制御信号CNT1, CNT2信号を最小に設定し、電源出力コントロール信号PCN2をOFFにする。

高圧電源、表示パネル駆動部の立ち下げ指示の後スタンバイモードに入るためにシステム制御部H111は電源出力コントロール信号PCN1、電源出力コントロール信号PCN0をOFFにする。

【0608】

以上の手順によりユーザーのリモコンなどからの再起動信号のみを受けつけるだけのスタンバイモードに入る。

【0609】

図175に異常時の処理手順を示す。異常時とは下記3種を想定している。

(A) AC入力がなくなる場合。

(B) 高圧電源異常。

(C) 電子放出素子の駆動電圧異常。

(A) AC入力がなくなる場合の処理手順について

本来画像表示装置は、ユーザーからの電源OFF指示により前述のように規定のシーケンスにより立ち下がることが望ましいが、停電やACケーブルが抜けてしまうなど望まない状況で立ち下がらなければならないこともある。

図172においてはシステム制御部H111が主電源部H121からの入力AC電位検出信号DT4により、AC入力変動を監視している。そして入力AC電位が想定値より低下した場合主電源H121の動作を停止する前にDT4により異常状態であることを判別しシステム制御部H111はスタンバイモードへの移行を指示する。

【0610】

まずシステム制御部は高圧電源を緊急OFFするために電源出力コントロール信号PCN3をOFFにし、行配線走査部・列配線部からの出力を緊急OFFするためにイネーブル信号EN0～2を同時にOFF状態にする。

次に高圧電圧発生部H103およびブロック2の立ち下げ処理の残りである高圧電圧出力値設定制御信号CNT3を最小にし列配線駆動量・行配線選択電位制御信号CNT1, CNT2信号を最小に設定する。そして電源出力コントロール信号PCN2をOFFにする。

【0611】

ここでシステム制御部H111はスタンバイモードに移行する前に再度入力AC電位を確認する。そして入力ACが正常状態に復帰したならば再起動処理を行い、主電源部H121へのAC入力が復帰していないならスタンバイモードへ移行する。この場合は再びON状態になるためにはユーザーが再起動を要求する必要がある。

【0612】

(B) 高圧電源異常の場合の処理手順について

図175においてはシステム制御部H111が高圧電圧発生部H103からの高圧電位検出信号DT3により、高圧電位変動を監視している。そして高圧電位

が想定値より上昇した場合あるいはCNT 3による指示値との差が大きくなった場合、高圧電圧発生部H 1 0 3が異常状態であると判定しシステム制御部H 1 1 1は異常処理を行う。

まずシステム制御部は高圧電源を緊急OFFするために電源出力コントロール信号PCN 3をOFFにし、行配線走査部・列配線部からの出力を緊急OFFするためにイネーブル信号EN 0～2を同時にOFF状態にする。

次に高圧電圧発生部H 1 0 3およびブロック2の立ち下げ処理の残りである高圧電圧出力値設定制御信号CNT 3を最小にし列配線駆動量・行配線選択電位制御信号CNT 1, CNT 2信号を最小に設定する。そして電源出力コントロール信号PCN 2をOFFにする。

【0613】

この異常は故障であるためシステム制御部H 1 1 1はスタンバイモードに移行する前に高圧電圧発生部H 1 0 3が異常になった旨の異常モードデータをバックアップメモリに書き込む。そしてスタンバイモードへ移行する。このことにより修理する場合に故障モードをバックアップメモリを確認することにより知ることが出来る。

【0614】

(C) 電子放出素子の駆動電圧異常。

電子放出素子の駆動電圧異常は行配線選択電位（非選択時の電位を規定する場合は非選択電位も含む）及び列配線印加電位（非印加時の電位を規定する場合は非印加時電位も含む）のいずれかの異常が考えられる。

図175においてはシステム制御部H 1 1 1が列配線変調部H 1 0 1からの列配線に生じるパルス電圧の振幅値検出信号DT 1および行配線変調部H 1 0 2からの行配線選択電位検出信号DT 2により、駆動電圧異常を監視している。

そして列配線駆動電圧振幅値が想定値より上昇した場合あるいはCNT 1による指示値との差が大きくなった場合列配線変調部H 1 0 1が異常状態であると判定しシステム制御部H 1 1 1は異常処理を行う。

【0615】

また行配線選択電位が想定値より上昇した場合あるいはCNT 2による指示値

との差が大きくなった場合行配線走査部H102が異常状態であると判定しシステム制御部H111は異常処理を行う。列配線変調部H101の異常・行配線走査部H102の異常の場合、異常処理手順は同じでありシステム制御部は行配線走査部・列配線部からの出力を緊急OFFするためにイネーブル信号EN0~2を同時にOFF状態にし、高圧電源を緊急OFFするために電源出力コントロール信号PCN3をOFFにする。

【0616】

次に高圧電圧発生部H103およびブロック2の立ち下げ処理の残りである高圧電圧出力値設定制御信号CNT3を最小にし列配線駆動量・行配線選択電位制御信号CNT1, CNT2信号を最小に設定する。そして電源出力コントロール信号PCN2をOFFにする。

この異常は故障であるためシステム制御部H111はスタンバイモードに移行する前に列配線変調部H101もしくは行配線走査部H102が異常になった旨の異常モードデータをバックアップメモリに書き込む。そしてスタンバイモードへ移行する。このことにより修理する場合に故障モードをバックアップメモリを確認することにより知ることが出来る。

【0617】

以上説明した電源立ち上がり時の動作手順・電源立ち下げ時の動作手順・異常時の動作手順により、表示パネルH100への定格外の高圧電圧印加および表示パネルH100内の電子放出素子への定格外駆動印加電圧を防止することができる。

【0618】

(構成34)

以下に本発明の各種装置への応用例について説明する。

【0619】

図177は、前記説明の表面伝導型電子放出素子を電子ビーム源として用いたディスプレイパネルに、例えばテレビジョン放送を初めとする種々の画像情報源より提供される画像情報を表示できるように構成した多機能表示装置の一例を示すための図である。図中2100はディスプレイパネル、2101はディスプレ

イパネルの駆動回路、2102はディスプレイコントローラ、2103はマルチプレクサ、2104はデコーダ、2105は入出力インターフェース回路、2106はCPU、2107は画像生成回路、2108、2109及び2110は画像メモリーインターフェース回路、2111は画像入力インターフェース回路、2112及び2113はTV信号受信回路、2114は入出力部である。

なお、本表示装置は、例えばテレビジョン信号のように映像情報と音声情報の両方を含む信号を受信する場合には、当然映像の表示と同時に音声を再生するものであるが、音声情報の受信、分離、再生、処理、記憶などに関係する回路やスピーカーなどは当該分野で使用されているものが適用可能である。

【0620】

以下、画像信号の流れに沿って各部の機能を説明する。まず、TV信号受信回路2113は、例えば電波や空間光通信などのような無線伝送系を用いて伝送されるTV画像信号を受信するための回路である。受信するTV信号の方式は特に限られるものではなく、例えば、NTSC方式、PAL方式、SECAM方式などの諸方式でもよい。また、これらよりさらに多数の走査線よりなるTV信号（例えばMUSE方式をはしめとするいわゆる高品位TV）は、大面積化や大画素数化に適した前記ディスプレイパネルの利点を生かすのに好適な信号源である。TV信号受信回路2113で受信されたTV信号はデコーダ2104に出力される。

【0621】

また、TV信号受信回路2112は、例えば同軸ケーブルや光ファイバーなどのような有線伝送系を用いて伝送されるTV画像信号を受信するための回路である。前記TV信号受信回路2113と同様に、受信するTV信号の方式は特に限られるものではなく、また本回路で受信されたTV信号もデコーダ2104に出力される。

【0622】

また、画像入力インターフェース回路2111は、例えばTVカメラや画像読み取りスキャナーなどの画像入力装置はから供給される画像信号を取り込むための回路で、取り込まれた画像信号はデコーダ2104に出力される。また、画像

メモリインターフェース回路 2110 は、ビデオテープレコーダー（以下、VTR と略す）に記憶されている画像信号を取り込むための回路で、取り込まれた画像信号はデコーダ 2104 に出力される。また、画像メモリインターフェース回路 2109 は、ビデオカメラに記憶されている画像信号を取り込むための回路で、取り込まれた画像信号はデコーダ 2104 に出力される。

【0623】

画像メモリインターフェース回路 2108 は、いわゆる静止画ディスクのように、静止画像データを記憶している装置から画像信号を取り込むための回路で、取り込まれた静止画像データはデコーダ 2104 に出力される。また、入出力インターフェース回路 2105 は、本表示装置と、外部のコンピュータもしくはコンピュータネットワーク、あるいはプリンターなどの出力装置とを接続するための回路である。画像データや文字、図形情報の入出力を行うのはもちろんのこと、場合によっては本表示装置の備える CPU 2106 と外部との間で制御信号や数値データの入出力などを行うことも可能である。また、画像生成回路 2107 は、前記入出力インターフェース回路 2105 を介して外部から入力される画像データや文字、図形情報や、あるいは CPU 2106 より出力される画像データや文字・図形情報に基づき表示用画像データを生成するための回路である。本回路の内部には、例えば画像データや文字・図形情報を蓄積するための書き換え可能メモリや、文字コードに対応する画像パターンが記憶されている読み出し専用メモリや、画像処理を行うためのプロセッサなどをはじめとして画像の生成に必要な回路が組み込まれている。本回路により生成された表示用画像データは、デコーダ 2104 に出力されるが、場合によっては前記入出力インターフェース回路 2105 を介して外部のコンピュータネットワークやプリンターに出力することも可能である。本発明に用いた画像情報処理回路は、デコーダ 2104、マルチプレクサ 2103 及び画像生成回路 2107 によって構成される。

【0624】

また、CPU 2106 は、主として本表示装置の動作制御、表示画像の生成、選択及び編集等に関わる作業を行う。例えば、マルチプレクサ 2103 に制御信号を出力し、ディスプレイパネルに表示する画像信号を適宜選択したり組み合わせ

せたりする。また、その際には、表示する画像信号に応じてディスプレイパネルコントローラ 2102 に対して制御信号を発生し、画面表示周波数や走査方法（例えばインターレースかノンインターレースか）や一画面の走査線の数など表示装置の動作を適宜制御する。また、前記画像生成回路 2107 に対して画像データや文字・図形情報を直接出力したり、あるいは前記入出力インターフェース回路 2105 を介して外部のコンピュータやメモリーをアクセスして画像データや文字・図形情報を入力する。

【0625】

なお、CPU 2106 は、むろんこれ以外の目的の作業にも関わるものであってもよい。例えば、パーソナルコンピュータやワードプロセッサなどのように、情報を生成したり処理する機能に直接関わってもよい。あるいは、前述したように入出力インターフェース回路 2105 を介して外部のコンピューターネットワークと接続し、例えば数値計算などの作業を外部機器と協同して行ってもよい。

入力部 2114 は、前記 CPU 2106 に使用者や命令やプログラム、あるいはデータなどを入力するためのものであり、例えばキーボードやマウスのほか、ジョイスティック、バーコードリーダー、音声認識装置など多様な入力機器を用いることが可能である。

【0626】

デコーダ 2104 は、前記 2107 ないし 2113 より入力される種々の画像信号を 3 原色信号、または輝度信号と I 信号、Q 信号に逆変換するための回路である。なお、同図中に点線で示すように、デコーダ 2104 は内部に画像メモリーを備えるのが望ましい。これは、例えば MUSE 方式を初めとして、逆変換するに際して画像メモリーを必要とするようなテレビ信号を扱うためである。また、画像メモリーを備えることにより、静止画の表示が容易になる、あるいは前記画像生成回路 2107 及び CPU 2106 と協同して画像の間引き、補完、拡大、縮小、合成をはじめとする画像処理や編集が容易に行えるようになるという利点が生まれるからである。

【0627】

マルチプレクサ 2103 は、前記 CPU 2106 より入力される制御信号に基

づき表示画像を適宜選択するものである。すなわち、マルチプレクサ2103はデコーダ2104から入力される逆変換された画像信号のうちから所望の画像信号を選択して駆動回路2101に出力する。その場合には、一画面表示時間内で画像信号を切り替えて選択することにより、いわゆる多画面テレビのように、一画面を複数の領域に分けて領域によって異なる画像を表示することも可能である。

【0628】

ディスプレイパネルコントローラ2102は、前記CPU2106より入力される制御信号に基づき駆動回路2101の動作を制御するための回路である。まず、ディスプレイパネルの基本的な動作に関わるものとして、例えばディスプレイパネルの駆動用電源（図示せず）の動作シーケンスを制御するための信号を駆動回路2101に対して出力する。

【0629】

ディスプレイパネルの駆動方法に関わるものとして、例えば画面表示周波数や走査方法（例えばインターレースかノンインターレースか）を制御するための信号を駆動回路2101に対して出力する。また、場合によっては表示画像の輝度、コントラスト、色調、シャープネスといった画質の調整に関わる制御信号を駆動回路2101に対して出力する場合もある。駆動回路2101は、ディスプレイパネル2100に印加する駆動信号を発生するための回路であり、前記マルチプレクサ2103から入力される画像信号と、前記ディスプレイパネルコントローラ2102より入力される制御信号に基づいて動作するものである。

【0630】

以上、各部の機能を説明したが、図177に例示した構成により、本表示装置においては多様な画像情源より入力される画像情報をディスプレイパネル2100に表示することが可能である。すなわち、テレビジョン放送をはじめとする各種の画像信号は、デコーダ2104において逆変換された後、マルチプレグサ2103において適宜選択され、駆動回路2101に入力される。一方、ディスプレイコントローラ2102は、表示する画像信号に応じて駆動回路2101の動作を制御するための制御信号を発生する。駆動回路2101は、上記画像信号

と制御信号に基づいてディスプレイパネル 2100 に駆動信号を印加する。これにより、ディスプレイパネル 2100 において画像が表示される。これらの一連の動作は、CPU 2106 により統括的に制御される。

【0631】

また、本表示装置においては、前記デコーダ 2104 に内蔵する画像メモリや、画像生成回路 2107 及び CPU 2106 が関与することにより、単に複数の画像情報の中から選択したものを表示するだけでなく、表示する画像情報に対して、例えば、拡大、縮小、回転、移動、エッジ強調、間引き、補間、色変換、画像の縦横比変換などをはじめとする画像処理や、合成、消去、接続、入れ換え、はめ込みなどをはじめとする画像編集を行うことも可能である。また、本例の説明では、特に触れなかったが、上記画像処理や画像編集と同様に、音声情報に関しても処理や編集を行うための専用回路を設けてもよい。従って、本表示装置は、テレビジョン放送の表示機器、テレビ会議の末端機器、静止画像及び動画像を扱う画像編集機器、コンピュータの末端機器、ワードプロセッサをはじめとする事務用末端機器、ゲーム機などの機能を一台で兼ね備えることが可能で、産業用あるいは民生用として極めて応用範囲が広い。

【0632】

なお、図示した例は、表面伝導型電子放出素子を電子ビーム源とするディスプレイパネルを用いた表示装置の構成の一例を示したものにすぎず、これのみに限定されるものではない。例えば、図示した構成要素のうち、使用目的上必要のない機能に関わる回路は省いても差し支えない。また、これとは逆に、使用目的によっては更に構成要素を追加をしてもよい。例えば、本表示装置をテレビ電話機として応用する場合には、テレビカメラ、音声マイク、照明機、モデムなどを含む送受信回路などを構成要素に追加するのが好適である。

【0633】

本表示装置においては、とりわけ表面伝導型電子放出素子を電子ビーム源とするディスプレイパネルは容易に薄型化できるため、表示装置全体の奥行きを小さくすることが可能である。それに加えて、表面伝導型電子放出素子を電子ビーム源とするディスプレイパネルは大画面化が容易で輝度が高く視野角特性にも優れ

るため、本表示装置は臨場感にあふれる迫力に富んだ画像を視認性よく表示することが可能である。

【0 6 3 4】

【発明の効果】

本発明によれば、大画面化に対応可能であり、かつ表示品位の優れた構成を有する画像形成装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 2】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 3】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 4】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 5】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 6】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 7】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 8】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 9】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 1 0】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 1 1】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 1 2】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 1 3】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 1 4】

本発明の画像形成装置の構成を説明するための図である。

【図 1 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 2 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 2 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 2 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 2 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 2 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 2 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 2 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 2 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 2 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 2 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 3 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 3 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 3 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 3 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 3 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 3 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 3 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 3 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 3 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 3 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 4 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 4 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 4 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 4 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 4 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 4 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 4 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 4 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 4 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 4 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 5 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 5 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 5 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 5 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 5 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 5 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 5 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 5 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 5 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 5 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 6 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 6 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 6 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 6 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 6 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 6 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 6 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 6 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 6 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 6 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 7 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 7 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 7 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 7 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 7 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 7 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 7 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 7 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 7 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 7 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 8 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 8 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 8 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 8 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 8 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 8 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 8 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 8 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 8 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 8 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 9 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 9 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 9 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 9 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 9 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 9 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 9 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 9 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 9 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 99】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 100】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 101】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 102】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 103】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 104】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 105】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 106】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 107】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 108】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 109】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 110】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 111】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 112】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 113】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 114】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 115】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 116】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 117】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 118】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 119】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 120】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 121】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 122】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 123】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 124】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 125】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 126】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 127】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 2 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 2 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 3 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 3 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 3 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 3 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 3 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 3 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 3 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 3 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 3 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 3 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 4 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 4 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 4 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 4 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 4 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 4 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 4 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 4 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 4 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 4 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 5 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 5 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 5 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 5 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 5 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 5 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 5 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 5 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 5 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 5 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 6 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 6 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 6 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 6 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 6 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 6 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 6 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 6 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 6 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 6 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 7 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 7 1】

従来技術を説明するための図である。

【図 1 7 2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 7 3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 7 4】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 7 5】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 7 6】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 7 7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 7 8】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 7 9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 8 0】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図 1 8 1】

本発明の実施例を説明するための図である。

【符号の説明】

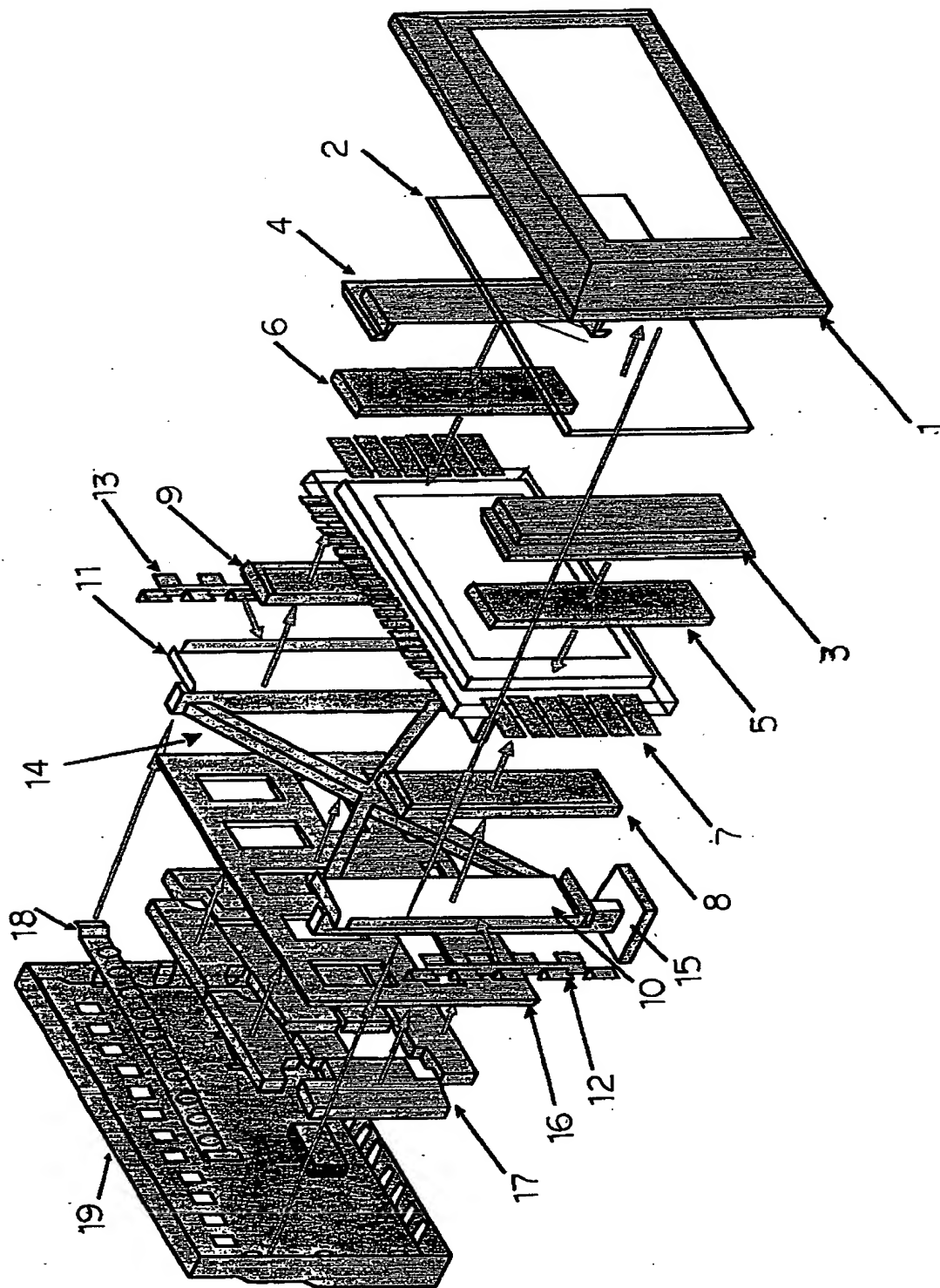
- 1 前カバー
- 3 左上板
- 4 右上板
- 5 左前面断熱部材
- 6 右前面断熱部材
- 7 画像表示パネル
- 8 左後面断熱材

- 9 右後面断熱材
- 1 0 左下板
- 1 1 右下板
- 1 2 フレキシブルケーブルの左押え
- 1 3 右押え
- 1 4 X字状のフレーム (Xフレーム)
- 1 5 スタンドユニット
- 1 6 ボード取付け板

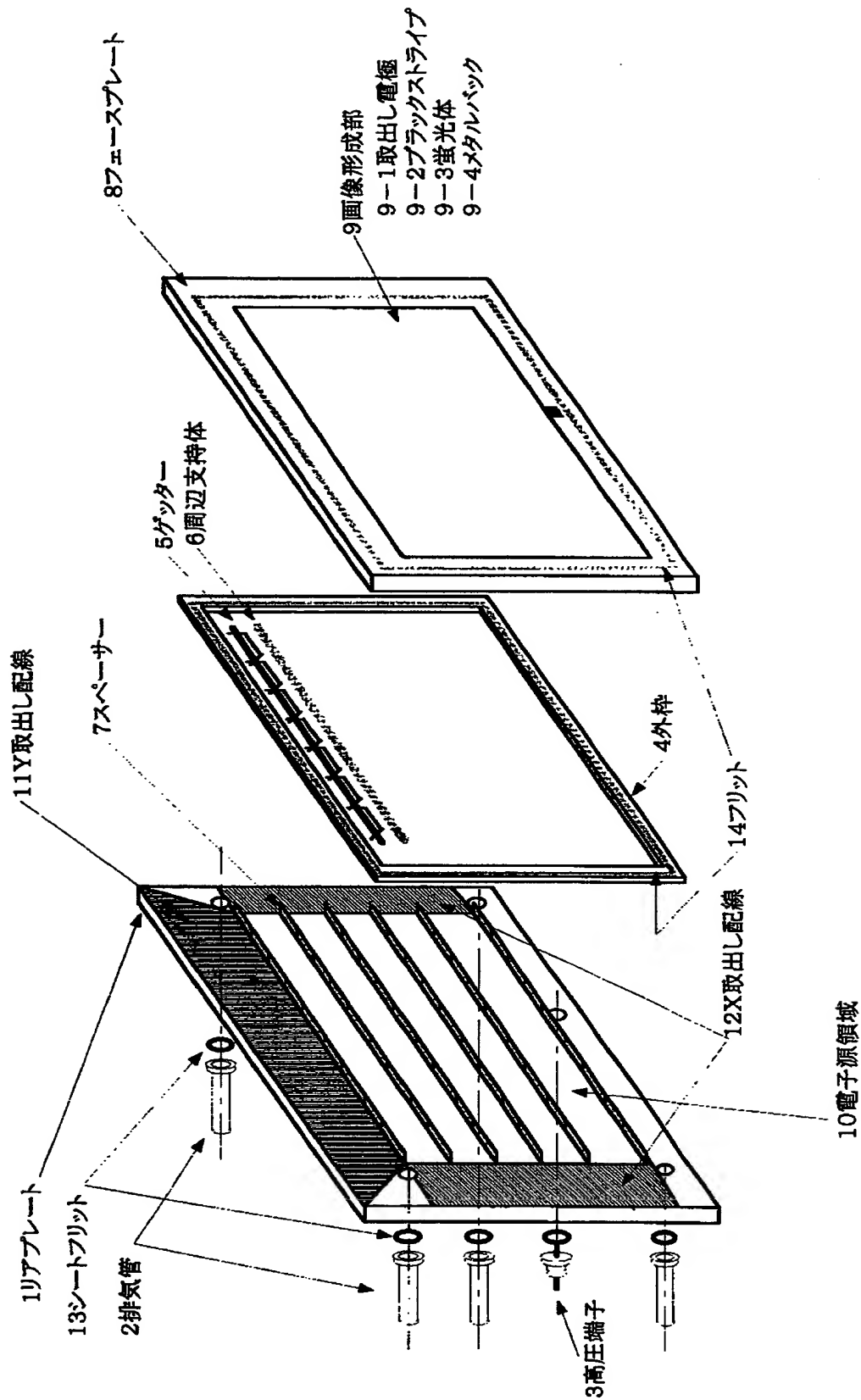
【書類名】

図面

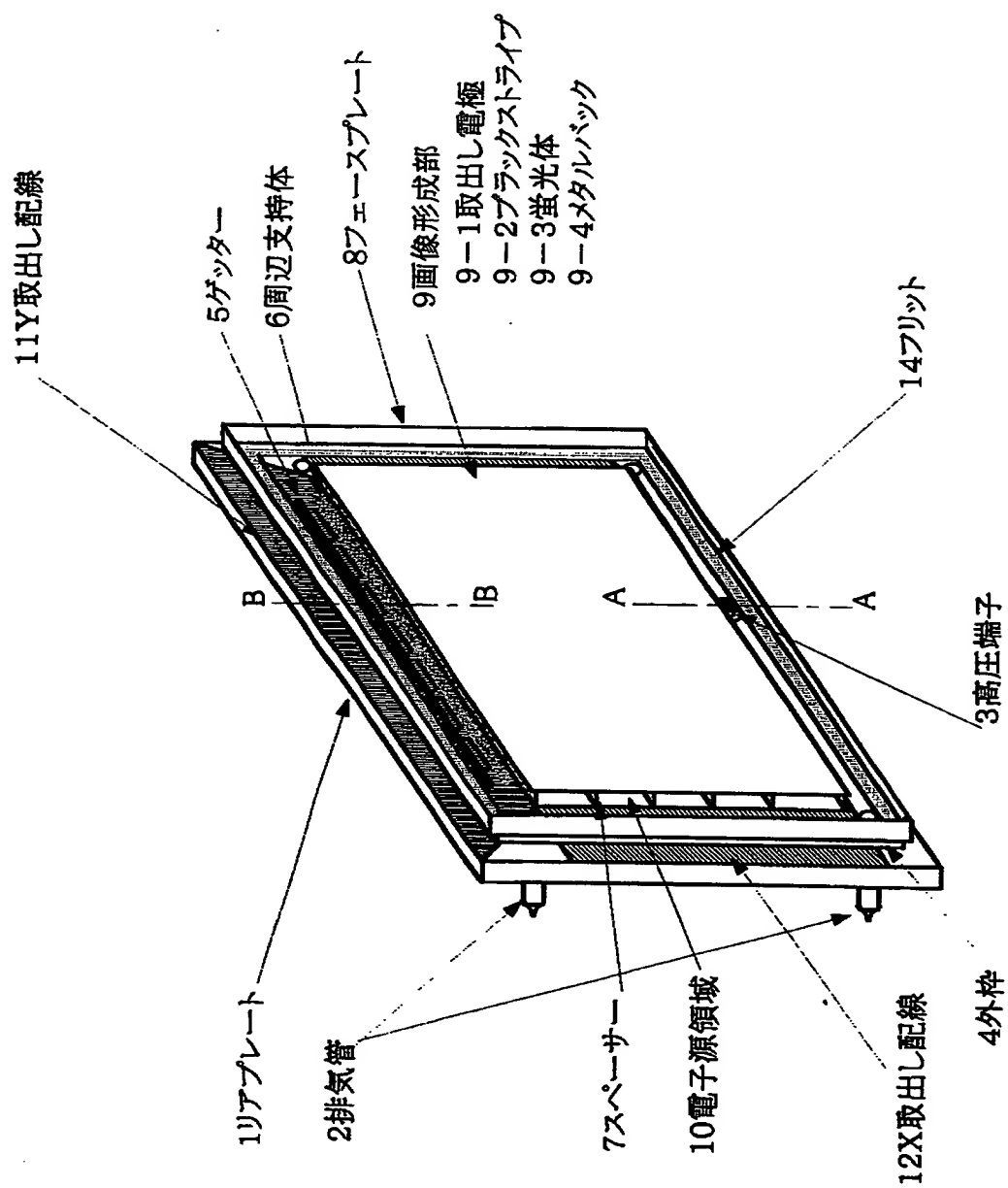
【図 1】



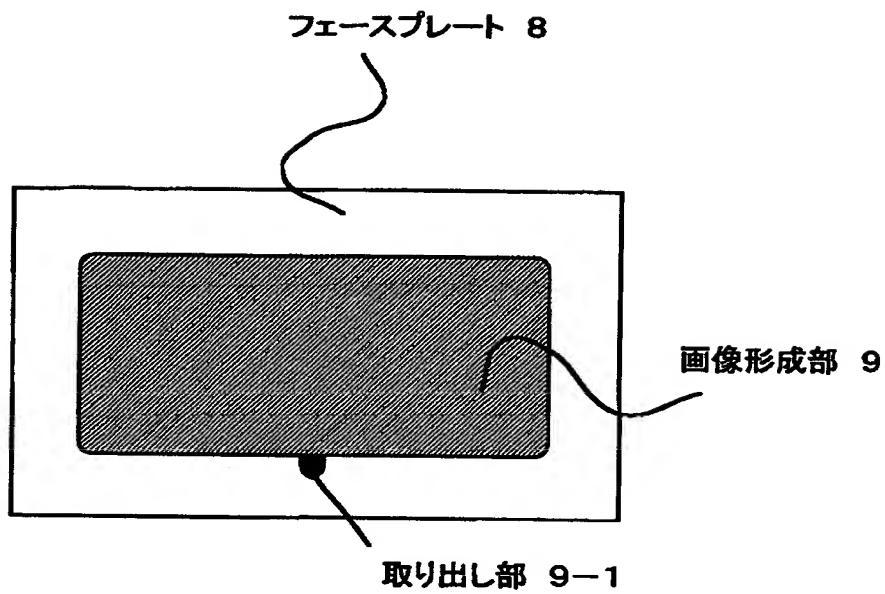
【図2】



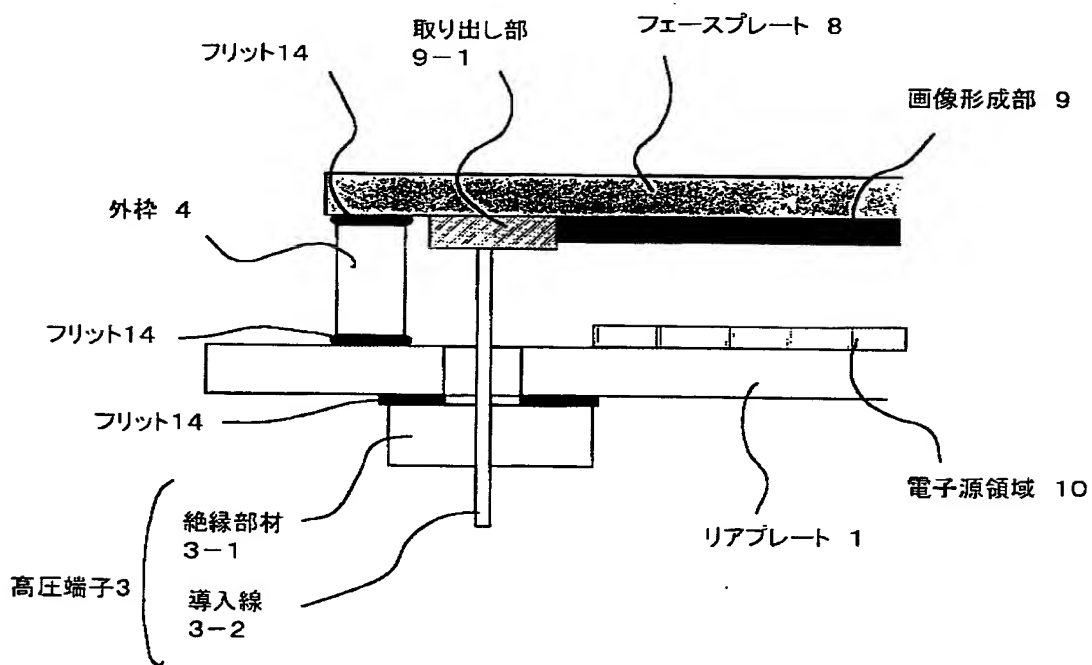
【図 3】



【図 4】

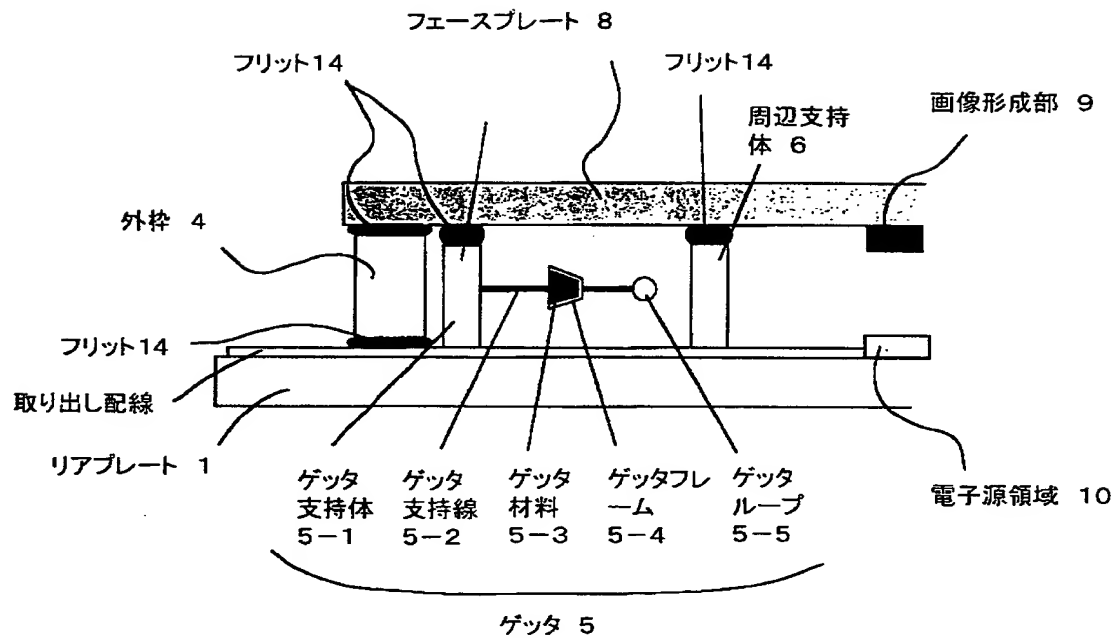


【図 5】



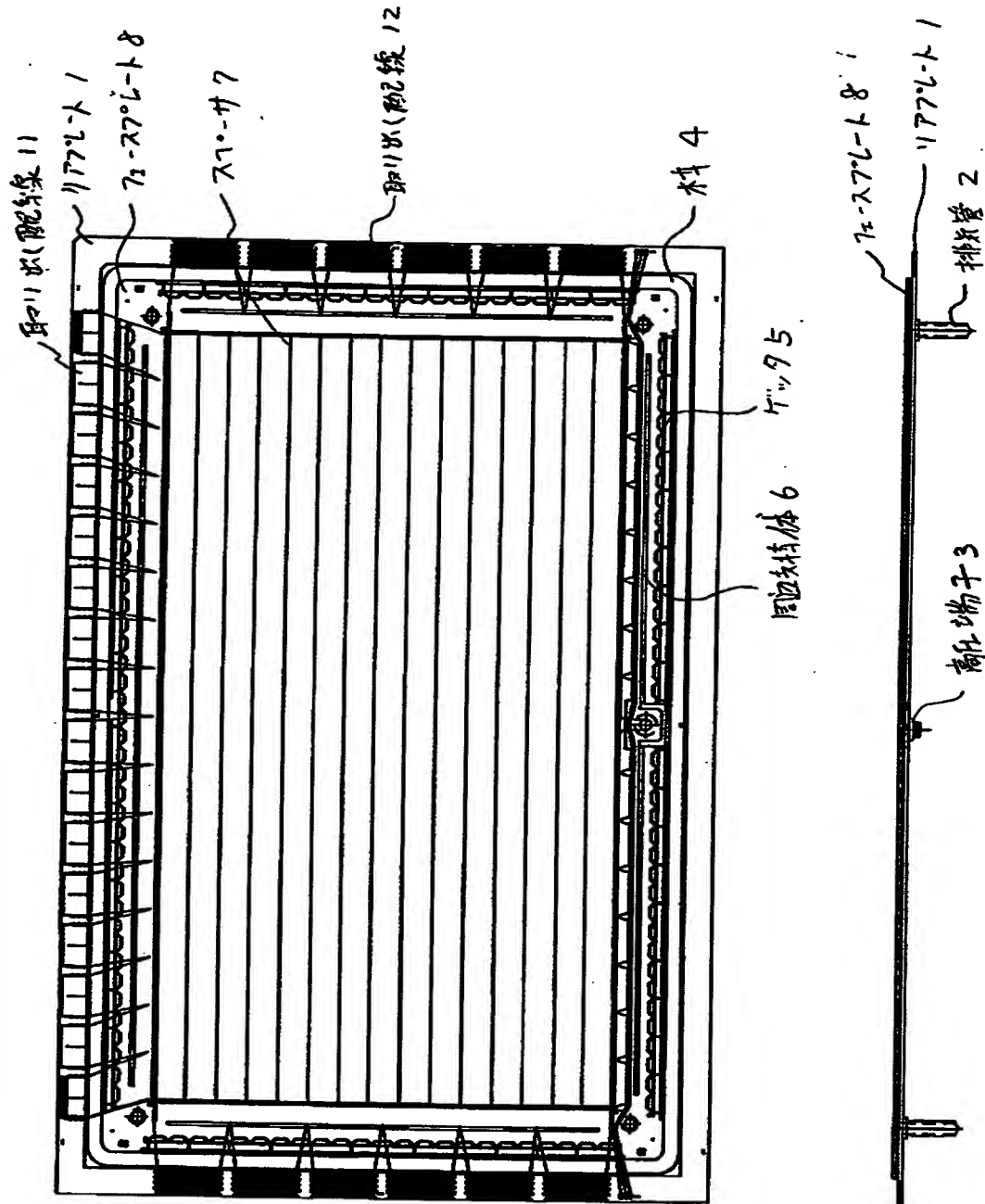
A-A 断面図

【図 6】

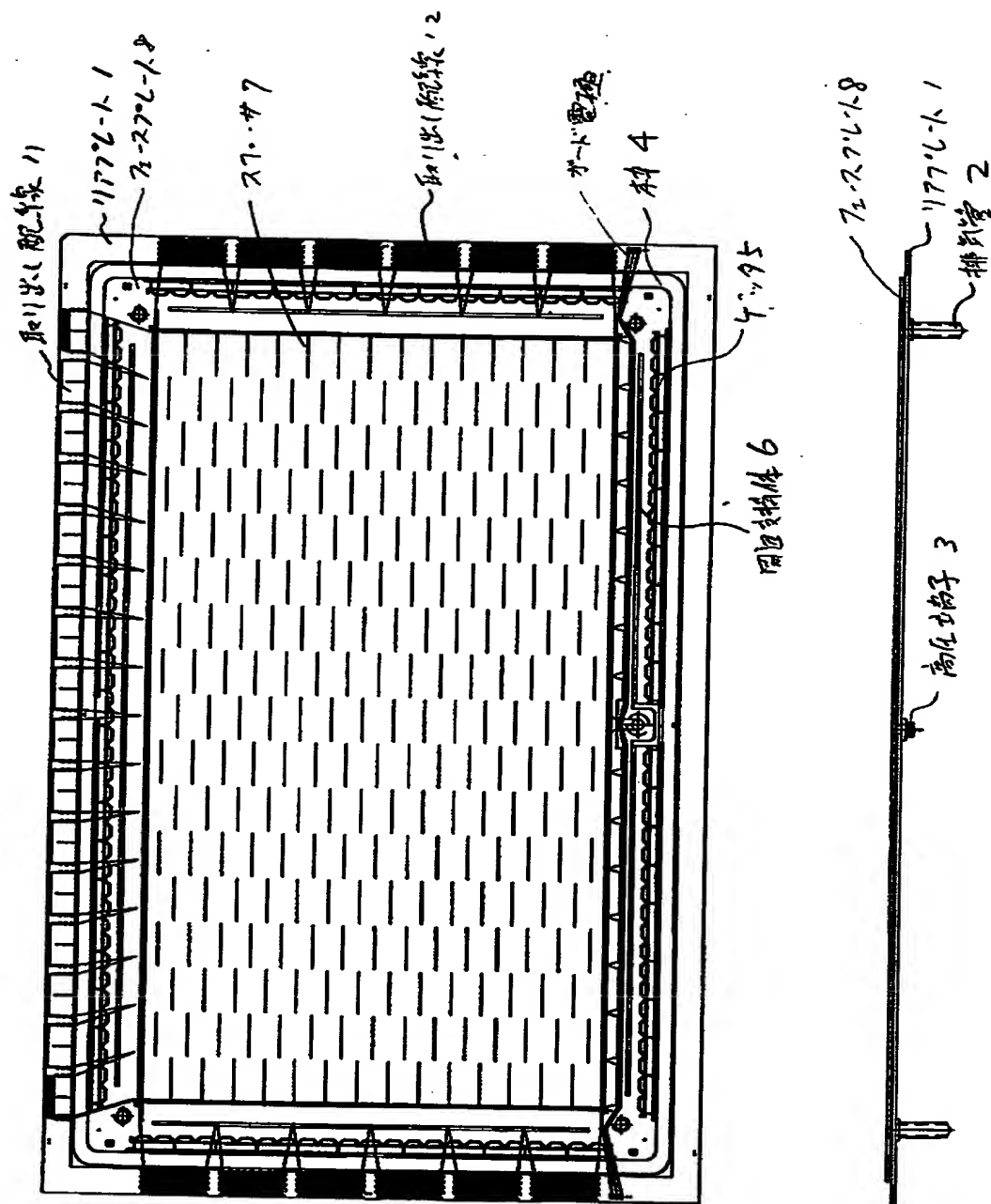


B-B断面図

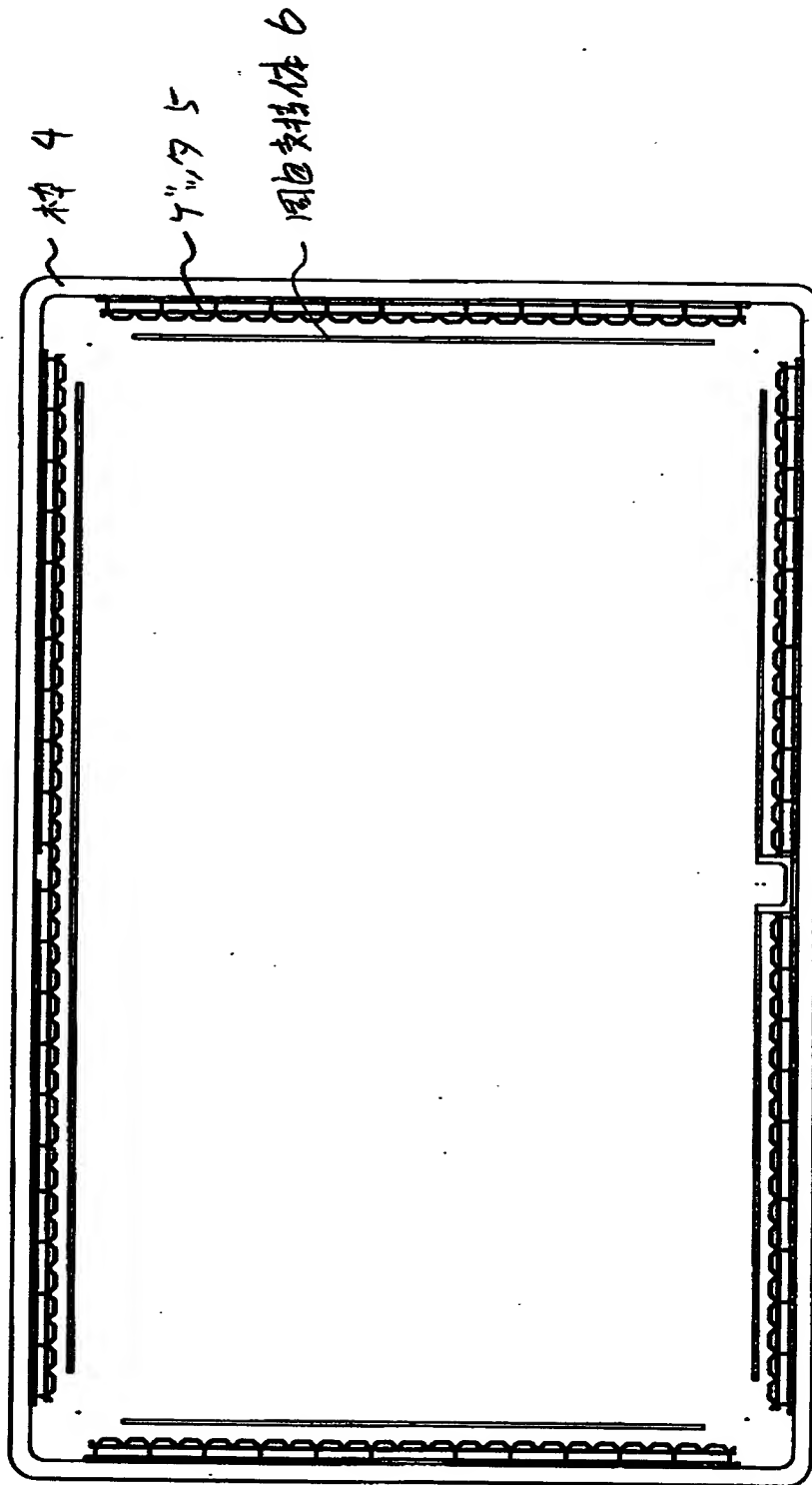
【図7】



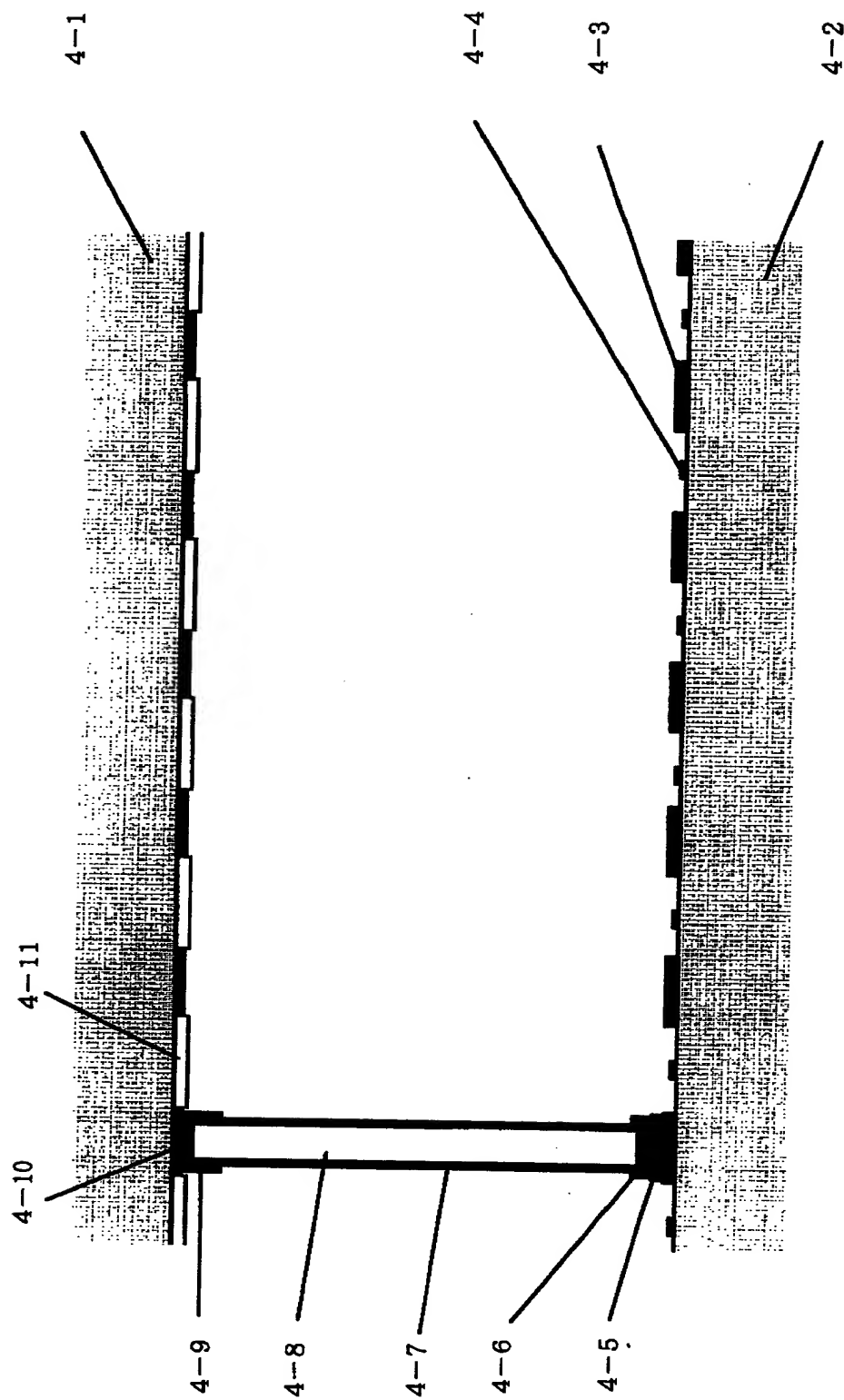
【図 8】



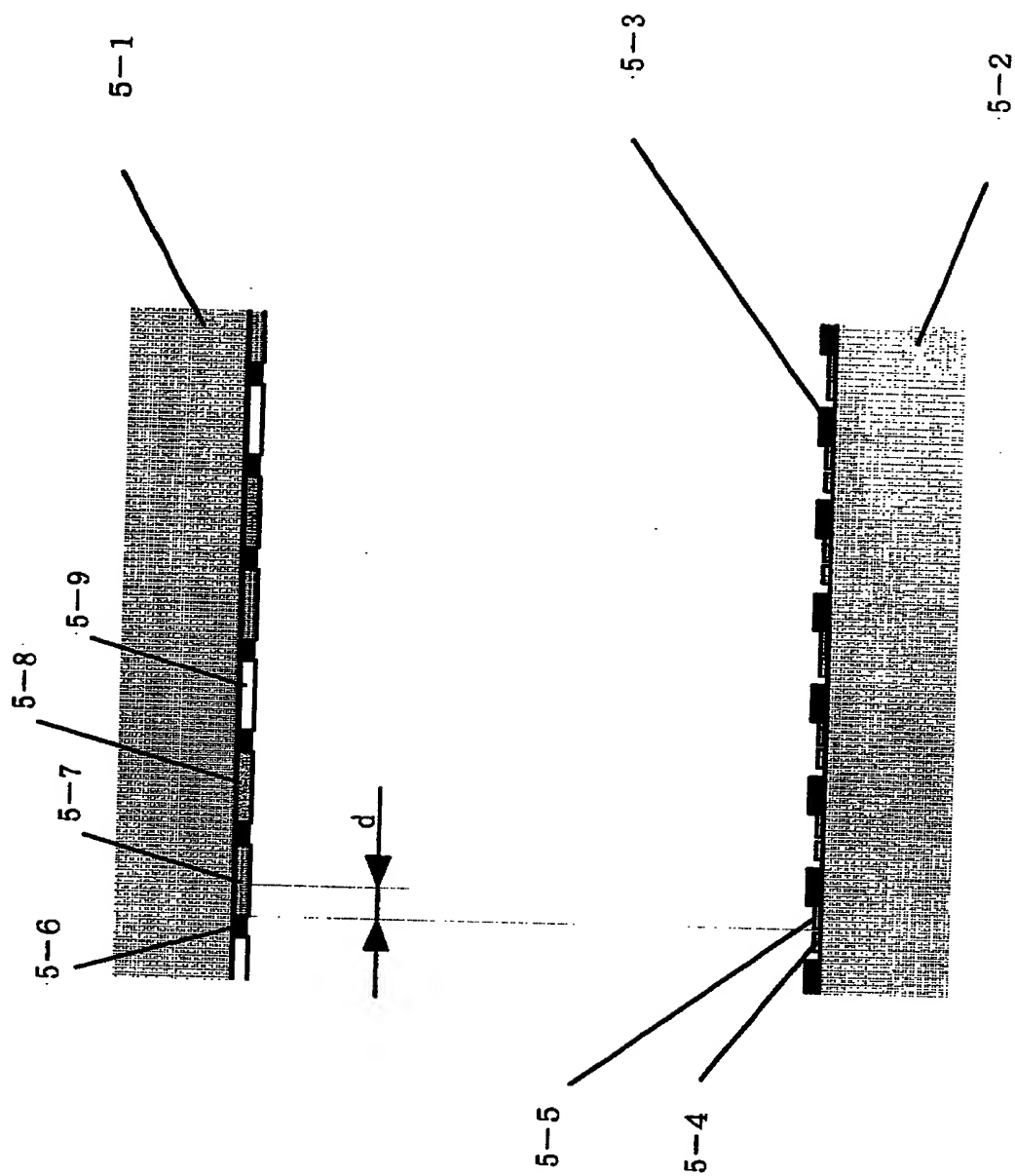
【図 9】



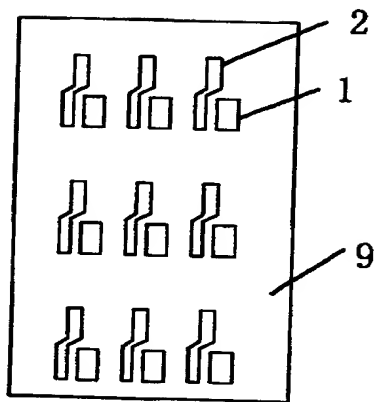
【図 10】



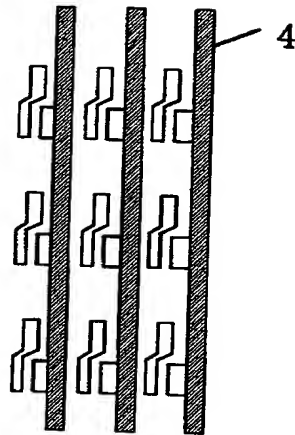
【図 11】



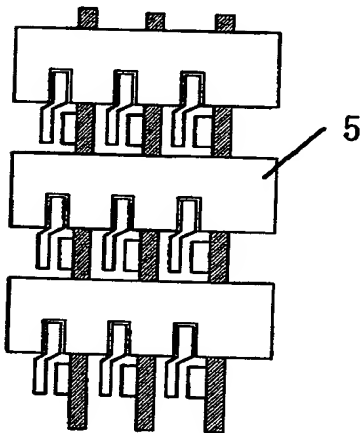
【図 12】



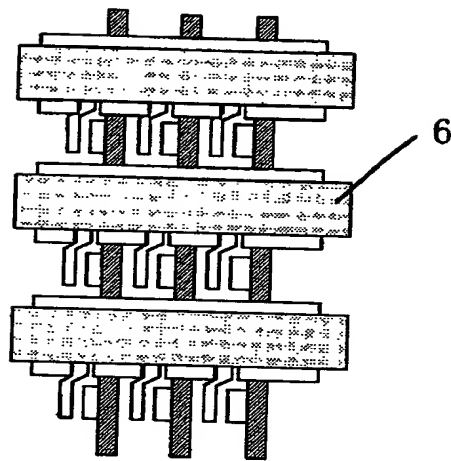
(a)



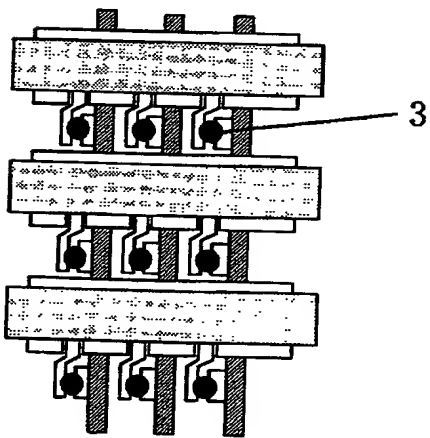
(b)



(c)

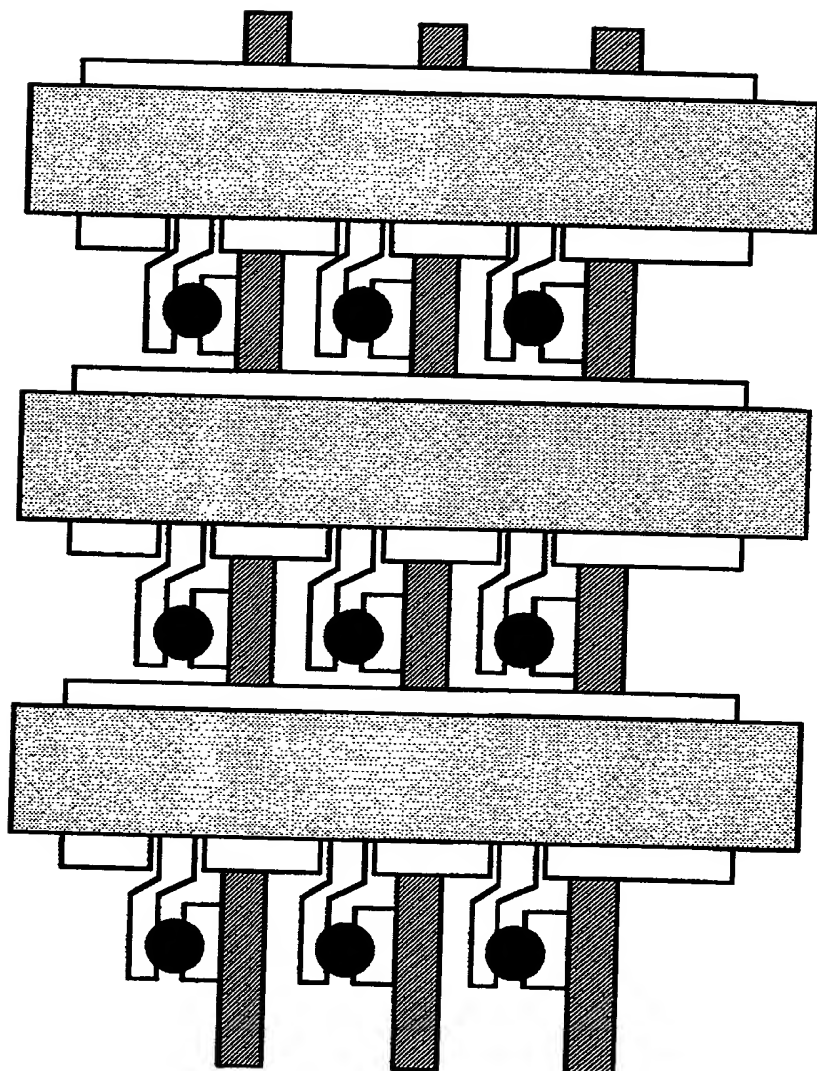


(d)

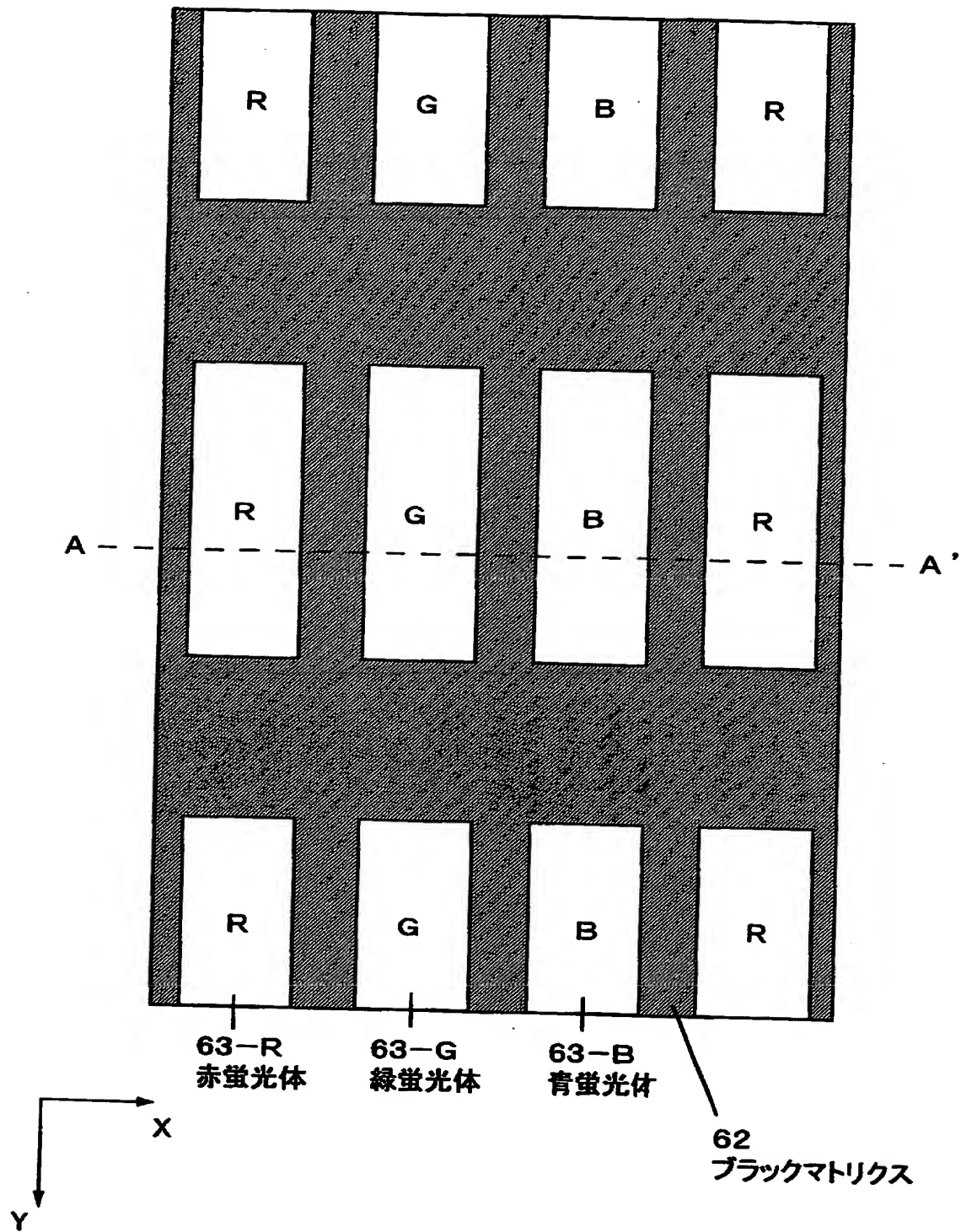


(e)

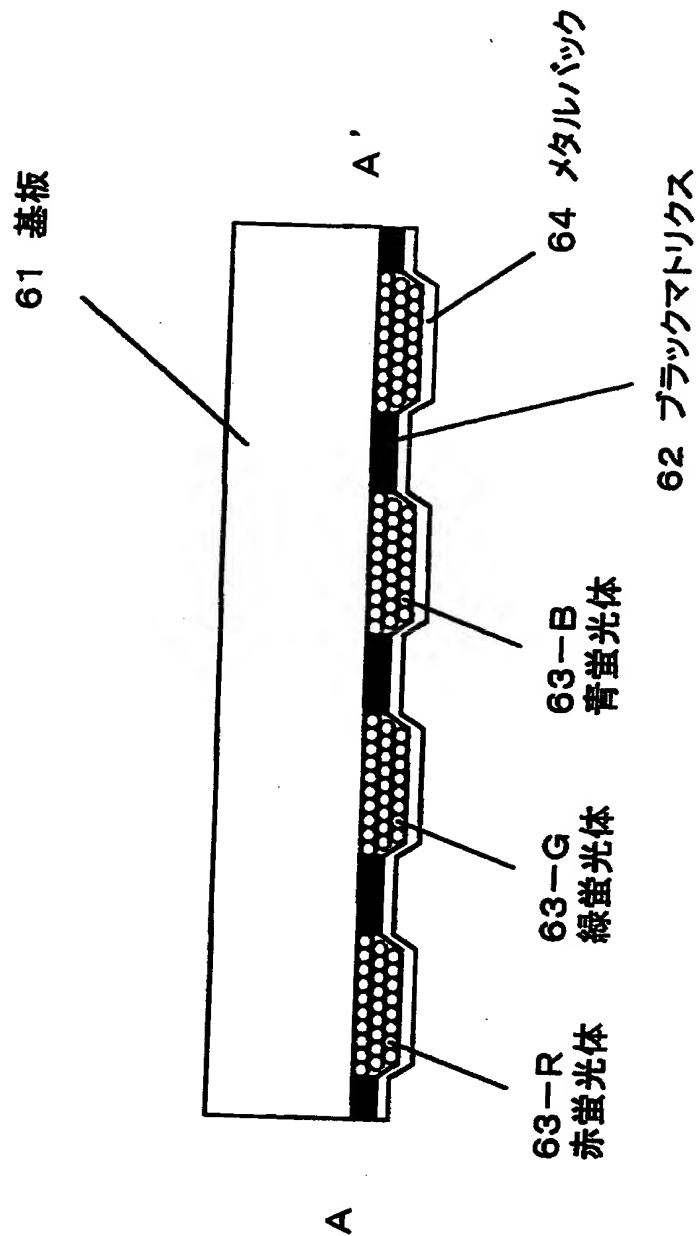
【図 13】



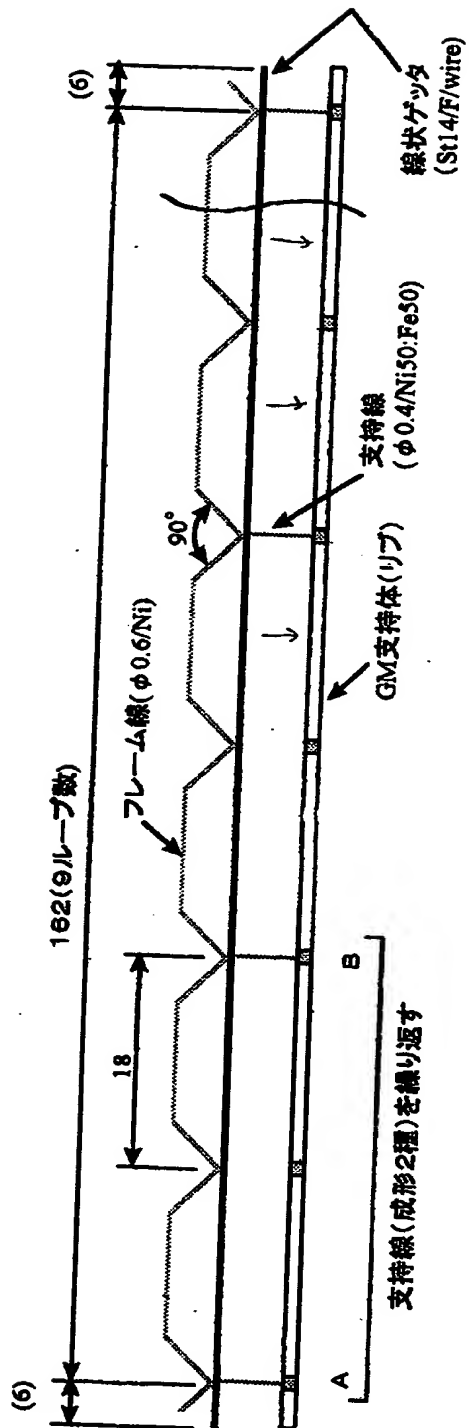
【図 1 4】



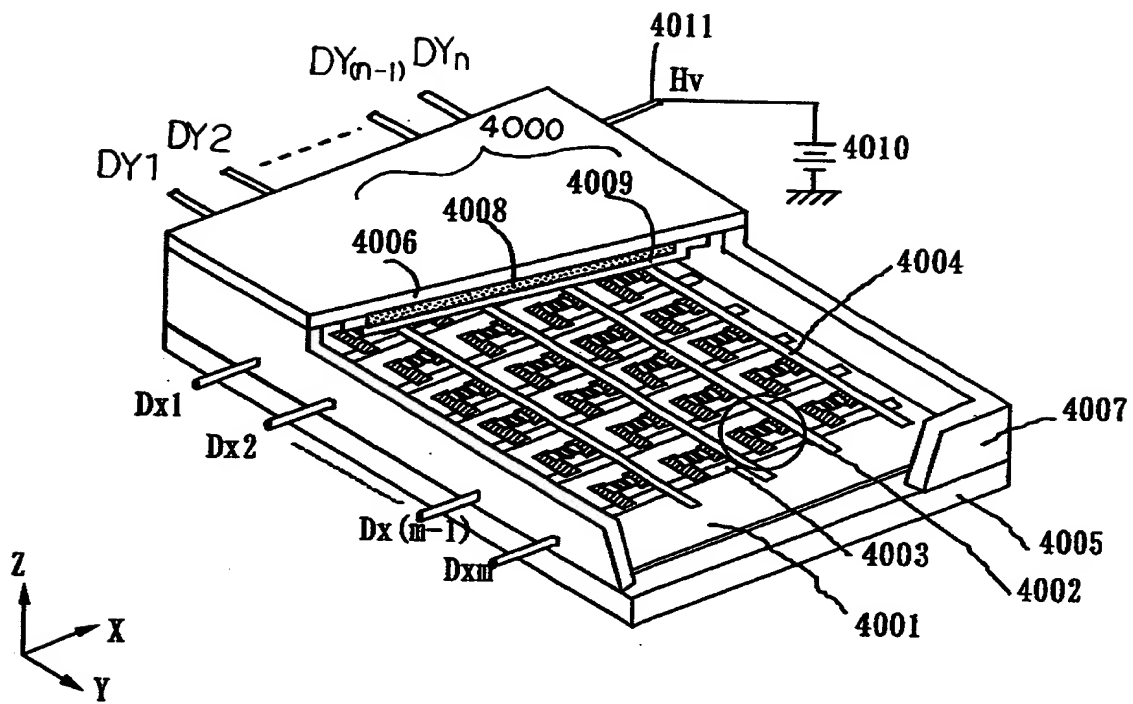
【図15】



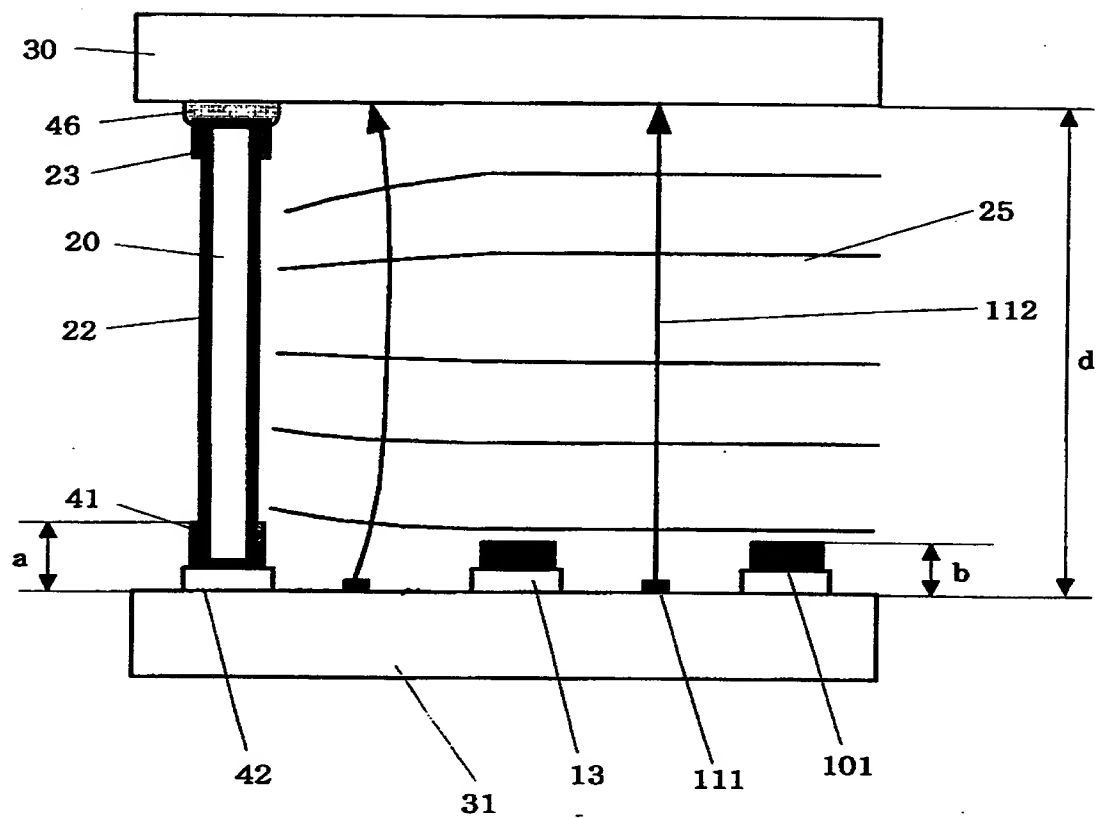
【図16】



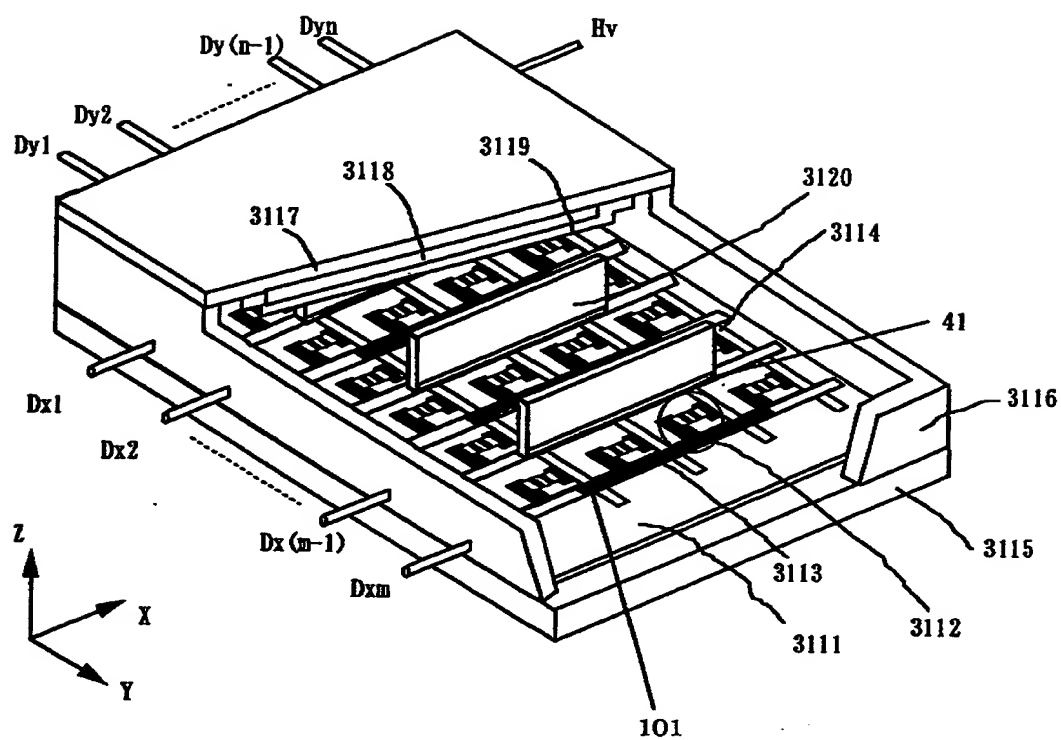
【図 17】



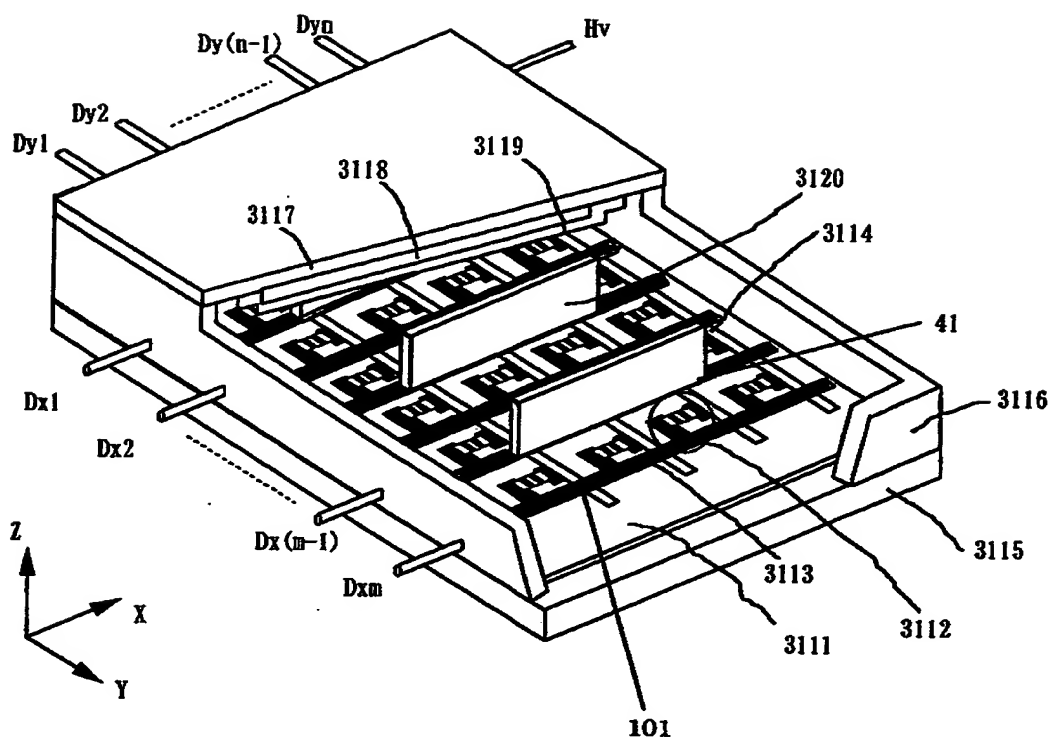
【図 18】



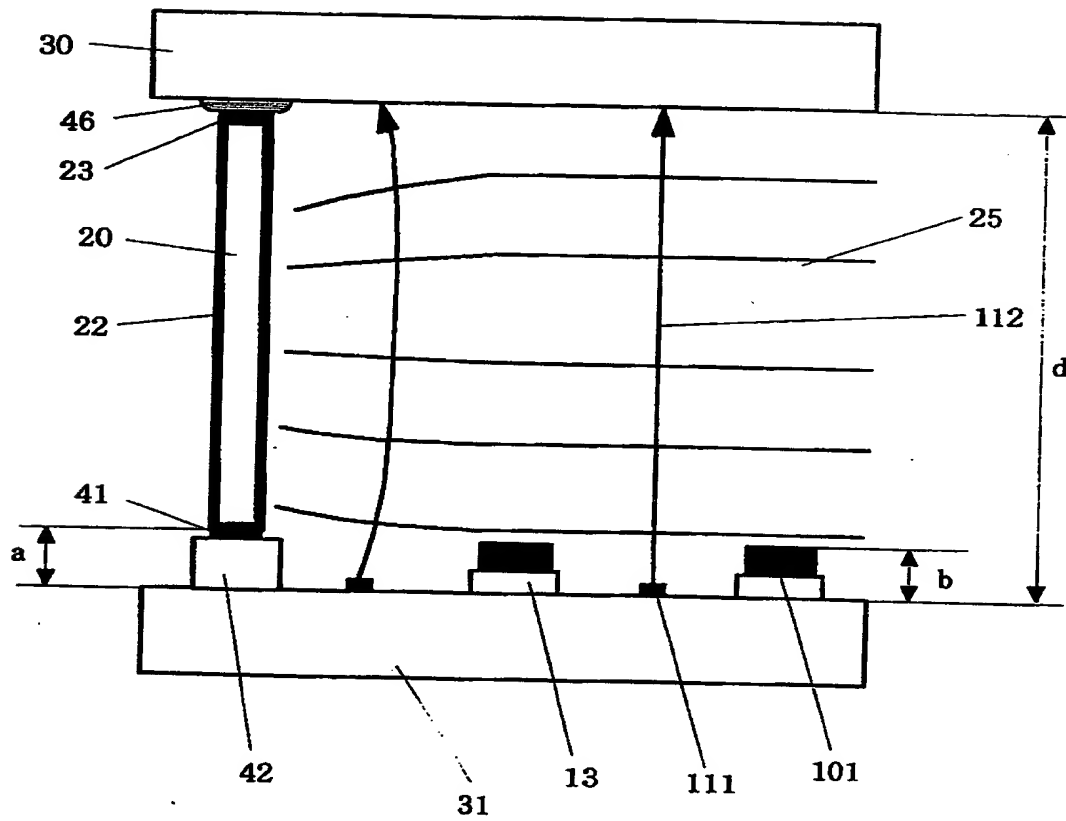
【図 1 9】



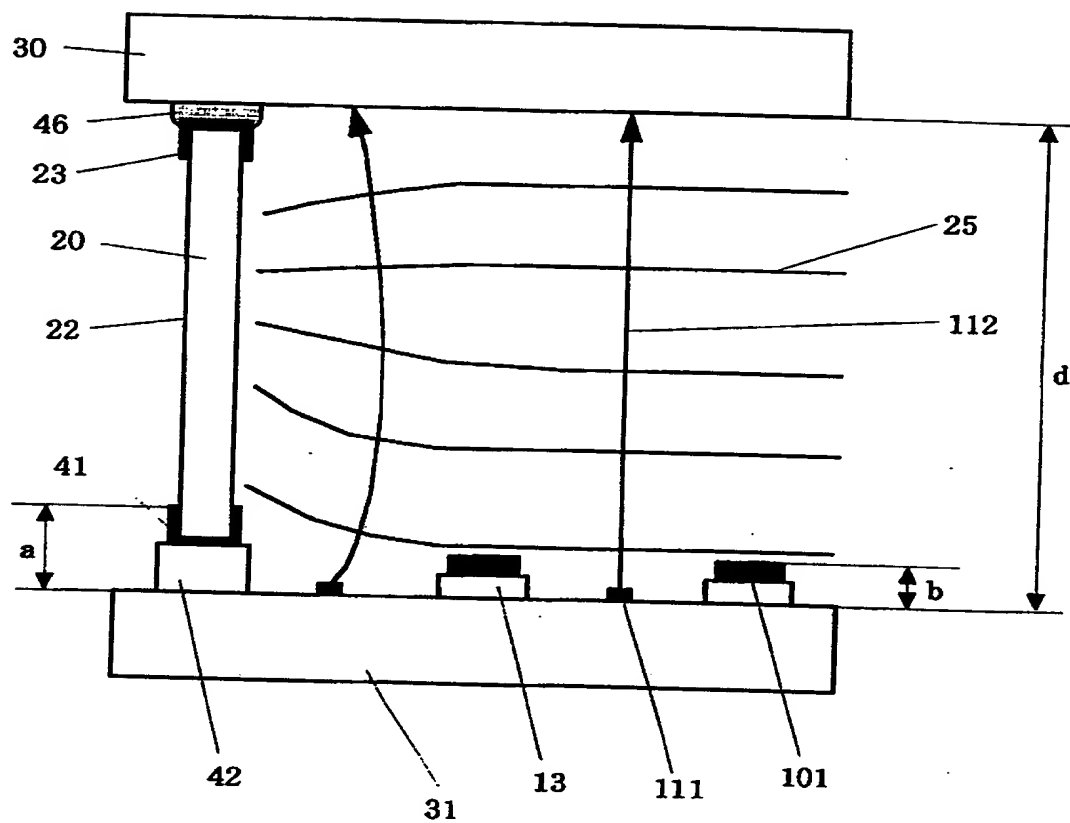
【図 2 0】



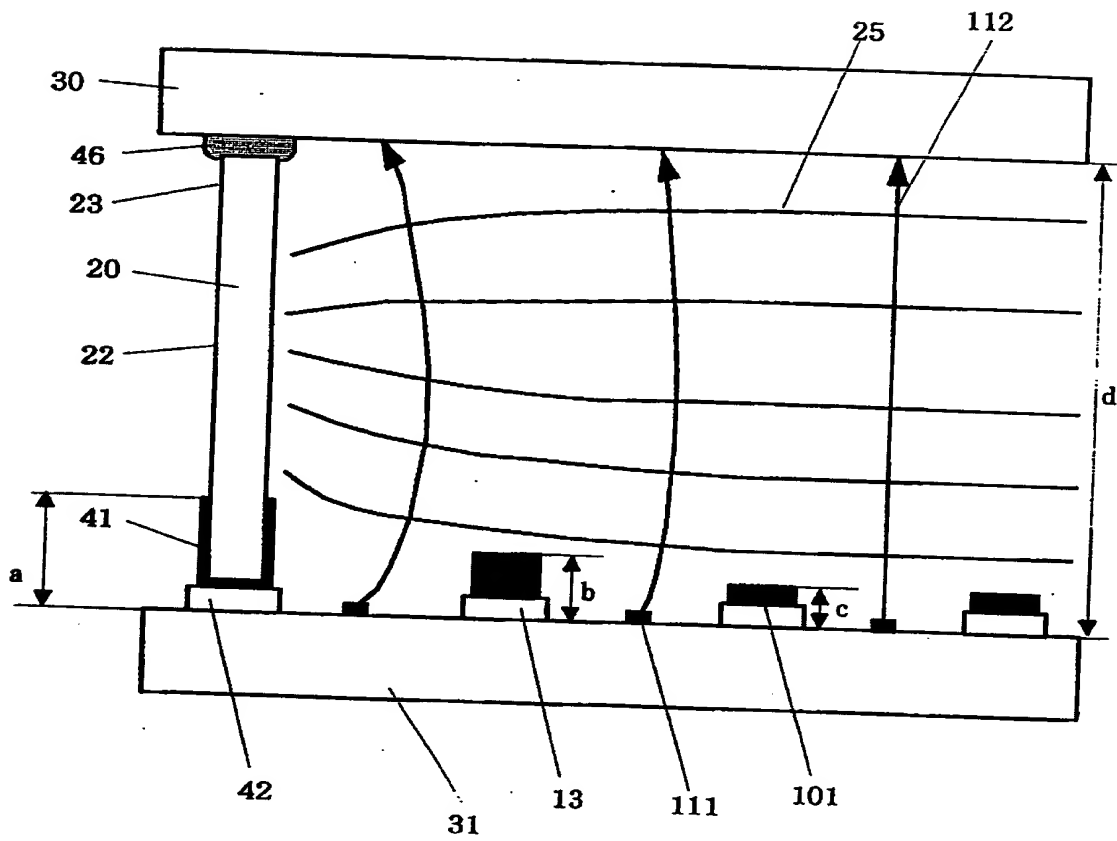
【図 21】



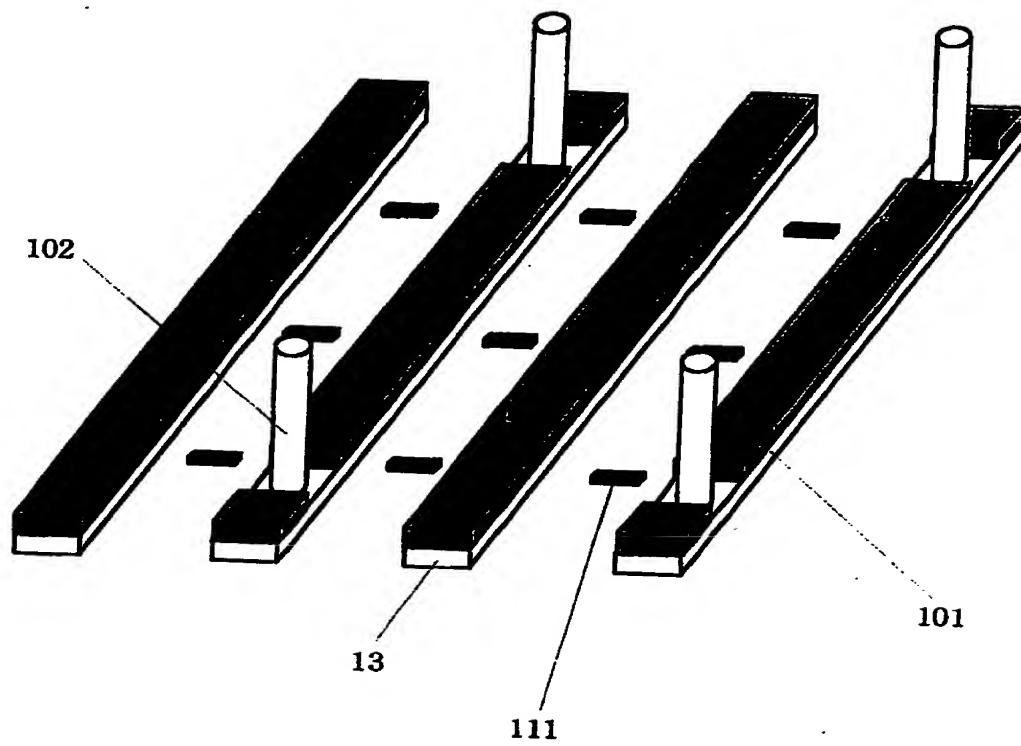
【図 22】



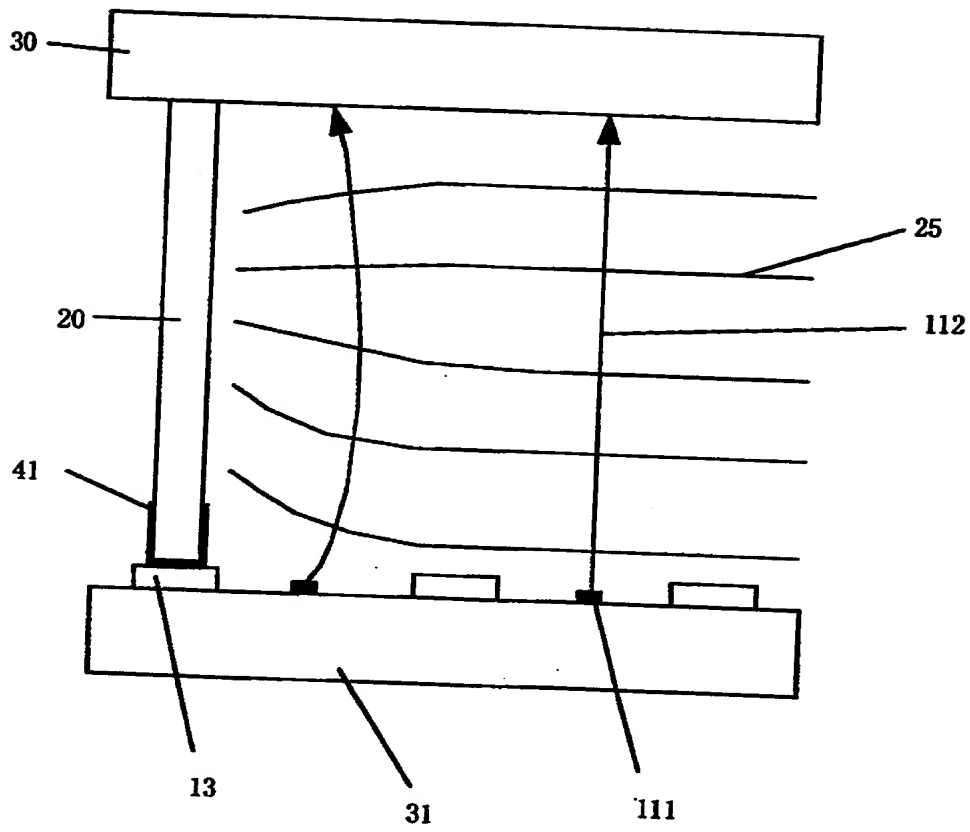
【図 23】



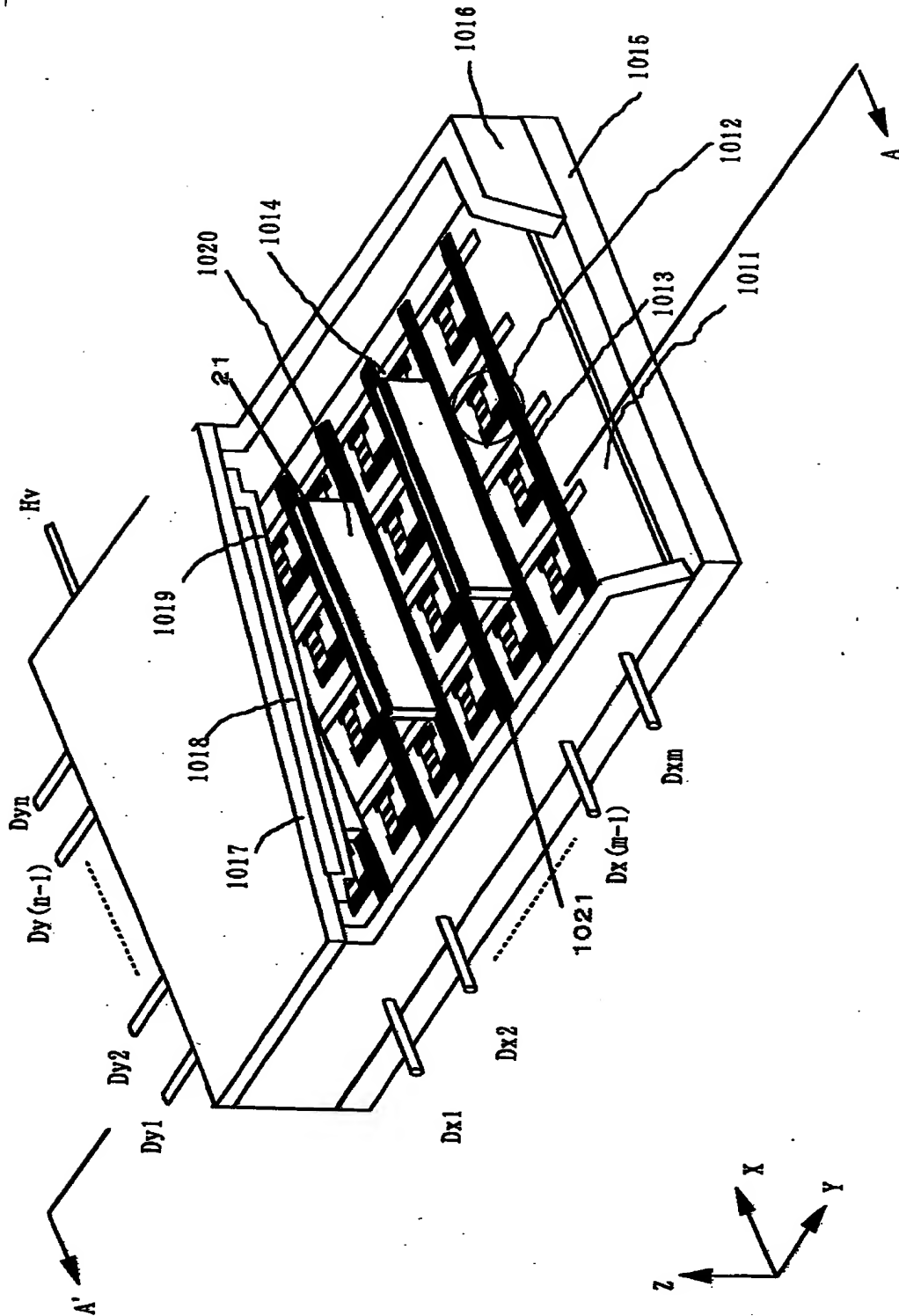
【図 24】



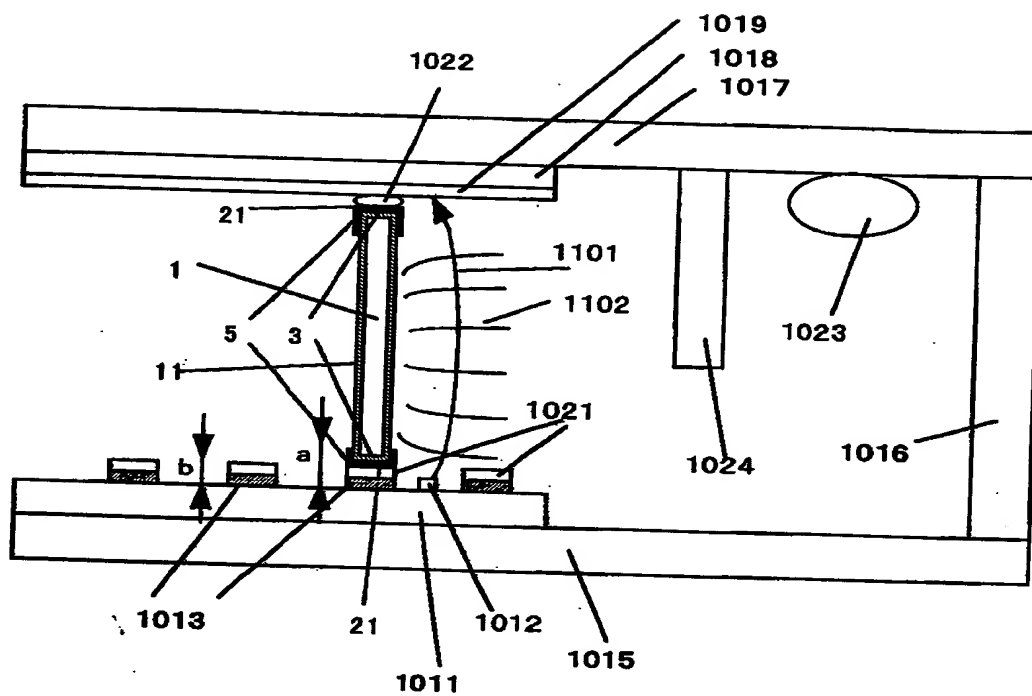
【図 25】



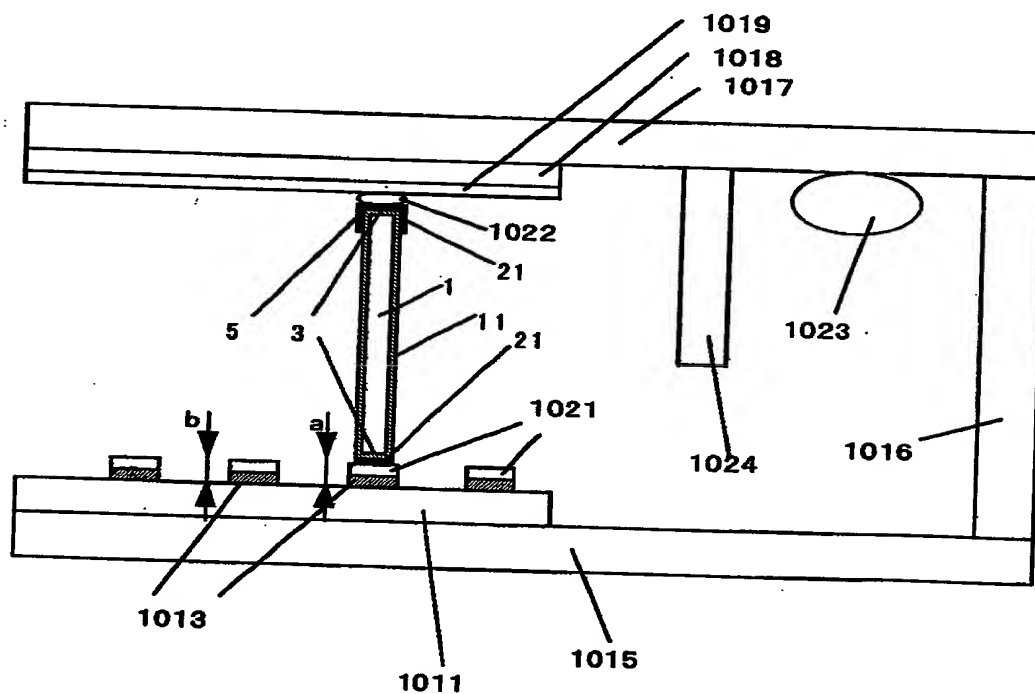
【図 26】



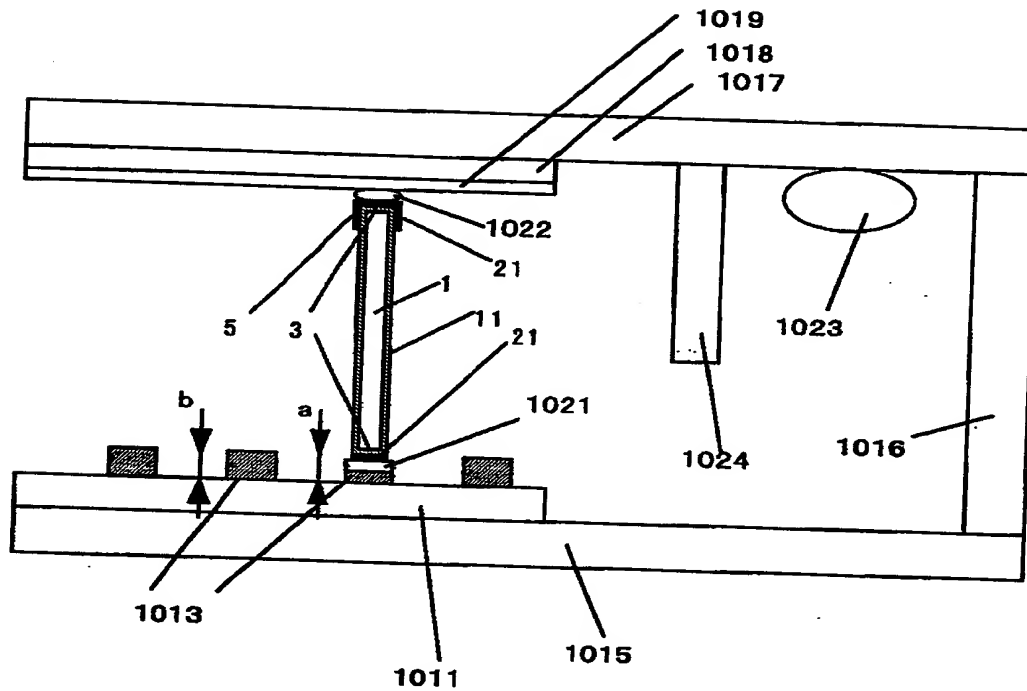
【図 27】



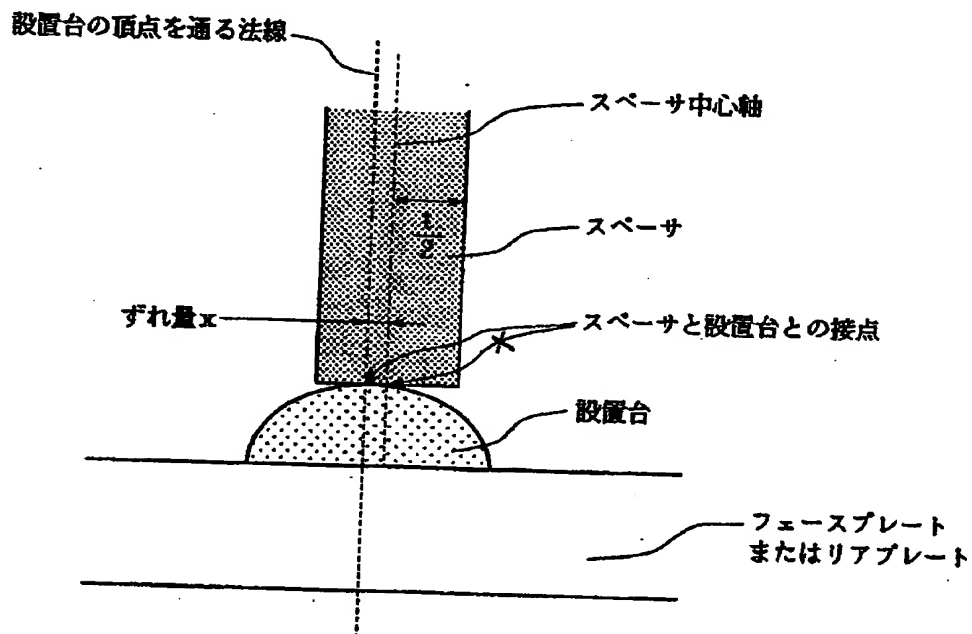
【図 28】



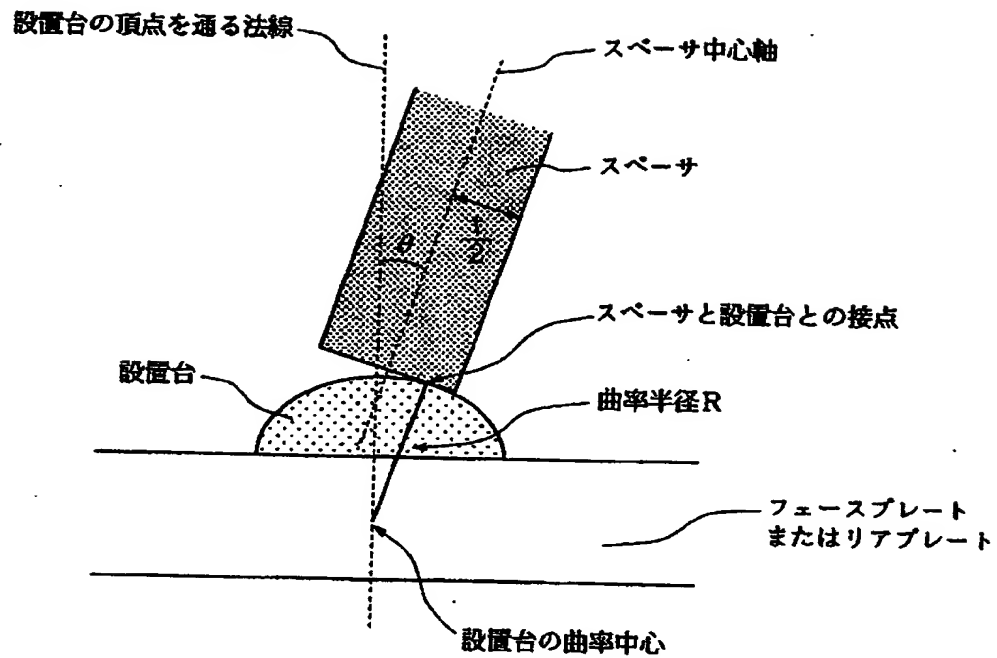
【図 29】



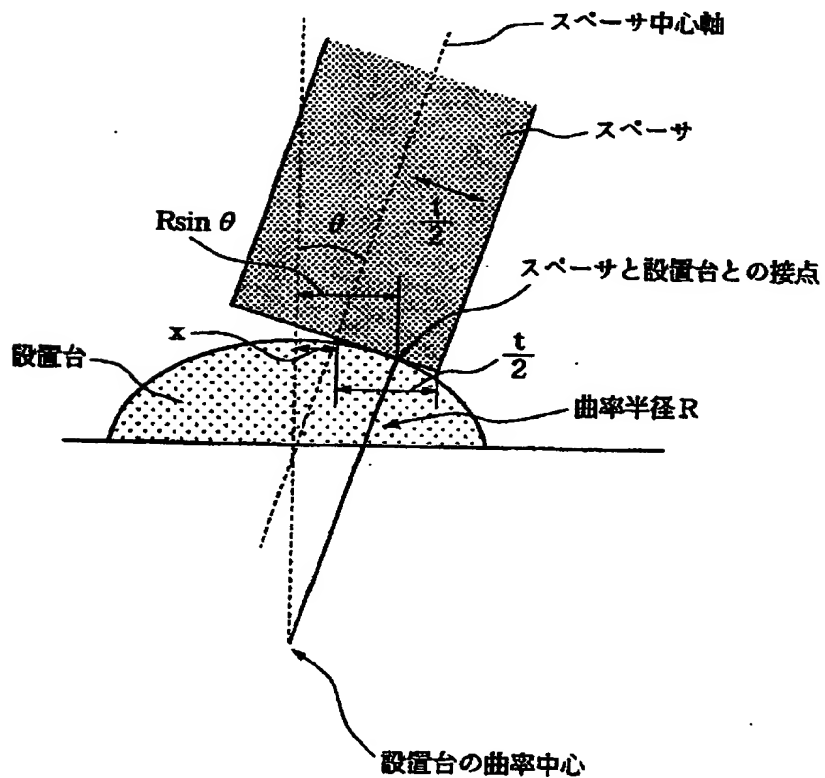
【図 30】



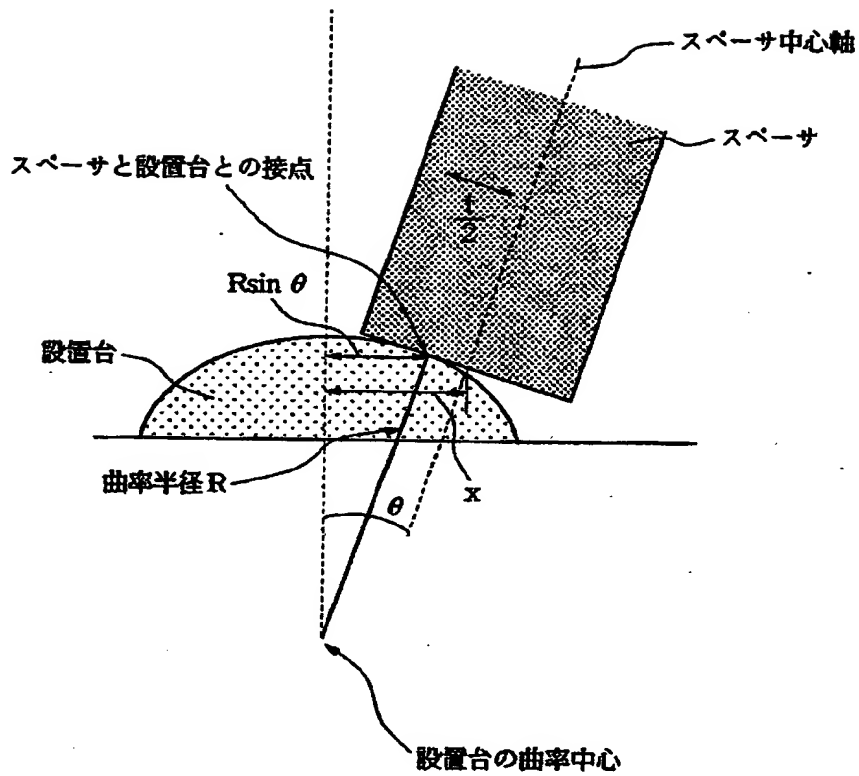
【図 3 1】



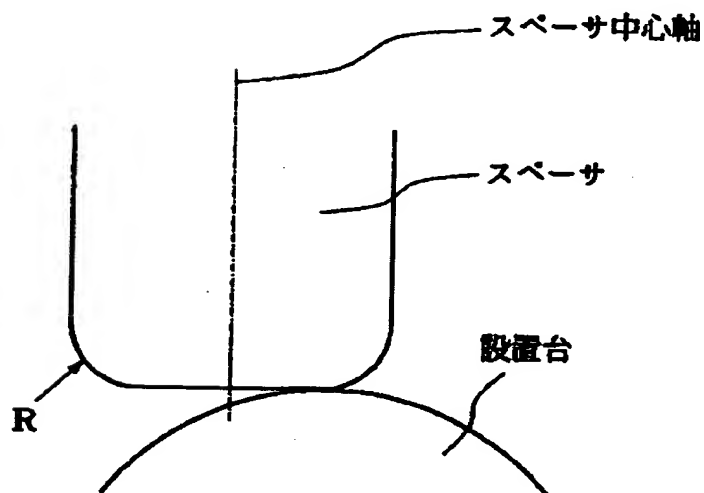
【図 3 2】



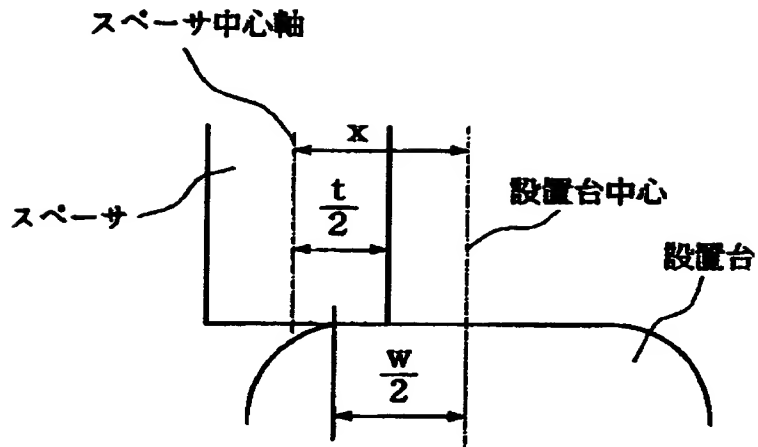
【図 33】



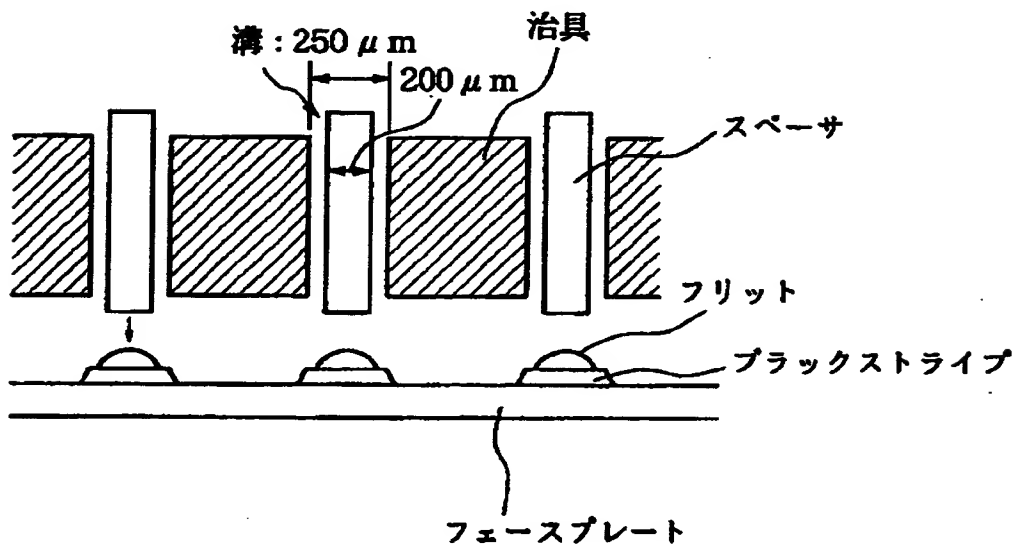
【図 34】



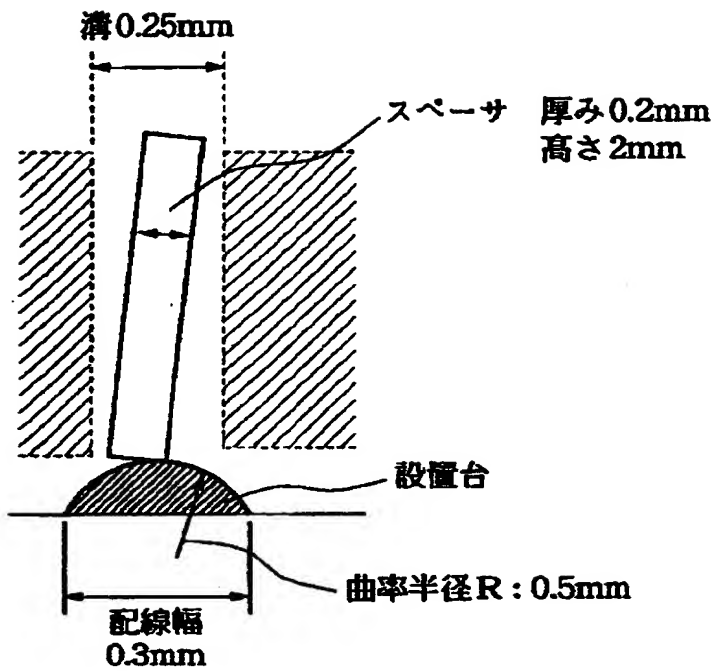
【図 3 5】



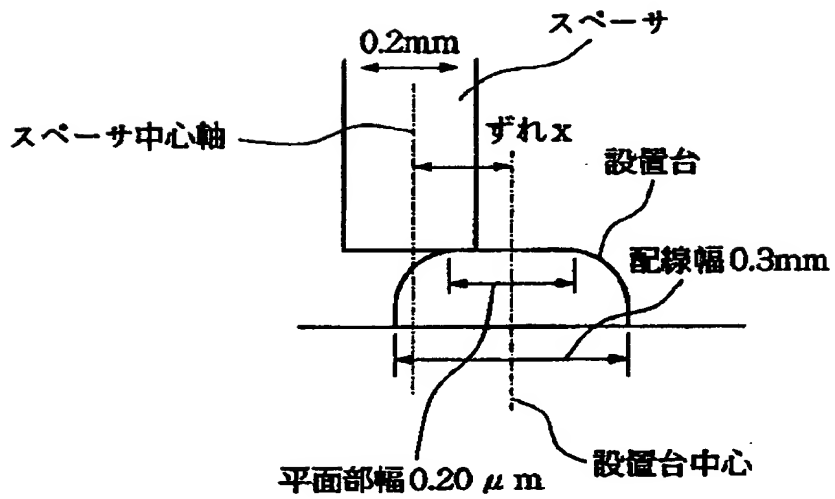
【図 3 6】



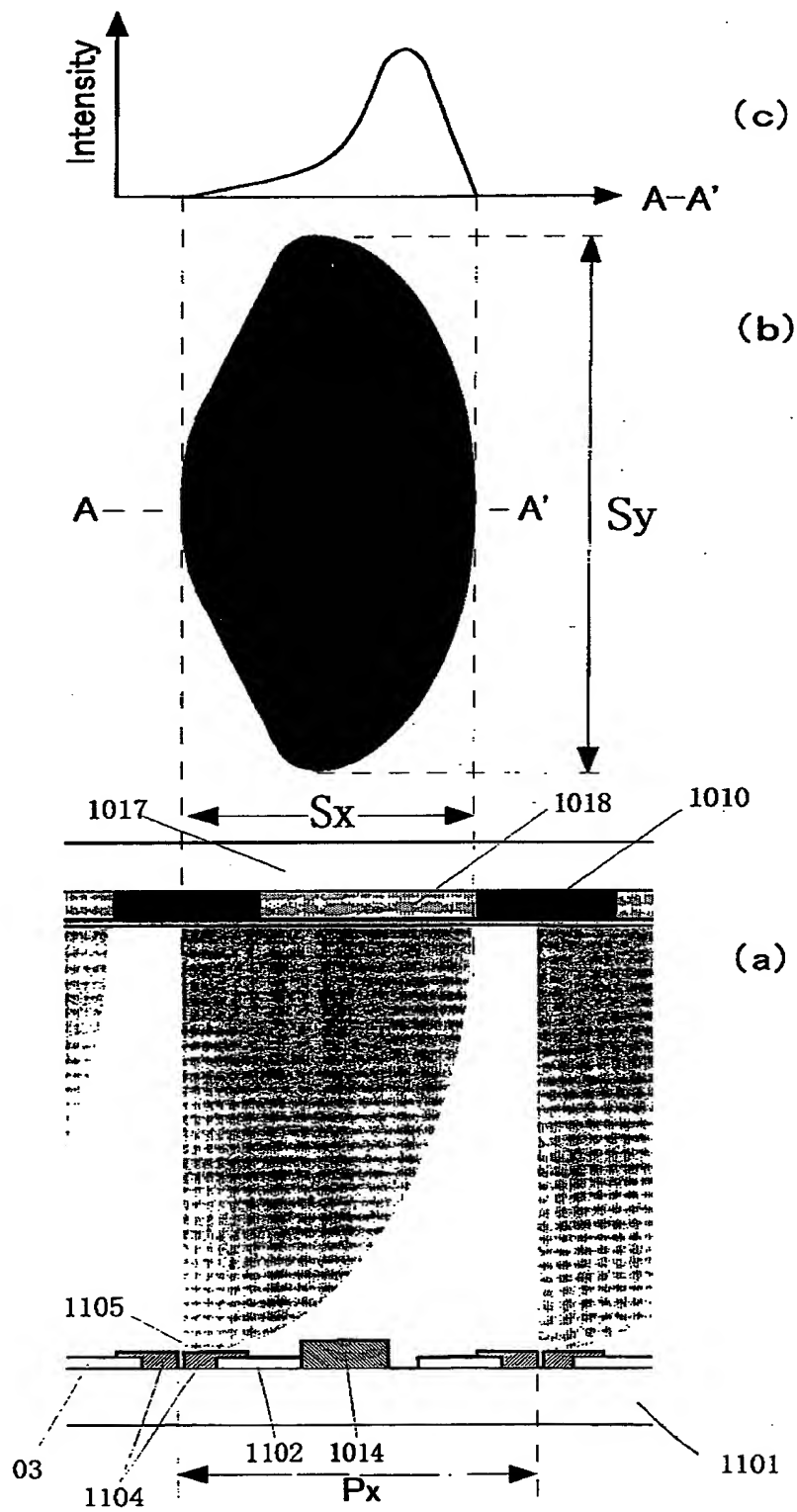
【図 3 7】



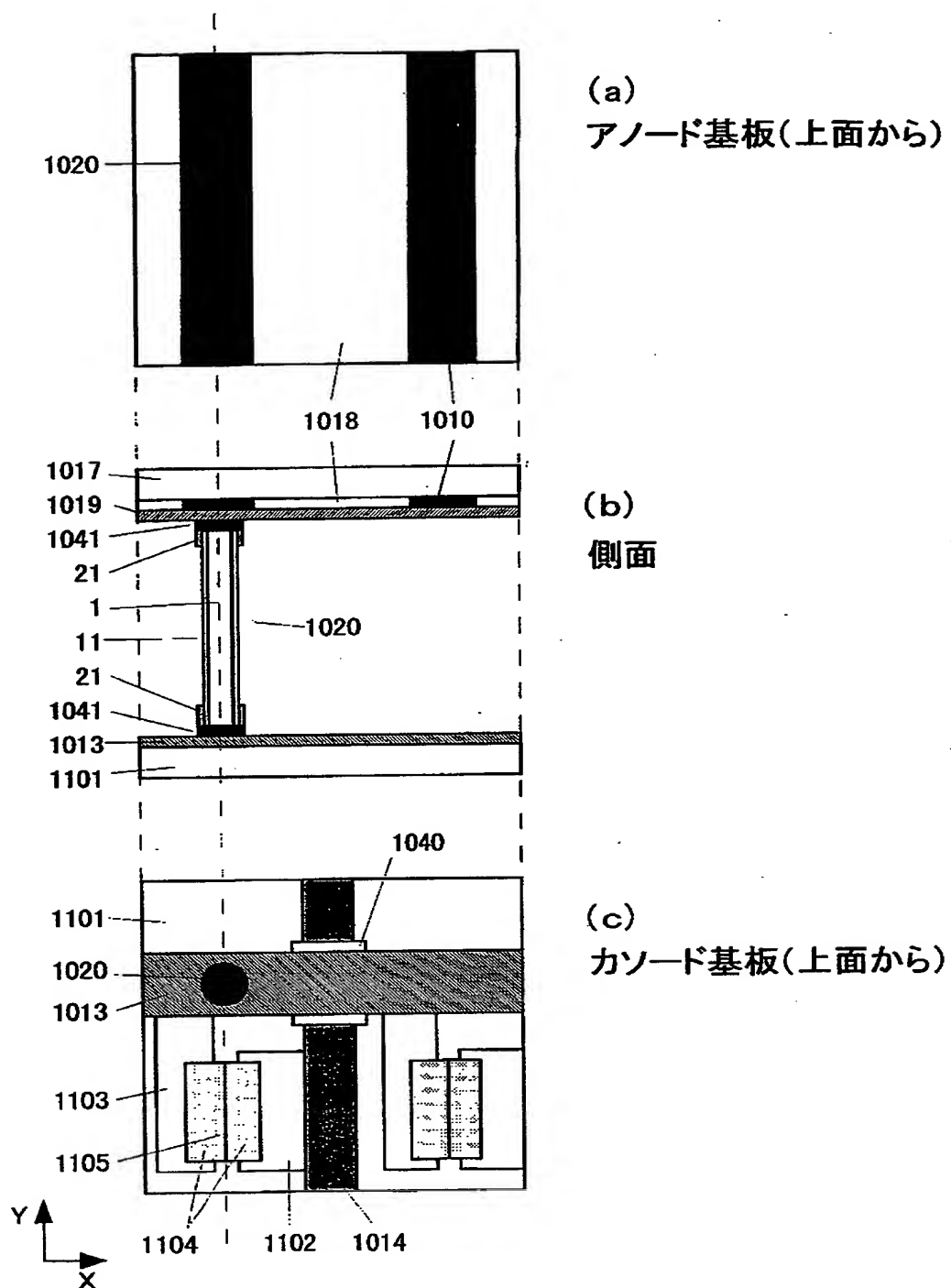
【図 3 8】



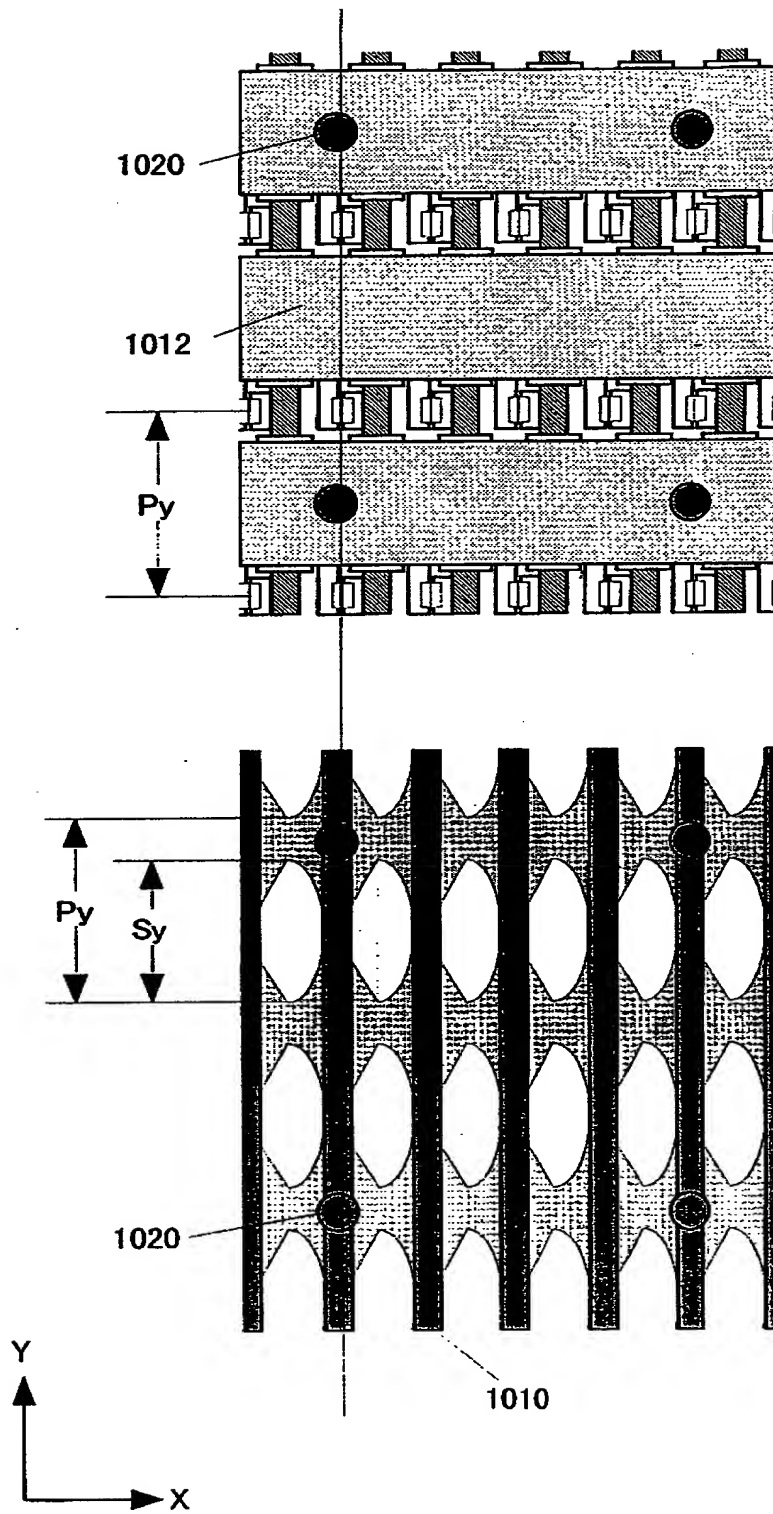
【図 39】



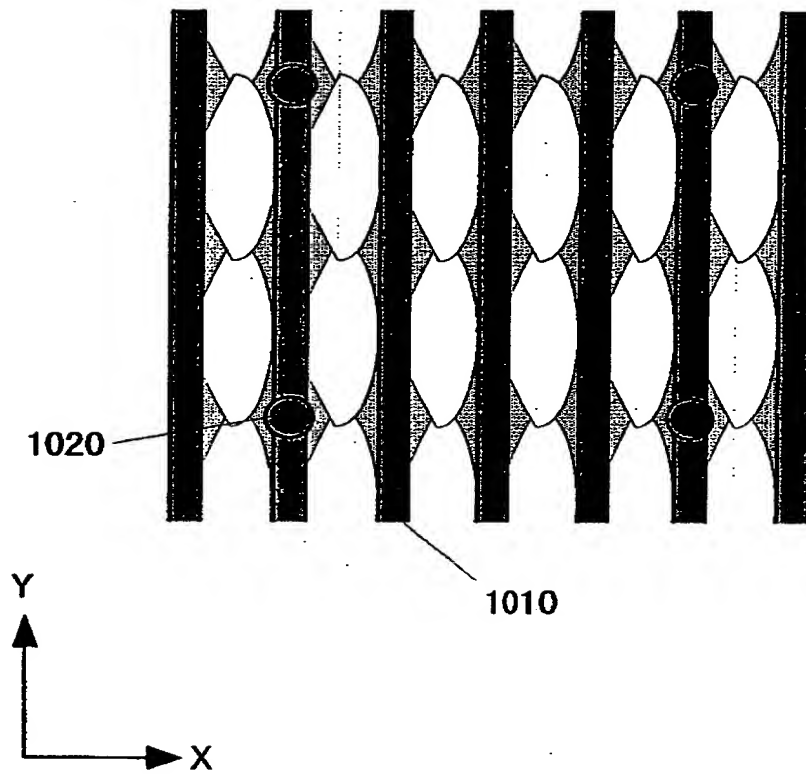
【図 40】



【図 4 1】

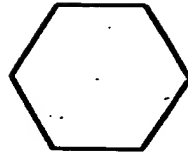
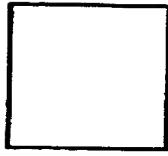


【図 4 2】

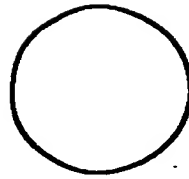
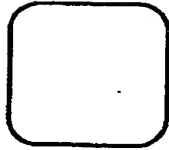


【図 4 3】

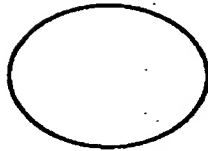
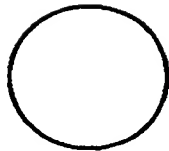
(a)



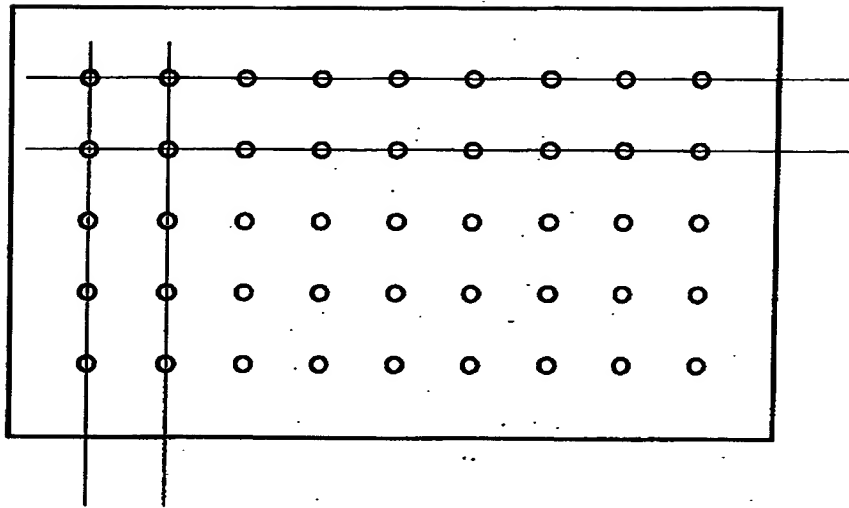
(b)



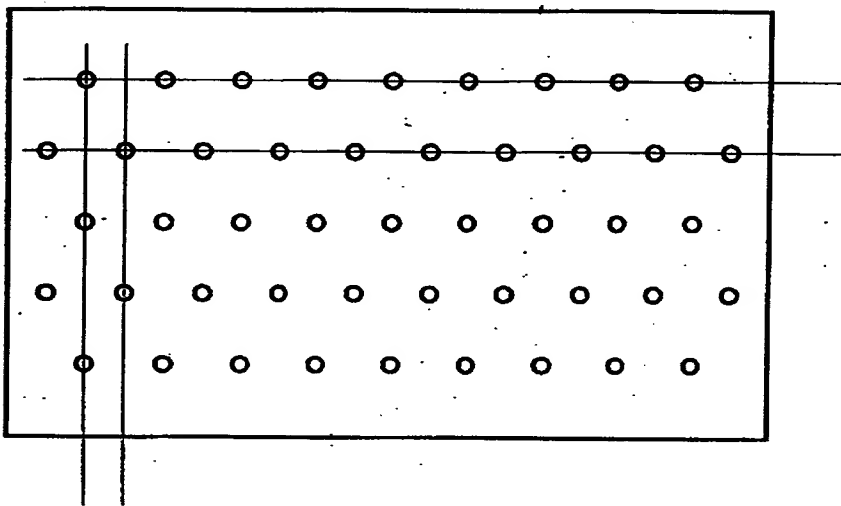
(c)



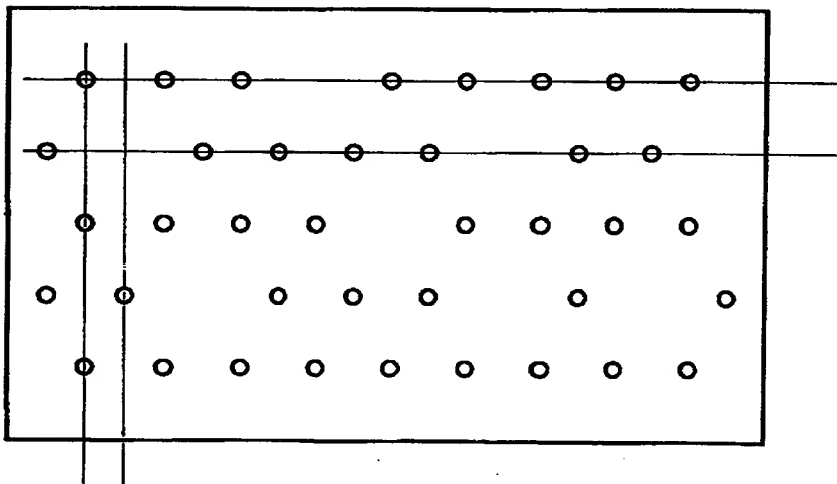
【図 4 4】



(a)

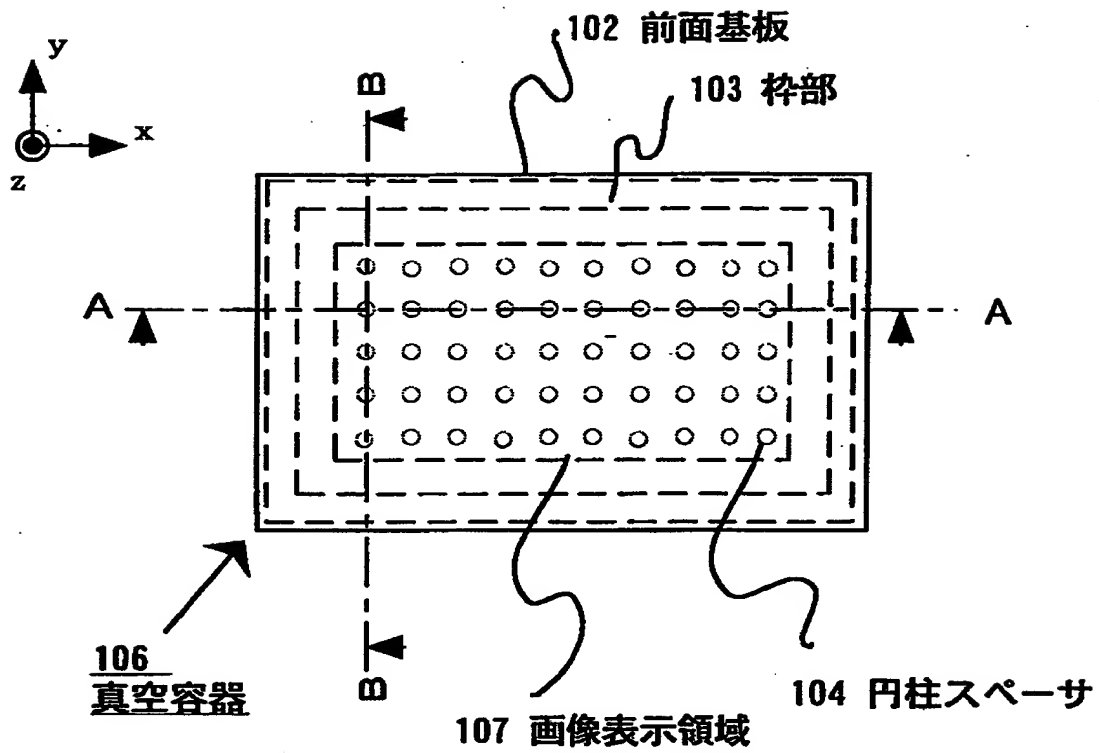


(b)

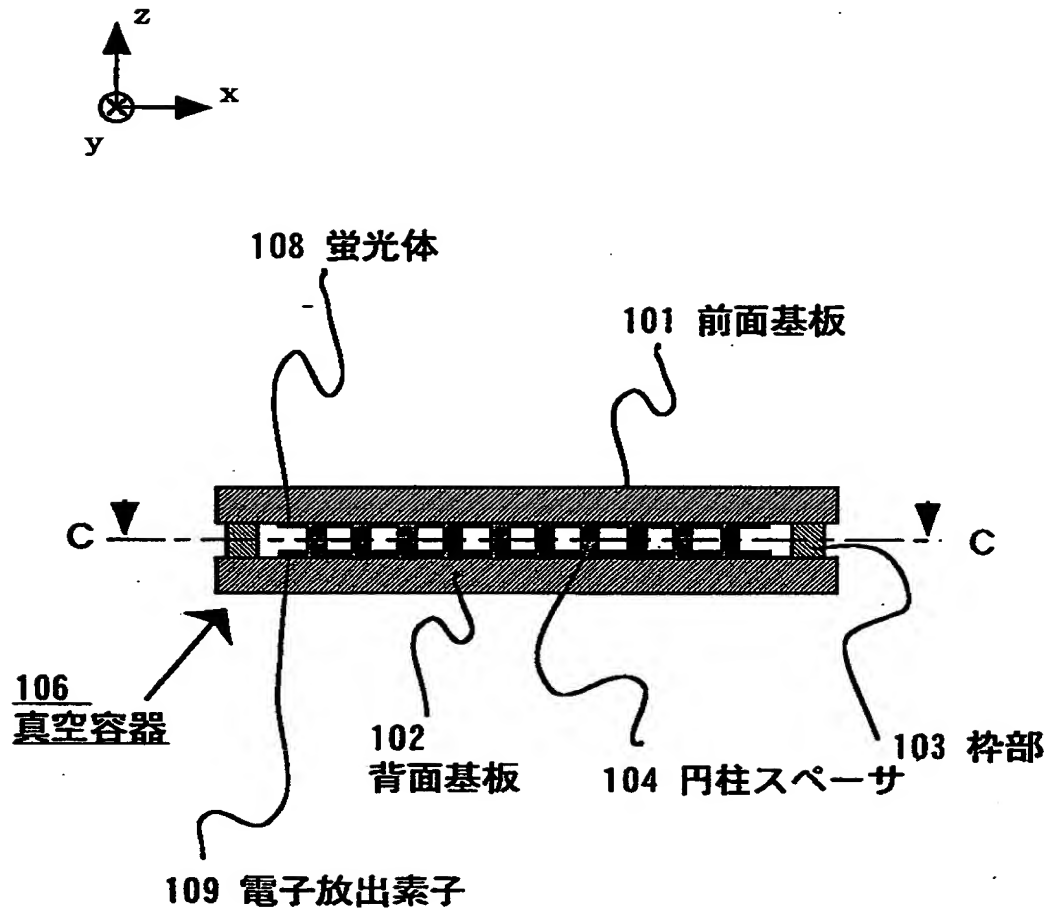


(c)

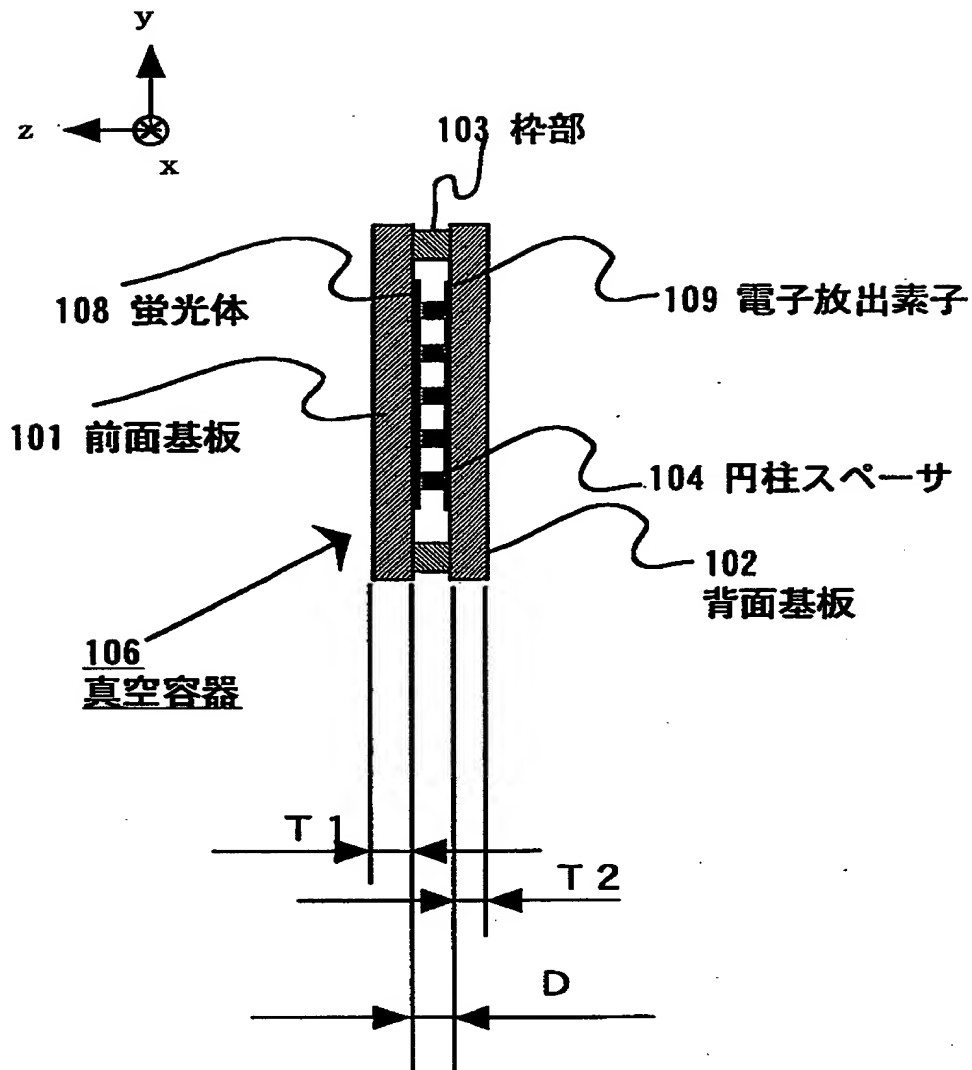
【図 45】



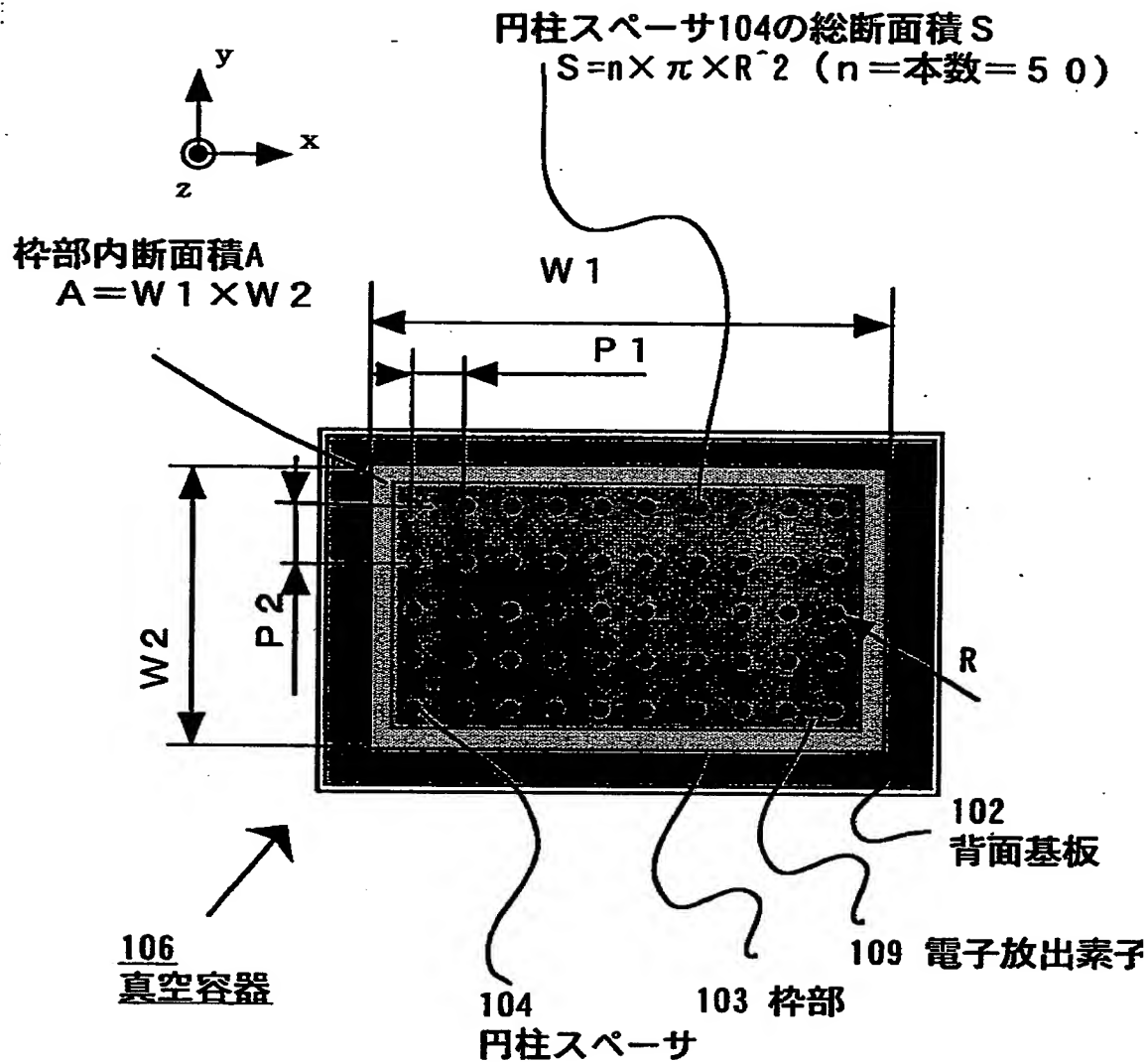
【図 4 6】



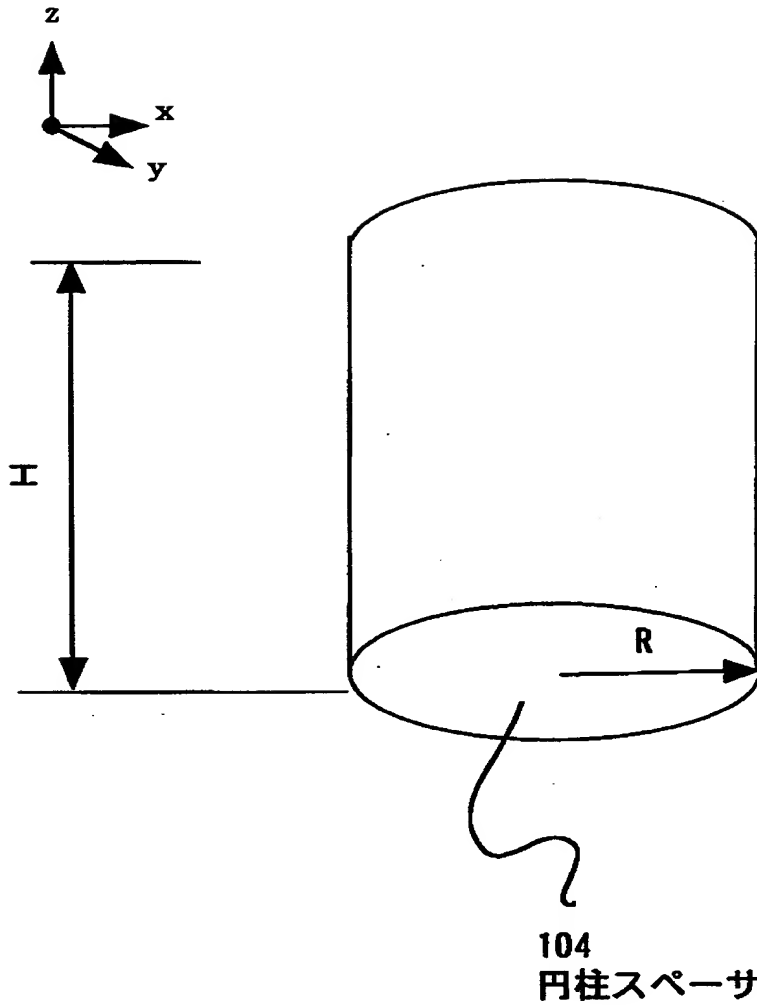
【図 4 7】



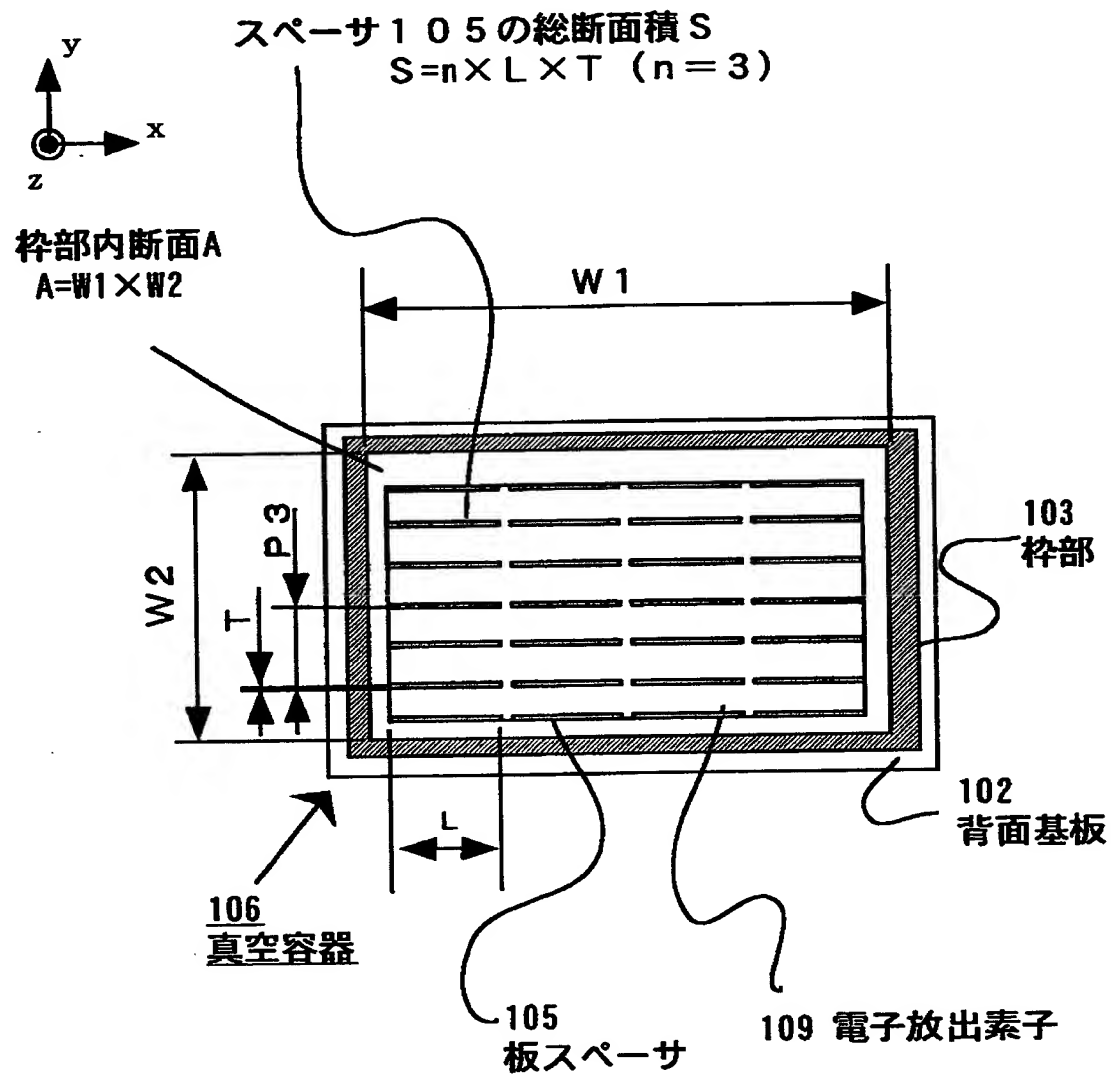
【図 4 8】



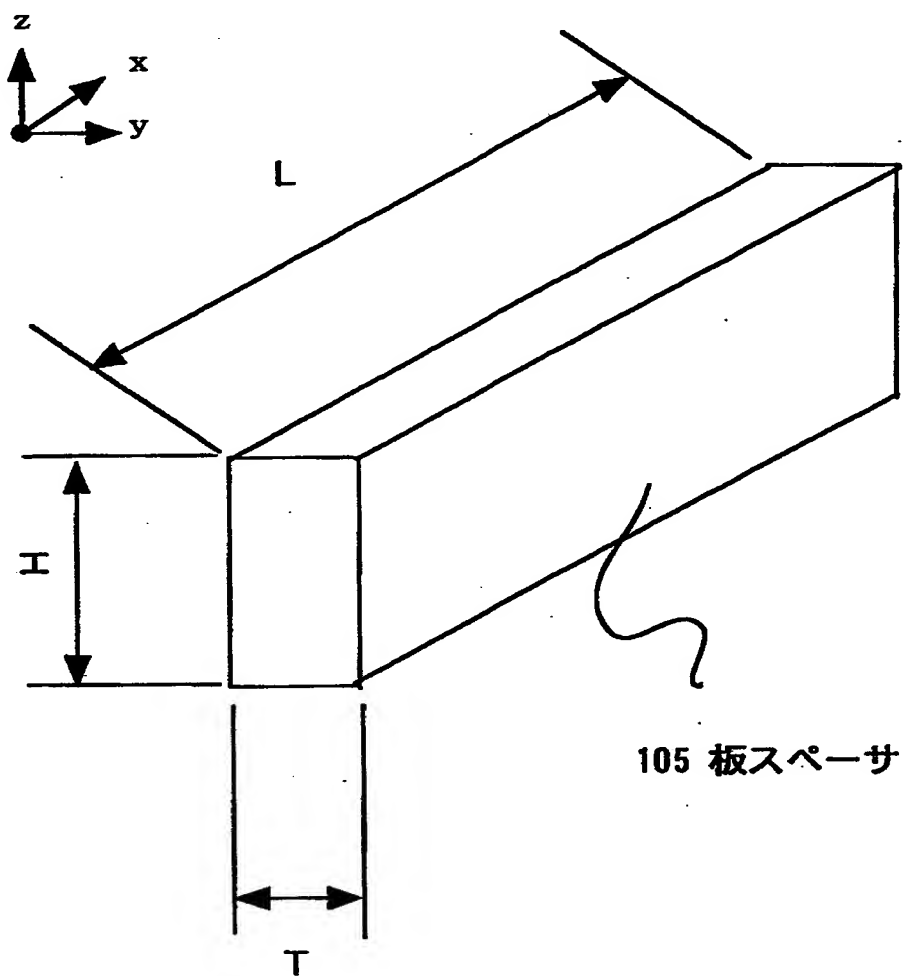
【図 4 9】



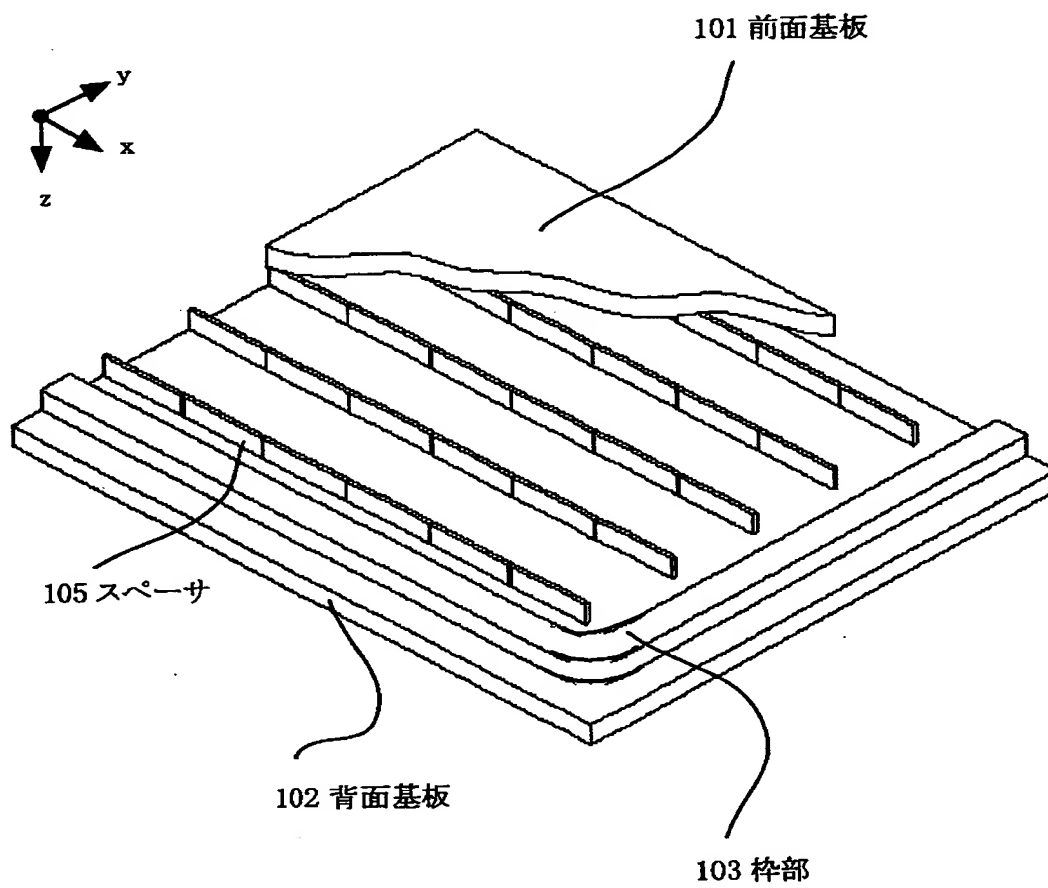
【図5.0】



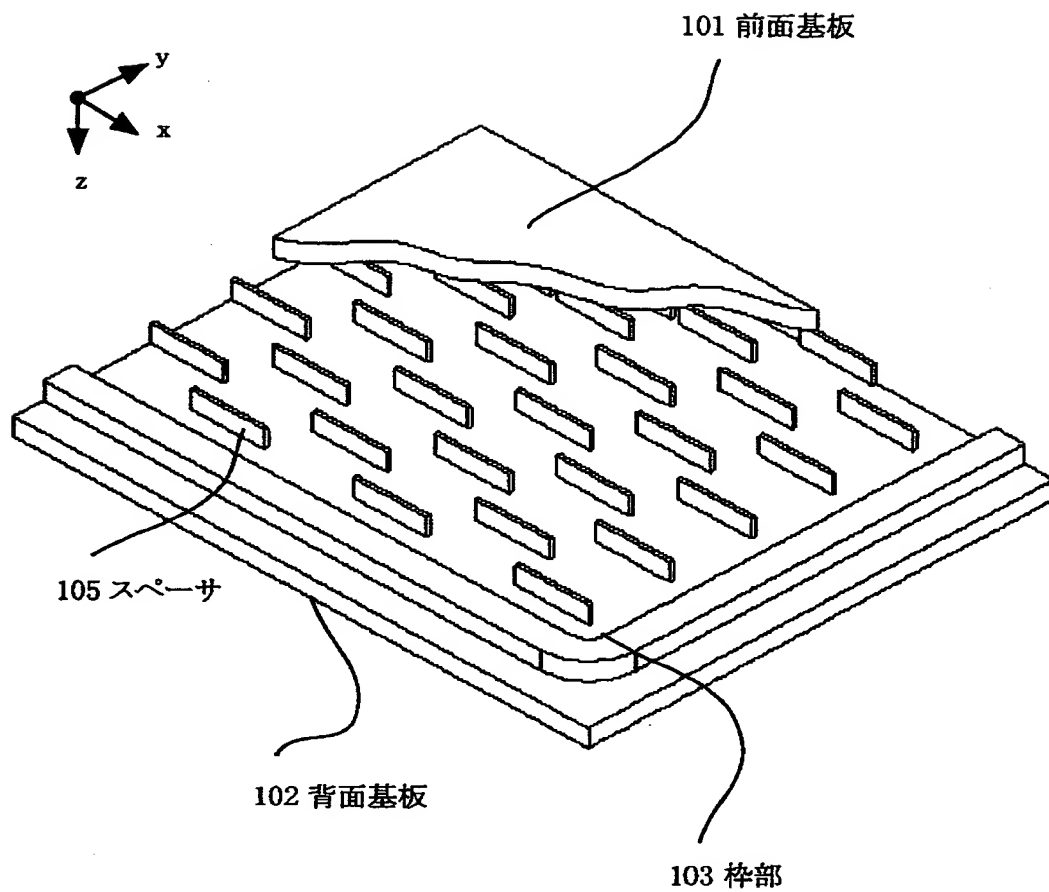
【図 51】



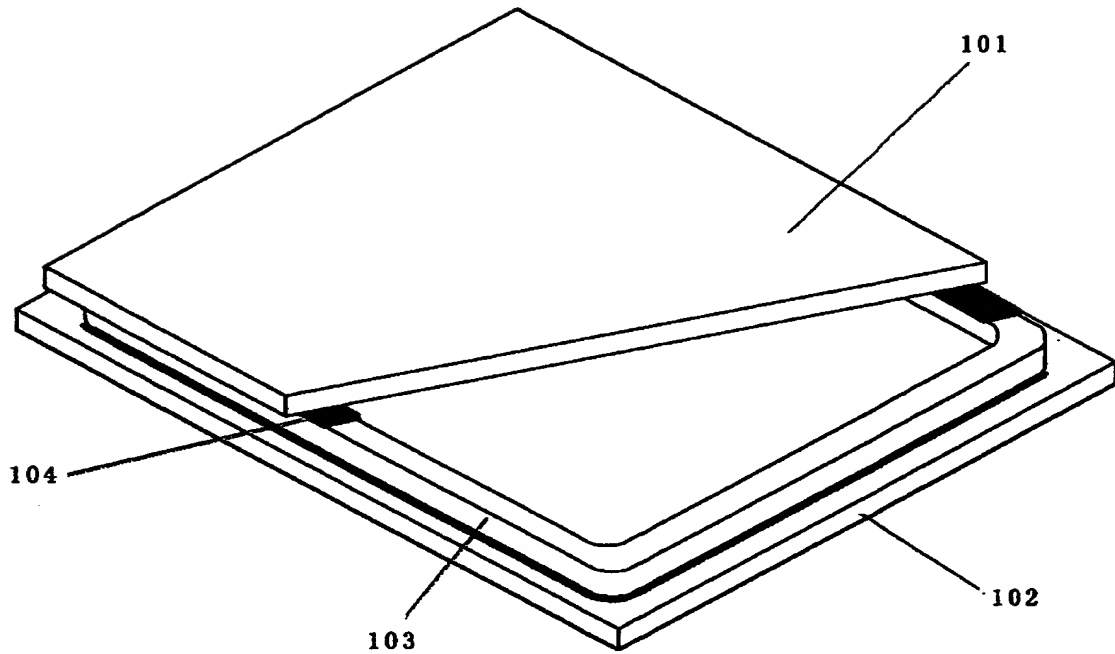
【図 5 2】



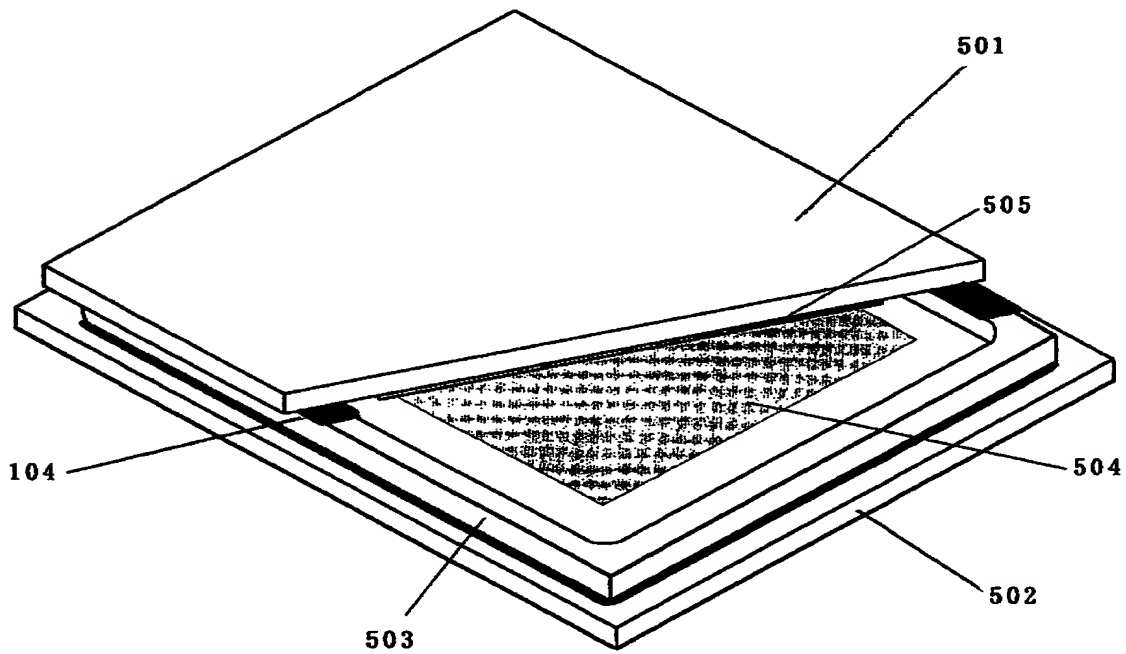
【図 5 3】



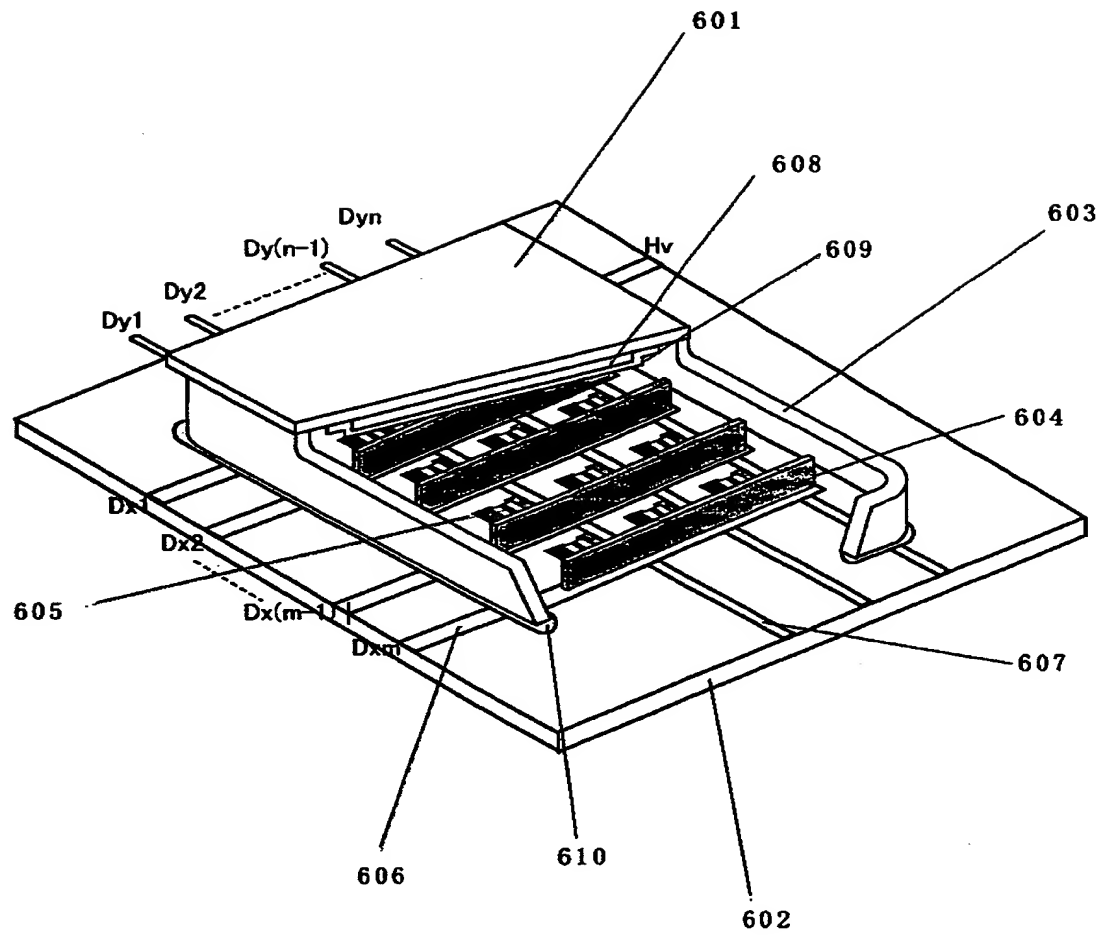
【図 54】



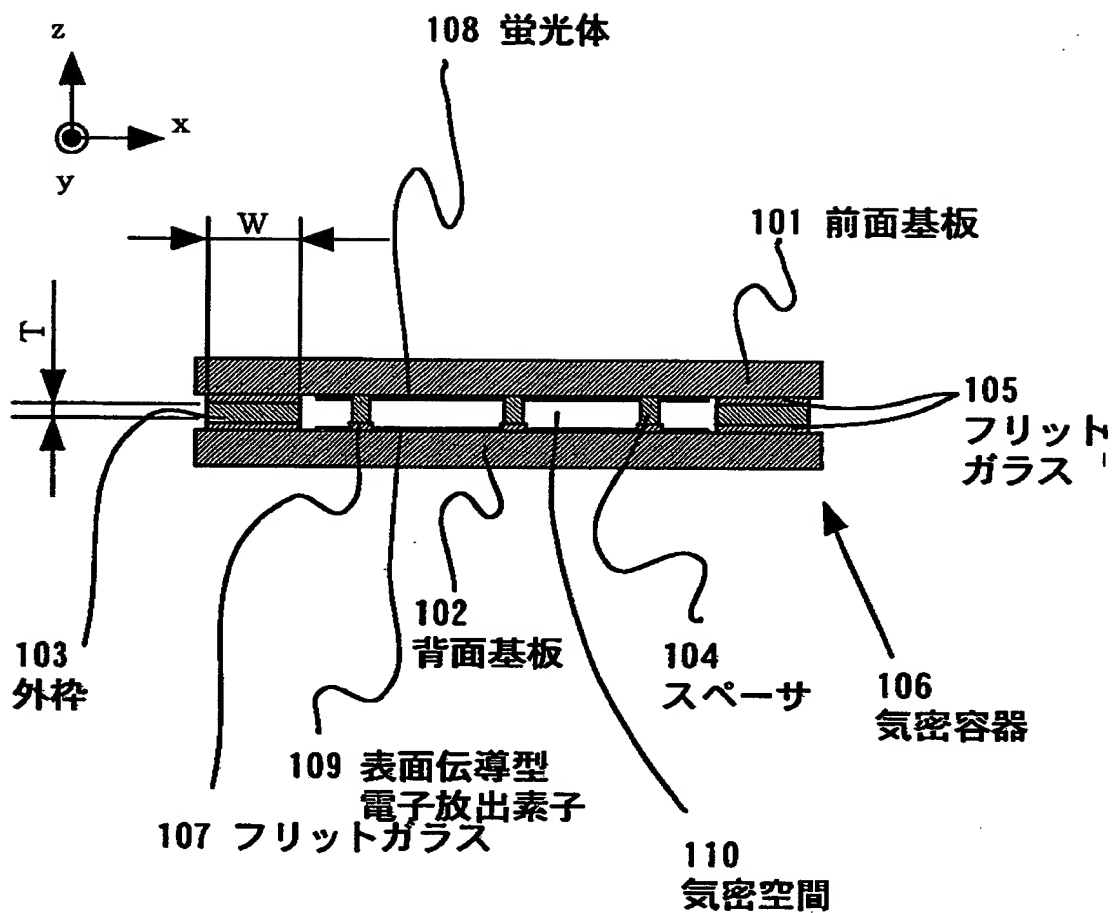
【図 55】



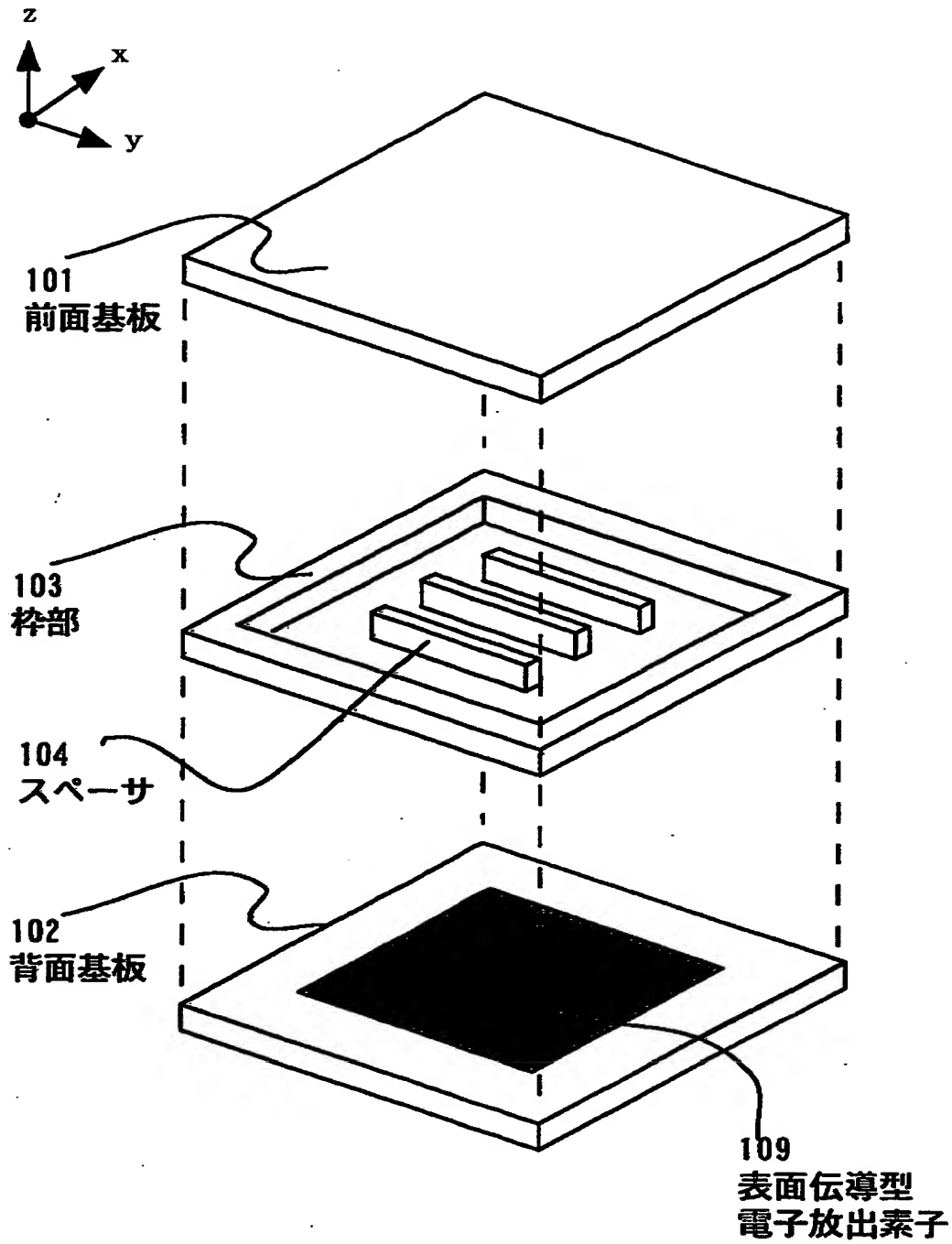
【図 5 6】



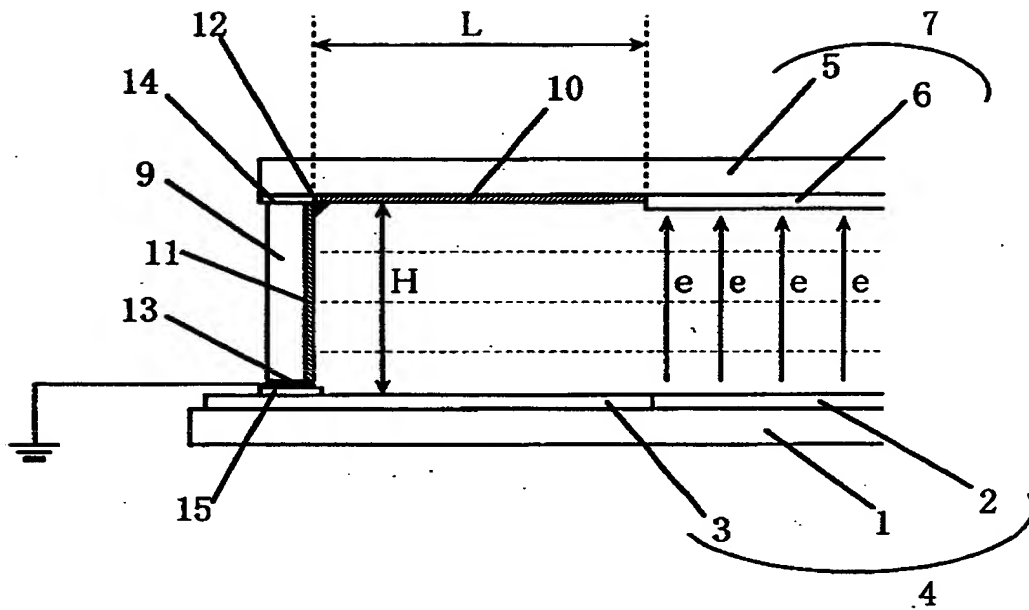
【図 5 7】



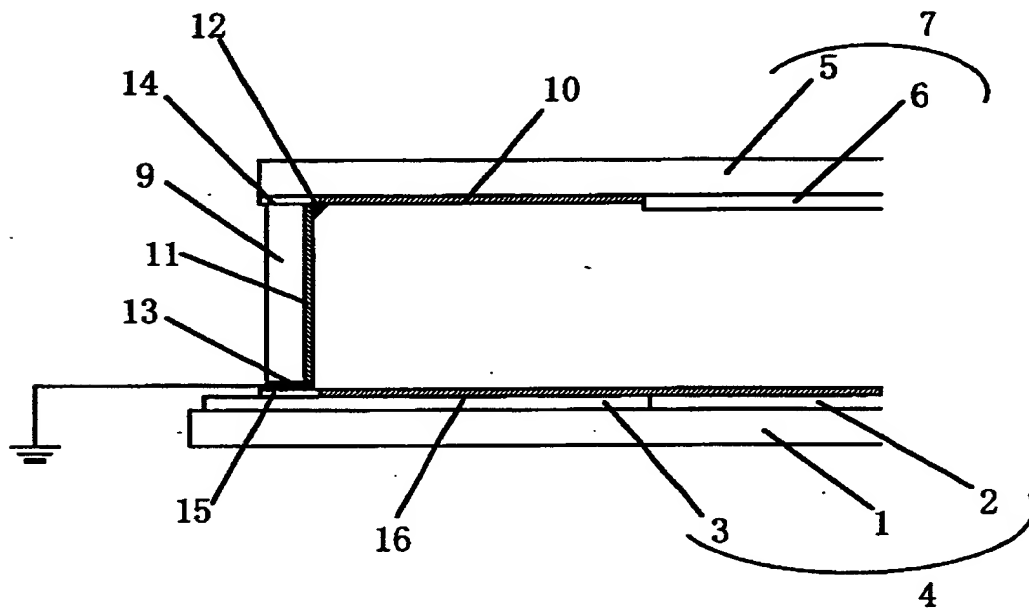
【図 58】



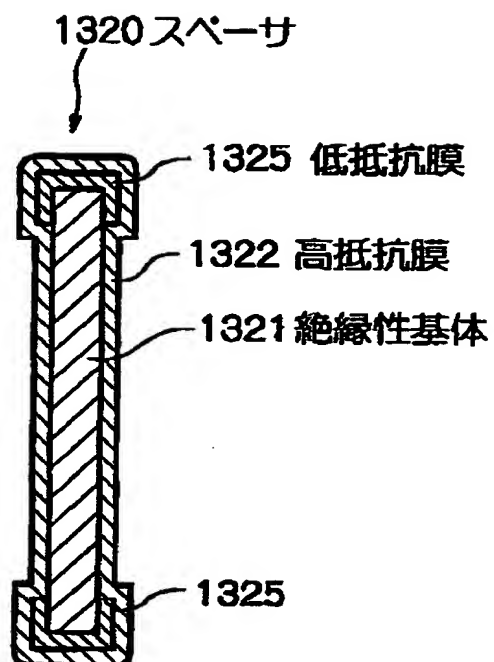
【図 59】



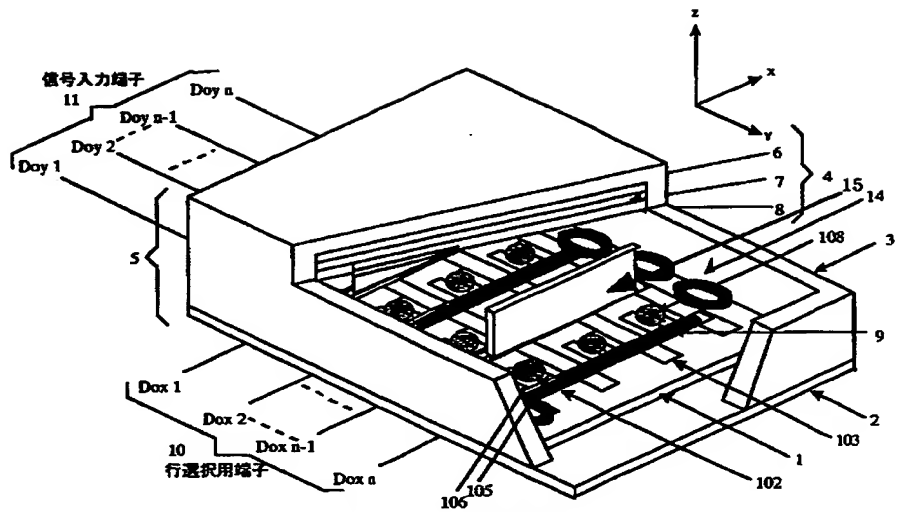
【図 60】



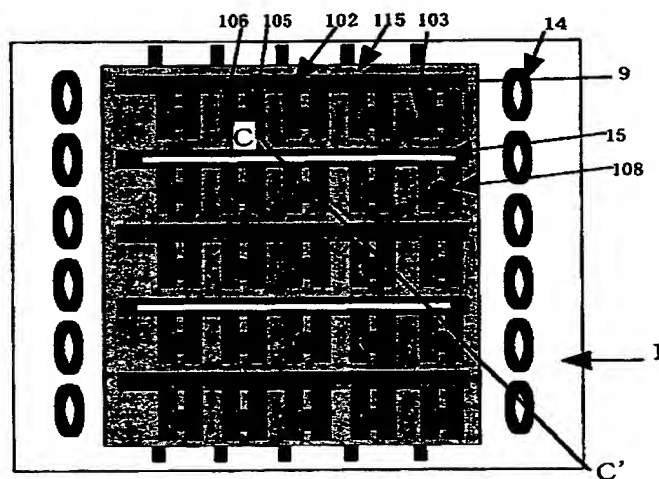
【図 6 1】



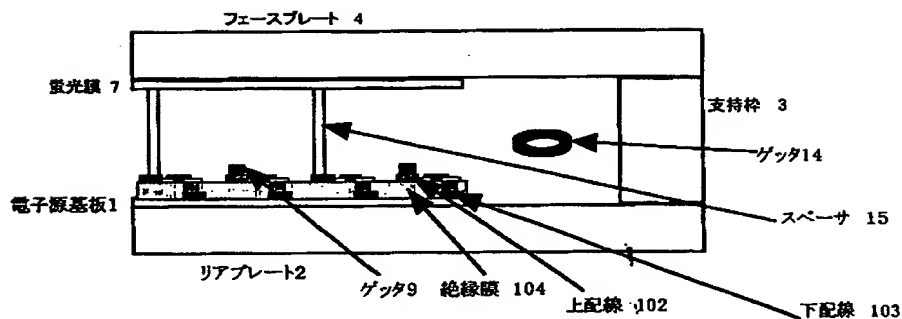
【図 6 2】



(a) 画像形成装置の斜図

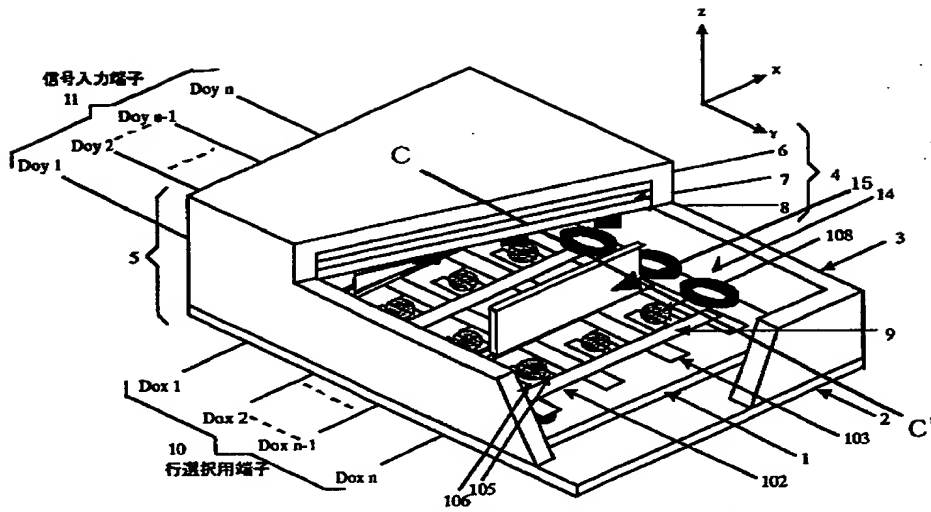


(b) ゲッタとスペーサの配置(平面図)

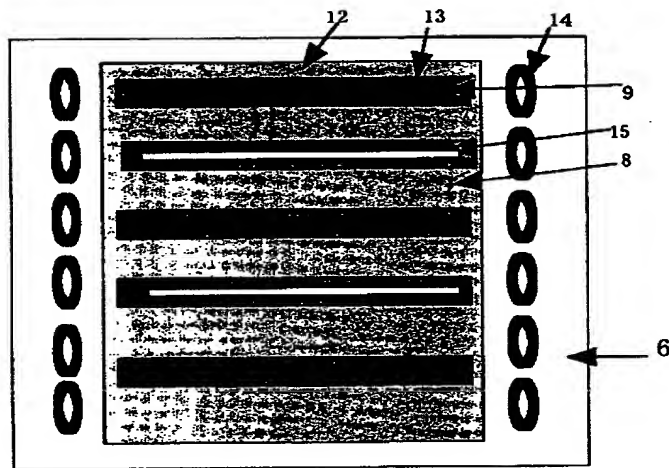


(c) C-C'断面図

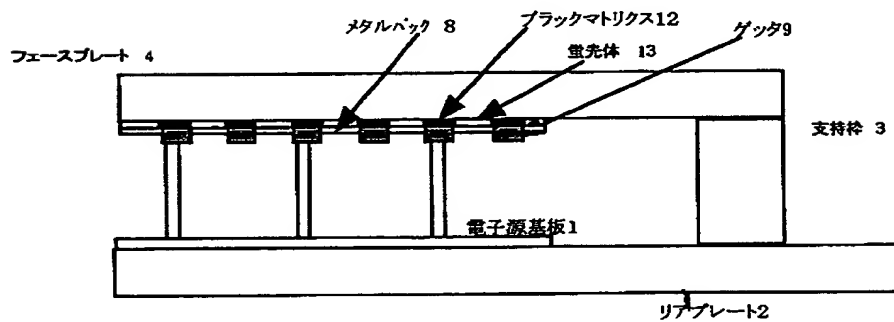
【図 6 3】



(a) 画像形成装置の斜図

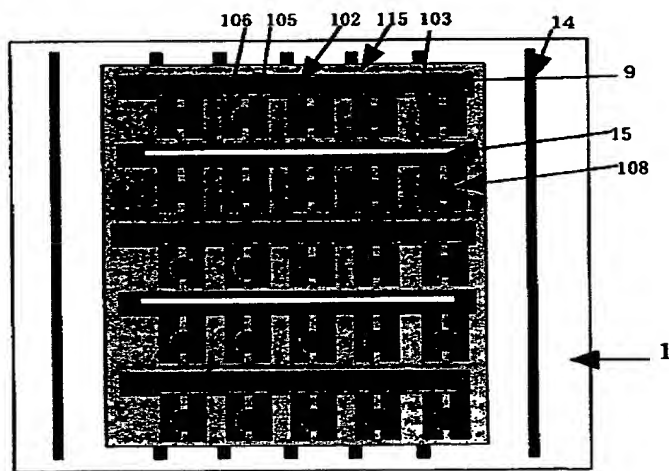
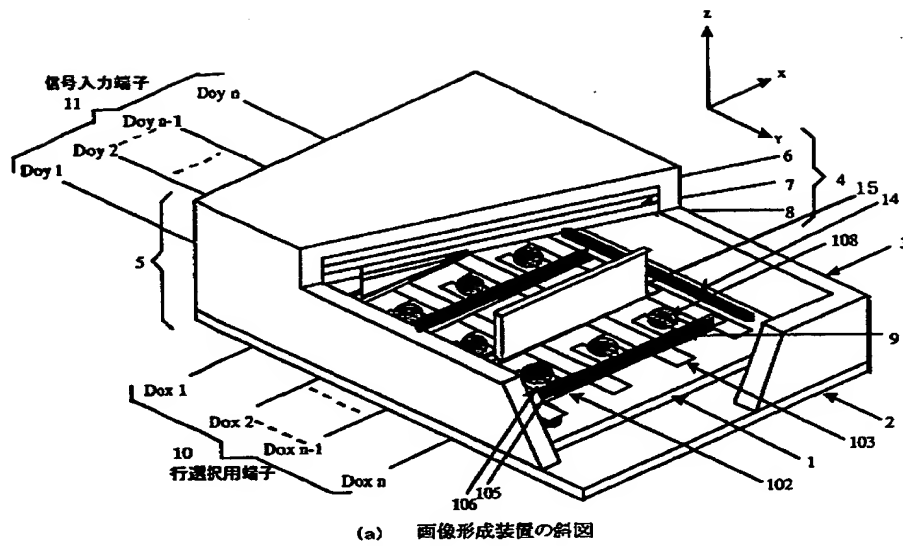


(b) ゲットとスペーサの配置(平面図)

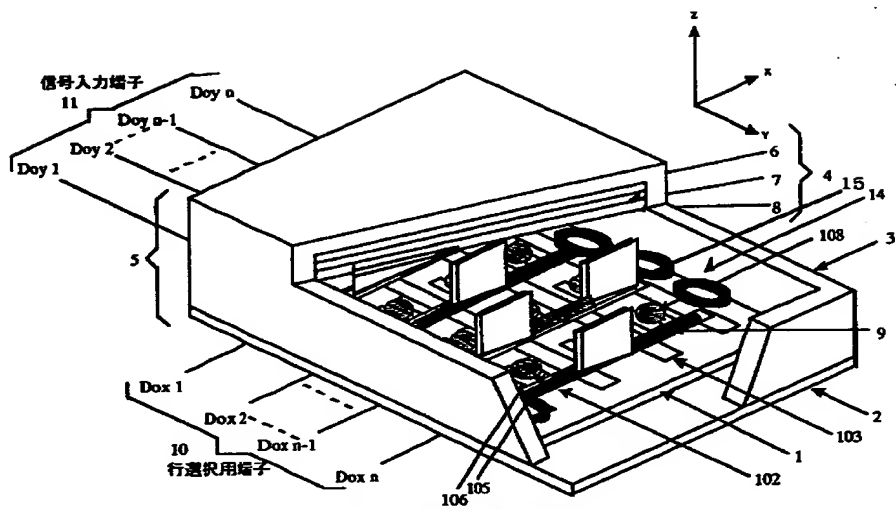


(c) C-C' 断面図

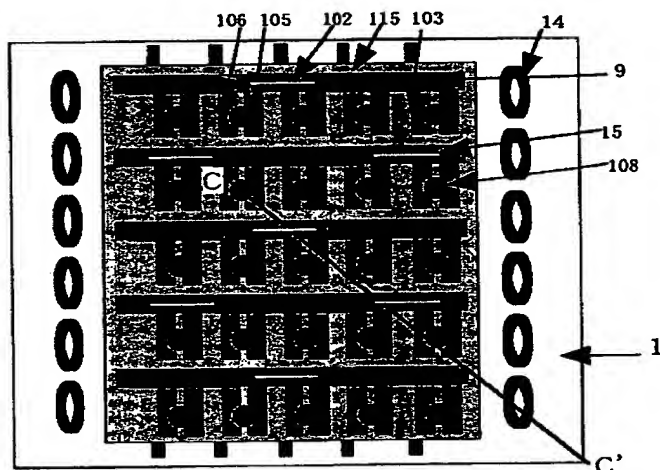
【図 6 4】



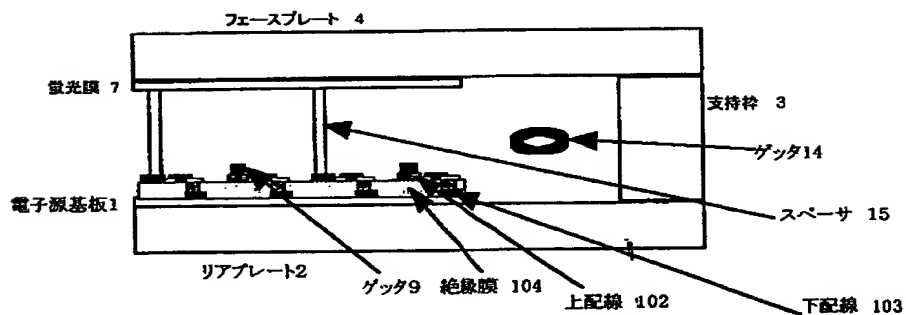
【図 65】



(a) 画像形成装置の斜図

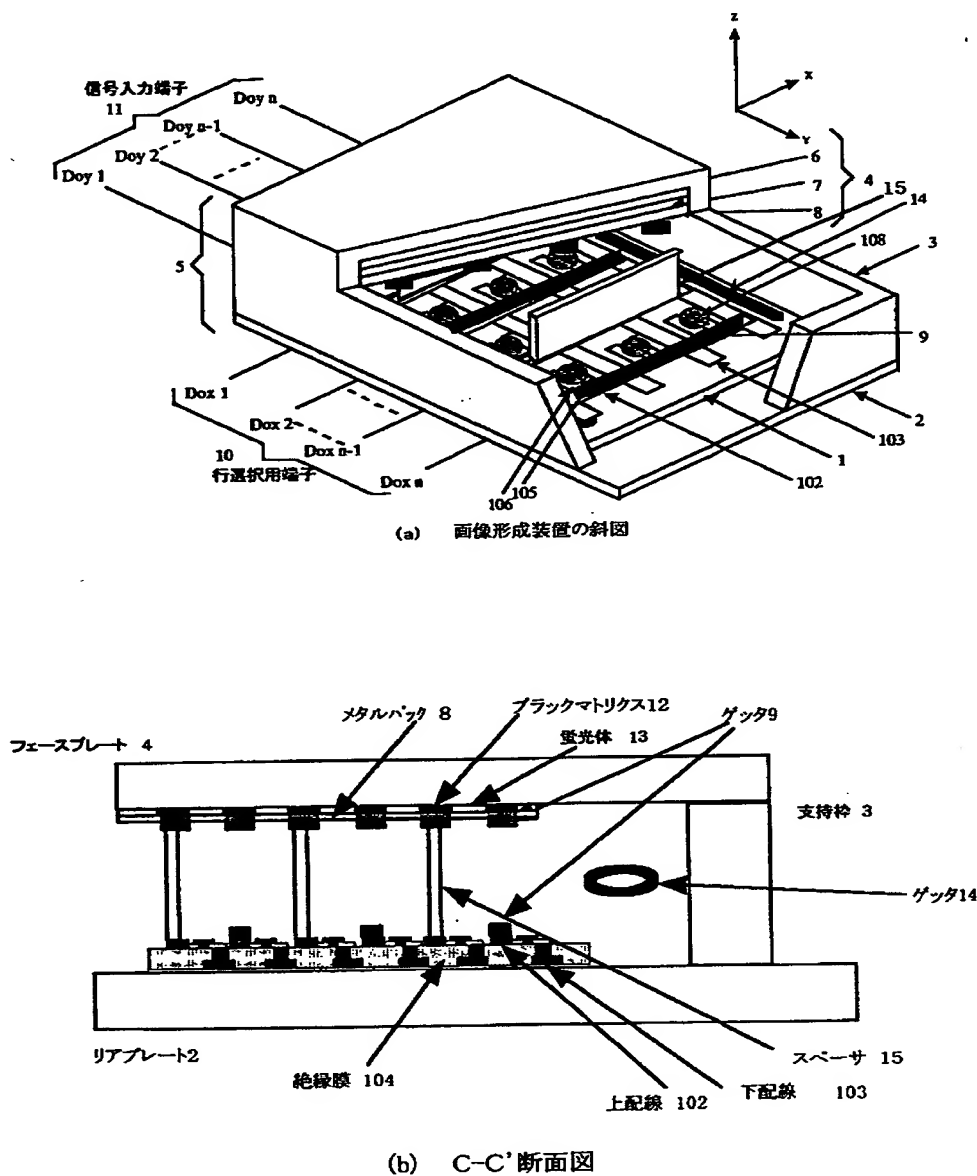


(b) ゲッタとスペーサの配置(平面図)

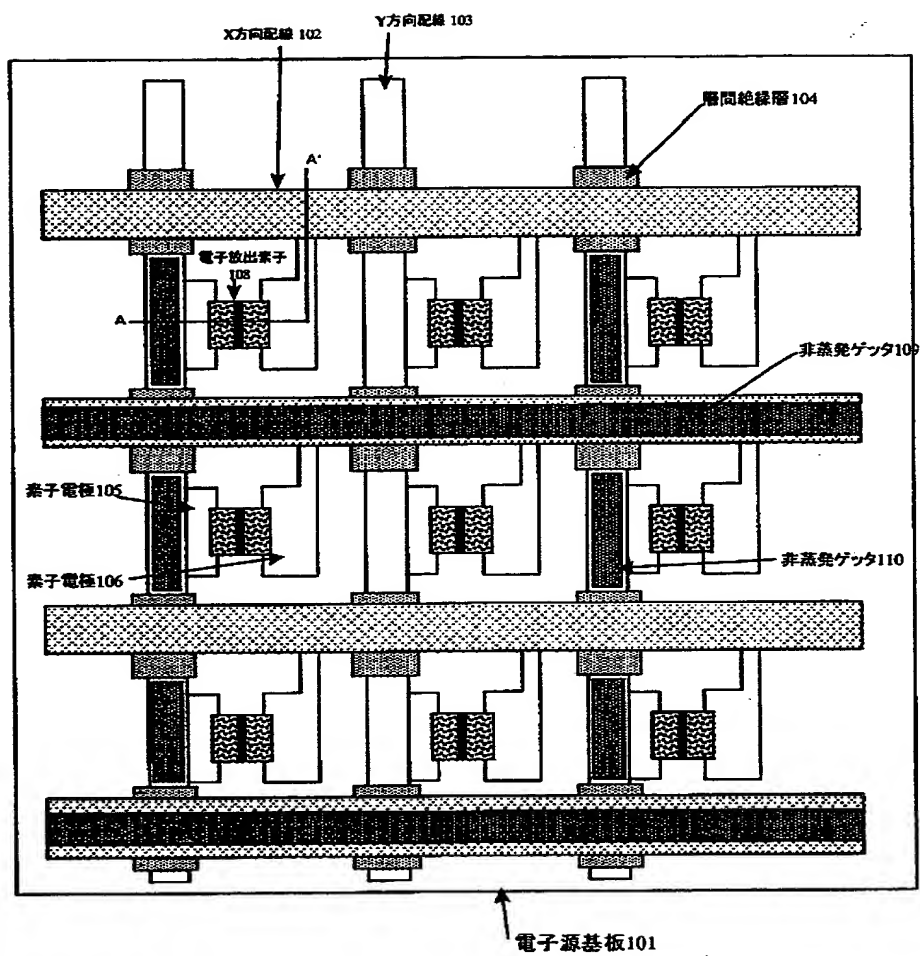


(c) C-C'断面図

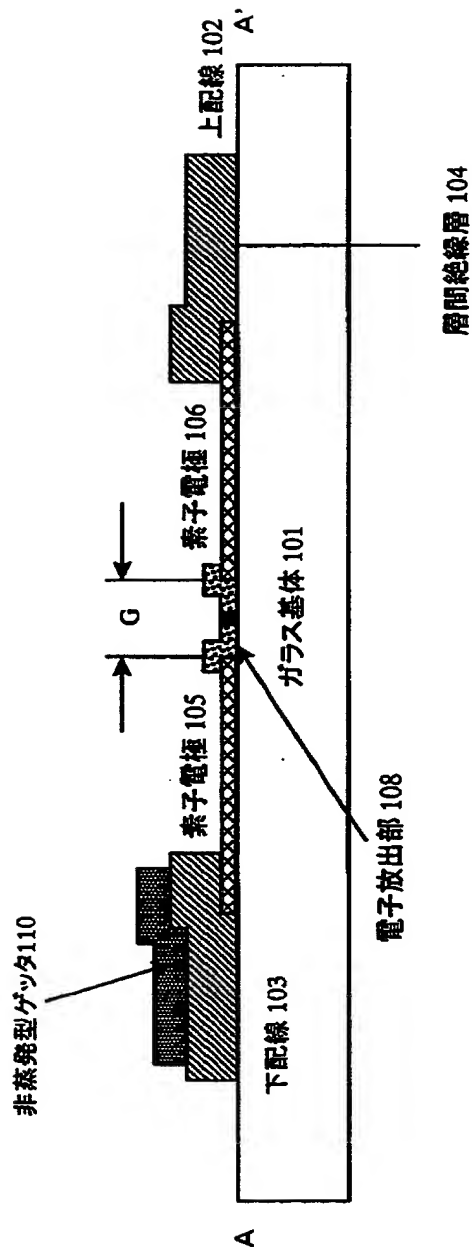
【図 66】



【图 6 7】

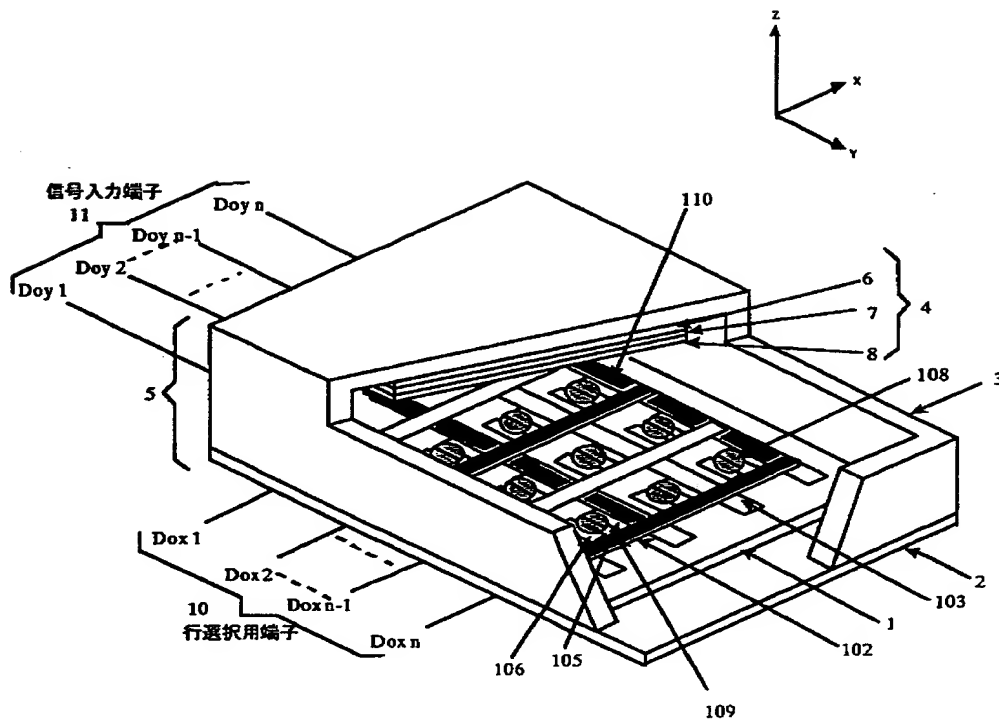


【図 68】

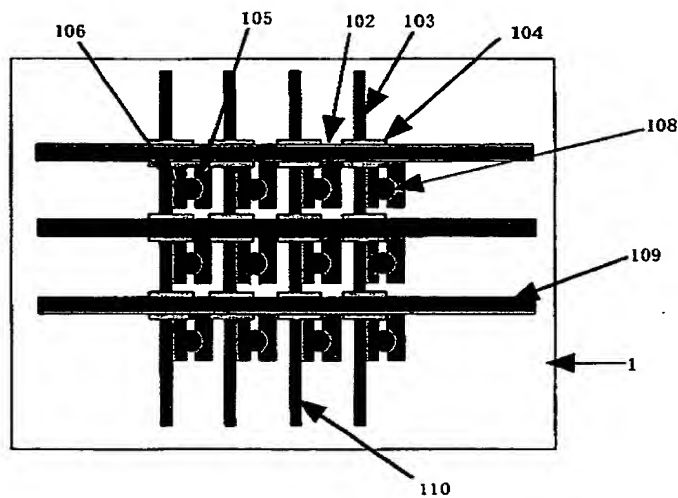


A-A'断面図

【図 69】

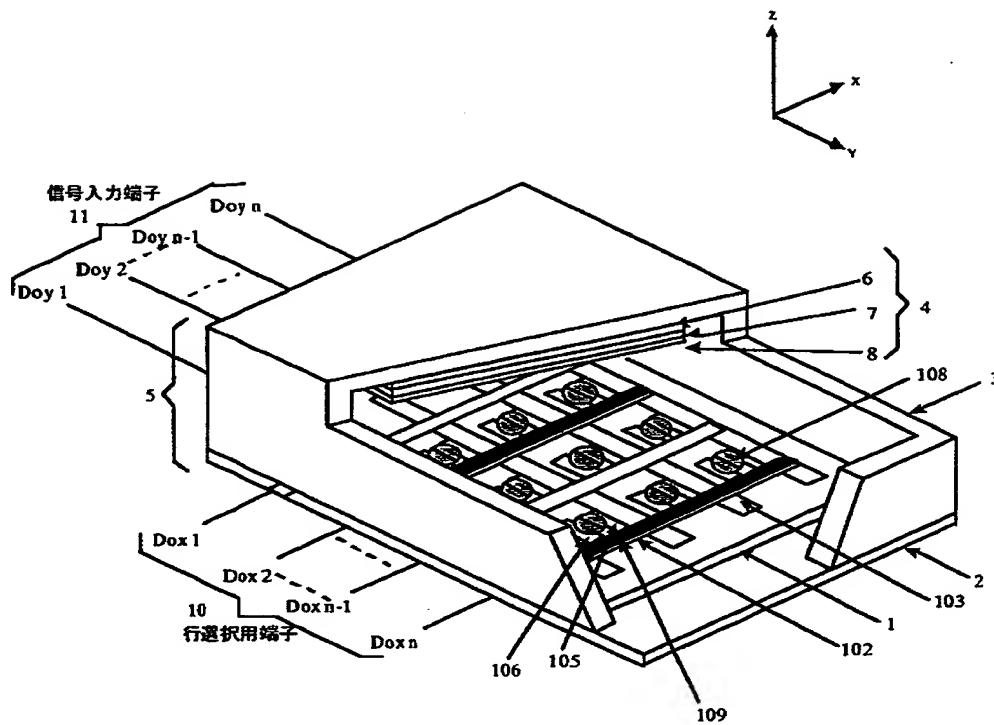


(a) 画像形成装置の斜図

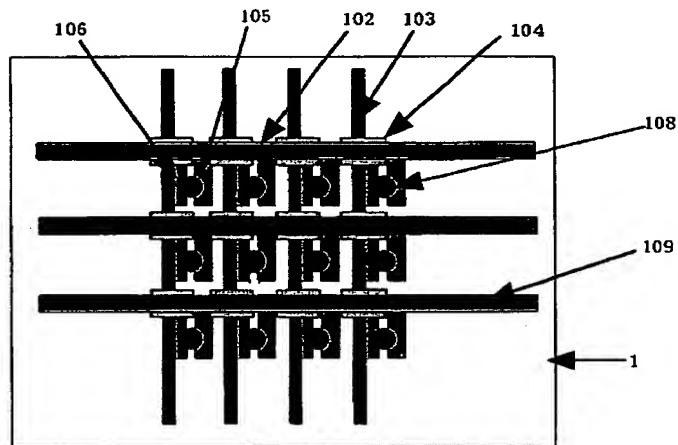


(b) 画像形成装置の上方図

【図 7 0】

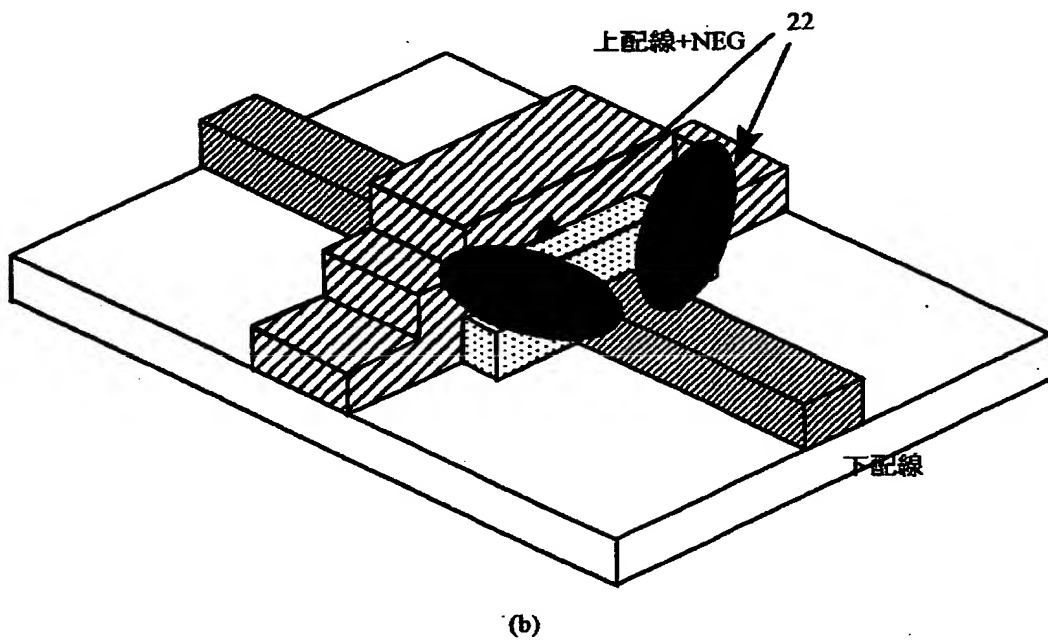
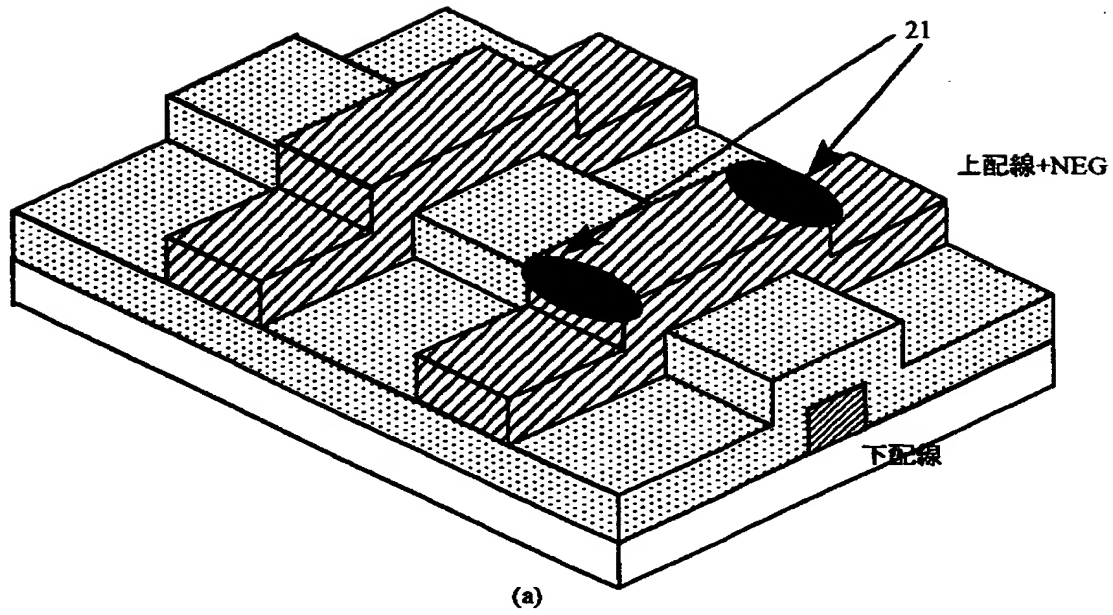


(a) 画像形成装置の斜図

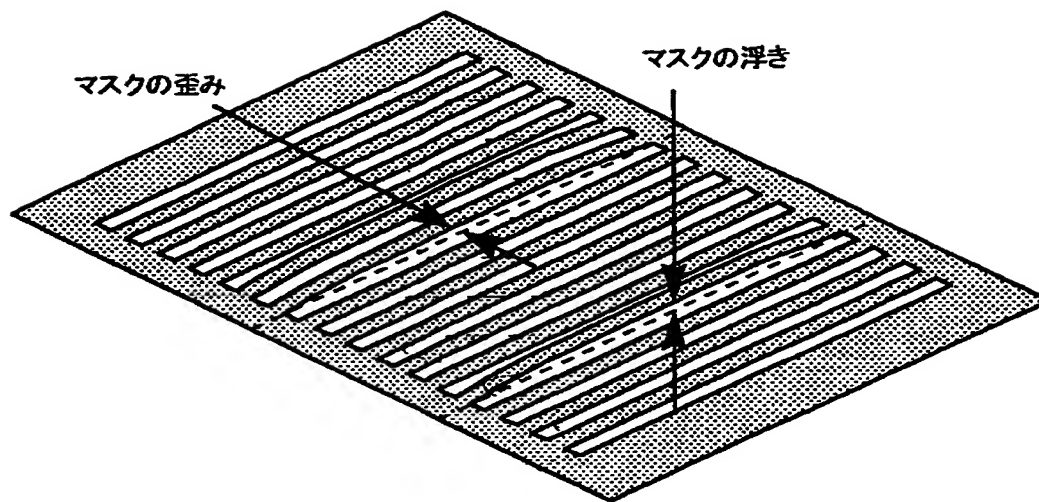


(b) 画像形成装置の上方図

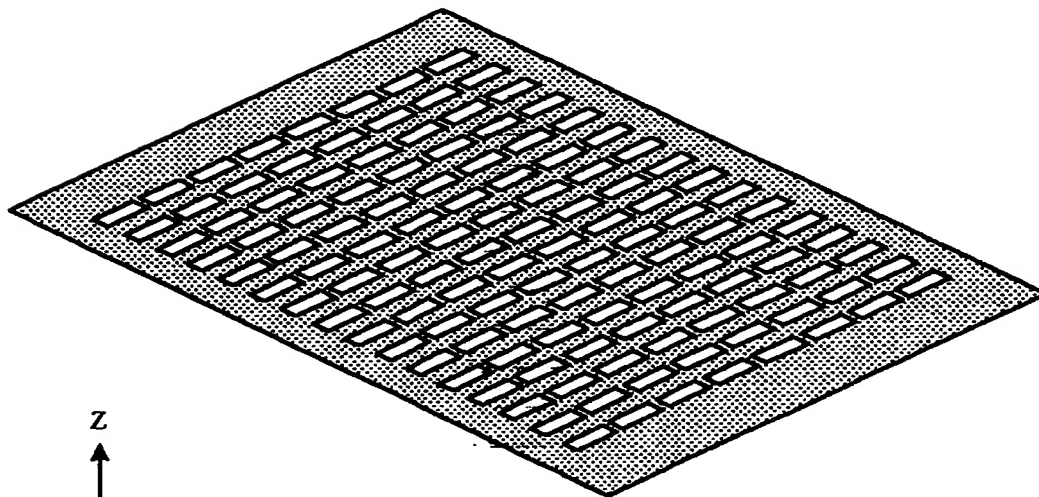
【図 7 1】



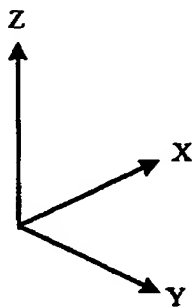
【図 7 2】



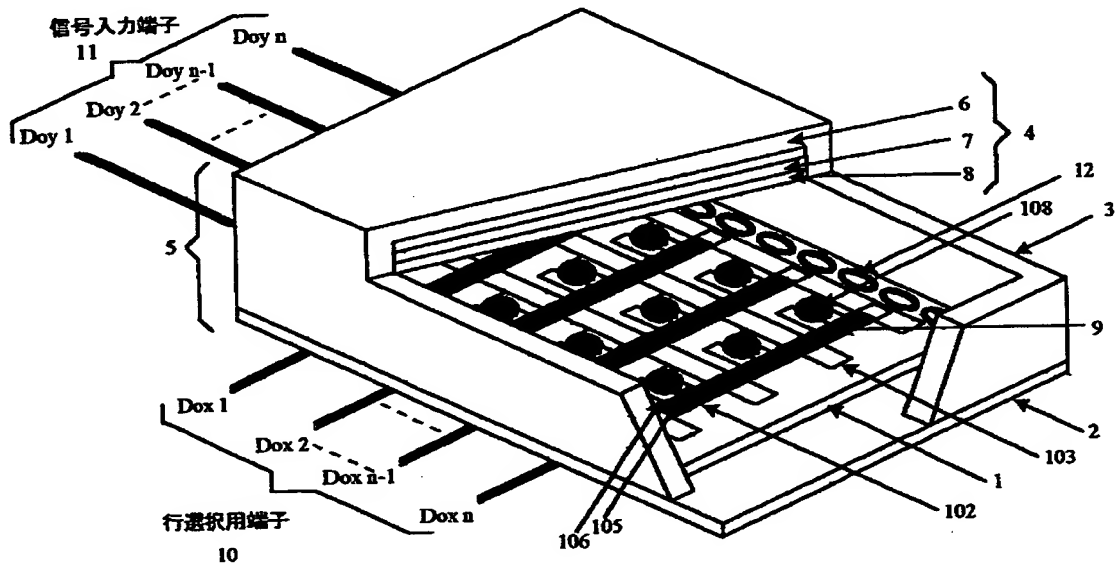
(a)



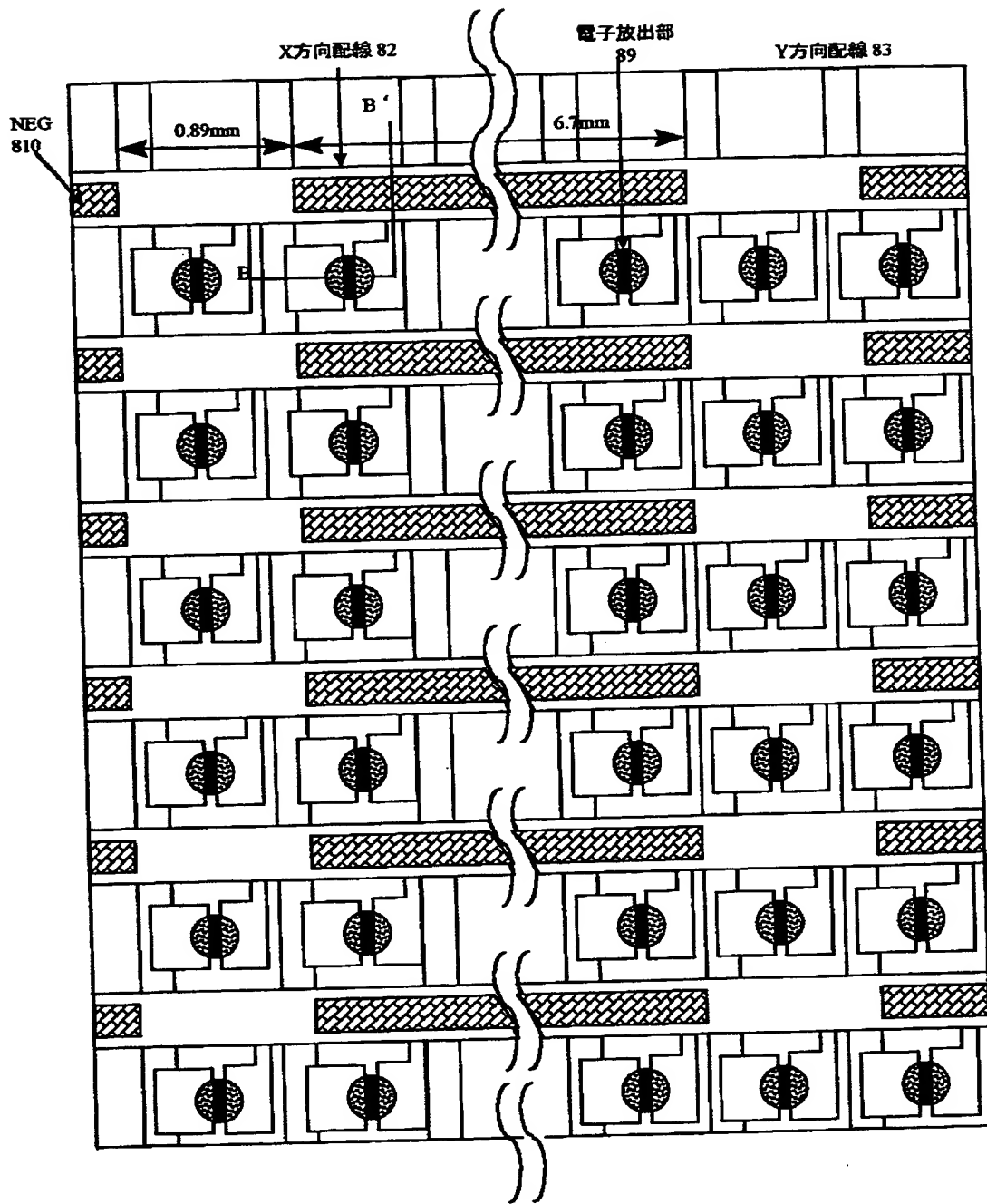
(b)



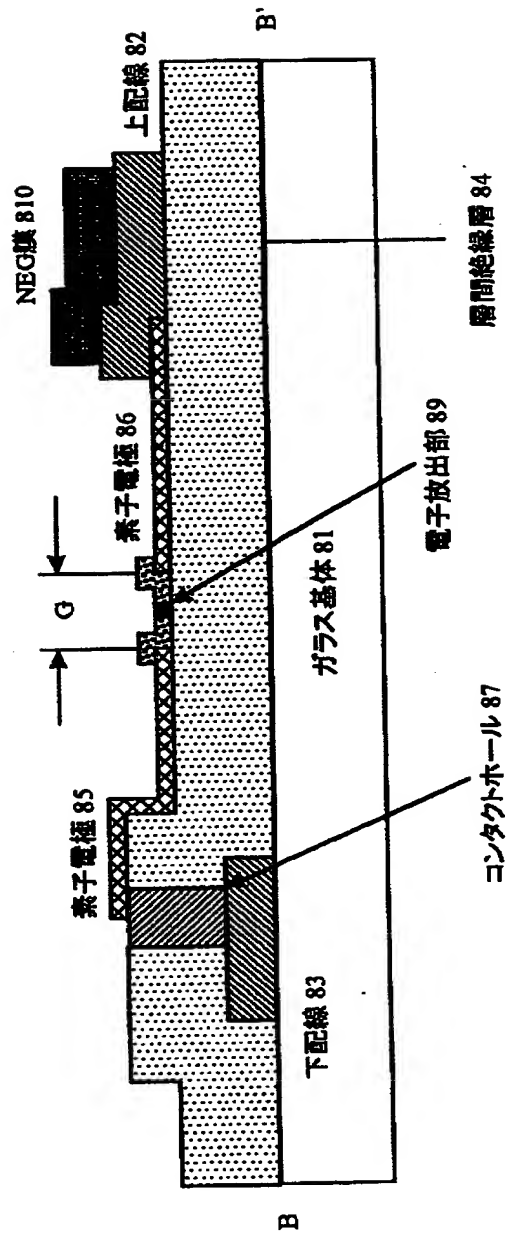
【図 7 3】



【図 7 4】



【図 75】



【図 7 6】

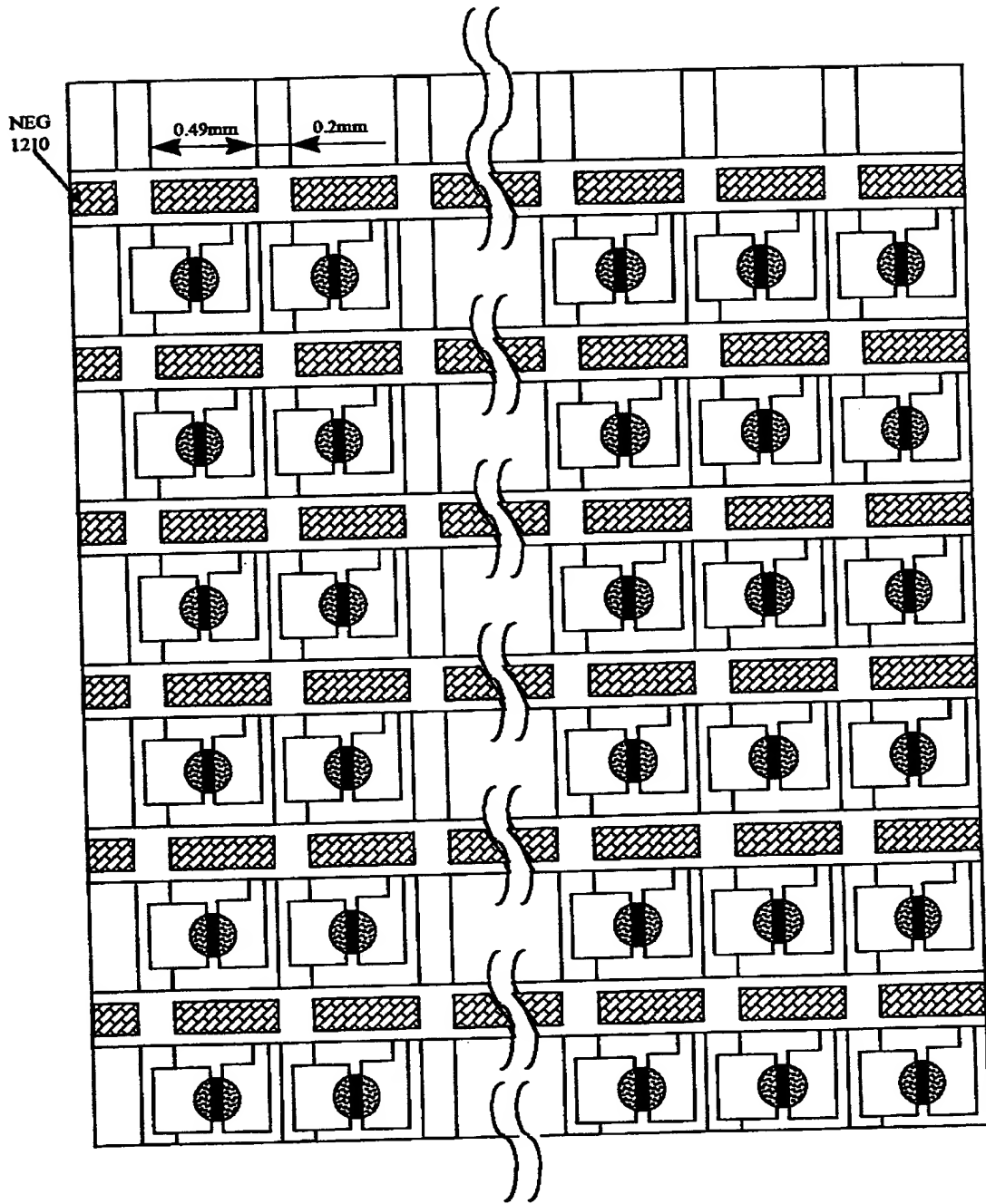
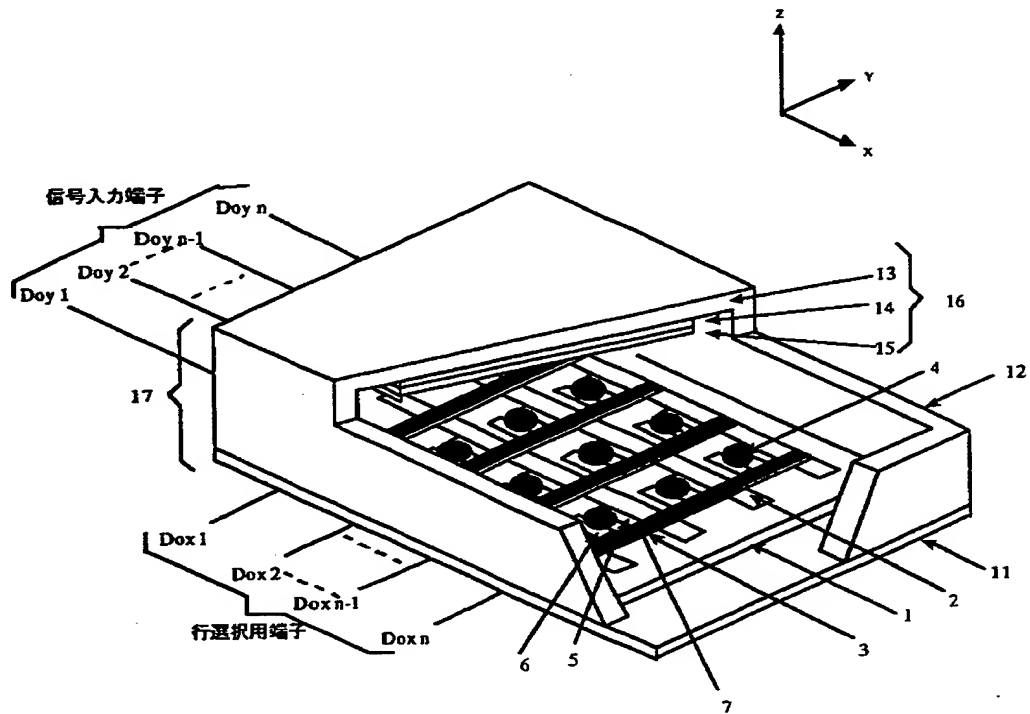
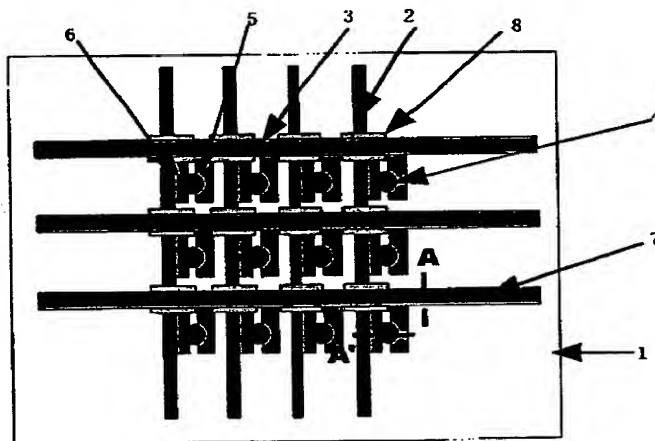


図12

【图 7-7】

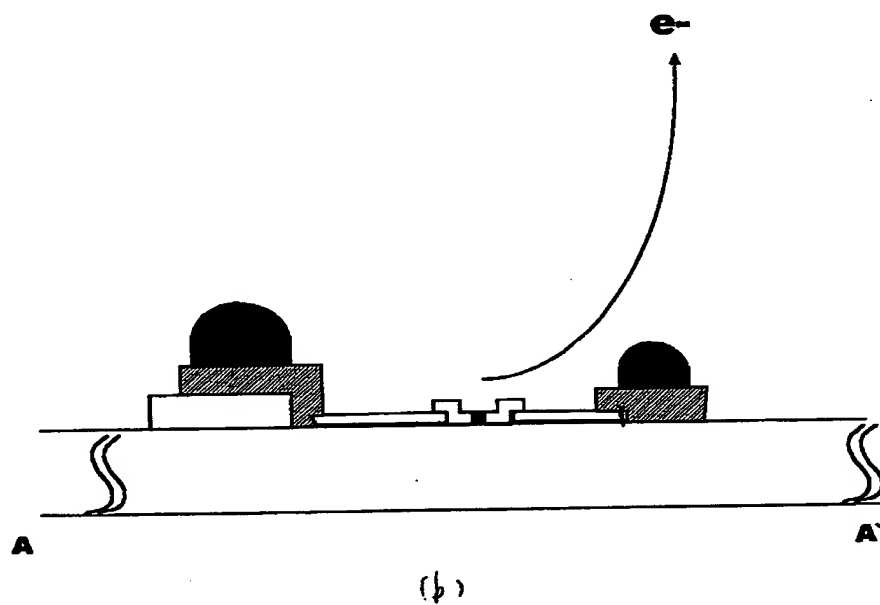
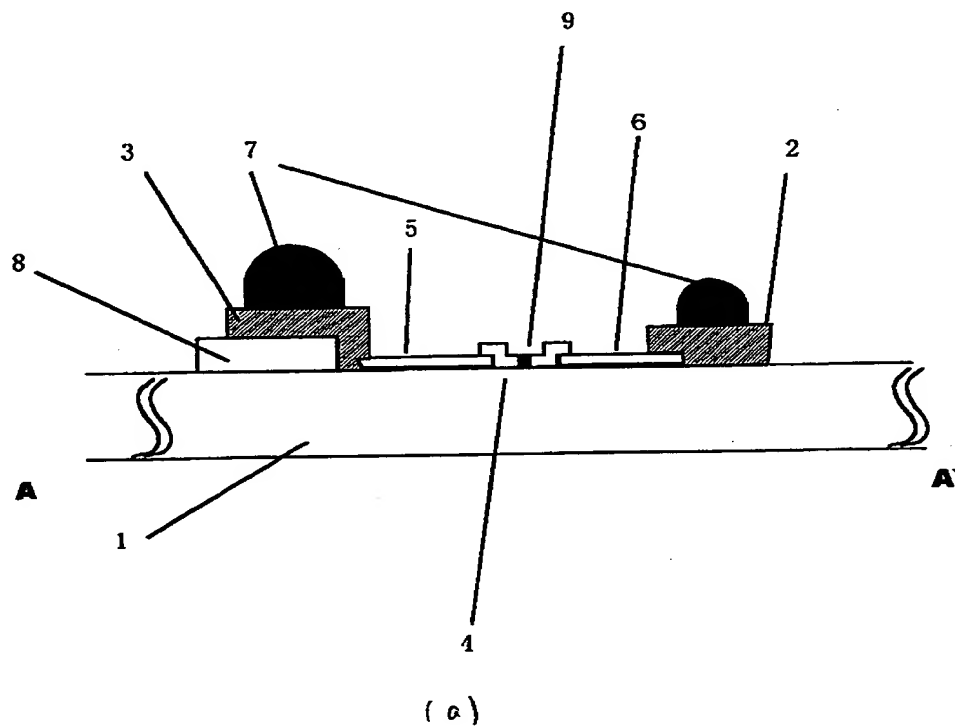


(a) 画像形成装置の斜図

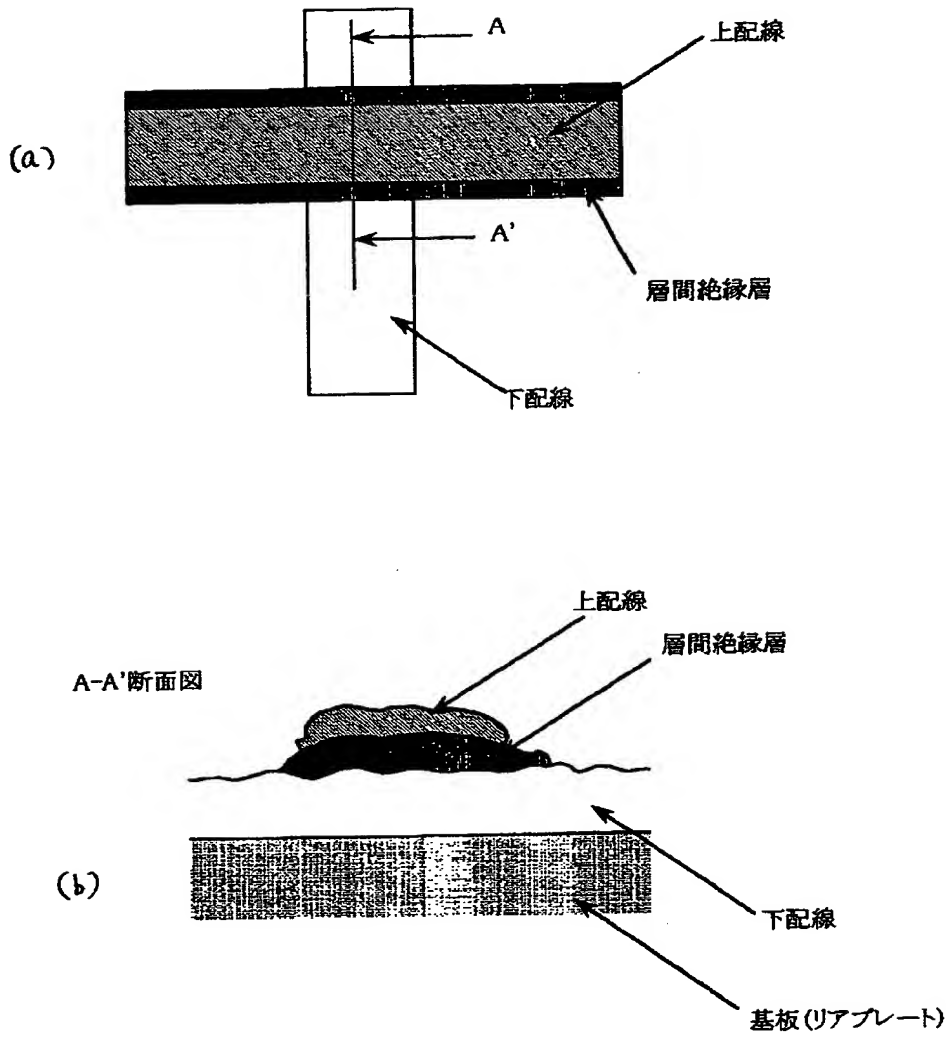


(b) 画像形成装置の上方図

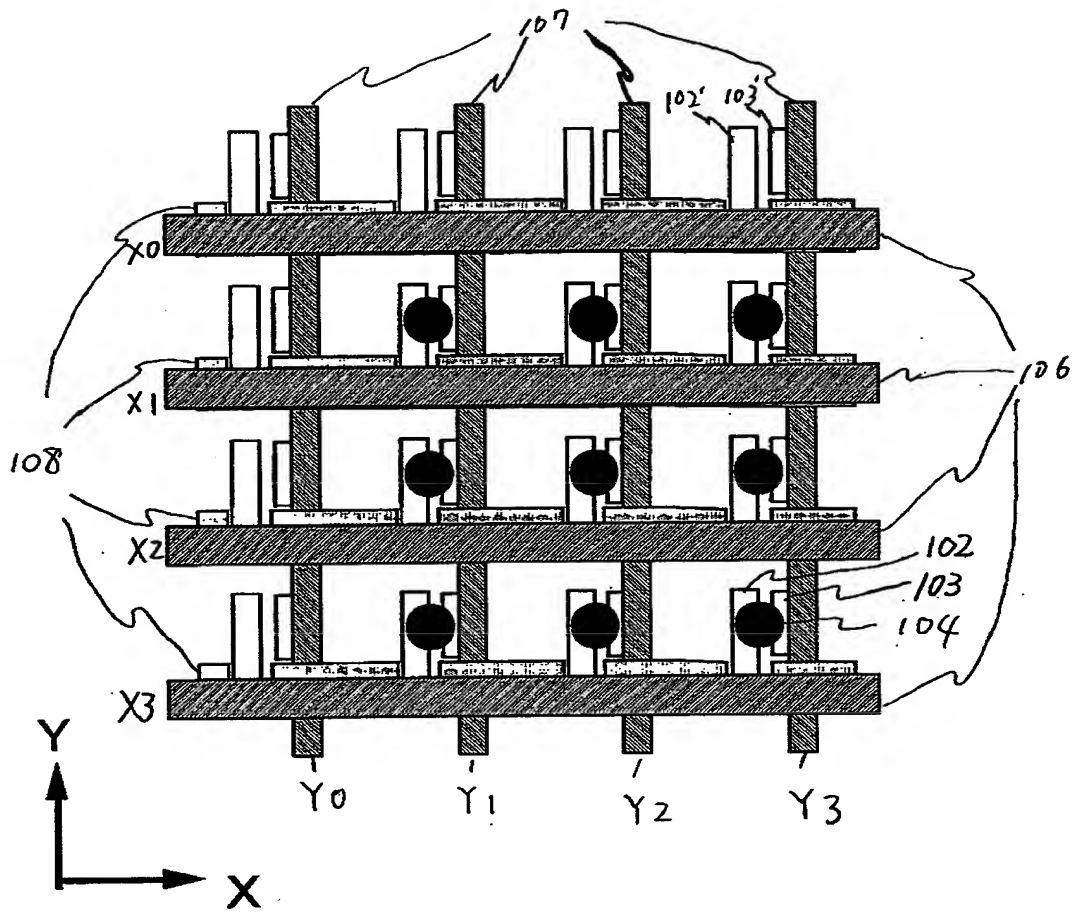
【図 78】



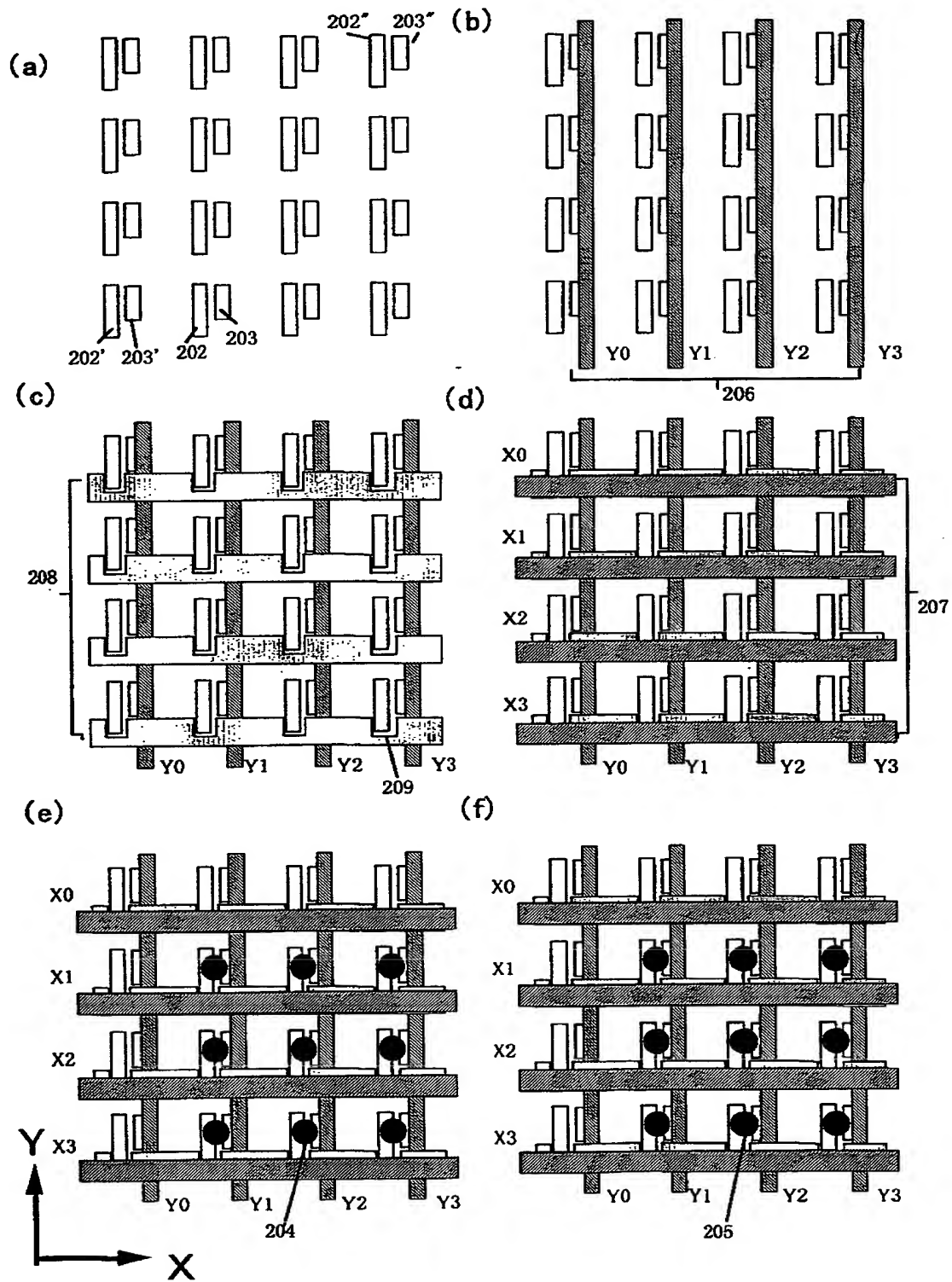
【図 79】



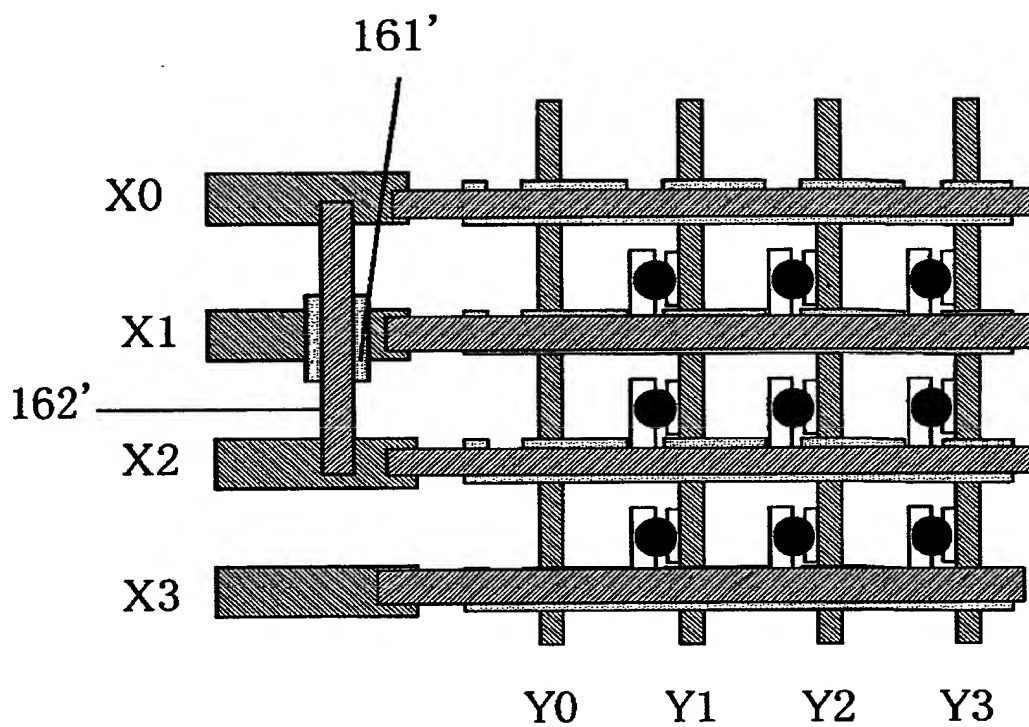
【図 80】



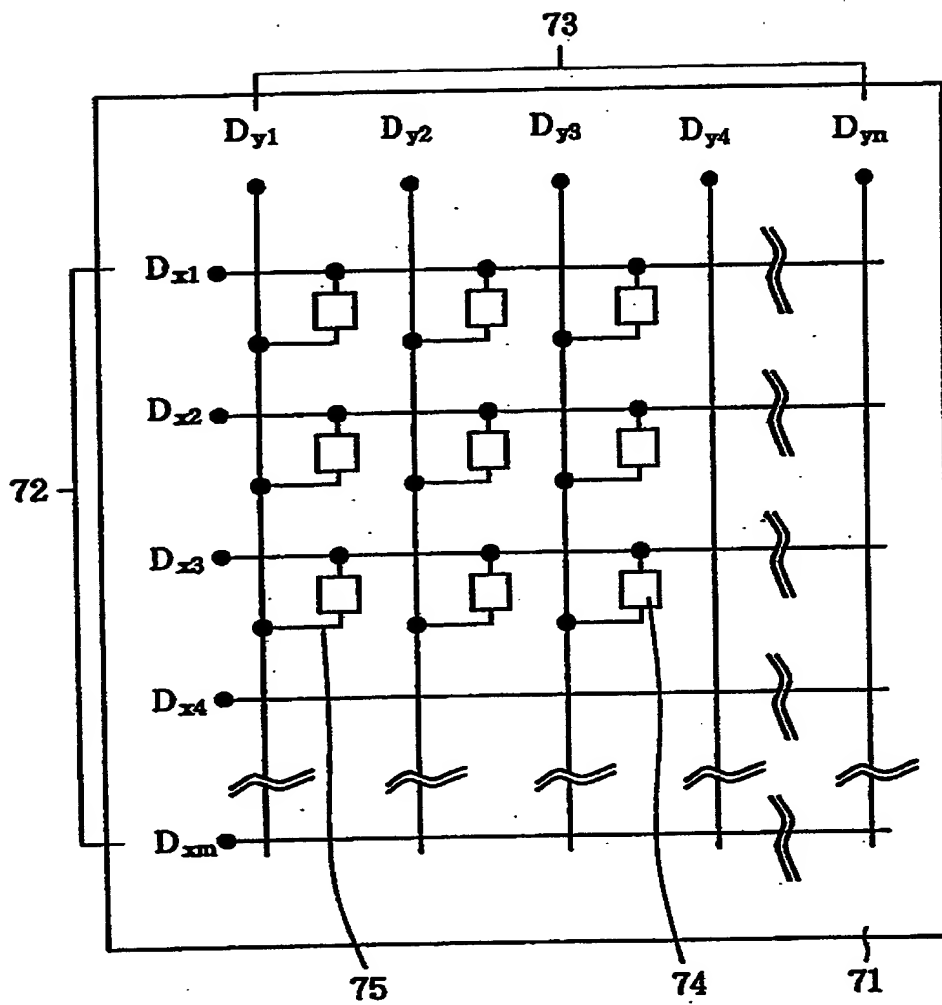
【図 8 1】



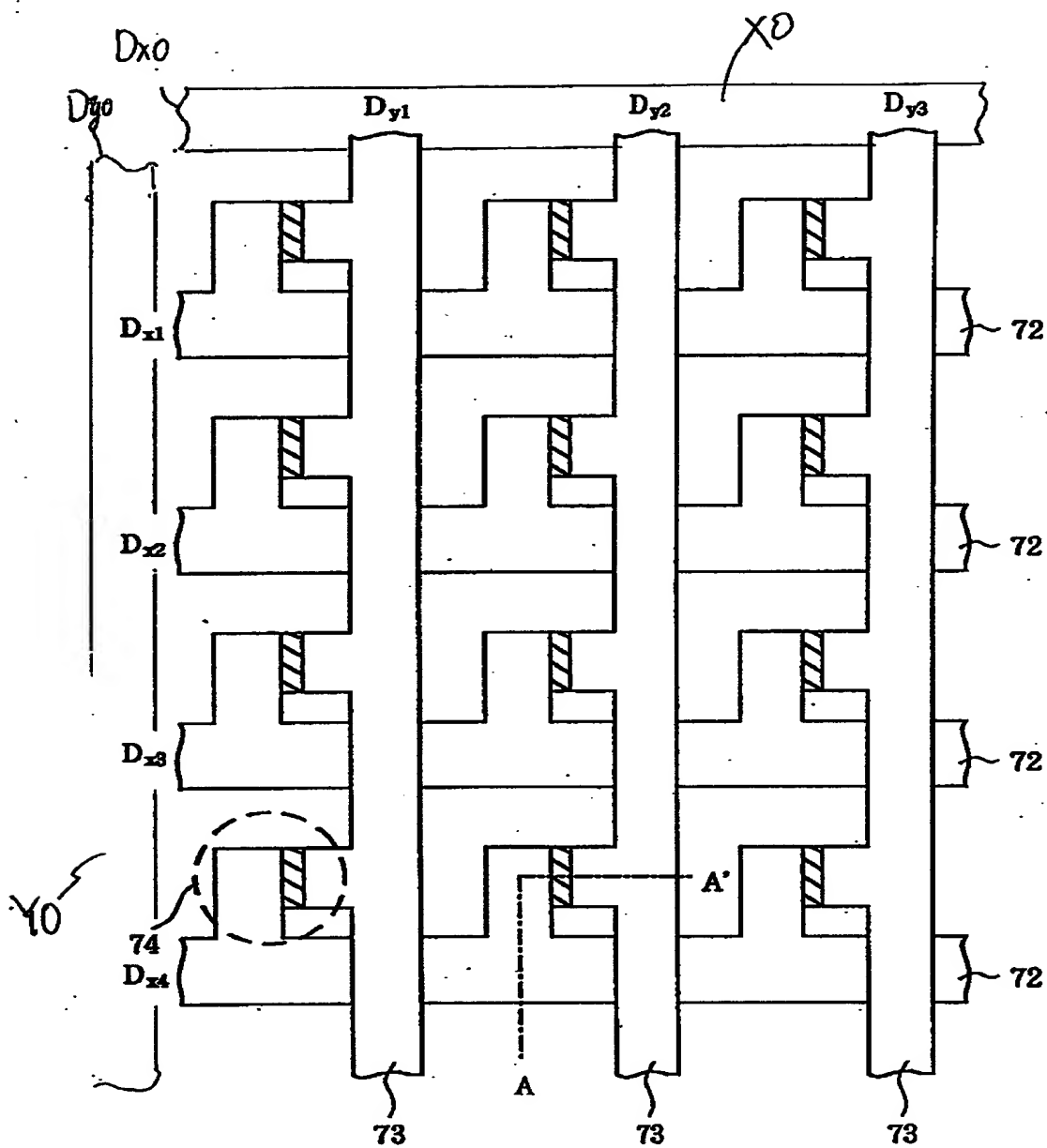
【図 8 2】



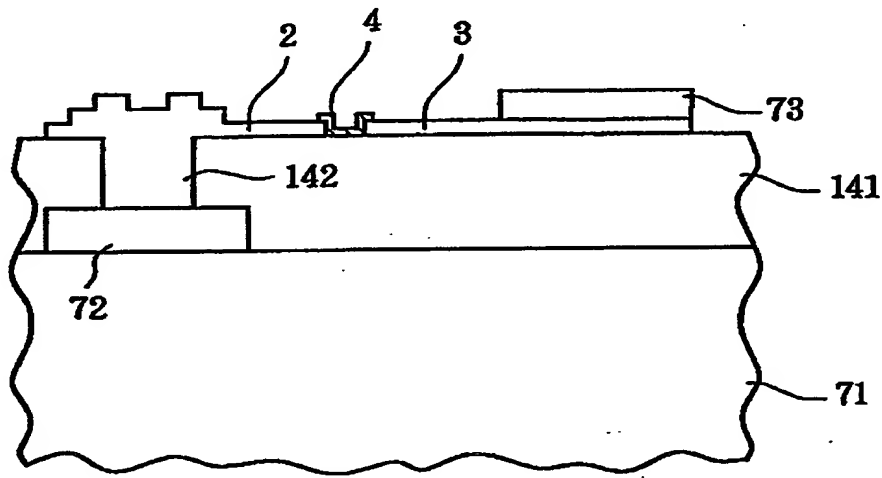
【図 83】



【図 84】

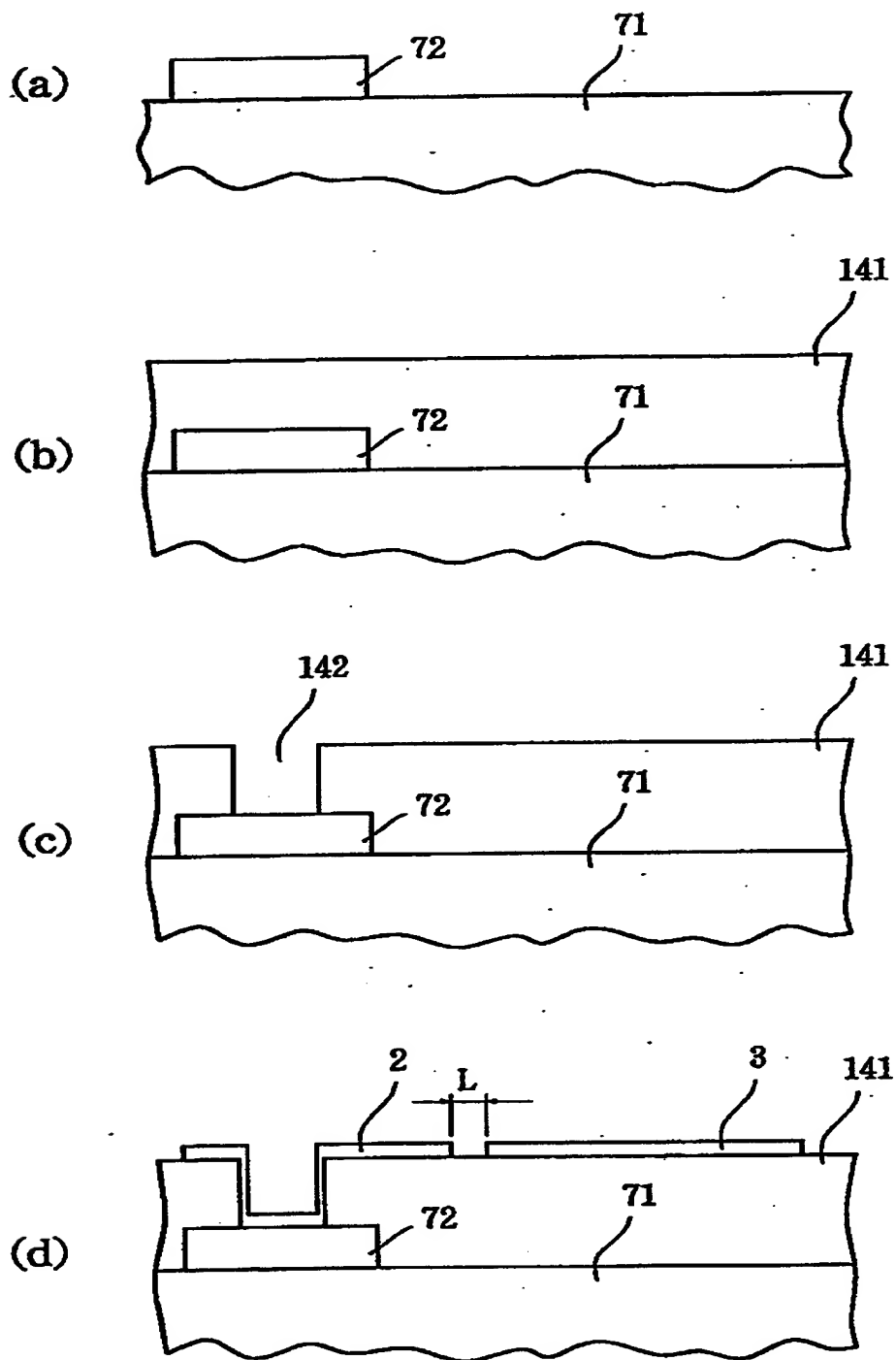


【図 85】

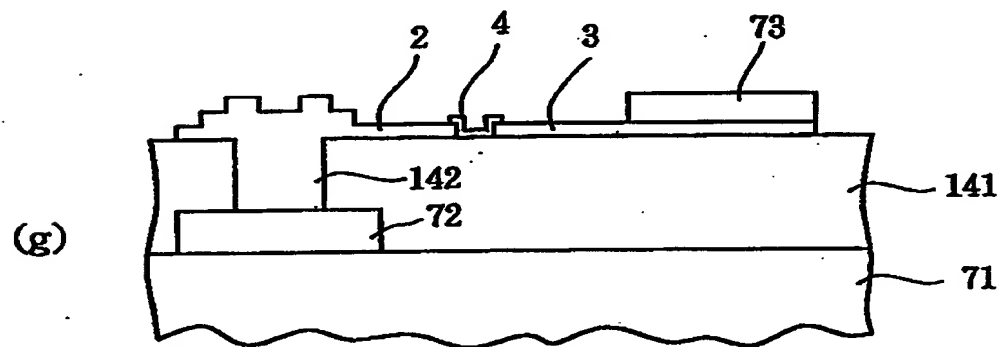
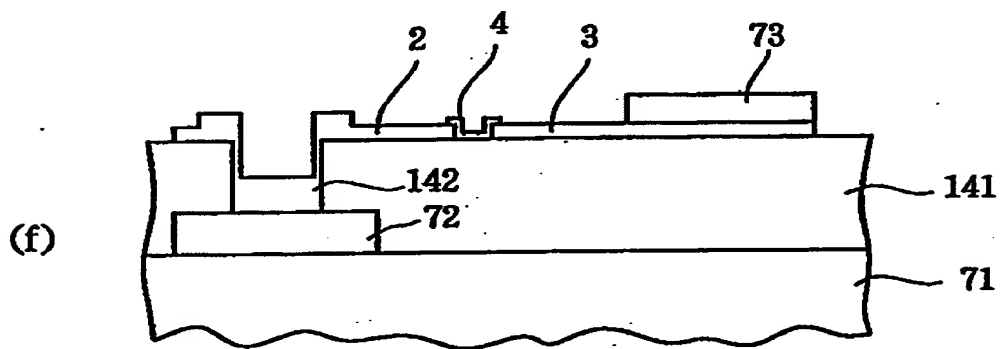
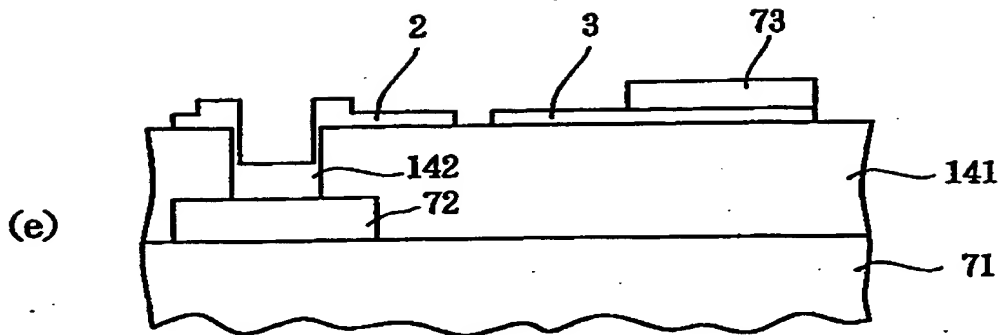


A-A' 断面図

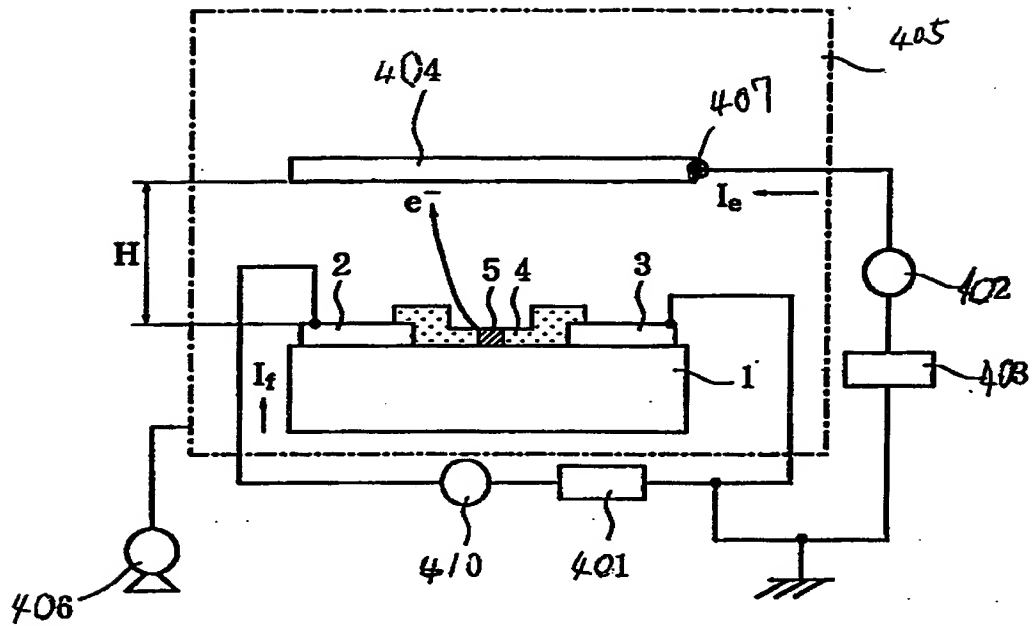
【図 86】



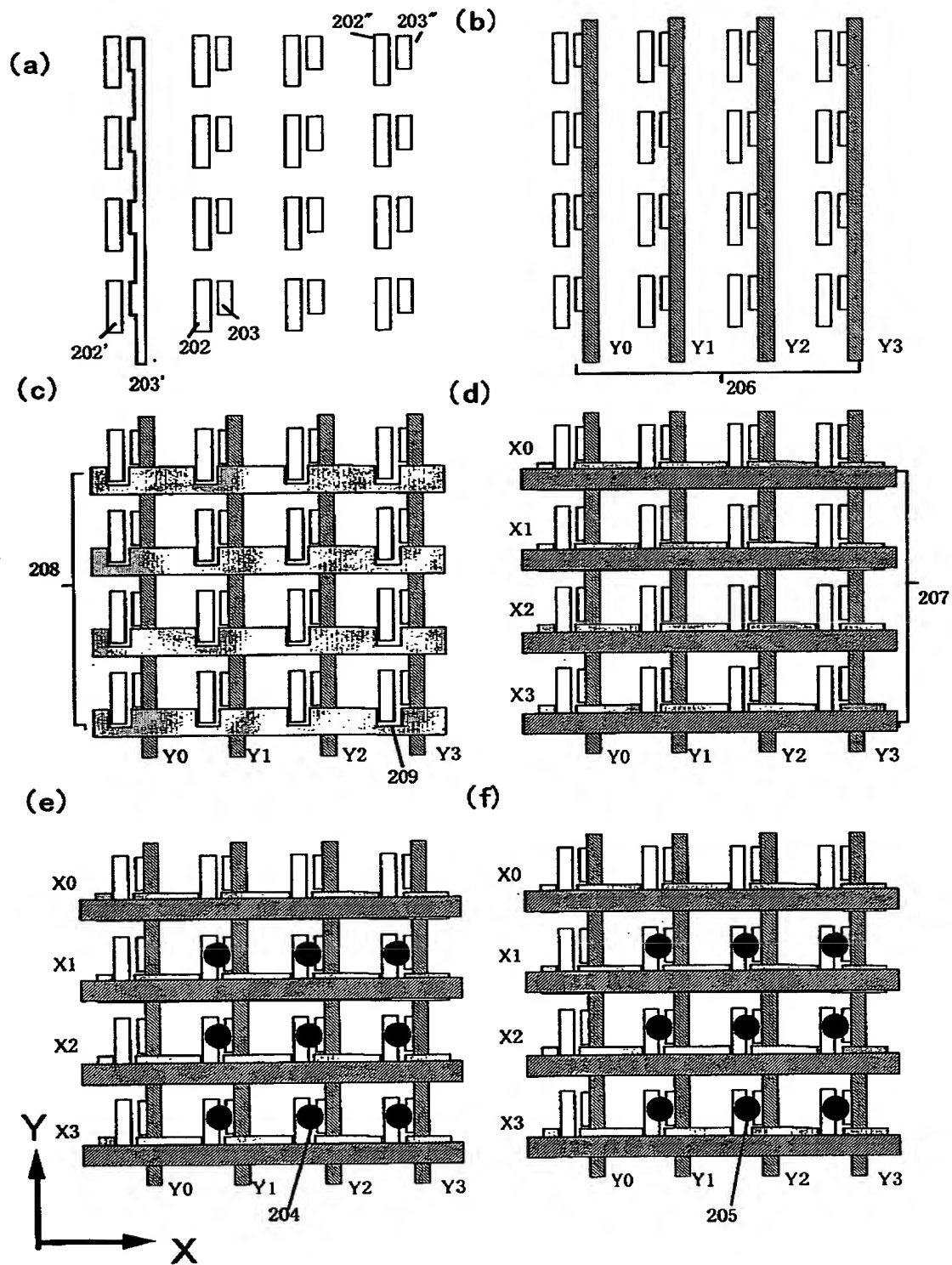
【図 87】



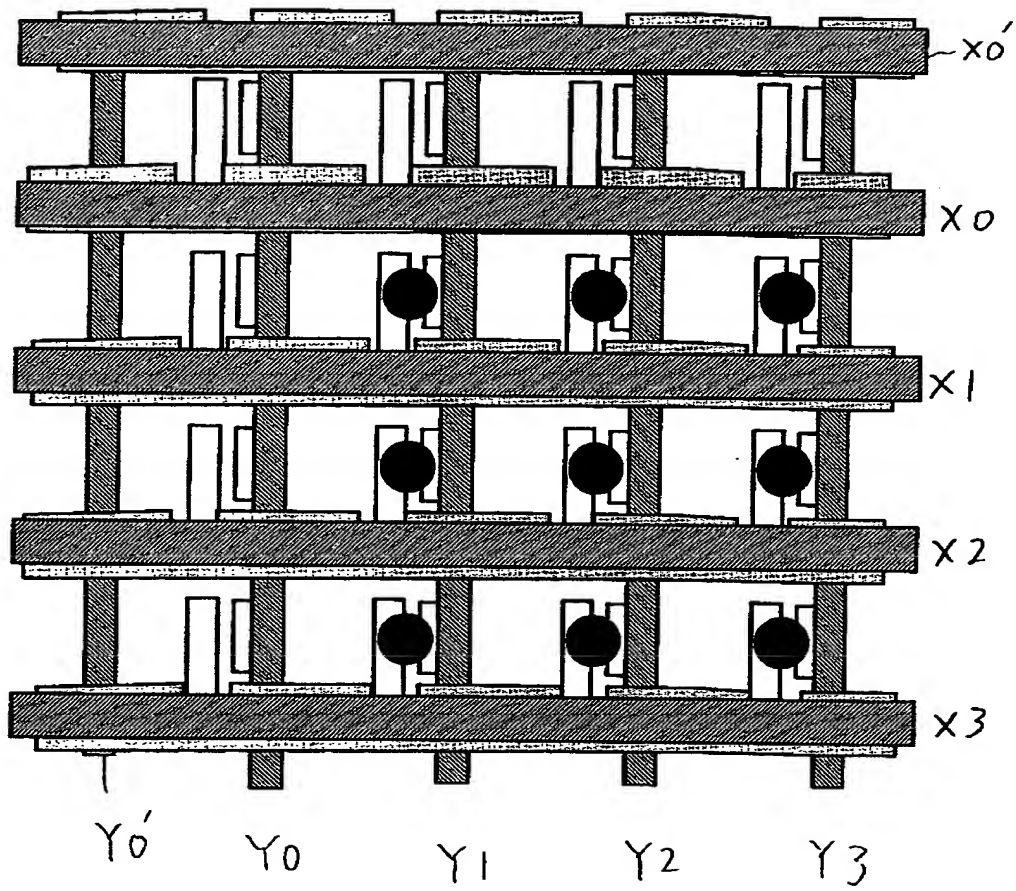
【図 88】



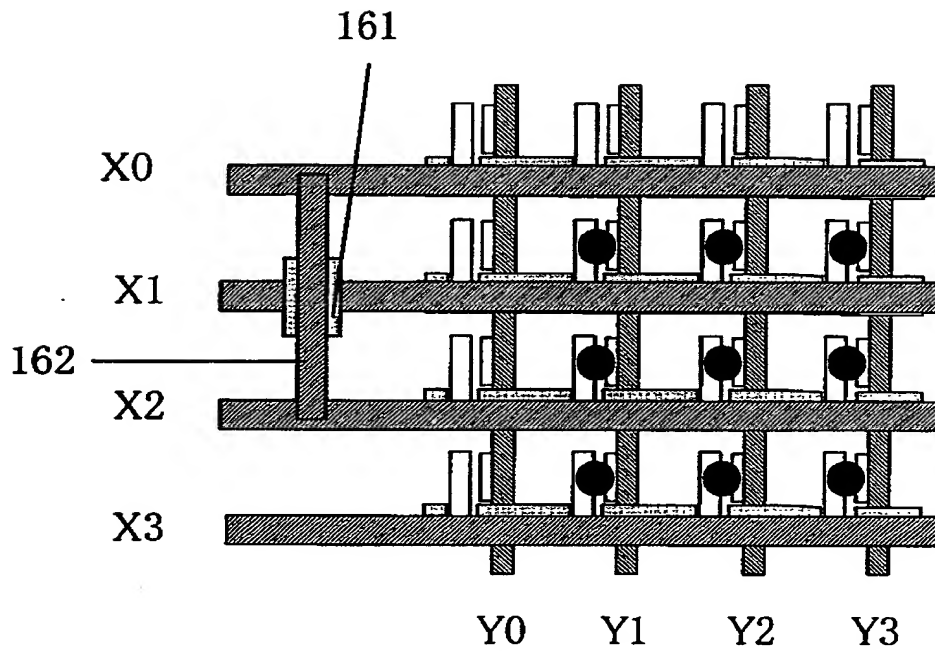
【図 89】



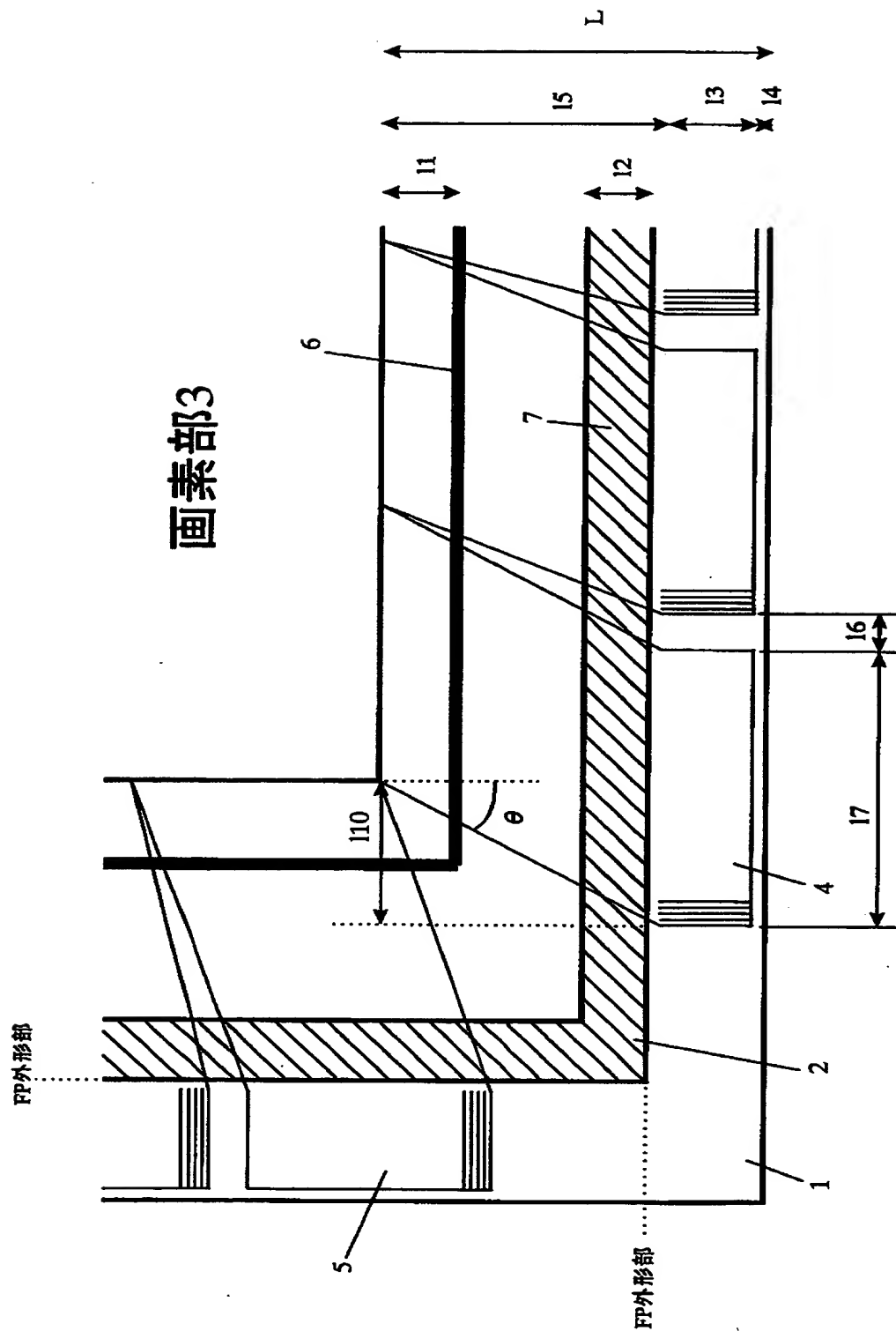
【図 9 0】



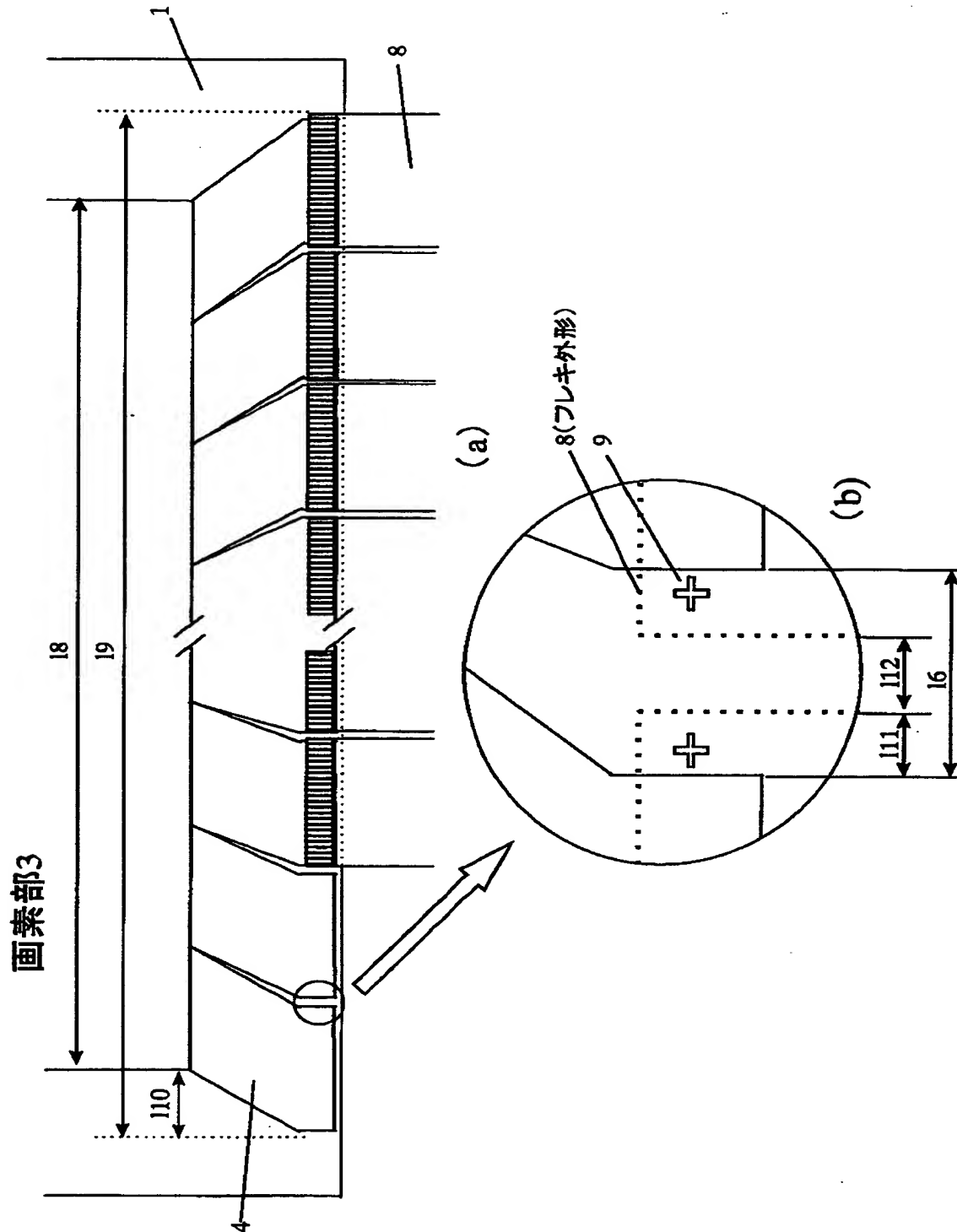
【図 9 1】



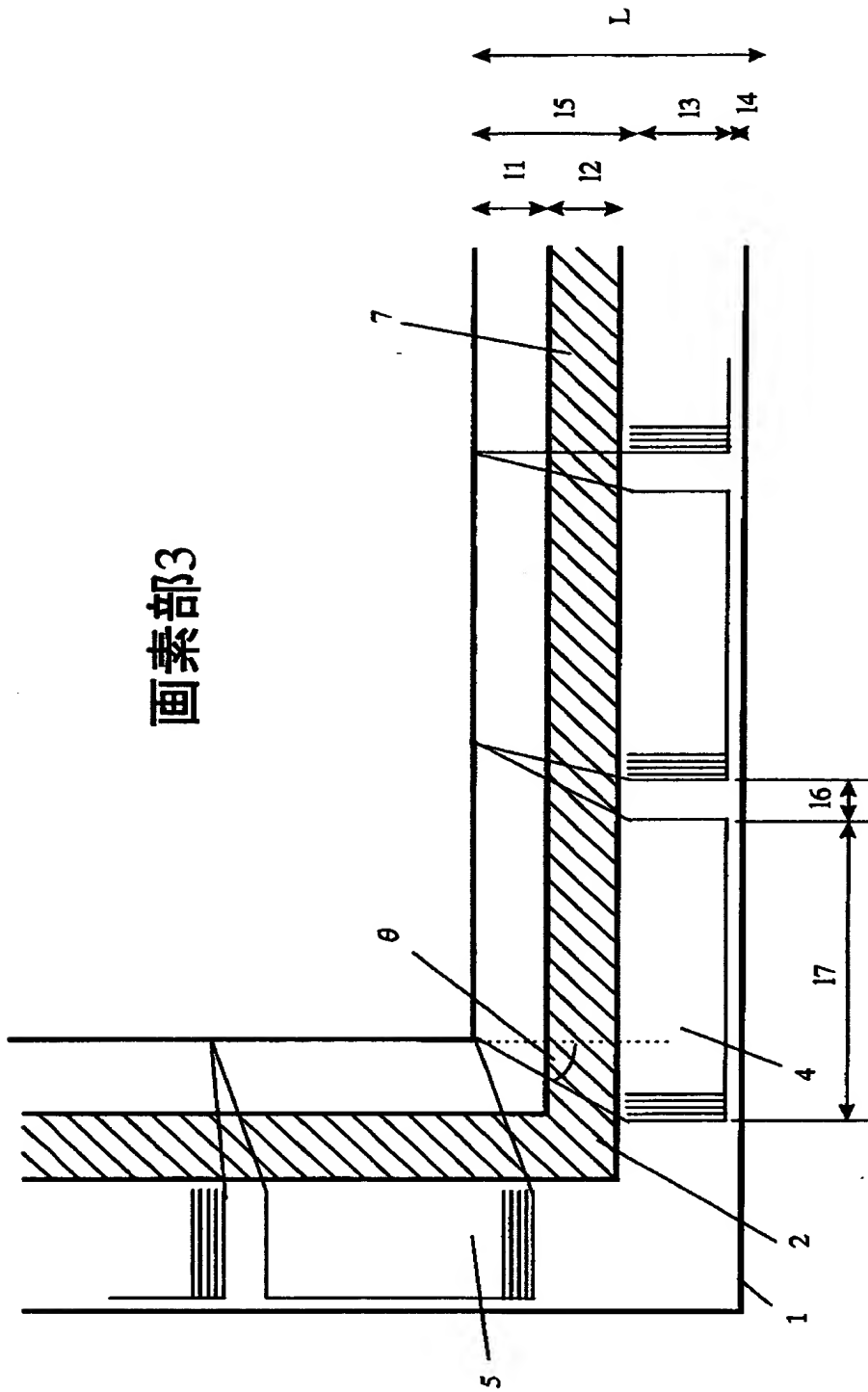
【図 9 2】



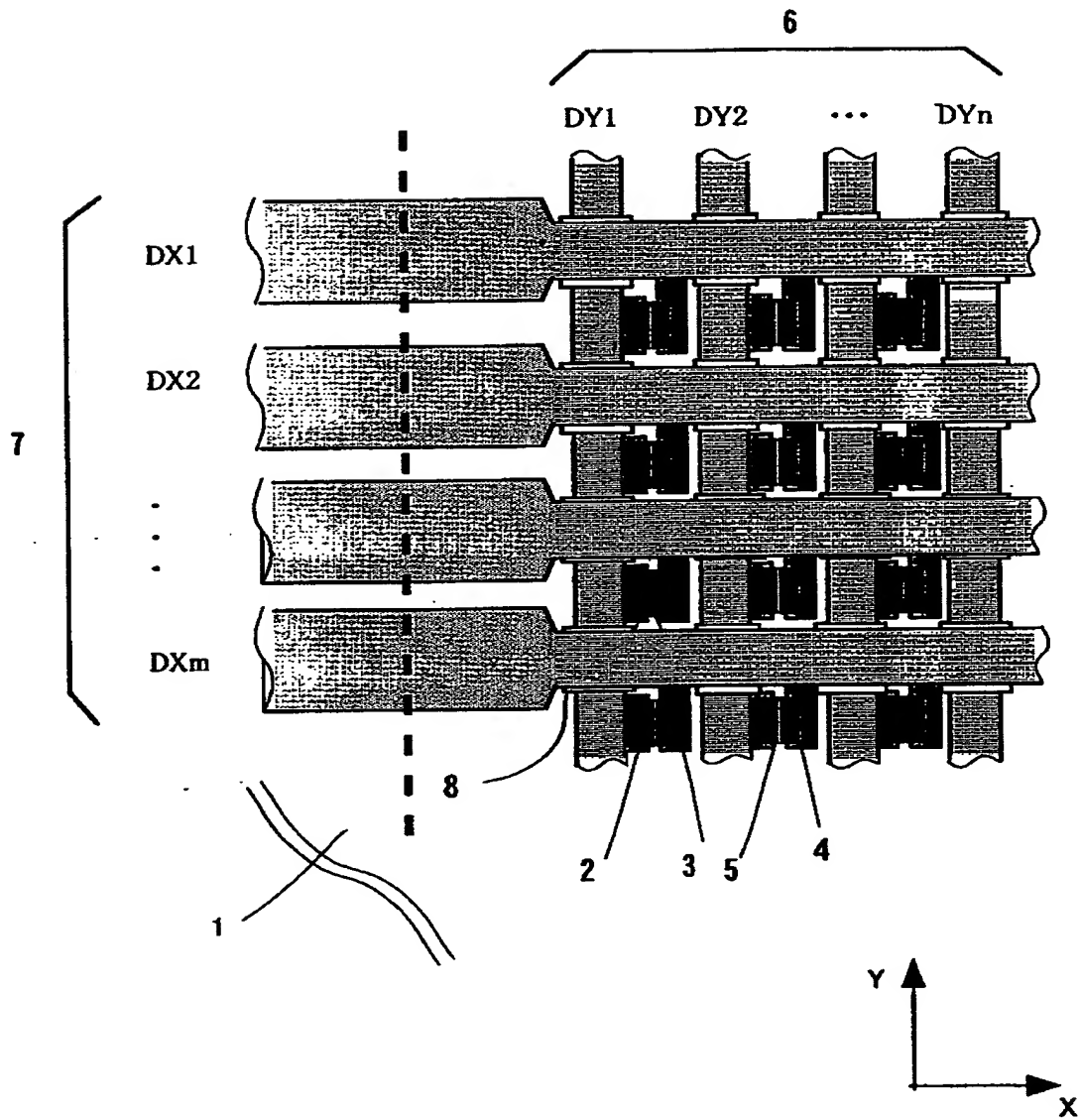
【図 9 3】



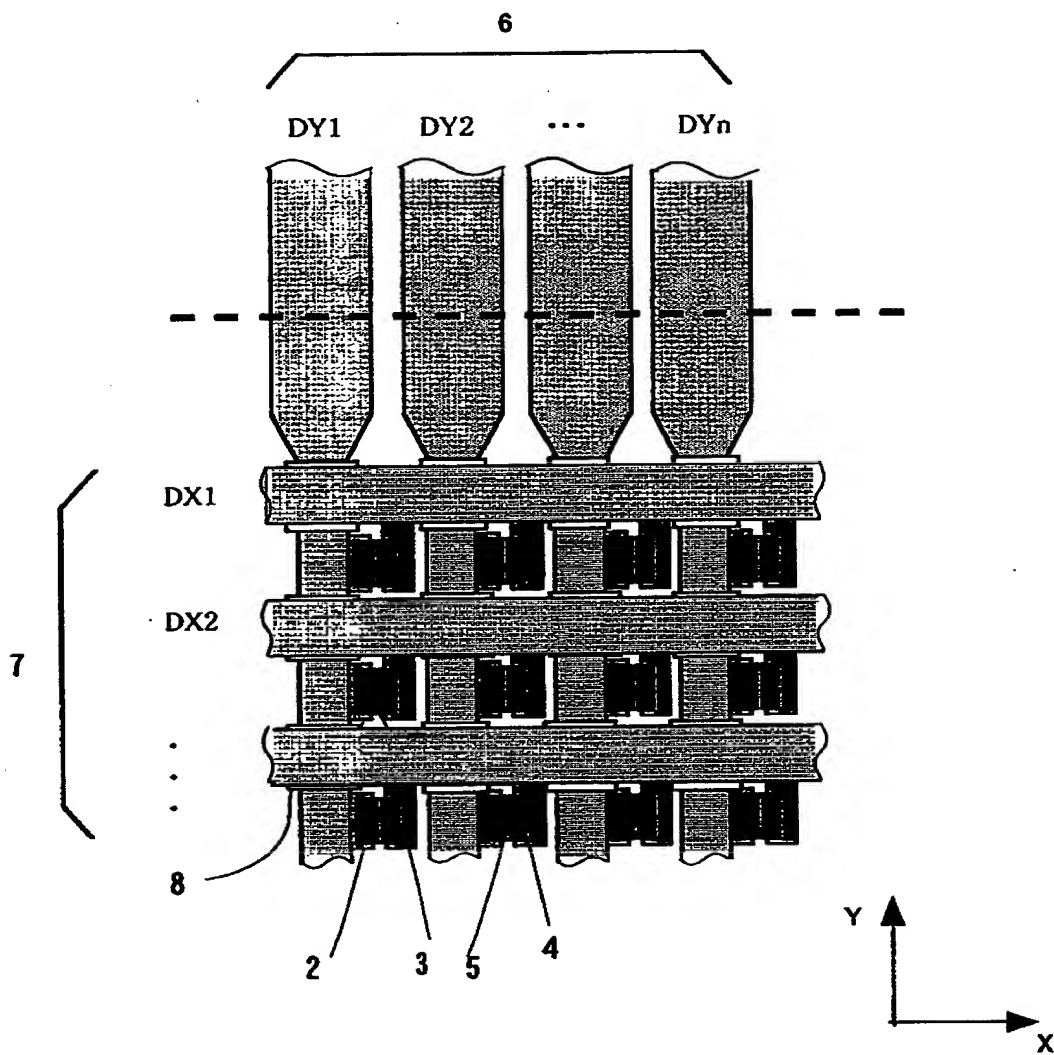
【図 9 4】



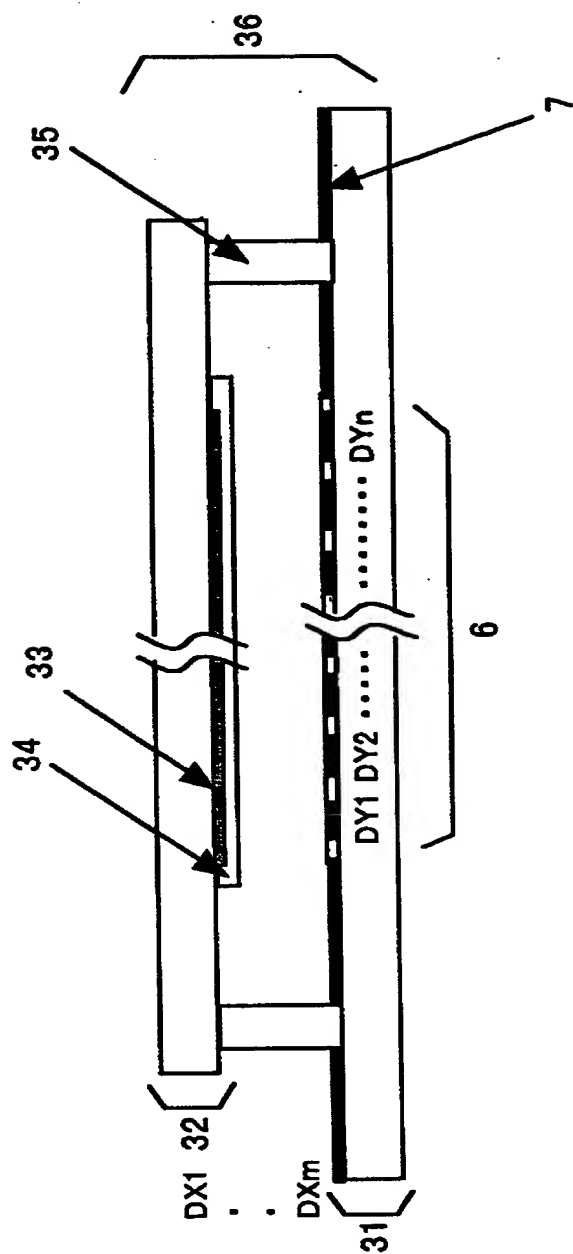
【図 9 5】



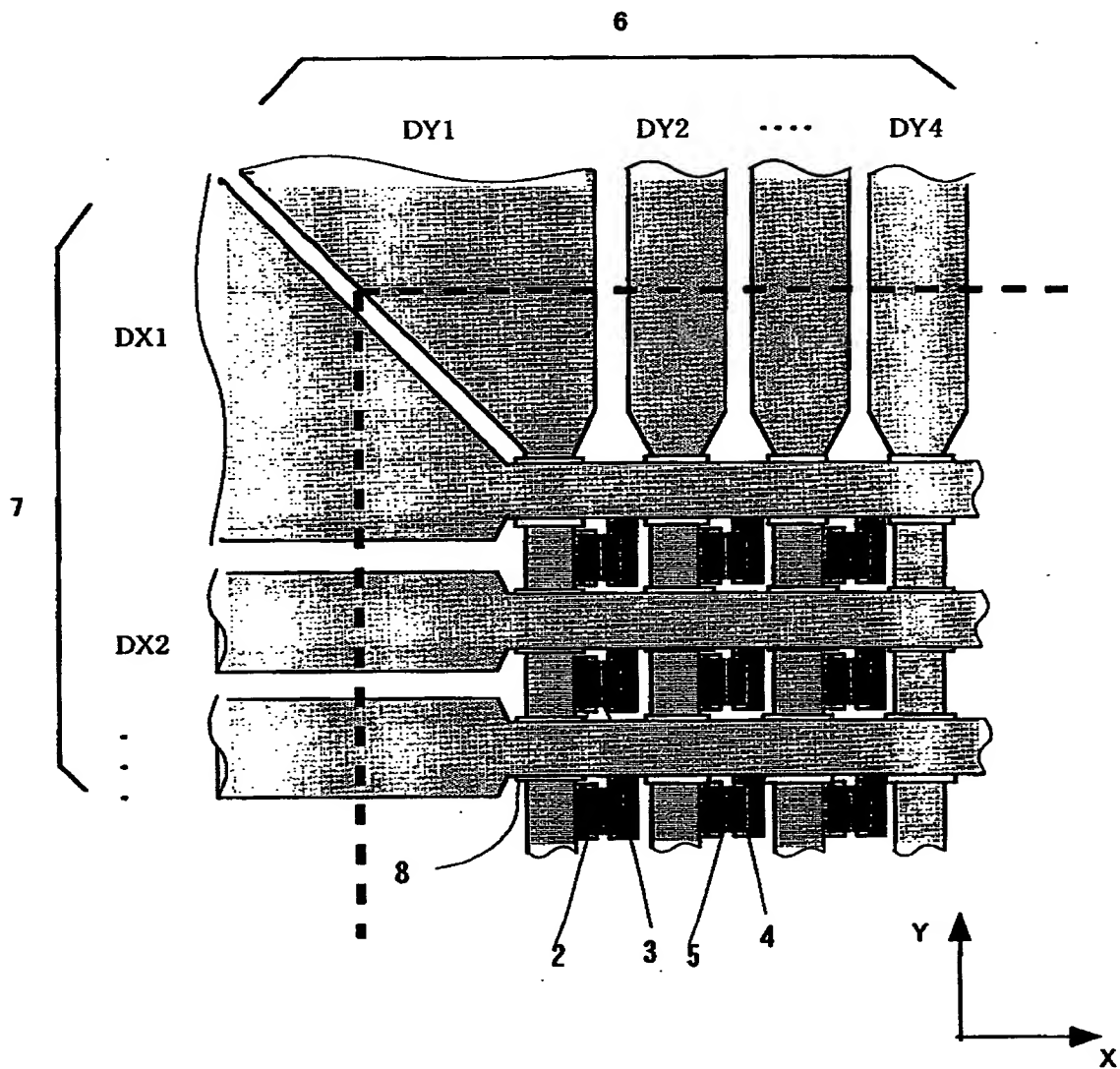
【図 9 6】



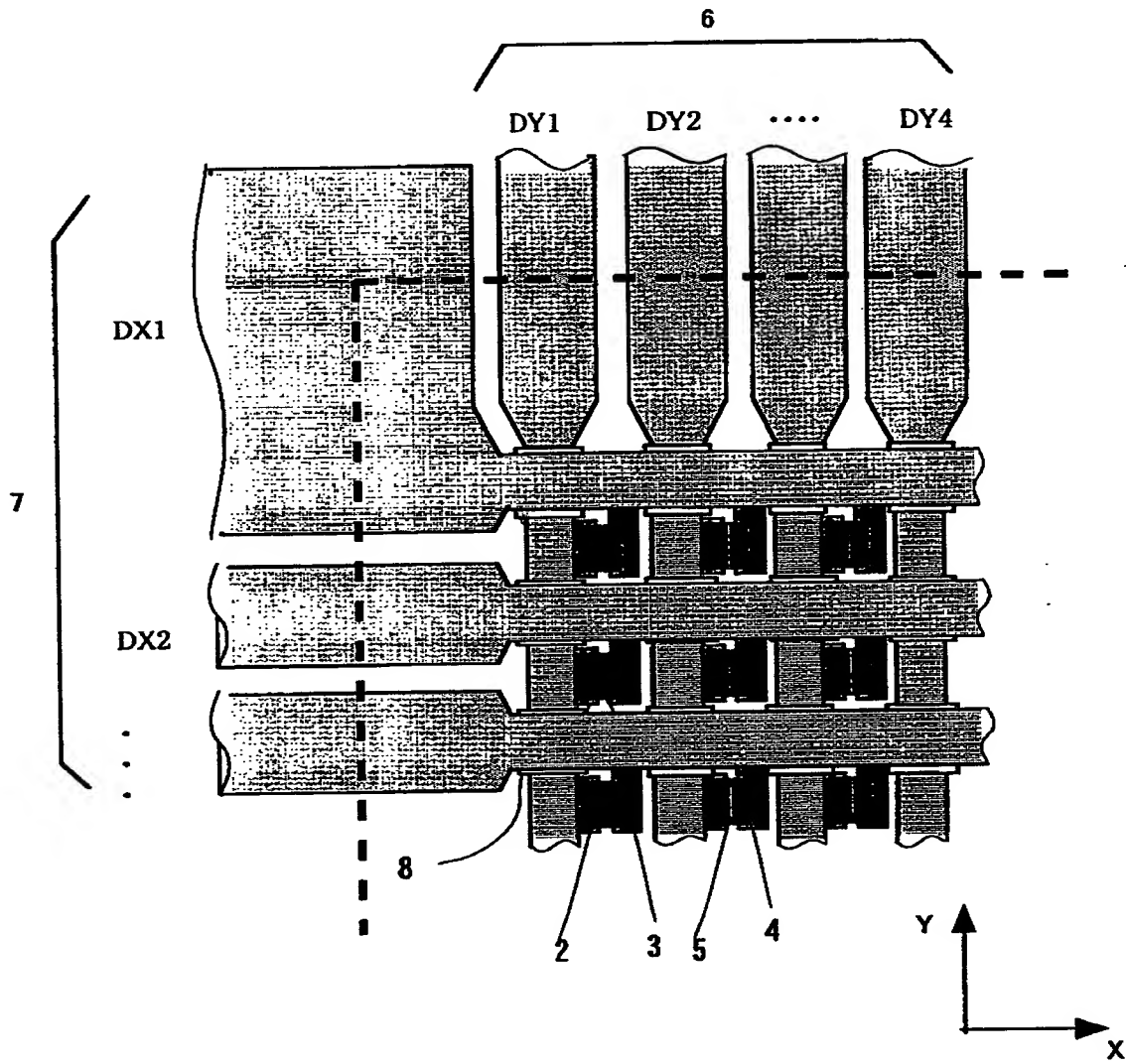
【図97】



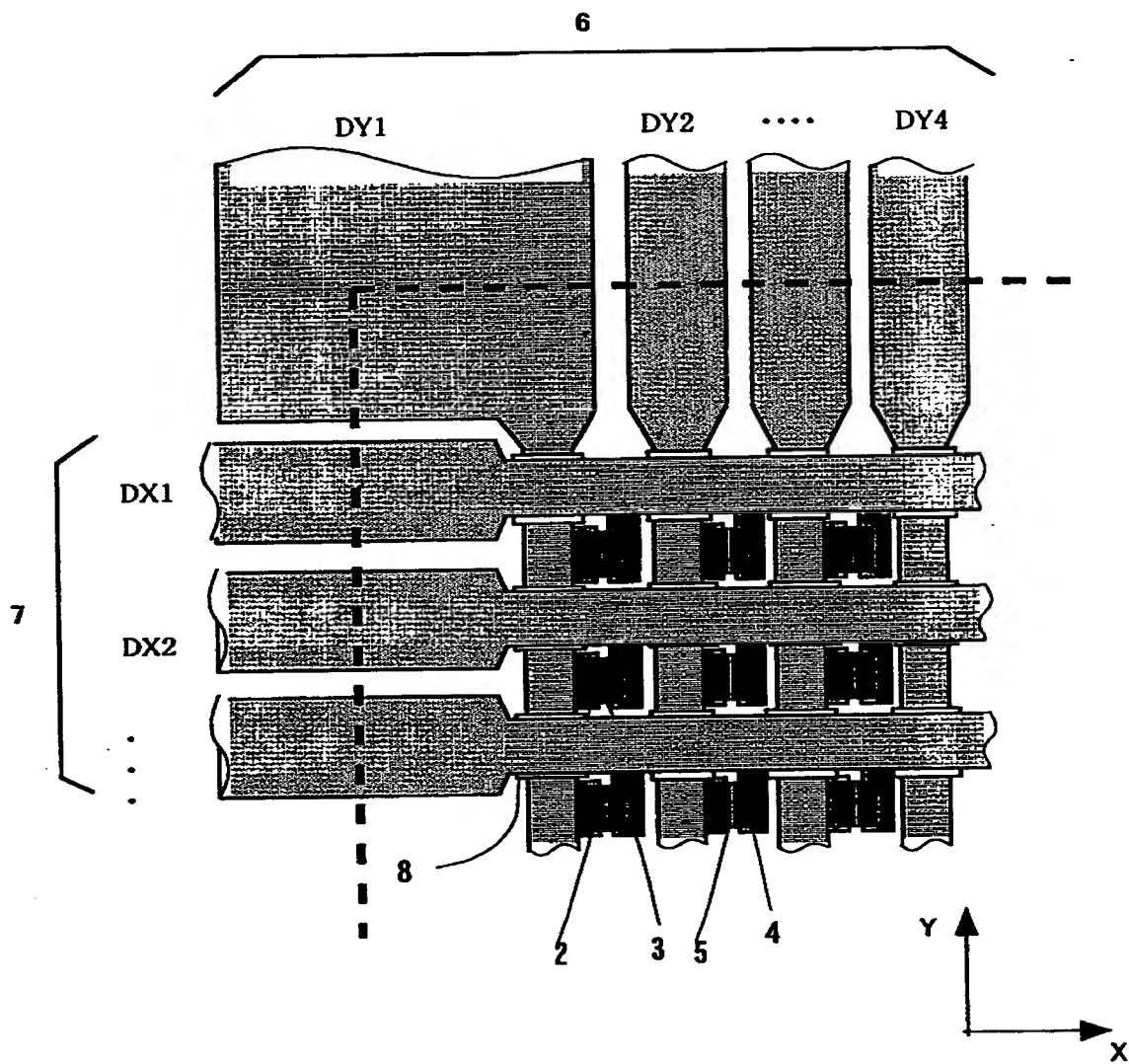
【図 9 8】



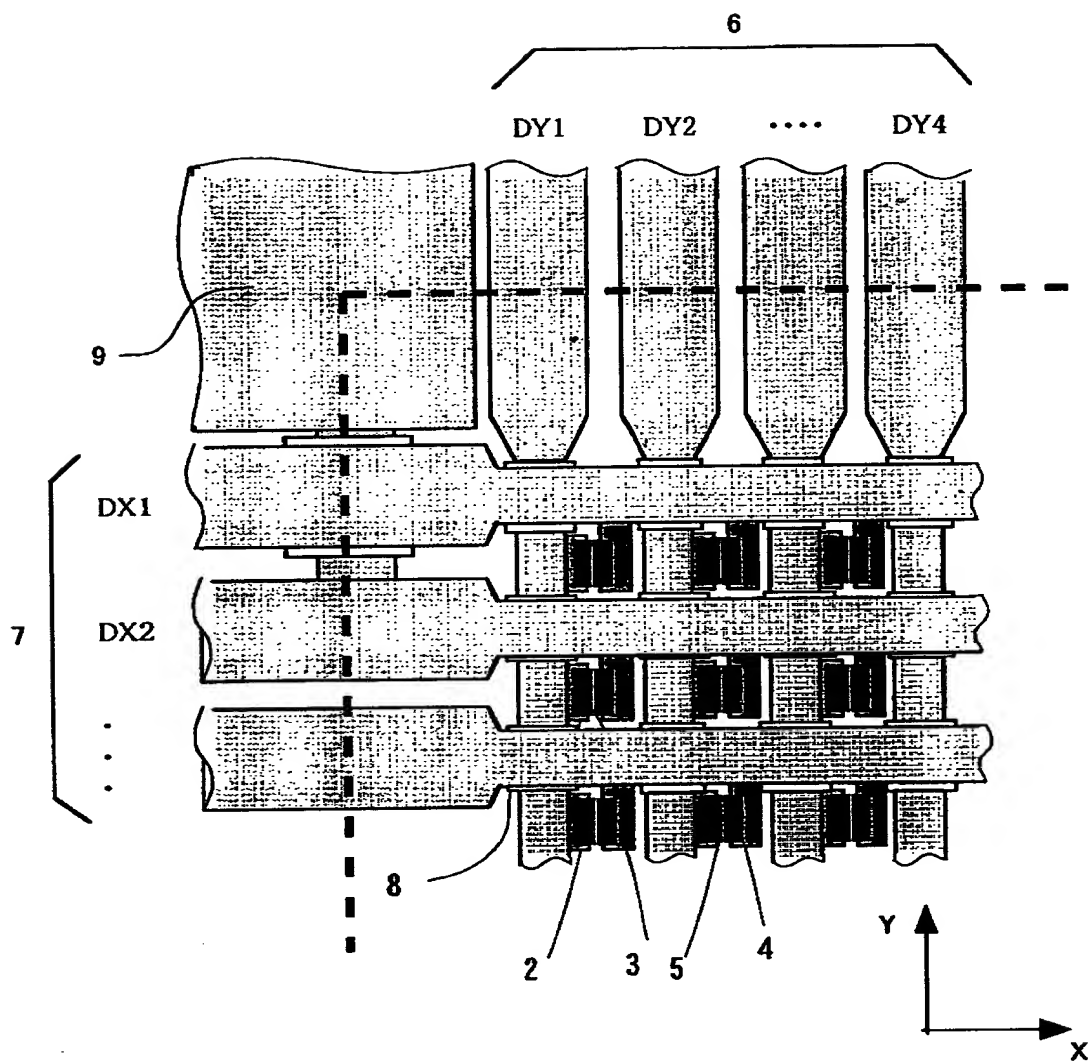
【図 99】



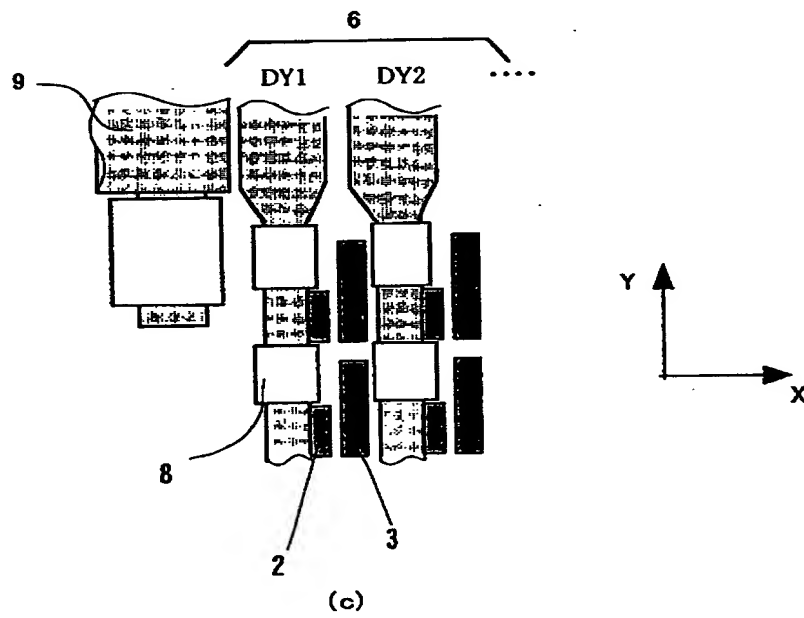
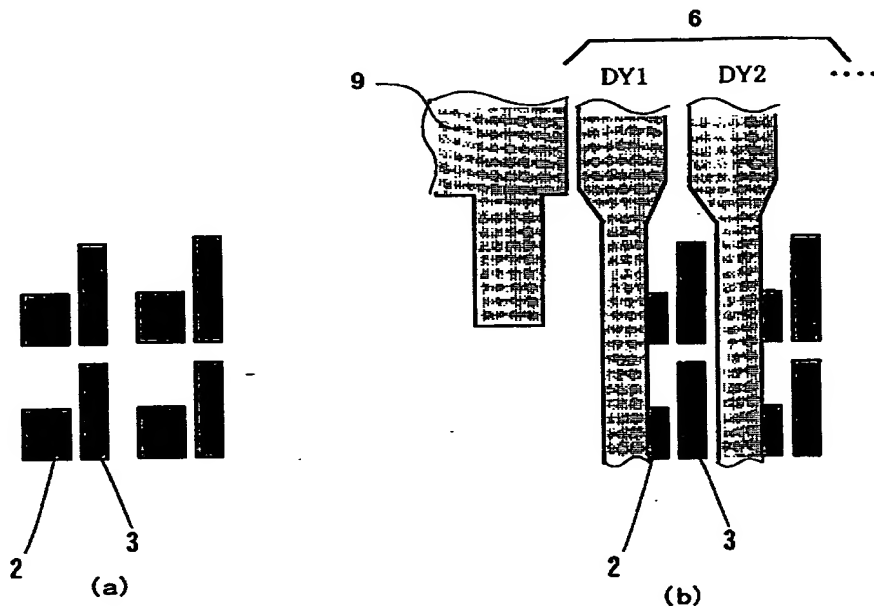
【図 1 0 0】



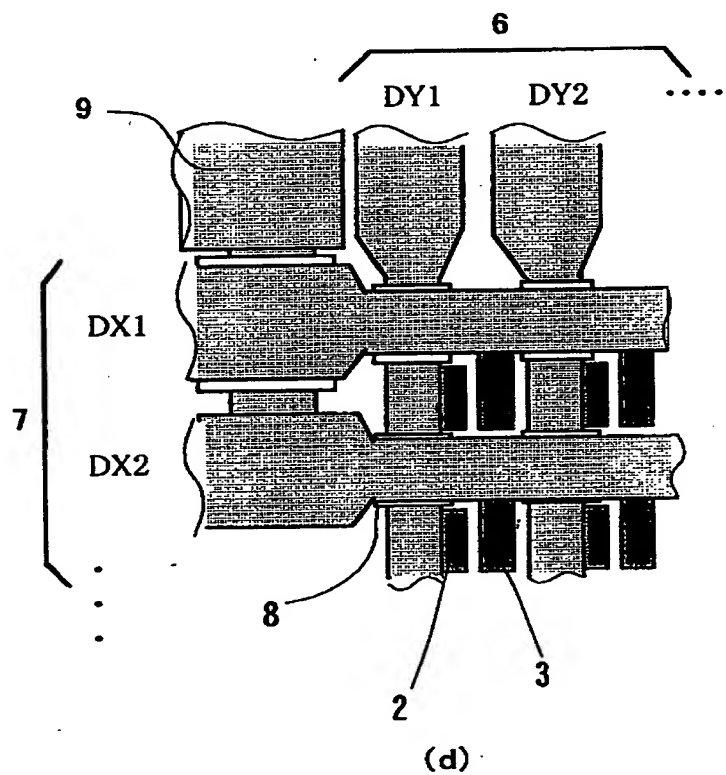
【図 101】



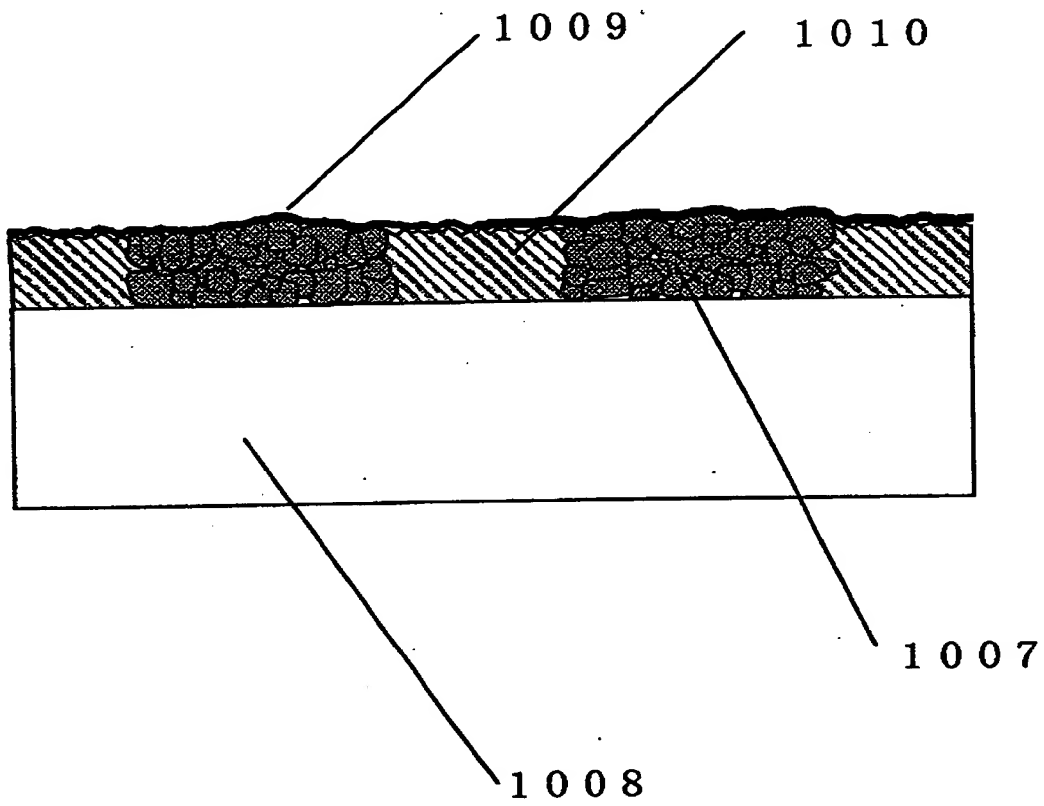
【図 1 0 2】



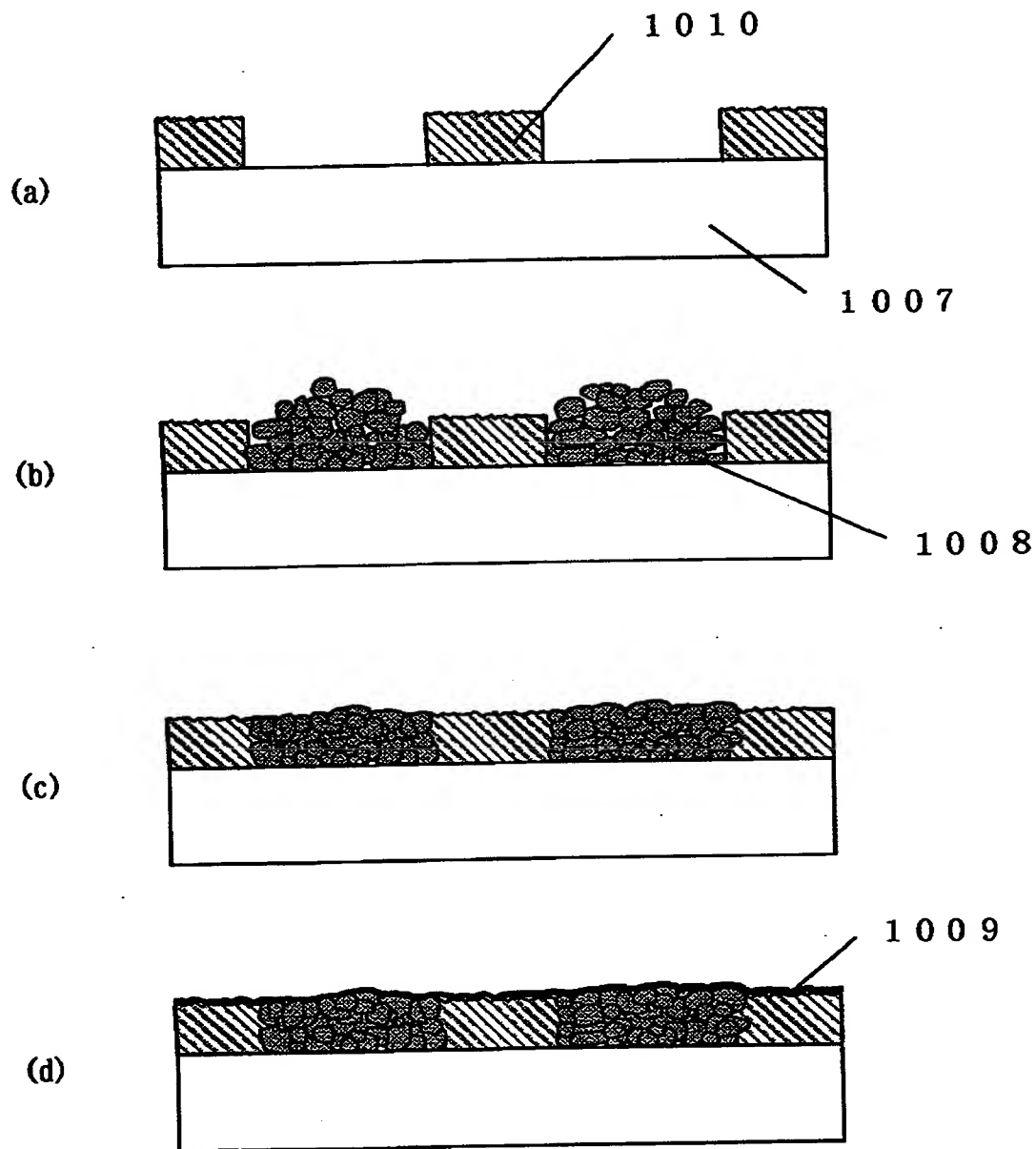
【図 103】



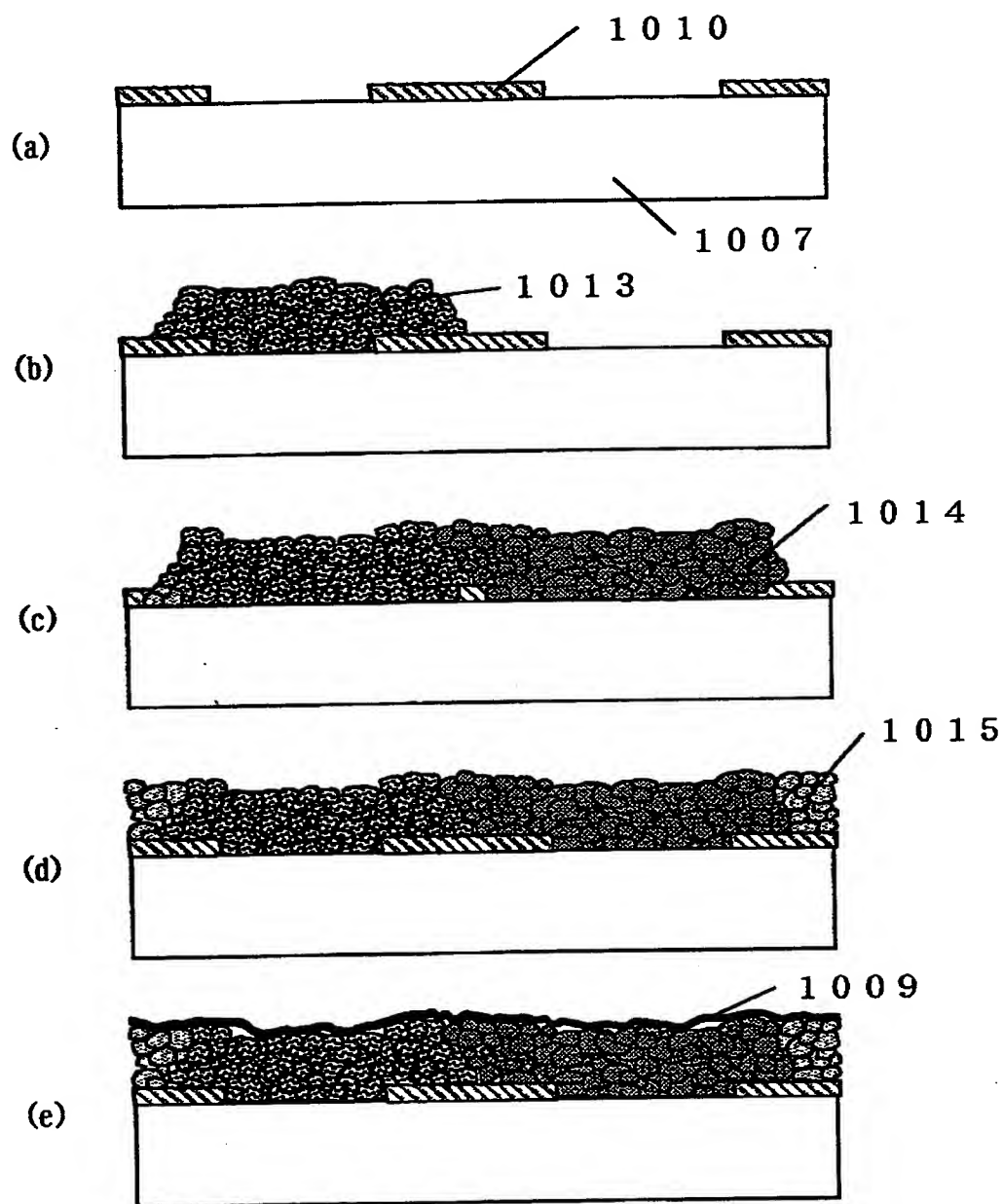
【図104】



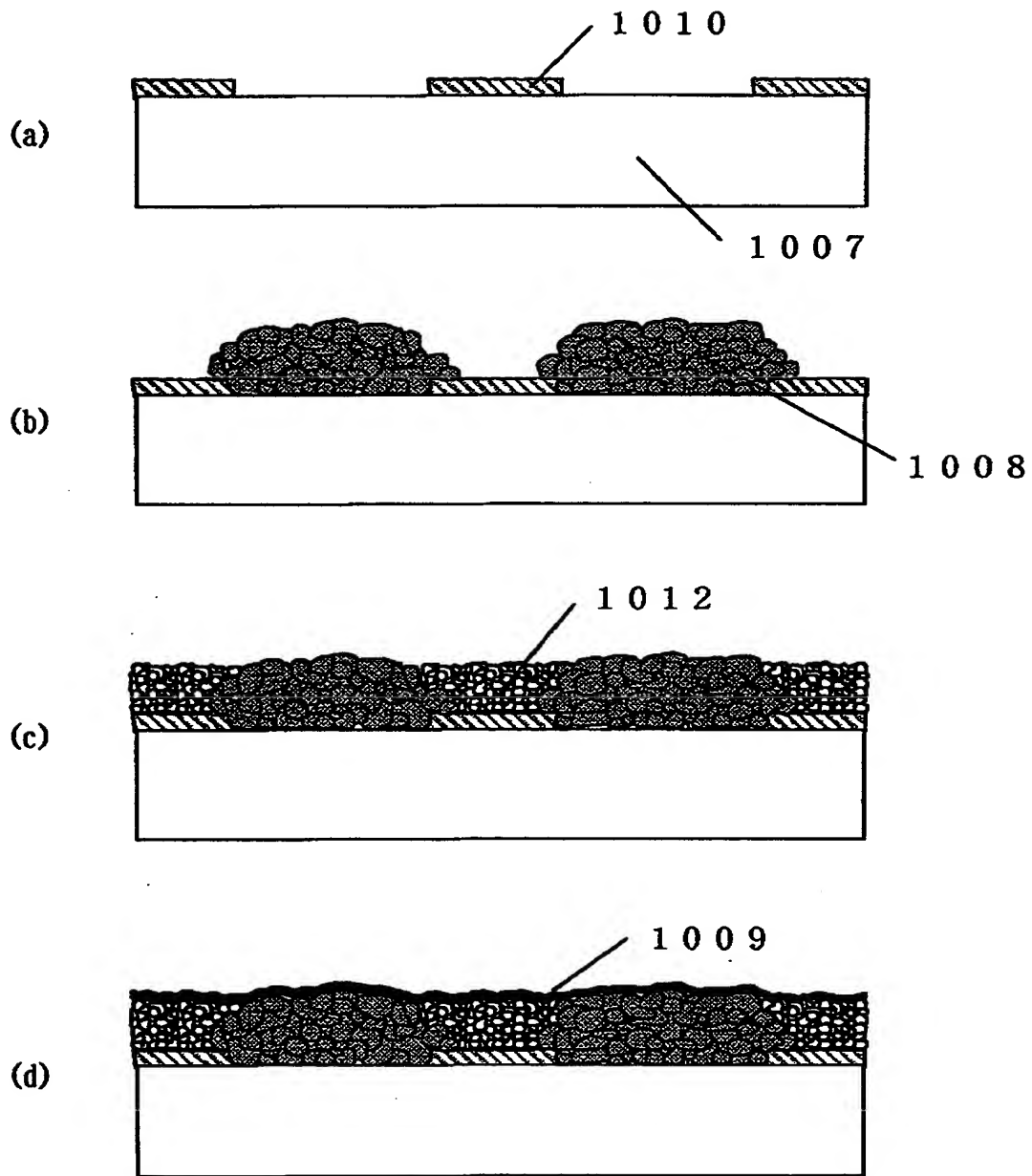
【図 105】



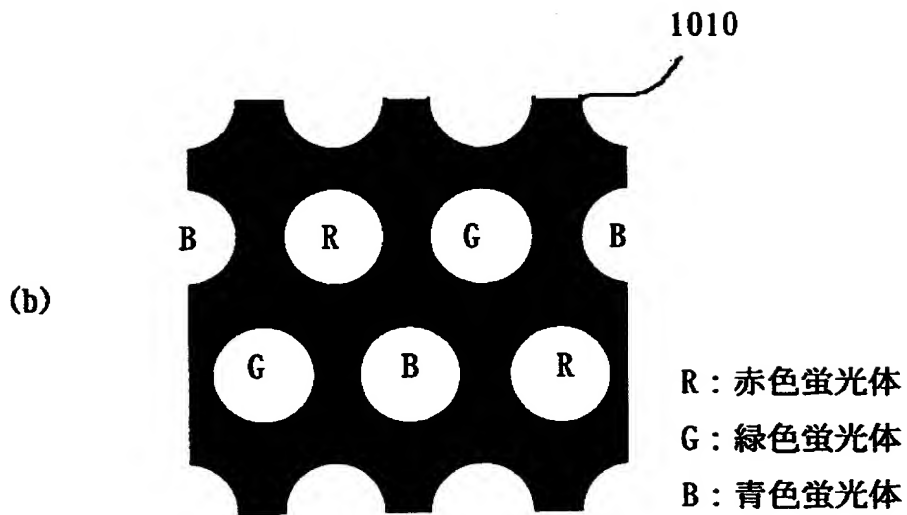
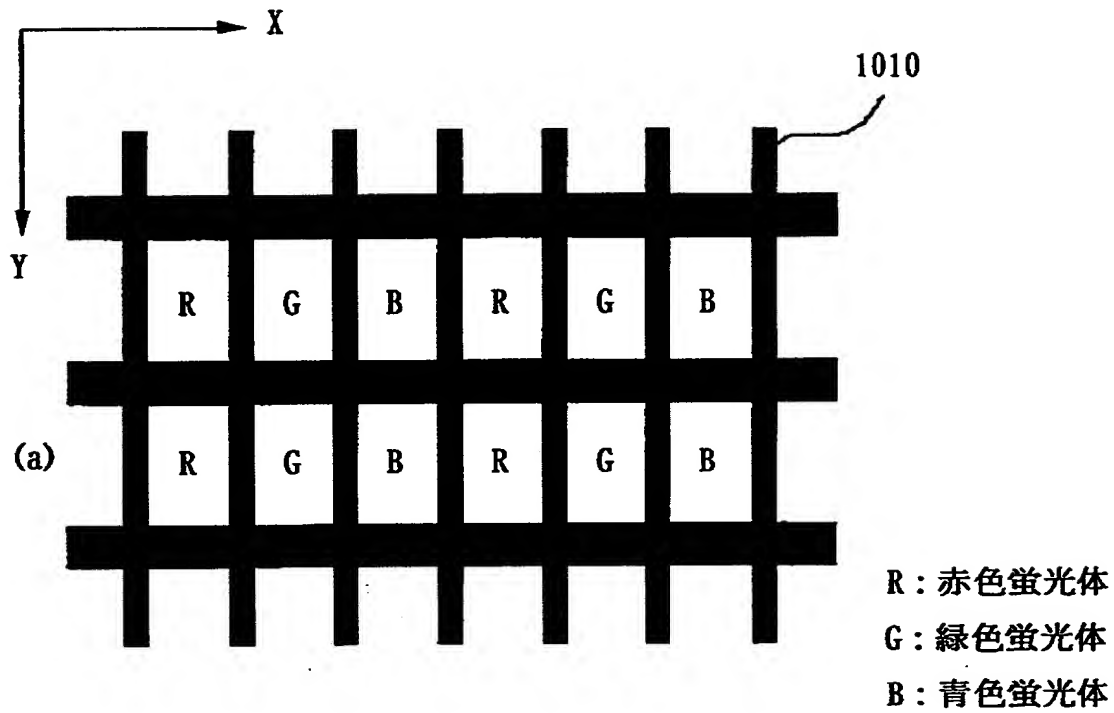
【図106】



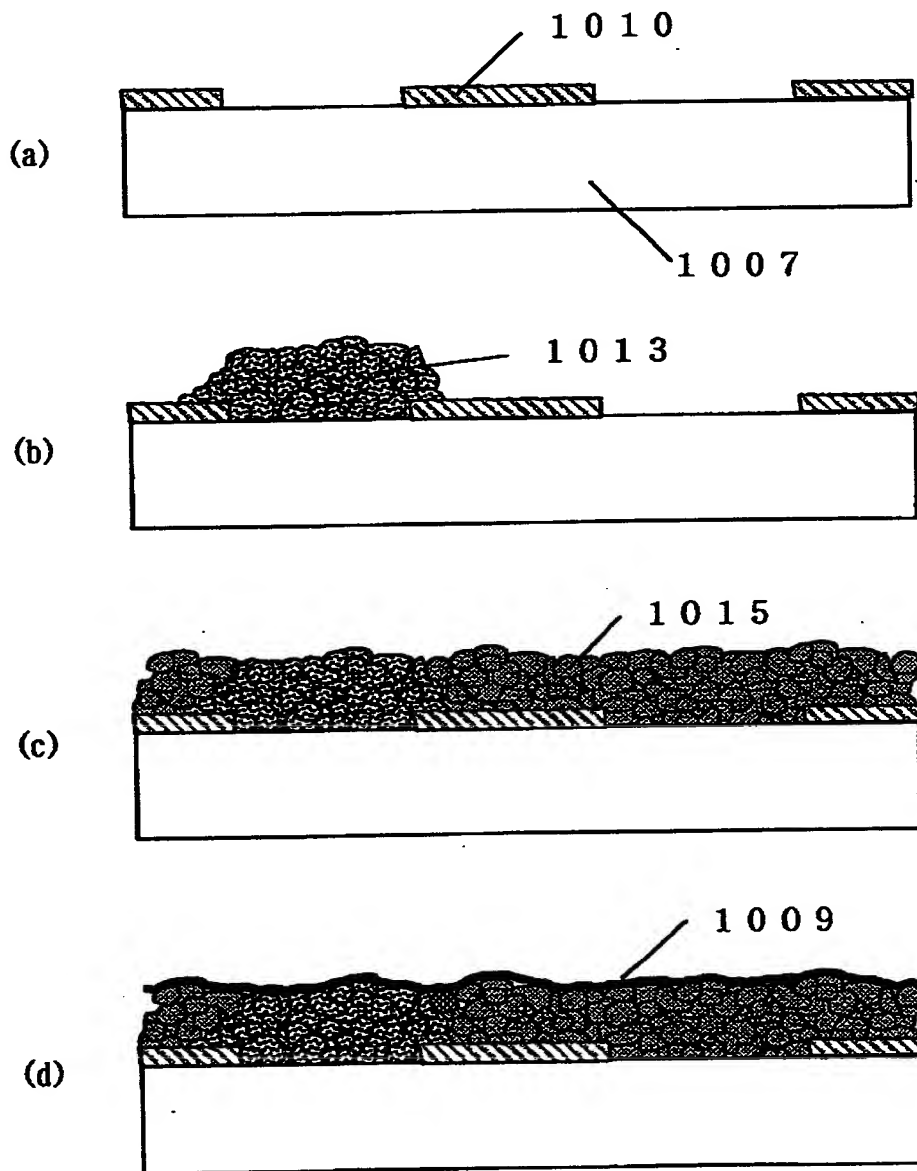
【図 1 0 7】



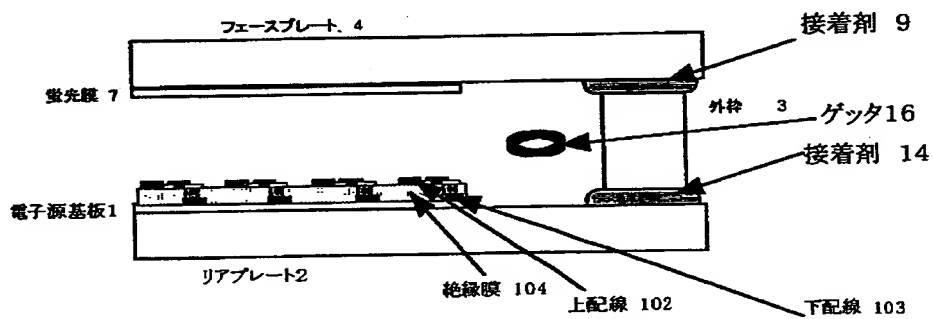
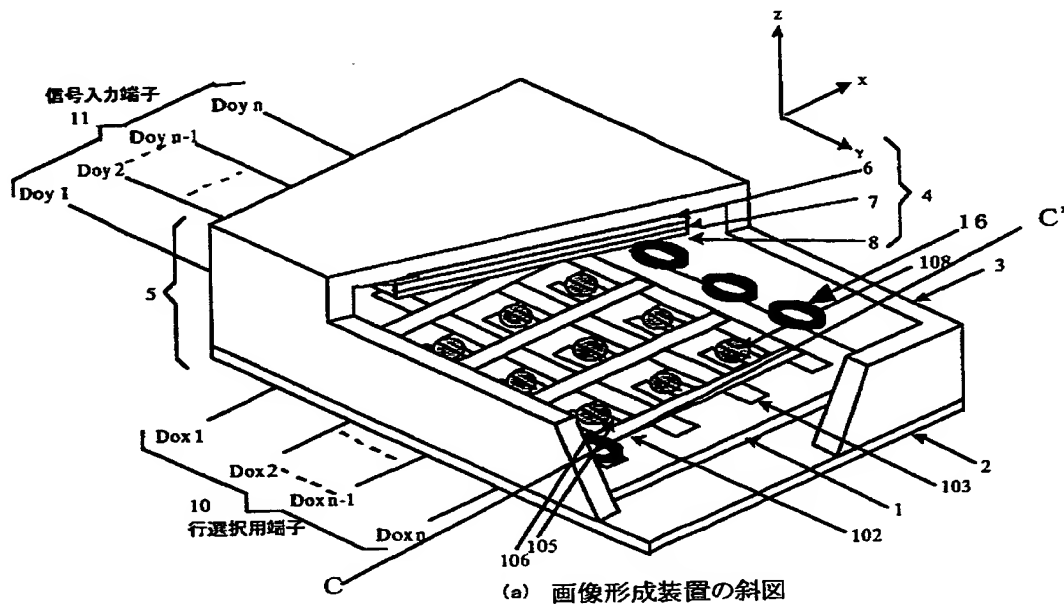
【図 1 0 8】



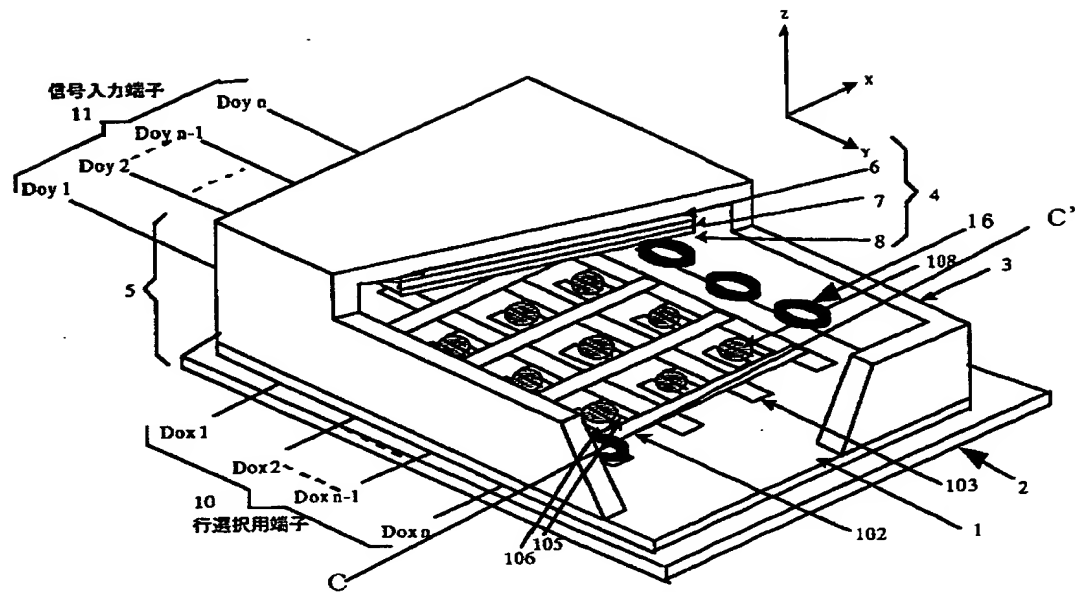
【図109】



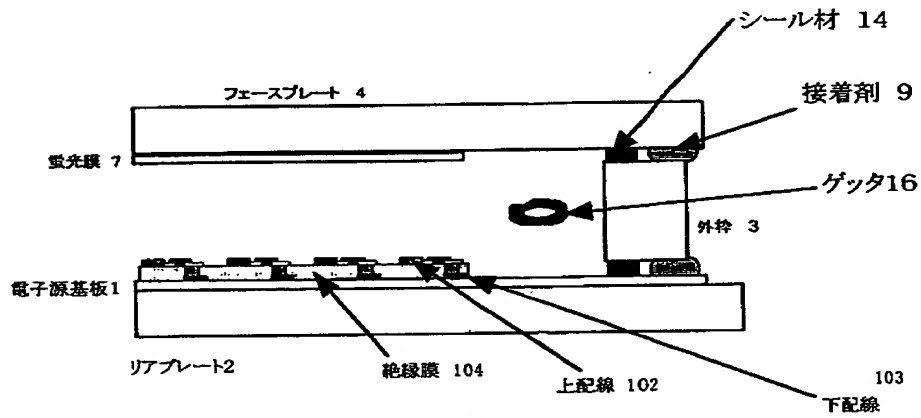
【図 110】



【図 111】

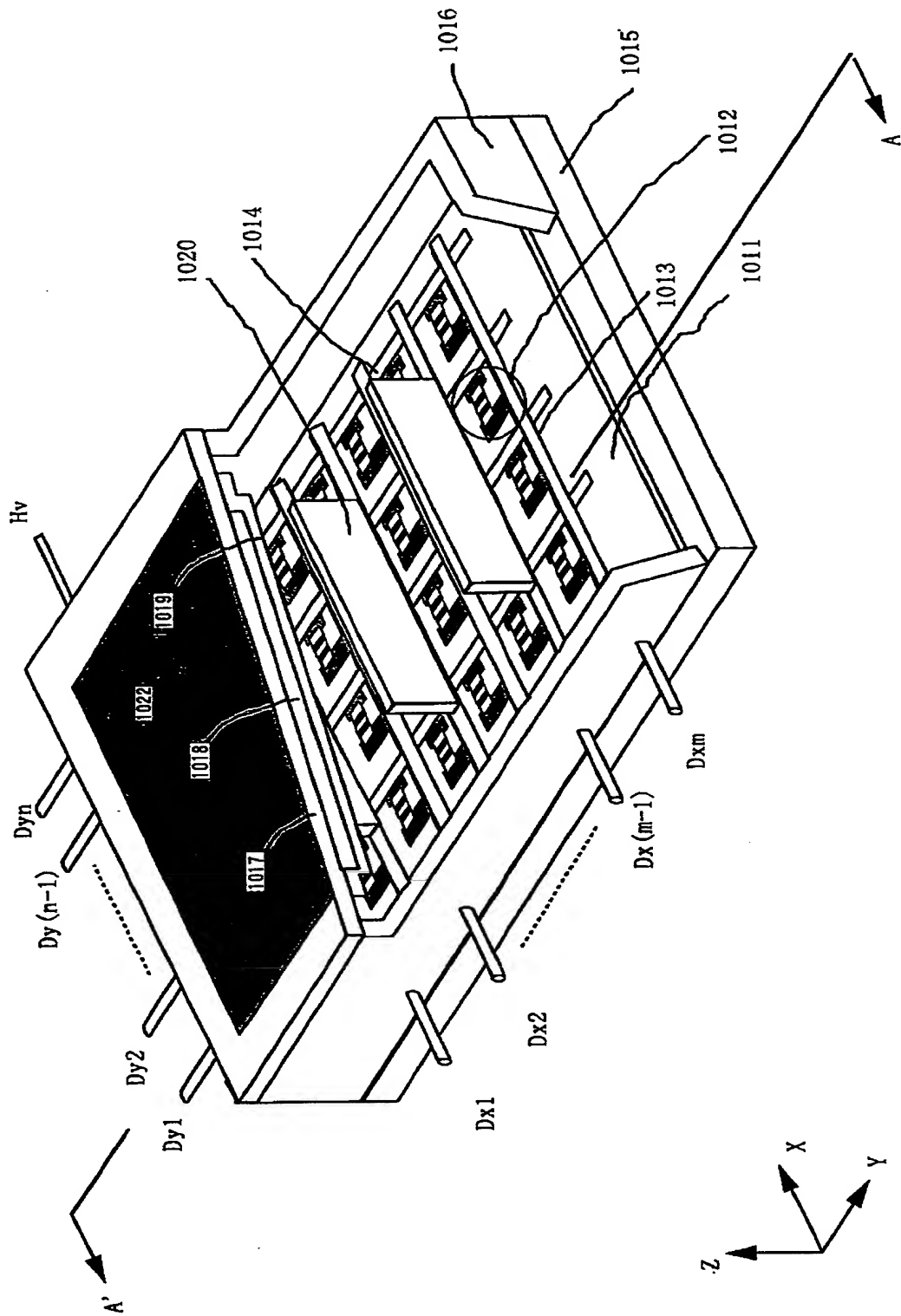


(a) 画像形成装置の斜図

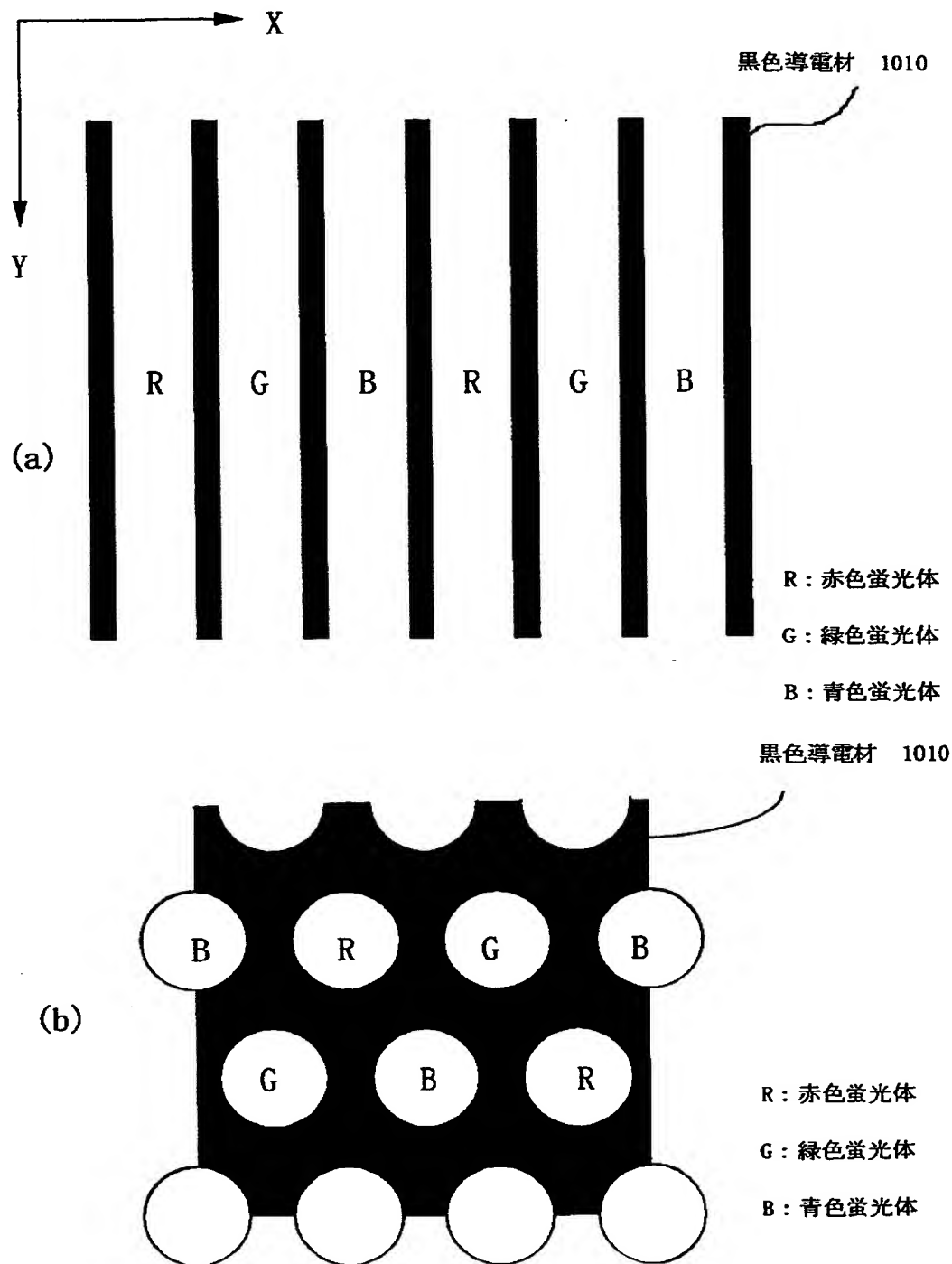


(b) C-C' 断面図

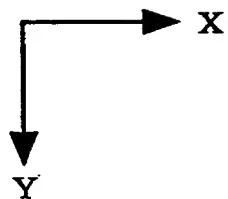
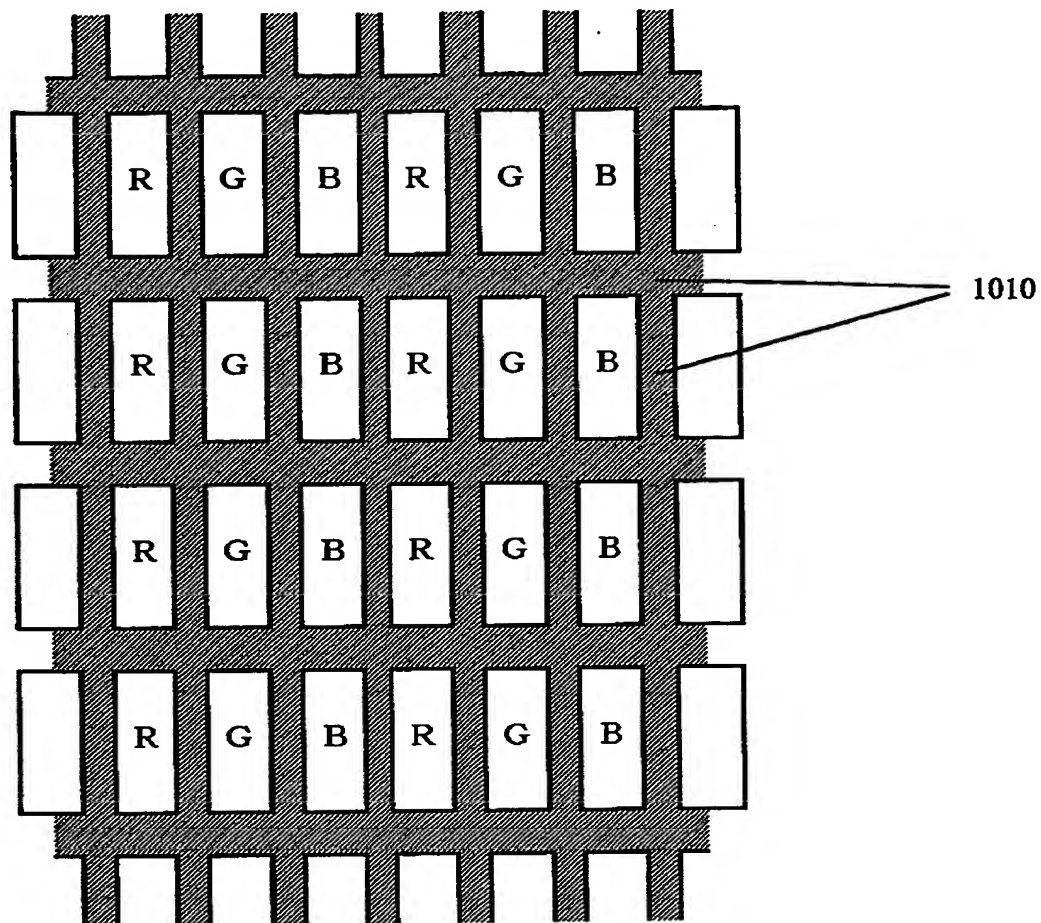
【图 1 1 2】



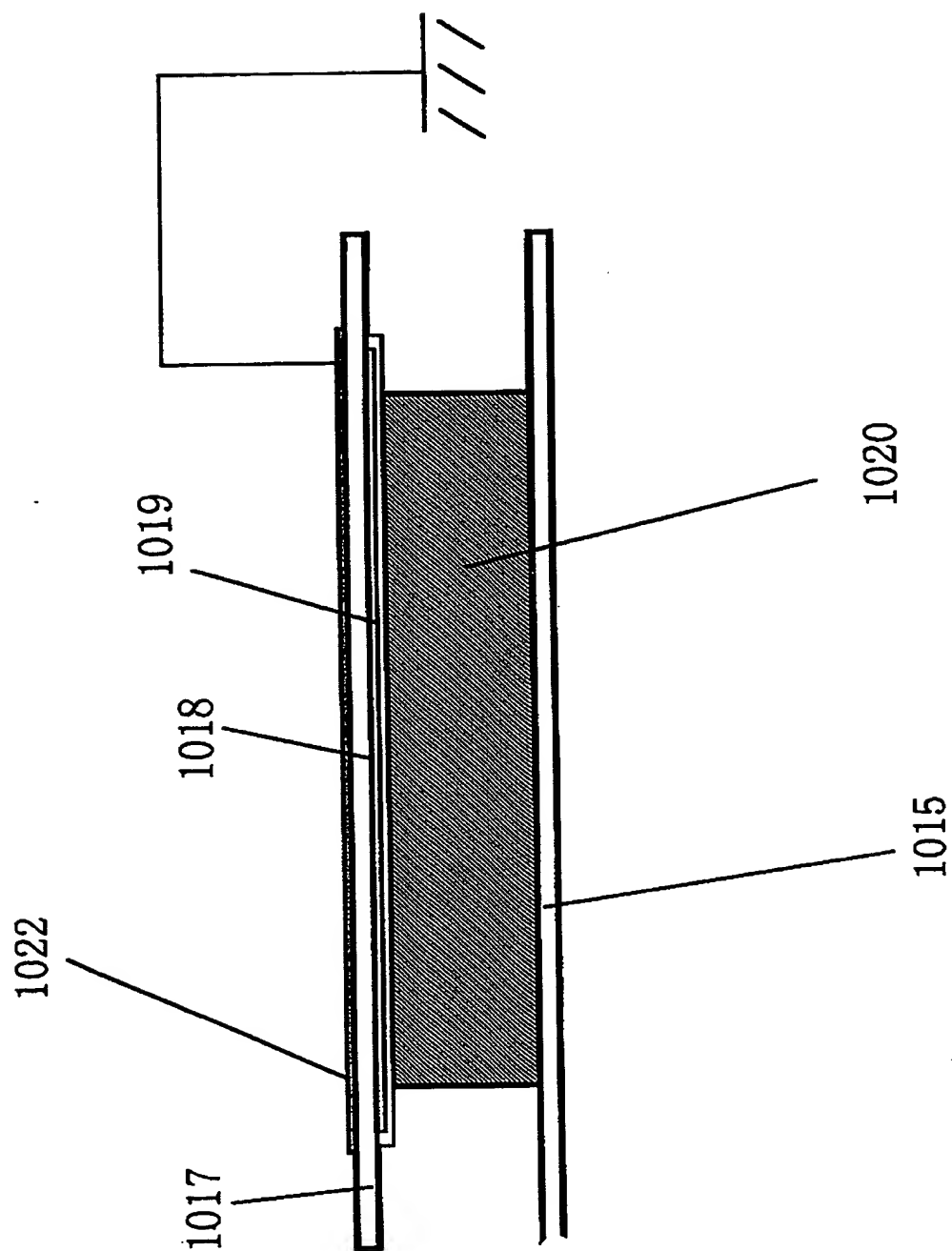
【図 1 1 3】



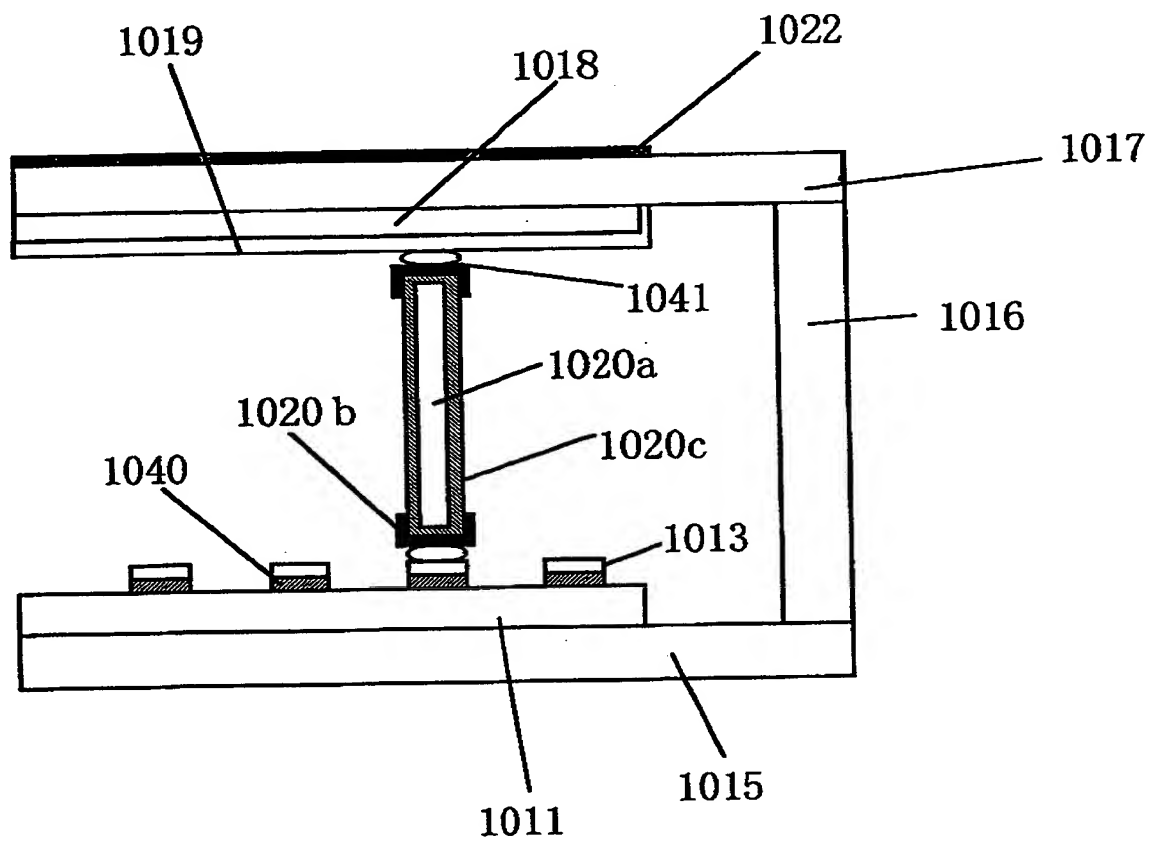
【図 1 1 4】



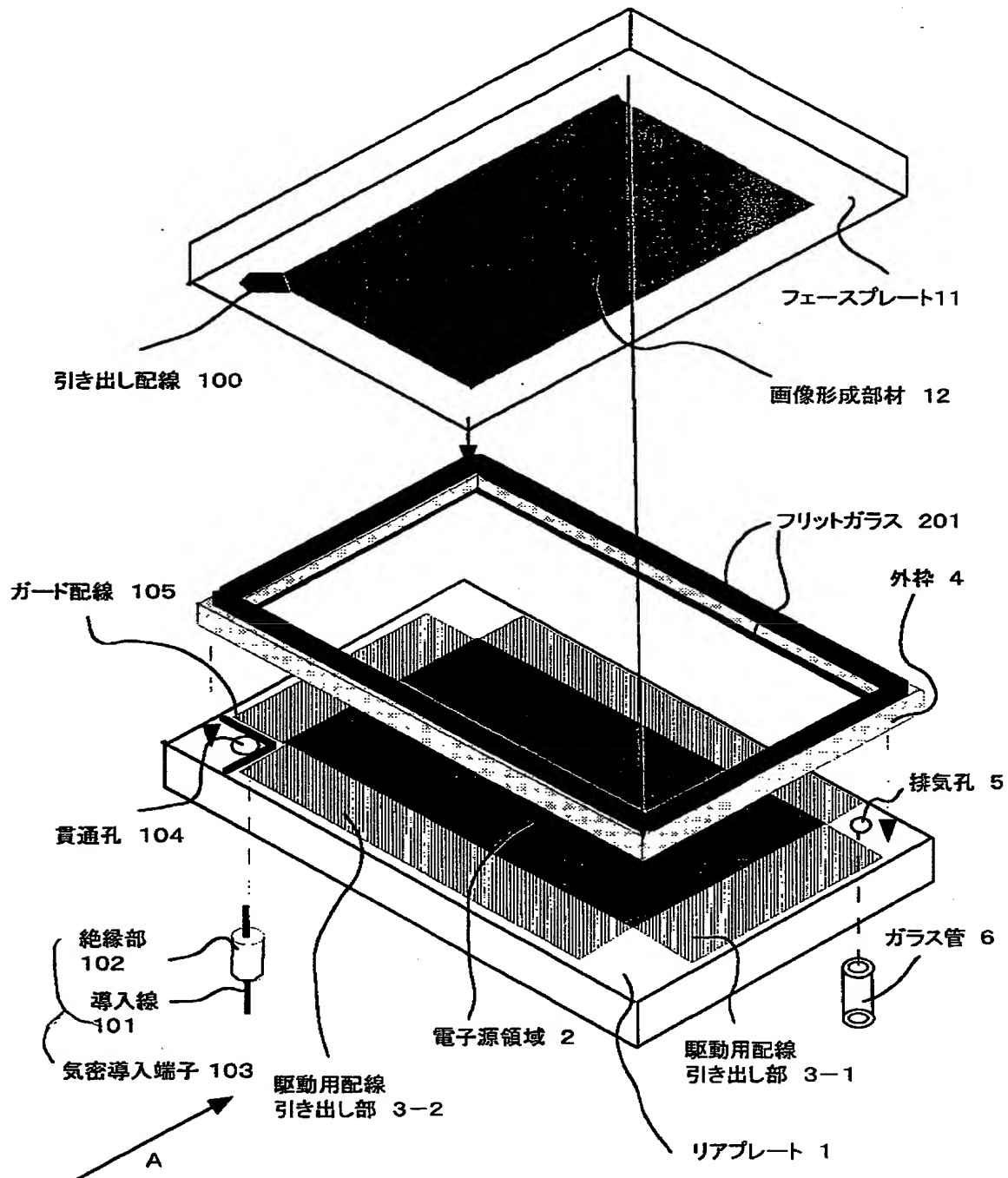
【図 1 1 5】



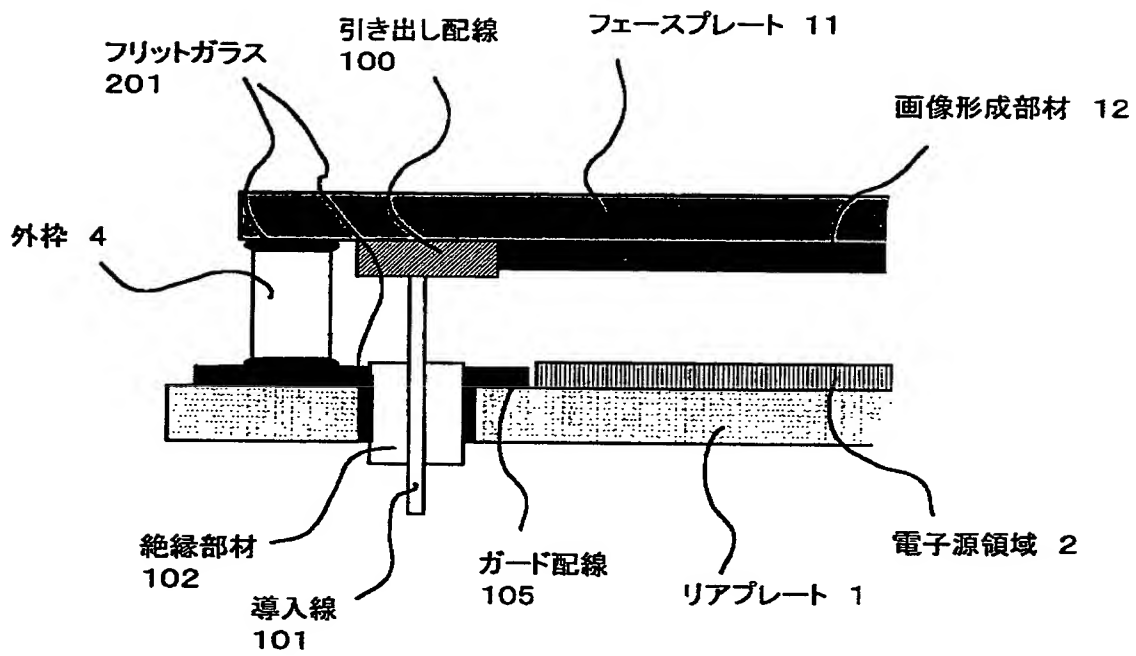
【図 1 1 6】



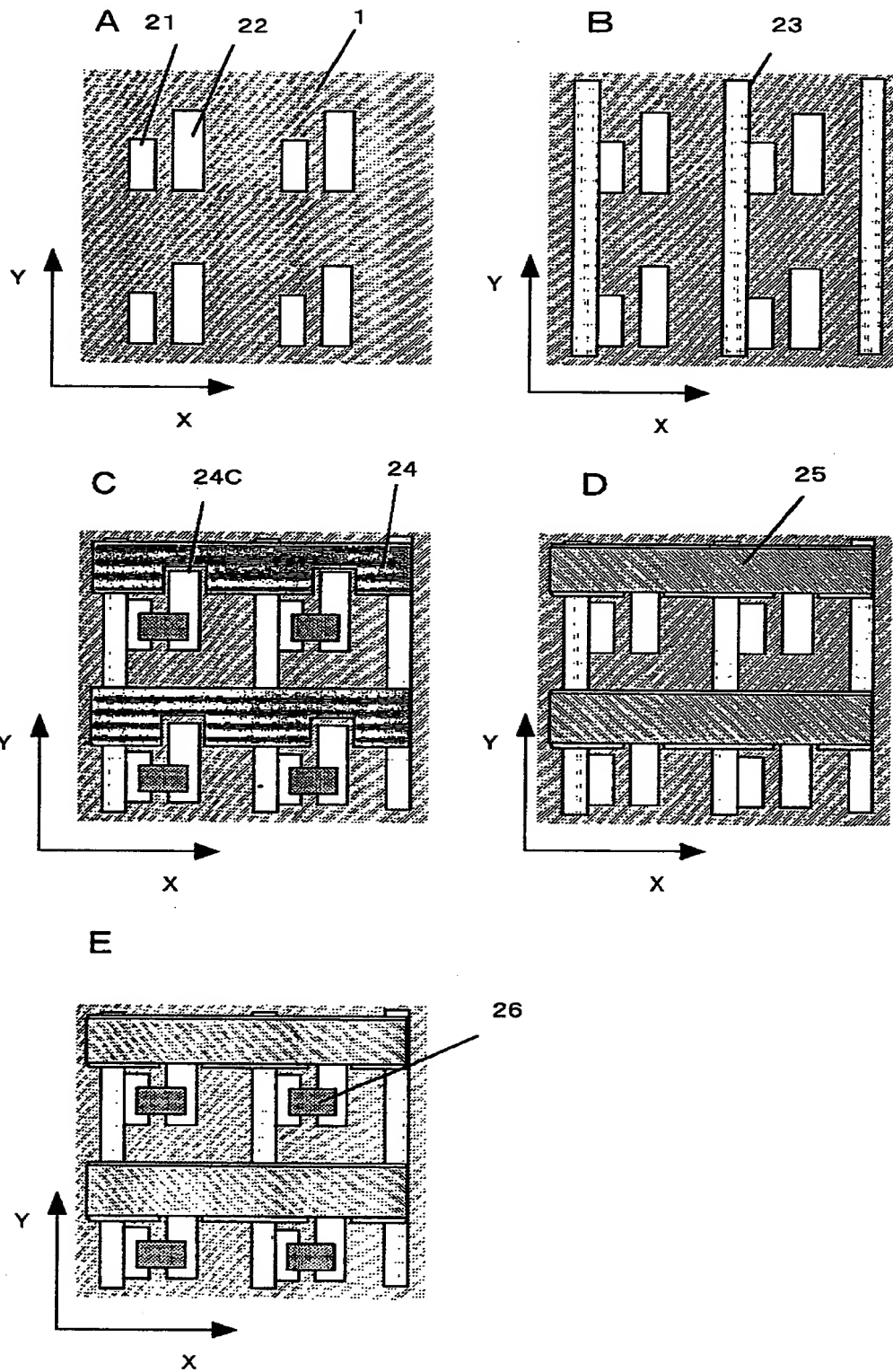
【図 1 1 7】



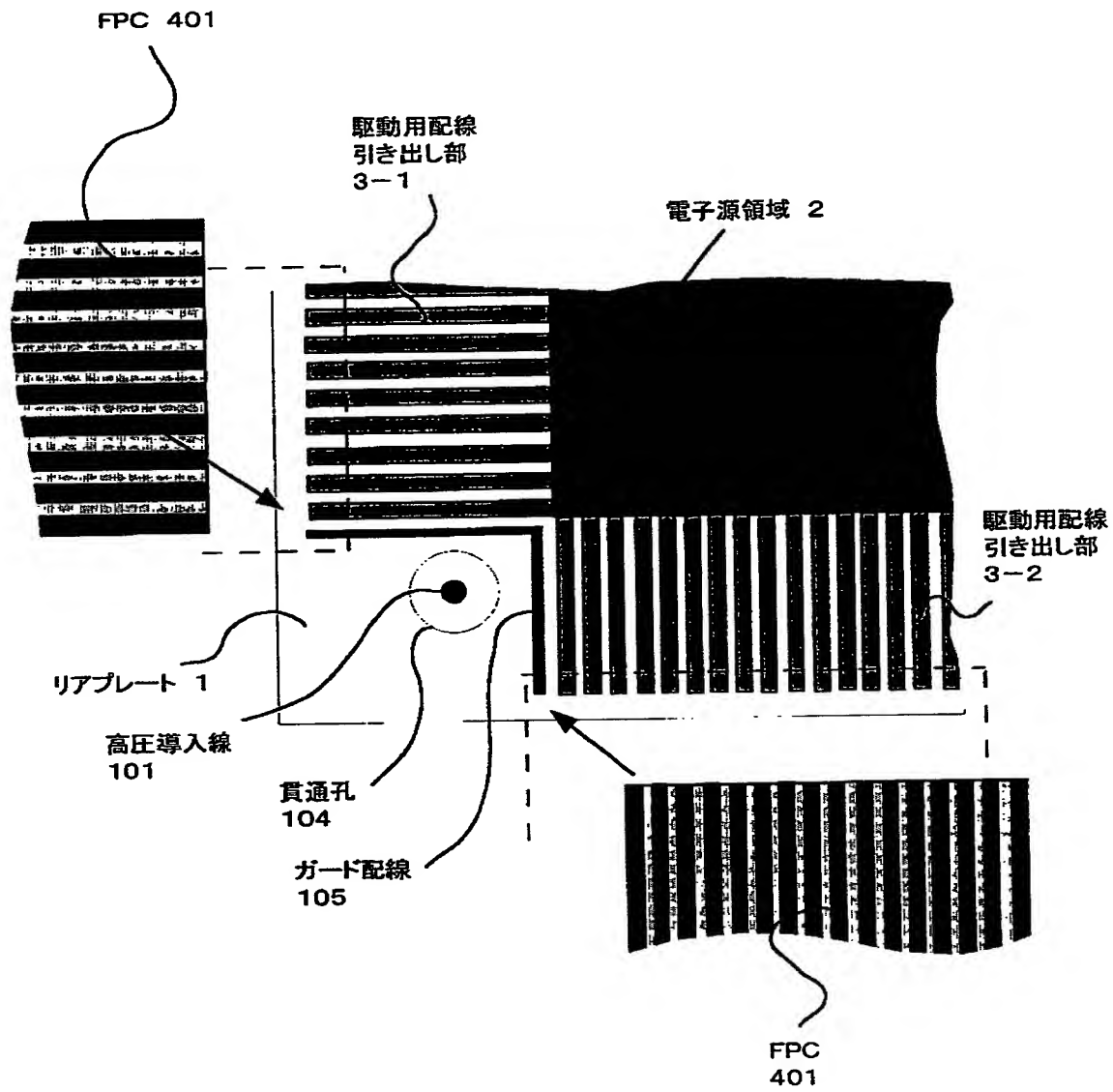
【図 118】



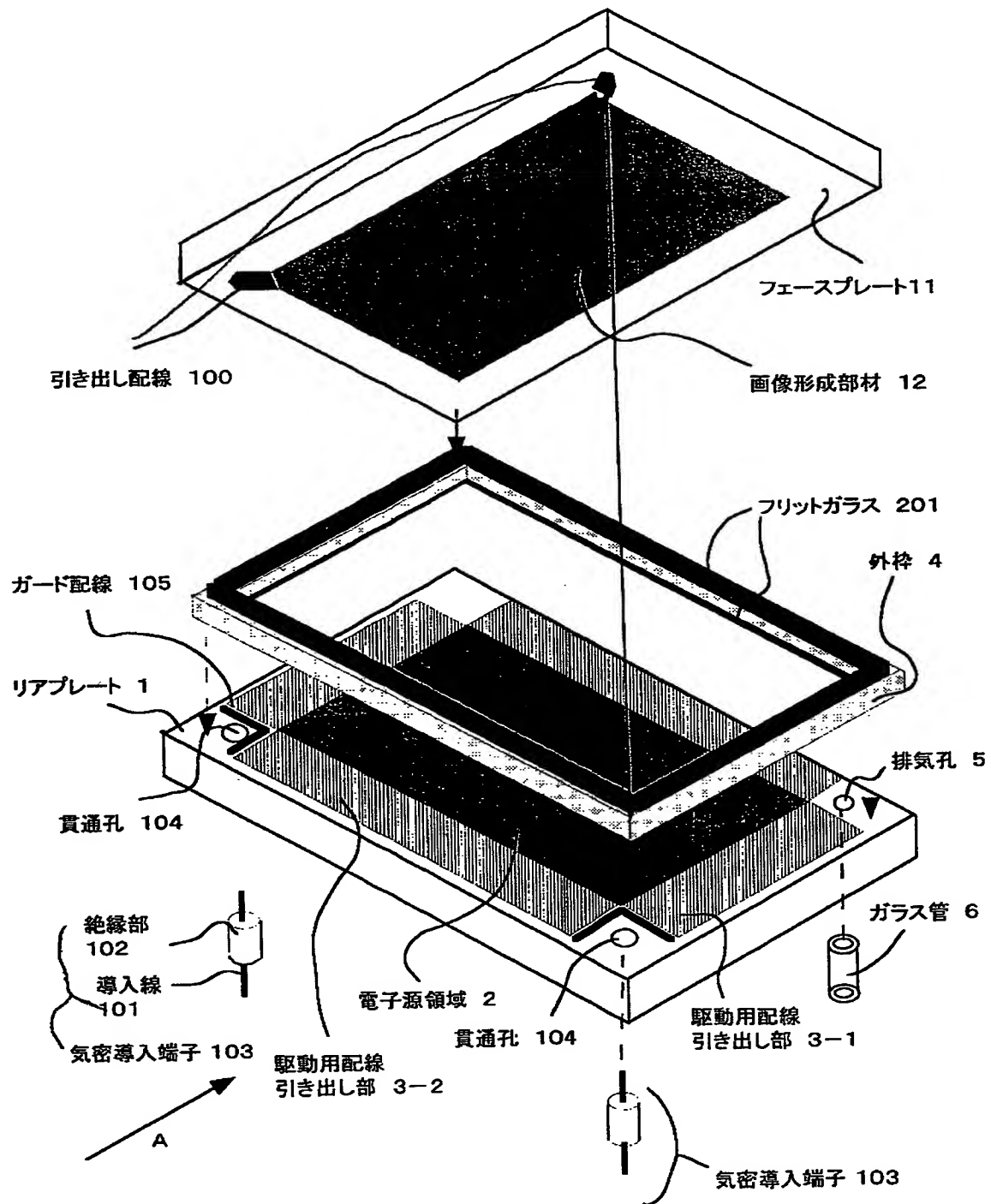
【図 119】



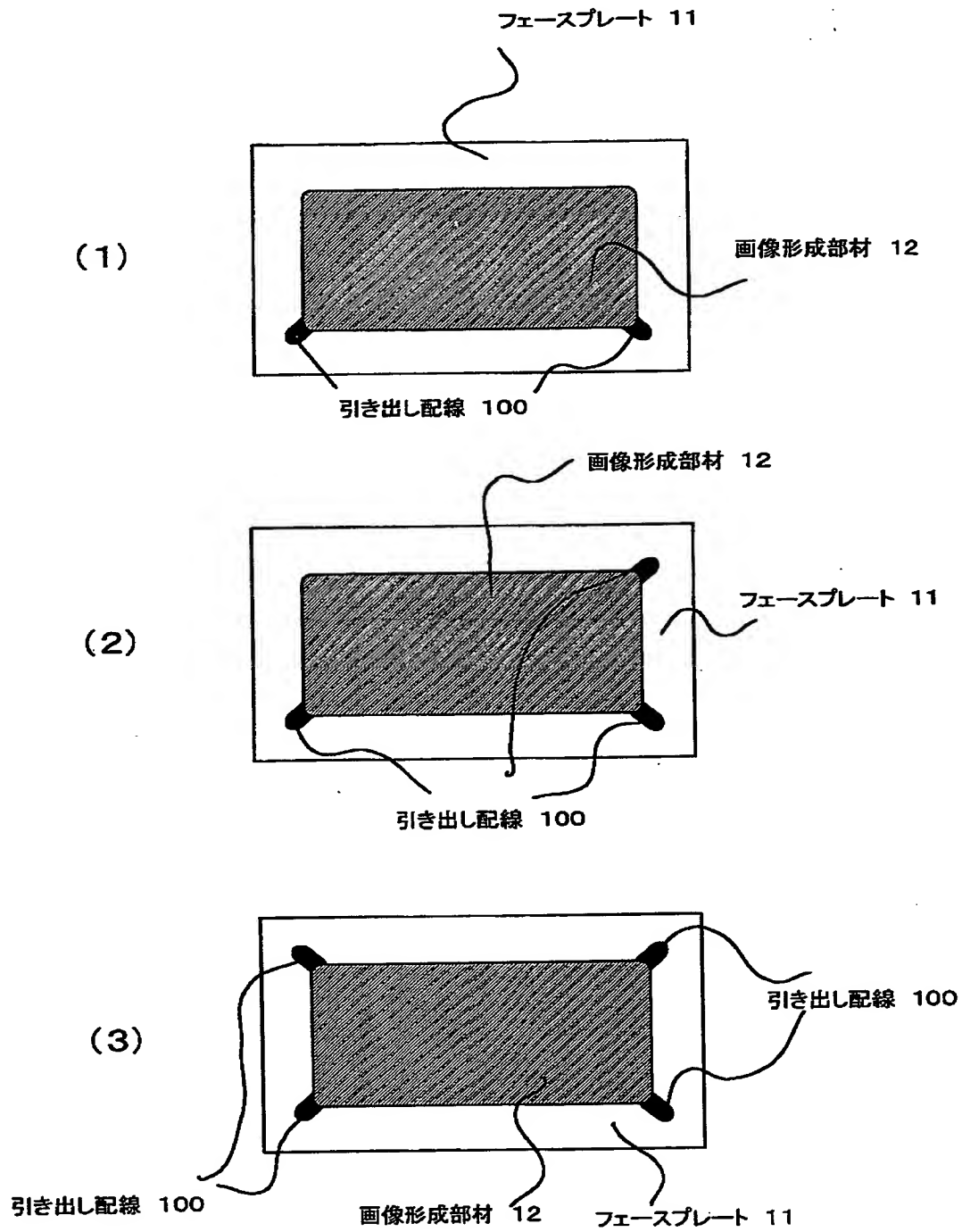
【図 1 2 0】



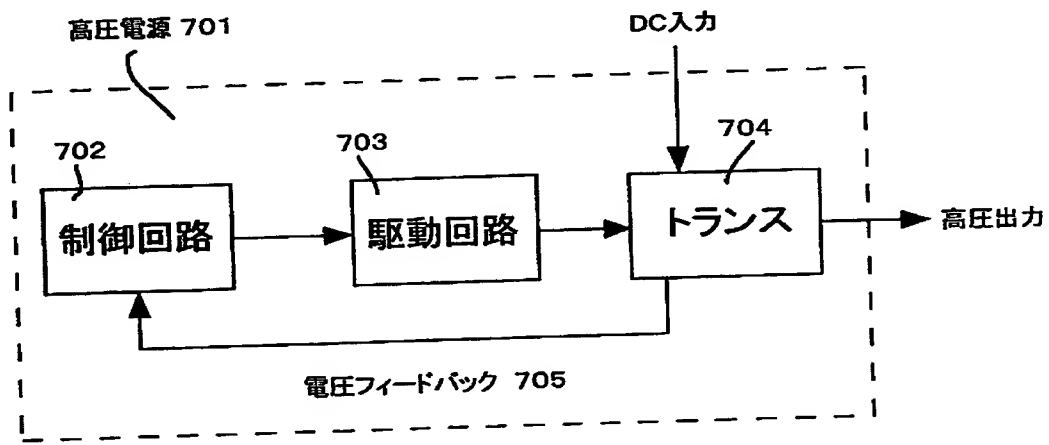
【図 121】



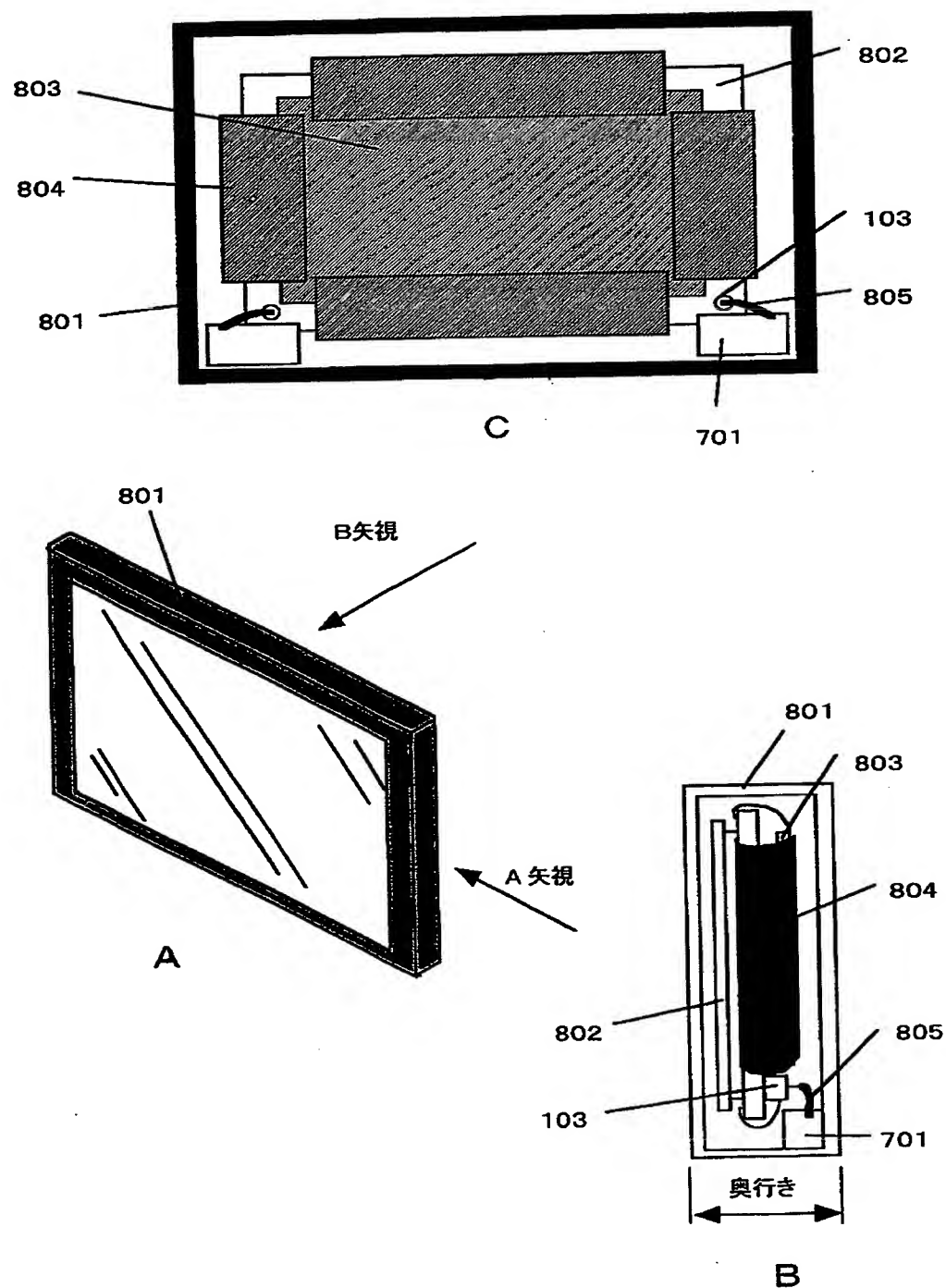
【図 122】



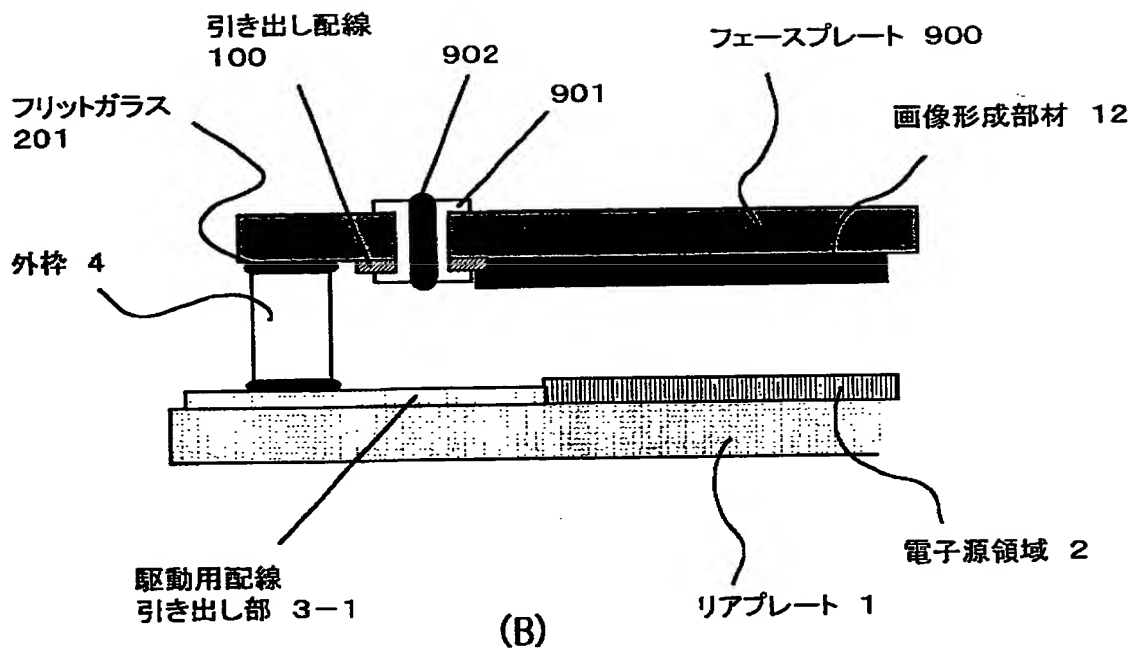
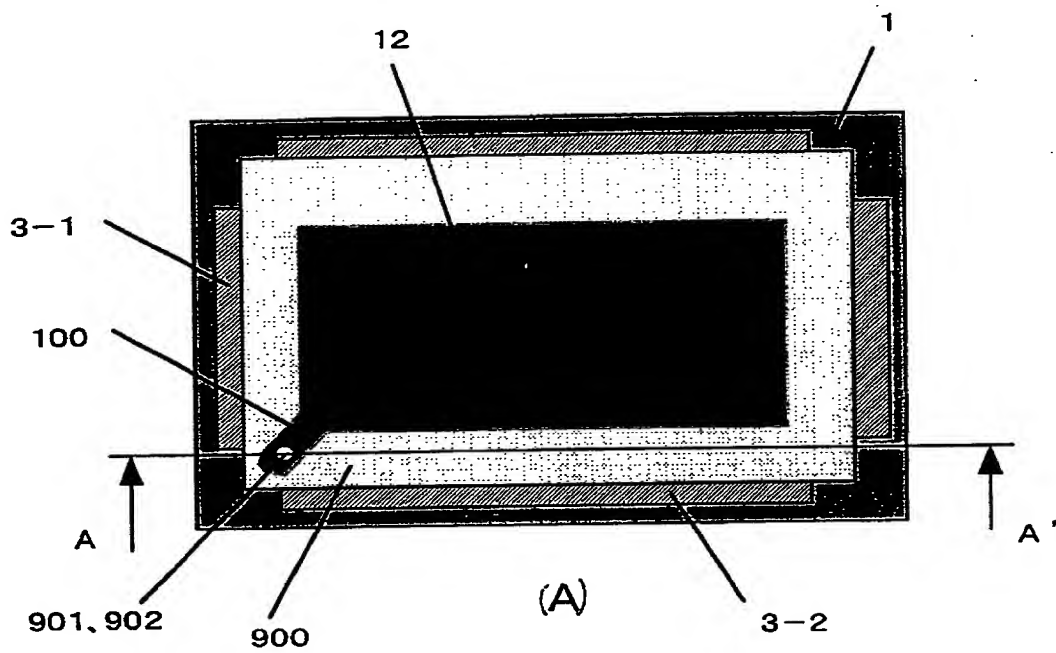
【図 1 2 3】



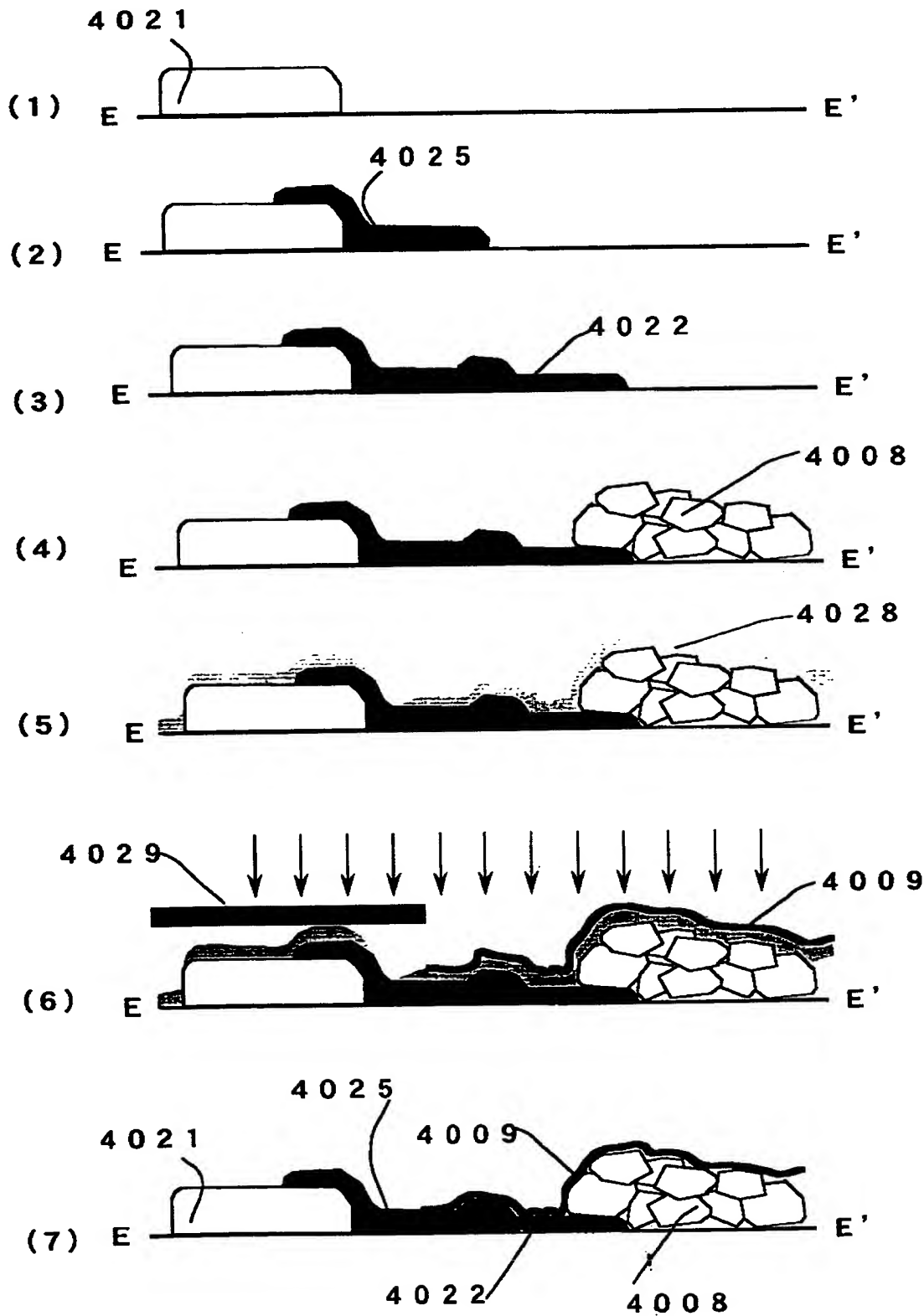
【図 124】



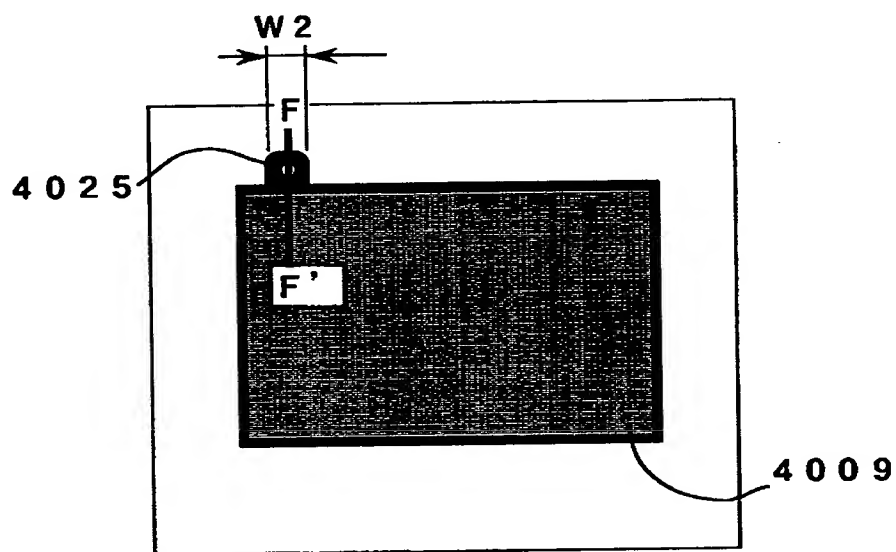
【図 125】



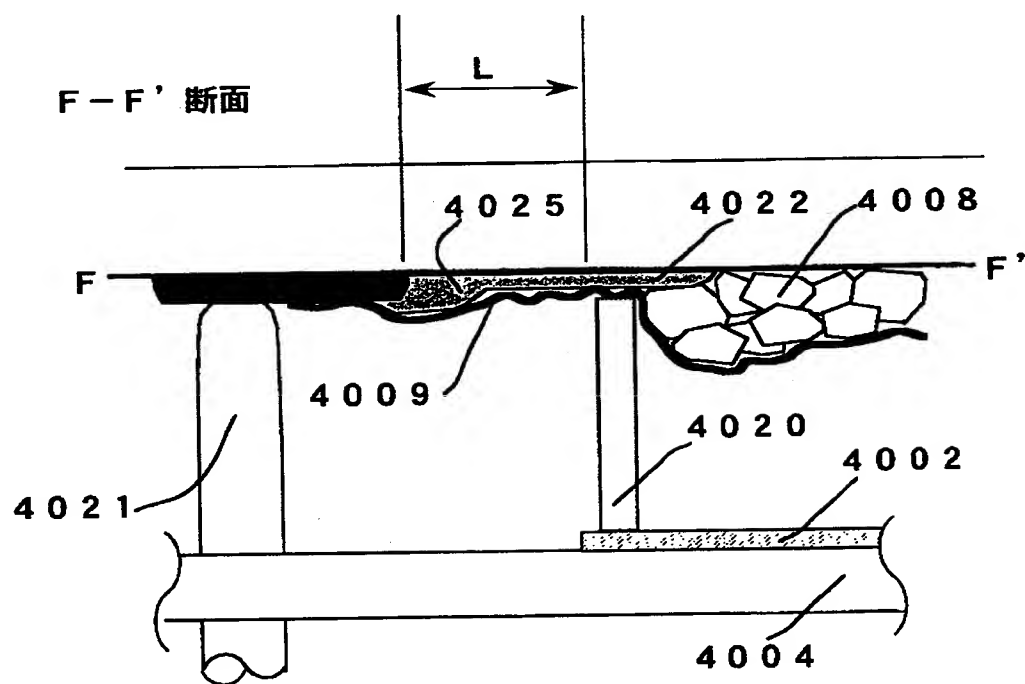
【図 126】



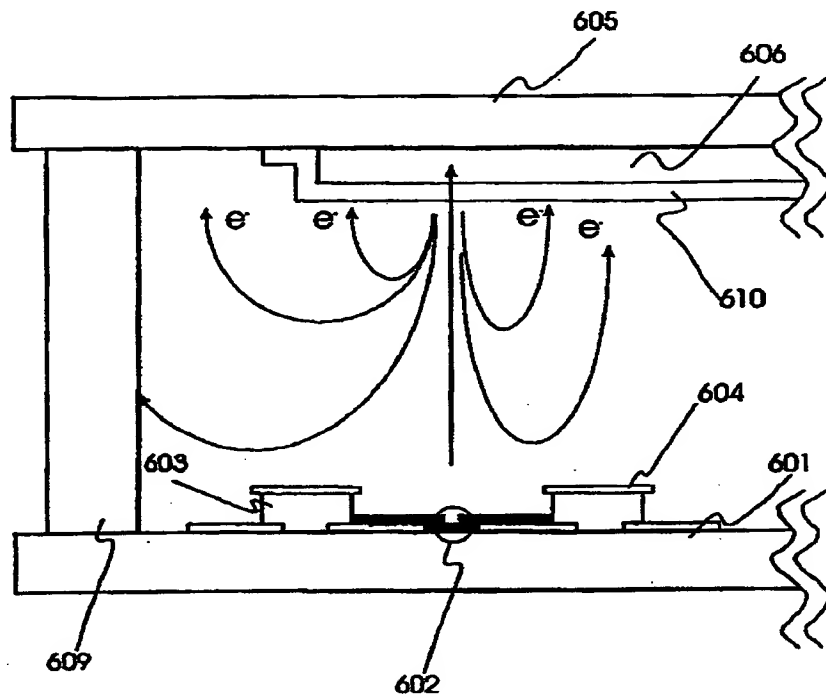
【図 127】



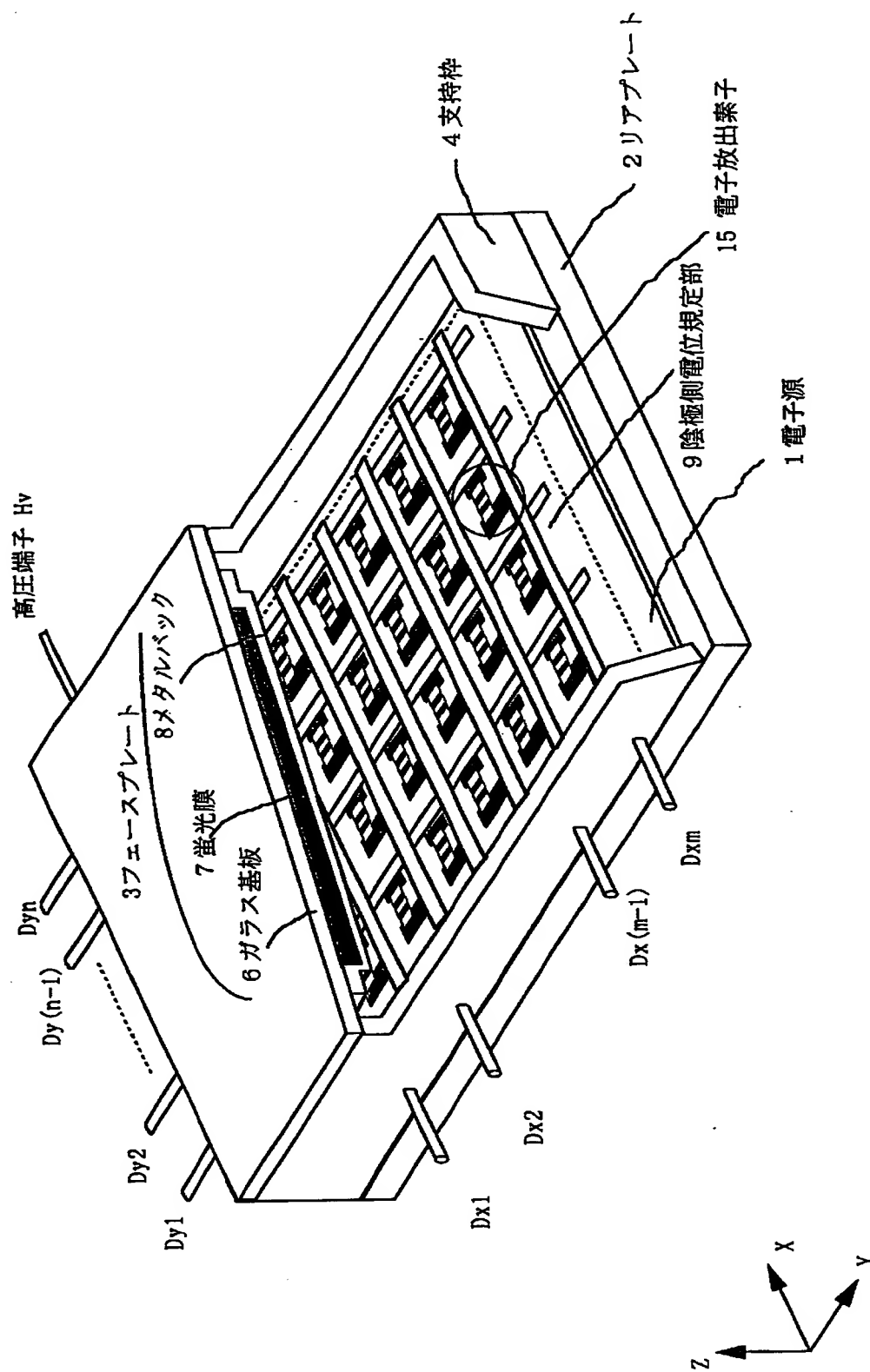
(1)



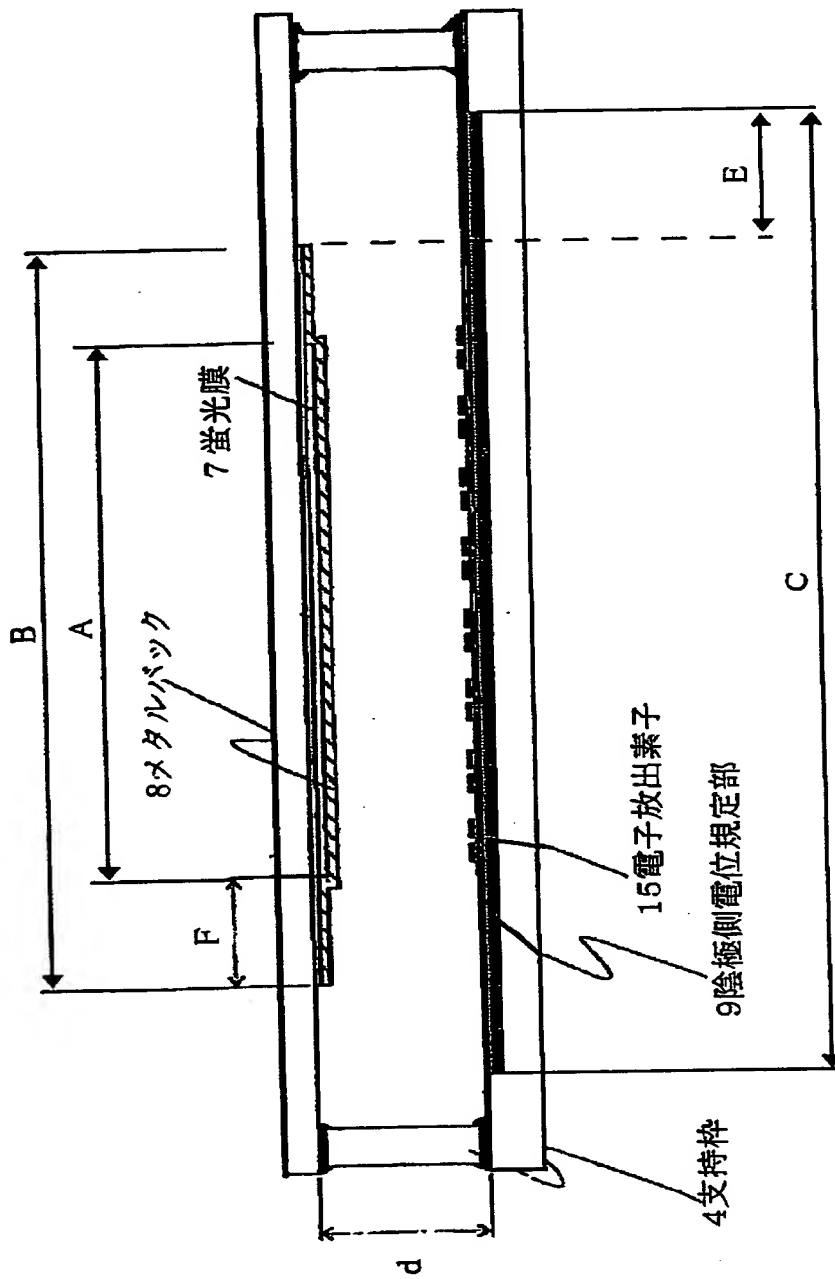
【図128】



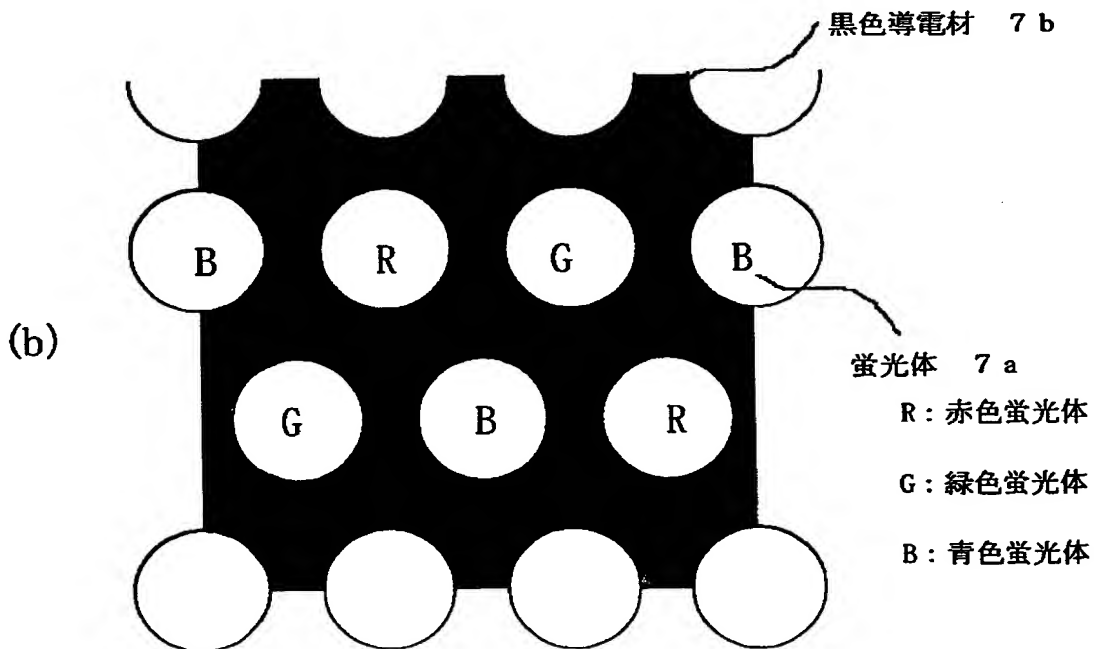
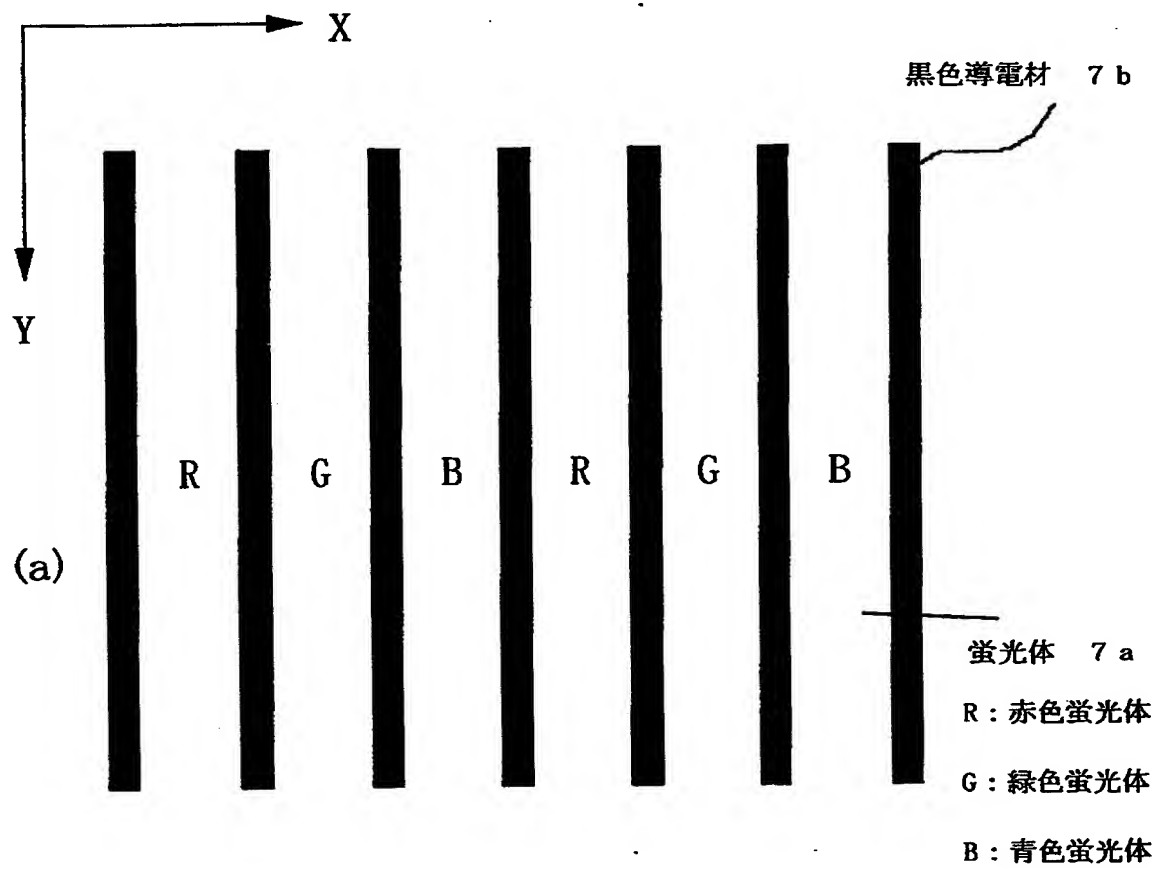
【図 129】



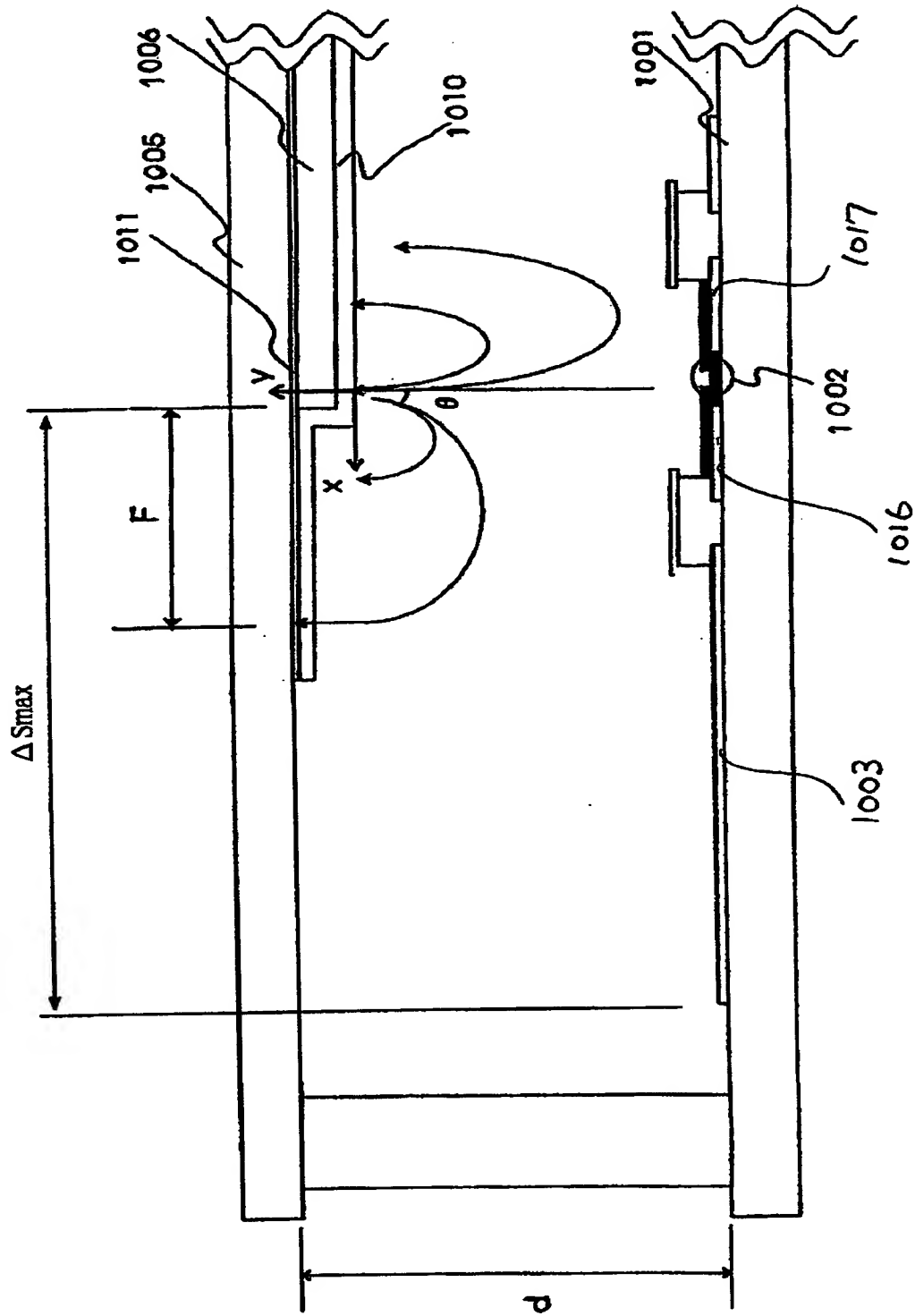
【図130】



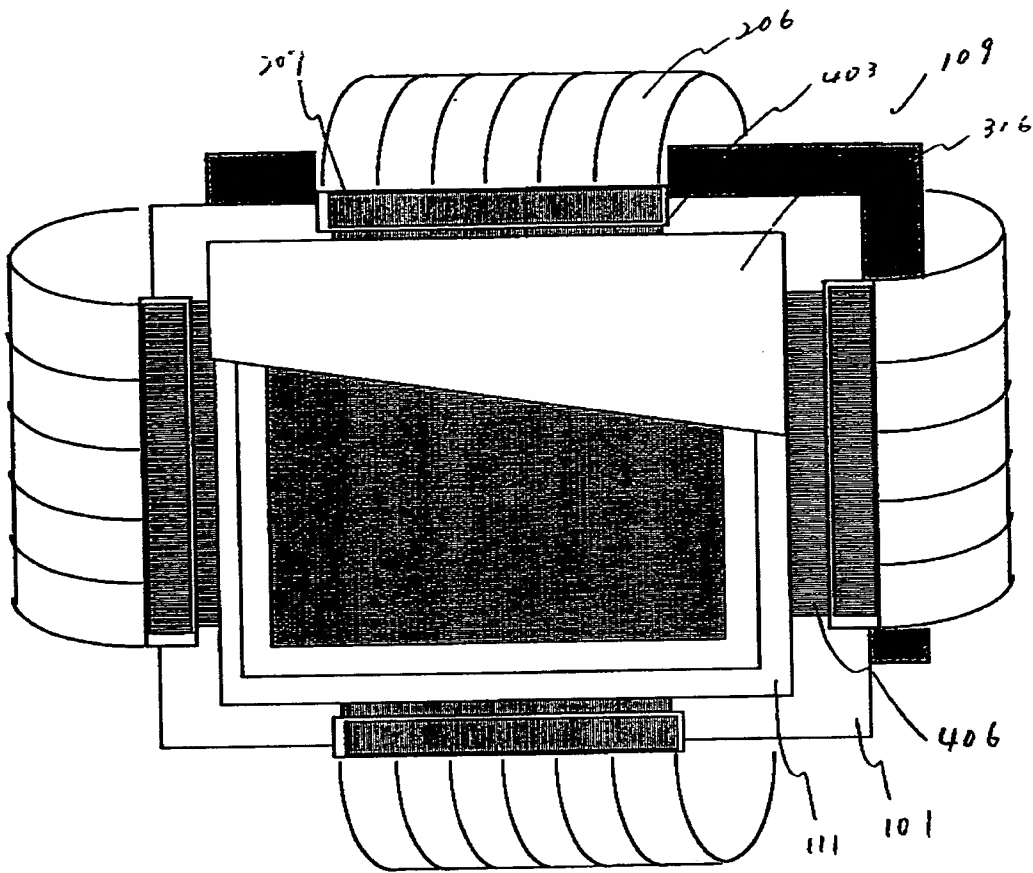
【圖 1 3 1】



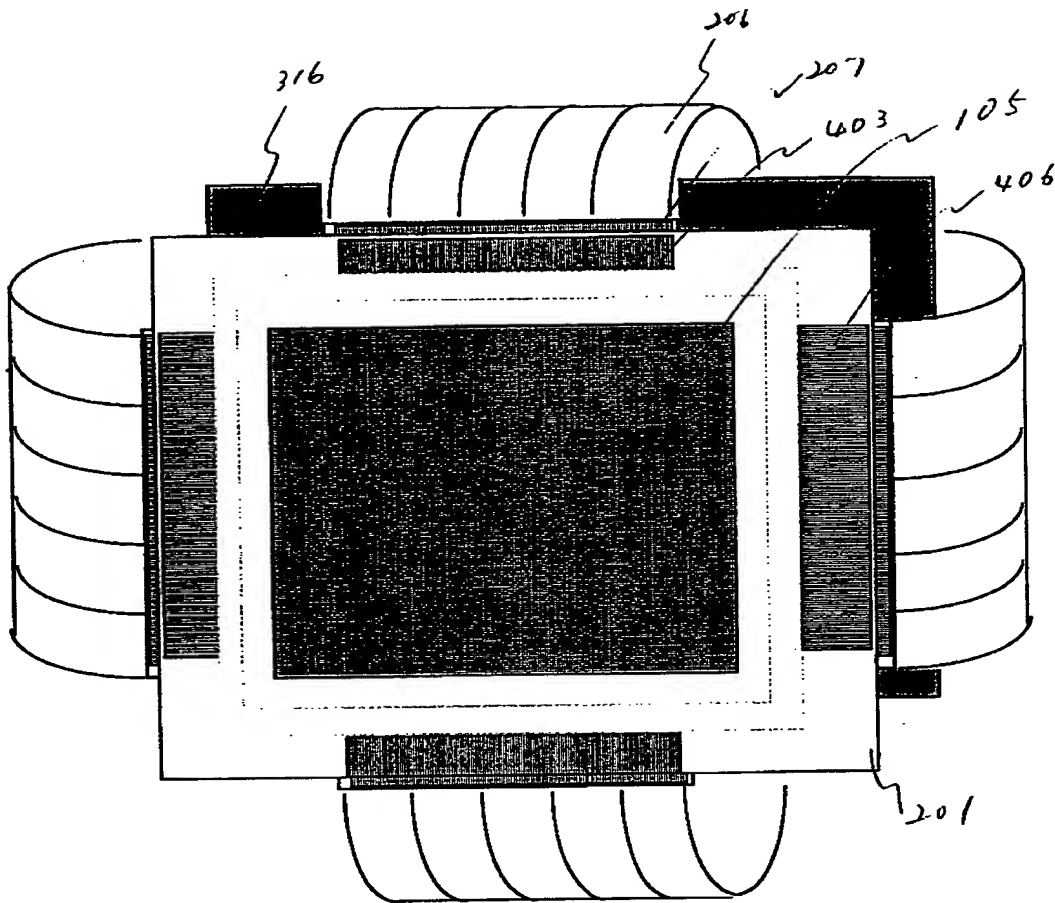
【図 132】



【図133】

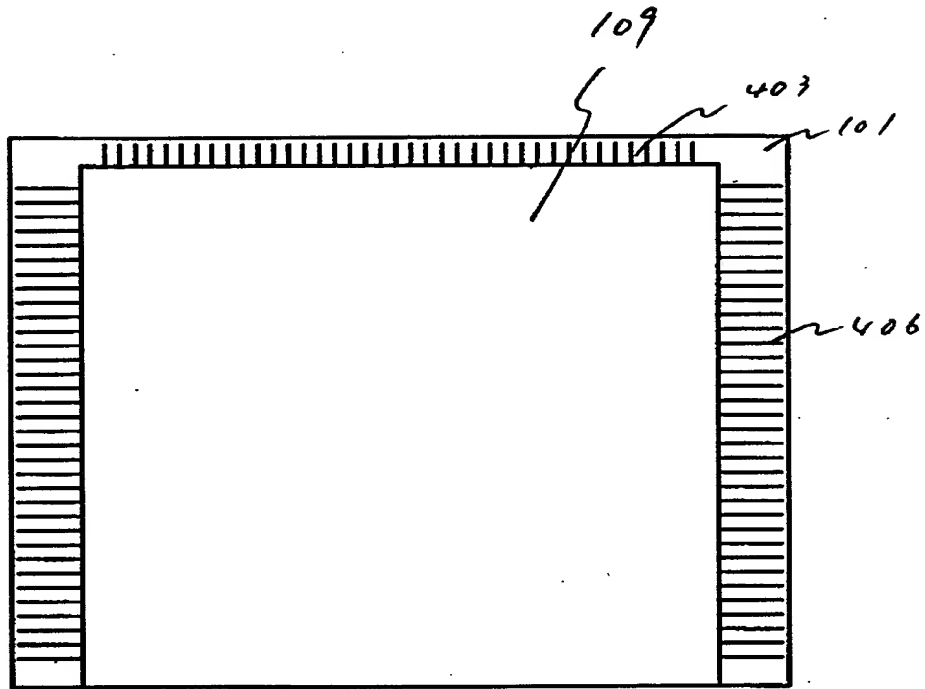


【図134】

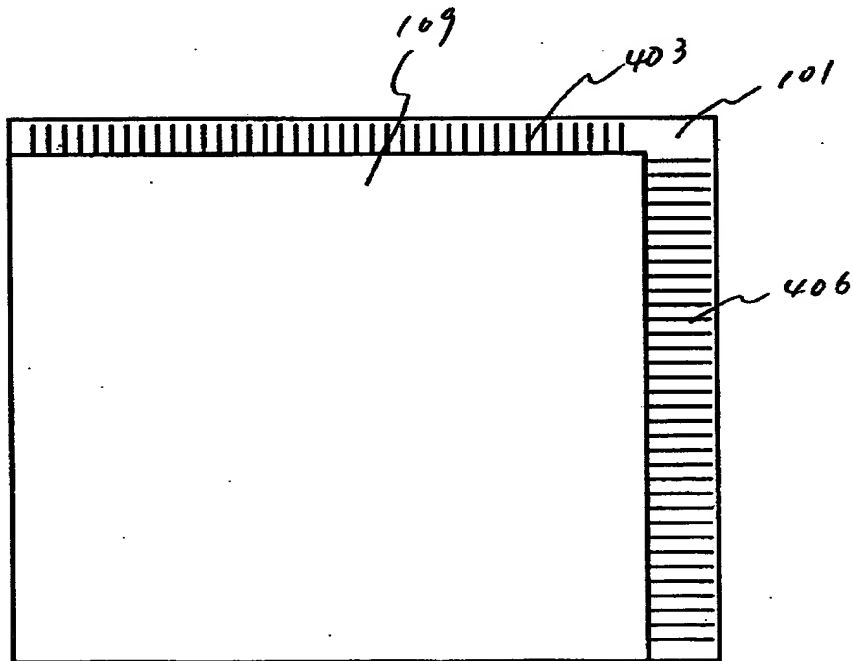


【図135】

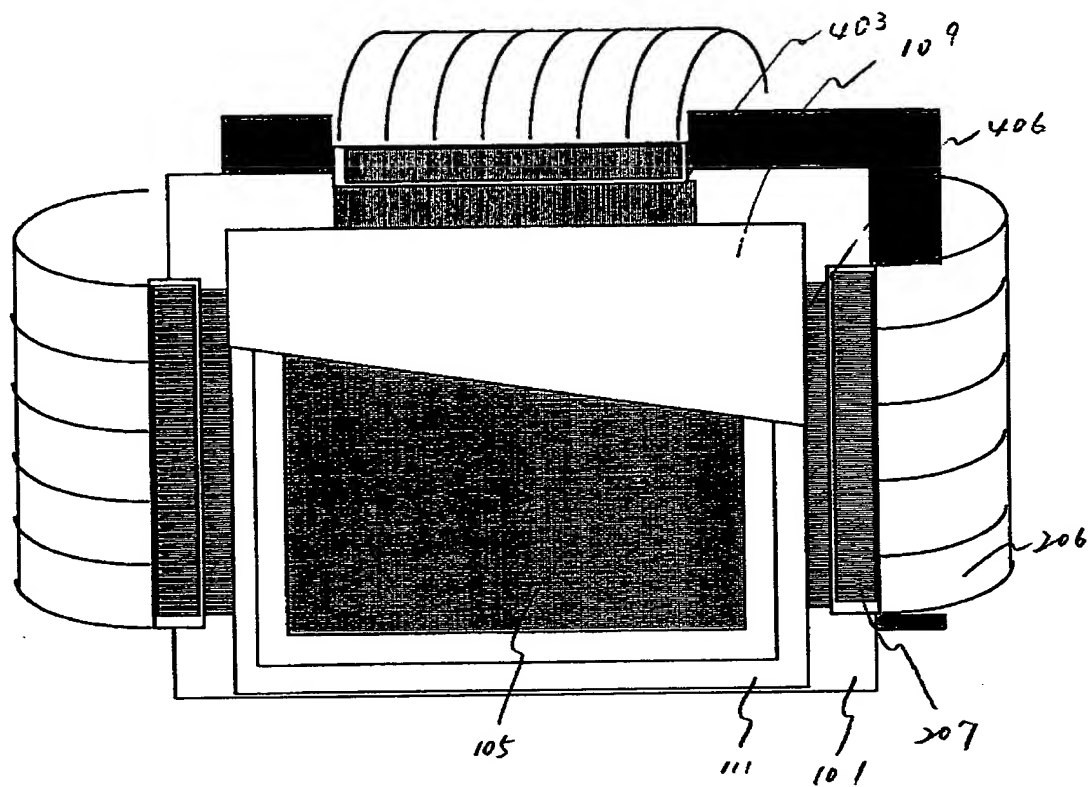
(a)



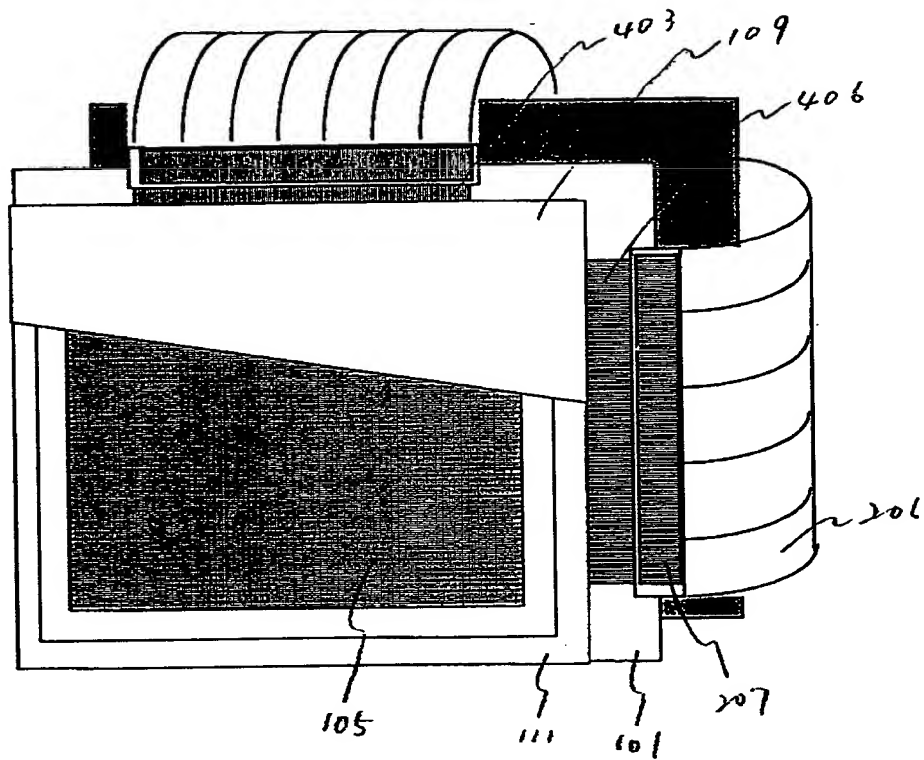
(b)



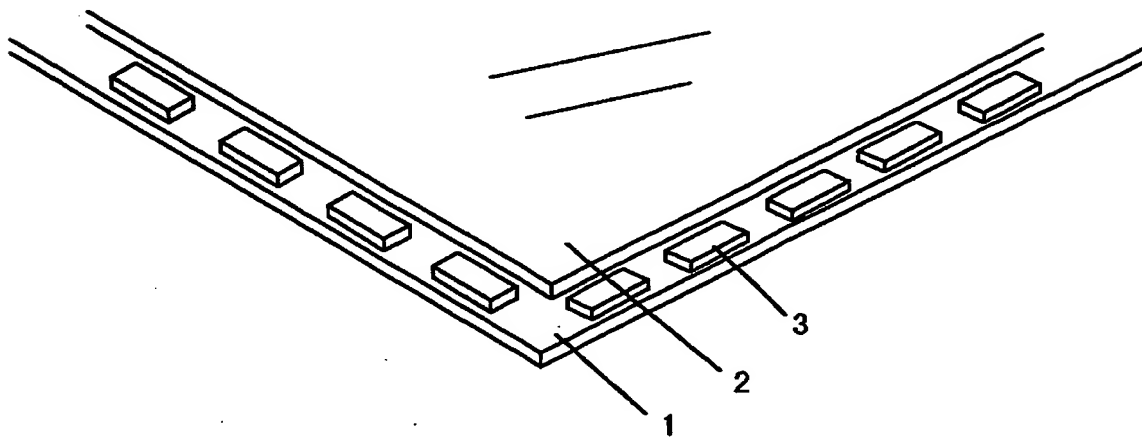
【図 136】



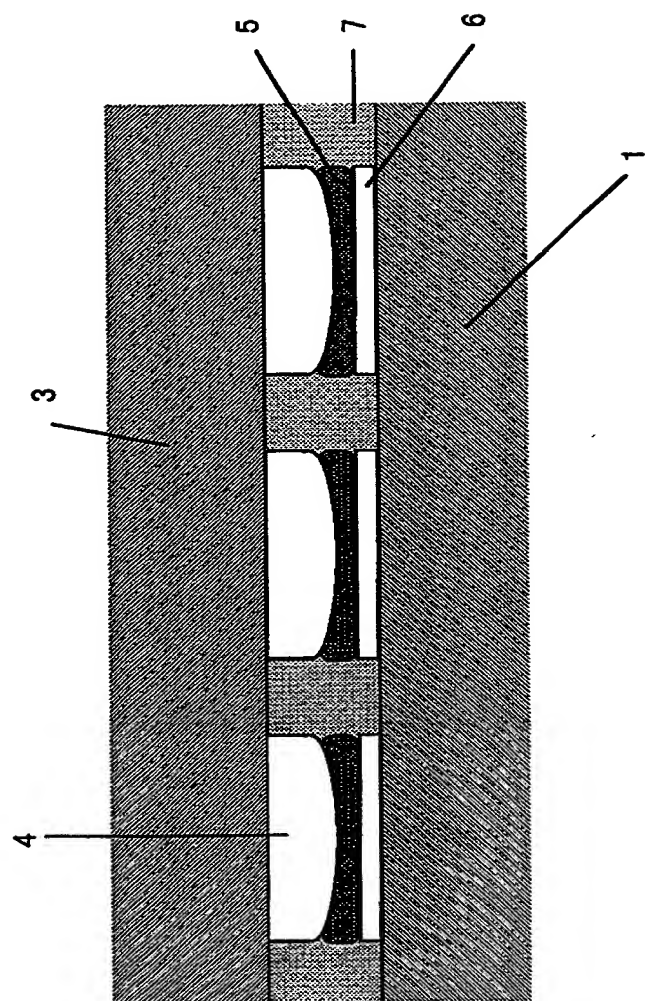
【図137】



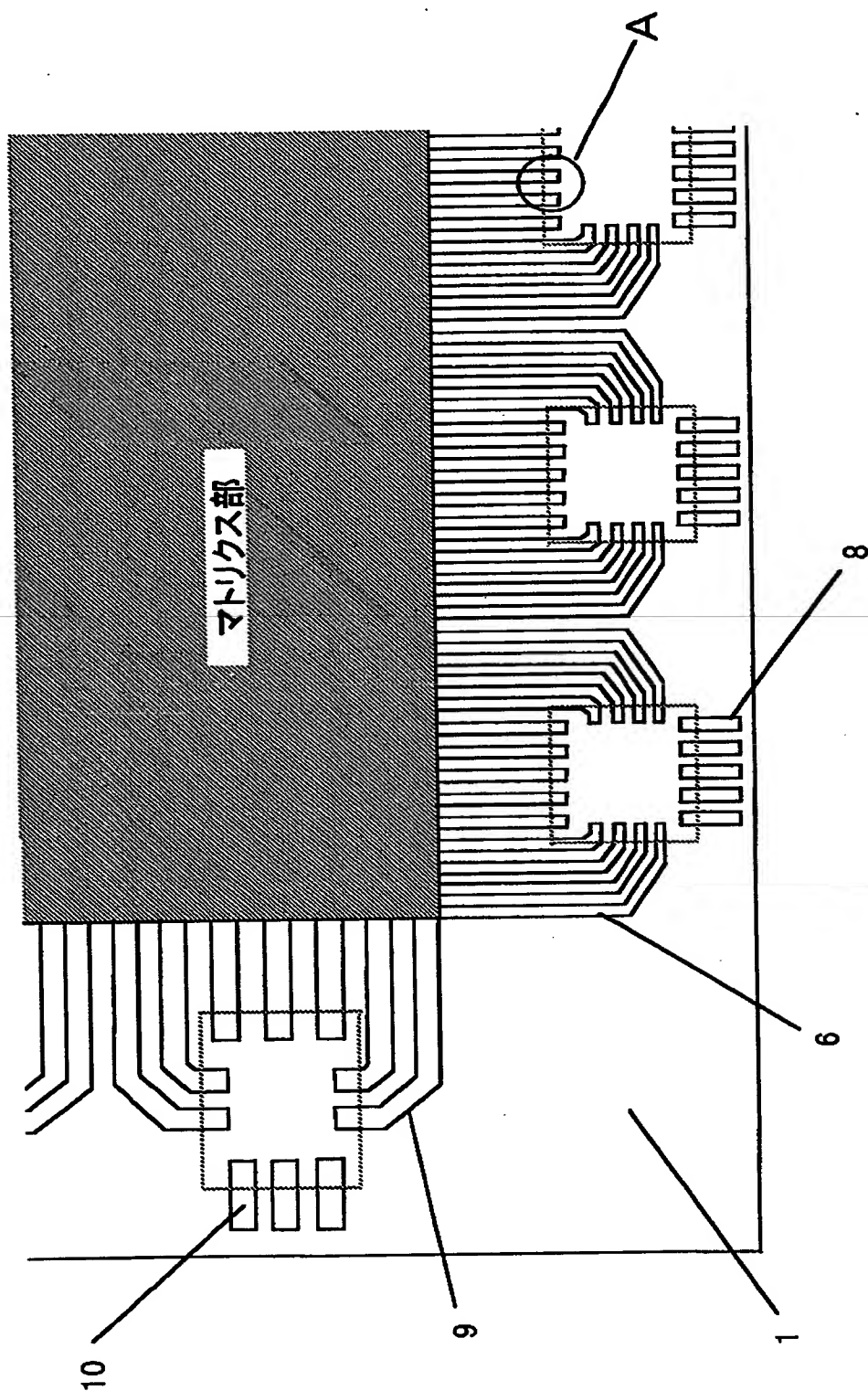
【図138】



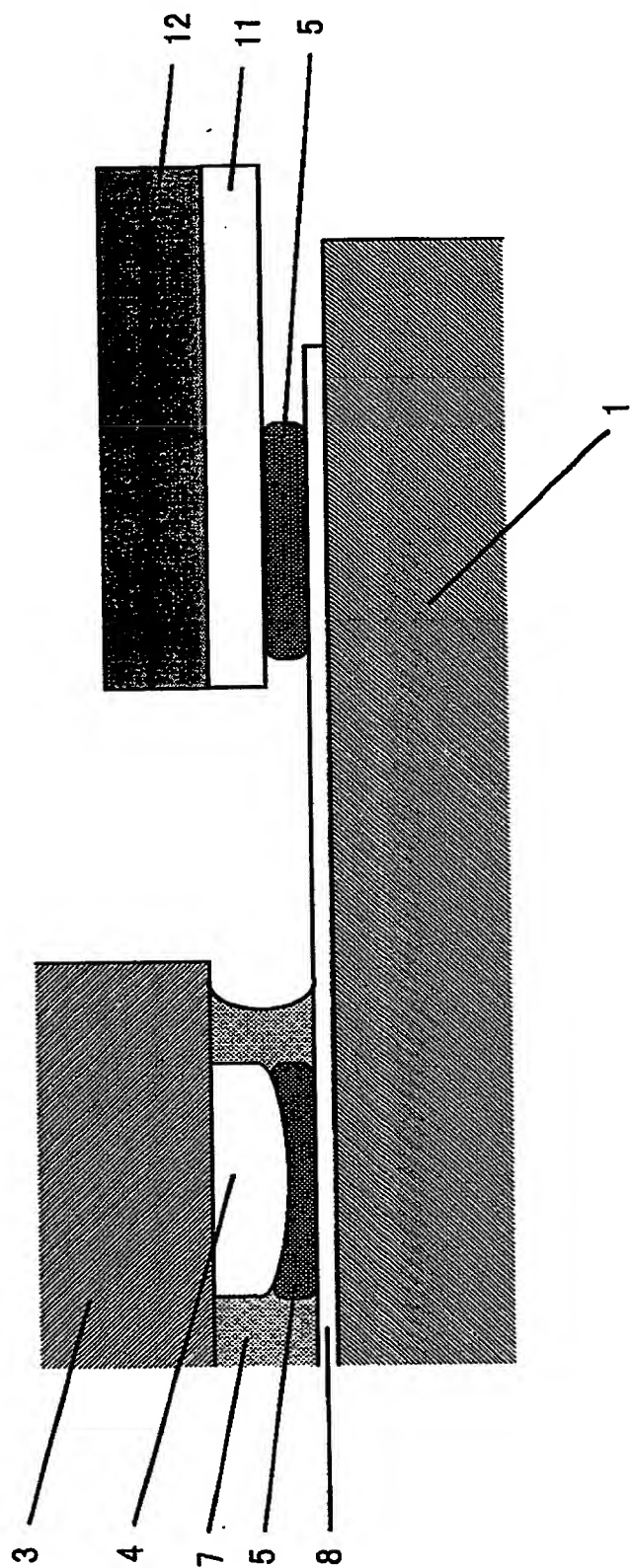
【図 1 3 9】



【図 140】

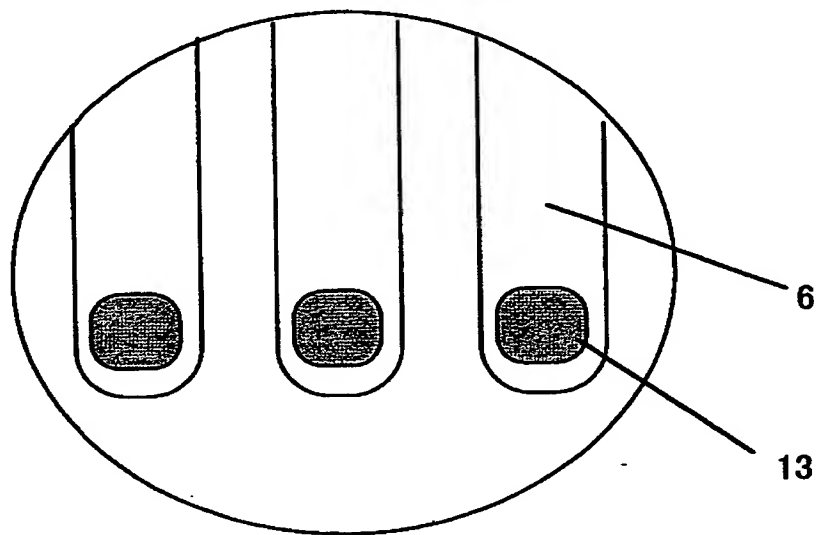


【図 1 4 1】

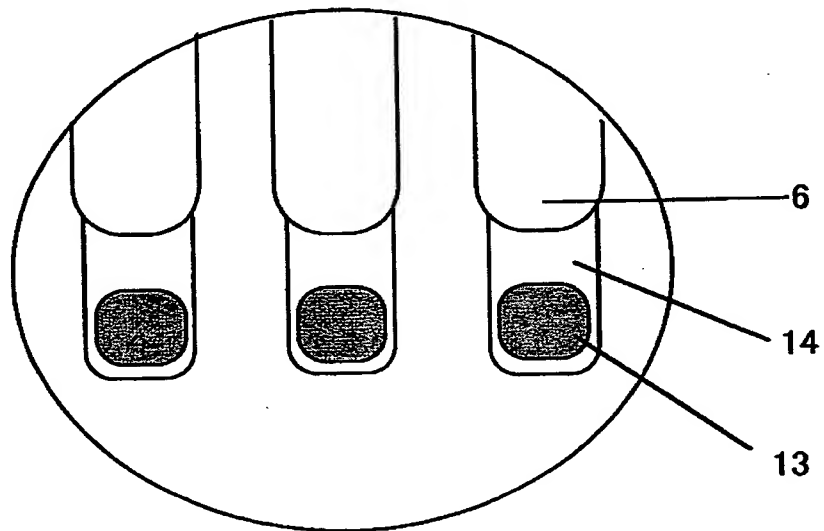


【図 1 4 2】

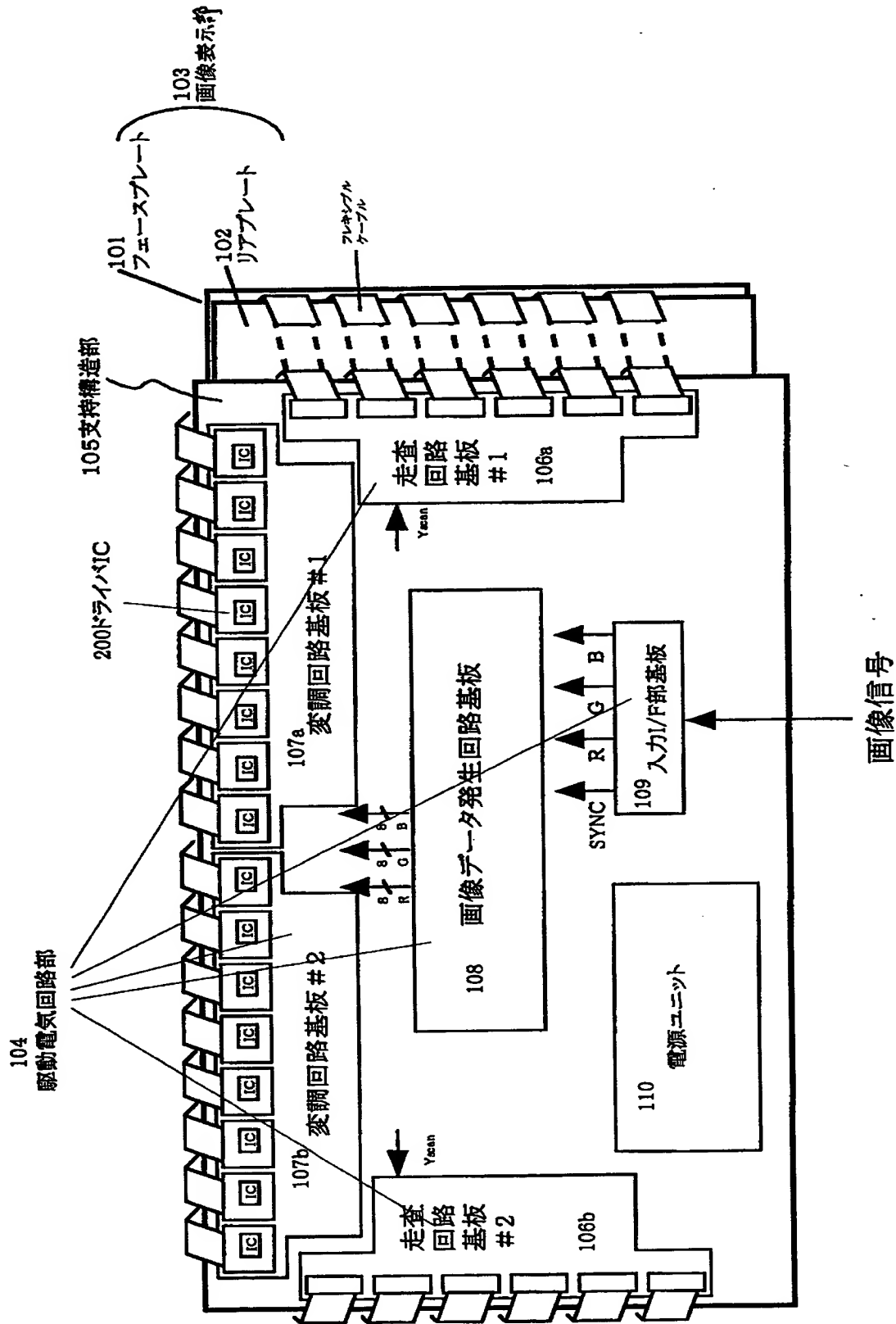
a)



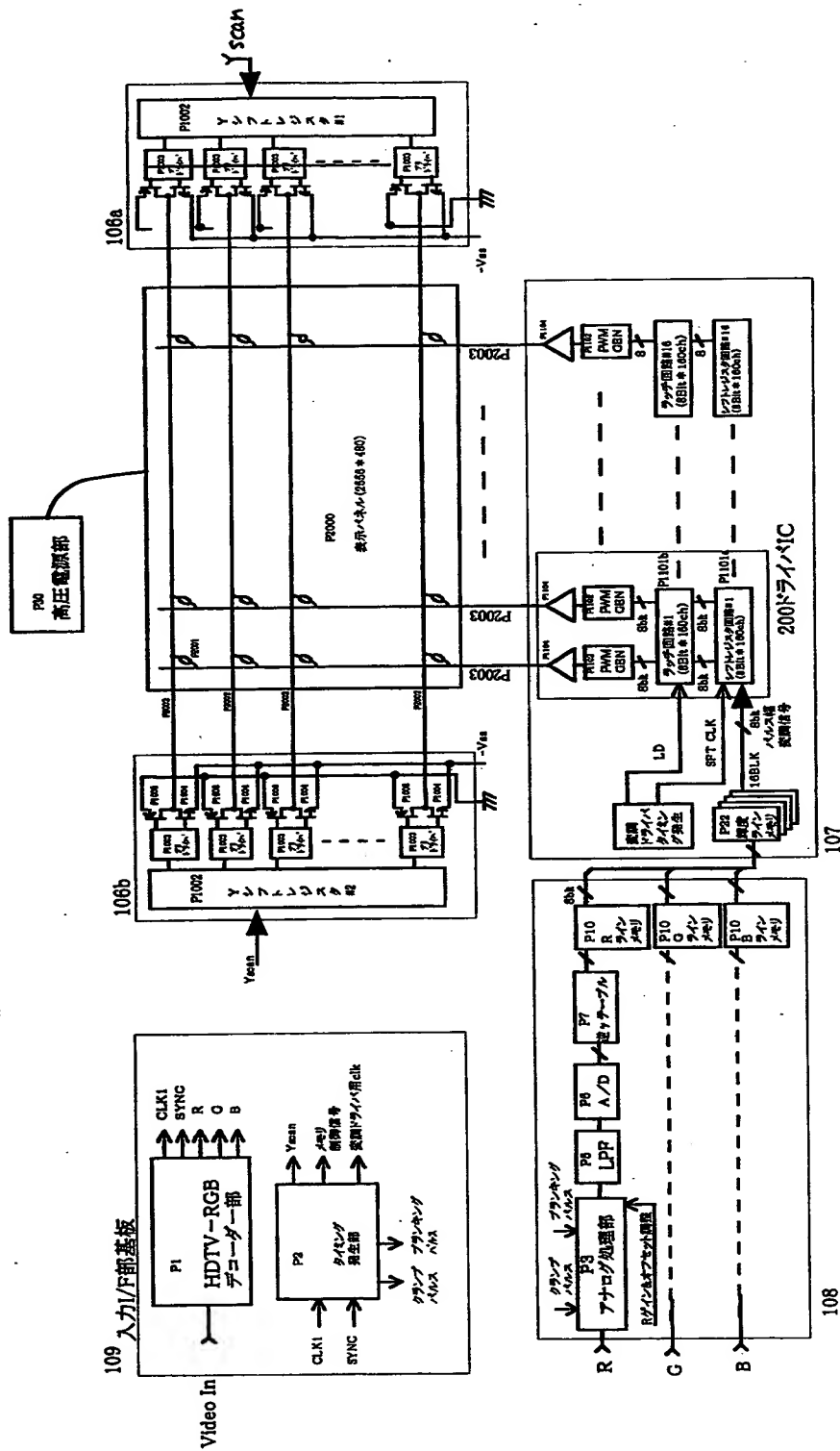
b)



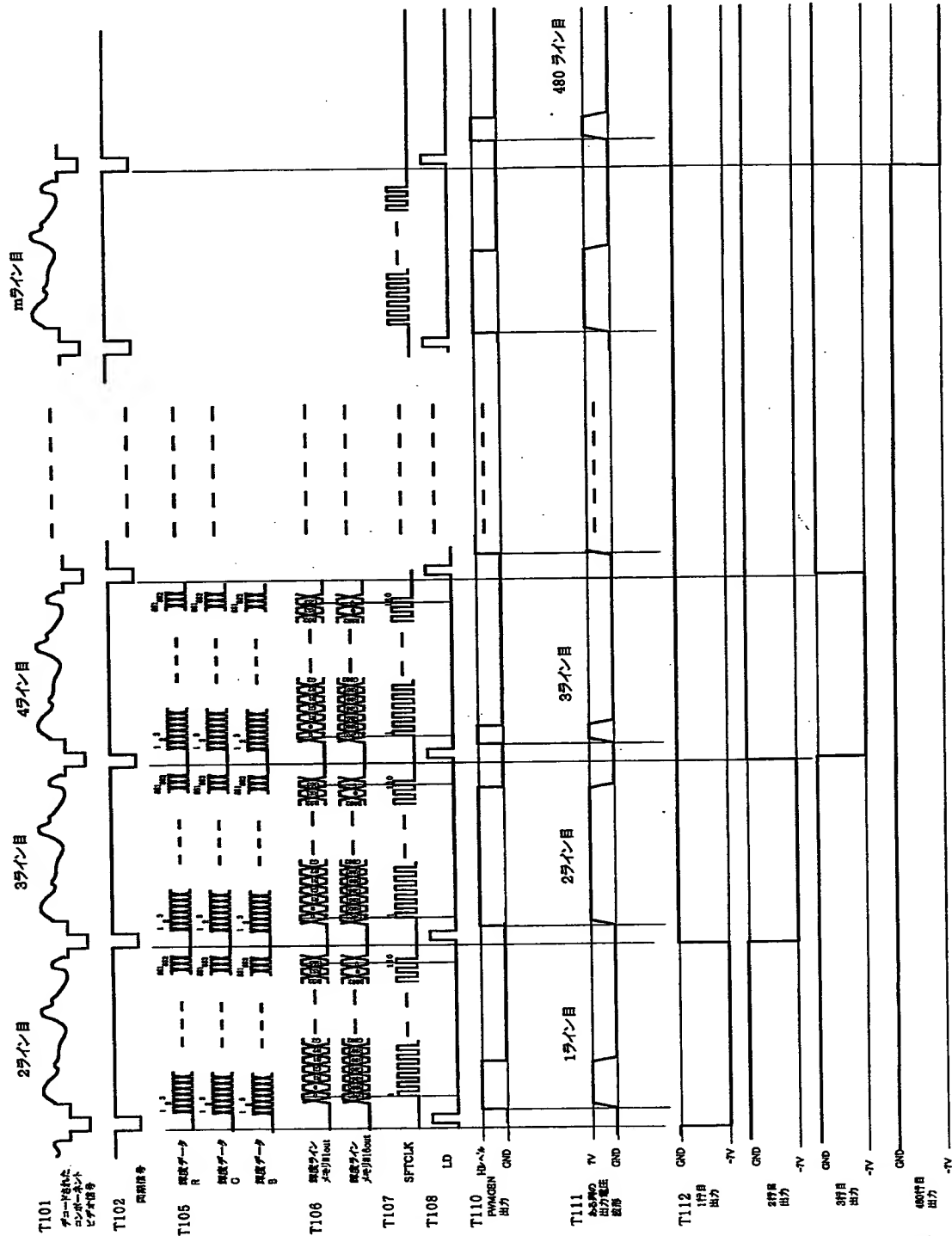
【図 143】



【図 1 4 4】

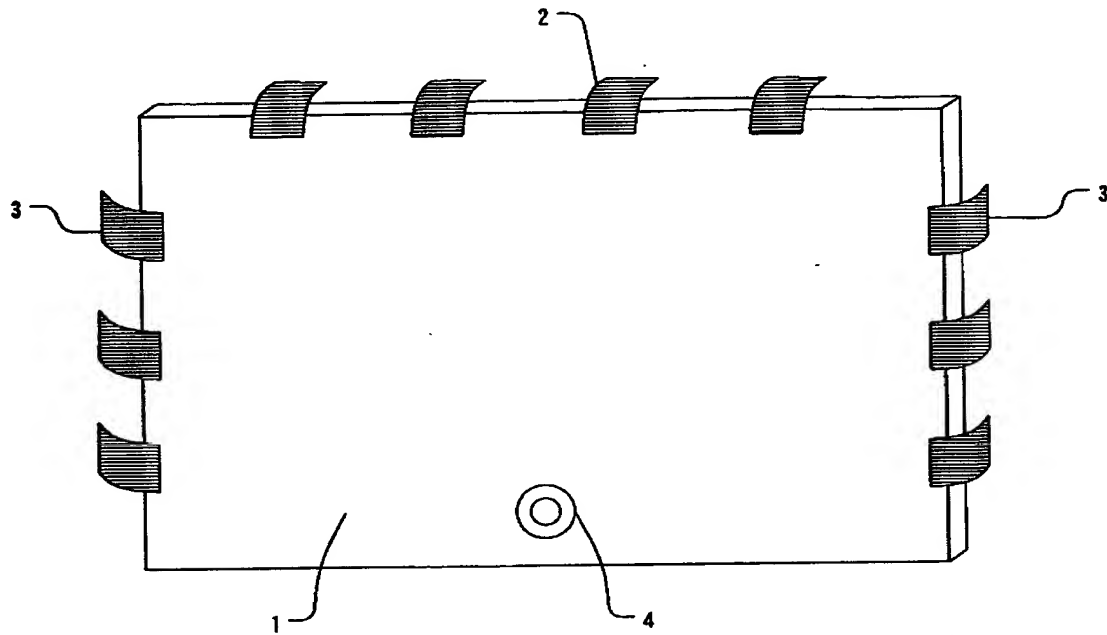


【図 145】

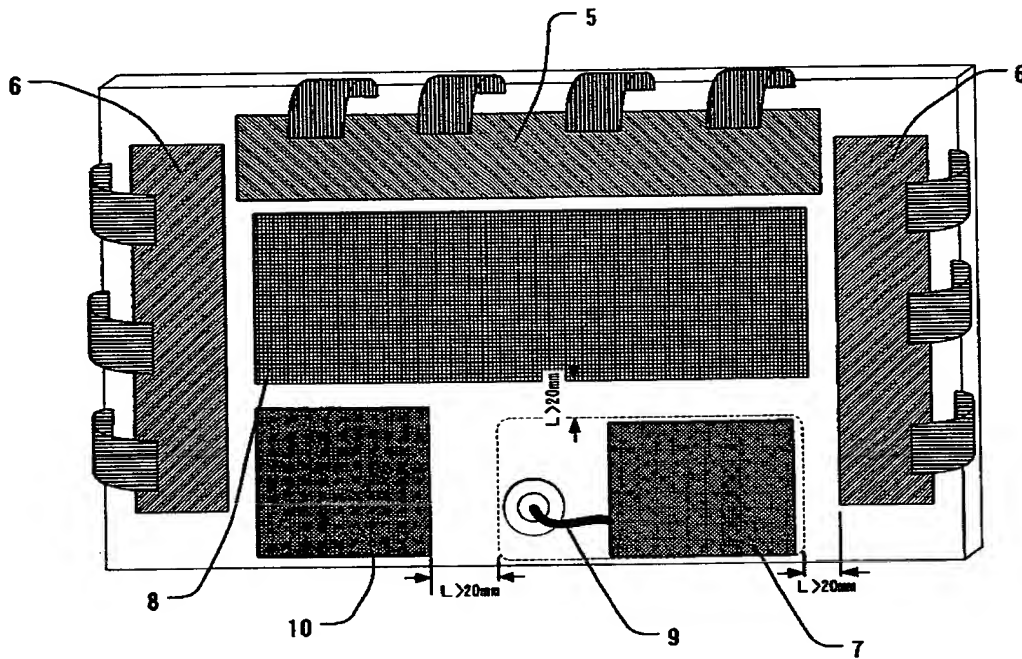


20

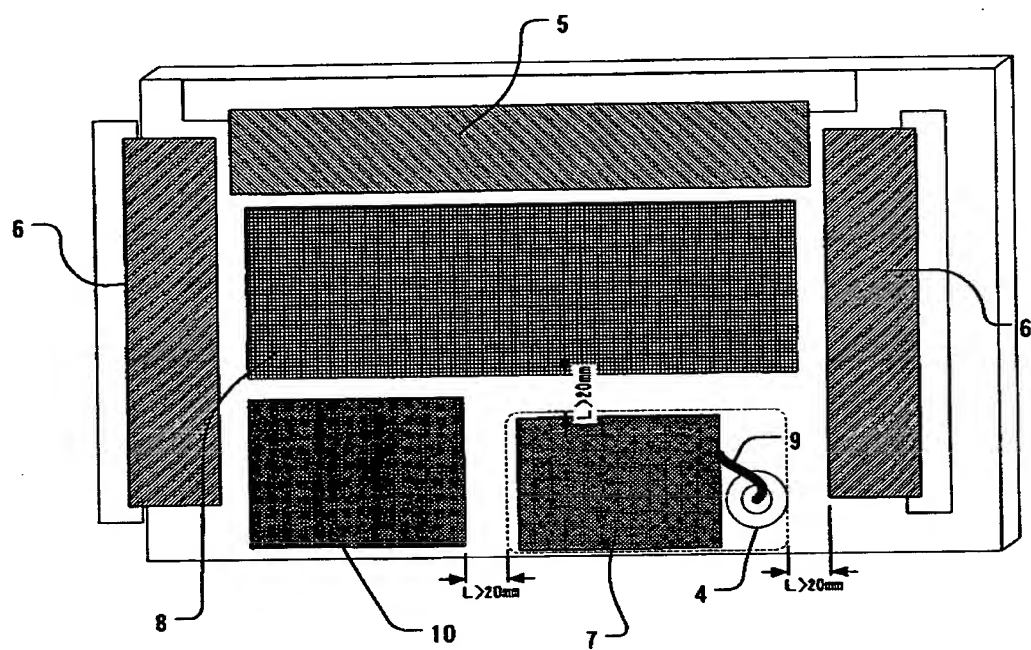
【図 146】



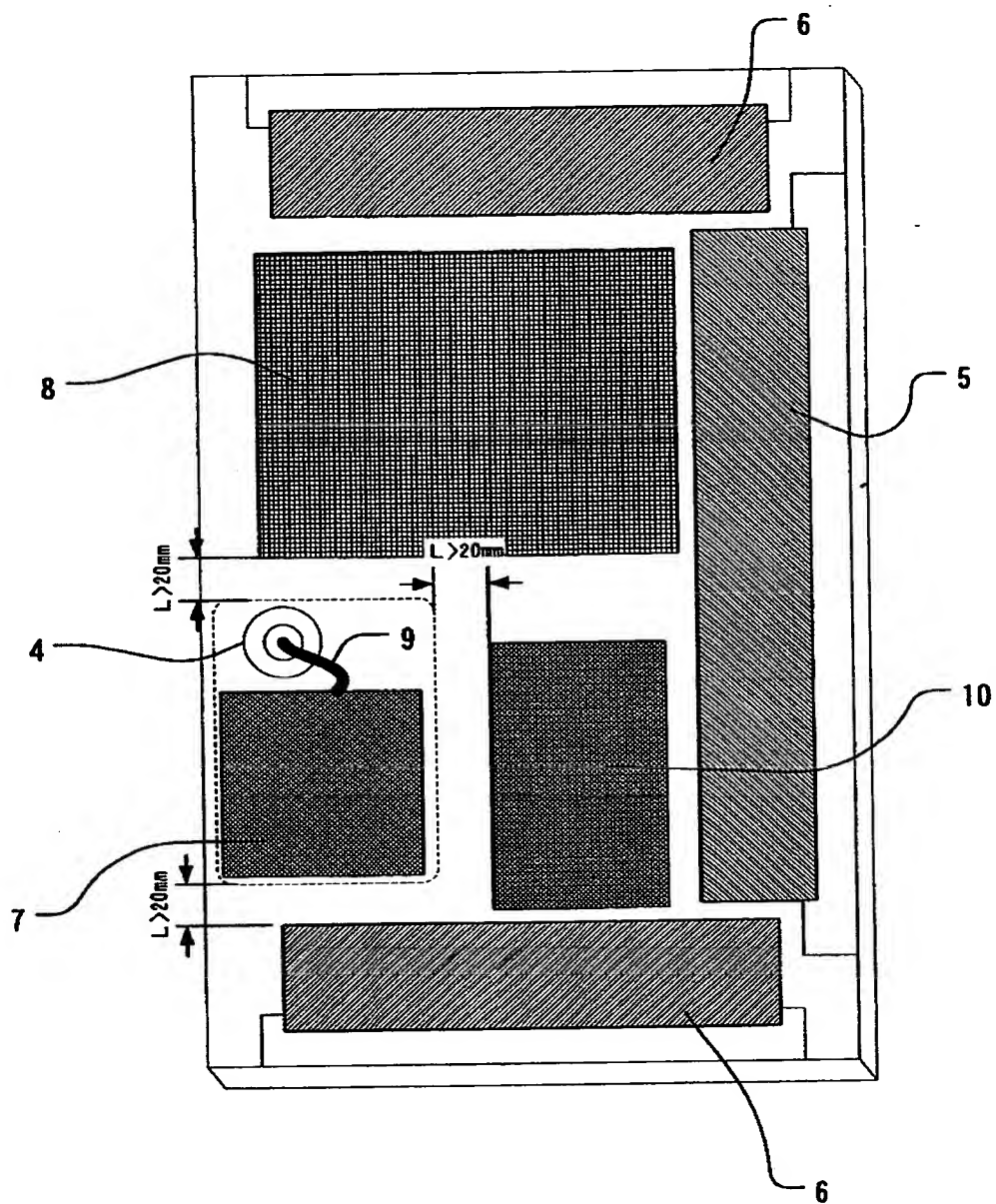
【図 147】



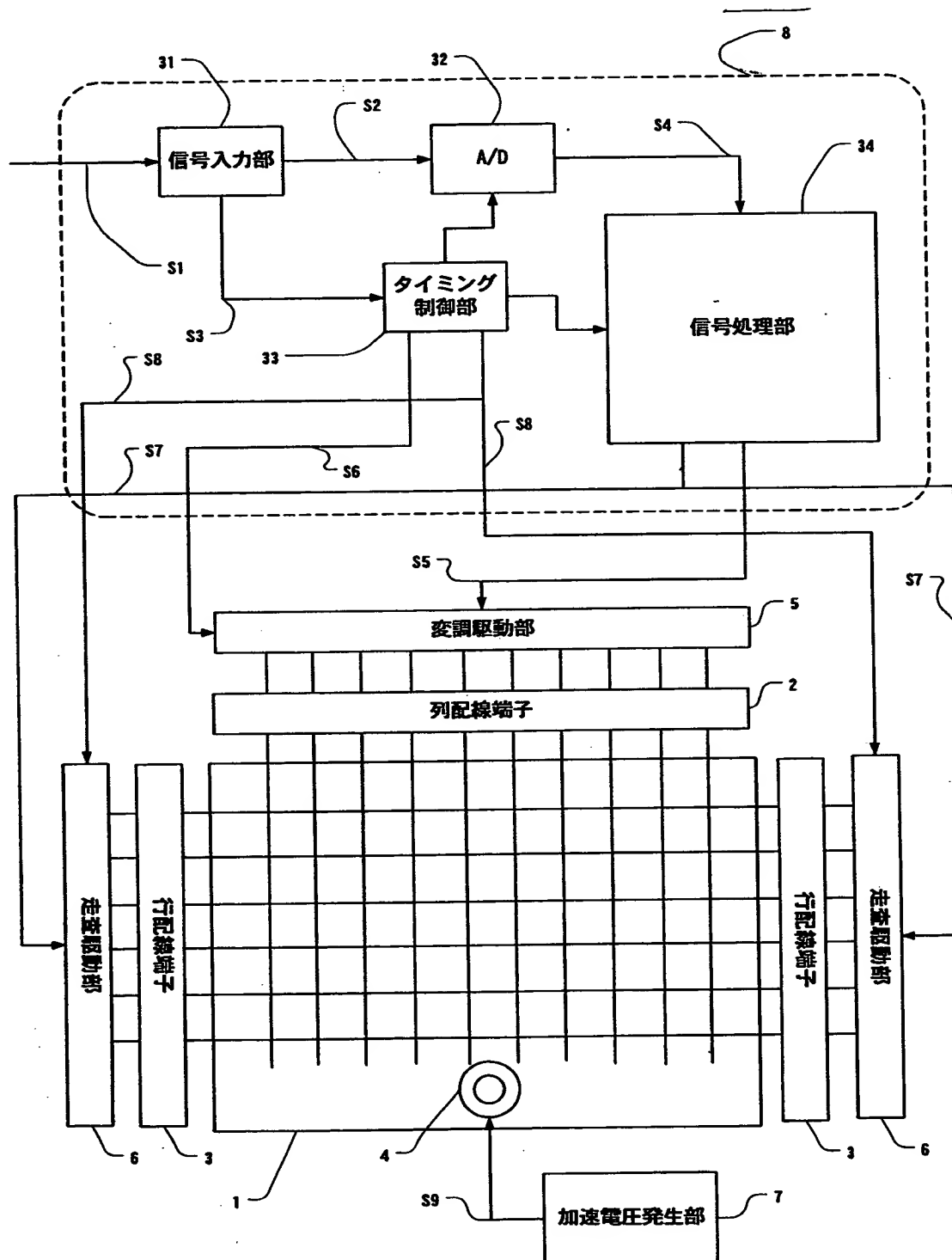
【図 1 4 8】



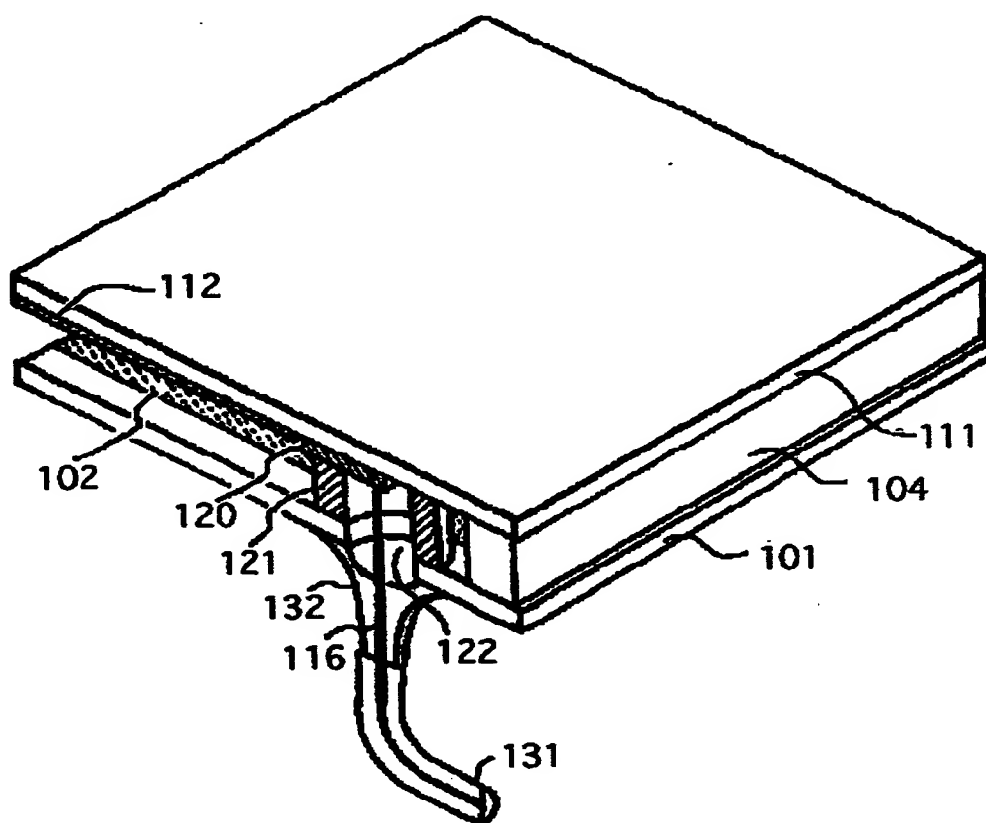
【図 149】



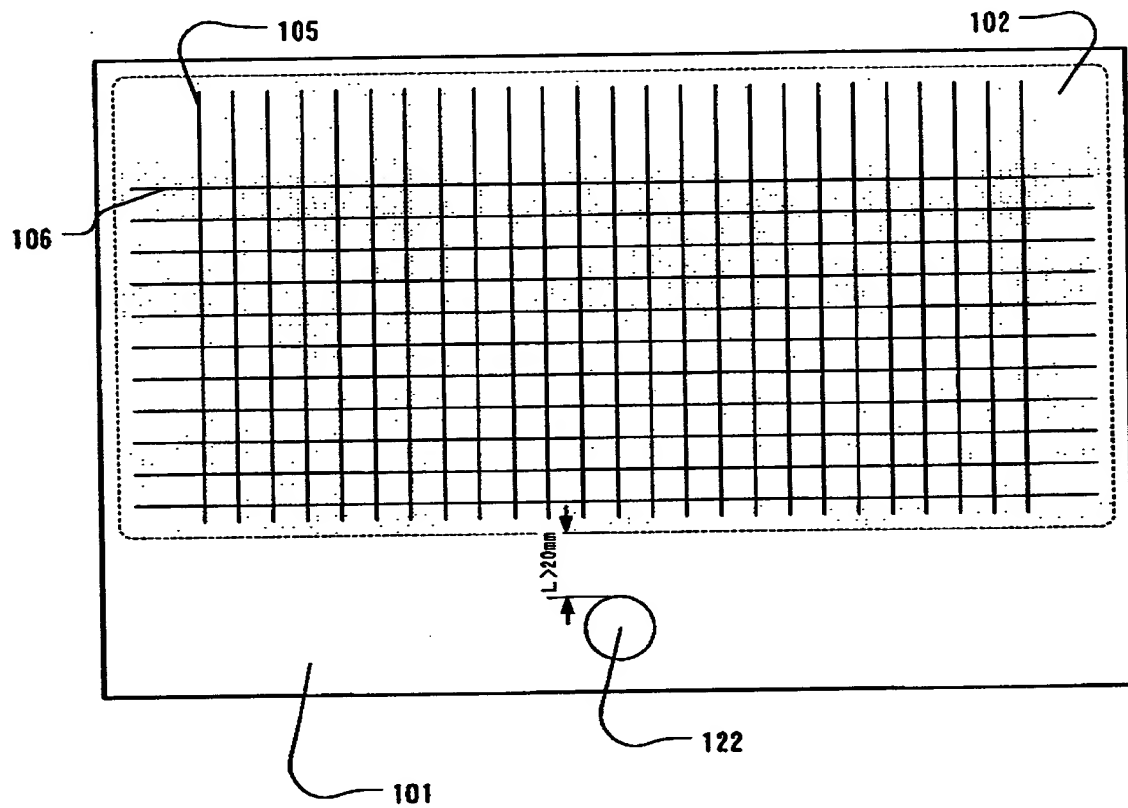
【図 150】



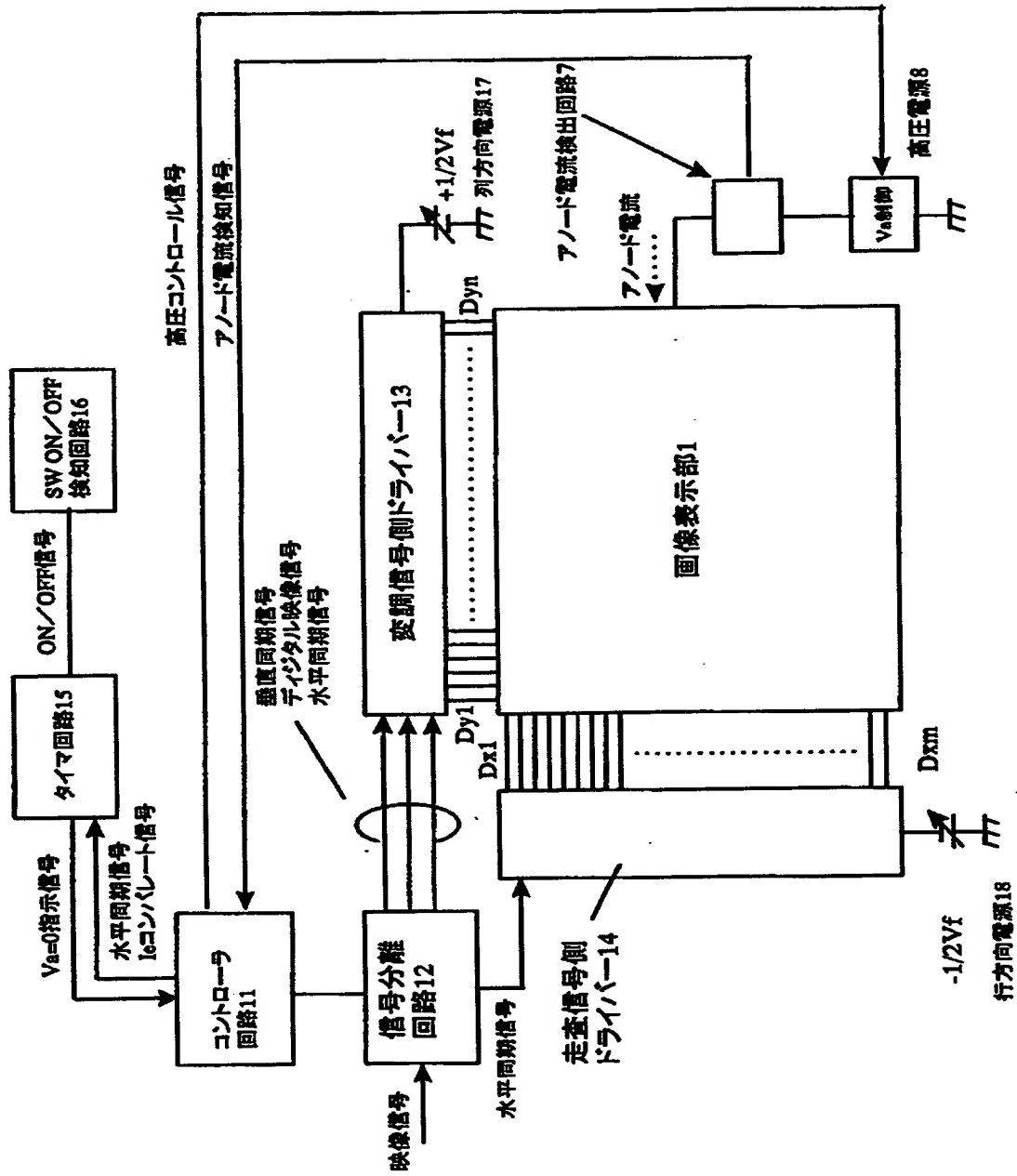
【図 1 5 1】



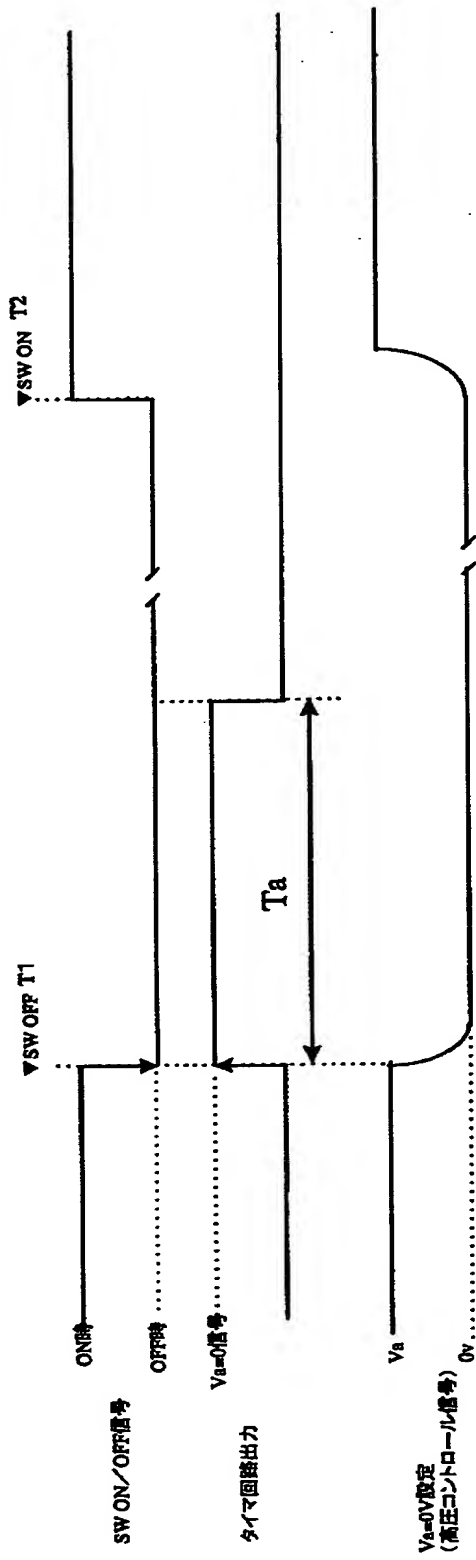
【図 1 5 2】



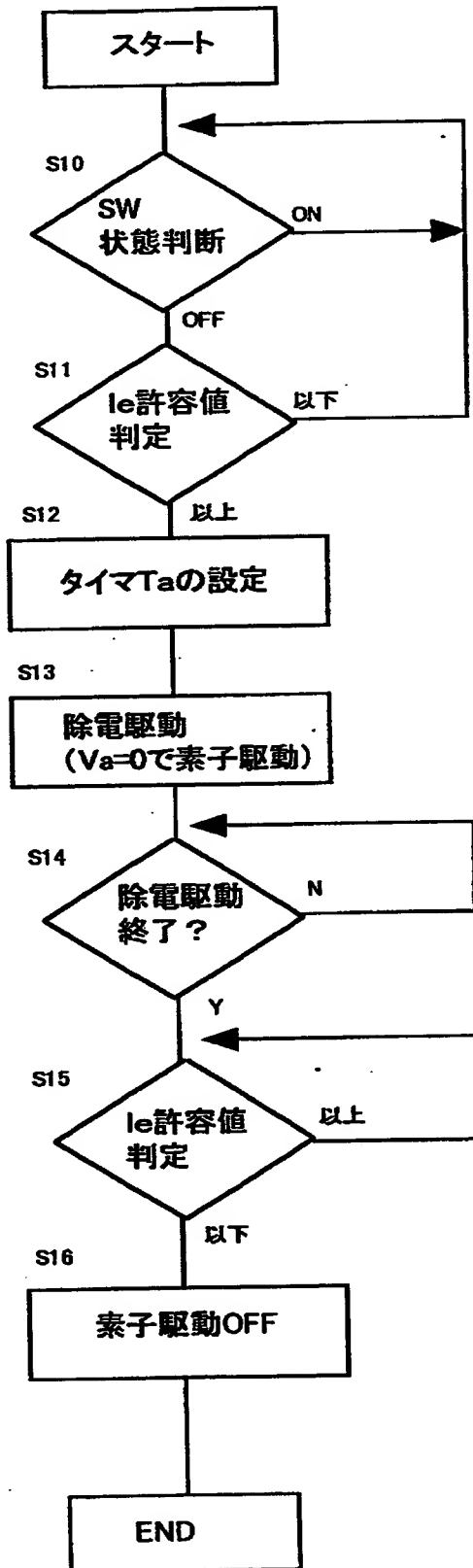
【図 1 5 3】



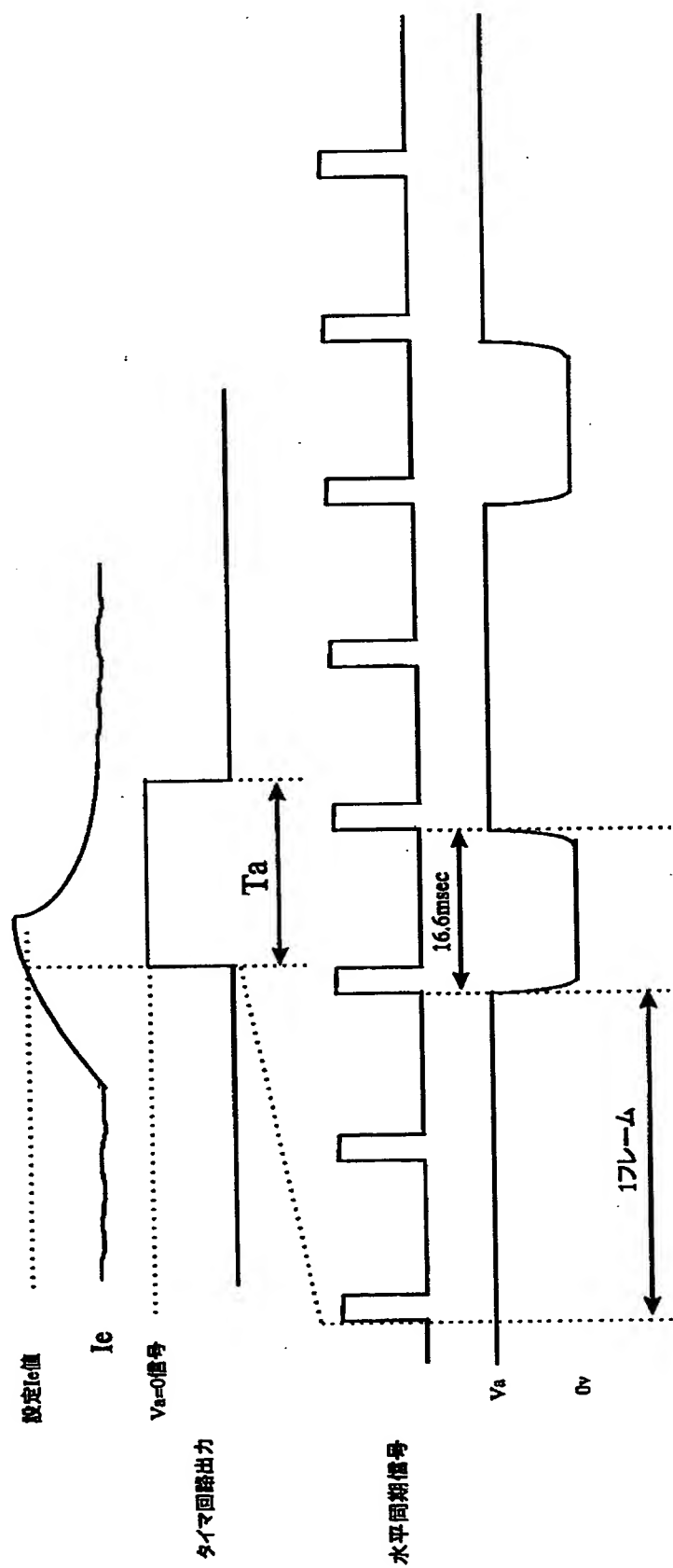
【図 1 5 4】



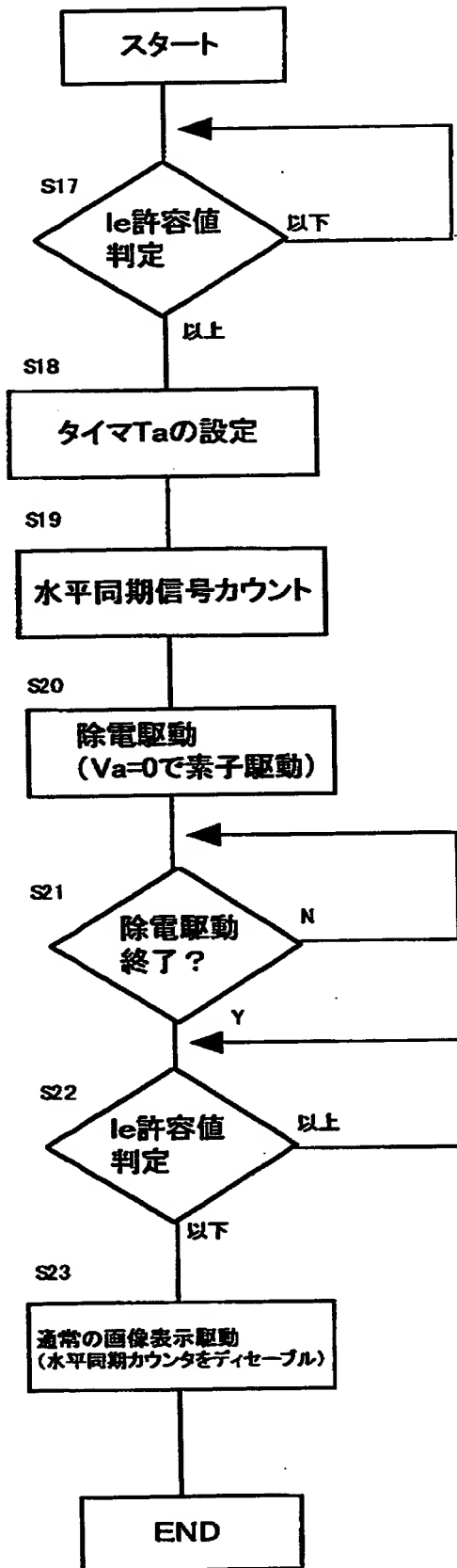
【図 1 5 5】



【図 156】

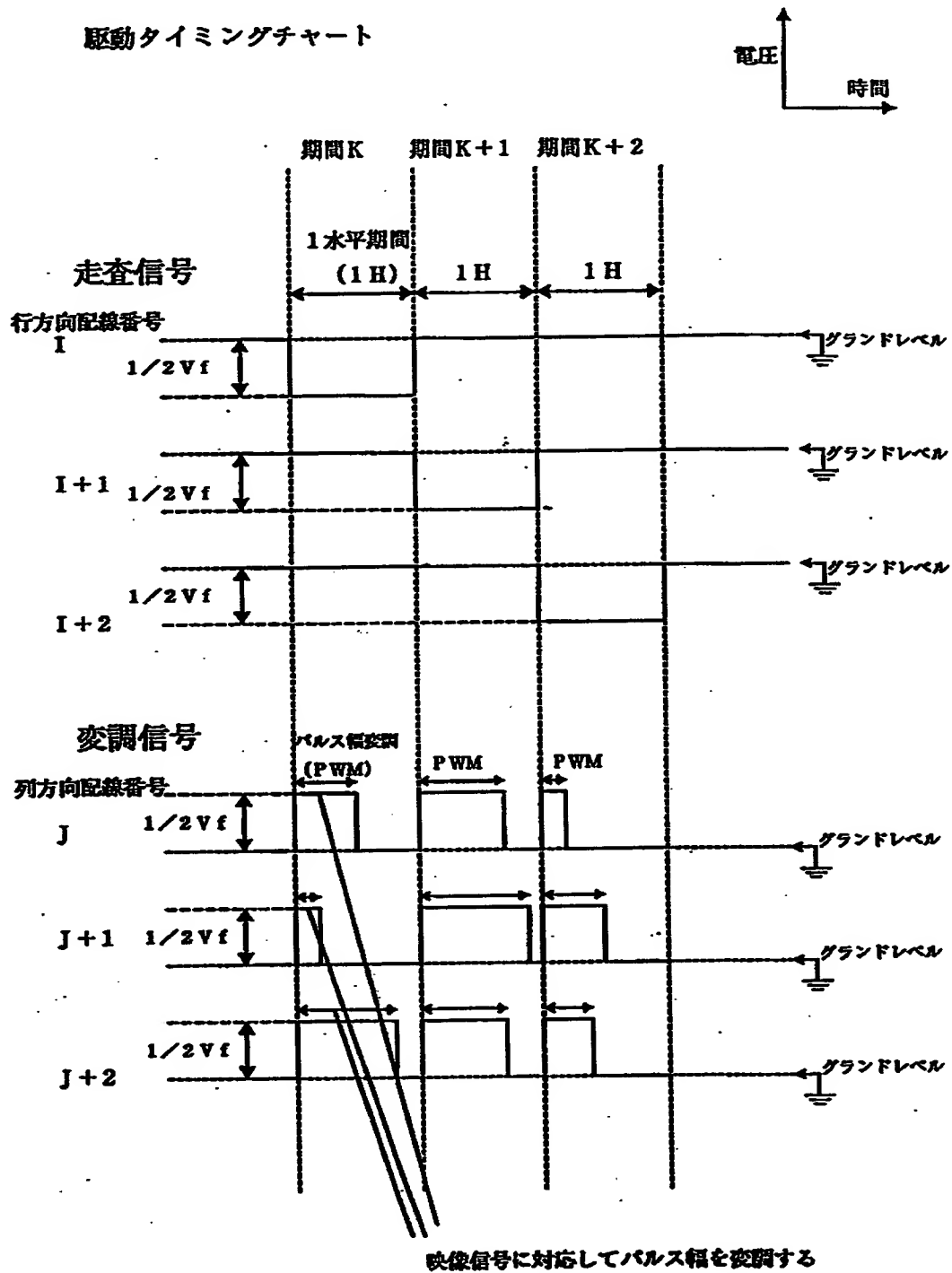


【図 157】

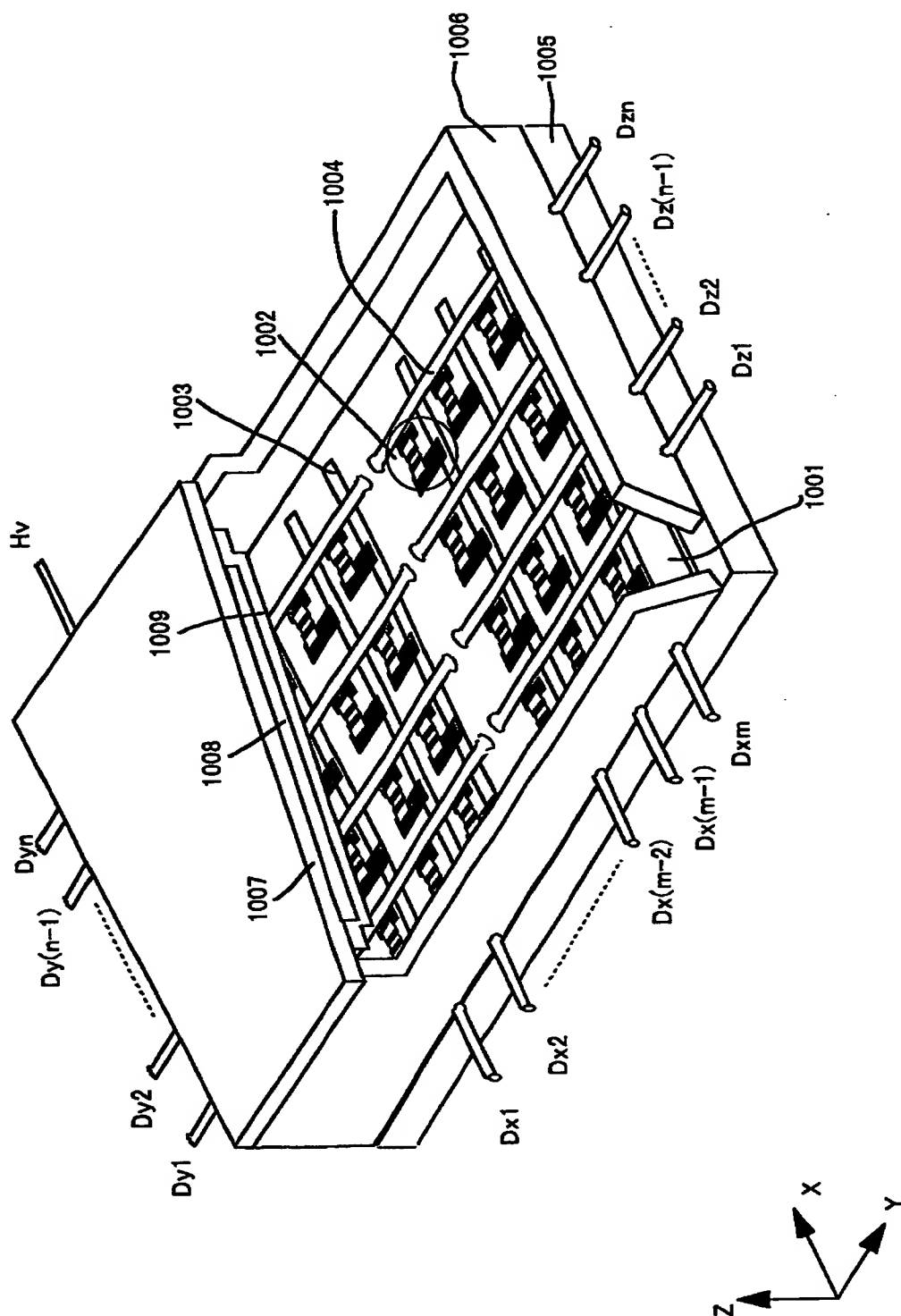


【図 158】

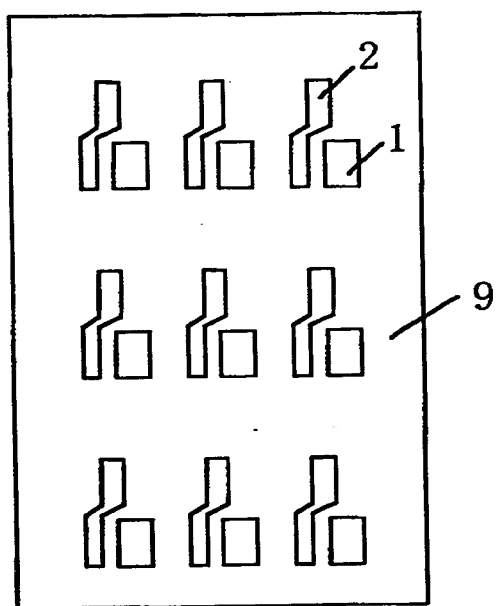
駆動タイミングチャート



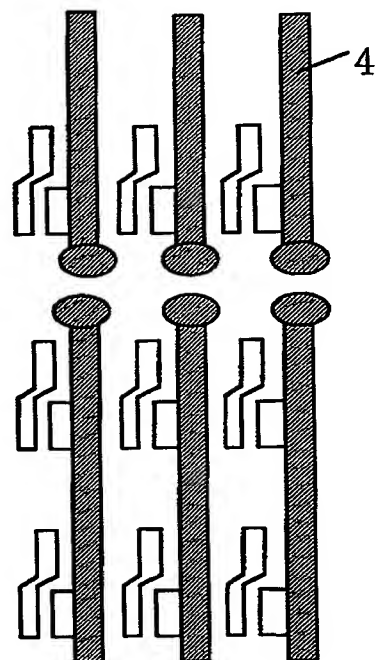
【図 1 5 9】



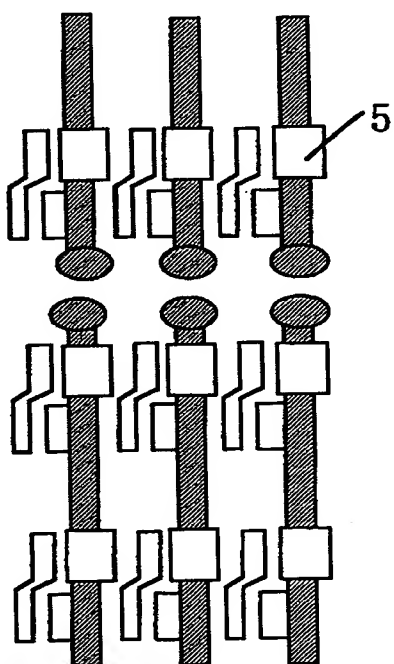
【図 1 6 0】



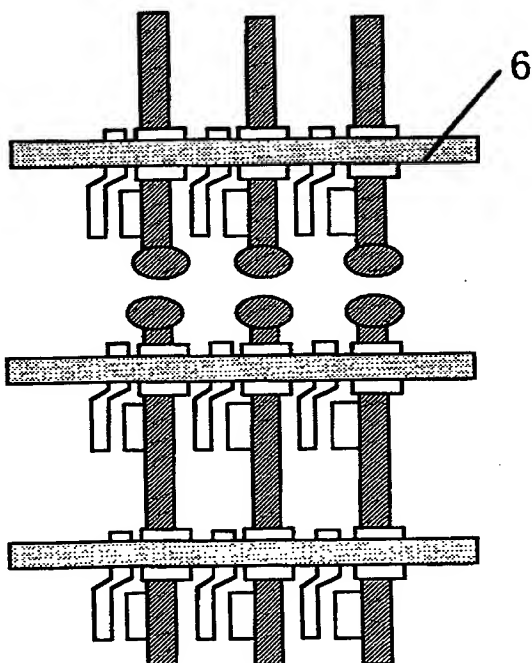
(a)



(b)

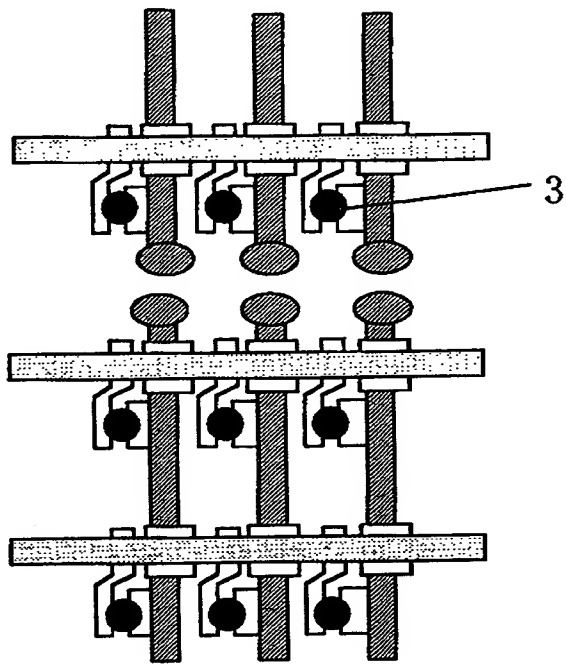


(c)



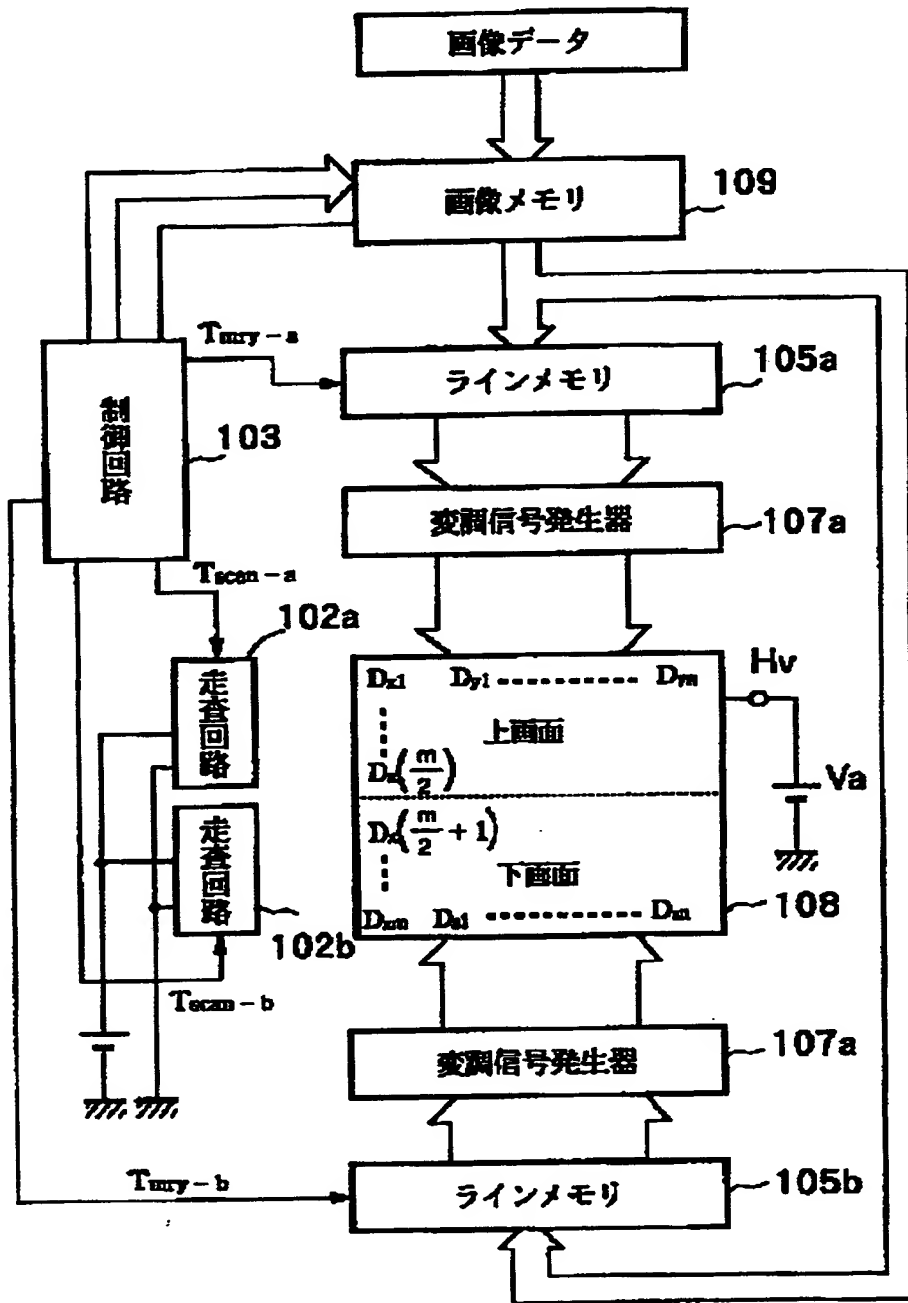
(d)

【図 1 6 1】

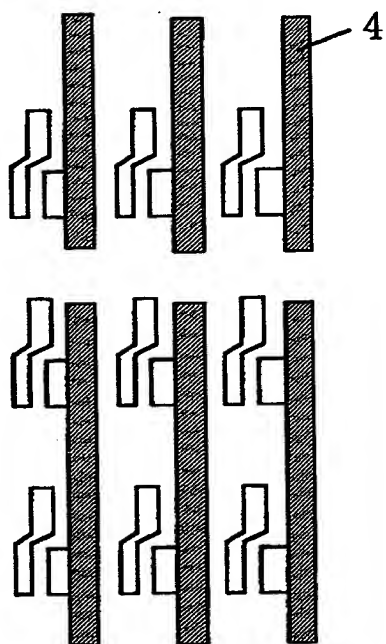


(e)

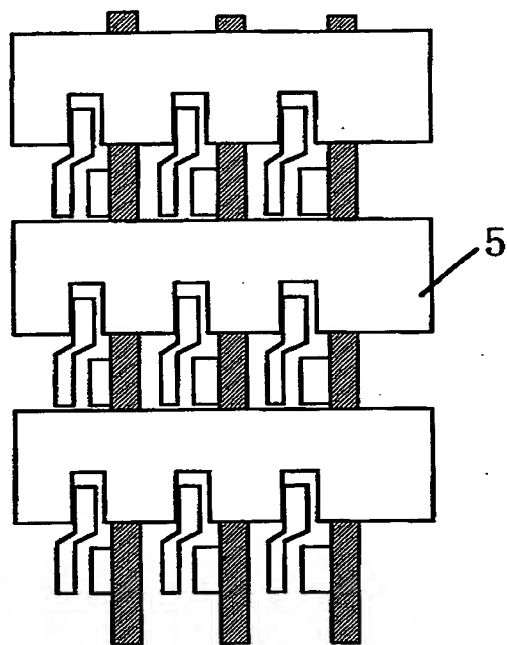
【図 162】



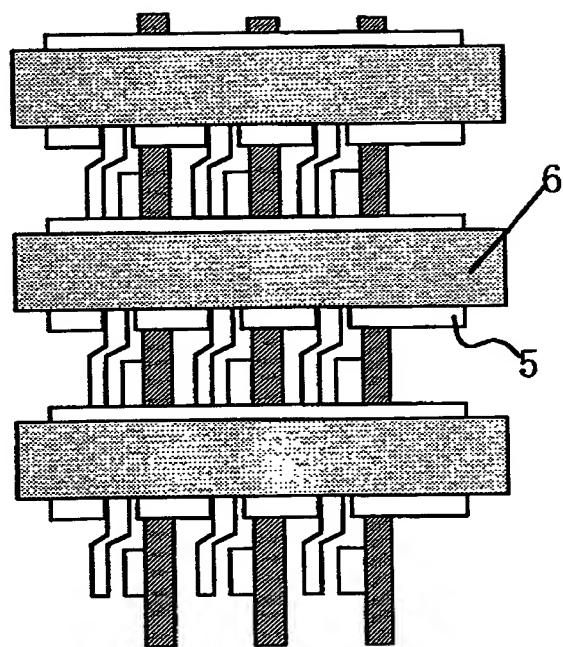
【図 1 6 3】



(b)

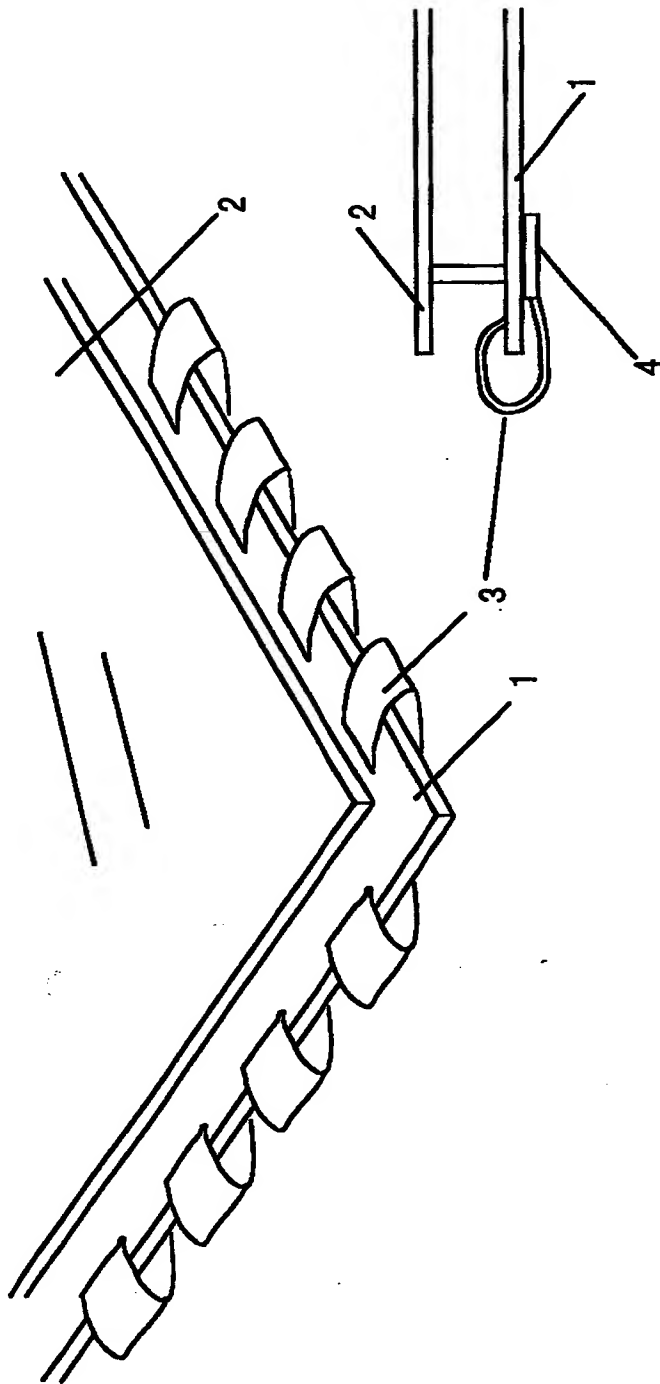


(c)

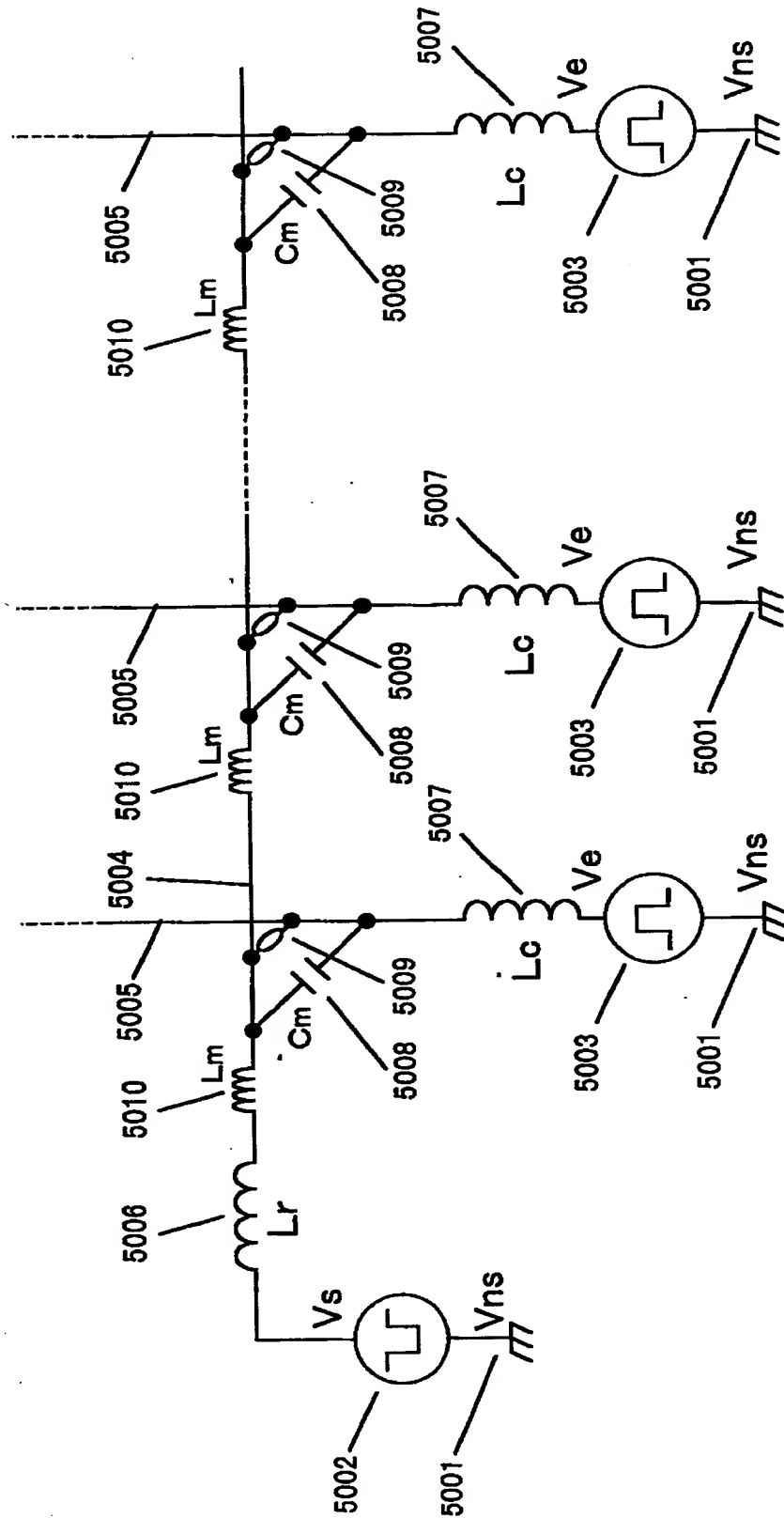


(d)

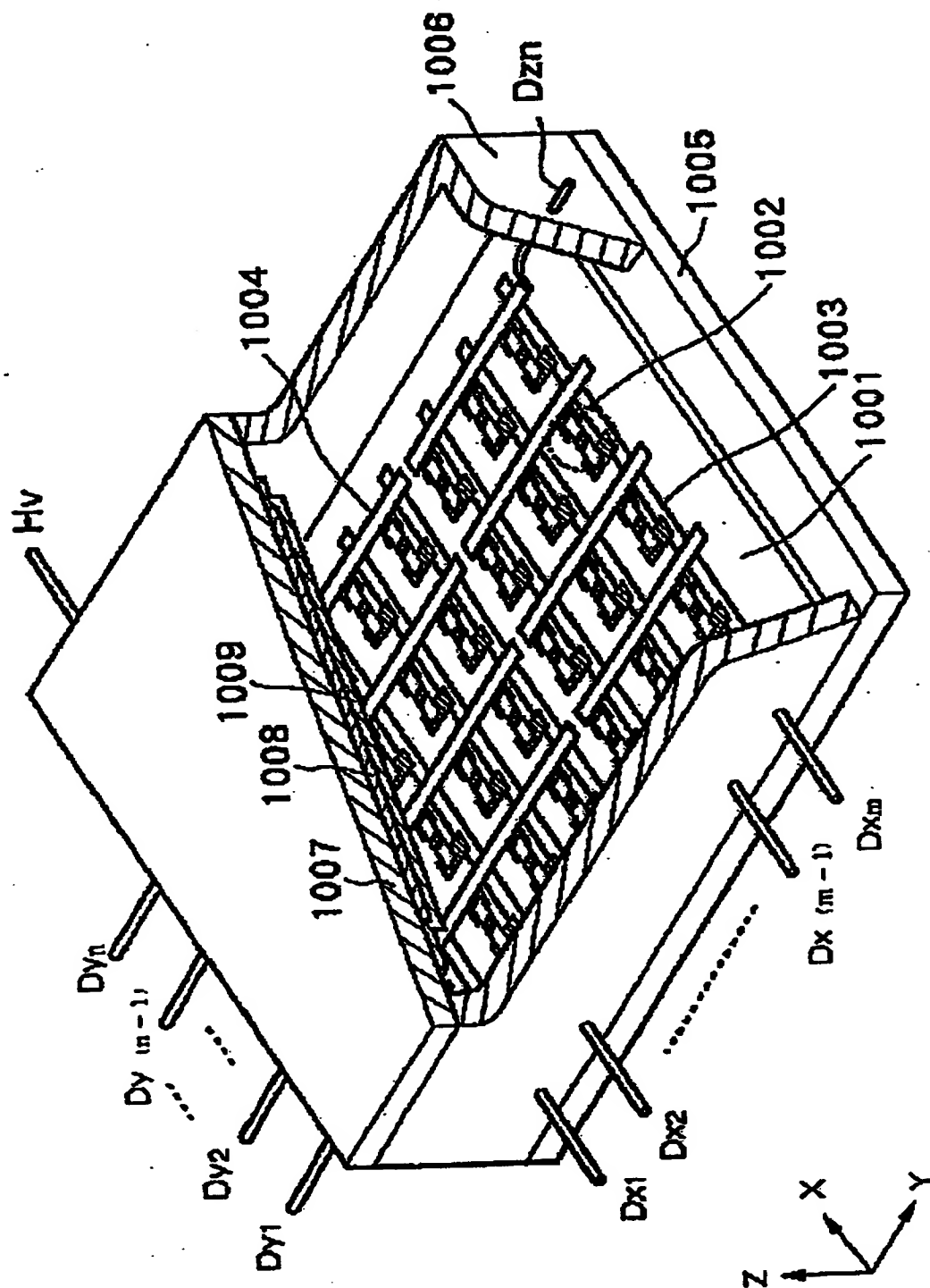
【図 1 6 4】



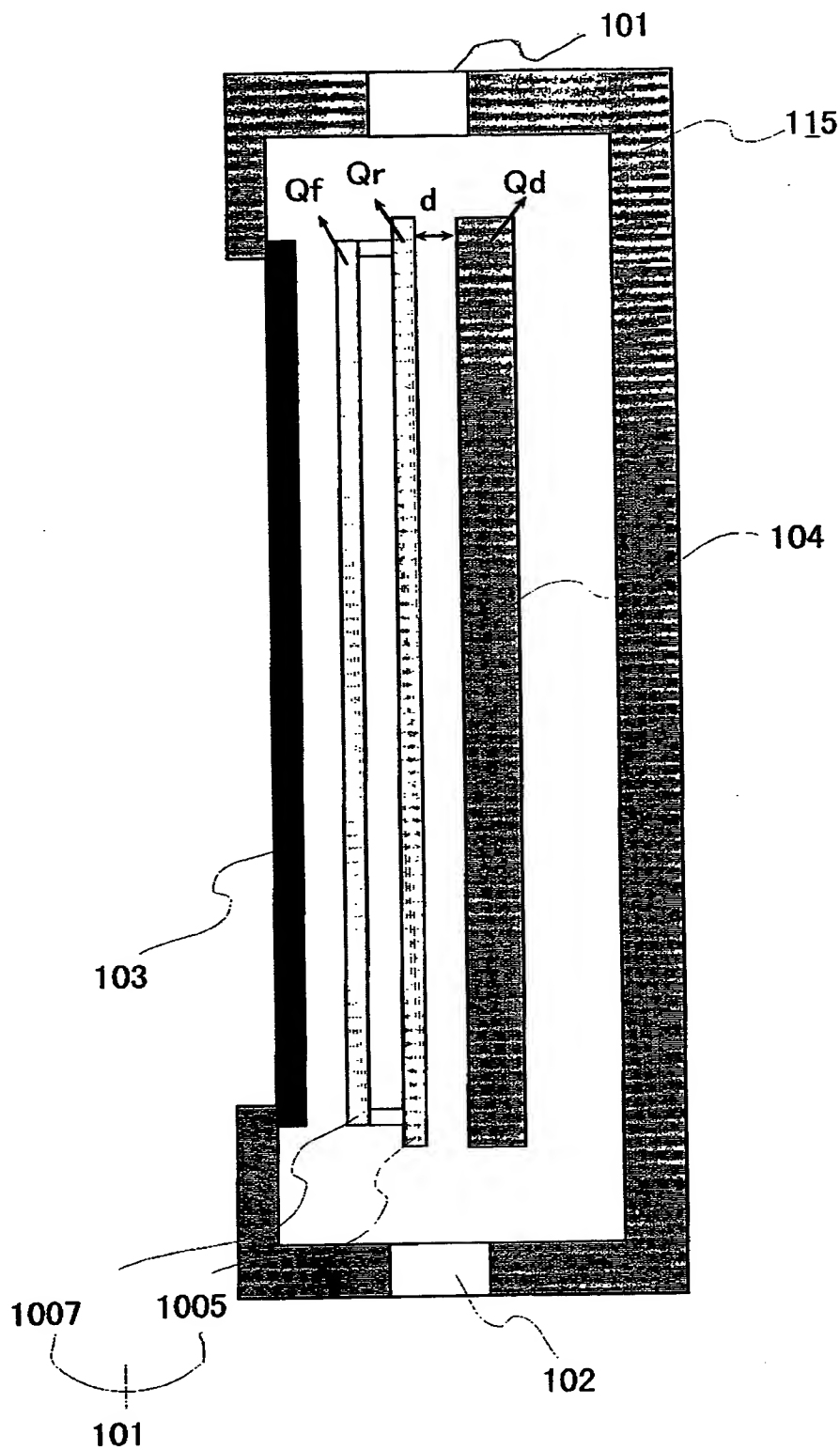
【図 1 6 5】



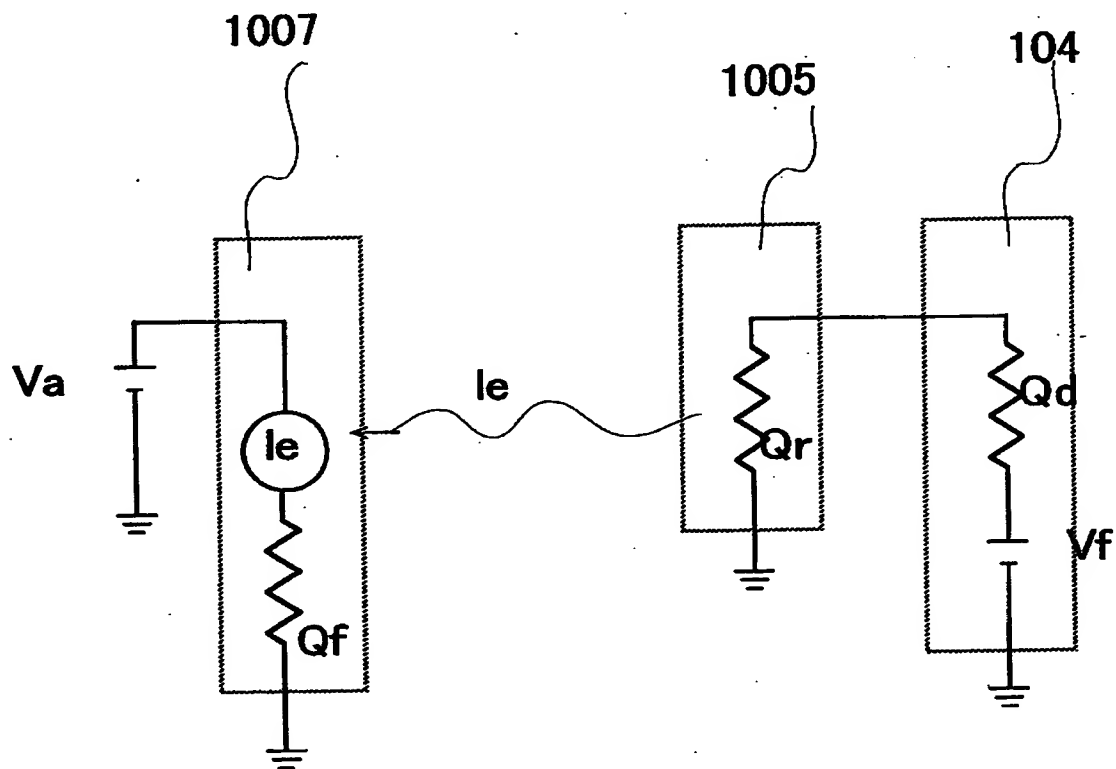
【図 166】



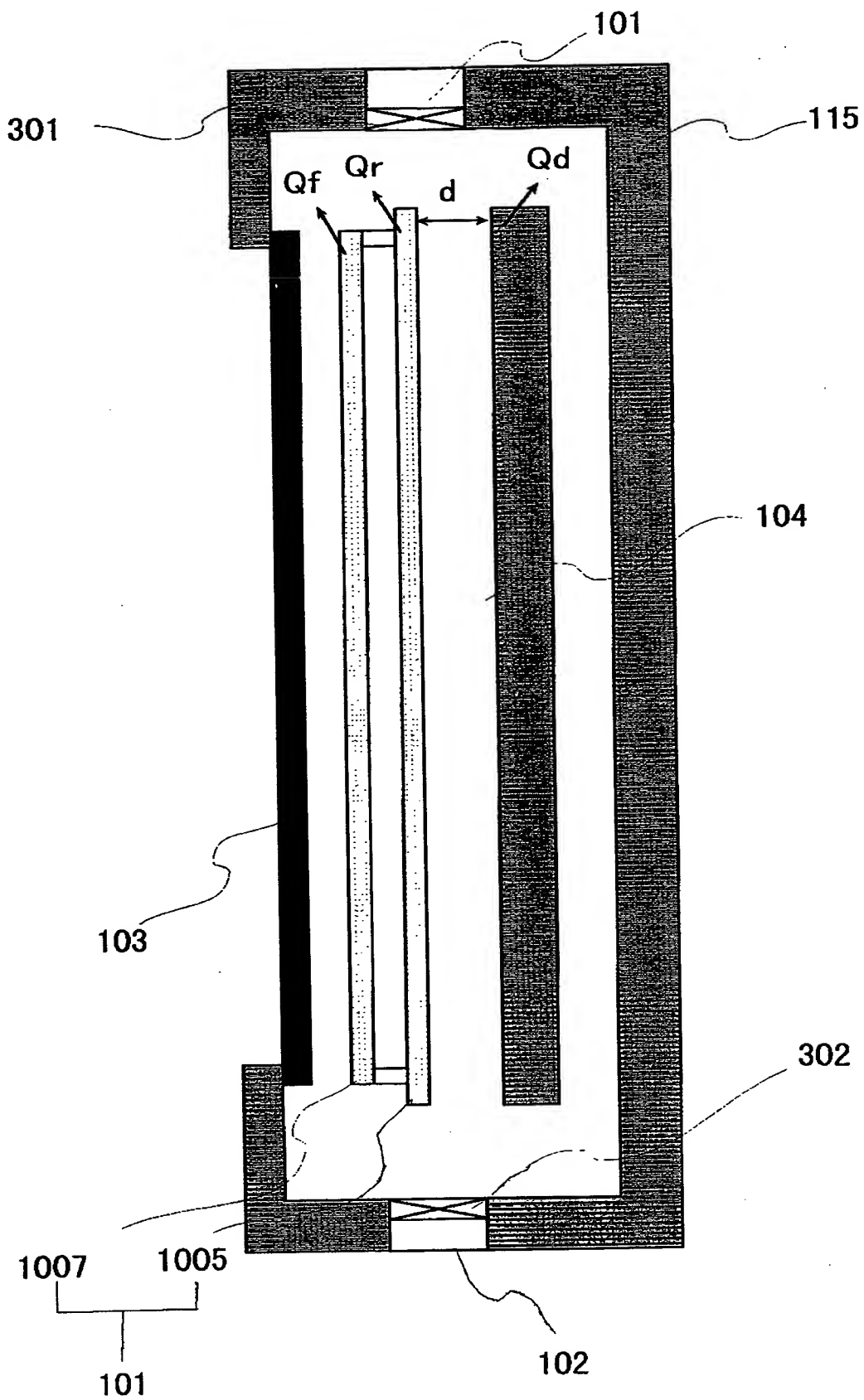
【図 1 6 7】



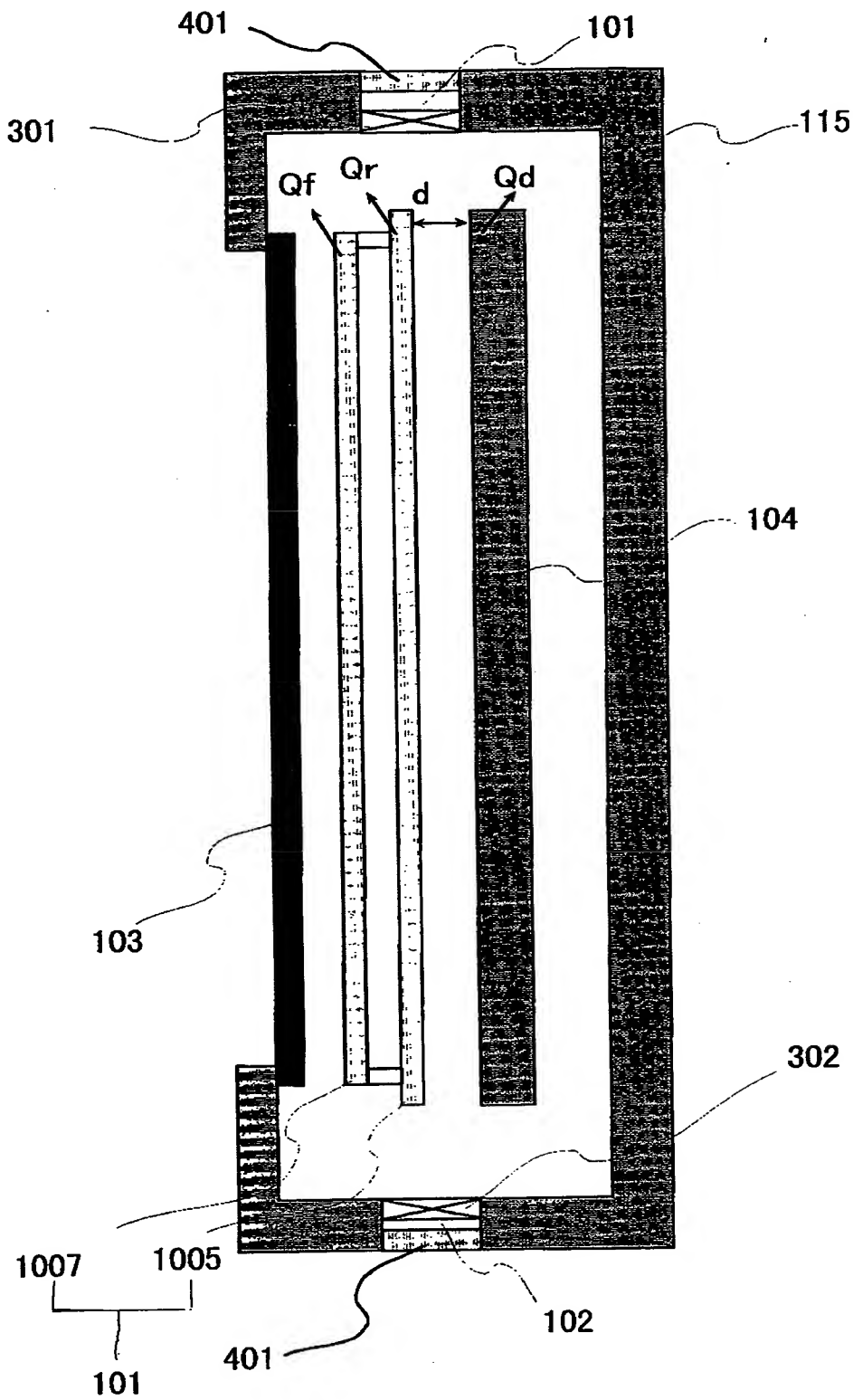
【図 168】



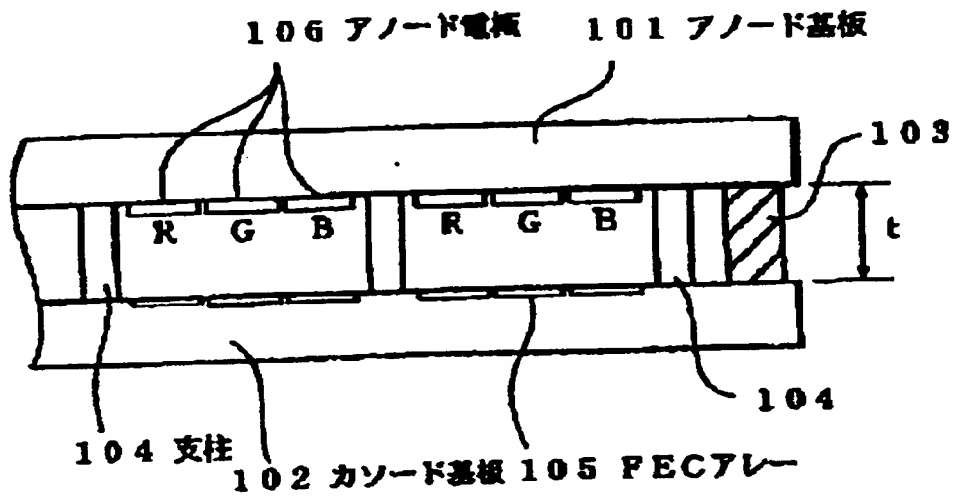
【図 169】



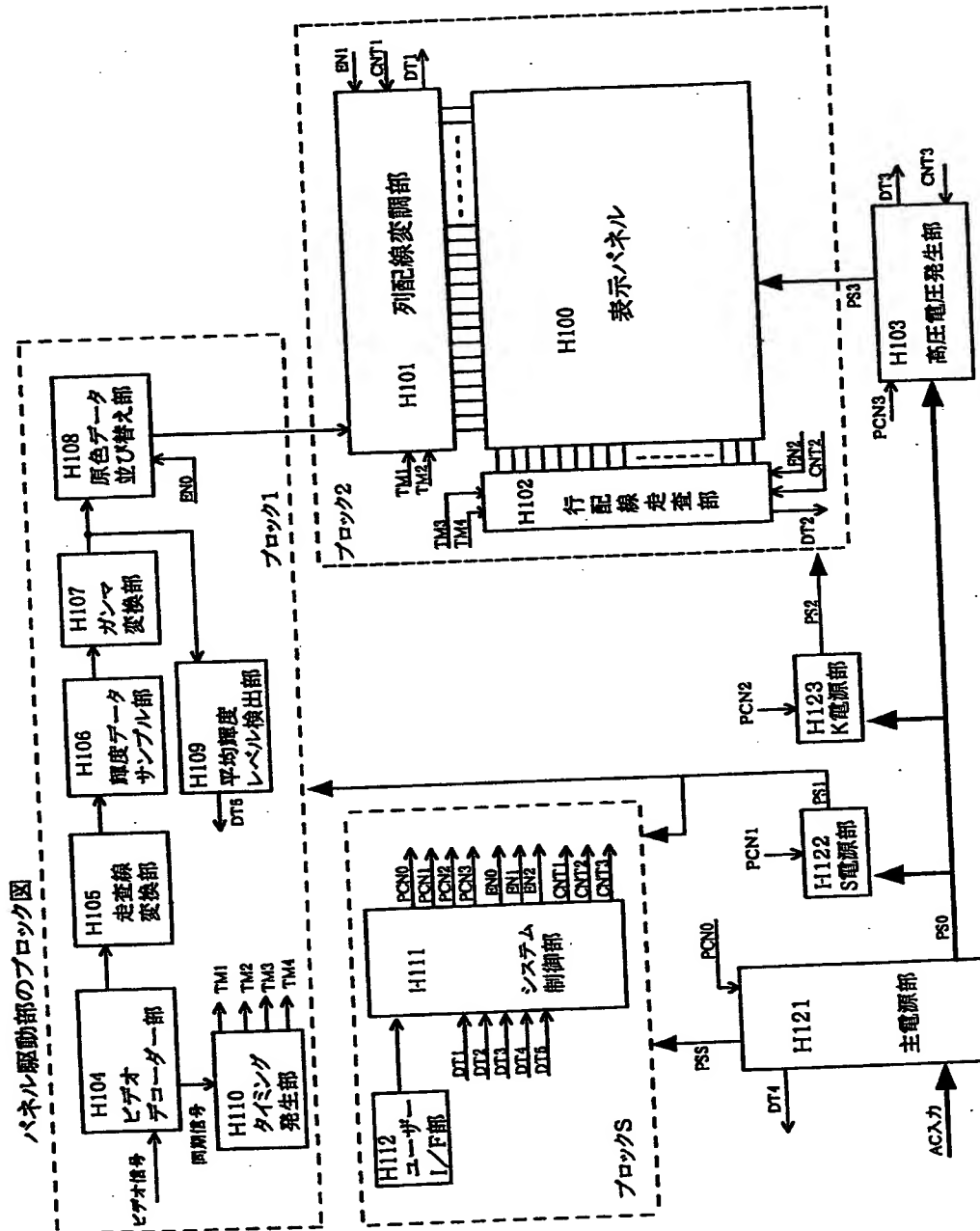
【図 170】



【図 171】

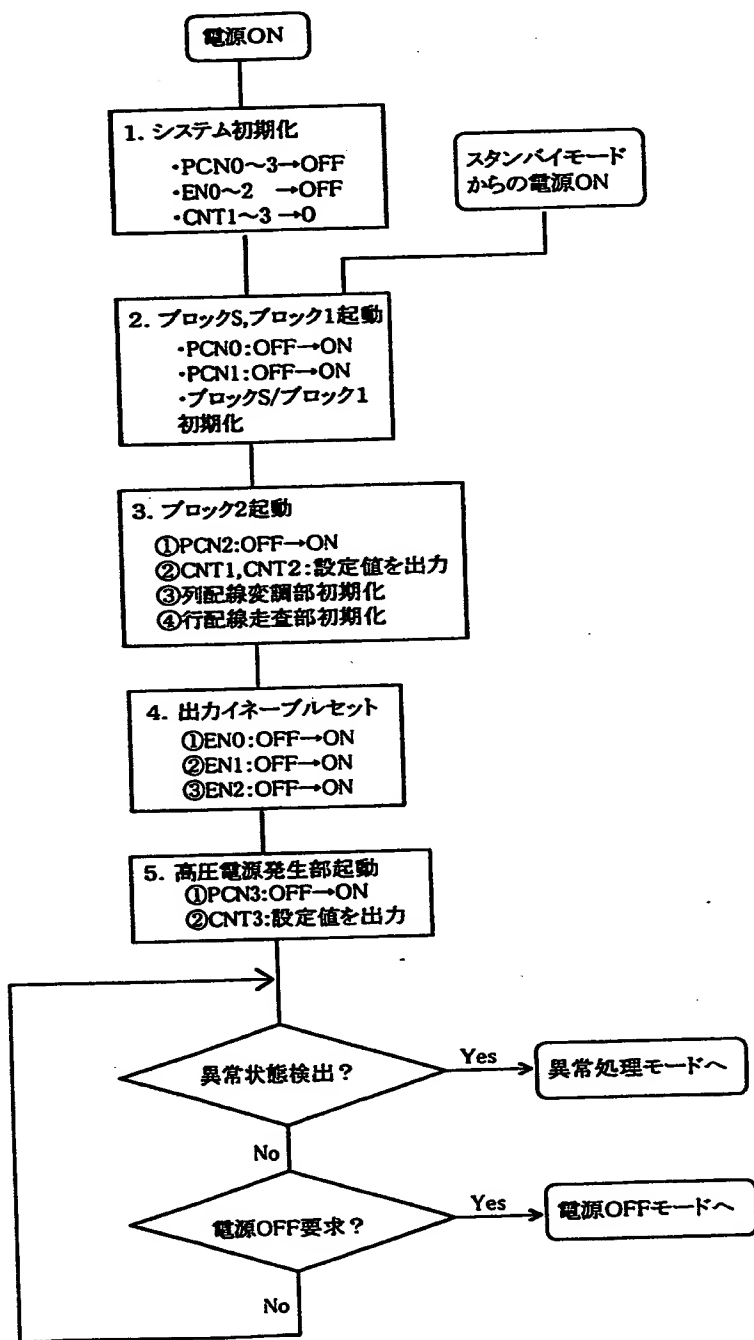


【図 172】



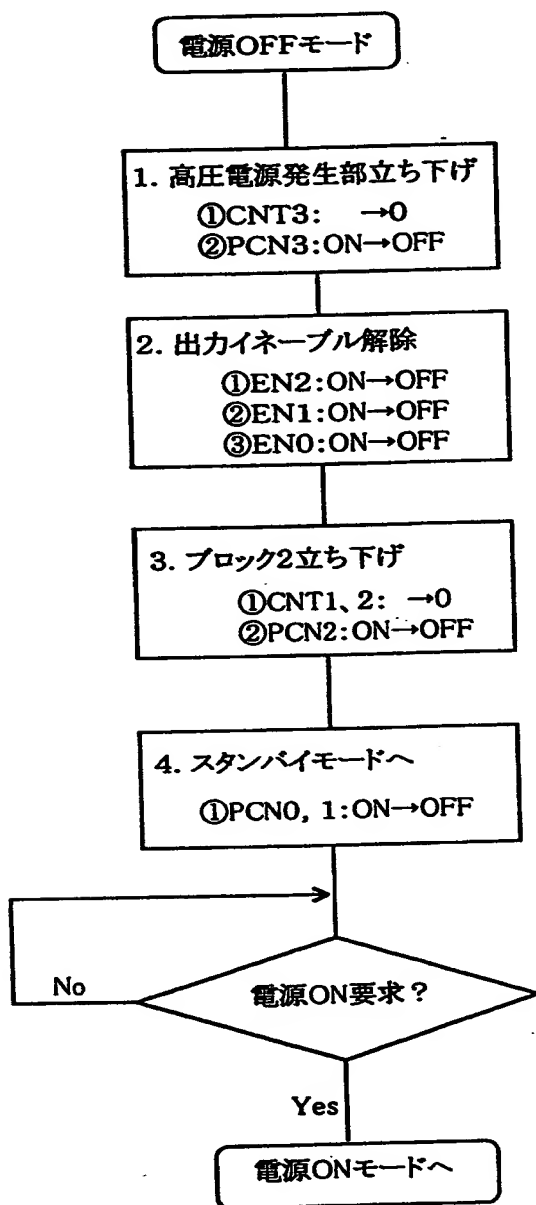
【図 1 7 3】

電源立ち上げ時の処理手順の一例



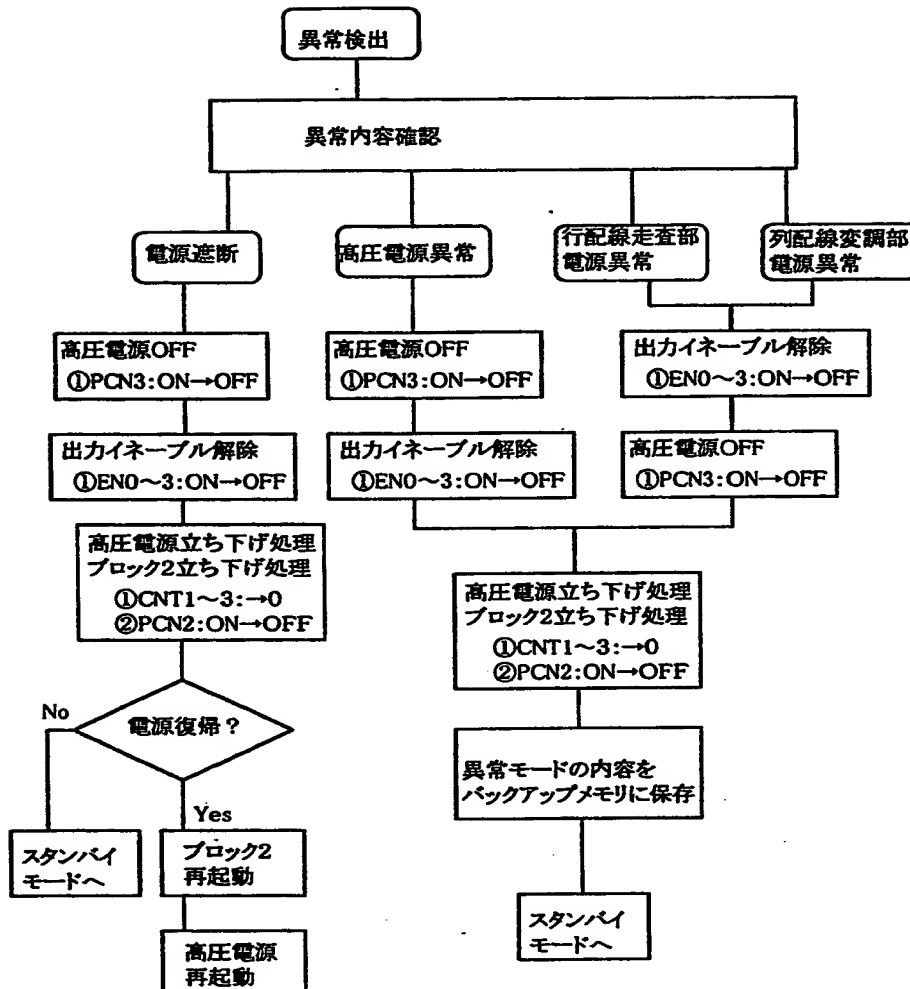
【図 1 7 4】

電源立ち下げ時の処理手順の一例

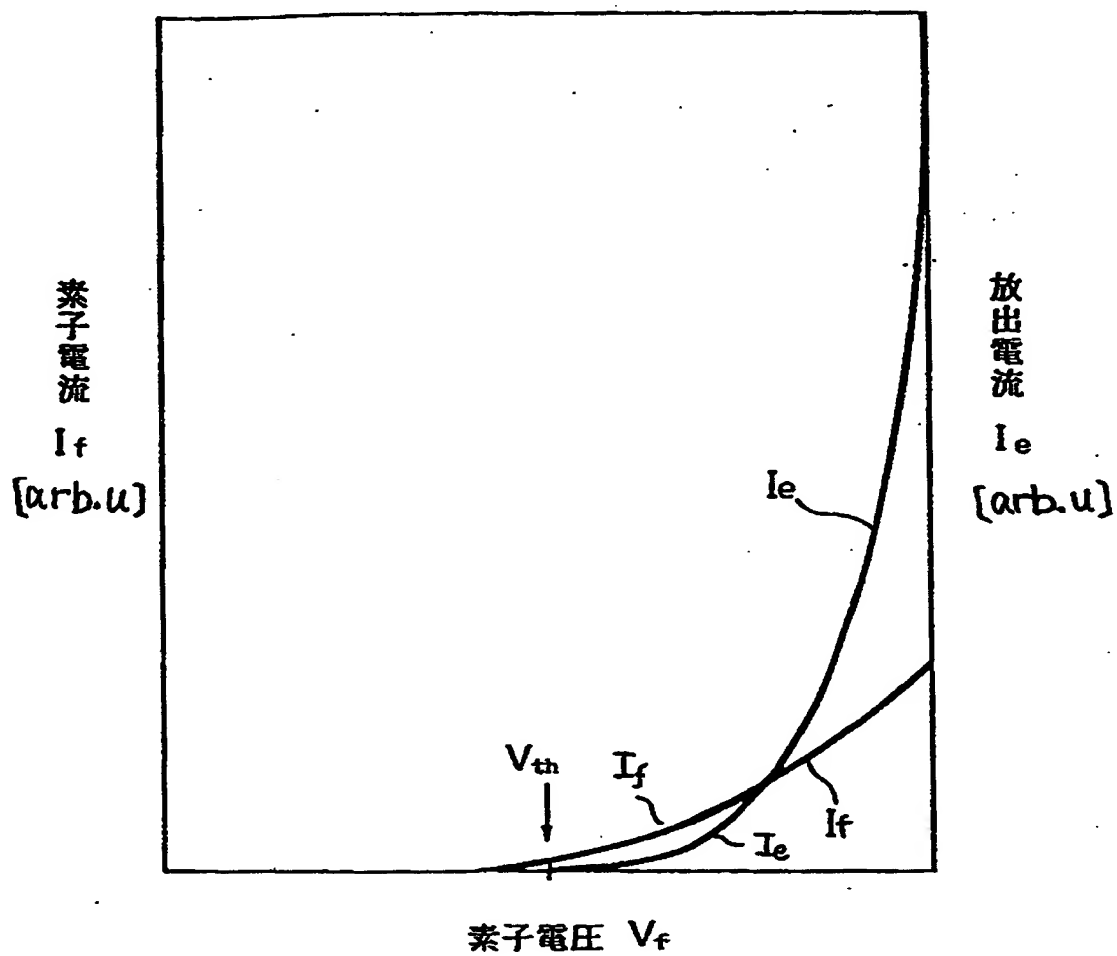


【図 175】

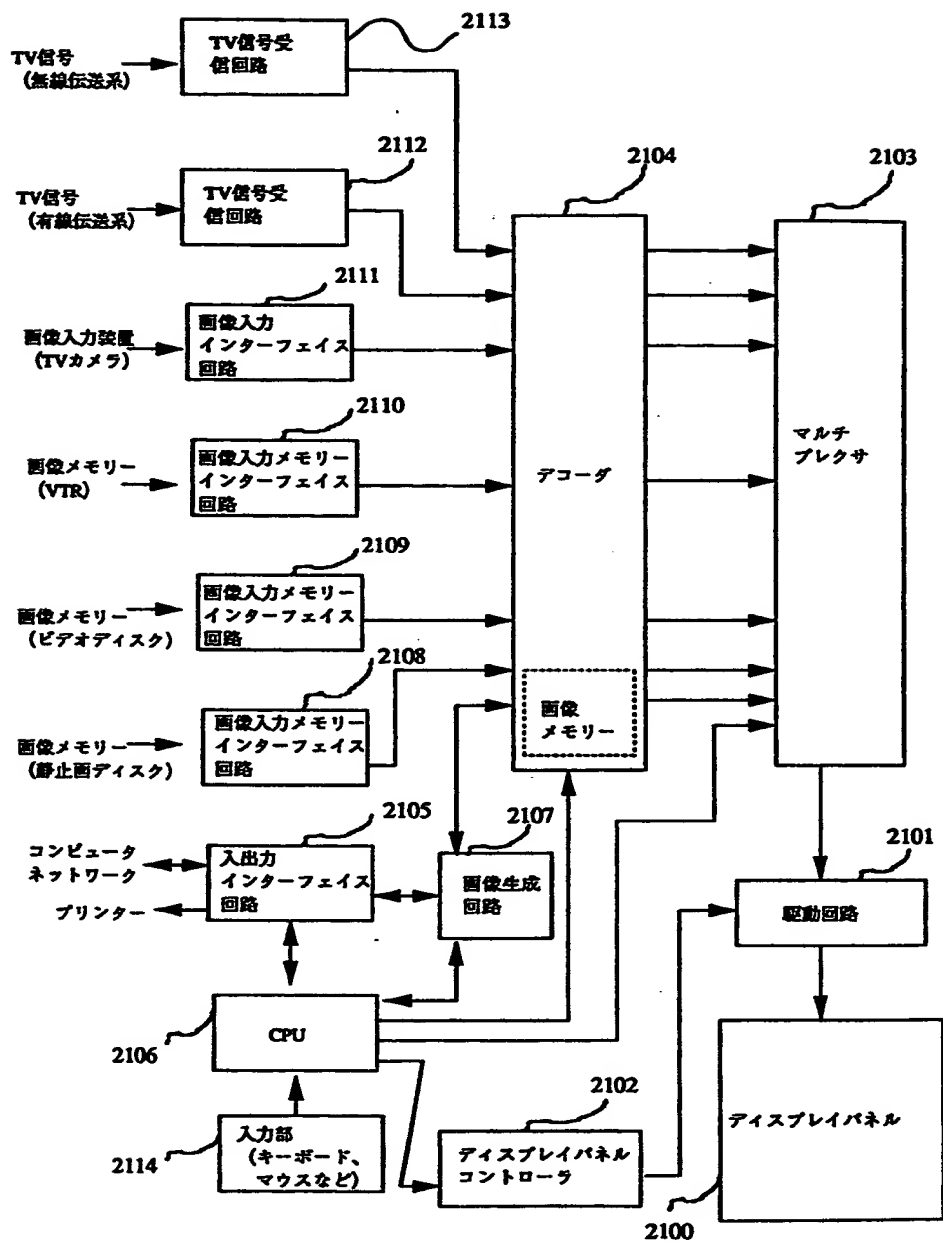
異常時の処理手順の一例



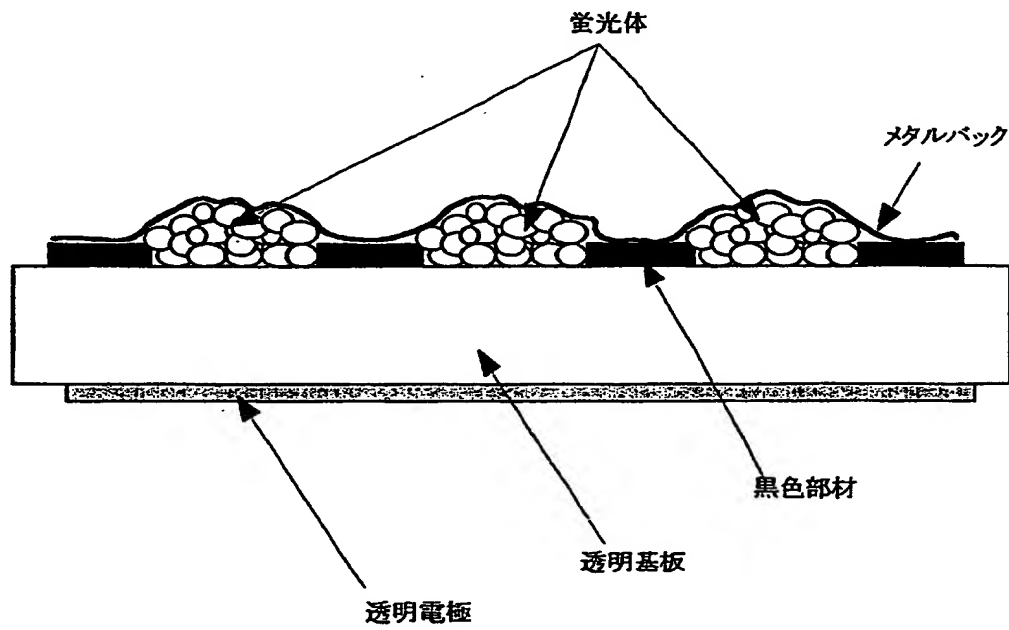
【図 176】



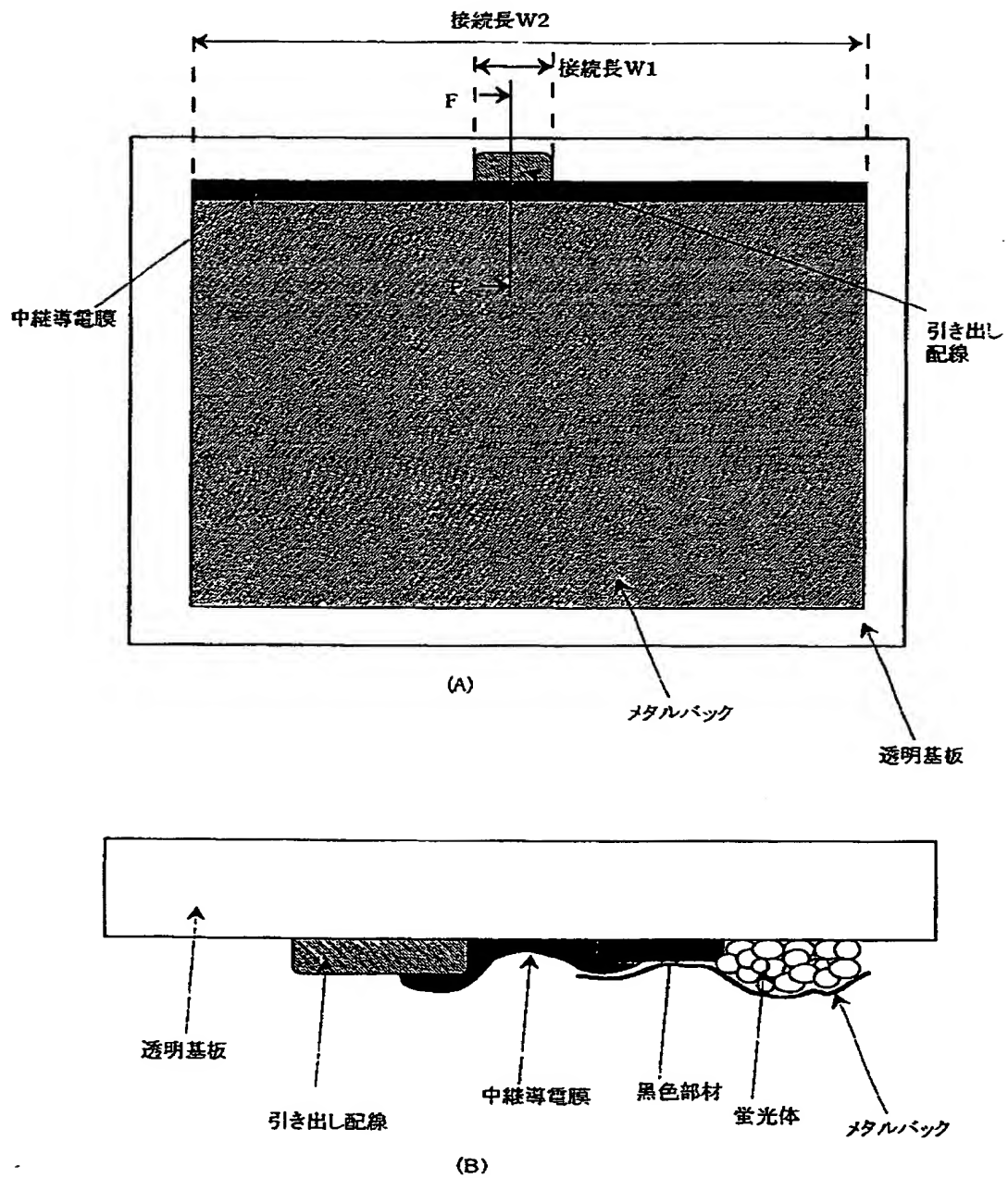
【図 177】



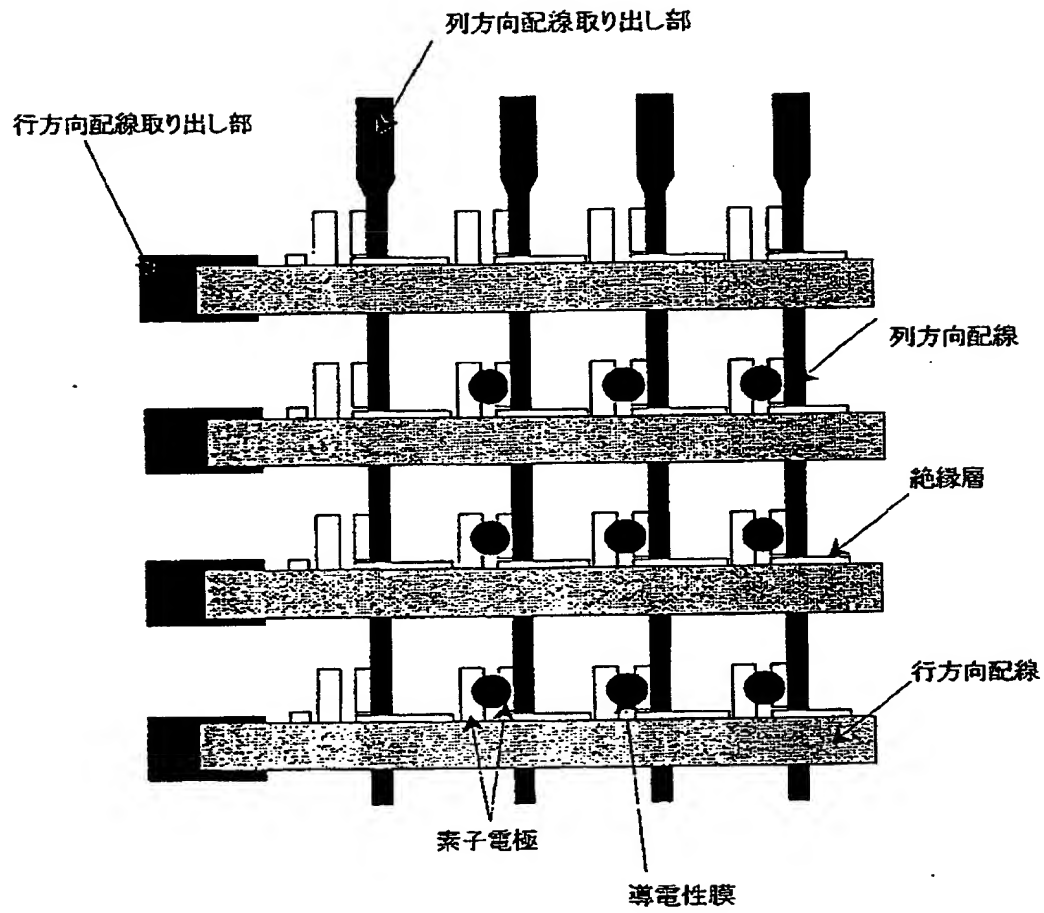
【図 178】



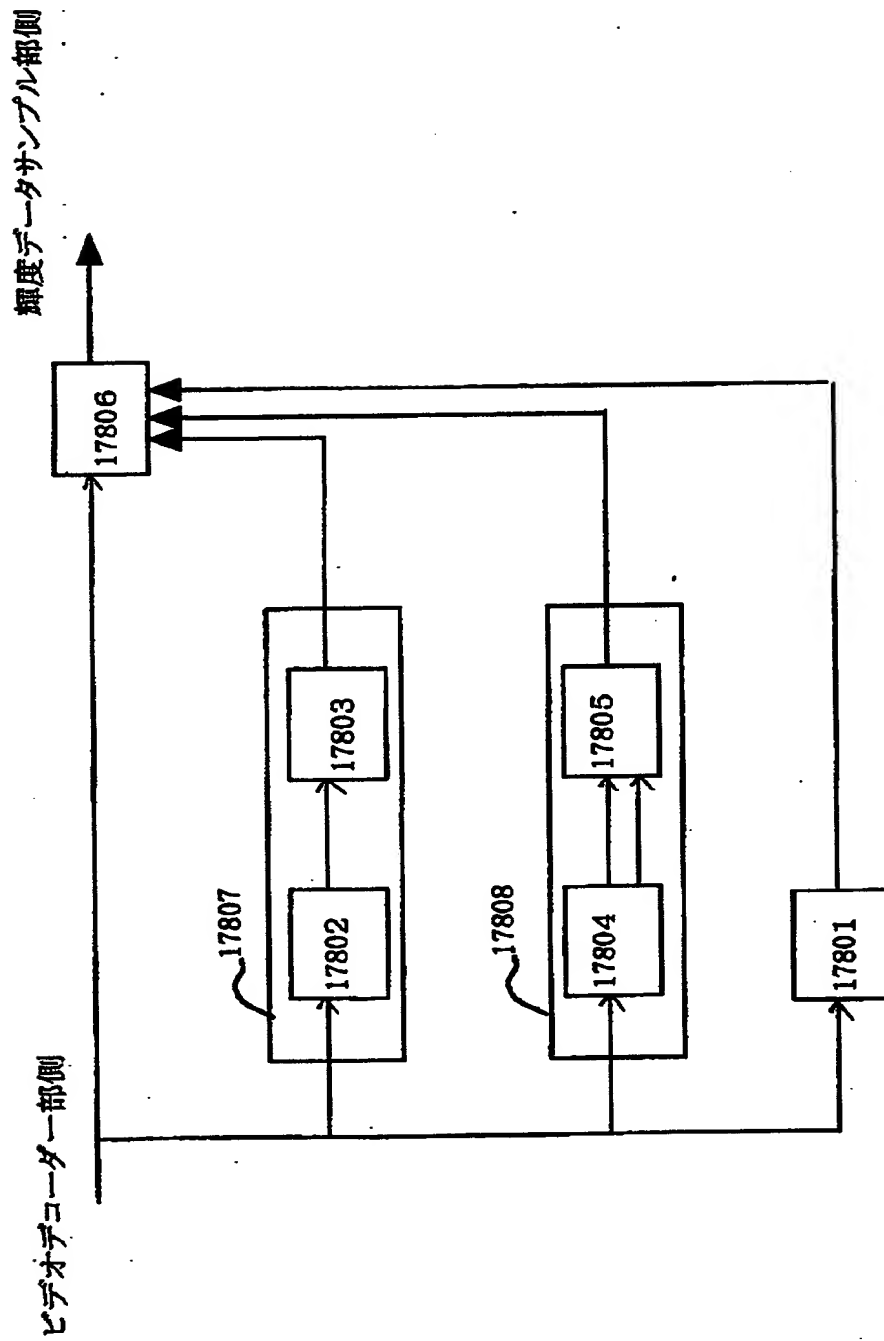
【図 1 7 9】



【図180】



【図 181】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 大画面化に対応可能であり、かつ表示品位の優れた構成を有する画像形成装置を提供することにある。

【解決手段】 対向配置された一对の基板と前記両基板間に配置された外枠とで構成された外囲器内に、前記一对の基板のうちの、一方の基板上に配置された電子源と、他方の基板上に配置された画像形成部材と、前記基板間に配置されたスペーサとを備える画像形成装置であって、前記スペーサ前記外枠とが導電性を有し、前記スペーサと前記外枠との間の等電位面が、駆動時に略平行となるように、前記スペーサと前記外枠とを電氣的に接続する手段を設ける。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年・特許願 第098232号
受付番号	59900322016
書類名	特許願
担当官	益子 美智子 8139
作成日	平成11年 8月31日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】

キャノン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100070219

【住所又は居所】

東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビル8階 若林国際特許事務所

【氏名又は名称】

若林 忠

【選任した代理人】

【識別番号】

100088328

【住所又は居所】

東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビル8階

【氏名又は名称】

金田 暢之

【選任した代理人】

【識別番号】

100106138

【住所又は居所】

東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビル8階

【氏名又は名称】

石橋 政幸

【選任した代理人】

【識別番号】

100106297

【住所又は居所】

東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビル8階 若林国際特許事務所

【氏名又は名称】

伊藤 克博

8232

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区丸子3丁目30番2号

氏 名

千ヤノン株式会社

BEST AVAILABLE COPY